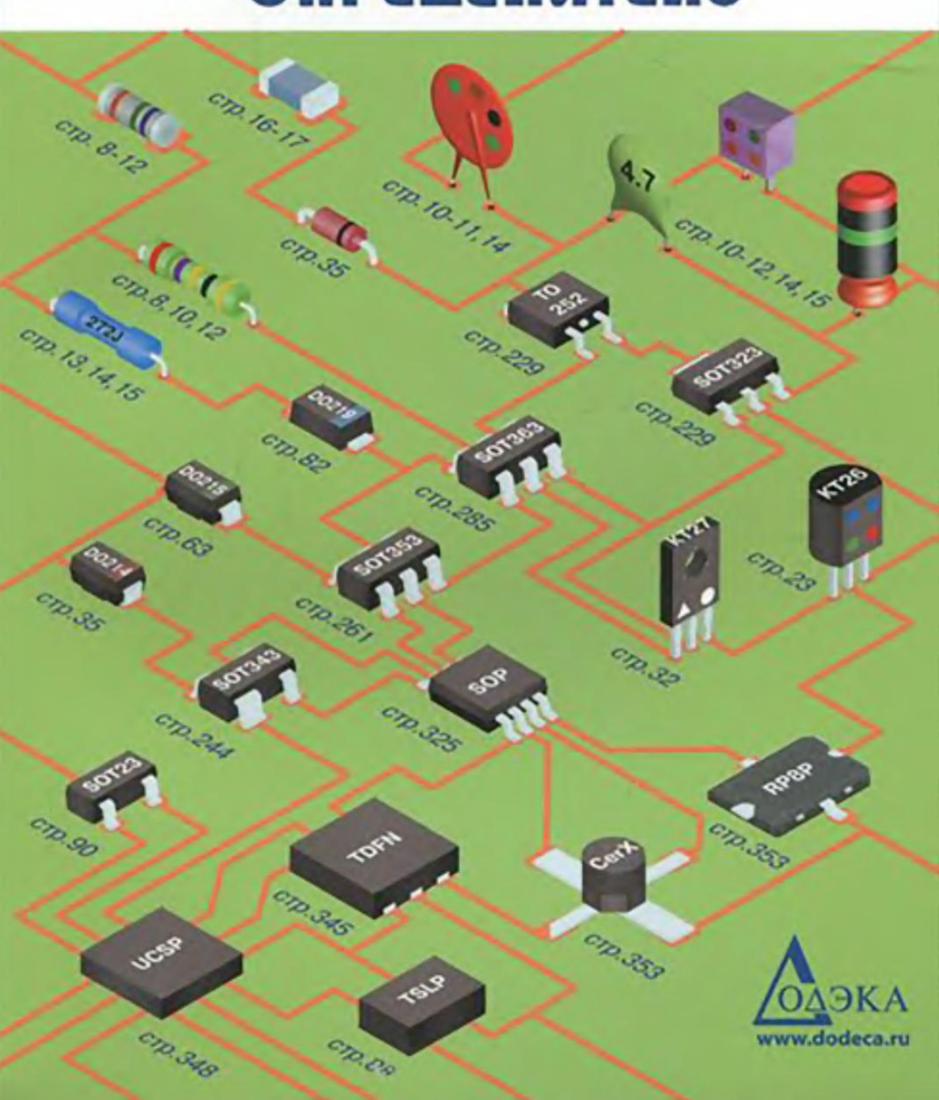
МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ





RadioHata.RU
Портал радиолюбителя
Радиотехнические журналы
Журнал Радио
Программы для радиолюбителя
Начинающему радиолюбителю
Телевидение и Радио
Источники питания
Для дома и быта
Прием-передача
Полезное видео
Автолюбителю
Аудиотехника
Arduino / Rasberry
Разное

МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

12-е издание
переработанное



Издательский дом «Додэка-XXI»
Москва

УДК 621.382-777(035)
ББК 32.844-06-7я22+32. 852-06-7я22
М27

М27 Маркировка электронных компонентов. Определитель. — Изд. 12, перераб. — М. : Додэка-XXI». — 386 с.

ISBN 978-5-94120-131-0

Книга представляет собой справочник-определитель электронных компонентов по их внешнему виду. Пользуясь данным справочником, можно расшифровать кодовую или цветовую маркировку большинства пассивных (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности) и активных (дискретные компоненты и микросхемы) электронных компонентов отечественного и импортного производства. Справочные материалы приведены в графической и табличной форме.

Поиск в определителе осуществляется по типу корпуса компонента, а далее по типу маркировки: цветовой или кодовой. Справочник содержит более 15000 кодовых маркировок активных компонентов: диодов, динисторов, стабилитронов, биполярных и полевых транзисторов, ключей, усилителей, компараторов, цифровых потенциометров, цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей, вентилей и т.п. в корпусах для поверхностного монтажа, включая такие корпуса, как SOD, SOT, MSOP, TQFN, UCSP. На все компоненты приводится справочная информация о функциональном назначении приборов, фирме-производителе, основных характеристиках и особенностях, а также цоколевке выводов. В отдельных главах приведены подробные сведения по цветовой и кодовой маркировке отечественных компонентов в корпусах типа КТ-26 и КТ-27.

В главах, посвященным пассивным компонентам, рассмотрены принципы цветовой и кодовой маркировки резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности и других элементов по номиналу, допускам и другим параметрам, а также нестандартная маркировка компонентов некоторых ведущих фирм-производителей.

Книга предназначена для широкого круга радиолюбителей и радиоинженеров.

УДК 621.382-777(035.5)
ББК 32.844-06-7я22+32.852-06-7я22

Материалы подготовили
А. А. Бахметьев, В.Б. Ежов, И. С. Кирюхин, А. В. Перебаскин, В. М. Халикеев
Главный редактор *В. М. Халикеев*
Дизайн обложки *А. Ю. Анненков*
Иллюстрации *А. Ю. Анненков, И. Л. Люско*
Верстка *А. Ю. Анненков*

Издательский дом «Додэка-XXI»

105318 Москва, а/я 70
Тел/факс: (495) 366-24-29, 366-81-45
E-mail: books@dodeca.ru; red@dodeca.ru

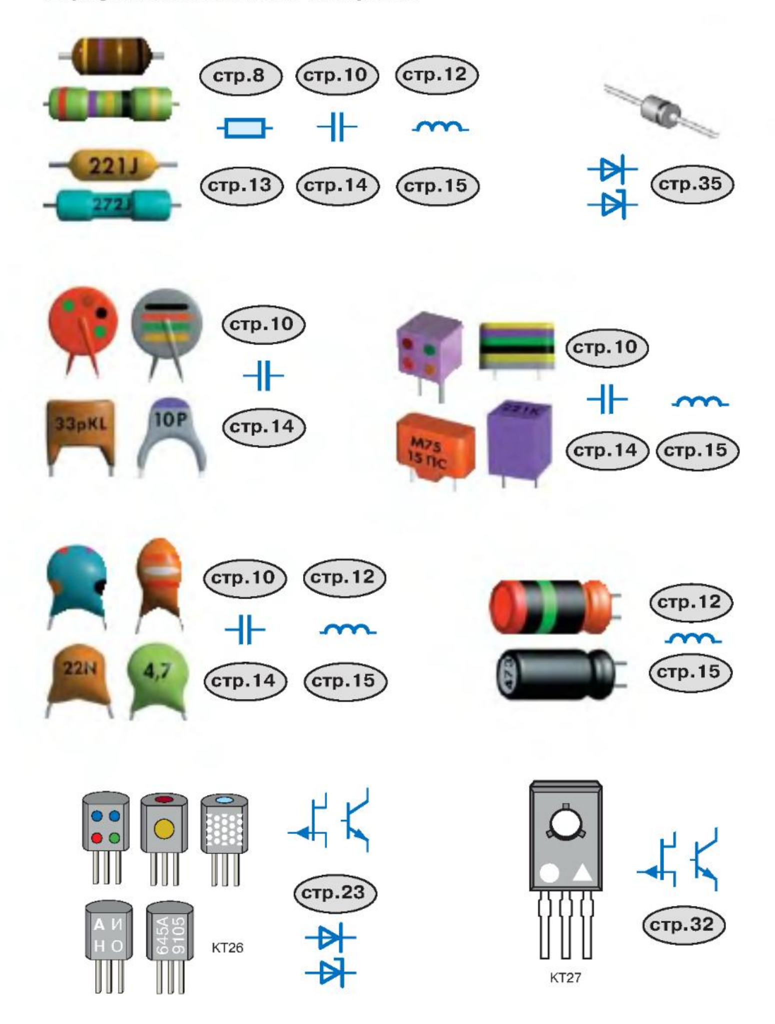
Формат 70 x 100/32. Бумага офсетная. Гарнитура «PragmaticaC».
Печать офсетная. Объем 11,5 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 829
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Щербинская типография».
117623 Москва, ул. Типографская, д.10. Тел. 659-23-27.

ISBN 978-5-94120-131-0

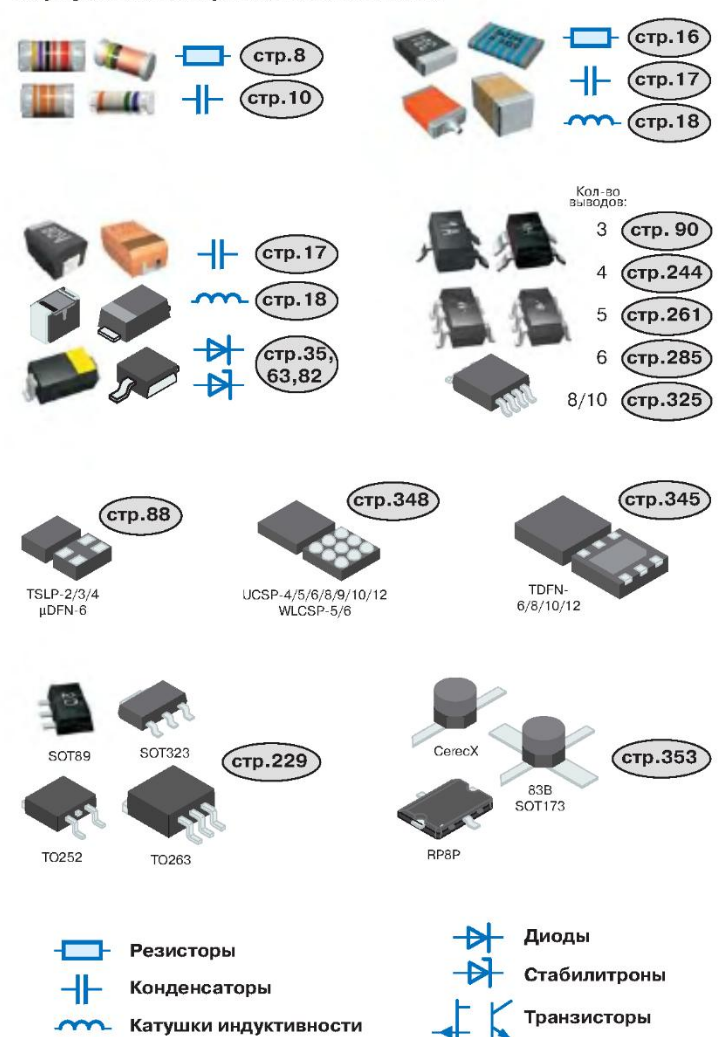
СОДЕРЖАНИЕ

НАВИГАТРОР ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ КОМПОНЕНТОВ

Корпуса для монтажа в отверстия



Корпуса для поверхностного монтажа



ОБЩИЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ

Это необходимо знать

Для того чтобы правильно воспринимать и использовать материал, представленный в этой книге, необходимо ознакомиться со следующей информацией.


SOD80

Очень важны размеры корпусов, поскольку внешне многие корпуса похожи друг на друга, а для идентификации прибора необходимо знать не только маркировку, но и тип корпуса. Но и это может не спасти. Так, корпус типа SOD-80 у фирмы Philips имеет диаметр 1.6 мм (ном.), а корпус с таким же названием у ряда других фирм имеет диаметр 1.4 мм, что даже меньше диаметра другого, более компактного, корпуса фирмы Philips SOD-80C. Корпус типа SOD-15 фирмы SGS-Thomson очень похож на корпуса 7043 и SMC, но не совпадает с ними по установочным размерам.


SOD15


7343


SMC

Возможны ситуации, когда фирмы-производители в одном и том же корпусе под одной и той же маркировкой выпускают разные приборы. Например, фирма Philips выпускает в корпусе SOT-323 *n-p-n*-транзистор BC818W и маркирует его кодом 6H, а фирма Motorola в таком же корпусе с той-же маркировкой 6H помещает *p-n-p*-транзистор MUN5131T1. Такая же ситуация встречается и внутри одной фирмы. Например, у фирмы Siemens в корпусе SOT-23 под маркировкой 1A выпускаются транзисторы BC846A и SMBT3904, имеющие разные параметры. Различить такие приборы, установленные на плате, можно только по окружающим их компонентам и, соответственно, схеме включения.

SOT323


BC818W (Philips)
MVN5131T1 (Motorola)

SOT23


BC846A (Siemens)
SMBT3904 (Siemens)

Путаница существует не только с маркировкой, но и цоколевкой корпусов. Например, корпус типа SOT-89 у фирм Rohm, Siemens, Toshiba имеет цоколевку 1-2-3 (вид сверху), а у Philips этот же корпус имеет цоколевку 2-3-1 или 3-2-1. В данной книге номера выводов и их функциональное значение у разных фирм приведены к единой системе.

Не лучше ситуация и с пассивными компонентами для поверхностного монтажа. Если на корпусе стоит маркировка 103, то это может быть резистор номиналом 10 кОм, конденсатор емкостью 10 нФ или индуктивность 10 мГн. Если на корпусе стоит маркировка 2R2, то это может быть и резистор номиналом 2.2 Ом, и конденсатор емкостью 2.2 пФ. Код 107 может означать 0.1 Ом (Philips) или 100 мкФ (Panasonic).

В корпусах типа 0603, 0805 и т.п. без маркировки могут находиться конденсатор, индуктивность или резистор-перемычка (Zero-Ohm, jumper).

Цветная полоса или выемка-ключ на корпусах типа SOD-123, DO-215 может указывать на катод диода или вывод «плюс» у электролитического конденсатора.

SOD123


Конденсатор — ⊕
Диод — катод
Стабилитрон — катод

По внешнему виду очень трудно отличить друг от друга R, C и L, если они находятся в цилиндрических корпусах с выводами и маркируются цветными кольцами. Но и после идентификации могут возникнуть сложности с определением параметров компонента. Например, на практике для цветовой маркировки постоянных конденсаторов используются несколько методик (см. главу «Конденсаторы. Цветовая маркировка»).

В одинаковых корпусах с одинаковым цветовым кодом может выпускаться целая серия приборов с разными параметрами. Например, фирма Motorola выпускает в корпусе типа SOD-80, маркируемом одним цветным кольцом, целую серию стабилитронов (51 прибор) с напряжением стабилизации от 1.8 до 100 В и током от 0.1 до 1.7 А. В таком же корпусе фирма Philips выпускает серию диодов.


R
L
C

Необходимо правильно определять сам цвет маркировки. На практике могут встречаться сложности с различием следующих оттенков: серый — св. голубой — серебристый; голубой — бирюзовый — электрик; желтый — золотистый; оранжевый — св. коричневый — табачный — бежевый.

Черное кольцо посередине корпуса имеют не только резисторы-перемычки (Zero-Ohm, jumper), но и другие приборы, особенно с учетом технологического разброса при нанесении маркировки.

Многие фирмы, помимо принципов маркировки, указанных в публикациях Международной Электротехнической Комиссии (IEC), используют свою внутрифирменную цветовую и кодовую маркировки. Например, встречается маркировка SMD-резисторов, когда вместо цифры 8 ставится двоеточие. В таких случаях маркировка 1:23 означает 182 кОм, а :0R6 — 80.6 Ом.

SOT (SOD) — Small Outline Transistor (Diode) — в дословном переводе означает «малогабаритный транзистор (диод)». На современном этапе в корпуса типа SOT помещают не только транзисторы и диоды, но и транзисторы с резисторами, стабилитроны, стабилизаторы напряжения на базе операционного усилителя и многое другое, а количество выводов может быть более трех. Органы стандартизации не успевают за новыми разработками фирм, и те вынуждены вводить свои новые обозначения, которые представлены в «Сводной таблице корпусов».

Цветовая маркировка пассивных компонентов

В соответствии с ГОСТ175-72 и требованиями Публикации 62 IEC цветовая маркировка наносится в виде 3, 4, 5 или 6 цветных колец. Маркировочные кольца должны быть сдвинуты к одному из выводов или ширина первого или второго кольца должна быть в два раза больше других, что на практике выдерживается не всегда. Вместо цветовых колец могут использоваться цветовые точки.

При маркировки конденсаторов тремя кольцами допуск равен 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель. При маркировки пятью кольцами цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения. В полярных конденсаторах положительный вывод отмечается точкой или выводом большего диаметра.

Для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.

Символьная маркировка пассивных компонентов

При символьной маркировке используются 2 или 3 цифры в сочетании с символом, расположенным на месте десятичной точки и обозначающим единицу измерения.

После номинала может указываться допуск и ТКЕ. Отсутствие маркировки допуска обычно означает допуск по умолчанию ±20%. Для конденсаторов дополнительно может указываться рабочее напряжение, символьное обозначение которого обычно размещается в начале, перед номиналом.

Иногда применяется непосредственная маркировка номинала без указания множителя. В этом случае надпись «680К» на индуктивности будет означать не 68 мкГн ±10% (в соответствии со стандартной маркировкой), а 680 мкГн ±10%.

Помимо вышеназванных параметров на корпус может наноситься дополнительная кодированная информация, например о дате выпуска, типе, номинальной мощности и т.д.

Цифровая маркировка пассивных компонентов

При этом способе используются 3 или 4 цифры, последняя из которых обозначает количество нулей, добавляемых к стоящим впереди цифрам. Исключение составляют цифры 7, 8 и 9 для сопротивлений и цифра 9 для конденсаторов, обозначающие множитель в соответствии с приведенной ниже таблицей. Полученное значение равно номиналу в Ом для сопротивлений, пФ для емкостей и мкГн для индуктивностей. Для электролитических конденсаторов номинальное значение обычно дается сразу в мкФ. При использовании 2 цифр номинальное значение берется из ряда Е24 и имеет допуск 5% и более, при 3 цифрах номинальное значение берется из ряда Е96 и имеет допуск 1% и менее.

Кроме стандартных способов маркировки используются и нестандартные, часть из которых приведена в примерах.

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ

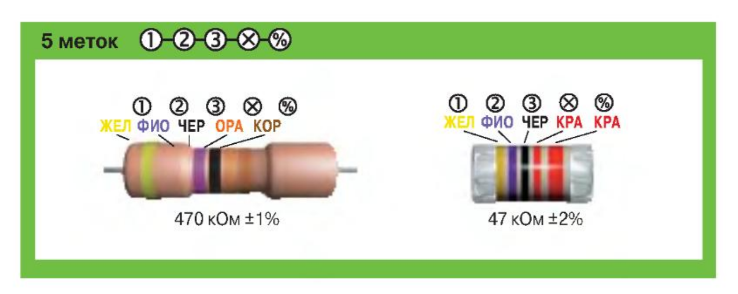
3 метки ①-②-⊗ (допуск 20%)



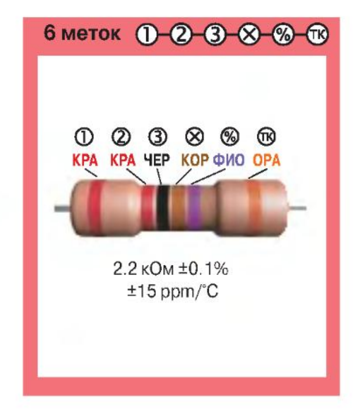
4 метки ①-②-⊗-%

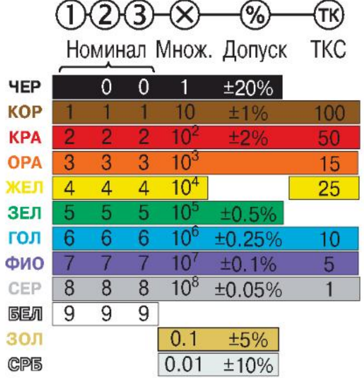


5 меток ①-②-③-⊗-%



6 меток ①-②-③-⊗-%-ТК



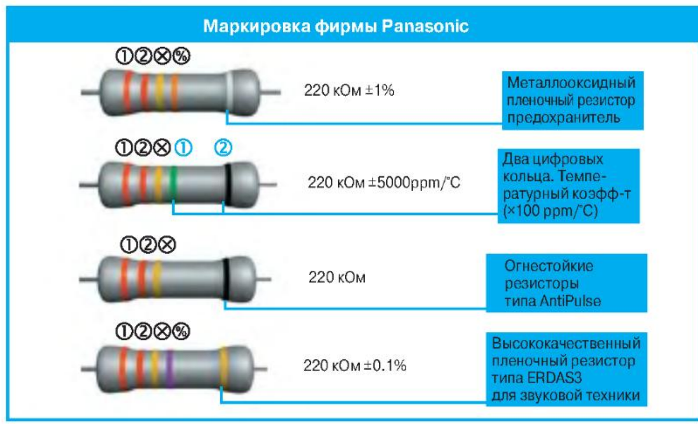


①②③-⊗—%—ТК

	①	②	③	Множ.	Допуск	ТКС
	Номинал					
ЧЕР		0	0	1	±20%	
КОР	1	1	1	10	±1%	100
КРА	2	2	2	10^2	±2%	50
ОРА	3	3	3	10^3		15
ЖЕЛ	4	4	4	10^4		25
ЗЕЛ	5	5	5	10^5	±0.5%	
ГОЛ	6	6	6	10^6	±0.25%	10
ФИО	7	7	7	10^7	±0.1%	5
СЕР	8	8	8	10^8	±0.05%	1
БЕЛ	9	9	9			
ЗОЛ				0.1	±5%	
СРБ				0.01	±10%	

Нестандартная маркировка

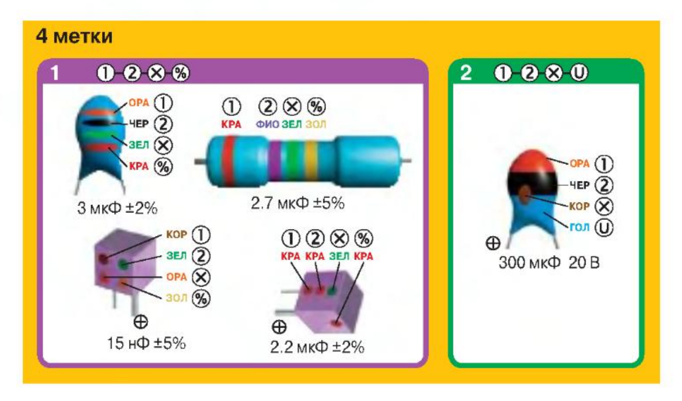


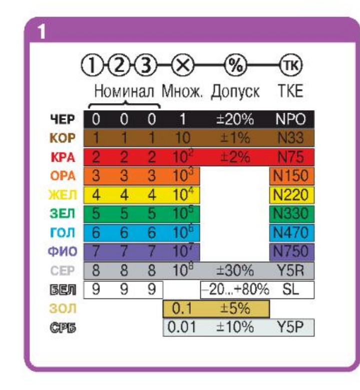




ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА КОНДЕНСАТОРОВ



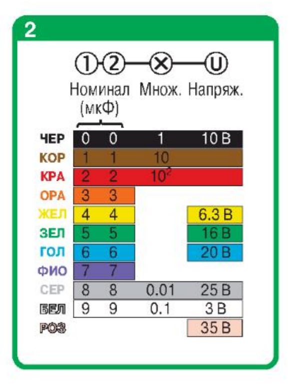




1

①②③—⊗—%—ТК

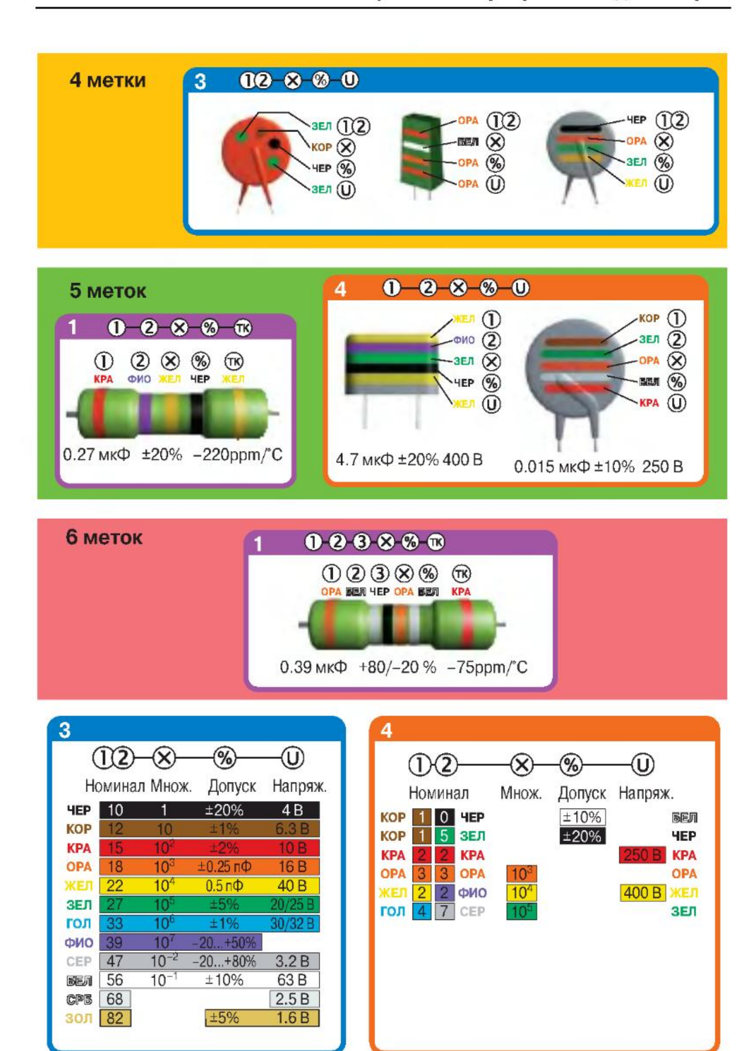
	①	②	③	⊗	%	ТК
	Номинал			Множ.	Допуск	ТКЕ
ЧЕР	0	0	0	1	±20%	NPO
КОР	1	1	1	10	±1%	N33
КРА	2	2	2	10^2	±2%	N75
ОРА	3	3	3	10^3		N150
ЖЕЛ	4	4	4	10^4		N220
ЗЕЛ	5	5	5	10^5		N330
ГОЛ	6	6	6	10^6		N470
ФИО	7	7	7	10^7		N750
СЕР	8	8	8	10^8	±30%	Y5R
БЕЛ	9	9	9		–20...+80%	SL
ЗОЛ				0.1	±5%	
СРБ				0.01	±10%	Y5P



2

①②—⊗—U

	①	②	⊗	U
	Номинал (мкФ)		Множ.	Напряж.
ЧЕР	0	0	1	10 В
КОР	1	1	10	
КРА	2	2	10^2	
ОРА	3	3		
ЖЕЛ	4	4		6.3 В
ЗЕЛ	5	5		16 В
ГОЛ	6	6		20 В
ФИО	7	7		
СЕР	8	8	0.01	25 В
БЕЛ	9	9	0.1	3 В
РОЗ				35 В



3

①② — ⊗ — % — U

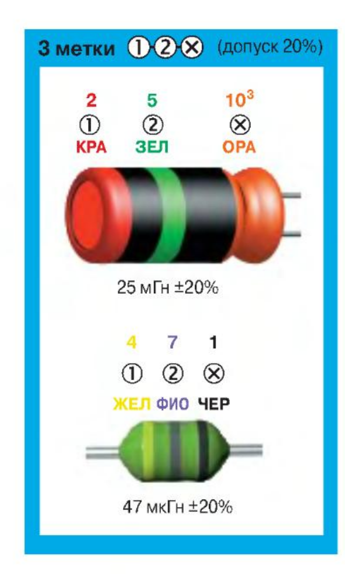
	Номинал	Множ.	Допуск	Напряж.
ЧЕР	10	1	±20%	4 В
КОР	12	10	±1%	6.3 В
КРА	15	10^2	±2%	10 В
ОРА	18	10^3	±0.25 пФ	16 В
ЖЕЛ	22	10^4	0.5 пФ	40 В
ЗЕЛ	27	10^5	±5%	20/25 В
ГОЛ	33	10^6	±1%	30/32 В
ФИО	39	10^7	−20...+50%	
СЕР	47	10^{-2}	−20...+80%	3.2 В
БЕЛ	56	10^{-1}	±10%	63 В
СРБ	68			2.5 В
ЗОЛ	82		±5%	1.6 В

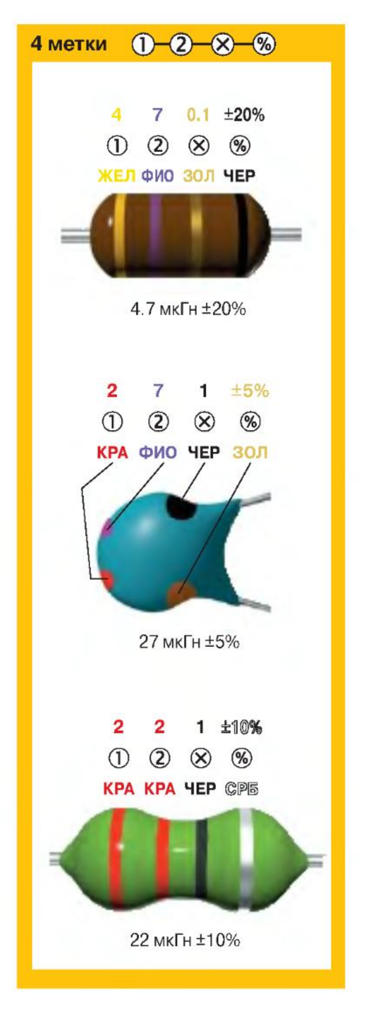
4

①② — ⊗ — % — U

	Номинал			Множ.	Допуск	Напряж.	
КОР	1	0	ЧЕР		±10%		БЕЛ
КОР	1	5	ЗЕЛ		±20%		ЧЕР
КРА	2	2	КРА			250 В	КРА
ОРА	3	3	ОРА	10^3			ОРА
ЖЕЛ	2	2	ФИО	10^4		400 В	ЖЕЛ
ГОЛ	4	7	СЕР	10^5			ЗЕЛ

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ

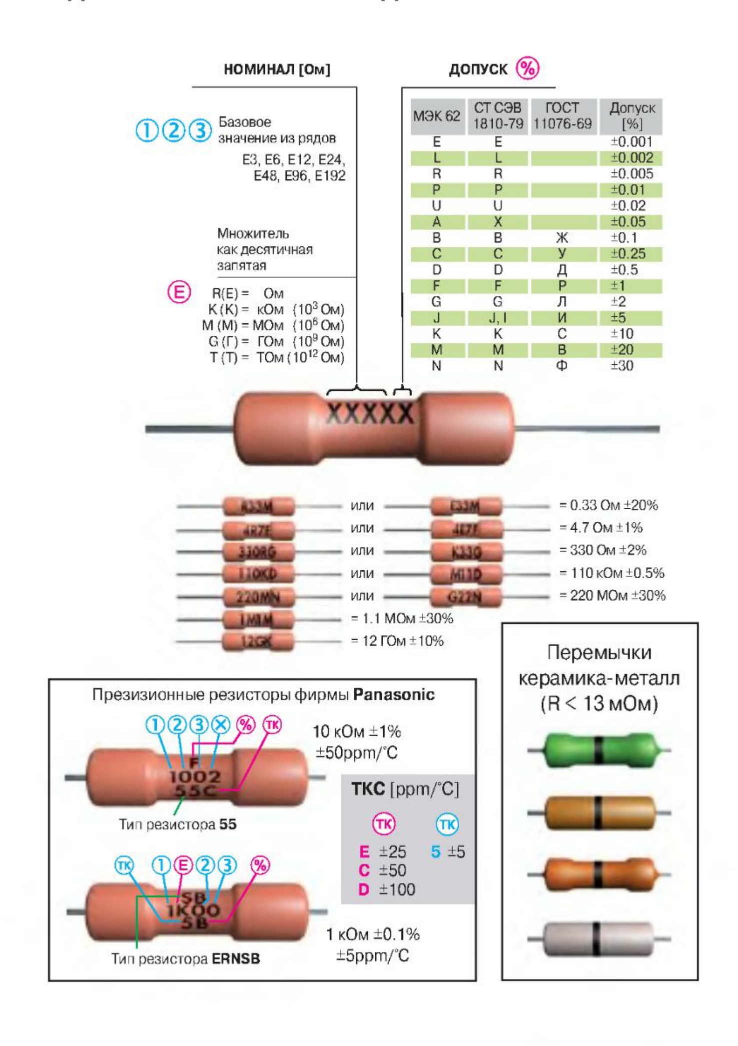






	①	②	⊗	%
	Номинал		Множ.	Допуск
ЧЕР		0	1	±20%
КОР	1	1	10	
КРА	2	2	10^2	
ОРА	3	3	10^3	
ЖЕЛ	4	4		
ЗЕЛ	5	5		
ГОЛ	6	6		
ФИО	7	7		
СЕР	8	8		
БЕЛ	9	9		
ЗОЛ			0.1	±5%
СРБ			0.01	±10%

КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ВЫВОДНЫХ РЕЗИСТОРОВ



МЭК 62	СТ СЭВ 1810-79	ГОСТ 11076-69	Допуск [%]
E	E		±0.001
L	L		±0.002
R	R		±0.005
P	P		±0.01
U	U		±0.02
A	X		±0.05
B	B	Ж	±0.1
C	C	У	±0.25
D	D	Д	±0.5
F	F	Р	±1
G	G	Л	±2
J	J, I	И	±5
K	K	С	±10
M	M	В	±20
N	N	Ф	±30

КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ВЫВОДНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

1 ①②⊗%

473K — 47 нФ ±10%

682M — 6.8 нФ ±20%

221J — 220 пФ ±5%

2 ①②Ⓔ%ТК

M75 15 ПС — 15 пФ ±0.25% −75 ppm/°C

①②Ⓔ%ТК 33pKL — 33 пФ ±0.10% −75 ppm/°C

H90 6μ8k — ①Ⓔ②%ТК — 6.8 мкФ ±0.10% ТКЕ ±90%

3 Ⓤ①②③⊗%

D1622K — 16.2 нФ ±10%, 20 В

4 ①②Ⓤ

Маркировка в мкФ

.02 10 — 0.02 мкФ 10 В

5 ①②ⒺТК

Смешанная маркировка

10P — 10 пФ 750 ppm/°C



Напряжение [В]

Ⓤ

Ⓤ	
G	4
J	6.3/7
A	10
C	16
D	20
E	25
V	35

Номинал



Вариант 1:

①②③Ⓔ

2 или 3 цифры и буква как десятичная точка и единица изм.:

Ⓔ	Ⓔ	
R	П	пФ
P,p		пФ
n	Н	нФ
m,μ		мкФ



Вариант 2:

①②③⊗

3 или 4 цифры, последняя из которых равна числу добавочных нулей, кроме:

9 = × 0.1

Единица измерения: пФ

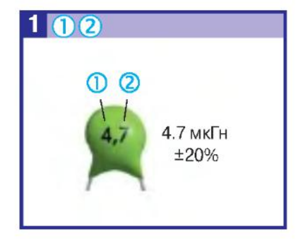
Допуск [%]

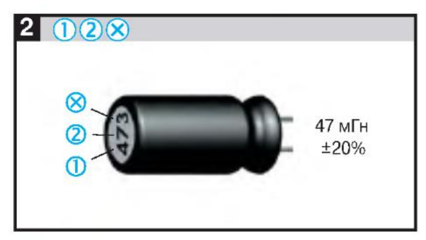
%	%	
B	Ж	±0.1
C	У	±0.25
D	Д	±0.5
F	Р	±1
G	Л	±2
J	И	±5
K	С	±10
M	В	±20
N	Ф	±30
Q	О	−10...+30
T	Э	−10...+50
Y	Ю	−10...+100
S	Б	−20...+50
Z	А	−20...+80

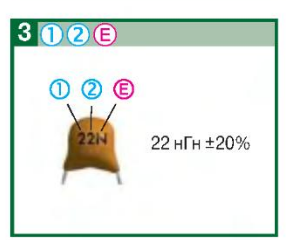
ТКЕ [ppm/°C]

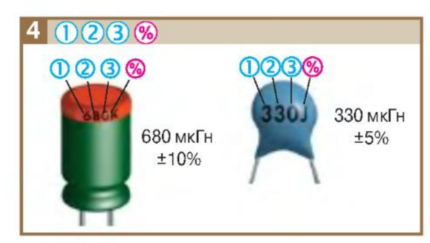
ТК	ТК
A	П100
B	Н10
C	МП0
D	Н30
E	Н70
F	Н90
H	М33
K	М2200
L	М75
N	П33
P	М150
R	М220
S	П330
T	М470
U	М750
V	М1500
X	Н50
Z	Н20

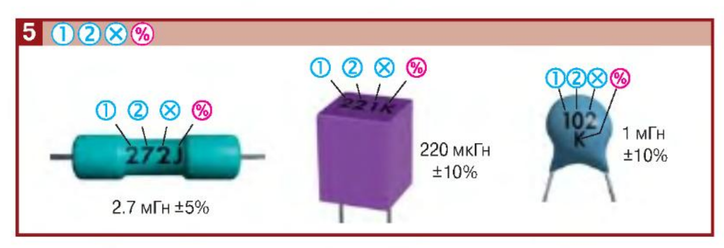
КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ВЫВОДНЫХ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ

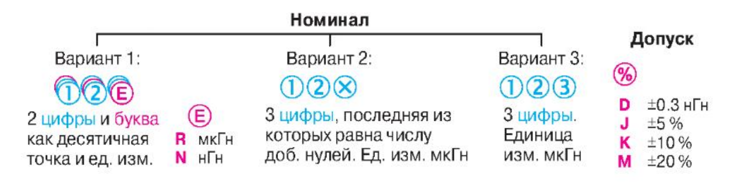








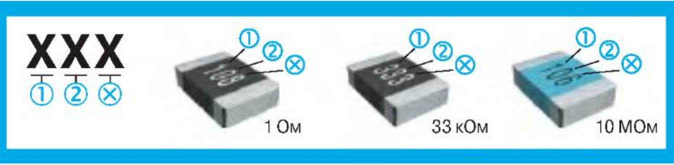


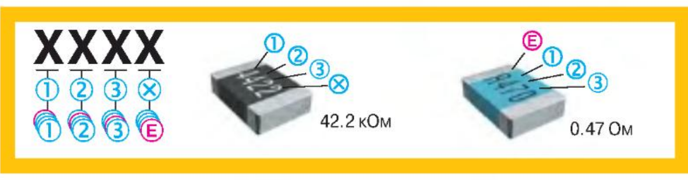


МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА



01 — 100	21 — 162	41 — 261	61 — 422	81 — 681
02 — 102	22 — 165	42 — 267	62 — 432	82 — 698
03 — 105	23 — 169	43 — 274	63 — 442	83 — 715
04 — 107	24 — 174	44 — 280	64 — 453	84 — 732
05 — 110	25 — 178	45 — 287	65 — 464	85 — 750
06 — 113	26 — 182	46 — 294	66 — 475	86 — 768
07 — 115	27 — 187	47 — 301	67 — 487	87 — 787
08 — 118	28 — 191	48 — 309	68 — 499	88 — 806
09 — 121	29 — 196	49 — 316	69 — 511	89 — 825
10 — 124	30 — 200	50 — 324	70 — 523	90 — 845
11 — 127	31 — 205	51 — 332	71 — 536	91 — 866
12 — 130	32 — 210	52 — 340	72 — 549	92 — 887
13 — 133	33 — 215	53 — 348	73 — 562	93 — 909
14 — 137	34 — 221	54 — 357	74 — 576	94 — 931
15 — 140	35 — 226	55 — 365	75 — 590	95 — 953
16 — 143	36 — 232	56 — 374	76 — 604	96 — 976
17 — 147	37 — 237	57 — 383	77 — 619	
18 — 150	38 — 243	58 — 392	78 — 634	
19 — 154	39 — 249	59 — 402	79 — 649	
20 — 158	40 — 255	60 — 412	80 — 665	





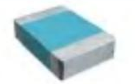
(1)(2)(3) Номинал [Ом]: **0…9**

(X) Множитель:
1 — 10 **4** — 10^{4} **7** — 10^{-2}
2 — 10^{2} **5** — 10^{5} **8** — 10^{-1}
3 — 10^{3} **6** — 10^{6} **9** — 10^{0}

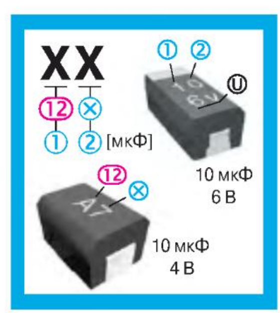
(E) Десятичная точка: **R**

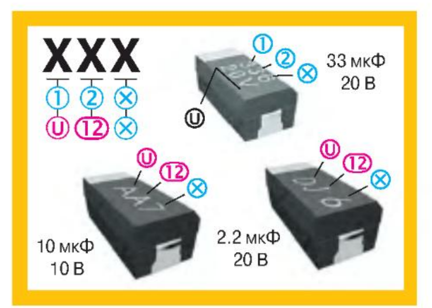
Перемычки (Jamper-Chip) R < 50 мОм

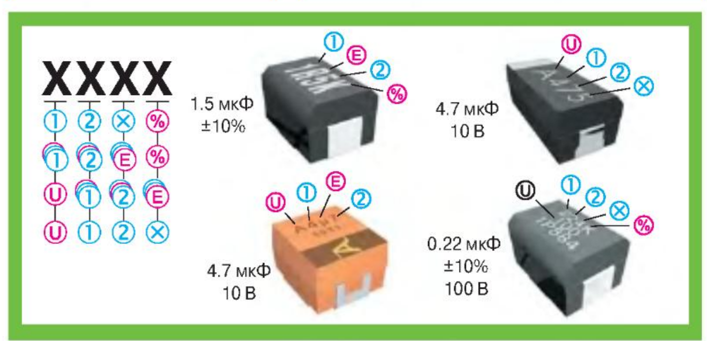




МАРКИРОВКА КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА







Ⓤ Рабочее напряжение:

G — 4	
J — 6.3/7	**D** — 20
A — 10	**E** — 25
C — 16	**V** — 35

Ⓤ Рабочее напряжение:
0…9 — величина
V — вольты

⑫ Номинал [пф]:

A — 1.0	**M** — 3.0	**Y** — 8.2
B — 1.1	**N** — 3.3	**Z** — 9.1
C — 1.2	**P** — 3.6	**a** — 2.5
D — 1.3	**Q** — 3.9	**b** — 3.5
E — 1.5	**R** — 4.3	**d** — 4.0
F — 1.6	**S** — 4.7	**e** — 4.5
G — 1.8	**T** — 5.1	**f** — 5.0
H — 2.0	**U** — 5.6	**m** — 6.0
J — 2.2	**V** — 6.2	**n** — 7.0
K — 2.4	**W** — 6.8	**t** — 8.0
L — 2.7	**X** — 7.5	**g** — 9.0

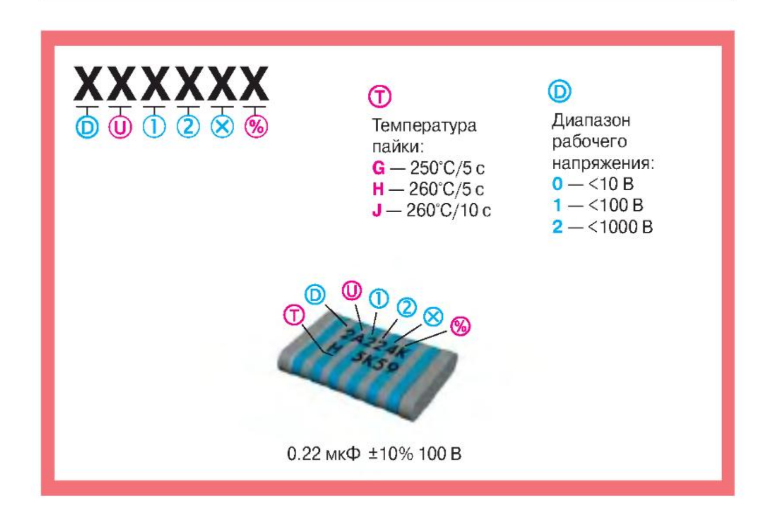
⊗ Множитель:

9	— 0.1
0	— 1
1	— 10
2	— 10^2
3	— 10^3
4	— 10^4
5	— 10^5
6	— 10^6
7	— 10^7

Ⓔ Десятичная точка и единица измерения:
μ — мкФ **R** — мкФ

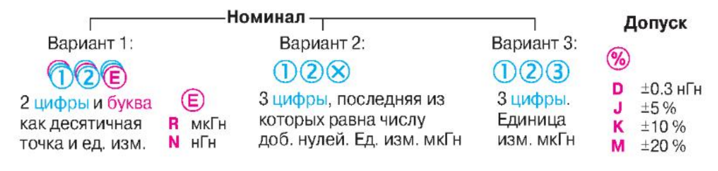
①② Номинал:
(①②⊗ — [пф])
0…9

% Допуск [%]:
J — ±5,
K — ±10,
M — ±20



МАРКИРОВКА ИНДУКТИВНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА





ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ

Ниже приведены таблицы соответствия между параметрами и их обозначением с помощью цвета, символов и цифр. Для названий цвета используются следующие сокращения: чер — черный, кор — коричневый, кра — красный, т-кра — темно-красный , ора — оранжевый, жел — желтый, зел — зеленый, т-зел — темно-зеленый, гол — голубой, син — синий, фио — фиолетовый, сер — серый, бел — белый, зол — золотой, срб — серебрянный, роз — розовый, беж — бежевый, сал — салатовый, таб — табачный, бир — бирюзовый, эле — электрик.

Ⓗ ① ② ③ Маркировка номинального значения

Единица измерения: сопротивления — Ом, емкости — пФ, индуктивности — мкГн

Значение	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цветовая маркировка	чер	кор	кра	ора	жел	зел	гол	фио	сер	бел
Цифровая марк.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

⊗ Маркировка множителя

Значение		0.01	0.1	1	10	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9
Цветовая маркировка		срб	зол	чер	кор	кра	ора	жел	зел	гол	фио	сер	бел
Цифровая маркировка	R	7	8	9	1	2	3	4	5	6			
	C		9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	

Ⓔ Маркировка единицы измерения

Положение символа указывает на положение десятичной точки

		Сопротивления					**Емкости**			**Индуктивности**	
Значение		Ом	кОм	МОм	ГОм	ТОм	пФ	нФ	мкФ	нГн	мкГн
Сим-вол	межд.	R	K	M	G	T	R,P	n	m,μ	N	R
	рус.	E	K	M	Г	T	П	Н			

ⓟ Маркировка допуска

Значение [%]		±0.001	±0.002	±0.005	±0.01	±0.02	±0.05	±0.1	±0.25	±0.5	±1	±2	±5	±10	±20	±30	−10 +30	−10 +50	−10 +100	−20 +50	−20 +80
Цве-товая мар-киров-ка	R						сер	фио	гол	зел	кор	кра	зол	срб							
	C L								ора	жел	кор	кра	зол	срб	чер	сер				фио	сер
Сим-вол:	межд.	E	L	R	P	U	A	B	C	D	F	G	J	K	M	N	Q	T	Y	S	Z
	рус.							Ж*	У*	Д*	Р*	Л	И	С	В	Ф	О	Э	Ю	Б	А

* Для конденсаторов емкостью <10 пф допуск имеет размерность пикофарад.
Для индуктивности используются допуски ±5%, ±10% и ±20%, символ D = ±0.3 нГн

ⓉⓀ Маркировка температурного коэффициента сопротивлений

Значение	1	5	10	15	25	50	100
Цвет	сер	фио	гол	ора	жел	кра	кор
Символ (межд.)					E	C	D

ТК Маркировка ненормируемого температурного коэффициента емкости

Группа	Н10	Н20	Н30	Н50	Н70	Н90
Допуск в диапозоне −60...+85°С	±10%	±20%	±30%	±50%	±70%	±90%
Цвет*	ора+чер	ора+кра	ора+зел	ора+гол	ора+фио	ора+бел
Символ (межд.)	B	Z	D	X	E	F

* Современная цветовая кодировка. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.

ТК Маркировка линейного температурного коэффициента емкости

Группа													
	межд.	P100		NP0	N030	N080	N150	N220	N330	N470	N750	N1500	N2200
	рус.	П100	П33	МП0	М33	М75	М150	М220	М330	М470	М750	М1500	М2200
ТКЕ [ppm/°C]		100	33	0	−33	−75	−150	−220	−330	−470	−750	−1500	−2200
Разброс*		−49 ...+130		−75 ...+30	−80 ...+30	−80 ...+30	−105 ...+30	−120 ...+30	−180 ...+60	−210 ...+60	−330 ...+120	−670 ...−250	
Цвет**		кра+фио	сер	чер	кор	кра	ора	жел	зел	гол	фио	ора+ора	жел+ора
Символ (межд.)		A	N	C	H	L	P	R	S	T	U	V	K

* Реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур −55...+85°С.

** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.

ТК Маркировка нелинейного температурного коэффициента емкости

Обозначения групп приведены в соответствии со стандартом EIA, в скобках указан стандарт IEC.

Маркировка дана в соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например Panasonic, пользуются другой кодировкой.

		Допуск						
		±7.5%	**±10%**	**±15%**	**±22%**	**+22...−56%**	**+22...−82%**	**+150...−1500%**
Темп. диап.*	**−10...+85°C**	Z5F: **B**	Z5P: **C**		Z5S	Z5U (2E): **E**	Z5V: **F**,	
	−30...+85°C	Y5F	Y5P:	Y5R: **R**,	Y5S: **S**,	Y5U: **A**	Y5V (2F)	
	−55...+85°C	X5F	X5P		X5S	X5U:	X5V	
	−55...+125°C			X7R (2R)				
	−55...+150°C							SLO (GP): **Nil**,

* В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например, фирма Philips для группы Y5P нормирует −55...+125 °С.

U Маркировка рабочего напряжения емкостей

Значение [В]	2.5	3	4	6.3/7	10	16	20	25	35	50	63	100	250	400	630
Код (межд.)	0E,E		0G,G	0J,J	1A,A	1C,C	1D,D	1E,V	1V,V	1H	1J	2A	2E	2G	2J

РЯДЫ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО EIA

Допуски: E3 — 50%, E6 — 20%, E12 —10%, E24 — 5%, E48 — 2%, E96 — 1%, E192 — < 0.5%

Не использ.	**E3**	100				220				470			
Редко исп.	**E6**	100		150		220		330		470		680	
	E12	100	120	150	180	220	270	330	390	470	560	680	820
	E24	100	120	150	180	220	270	330	390	470	560	680	820
		110	130	160	200	240	300	360	430	510	620	750	910

E48	**E96**	**E192**	**E48**	**E96**	**E192**	**E48**	**E96**	**E192**	**E48**	**E96**	**E192**	**E48**	**E96**	**E192**	**E48**	**E96**	**E192**
100	100	100	147	147	147	215	215	215	316	316	316	464	464	464	681	681	681
		101			149			218			320			470			690
	102	102		150	150		221	221		324	324		475	475		698	698
		104			152			223			328			481			706
105	105	105	154	154	154	226	226	226	332	332	332	487	487	487	715	715	715
		106			156			229			336			493			723
	107	107		158	158		232	232		340	340		499	499		732	732
		109			160			234			344			505			741
110	110	110	162	162	162	237	237	237	348	348	348	511	511	511	750	750	750
		111			164			240			352			517			759
	113	113		165	165		243	243		357	357		523	523		768	768
		114			167			246			361			530			777
115	115	115	169	169	169	249	249	249	365	365	365	536	536	536	787	787	787
		117			172			252			370			542			796
	118	118		174	174		255	255		374	374		549	549		806	806
		120			176			258			379			556			816
121	121	121	178	178	178	261	261	261	383	383	383	562	562	562	825	825	825
		123			180			264			388			569			835
	124	124		182	182		267	267		392	392		576	576		845	845
		126			184			271			397			583			856
127	127	127	187	187	187	274	274	274	402	402	402	590	590	590	866	866	866
		129			189			277			407			597			876
	130	130		191	191		280	280		412	412		604	604		887	887
		132			193			284			417			612			898
133	133	133	196	196	196	287	287	287	422	422	422	619	619	619	909	909	909
		135			198			291			427			626			920
	137	137		200	200		294	294		432	432		634	634		931	931
		138			203			298			437			642			942
140	140	140	205	205	205	301	301	301	442	442	442	649	649	649	953	953	953
		142			208			305			448			657			965
	143	143		210	210		309	309		453	453		665	665		976	976
		145			213			312			459			673			988

МАРКИРОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ П/П ПРИБОРОВ В КОРПУСЕ КТ-26 (ТО-92)

Нет, не удалось нам догнать буржуев нигде, кроме как в области цветовой и кодовой маркировки радиокомпонентов. Здесь мы не только догнали загнивающий Запад, но и перегнали его, как говорится, «навсегда». Никакому иностранцу никогда не удастся расшифровать таинственные и постоянно меняющиеся комбинации странных значков и таинственных точечек, коими маркируются отечественные полупроводниковые приборы. Что, в общем-то, хорошо: чего не понимают, того хотя бы опасаются, так что можно считать отечественную маркировку частью нашей оборонной инициативы, как говорится, «наш ответ на ультиматум Керзона». Но в своей страсти зашифровывать и засекречивать все и вся мы зашли слишком далеко, так как и собственное население уже не может понять, что же за загадочные приборы впаяны в наши неказистые платы.

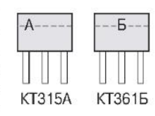
Невозможно объять необъятное, поэтому из всей массы приборов мы постарались выбрать группу, которая наиболее часто маркируется всевозможными кодами. Понятно, что применение кодовой маркировки связано в первую очередь с размерами, а значит, и типом корпуса. Безусловным лидером по частоте применения кодовой маркировки является корпус типа КТ-26. Выпускавшийся ранее корпус КТП-4 представляет собой модификацию КТ-26 и, следовательно, тоже попадает под рассмотрение. В связи с вышеизложенным, упор, сделанный в данном издании на маркировку полупроводниковых приборов, выпускающихся в корпусе КТ-26, является закономерным и позволяет ответить на большинство вопросов, связанных с кодовой маркировкой.

Первый и самый неутешительный вывод, полученный в результате исследований: по маркировке полупроводниковых приборов, выпускающихся в корпусе КТ-26, часто НЕВОЗМОЖНО однозначно установить тип прибора. Можно долго рассуждать, почему так случилось и кто в этом виноват; мы же считаем, что сложившаяся ситуация является, результатом во-первых, нашего российского менталитета, то есть привычкой решать все проблемы административным путем, а во-вторых, особенностей протекания исторического процесса в нашей стране. Из последнего утверждения следует очень важный вывод: маркировка полупроводниковых приборов, выпускающихся в корпусе КТ-26, есть категория историческая. Это значит, в частности, что если производитель какого-нибудь транзистора в 1992 году маркировал его, допустим, красной точкой, а в 1993 году перестал выпускать этот транзистор, то в 1994 году мог появиться другой (а иногда и тот же самый) производитель и замаркировать красной точкой совершенно другой прибор, считая, что данная конкретная маркировка «свободна».

Вообще-то, служение полупроводниковой промышленности в советское время нуждам военно-промышленного комплекса не пошло ей на пользу. До сих пор принципы маркировки компонентов их изготовитель считает исключительно своей прерогативой и руководствуется в них даже не ГОСТами, а своими сиюминутными интересами, как-то: наличием или отсутствием необходимой краски, трудностями, связанными с изготовлением клейма, и т.п. Выполнение требований по маркировке, внесенных в ТУ, обходят обычно следующим образом: достаточно крупные партии приборов выпускаются «по нормали главного конструктора» или «по конкретному контракту», что позволяет маркировать эти партии так, как удобно изготовителю. Еще «хлеще» маркируются приборы, выпускаемые в странах СНГ для российского рынка. Самостийность, видимо, не позволяет маркировать по российским стандартам, а свои вырабатывать просто некогда, да и некому, надо быстрее клепать приборы, а то скоро эту «высокотехнологичную продукцию» никто брать не будет. Исключения в лучшую сторону достаточно редки и серьезного исследователя интересовать не могут.

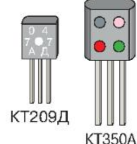
История

Первым массовым транзистором с кодовой маркировкой был КТ315 в миниатюрном пластмассовом корпусе КТ-13. На нем в левом верхнем углу плоской стороны ставилась буква, обозначающая группу, ниже иногда указывалась дата изготовления. Через несколько лет в корпусе КТ-13 стали выпускать транзистор прямой проводимости — КТ361. Для отличия от КТ315 буква, обозначающая группу, ставилась посередине верхней части плоской стороны.



В 1974 году появился транзистор КТ375 в корпусе КТ-26 (тогда еще с круглыми выводами), который маркировался цифрами 375 и буквой, указывающей группу транзистора.

В 1976 году появляется целая группа транзисторов в корпусах КТП-4 и КТ-26, отмаркированных цветовым четырехточечным кодом, и транзистор КТ209 (корпус КТП-4), который маркировался буквой А в левом нижнем углу плоской стороны корпуса. В правом нижнем углу плоской стороны корпуса буквой указывалась группа прибора, выше — двумя цифрами год, а еще выше — двумя цифрами дата изготовления. Понять, что это за приборы, без расшифровки кода было уже невозможно, поэтому 1976 год можно считать началом эры цветовой и кодовой маркировки корпуса КТ-26 в СССР.



В 1979 году появляются транзисторы в корпусе КТ-26, маркированные символами. Сначала символы ставятся где попало, но к 1985 году они обретают постоянное место в левом верхнем углу плоской стороны корпуса. Примерно в это же время появляются транзисторы, маркируемые двумя цветовыми метками. С 1988 года набирает обороты сокращенная символьная маркировка.

Общие принципы маркировки

Корпус КТ-26 (ТО-92) изготавливается из пластмассы темного, чаще черного, цвета, поэтому все надписи наносятся белой или серебристой краской. Маркировка обычно наносится на срезе боковой поверхности корпуса, реже — на цилиндрической части боковой поверхности корпуса, на торце корпуса цветовым кодом указывают группу прибора.

Встречаются приборы, торец корпуса которых целиком закрашен каким-либо цветом. Это, за немногими исключениями, внутризаводская маркировка, которая, как правило, не стандартизируется и не расшифровывается (обозначает иногда разбраковку по одному или нескольким параметрам: номер смены и т.п.). Уловить какие-нибудь закономерности здесь не удалось, да и не очень надо, так как для массового потребителя данный тип маркировки несет немного полезной информации.

На корпусе стараются указать тип прибора, группу, дату выпуска (год, месяц или номер смены). Наиболее важными представляются тип и группа прибора — на них мы и сосредоточим свое внимание; что касается даты изготовления, то часто она вообще не указывается. Когда же дата указывается, чаще всего это делается согласно ГОСТ 25486-82 (см. раздел Символьно-буквенная маркировка) или просто: двумя цифрами год, двумя (одной) месяц (например, 95 09 означает 1995 год, сентябрь-месяц). Встречается обратный порядок указания года и месяца (например, 3-74 означает март 1974 года) или обозначение только года изготовления двумя цифрами (например, 85 — 1985 год).

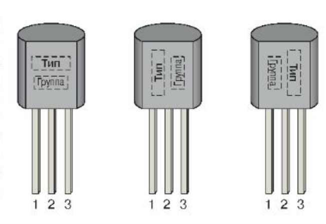
Типы маркировки полупроводниковых приборов

Для удобства все рассмотренные варианты маркировки полупроводниковых приборов, выпускающихся в корпусе КТ-26, были разбиты на шесть классов, которым были присвоены условные названия:



Цифро-буквенная маркировка

Цифро-буквенная маркировка может быть полной и сокращенной. Наносится на срез боковой поверхности корпуса, как правило, в две строки друг над другом, возможны как правый поворот надписи, так и левый, а также маркировка в одну строку. Относительно полный список сокращенного варианта цифро-буквенной маркировки приведен ниже в таблице (используемые условные обозначения расшифрованы в списке сокращений). Приборы, тип и группа которых промаркированы полностью, по понятным причинам в данном издании не рассматриваются.

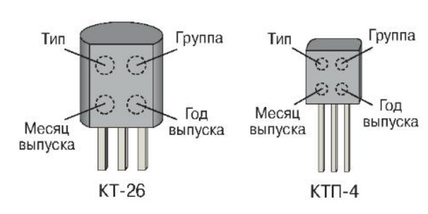


Тип	Функция	1-2-3	Маркировка	Тип	Функция	1-2-3	Маркировка	Тип	Функция	1-2-3	Маркировка
КТ969А1	n-p-n	E-C-B	1A	КП307Е1	n-FET	G-D-S	307E	КТ349В	p-n-p	C-B-E	349В
КР1188ЕН5	reg+	I-C-O	8ЕН5	КП307Ж1	n-FET	G-D-S	307Ж	КТ350А	p-n-p	C-B-E	350А
КР1188ЕН8	reg+	I-C-O	8ЕН8	КТ313А1	p-n-p	C-B-E	313А1	КТ351А	p-n-p	C-B-E	351А
КР1188ЕН9	reg+	I-C-O	8ЕН9	КТ313А2	p-n-p	E-C-B	313А2	КТ351Б	p-n-p	C-B-E	351Б
КР1188ЕН12	reg+	I-C-O	8ЕН12	КТ313Б1	p-n-p	C-B-E	313Б1	КТ352А	p-n-p	C-B-E	352А
КТ117АМ	O	E-B1-B2	17А	КТ313Б2	p-n-p	E-C-B	313Б2	КТ352Б	p-n-p	C-B-E	352Б
КТ117БМ	O	E-B1-B2	17Б	КТ313В1	p-n-p	C-B-E	313В1	КТ355АМ	n-p-n	C-B-E	355А
КТ117ВМ	O	E-B1-B2	17В	КТ313В2	p-n-p	E-C-B	313В2	КТ357В	p-n-p	C-B-E	357А
КТ117ГМ	O	E-B1-B2	17Г	КТ313Г1	p-n-p	C-B-E	313Г1	КТ357А	p-n-p	C-B-E	357Б
КР1157ЕН1	reg+	C-O-I	57ЕН	КТ313Г2	p-n-p	E-C-B	313Г2	КТ357Б	p-n-p	C-B-E	357В
КР1168ЕН1	reg+	C-O-I	68ЕН1	КТ3157А	p-n-p	C-E-B	3157А	КТ361А2	p-n-p	E-C-B	361А2
КР142ЕН17А	reg+	O-C-I	69	КТ315А1	n-p-n	E-C-B	315А1	КТ361А3	p-n-p	E-C-B	361А3
КР142ЕН17Б	reg+	O-C-I	70	КТ315Б1	n-p-n	E-C-B	315Б1	КТ361Б2	p-n-p	E-C-B	361Б2
КР142ЕН19	reg+	G-A-K	71	КТ315В1	n-p-n	E-C-B	315В1	КТ361В2	p-n-p	E-C-B	361В2
КТ133А	O	B1-E-B2	133А	КТ315Г1	n-p-n	E-C-B	315Г1	КТ361Г2	p-n-p	E-C-B	361Г2
КТ133Б	O	B1-E-B2	133Б	КТ315Д1	n-p-n	E-C-B	315Д1	КТ361Г3	p-n-p	E-C-B	361Г3
КР1125КП3А	btd	K-A1-A2	153А	КТ315Е1	n-p-n	E-C-B	315Е1	КТ361Д2	p-n-p	E-C-B	361Д2
КР1125КП3Б	btd	K-A1-A2	153Б	КТ315Ж1	n-p-n	E-C-B	315Ж1	КТ361Д3	p-n-p	E-C-B	361Д3
КР1125КП3В	btd	K-A1-A2	153В	КТ315И1	n-p-n	E-C-B	315И1	КТ361Е2	p-n-p	E-C-B	361Е2
КТ208А1	p-n-p	C-B-E	208А	КТ315Н1	n-p-n	E-C-B	315Н1	КТ361Ж2	p-n-p	E-C-B	361Ж2
КТ208Б1	p-n-p	C-B-E	208Б	КТ315Р1	n-p-n	E-C-B	315Р1	КТ361И2	p-n-p	E-C-B	361И2
КТ208В1	p-n-p	C-B-E	208В	КТ316АМ	n-p-n	C-B-E	316А(М)	КТ361К2	p-n-p	E-C-B	361К2
КТ209А	p-n-p	C-B-E	209А	КТ316БМ	n-p-n	C-B-E	316Б(М)	КТ361Л2	p-n-p	E-C-B	361Л2
КТ209Б	p-n-p	C-B-E	209Б	КТ316ВМ	n-p-n	C-B-E	316В(М)	КТ361М2	p-n-p	E-C-B	361М2
КТ209Б1	p-n-p	C-B-E	209Б1	КТ316ГМ	n-p-n	C-B-E	316Г(М)	КТ361Н2	p-n-p	E-C-B	361Н2
КТ209В	p-n-p	C-B-E	209В	КТ316ДМ	n-p-n	C-B-E	316Д(М)	КТ361П2	p-n-p	E-C-B	361П2
КТ209В1	p-n-p	C-B-E	209В1	КТ325АМ	n-p-n	C-E-B	325А	КТ363АМ	p-n-p	C-B-E	363АМ
КТ209В2	p-n-p	C-B-E	209В2	КТ325БМ	n-p-n	C-E-B	325Б	КТ363БМ	p-n-p	C-B-E	363БМ
КТ209Г	p-n-p	C-B-E	209Г	КТ325ВМ	n-p-n	C-E-B	325В	КП364А	nFET	G-D-S	364А
КТ209Д	p-n-p	C-B-E	209Д	КТ326АМ	p-n-p	C-B-E	326АМ	КП364Б	nFET	G-D-S	364Б
КТ209Е	p-n-p	C-B-E	209Е	КТ326БМ	p-n-p	C-B-E	326БМ	КП364В	nFET	G-D-S	364В
КТ209Ж	p-n-p	C-B-E	209Ж	КТ337А	p-n-p	C-B-E	337А	КП364Г	nFET	G-D-S	364Г
КТ209И	p-n-p	C-B-E	209И	КТ337Б	p-n-p	C-B-E	337Б	КП364Д	nFET	G-D-S	364Д
КТ209К	p-n-p	C-B-E	209К	КТ337В	p-n-p	C-B-E	337В	КП364Е	nFET	G-D-S	364Е
КТ209Л	p-n-p	C-B-E	209Л	КТ339АМ	n-p-n	C-E-B	339А	КП364Ж	nFET	G-D-S	364Ж
КТ209М	p-n-p	C-B-E	209М	КТ342АМ	n-p-n	C-B-E	342АМ	КП364И	nFET	G-D-S	364И
КТ219А	n-p-n	C-B-E	219А	КТ342БМ	n-p-n	C-B-E	342БМ	КТ368АМ	n-p-n	C-B-E	368А/М
КТ306АМ	n-p-n	C-B-E	306А	КТ342ВМ	n-p-n	C-B-E	342ВМ	КТ368БМ	n-p-n	C-B-E	368Б/М
КТ306БМ	n-p-n	C-B-E	306Б	КТ342ГМ	n-p-n	C-B-E	342ГМ	КТ368ВМ	n-p-n	C-B-E	368ВМ
КТ306ВМ	n-p-n	C-B-E	306В	КТ342ДМ	n-p-n	C-B-E	342ДМ	КТ373А	n-p-n	E-B-C	373А
КТ306ГМ	n-p-n	C-B-E	306Г	КТ345А	p-n-p	C-B-E	345А	КТ373Б	n-p-n	E-B-C	373Б
КТ306ДМ	n-p-n	C-B-E	306Д	КТ345Б	p-n-p	C-B-E	345Б	КТ373В	n-p-n	E-B-C	373В
КП307А1	n-FET	G-D-S	307А	КТ345В	p-n-p	C-B-E	345В	КТ373Г	n-p-n	E-B-C	373Г
КП307Б1	n-FET	G-D-S	307Б	КТ349А	p-n-p	C-B-E	349А	КТ375А	n-p-n	C-B-E	375А
КП307Г1	n-FET	G-D-S	307Г	КТ349Б	p-n-p	C-B-E	349Б	КТ375Б	n-p-n	C-B-E	375Б

Тип	Функция	1-2-3	Маркировка	Тип	Функция	1-2-3	Маркировка	Тип	Функция	1-2-3	Маркировка
КТ399АМ	n-p-n	C-B-E	399А	КТ686Г	p-n-p	C-B-E	686Г	КТ6110Д	n-p-n	E-B-C	6110Д
КТ399БМ	n-p-n	C-B-E	399Б	КТ686Д	p-n-p	C-B-E	686Д	КТ6111А	n-p-n	E-B-C	6111А
КТ399ВМ	n-p-n	C-B-E	399В	КТ686Е	p-n-p	C-B-E	686Е	КТ6111Б	n-p-n	E-B-C	6111Б
КТ399ГМ	n-p-n	C-B-E	399Г	КТ686Ж	p-n-p	C-B-E	686Ж	КТ6111В	n-p-n	E-B-C	6111В
КП501А	n-MOS	G-D-S	501А	КТ698А	n-p-n	C-B-E	698А	КТ6111Г	n-p-n	E-B-C	6111Г
КП501Б	n-MOS	G-D-S	501Б	КТ698Б	n-p-n	C-B-E	698Б	КТ6112А	p-n-p	E-B-C	6112А
КП501В	n-MOS	G-D-S	501В	КТ698В	n-p-n	C-B-E	698В	КТ6112Б	p-n-p	E-B-C	6112Б
КП502А	n-MOS	S-D-G	502А	КТ698Г	n-p-n	C-B-E	698Г	КТ6112В	p-n-p	E-B-C	6112В
КТ502А	p-n-p	C-B-E	502А	КТ698Д	n-p-n	C-B-E	698Д	КТ6113А	n-p-n	E-B-C	6113А
КТ502Б	p-n-p	C-B-E	502Б	КТ698Е	n-p-n	C-B-E	698Е	КТ6113Б	n-p-n	E-B-C	6113Б
КТ502В	p-n-p	C-B-E	502В	КТ698Ж	n-p-n	C-B-E	698Ж	КТ6113В	n-p-n	E-B-C	6113В
КТ502Г	p-n-p	C-B-E	502Г	КТ698И	n-p-n	C-B-E	698И	КТ6113Г	n-p-n	E-B-C	6113Г
КТ502Д	p-n-p	C-B-E	502Д	КТ698К	n-p-n	C-B-E	698К	КТ6113Д	n-p-n	E-B-C	6113Д
КТ502Е	p-n-p	C-B-E	502Е	КТ3102АМ	n-p-n	C-B-E	3102АМ	КТ6113Е	n-p-n	E-B-C	6113Е
КП503А	n-MOS	S-D-G	503А	КТ3102БМ	n-p-n	C-B-E	3102БМ	КТ6114А	n-p-n	E-B-C	6114А
КТ503А	n-p-n	C-B-E	503А	КТ3102ВМ	n-p-n	C-B-E	3102ВМ	КТ6114Б	n-p-n	E-B-C	6114Б
КТ503Б	n-p-n	C-B-E	503Б	КТ3102ГМ	n-p-n	C-B-E	3102ГМ	КТ6114В	n-p-n	E-B-C	6114В
КТ503В	n-p-n	C-B-E	503В	КТ3102ДМ	n-p-n	C-B-E	3102ДМ	КТ6114Г	n-p-n	E-B-C	6114Г
КТ503Г	n-p-n	C-B-E	503Г	КТ3102ЕМ	n-p-n	C-B-E	3102ЕМ	КТ6114Д	n-p-n	E-B-C	6114Д
КТ503Д	n-p-n	C-B-E	503Д	КТ3102ЖМ	n-p-n	C-B-E	3102ЖМ	КТ6114Е	n-p-n	E-B-C	6114Е
КТ503Е	n-p-n	C-B-E	503Е	КТ3102ИМ	n-p-n	C-B-E	3102ИМ	КТ6115А	p-n-p	E-B-C	6115А
КП504А	n-MOS	S-D-G	504А	КТ3102КМ	n-p-n	C-B-E	3102КМ	КТ6115Б	p-n-p	E-B-C	6115Б
КП504Б	n-MOS	S-D-G	504Б	КТ3107А	p-n-p	C-B-E	3107А	КТ6115В	p-n-p	E-B-C	6115В
КП504В	n-MOS	S-D-G	504В	КТ3107А1	p-n-p	B-C-E	3107А1	КТ6115Г	p-n-p	E-B-C	6115Г
КП505А	n-MOS	S-D-G	505А	КТ3107Б	p-n-p	C-B-E	3107Б	КТ6115Д	p-n-p	E-B-C	6115Д
КП505Б	n-MOS	S-D-G	505Б	КТ3107Б1	p-n-p	B-C-E	3107Б1	КТ6115Е	p-n-p	E-B-C	6115Е
КП505В	n-MOS	S-D-G	505В	КТ3107В	p-n-p	C-B-E	3107В	КТ6116А	p-n-p	E-B-C	6116А
КП505Г	n-MOS	S-D-G	505Г	КТ3107В1	p-n-p	B-C-E	3107В1	КТ6116Б	p-n-p	E-B-C	6116Б
КП523А	n-MOS	S-D-G	505Г	КТ3107Г	p-n-p	C-B-E	3107Г	КТ6117А	n-p-n	E-B-C	6117А
КС515Г1	dz		515Г1	КТ3107Г1	p-n-p	B-C-E	3107Г1	КТ6117Б	n-p-n	E-B-C	6117Б
КС520В1	dz		520В1	КТ3107Д	p-n-p	C-B-E	3107Д	КТ6127А	p-n-p	C-B-E	6127А
КС531В1	dz		531В1	КТ3107Д1	p-n-p	B-C-E	3107Д1	КТ6127Б	p-n-p	C-B-E	6127Б
КТ632А1	p-n-p	C-B-E	632А1	КТ3107Е	p-n-p	C-B-E	3107Е	КТ6127В	p-n-p	C-B-E	6127В
КТ632Б1	p-n-p	C-B-E	632Б1	КТ3107Е1	p-n-p	B-C-E	3107Е1	КТ6127Г	p-n-p	C-B-E	6127Г
КТ632В1	p-n-p	C-B-E	632В1	КТ3107Ж	p-n-p	C-B-E	3107Ж	КТ6127Д	p-n-p	C-B-E	6127Д
КТ638А	n-p-n	C-B-E	638А	КТ3107Ж1	p-n-p	B-C-E	3107Ж1	КТ6127Е	p-n-p	C-B-E	6127Е
КТ638Б	n-p-n	C-B-E	638Б	КТ3107И	p-n-p	C-B-E	3107И	КТ6127Ж	p-n-p	C-B-E	6127Ж
КТ645А	n-p-n	C-B-E	645А	КТ3107И1	p-n-p	B-C-E	3107И1	КТ6127И	p-n-p	C-B-E	6127И
КТ645Б	n-p-n	C-B-E	645Б	КТ3107К	p-n-p	C-B-E	3107К	КТ6127К	p-n-p	C-B-E	6127К
КТ660А	n-p-n	C-B-E	660А	КТ3107К1	p-n-p	B-C-E	3107К1	КТ6128А	n-p-n	E-B-C	6128А
КТ660Б	n-p-n	C-B-E	660Б	КТ3107Л	p-n-p	C-B-E	3107Л	КТ6128Б	n-p-n	E-B-C	6128Б
КТ668А	p-n-p	C-B-E	668А	КТ3107Л1	p-n-p	B-C-E	3107Л1	КТ6128В	n-p-n	E-B-C	6128В
КТ668Б	p-n-p	C-B-E	668Б	КТ3117А1	n-p-n	C-B-E	3117	КТ6128Г	n-p-n	E-B-C	6128Г
КТ668В	p-n-p	C-B-E	668В	КТ3126А	p-n-p	C-B-E	3126А	КТ6128Д	n-p-n	E-B-C	6128Д
КТ680А	n-p-n	C-B-E	680А	КТ3126Б	p-n-p	C-B-E	3126Б	КТ6128Е	n-p-n	E-B-C	6128Е
КТ681А	p-n-p	C-B-E	681А	КТ3128А1	p-n-p	C-B-E	3128А1	КТ6133А	p-n-p	C-B-E	6133А
КТ684А	p-n-p	B-C-E	684А	КТ3128Б1	p-n-p	C-B-E	3128Б1	КТ6133Б	p-n-p	C-B-E	6133Б
КТ684Б	p-n-p	B-C-E	684Б	КТ3166А	n-p-n	C-B-E	3166А	КТ6133В	p-n-p	C-B-E	6133В
КТ684В	p-n-p	B-C-E	684В	КТ3166Б	n-p-n	C-B-E	3166Б	КТ6134А	n-p-n	C-B-E	6134А
КТ684Г	p-n-p	B-C-E	684Г	КТ3166В	n-p-n	C-B-E	3166В	КТ6134Б	n-p-n	C-B-E	6134Б
КТ685А	p-n-p	C-B-E	685А	КТ3166Г	n-p-n	C-B-E	3166Г	КТ6134В	n-p-n	C-B-E	6134В
КТ685Б	p-n-p	C-B-E	685Б	КТ6109А	p-n-p	E-B-C	6109А	КТ6135А	n-p-n	C-B-E	6135А
КТ685В	p-n-p	C-B-E	685В	КТ6109Б	p-n-p	E-B-C	6109Б	КТ6135Б	n-p-n	C-B-E	6135Б
КТ685Г	p-n-p	C-B-E	685Г	КТ6109В	p-n-p	E-B-C	6109В	КТ6135В	n-p-n	C-B-E	6135В
КТ685Д	p-n-p	C-B-E	685Д	КТ6109Г	p-n-p	E-B-C	6109Г	КТ6135Г	n-p-n	C-B-E	6135Г
КТ685Е	p-n-p	C-B-E	685Е	КТ6109Д	p-n-p	E-B-C	6109Д	КТ6136А	p-n-p	C-B-E	6136А
КТ685Ж	p-n-p	C-B-E	685Ж	КТ6110А	n-p-n	E-B-C	6110А	КТ6137А	n-p-n	C-B-E	6137А
КТ686А	p-n-p	C-B-E	686А	КТ6110Б	n-p-n	E-B-C	6110Б	КР1210ЕН1	ref	K-K-A	ЕН1
КТ686Б	p-n-p	C-B-E	686Б	КТ6110В	n-p-n	E-B-C	6110В				
КТ686В	p-n-p	C-B-E	686В	КТ6110Г	n-p-n	E-B-C	6110Г				

Цветовая четырехточечная маркировка

Использовалась до 1986 года. Почти все приборы, отмаркированные четырьмя цветными точками на срезе боковой поверхности корпуса, выпускались как в корпусе КТ-26 (**Рис. 18**), так и в корпусе КТП-4 (**Рис. 19**). Точки наносятся цветной эмалью типа ЭП140. Кодирование группы, месяца и года выпуска производится строго согласно цветовым рядам, приведенным в таблицах ниже. Также в последней таблице приведены все варианты данного класса маркировки (расшифровку колонки «Функция» см. в списке сокращений).



(М) Левая нижняя точка (месяц выпуска)

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Цвет	беж	син	зел	кра	сал	сер	кор	ора	эле	бел	жел	гол

(Г) Правая нижняя точка (год выпуска)

Год	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Цвет	беж	сал	ора	эле	бир	бел	кра	кор	зел	гол

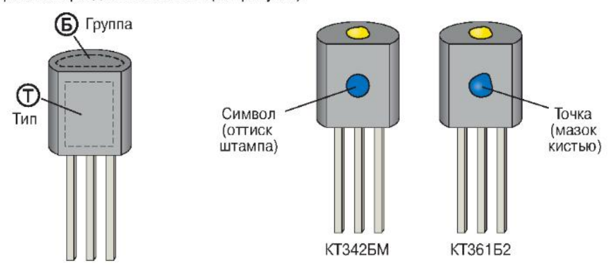
(Т) (Б) Варианты маркировки

(Т) Цвет левой верхней точки (тип)	Тип	Функция	1-2-3	(Б) Цвет правой верхней точки (буква группы): А роз	Б жел	В син	Г беж	Д ора	Е бел	Ж эле	И сал	К зел	Л кра	М сер
гол	КТ3107	p-n-p	С-В-Е	А	Б	В	Г	Д		Е	Ж	И	К	Л
кор	КТ326	p-n-p	С-В-Е	АМ	БМ									
кра	КТ337	p-n-p	С-В-Е	А	Б	В								
бел	КТ345	p-n-p	С-В-Е	А	Б	В								
син	КТ349	p-n-p	С-В-Е	А	Б	В								
сер	КТ350	p-n-p	С-В-Е	А										
жел	КТ351	p-n-p	С-В-Е	А	Б									
зел	КТ352	p-n-p	С-В-Е	А	Б									
роз	КТ363	p-n-p	С-В-Е	АМ	БМ									

(Т) (Б) (М) (Г)
С В Е
КТ337В
март, 1979

Символьно-цветовая маркировка

Основным признаком является наличие цветных геометрических символов на срезе боковой поверхности корпуса и отсутствие каких-либо букв/цифр. Тип прибора указывается на срезе боковой поверхности корпуса цветным геометрическим символом, группа — на торце корпуса цветными точками (см. рисунок). Различают два способа нанесения маркировки: в первом случае маркировка наносится с помощью накатки и занимает все поверхность от левого края до правого (первая таблица), а во втором случае символ наносится штампом (вторая таблица). Используемые в таблицах условные обозначения расшифрованы в списке сокращений. Следует различать символьную и двухточечную маркировку: кружок-символ наносится с помощью специального штампа и поэтому имеет четкую форму и «оттиснутый» вид, а точка наносится кистью и поэтому не имеет четкой формы, но заполняется краской гораздо более плотно (см. рисунок).



Символьно-цветовая маркировка накаткой

Т		Тип	Функция	1-2-3	Б Цвет точки на торце (буква группы): нет	кра	бел	зел	гол	2 бел	2 зел	2 кра	2 гол	бел+зел	бел+кра	бел+гол
Накатка на боковом срезе (тип)		КТ3102	n-p-n	С-В-Е		АМ	БМ	ЕМ	ДМ	ВМ		ГМ		ИМ	ЖМ	КМ
		КТ3107	p-n-p	С-В-Е		Ж	К	Б	А	Л	Е	И	В	Г	Д	
		КТ316	n-p-n	С-В-Е		АМ	БМ	ВМ	ГМ	ДМ						
		КТ3144	n-p-n	С-В-Е	А											
		КТ201	n-p-n	С-В-Е		АМ	БМ	ВМ	ГМ	ДМ						
		КТ399	n-p-n	С-В-Е		АМ	БМ	ВМ	ГМ							
		КР1064КТ1	btd	D-G-S		А	Б	В	Г							
		КЖ101	cld	I-C-O	А1											
		КС106	dz	C-B-E	А1											

Б, Т, С В Е, КТ3107А

Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-26 (ТО-92)

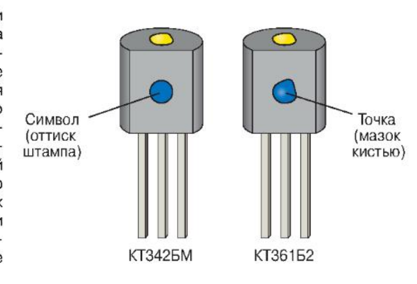
Символьно-цветовая маркировка геометрической фигурой

Ⓣ Метка на боковом срезе (тип)	Тип	Функция	1-2-3	Ⓑ Цвет точки на торце (буква группы): нет	бел	зел	кра	жел	син	2 бел	2 зел	2 кра	2 жел	2 син
бел	КТ645	n-p-n	C-B-E	А	Б									
зел	КТ645	n-p-n	C-B-E		И	Д	В	Г	Е	М	Л	К	Ж	
бел	КТ645	n-p-n	C-B-E	А	Б									
зел	КТ3126	p-n-p	C-B-E	А		Б								
син	КТ361	p-n-p	E-C-B	А3...*	А2	И2	Г3	Б2	Д2					
бел	КТ6109	p-n-p	E-B-C		А	Б	В	Г	Д					
зел	КТ6110	n-p-n	E-B-C		А	Б	В	Г	Д					
бел	КТ6114	n-p-n	E-B-C		А	Б	В			Г	Д	Е		
зел	КТ6115	p-n-p	E-B-C		А	Б	В			Г	Д	Е		
зел	КТ6116	p-n-p	E-B-C	А		Б								
бел	КТ6117	n-p-n	E-B-C	А	Б									
бел	КТ502	p-n-p	C-B-E		А	Б	В	Г	Д	Е				
зел	КТ503	n-p-n	C-B-E		А	Б	В	Г	Д	Е				
зел	КТ315	n-p-n	E-C-B		Е1	В1	А1	Б1	Г1	Р1	Н1	Ж1	Д1	И1
бел	КП365	n-FET	G-S-D	А	Б									
зел	КП501	n-MOS	G-D-S	А	Б	В								
бел	КТ6111	n-p-n	E-B-C			В	А	Б	Г					
бел	КТ3117	p-n-p	C-B-E	А1										
зен	КД130	d	A1-K-A2	AC										
зел	КД130 КВ134	d var	K1-A-K2 K1-A-K2	AC1 A1										
кра	КВС111	var	A1-K-A2		А	В		Г	Б	Д-2				
син	КТ660	n-p-n	C-B-E	А										
син	КТ660	n-p-n	C-B-E	Б										

*А3,В2, Д3, Е2, Ж2, К2, Л2, М2, Н2, Г2, П2

Цветовая двухточечная маркировка

Отличается наличием цветной точки на срезе боковой поверхности корпуса (капля краски, наносимая кистью вручную), кодирующей тип прибора; на торце корпуса цветной точкой указывается группа. Точки наносятся цветной эмалью типа ЭП140 по ГОСТ 24709-81. Кодирование группы производится согласно цветовому ряду, приведенному во второй строке таблицы с вариантами данного класса маркировки, хотя возможны как частичные нарушения этого ряда, так и полное пренебрежение ими. Расшифровку колонки «Функция» см. в списке сокращений.



Следует различать символьную и двухточечную маркировку: кружок-символ наносится с помощью специального штампа и поэтому имеет четкую форму и «оттиснутый» вид, а точка наносится кистью и поэтому не имеет четкой формы, но заполняется краской гораздо более плотно (см. рисунок).

Т — Цвет точки на боковом срезе (тип)	Тип	Функция	1-2-3	Б — Цвет точки на торце (буква группы): нет	роз	А т-кра	Б жел	В т-зел	Г гол	Д син	Е бел	Ж кор	И срб	К ора	Л таб	М сер
сер	КТ209	p-n-p	C-B-E			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К	Л	М
т-зел	КТ3102	n-p-n	C-B-E			АМ	БМ	ВМ	ГМ	ДМ	ЕМ	ЖМ			ИМ	КМ
таб	КП364	n-FET	G-D-S			А	Б	В	Г	Д	Е				И	
кор	КТ326	p-n-p	C-B-E		АМ		БМ									
т-кра	КТ203	p-n-p	C-B-E			АМ	БМ	ВМ								
кра	КТ6112	p-n-p	E-B-C			А	Б	В								
ора	КТ313 КТ638	p-n-p n-p-n	C-B-E C-B-E			А1 А	Б1 Б	В1	Г1							
жел	КТ502	p-n-p	C-B-E			А	Б	В	Г	Д	Е					
гол	КТ6111 КТ339	n-p-n n-p-n	E-B-C C-E-B	 А		А	Б	В		Г						
син	КТ342 КВ131	n-p-n var	C-B-E A-K	 А/А2		АМ	БМ	ВМ	ГМ	ДМ						
бел	КТ503	n-p-n	C-B-E			А	Б	В	Г	Д	Е					
срб	КТ632	p-n-p	C-B-E			А1	Б1	В1								

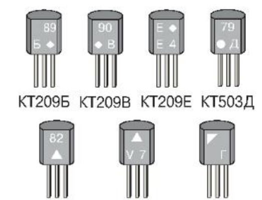
Б Т C B E КТ3102БМ

Символьно-буквенная маркировка

Основным признаком этой маркировки является сочетание геометрических символов, букв и цифр. Срез боковой поверхности корпуса делится на четыре информационных поля. До 1991 года встречались различные порядки использования информационных полей (см. рисунок).

В настоящее время используется следующий порядок: верхнее левое поле обозначает тип прибора (один геометрический символ, буква или цифра), верхнее правое поле — группу (одна буква), нижнее левое поле — год выпуска, нижнее правое — месяц выпуска (дата согласно ГОСТ 25486-82).

Варианты маркировки приведены в таблице.



КТ209Б КТ209В КТ209Е КТ503Д

КТ339АМ КТ339АМ КТ3102Г

(М) Левый нижний символ (год выпуска)

Символ	U	V	W	X	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M
Год	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000

(Г) Правый нижний символ (месяц выпуска)

Символ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D
Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

(Т) Маркировка типономинала

(Т) Накатка на боковом срезе (тип)	Тип	Функция	1-2-3	(Т) Накатка на боковом срезе (тип)	Тип	Функция	1-2-3
1	КТ632х1	p-n-p	C-B-E	⊔	КТ6127х	p-n-p	C-B-E
2	КТ638 КТ3102хМ	n-p-n n-p-n	C-B-E	С	КТ523х	p-n-p	C-B-E
3	КТ3102хМ2	n-p-n	E-C-B	Т	КТ3166х	n-p-n	D-G-S
4	КТ3102хМ2	n-p-n	E-C-B	┸	КТ313х1	p-n-p	I-C-O
7	КТ3107х2	p-n-p	B-C-E	●	КТ503х	n-p-n	C-B-E
I	КТ681А	p-n-p	C-B-E	◗	КТ502х	p-n-p	C-B-E
IA	КР1157ЕНхх02А	reg+	O-C-I	◤	КТ3102хМ	n-p-n	C-B-E
А	КР1157ЕНхх01А КП364х	reg+ n-FET	C-I-O B-C-E	◢	КТ203хМ	p-n-p	C-B-E
Б	КП361х	n-FET	G-D-S	◣	КТ3157А	p-n-p	C-E-B
В	КП307х1 КР1171СПхх	n-FET vd	G-D-S I-C-O	◥	КТ342хМ	n-p-n	C-B-E
Г	КР1170ЕНхх КТ680А	reg+ n-p-n	O-C-I O-C-I	◆	КТ209х1	p-n-p	C-B-E
┓	КТ680А3	n-p-n	C-B-E	▼	КТ3107х2 КТ326хМ	p-n-p p-n-p	C-B-E C-B-E
П	КТ517х КТ698х	n-p-n n-p-n	C-B-E C-B-E	▲	КТ339хМ	n-p-n	C-E-B

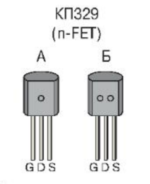
(Т) (Б) ◤ А Е 5 (Г) (М)
C B E
КТ3102АМ
май, 1994

(Т) (Б) ⊔ Б С 0 (Г) (М)
C B E
КТ6127Б
октябрь, 1992

Нестандартизируемая маркировка

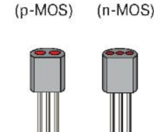
Включает приборы, маркировка которых не подпадает под вышеперечисленные классы. Многие из них приведены ниже.

КП329
(n-FET)



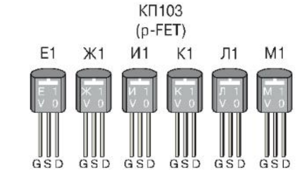
Одна или две цветные точки на корпусе (цвет не оговаривается)

КП402А (p-MOS) КП403А (n-MOS)



Две или три красных точки на торце корпуса

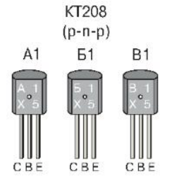
КП103
(p-FET)



Перевернутый Т-образный знак в верхней части среза боковой стороны и буква группы под ним

КТ208
(p-n-p)

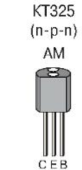
А1 Б1 В1



Маленький кружок в центре среза боковой стороны и буква группы

КТ325
(n-p-n)

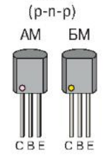
АМ



Две белых точки на торце корпуса, расположенные перпендикулярно срезу

КТ326
(p-n-p)

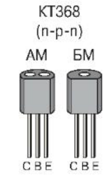
АМ БМ



Розовая или желтая точка у коллектора на срезе боковой стороны

КТ368
(n-p-n)

АМ БМ



Одна или две белые или красные точки на торце корпуса

КР1125КП2
(btd)

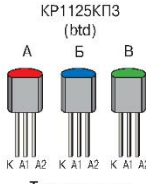
А



Белая точка на торце корпуса

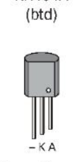
КР1125КП3
(btd)

А Б В



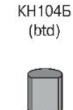
Торец корпуса закрашен красным, синим или зеленым

КН104А
(btd)



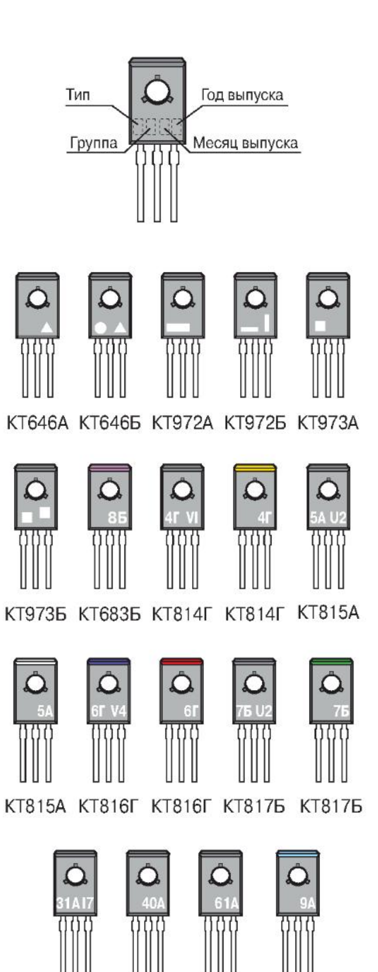
Точка (обычно белая) у анода, длинный вывод не используется, анодом может быть любой из коротких выводов

КН104Б
(btd)



Нет маркировки, длинный вывод не используется (неполярный прибор)

МАРКИРОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ П/П ПРИБОРОВ В КОРПУСЕ КТ-27 (ТО-126)



МАРКИРОВКА П/П КОМПОНЕТОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Назначение колонок в таблицах

Код — код, нанесенный на корпус. Сортировка по кодам задана с приоритетом цифр перед буквами, следовательно, код 618 расположен раньше, чем код 64S и 6A, а код A1 — после 9A. Бывают ситуации, когда совпадают код и тип корпуса, а приборы разные. Например, на корпусе типа SOT-323 нанесен код 6H. У фирмы «Philips» это *n-p-n*-транзистор типа BC818W, а у фирмы «Motorola» это *p-n-p*-транзистор типа MUN5131T1 с совершенно другими параметрами;

Типономинал — типономинал (полное название прибора);

Б — сокращенное название фирмы-производителя. Например, SIEM — фирма «Siemens», HP — «Hewlett-Packard» и т.д. Для расшифровки необходимо воспользоваться таблицей «Список фирм-производителей», помещенной в конце книги;

Ф — функциональное назначение прибора. Например, n-p-n-транзистор с указанной проводимостью, shd — диод Шоттки и т.д. Для расшифровки необходимо воспользоваться таблицей «Список обозначений функции прибора», помещенной в конце книги;

Особенности — особенности или основные электрические характеристики прибора. Для расшифровки необходимо воспользоваться таблицей «Список сокращений и условных обозначений», помещенной в конце книги;

Корпус — название корпуса (EIAJ, JEDEC....);

Ц/Цоколевка — цоколевка. Аббревиатуры выводов приводятся в порядке возрастания номеров выводов, начиная с первого. Нумерация выводов указана на корпусах в колонтитуле. Для расшифровки необходимо воспользоваться таблицей «Список сокращений и условных обозначений», помещенной в конце книги.

SOD66/91

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
11D	BYD11D	PHIL	byg	V_R < 200 В; I_F < 0.5 А; V_F(0.5 А) < 0.91 В; V_R > 225 В; I_R < 1 мкА; C_D = 14 пФ; t_{RR} = 3мкс	SOD-91	K • A
11G	BYD11G	PHIL	byg	V_R < 400 В; I_F < 0.5 А; V_F(0.5 А) < 0.91 В; V_R > 450 В; I_R < 1 мкА; C_D = 14 пФ; t_{RR} = 3мкс	SOD-91	K • A
11J	BYD11J	PHIL	byg	V_R < 600 В; I_F < 0.5 А; V_F(0.5 А) < 0.91 В; V_R > 650 В; I_R < 1 мкА; C_D = 14 пФ; t_{RR} = 3мкс	SOD-91	K • A
11K	BYD11K	PHIL	byg	V_R < 800 В; I_F < 0.5 А; V_F(0.5 А) < 0.91 В; V_R > 900 В; I_R < 1 мкА; C_D = 14 пФ; t_{RR} = 3мкс	SOD-91	K • A
11M	BYD11M	PHIL	byg	V_R < 1000 В; I_F < 0.5 А; V_F(0.5 А) < 0.91 В; V_R > 1100 В; I_R < 1 мкА; C_D = 14 пФ; t_{RR} = 3мкс	SOD-91	K • A
31D	BYD31D	PHIL	byg	V_R < 200 В; I_F < 0.44 А; V_F(0.5 А) < 1.35 В; V_R > 300 В; C_D = 9 пФ; t_{RR} < 250 нс	SOD-91	K • A
31G	BYD31G	PHIL	byg	V_R < 400 В; I_F < 0.44 А; V_F(0.5 А) < 1.35 В; V_R > 500 В; C_D = 9 пФ; t_{RR} < 250 нс	SOD-91	K • A
31J	BYD31J	PHIL	byg	V_R < 600 В; I_F < 0.44 А; V_F(0.5 А) < 1.35 В; V_R > 700 В; C_D = 9 пФ; t_{RR} < 250 нс	SOD-91	K • A
31K	BYD31K	PHIL	byg	V_R < 800 В; I_F < 0.44 А; V_F(0.5 А) < 1.35 В; V_R > 900 В; C_D = 8 пФ; t_{RR} < 300 нс	SOD-91	K • A
31M	BYD31M	PHIL	fid	V_R < 1000 В; I_F < 0.44 А; V_F(0.5 А) < 1.35 В; V_R > 1100 В; C_D = 8 пФ; t_{RR} < 300 нс	SOD-91	K • A
C10PH	BZV85-C10	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 25 мА) = 9.4...10.6 В; Z_{ZT} < 8 Ом	SOD-66	K • A
C11PH	BZV85-C11	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 20 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-66	K • A
C12PH	BZV85-C12	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 20 мА) = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-66	K • A
C13PH	BZV85-C13	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 20 мА) = 12.4...14.1 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-66	K • A
C15PH	BZV85-C15	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 15 мА) = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-66	K • A
C16PH	BZV85-C16	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 15 мА) = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-66	K • A
C18PH	BZV85-C18	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 15 мА) = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-66	K • A
C20PH	BZV85-C20	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} < 24 Ом	SOD-66	K • A
C22PH	BZV85-C22	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 20.8...23.3 В; Z_{ZT} < 25 Ом	SOD-66	K • A
C24PH	BZV85-C24	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 22.8...25.6 В; Z_{ZT} < 30 Ом	SOD-66	K • A
C27PH	BZV85-C27	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 8 мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-66	K • A
C30PH	BZV85-C30	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 8 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 45 Ом	SOD-66	K • A
C33PH	BZV85-C33	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 8 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 45 Ом	SOD-66	K • A
C36PH	BZV85-C36	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 8 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 50 Ом	SOD-66	K • A
C39PH	BZV85-C39	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 6 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-66	K • A
C3V6PH	BZV85-C3V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 60 мА) = 3.4...3.8 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-66	K • A
C3V9PH	BZV85-C3V9	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 60 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-66	K • A
C43PH	BZV85-C43	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 6 мА) = 40...46 В; Z_{ZT} < 75 Ом	SOD-66	K • A
C47PH	BZV85-C47	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 4 мА) = 44...50 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-66	K • A
C4V3PH	BZV85-C4V3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 50 мА) = 4.0...4.6 В; Z_{ZT} < 13 Ом	SOD-66	K • A
C4V7PH	BZV85-C4V7	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 45 мА) = 4.4...5.0 В; Z_{ZT} < 13 Ом	SOD-66	K • A
C51PH	BZV85-C51	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 4 мА) = 48...54 В; Z_{ZT} < 125 Ом	SOD-66	K • A
C56PH	BZV85-C56	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 4 мА) = 52...60 В; Z_{ZT} < 150 Ом	SOD-66	K • A
C5V1PH	BZV85-C5V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 45 мА) = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-66	K • A
C5V6PH	BZV85-C5V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 45 мА) = 5.2...6.0 В; Z_{ZT} < 7 Ом	SOD-66	K • A
C62PH	BZV85-C62	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 4 мА) = 58...66 В; Z_{ZT} < 175 Ом	SOD-66	K • A
C68PH	BZV85-C68	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 4 мА) = 64...72 В; Z_{ZT} < 200 Ом	SOD-66	K • A
C6V2PH	BZV85-C6V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 35 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} < 4 Ом	SOD-66	K • A
C6V8PH	BZV85-C6V8	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 35 мА) = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} < 3.5 Ом	SOD-66	K • A
C75PH	BZV85-C75	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 4 мА) = 70...80 В; Z_{ZT} < 225 Ом	SOD-66	K • A
C7V5PH	BZV85-C7V5	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 35 мА) = 7.0...7.9 В; Z_{ZT} < 3 Ом	SOD-66	K • A
C8V2PH	BZV85-C8V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 25 мА) = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} < 5 Ом	SOD-66	K • A
C9V1PH	BZV85-C9V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 25 мА) = 8.5...9.6 В; Z_{ZT} < 5 Ом	SOD-66	K • A
S11	BAS11	PHIL	dl	V_R < 300 В; I_F < 300 мА; V_F(I_F = 300 мА) < 1.0 В; C_D = 20 пФ; t_{RR} < 1мкс	SOD-91	K • A
S12	BAS12	PHIL	dl	V_R < 400 В; I_F < 300 мА; V_F(I_F = 300 мА) < 1.0 В; C_D = 20 пФ; t_{RR} < 1мкс	SOD-91	K • A

SOD110, DO214, SMA/B/C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
01C100PH	BZG01-C100	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.7 мА) = 94...106В; Z_{ZT} < 350 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C10PH	BZG01-C10	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 9.4...10.6 В; Z_{ZT} < 7 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C110PH	BZG01-C110	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.7 мА) = 104...116В; Z_{ZT} < 450 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C11PH	BZG01-C11	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} < 8 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C120PH	BZG01-C120	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 114...127В; Z_{ZT} < 550 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C12PH	BZG01-C12	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} < 9 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C130PH	BZG01-C130	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 124...141 В; Z_{ZT} < 700 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C13PH	BZG01-C13	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 12.4...14.1 В; Z_{ZT} < 10 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C150PH	BZG01-C150	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 138...156В; Z_{ZT} < 1000 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C15PH	BZG01-C15	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 15 мА) = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C160PH	BZG01-C160	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 1.5 мА) = 153...171 В; Z_{ZT} < 1100 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C16PH	BZG01-C16	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 15 мА) = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C180PH	BZG01-C180	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 1.5 мА) = 168...191 В; Z_{ZT} < 1200 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C18PH	BZG01-C18	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 15 мА) = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} < 20 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C200PH	BZG01-C200	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 1.5 мА) = 188...212В; Z_{ZT} < 1500 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C20PH	BZG01-C20	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} < 24 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C220PH	BZG01-C220	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 1 мА) = 208...233В; Z_{ZT} < 2250 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C22PH	BZG01-C22	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 20.8...23.3 В; Z_{ZT} < 25 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C240PH	BZG01-C240	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 1 мА) = 228...256В; Z_{ZT} < 2550 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C24PH	BZG01-C24	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 22.8...25.6 В; Z_{ZT} < 25 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C270PH	BZG01-C270	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 1 мА) = 251...289В; Z_{ZT} < 3000 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C27PH	BZG01-C27	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 8 мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C30PH	BZG01-C30	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 8 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C33PH	BZG01-C33	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 8 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 35 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C36PH	BZG01-C36	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 8 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 40 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C39PH	BZG01-C39	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 6 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 50 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C43PH	BZG01-C43	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 6 мА) = 40...46 В; Z_{ZT} < 50 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C47PH	BZG01-C47	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 44...50 В; Z_{ZT} < 90 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C51PH	BZG01-C51	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 48...54 В; Z_{ZT} < 115 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C56PH	BZG01-C56	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 52...60 В; Z_{ZT} < 120 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C62PH	BZG01-C62	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 58...66 В; Z_{ZT} < 125 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C68PH	BZG01-C68	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 64...72 В; Z_{ZT} < 130 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C75PH	BZG01-C75	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 70...79 В; Z_{ZT} < 135 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C82PH	BZG01-C82	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.7 мА) = 77...87 В; Z_{ZT} < 200 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
01C91PH	BZG01-C91	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.7 мА) = 85...96 В; Z_{ZT} < 250 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C100PH	BZG03-C100	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 94...106В; Z_{ZT} < 200 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C10PH	BZG03-C10	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 9.4...10.6 В; Z_{ZT} < 4 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C110PH	BZG03-C110	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 104...116В; Z_{ZT} < 250 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C11PH	BZG03-C11	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} < 7 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C120PH	BZG03-C120	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 114...127В; Z_{ZT} < 250 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C12PH	BZG03-C12	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} < 7 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C130PH	BZG03-C130	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 124...141 В; Z_{ZT} < 300 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C13PH	BZG03-C13	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 12.4...14.1 В; Z_{ZT} < 10 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C150PH	BZG03-C150	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 138...156В; Z_{ZT} < 300 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C15PH	BZG03-C15	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C160PH	BZG03-C160	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 153...171 В; Z_{ZT} < 350 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C16PH	BZG03-C16	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C180PH	BZG03-C180	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 168...191 В; Z_{ZT} < 400 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
03C18PH	BZG03-C18	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
03C200PH	BZG03-C200	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА) = 188...212 В; Z_{ZT} < 500 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C20PH	BZG03-C20	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=25$ мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C220PH	BZG03-C220	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА) = 208...233 В; Z_{ZT} < 750 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C22PH	BZG03-C22	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=25$ мА) = 20.8...23.3 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C240PH	BZG03-C240	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА) = 228...256 В; Z_{ZT} < 850 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C24PH	BZG03-C24	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=25$ мА) = 22.8...25.6 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C270PH	BZG03-C270	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА) = 251...289 В; Z_{ZT} < 1000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C27PH	BZG03-C27	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=25$ мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C30PH	BZG03-C30	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=25$ мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C33PH	BZG03-C33	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=25$ мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C36PH	BZG03-C36	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 40 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C39PH	BZG03-C39	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 40 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C43PH	BZG03-C43	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 40...46 В; Z_{ZT} < 45 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C47PH	BZG03-C47	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 44...50 В; Z_{ZT} < 45 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C51PH	BZG03-C51	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 48...54 В; Z_{ZT} < 60 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C56PH	BZG03-C56	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 52...60 В; Z_{ZT} < 60 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C62PH	BZG03-C62	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 58...66 В; Z_{ZT} < 80 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C68PH	BZG03-C68	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 64...72 В; Z_{ZT} < 80 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C75PH	BZG03-C75	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 70...79 В; Z_{ZT} < 100 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C82PH	BZG03-C82	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=10$ мА) = 77...87 В; Z_{ZT} < 100 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
03C91PH	BZG03-C91	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА) = 85...96 В; Z_{ZT} < 200 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
04100PH	BZG04-100	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5$ мА) = 114 В; V_{WM} = 167 В	DO-214AC, SMA	K•A
0410PH	BZG04-10	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=50$ мА) = 11.4 В; V_{WM} = 17 В	DO-214AC, SMA	K•A
04110PH	BZG04-110	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5$ мА) = 124 В; V_{WM} = 185 В	DO-214AC, SMA	K•A
0411PH	BZG04-11	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=50$ мА) = 12.4 В; V_{WM} = 18.9 В	DO-214AC, SMA	K•A
04120PH	BZG04-120	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5$ мА) = 138 В; V_{WM} = 204 В	DO-214AC, SMA	K•A
0412PH	BZG04-12	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=50$ мА) = 13.8 В; V_{WM} = 20.9 В	DO-214AC, SMA	K•A
04130PH	BZG04-130	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5$ мА) = 153 В; V_{WM} = 224 В	DO-214AC, SMA	K•A
0413PH	BZG04-13	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25$ мА) = 15.3 В; V_{WM} = 22.9 В	DO-214AC, SMA	K•A
04150PH	BZG04-150	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5$ мА) = 168 В; V_{WM} = 249 В	DO-214AC, SMA	K•A
0415PH	BZG04-15	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25$ мА) = 16.8 В; V_{WM} = 25.6 В	DO-214AC, SMA	K•A
04160PH	BZG04-160	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5$ мА) = 188 В; V_{WM} = 279 В	DO-214AC, SMA	K•A
0416PH	BZG04-16	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25$ мА) = 18.8 В; V_{WM} = 28.4 В	DO-214AC, SMA	K•A
04180PH	BZG04-180	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=2$ мА) = 208 В; V_{WM} = 305 В	DO-214AC, SMA	K•A
0418PH	BZG04-18	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25$ мА) = 20.8 В; V_{WM} = 31.0 В	DO-214AC, SMA	K•A
04200PH	BZG04-200	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=2$ мА) = 228 В; V_{WM} = 336 В	DO-214AC, SMA	K•A
0420PH	BZG04-20	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25$ мА) = 22.8 В; V_{WM} = 33.8 В	DO-214AC, SMA	K•A
04220PH	BZG04-220	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=2$ мА) = 251 В; V_{WM} = 380 В	DO-214AC, SMA	K•A
0422PH	BZG04-22	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25$ мА) = 25.1 В; V_{WM} = 38.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
0424PH	BZG04-24	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25$ мА) = 28 В; V_{WM} = 42.2 В	DO-214AC, SMA	K•A
0427PH	BZG04-27	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25$ мА) = 31 В; V_{WM} = 46.2 В	DO-214AC, SMA	K•A
0430PH	BZG04-30	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 34 В; V_{WM} = 50.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
0433PH	BZG04-33	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 37 В; V_{WM} = 54.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
0436PH	BZG04-36	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 40 В; V_{WM} = 60.7 В	DO-214AC, SMA	K•A
0439PH	BZG04-39	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 44 В; V_{WM} = 65.5 В	DO-214AC, SMA	K•A
0443PH	BZG04-43	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 48 В; V_{WM} = 70.8 В	DO-214AC, SMA	K•A
0447PH	BZG04-47	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 52 В; V_{WM} = 78.6 В	DO-214AC, SMA	K•A
0451PH	BZG04-51	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 58 В; V_{WM} = 86.5 В	DO-214AC, SMA	K•A
0456PH	BZG04-56	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 64 В; V_{WM} = 94.4 В	DO-214AC, SMA	K•A
0462PH	BZG04-62	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 70 В; V_{WM} = 103.5 В	DO-214AC, SMA	K•A
0468PH	BZG04-68	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10$ мА) = 77 В; V_{WM} = 114 В	DO-214AC, SMA	K•A
0475PH	BZG04-75	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5$ мА) = 85 В; V_{WM} = 126 В	DO-214AC, SMA	K•A
0482PH	BZG04-82	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5$ мА) = 94 В; V_{WM} = 139 В	DO-214AC, SMA	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
048V2PH	BZG04-8V2	PHIL	vs	V_{BR}(I_T = 50 мА) = 9.4 В; V_{WM} = 14.8 В	DO-214AC, SMA	К•А
0491PH	BZG04-91	PHIL	vs	V_{BR}(I_T = 5 мА) = 104 В; V_{WM} = 152 В	DO-214AC, SMA	К•А
049V1PH	BZG04-9V1	PHIL	vs	V_{BR}(I_T = 50 мА) = 10.4 В; V_{WM} = 15.7 В	DO-214AC, SMA	К•А
10	SML4740	GS	dz	V_Z (I_Z = 25.0 мА) = 10 В; Z_{ZT} = 7.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
10	U1ZB10	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 9.0...11.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
100	U1ZB100	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 3 мА) = 90...110 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 3 мА) < 300 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
100A	P6SMB100AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 95...105 В; V_{WM} = 137 В	DO-214AA, SMB	К•А
10A	1.5SMC10AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 9.5...10.5 В; V_{WM} = 8.55 В; I_{PP} = 103 А	DO-214AB, SMC	К•А
10A	P6SMB10AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 9.5...10.5 В; V_{WM} = 14.5 В	DO-214AA, SMB	К•А
11	SML4741	GS	dz	V_{ZZ} (I_Z = 23.0 мА) = 11 В; Z_{ZT} = 8.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
11	U1ZB11	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 9.9...12.1 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
110	U1ZB110	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 3 мА) = 99...121 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 3 мА) < 300 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
110A	P6SMB110AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 105...116 В; V_{WM} = 152 В	DO-214AA, SMB	К•А
11A	1.5SMC11AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 10.5...11.6 В; V_{WM} = 9.4 В; I_{PP} = 96 А	DO-214AB, SMC	К•А
11A	P6SMB11AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 10.5...11.6 В; V_{WM} = 15.6 В	DO-214AA, SMB	К•А
11C	P6SMB11CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 10.5...11.6 В; V_{WM} = 15.6 В	DO-214AA, SMB	x•x
12	SML4742	GS	dz	V_Z (I_Z = 21.0 мА) = 12 В; Z_{ZT} = 9.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
12	U1ZB12	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 10.8...13.2 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
120A	P6SMB120AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 114...126 В; V_{WM} = 165 В	DO-214AA, SMB	К•А
12A	1.5SMC12AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 11.4...12.6 В; V_{WM} = 10.2 В; I_{PP} = 90 А	DO-214AB, SMC	К•А
12A	P6SMB12AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 11.4...12.6 В; V_{WM} = 16.7 В	DO-214AA, SMB	К•А
12C	P6SMB12CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 11.4...12.6 В; V_{WM} = 16.7 В	DO-214AA, SMB	x•x
13	SML4743	GS	dz	V_Z (I_Z = 19.0 мА) = 13 В; Z_{ZT} = 10.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
13	U1ZB13	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 11.7...14.3 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
130A	P6SMB130AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 124...137 В; V_{WM} = 179 В	DO-214AA, SMB	К•А
13A	1.5SMC13AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.4...13.7 В; V_{WM} = 11.1 В; I_{PP} = 82 А	DO-214AB, SMC	К•А
13A	P6SMB13AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 12.4...13.7 В; V_{WM} = 18.2 В	DO-214AA, SMB	К•А
13C	P6SMB13CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 12.4...13.7 В; V_{WM} = 18.2 В	DO-214AA, SMB	x•x
15	SML4744	GS	dz	V_Z (I_Z = 17.0 мА) = 15 В; Z_{ZT} = 14.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
15	U1ZB15	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 13.5...16.5 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
150	U1ZB150	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 135...165 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2 мА) < 450 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
150A	P6SMB150AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 143...158 В; V_{WM} = 207 В	DO-214AA, SMB	К•А
15A	1.5SMC15AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.3...15.8 В; V_{WM} = 12.8 В; I_{PP} = 71 А	DO-214AB, SMC	К•А
15A	P6SMB15AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 14.3...15.8 В; V_{WM} = 21.2 В	DO-214AA, SMB	К•А
15C	P6SMB15CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 14.3...15.8 В; V_{WM} = 21.2 В	DO-214AA, SMB	x•x
16	SML4745	GS	dz	V_Z (I_Z = 15.5 мА) = 16 В; Z_{ZT} = 16.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
16	U1ZB16	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 14.4...17.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
160A	P6SMB160AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 152...168 В; V_{WM} = 219 В	DO-214AA, SMB	К•А
16A	1.5SMC16AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.2...16.8 В; V_{WM} = 13.6 В; I_{PP} = 67 А	DO-214AB, SMC	К•А
16A	P6SMB16AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 15.2...16.8 В; V_{WM} = 22.5 В	DO-214AA, SMB	К•А
16C	P6SMB16CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 15.2...16.8 В; V_{WM} = 22.5 В	DO-214AA, SMB	x•x
170A	P6SMB170AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 162...179 В; V_{WM} = 234 В	DO-214AA, SMB	К•А
18	SML4746	GS	dz	V_Z (I_Z = 14.0 мА) = 18 В; Z_{ZT} = 20.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
18	U1ZB18	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 16.2...19.8 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
180	U1ZB180	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 1.5 мА) = 162...198 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 1.5 мА) < 500 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
180A	P6SMB180AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 171...189 В; V_{WM} = 246 В	DO-214AA, SMB	К•А
18A	1.5SMC18AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.1...18.9 В; V_{WM} = 15.3 В; I_{PP} = 59.5 А	DO-214AB, SMC	К•А
18A	P6SMB18AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 17.1...18.9 В; V_{WM} = 25.2 В	DO-214AA, SMB	К•А
18C	P6SMB18CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 17.1...18.9 В; V_{WM} = 25.2 В	DO-214AA, SMB	x•x
1C	10BQ015	IR	shd	V_R < 15 В; VF < 0.32 В; I_F < 1 А	DO-214AA, SMB	К•А
1F	10BQ040	IR	shd	V_R < 40 В; VF < 0.49 В; I_F < 1 А	DO-214AA, SMB	К•А
1F	10MQ040N	IR	shd	V_R < 40 В; VF < 0.51 В; I_F < 1.1 А	DO-214AC, SMA	К•А
1J	10BQ100	IR	shd	V_R < 100 В; VF < 0.62 В; I_F < 1 А	DO-214AA, SMB	К•А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
1J	10MQ100N	IR	shd	V_R < 100 В; VF < 0.68 В; I_F < 2.1 А	DO-214AC, SMA	K•A
1P	10BF10	IR	shd	V_R < 100 В; V_F < 0.95 В; I_F < 1 А; I_R < 100 мкА; t_{RR} = 35 нс	DO-214AA, SMB	K•A
1P	10BF40	IR	shd	V_R < 400 В; V_F < 1.4 В; I_F < 1 А; I_R < 100 мкА; t_{RR} = 50 нс	DO-214AA, SMB	K•A
1S	10BF20	IR	shd	V_R < 200 В; V_F < 0.95 В; I_F < 1 А; I_R < 100 мкА; t_{RR} = 35 нс	DO-214AA, SMB	K•A
1U	10BF60	IR	shd	V_R < 600 В; V_F < 1.7 В; I_F < 1 А; I_R < 100 мкА; t_{RR} = 100 нс	DO-214AA, SMB	K•A
1V	10BF80	IR	shd	V_R < 800 В; V_F < 1.7 В; I_F < 1 А; I_R < 100 мкА; t_{RR} = 100 нс	DO-214AA, SMB	K•A
1X	10BF100	IR	shd	V_R < 1000 В; V_F < 1.7 В; I_F < 1 А; I_R < 100 мкА; t_{RR} = 100 нс	DO-214AA, SMB	K•A
20	SML4747	GS	dz	V_Z (Z = 12.5 мА) = 20 В; Z_{ZT} = 22.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
20	U1ZB20	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 18.0...22.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
200	U1ZB200	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 180...220 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
200A	P6SMB200AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 190...210 В; V_{WM} = 274 В	DO-214AA, SMB	K•A
200Y	U1ZB200-Y	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 190...210 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
200Z	U1ZB200-Z	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 200...220 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
20A	1.5SMC20AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 19...21 В; V_{WM} = 17.1 В; I_{PP} = 54 А	DO-214AB, SMC	K•A
20A	P6SMB20AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 19...21 В; V_{WM} = 27.7 В	DO-214AA, SMB	K•A
20C	P6SMB20CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 19...21 В; V_{WM} = 27.7 В	DO-214AA, SMB	x•x
22	SML4748	GS	dz	V_Z (I_Z = 11.5 мА) = 22 В; Z_{ZT} = 23.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
22	U1ZB22	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 19.8...24.2 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
220	U1ZB220	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 198...242 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
220Y	U1ZB220-Y	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 210...230 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
220Z	U1ZB220-Z	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 220...240 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
22A	1.5SMC22AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20.9...23.1 В; V_{WM} = 18.8 В; I_{PP} = 49 А	DO-214AB, SMC	K•A
22A	P6SMB22AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 20.9...23.1 В; V_{WM} = 30.6 В	DO-214AA, SMB	K•A
22C	P6SMB22CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 20.9...23.1 В; V_{WM} = 30.6 В	DO-214AA, SMB	x•x
24	SML4749	GS	dz	V_Z (I_Z = 10.5 мА) = 24 В; Z_{ZT} = 25.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
24	U1ZB24	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 21.6...26.4 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
240	U1ZB240	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 216...264 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
240Y	U1ZB240-Y	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 230...250 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
240Z	U1ZB240-Z	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 240...260 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
24A	1.5SMC24AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 22.8...25.2 В; V_{WM} = 20.5 В; I_{PP} = 45 А	DO-214AB, SMC	K•A
24A	P6SMB24AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 22.8...25.2 В; V_{WM} = 33.2 В	DO-214AA, SMB	K•A
24C	P6SMB24CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 22.8...25.2 В; V_{WM} = 33.2 В	DO-214AA, SMB	x•x
27	SML4750	GS	dz	V_Z (I_Z = 9.5 мА) = 27 В; Z_{ZT} = 35.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
27	U1ZB27	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 24.3...29.7 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
270	U1ZB270	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 243...297 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
270X	U1ZB270-X	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 250...270 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
270Y	U1ZB270-Y	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 260...280 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
270Z	U1ZB270-Z	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 270...290 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
27A	1.5SMC27AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 25.7...28.4 В; V_{WM} = 23.1 В; I_{PP} = 40 А	DO-214AB, SMC	K•A
27A	P6SMB27AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 25.7...28.4 В; V_{WM} = 37.5 В	DO-214AA, SMB	K•A
27C	P6SMB27CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 25.7...28.4 В; V_{WM} = 37.5 В	DO-214AA, SMB	x•x
30	SML4751	GS	dz	V_Z (I_Z = 8.5 мА) = 30 В; Z_{ZT} = 40.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
30	U1ZB30	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 27.0...33.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
300	U1ZB300	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 270...330 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
300X	U1ZB300-X	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 280...300 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
300Y	U1ZB300-Y	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 290...310 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
300Z	U1ZB300-Z	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 300...320 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
30A	1.5SMC30AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.5...31.5 В; V_{WM} = 25.6 В; I_{PP} = 36 А	DO-214AB, SMC	K•A
30A	P6SMB30AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 28.5...31.5 В; V_{WM} = 41.4 В	DO-214AA, SMB	K•A
30C	P6SMB30CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 28.5...31.5 В; V_{WM} = 41.4 В	DO-214AA, SMB	x•x
33	SML4752	GS	dz	V_Z (I_Z = 7.5 мА) = 33 В; Z_{ZT} = 45.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
33	U1ZB33	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 29.7...36.3 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
330	U1ZB330	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 297...363 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
330X	U1ZB330-X	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 310...330 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
330Y	U1ZB330-Y	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 320...340 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
330Z	U1ZB330-Z	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 330...350 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 5000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
33A	1.5SMC33AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 31.4...34.7 В; V_{WM} = 28.2 В; I_{PP} = 33 A	DO-214AB, SMC	K•A
33A	P6SMB33AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 31.4...34.7 В; V_{WM} = 45.7 В	DO-214AA, SMB	K•A
33C	P6SMB33CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 31.4...34.7 В; V_{WM} = 45.7 В	DO-214AA, SMB	x•x
36	SML4753	GS	dz	V_Z (I_Z = 7.0 мА) = 36 В; Z_{ZT} = 50.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
36	U1ZB36	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 9 мА) = 32.4...39.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 9 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
36A	1.5SMC36AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 34.2...37.8 В; V_{WM} = 30.8 В; I_{PP} = 30 A	DO-214AB, SMC	K•A
36A	P6SMB36AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 34.2...37.8 В; V_{WM} = 49.9 В	DO-214AA, SMB	K•A
36C	P6SMB36CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 34.2...37.8 В; V_{WM} = 49.9 В	DO-214AA, SMB	x•x
39	SML4754	GS	dz	V_Z (I_Z = 6.5 мА) = 39 В; Z_{ZT} = 60.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
390	U1ZB390	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 351...429 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 10000 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
39A	1.5SMC39AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 37.1...41 В; V_{WM} = 33.3 В; I_{PP} = 28 A	DO-214AB, SMC	K•A
39A	P6SMB39AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 37.1...41.0 В; V_{WM} = 53.9 В	DO-214AA, SMB	K•A
39C	P6SMB39CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 37.1...41.0 В; V_{WM} = 53.9 В	DO-214AA, SMB	x•x
3C	30BQ015	IR	shd	V_R = 15 В; V_F < 0.3 В; I_F = 3 A	DO-214AB, SMC	K•A
3F	15MQ40N	IR	shd	V_R < 40 В; VF < 0.43 В; I_F < 3 A	DO-214AC, SMA	K•A
3F	30BQ040	IR	shd	V_R = 40 В; V_F < 0.43 В; I_F = 3 A	DO-214AB, SMC	K•A
3H	30BQ060	IR	shd	V_R = 60 В; V_F < 0.52 В; I_F = 3 A	DO-214AB, SMC	K•A
3J	30BQ100	IR	shd	V_R = 100 В; V_F < 0.62 В; I_F = 3 A	DO-214AB, SMC	K•A
43	SML4755	GS	dz	V_Z (I_Z = 6.0 мА) = 43 В; Z_{ZT} = 70.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
43	U1ZB43	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 7 мА) = 38.7...47.3 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 7 мА) < 40 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
43A	1.5SMC43AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 40.9...45.2 В; V_{WM} = 36.8 В; I_{PP} = 25.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
43A	P6SMB43AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 40.9...45.2 В; V_{WM} = 59.3 В	DO-214AA, SMB	K•A
43C	P6SMB43CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 40.9...45.2 В; V_{WM} = 59.3 В	DO-214AA, SMB	x•x
47	SML4756	GS	dz	V_Z (I_Z = 5.5 мА) = 47 В; Z_{ZT} = 80.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
47	U1ZB47	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 6 мА) = 42.3...51.7 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 6 мА) < 65 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
47A	1.5SMC47AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 44.7...49.4 В; V_{WM} = 40.2 В; I_{PP} = 23.2 A	DO-214AB, SMC	K•A
47A	P6SMB47AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 44.7...49.4 В; V_{WM} = 64.8 В	DO-214AA, SMB	K•A
47C	P6SMB47CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 44.7...49.4 В; V_{WM} = 64.8 В	DO-214AA, SMB	x•x
51	SML4757	GS	dz	V_Z (I_Z = 5.0 мА) = 51 В; Z_{ZT} = 95.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
51	U1ZB51	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 6 мА) = 45.9...56.1 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 6 мА) < 65 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
51A	1.5SMC51AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 48.5...53.6 В; V_{WM} = 43.6 В; I_{PP} = 21.4 A	DO-214AB, SMC	K•A
51A	P6SMB51AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 48.5...53.6 В; V_{WM} = 70.1 В	DO-214AA, SMB	K•A
51C	P6SMB51CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 48.5...53.6 В; V_{WM} = 70.1 В	DO-214AA, SMB	x•x
56	SML4758	GS	dz	V_Z (Z = 4.5 мА) = 56 В; Z_{ZT} = 110.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
56A	1.5SMC56AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.2...58.8 В; V_{WM} = 47.8 В; I_{PP} = 19.5 A	DO-214AB, SMC	K•A
56A	P6SMB56AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 53.2...58.8 В; V_{WM} = 77 В	DO-214AA, SMB	K•A
56C	P6SMB56CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 53.2...58.8 В; V_{WM} = 77 В	DO-214AA, SMB	x•x
6.8	U1ZB6.8	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 6.2...7.4 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 60 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
62	SML4759	GS	dz	V_Z (I_Z = 4.0 мА) = 62 В; Z_{ZT} = 125.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
62A	1.5SMC62AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 58.9...65.1 В; V_{WM} = 53 В; I_{PP} = 17.7 A	DO-214AB, SMC	K•A
62A	P6SMB62AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 58.9...65.1 В; V_{WM} = 85 В	DO-214AA, SMB	K•A
62C	P6SMB62CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 58.9...65.1 В; V_{WM} = 85 В	DO-214AA, SMB	x•x
68	SML4760	GS	dz	V_Z (I_Z = 3.7 мА) = 68 В; Z_{ZT} = 150.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
68	U1ZB68	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 61.2...74.8 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 4 мА) < 120 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
68A	1.5SMC68AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.6...71.4 В; V_{WM} = 58.1 В; I_{PP} = 16.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
68A	P6SMB68AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 64.6...71.4 В; V_{WM} = 92 В	DO-214AA, SMB	K•A
68C	P6SMB68CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 64.6...71.4 В; V_{WM} = 92 В	DO-214AA, SMB	x•x
6P2	SML4735	GS	dz	V_Z (I_Z = 41.0 мА) = 6.2 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
6P8	SML4736	GS	dz	V_Z (I_Z = 37.0 мА) = 6.8 В; Z_{ZT} = 3.5 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
6V8A	1.5SMC6.8AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.45...7.14 В; V_{WM} = 5.8 В; I_{PP} = 143 A	DO-214AB, SMC	K•A

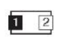
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
6V8A	P6SMB6.8AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10 мА) = 6.45...7.14 В; V_{WM} = 10.5 В	DO-214AA, SMB	K • A
7.5	U1ZB7.5	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 6.8...8.3 В; Z_{ZT}(I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
75	SML4761	GS	dz	V_Z(I_Z = 3.3 мА) = 75 В; Z_{ZT} = 175.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
75	U1ZB75	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT} = 4 мА) = 67.5...82.5 В; Z_{ZT}(I_{ZT} = 4 мА) < 150 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
75A	1.5SMC75AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 71.3...78.8 В; V_{WM} = 64.1 В; I_{PP} = 14.6 A	DO-214AB, SMC	K • A
75A	P6SMB75AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 71.3...78.8 В; V_{WM} = 103 В	DO-214AA, SMB	K • A
75C	P6SMB75CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 71.3...78.8 В; V_{WM} = 103 В	DO-214AA, SMB	x • x
7P5	SML4737	GS	dz	V_Z(I_Z = 34.0 мА) = 7.5 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
7V5A	1.5SMC7.5AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.13...7.88 В; V_{WM} = 6.4 В; I_{PP} = 132 A	DO-214AB, SMC	K • A
7V5A	P6SMB7.5AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10 мА) = 7.13...7.88 В; V_{WM} = 11.3 В	DO-214AA, SMB	K • A
8.2	U1ZB8.2	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 7.4...9.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
813B	1SMA5913BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 113.6 мА) = 3.3 В; Z_{ZT} = 10.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
814B	1SMA5914BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 104.2 мА) = 3.6 В; Z_{ZT} = 9.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
815B	1SMA5915BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 96.1 мА) = 3.9 В; Z_{ZT} = 7.5 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
816B	1SMA5916BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 87.2 мА) = 4.3 В; Z_{ZT} = 6.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
817B	1SMA5917BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 79.8 мА) = 4.7 В; Z_{ZT} = 5.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
818B	1SMA5918BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 73.5 мА) = 5.1 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
819B	1SMA5919BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 66.9 мА) = 5.6 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
82	SML4762	GS	dz	V_Z(I_Z = 3.0 мА) = 82 В; Z_{ZT} = 200.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
82	U1ZB82	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT} = 3 мА) = 73.8...90.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT} = 3 мА) < 170 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
820B	1SMA5920BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 60.5 мА) = 6.2 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
821B	1SMA5921BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 55.1 мА) = 6.8 В; Z_{ZT} = 2.5 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
822B	1SMA5922BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 50.0 мА) = 7.5 В; Z_{ZT} = 3.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
823B	1SMA5923BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 45.7 мА) = 8.2 В; Z_{ZT} = 3.5 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
824B	1SMA5924BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 41.2 мА) = 9.1 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
825B	1SMA5925BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 37.5 мА) = 10 В; Z_{ZT} = 4.5 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
826B	1SMA5926BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 34.1 мА) = 11 В; Z_{ZT} = 5.5 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
827B	1SMA5927BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 31.2 мА) = 12 В; Z_{ZT} = 6.5 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
828B	1SMA5928BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 28.8 мА) = 13 В; Z_{ZT} = 7.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
829B	1SMA5929BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 25.0 мА) = 15 В; Z_{ZT} = 9.0 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
82A	1.5SMC82AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 77.9...86.1 В; V_{WM} = 70.1 В; I_{PP} = 13.3 A	DO-214AB, SMC	K • A
82A	P6SMB82AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 77.9...86.1 В; V_{WM} = 113 В	DO-214AA, SMB	K • A
82C	P6SMB82CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1 мА) = 77.9...86.1 В; V_{WM} = 113 В	DO-214AA, SMB	x • x
830B	1SMA5930BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 23.4 мА) = 16 В; Z_{ZT} = 10 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
831B	1SMA5931BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 20.8 мА) = 18 В; Z_{ZT} = 12 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
832B	1SMA5932BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 18.7 мА) = 20 В; Z_{ZT} = 14 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
833B	1SMA5933BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 17.0 мА) = 22 В; Z_{ZT} = 17.5 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
834B	1SMA5934BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 15.6 мА) = 24 В; Z_{ZT} = 19 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
835B	1SMA5935BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 13.9 мА) = 27 В; Z_{ZT} = 23 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
836B	1SMA5936BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 12.5 мА) = 30 В; Z_{ZT} = 26 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
837B	1SMA5937BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 11.4 мА) = 33 В; Z_{ZT} = 33 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
838B	1SMA5938BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 10.4 мА) = 36 В; Z_{ZT} = 38 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
839B	1SMA5939BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 9.6 мА) = 39 В; Z_{ZT} = 45 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
840B	1SMA5940BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 8.7 мА) = 43 В; Z_{ZT} = 53 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
841B	1SMA5941BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 8.0 мА) = 47 В; Z_{ZT} = 67 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
842B	1SMA5942BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 7.3 мА) = 51 В; Z_{ZT} = 70 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
843B	1SMA5943BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 6.7 мА) = 56 В; Z_{ZT} = 86 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
844B	1SMA5944BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 6.0 мА) = 62 В; Z_{ZT} = 100 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
845B	1SMA5945BT3	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5.5 мА) = 68 В; Z_{ZT} = 120 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
8P2	SML4738	GS	dz	V_Z(I_Z = 31.0 мА) = 8.2 В; Z_{ZT} = 4.5 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
8V2A	1.5SMC8.2AT3	MOT	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.79...8.61 В; V_{WM} = 7.02 В; I_{PP} = 124 A	DO-214AB, SMC	K • A
8V2A	P6SMB8.2AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10 мА) = 7.79...8.61 В; V_{WM} = 12.1 В	DO-214AA, SMB	K • A
9.1	U1ZB9.1	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 8.2...10.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AC, SMA	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
91	SML4763	GS	dz	V_Z (I_Z = 2.0 мА) = 91 В; Z_{ZT} = 250.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
913B	1SMB5913BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 113.6 мА) = 3.3 В; Z_{ZT} = 10.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
914B	1SMB5914BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 104.2 мА) = 3.6 В; Z_{ZT} = 9.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
915B	1SMB5915BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 96.1 мА) = 3.9 В; Z_{ZT} = 7.5 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
916B	1SMB5916BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 87.2 мА) = 4.3 В; Z_{ZT} = 6.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
917B	1SMB5917BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 79.8 мА) = 4.7 В; Z_{ZT} = 5.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
918B	1SMB5918BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 73.5 мА) = 5.1 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
919B	1SMB5919BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 66.9 мА) = 5.6 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
91A	1.5SMC91AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.5...95.5 В; V_{WM} = 77.8 В; I_{PP} = 12 А	DO-214AB, SMC	K•A
91A	P6SMB91AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 86.5...95.5 В; V_{WM} = 125 В	DO-214AA, SMB	K•A
91C	P6SMB91CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 86.5...95.5 В; V_{WM} = 125 В	DO-214AA, SMB	x•x
920B	1SMB5920BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 60.5 мА) = 6.2 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
921B	1SMB5921BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 55.1 мА) = 6.8 В; Z_{ZT} = 2.5 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
922B	1SMB5922BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50.0 мА) = 7.5 В; Z_{ZT} = 3.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
923B	1SMB5923BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 45.7 мА) = 8.2 В; Z_{ZT} = 3.5 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
924B	1SMB5924BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 41.2 мА) = 9.1 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
925B	1SMB5925BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 37.5 мА) = 10 В; Z_{ZT} = 4.5 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
926B	1SMB5926BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 34.1 мА) = 11 В; Z_{ZT} = 5.5 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
927B	1SMB5927BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 31.2 мА) = 12 В; Z_{ZT} = 6.5 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
928B	1SMB5928BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 28.8 мА) = 13 В; Z_{ZT} = 7.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
929B	1SMB5929BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 25.0 мА) = 15 В; Z_{ZT} = 9.0 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
930B	1SMB5930BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 23.4 мА) = 16 В; Z_{ZT} = 10 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
931B	1SMB5931BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20.8 мА) = 18 В; Z_{ZT} = 12 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
932B	1SMB5932BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 18.7 мА) = 20 В; Z_{ZT} = 14 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
933B	1SMB5933BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 17.0 мА) = 22 В; Z_{ZT} = 17.5 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
934B	1SMB5934BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 15.6 мА) = 24 В; Z_{ZT} = 19 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
935B	1SMB5935BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 13.9 мА) = 27 В; Z_{ZT} = 23 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
936B	1SMB5936BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 12.5 мА) = 30 В; Z_{ZT} = 28 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
937B	1SMB5937BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 11.4 мА) = 33 В; Z_{ZT} = 33 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
938B	1SMB5938BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 10.4 мА) = 36 В; Z_{ZT} = 38 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
939B	1SMB5939BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 9.6 мА) = 39 В; Z_{ZT} = 45 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
940B	1SMB5940BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 8.7 мА) = 43 В; Z_{ZT} = 53 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
941B	1SMB5941BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 8.0 мА) = 47 В; Z_{ZT} = 67 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
942B	1SMB5942BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 7.3 мА) = 51 В; Z_{ZT} = 70 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
943B	1SMB5943BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 6.7 мА) = 56 В; Z_{ZT} = 86 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
944B	1SMB5944BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 6.0 мА) = 62 В; Z_{ZT} = 100 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
945B	1SMB5945BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.5 мА) = 68 В; Z_{ZT} = 120 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
946B	1SMB5946BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 75 В; Z_{ZT} = 140 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
947B	1SMB5947BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 4.6 мА) = 82 В; Z_{ZT} = 160 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
948B	1SMB5948BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 4.1 мА) = 91 В; Z_{ZT} = 200 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
949B	1SMB5949BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 3.7 мА) = 100 В; Z_{ZT} = 250 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
950B	1SMB5950BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 3.4 мА) = 110 В; Z_{ZT} = 300 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
951B	1SMB5951BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 3.1 мА) = 120 В; Z_{ZT} = 380 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
952B	1SMB5952BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.9 мА) = 130 В; Z_{ZT} = 450 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
953B	1SMB5953BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.5 мА) = 150 В; Z_{ZT} = 600 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
954B	1SMB5954BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.3 мА) = 160 В; Z_{ZT} = 700 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
955B	1SMB5955BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.1 мА) = 180 В; Z_{ZT} = 900 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
956B	1SMB5956BT3	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 1.9 мА) = 200 В; Z_{ZT} = 1200 Ом	DO-214AA, SMB	K•A
9P1	SML4739	GS	dz	V_Z (I_Z = 28.0 мА) = 9.1 В; Z_{ZT} = 5.0 Ом	DO-214AC, SMA	K•A
9V1A	1.5SMC9.1AT3	MOT	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 8.65...9.55 В; V_{WM} = 7.78 В; I_{PP} = 112 А	DO-214AB, SMC	K•A
9V1A	P6SMB9.1AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1 мА) = 8.65...9.55 В; V_{WM} = 13.4 В	DO-214AA, SMB	K•A
A6	BAS216	PHIL	di	V_R < 75 В; I_F < 250 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 50 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOD-110	K•A



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
AD	SMBJ5.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.55 В; V_{WM} = 5.0 В; I_{PP} = 62.5 А	DO-214AA, SMB	x • x
ADP	TPSMA6.8	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.12...7.48 В; V_{WM} = 5.50 В; I_{PP} = 37.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
AE	SMBJ5.0CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.23 В; V_{WM} = 5.0 В; I_{PP} = 65.2 А	DO-214AA, SMB	x • x
AEP	TPSMA6.8A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.45...7.14 В; V_{WM} = 5.80 В; I_{PP} = 38.1 А	DO-214AC, SMA	K • A
AF	SMBJ6.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.67...8.45 В; V_{WM} = 6.0 В; I_{PP} = 52.6 А	DO-214AA, SMB	x • x
AFP	TPSMA7.5	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.75...8.25 В; V_{WM} = 6.05 В; I_{PP} = 34.2 А	DO-214AC, SMA	K • A
AG	SMBJ6.0CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.67 В; V_{WM} = 6.0 В; I_{PP} = 58.3 А	DO-214AA, SMB	x • x
AGP	TPSMA7.5A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.13...7.88 В; V_{WM} = 6.40 В; I_{PP} = 35.4 А	DO-214AC, SMA	K • A
AH	SMBJ6.5C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.22...9.14 В; V_{WM} = 6.5 В; I_{PP} = 48.7 А	DO-214AA, SMB	x • x
AHP	TPSMA8.2	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.38...9.02 В; V_{WM} = 6.63 В; I_{PP} = 32.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
AK	SMBJ6.5CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.22...8.30 В; V_{WM} = 6.5 В; I_{PP} = 53.6 А	DO-214AA, SMB	x • x
AKP	TPSMA8.2A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.79...8.61 В; V_{WM} = 7.02 В; I_{PP} = 33.1 А	DO-214AC, SMA	K • A
AL	SMBJ7.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.78...9.86 В; V_{WM} = 7.0 В; I_{PP} = 45.1 А	DO-214AA, SMB	x • x
ALP	TPSMA9.1	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.19...10.00 В; V_{WM} = 7.37 В; I_{PP} = 29.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
AM	SMBJ7.0CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.78...8.95 В; V_{WM} = 7.0 В; I_{PP} = 50.0 А	DO-214AA, SMB	x • x
AMP	TPSMA9.1A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.65...9.55 В; V_{WM} = 7.78 В; I_{PP} = 29.9 А	DO-214AC, SMA	K • A
AN	SMBJ7.5C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...10.80 В; V_{WM} = 7.5 В; I_{PP} = 42.0 А	DO-214AA, SMB	x • x
ANP	TPSMA10	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.00...11.00 В; V_{WM} = 8.10 В; I_{PP} = 26.7 А	DO-214AC, SMA	K • A
AP	SMBJ7.5CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.58 В; V_{WM} = 7.5 В; I_{PP} = 46.5 А	DO-214AA, SMB	x • x
APP	TPSMA10A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.50...10.50 В; V_{WM} = 8.65 В; I_{PP} = 27.6 А	DO-214AC, SMA	K • A
AQ	SMBJ8.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...11.30 В; V_{WM} = 8.0 В; I_{PP} = 40.0 А	DO-214AA, SMB	x • x
AQP	TPSMA11	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.90...12.10 В; V_{WM} = 8.92 В; I_{PP} = 24.7 А	DO-214AC, SMA	K • A
AR	SMBJ8.0CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...10.23 В; V_{WM} = 8.0 В; I_{PP} = 44.1 А	DO-214AA, SMB	x • x
ARP	TPSMA11A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.50...11.60 В; V_{WM} = 9.40 В; I_{PP} = 25.6 А	DO-214AC, SMA	K • A
AS	SMBJ8.5C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...11.92 В; V_{WM} = 8.5 В; I_{PP} = 37.7 А	DO-214AA, SMB	x • x
ASP	TPSMA12	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.80...13.20 В; V_{WM} = 9.72 В; I_{PP} = 23.1 А	DO-214AC, SMA	K • A
AT	SMBJ8.5CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.82 В; V_{WM} = 8.5 В; I_{PP} = 41.7 А	DO-214AA, SMB	x • x
ATP	TPSMA12A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.40...12.60 В; V_{WM} = 10.20 В; I_{PP} = 24.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
AU	SMBJ9.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.00...12.80 В; V_{WM} = 9.0 В; I_{PP} = 35.5 А	DO-214AA, SMB	x • x
AUP	TPSMA13	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.70...14.30 В; V_{WM} = 10.50 В; I_{PP} = 21.1 А	DO-214AC, SMA	K • A
AV	pSMBJ9.0CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.00...11.50 В; V_{WM} = 9.0 В; I_{PP} = 39.0 А	DO-214AA, SMB	x • x
AVP	TPSMA13A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.40...13.70 В; V_{WM} = 11.10 В; I_{PP} = 22.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
AW	SMBJ10C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.10...14.10 В; V_{WM} = 10.0 В; I_{PP} = 31.9 А	DO-214AA, SMB	x • x
AWP	TPSMA15	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.50...16.30 В; V_{WM} = 12.10 В; I_{PP} = 18.2 А	DO-214AC, SMA	K • A
AX	SMBJ10CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.10...12.80 В; V_{WM} = 10.0 В; I_{PP} = 35.3 А	DO-214AA, SMB	x • x
AXP	TPSMA15A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.30...15.80 В; V_{WM} = 12.80 В; I_{PP} = 18.9 А	DO-214AC, SMA	K • A
AY	SMBJ11C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.20...15.40 В; V_{WM} = 11.0 В; I_{PP} = 29.9 А	DO-214AA, SMB	x • x
AYP	TPSMA16	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.40...17.60 В; V_{WM} = 12.90 В; I_{PP} = 17.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
AZ	SMBJ11CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.20...14.40 В; V_{WM} = 11.0 В; I_{PP} = 33.0 А	DO-214AA, SMB	x • x
AZP	TPSMA16A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.20...16.80 В; V_{WM} = 13.60 В; I_{PP} = 17.8 А	DO-214AC, SMA	K • A
BD	SMBJ12C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.30...16.90 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 27.3 А	DO-214AA, SMB	x • x
BDD	SMCJ5.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.55 В; V_{WM} = 5.0 В; I_{PP} = 156.2 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDE	SMCJ5.0CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.25 В; V_{WM} = 5.0 В; I_{PP} = 163.0 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDF	SMCJ6.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.67...8.45 В; V_{WM} = 6.0 В; I_{PP} = 131.6 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDG	SMCJ6.0CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.67 В; V_{WM} = 6.0 В; I_{PP} = 145.6 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDH	SMCJ6.5C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.22...9.14 В; V_{WM} = 6.5 В; I_{PP} = 122.0 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDK	SMCJ6.5CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.22...8.30 В; V_{WM} = 6.5 В; I_{PP} = 133.9 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDL	SMCJ7.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.78...9.86 В; V_{WM} = 7.0 В; I_{PP} = 112.8 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDM	SMCJ7.0CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.78...8.95 В; V_{WM} = 7.0 В; I_{PP} = 125.0 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDN	SMCJ7.5C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...10.80 В; V_{WM} = 7.5 В; I_{PP} = 104.9 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDP	SMCJ7.5CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.58 В; V_{WM} = 7.5 В; I_{PP} = 116.3 А	DO-214AB, SMC	x • x
BDP	TPSMA18	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 16.20...19.80 В; V_{WM} = 14.50 В; I_{PP} = 15.1 А	DO-214AC, SMA	K • A
BDQ	SMCJ8.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...11.30 В; V_{WM} = 8.0 В; I_{PP} = 100.0 А	DO-214AB, SMC	x • x

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
BDR	SMCJ8.0CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...10.23 В; V_{WM} = 8.0 В; I_{PP} = 110.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BDS	SMCJ8.5C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...11.92 В; V_{WM} = 8.5 В; I_{PP} = 94.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BDT	SMCJ8.5CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.82 В; V_{WM} = 8.5 В; I_{PP} = 104.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BDU	SMCJ9.0C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.00...12.80 В; V_{WM} = 9.0 В; I_{PP} = 88.7 А	DO-214AB, SMC	x•x
BDV	SMCJ9.0CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.00...11.50 В; V_{WM} = 9.0 В; I_{PP} = 97.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BDW	SMCJ10C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.10...14.10 В; V_{WM} = 10.0 В; I_{PP} = 79.8 А	DO-214AB, SMC	x•x
BDX	SMCJ10CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.10...12.80 В; V_{WM} = 10.0 В; I_{PP} = 88.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BDY	SMCJ11C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.20...15.40 В; V_{WM} = 11.0 В; I_{PP} = 74.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BDZ	SMCJ11CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.20...14.40 В; V_{WM} = 11.0 В; I_{PP} = 82.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BE	SMBJ12CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.30...15.30 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 30.2 А	DO-214AA, SMB	x•x
BED	SMCJ12C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.30...16.90 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 68.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEE	SMCJ12CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.30...15.30 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 75.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEF	SMCJ13C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.40...18.20 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 63.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEG	SMCJ13CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.40...16.50 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 69.7 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEH	SMCJ14C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.60...19.80 В; V_{WM} = 14.0 В; I_{PP} = 58.1 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEK	SMCJ14CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.60...17.90 В; V_{WM} = 14.0 В; I_{PP} = 64.7 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEL	SMCJ15C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 16.70...21.10 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 55.8 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEM	SMCJ15CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 16.70...19.20 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 61.5 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEN	SMCJ16C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 17.80...22.60 В; V_{WM} = 16.0 В; I_{PP} = 52.1 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEP	SMCJ16CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 17.80...20.50 В; V_{WM} = 16.0 В; I_{PP} = 57.7 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEP	TPSMA18A	GS	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 17.10...18.90 В; V_{WM} = 15.30 В; I_{PP} = 15.9 А	DO-214AC, SMA	K•A
BEQ	SMCJ17C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 18.90...23.90 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 49.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BER	SMCJ17CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 18.90...21.70 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 53.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BES	SMCJ18C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20.00...25.30 В; V_{WM} = 18.0 В; I_{PP} = 46.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BET	SMCJ18CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20.00...23.30 В; V_{WM} = 18.0 В; I_{PP} = 51.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEU	SMCJ20C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 22.20...28.10 В; V_{WM} = 20.0 В; I_{PP} = 41.9 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEV	SMCJ20CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 22.20...25.50 В; V_{WM} = 20.0 В; I_{PP} = 46.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEW	SMCJ22C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 24.40...30.90 В; V_{WM} = 22.0 В; I_{PP} = 38.1 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEX	SMCJ22CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 24.40...28.00 В; V_{WM} = 22.0 В; I_{PP} = 42.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEY	SMCJ24C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 26.70...33.80 В; V_{WM} = 24.0 В; I_{PP} = 34.9 А	DO-214AB, SMC	x•x
BEZ	SMCJ24CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 26.70...30.70 В; V_{WM} = 24.0 В; I_{PP} = 38.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BF	SMBJ13C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.40...18.20 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 25.2 А	DO-214AA, SMB	x•x
BFD	SMCJ26C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.90...36.80 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 32.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFE	SMCJ26CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.90...33.20 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 35.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFF	SMCJ28C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 31.10...39.40 В; V_{WM} = 28.0 В; I_{PP} = 30.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFG	SMCJ28CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 31.10...35.80 В; V_{WM} = 28.0 В; I_{PP} = 33.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFH	SMCJ30C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 33.30...42.40 В; V_{WM} = 30.0 В; I_{PP} = 28.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFK	SMCJ30CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 33.30...38.30 В; V_{WM} = 30.0 В; I_{PP} = 31.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFL	SMCJ33C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 36.70...46.90 В; V_{WM} = 33.0 В; I_{PP} = 25.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFM	SMCJ33CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 36.70...42.20 В; V_{WM} = 33.0 В; I_{PP} = 28.1 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFN	SMCJ36C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 40.00...50.70 В; V_{WM} = 36.0 В; I_{PP} = 23.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFP	SMCJ36CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 40.00...46.00 В; V_{WM} = 36.0 В; I_{PP} = 25.8 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFP	TPSMA20	GS	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 18.00...22.00 В; V_{WM} = 16.20 В; I_{PP} = 13.7 А	DO-214AC, SMA	K•A
BFQ	SMCJ40C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 44.40...56.30 В; V_{WM} = 40.0 В; I_{PP} = 21.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFR	SMCJ40CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 44.40...51.10 В; V_{WM} = 40.0 В; I_{PP} = 23.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFS	SMCJ43C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 47.80...60.50 В; V_{WM} = 43.0 В; I_{PP} = 19.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFT	SMCJ43CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 47.80...54.90 В; V_{WM} = 43.0 В; I_{PP} = 21.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFU	SMCJ45C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 50.00...63.30 В; V_{WM} = 45.0 В; I_{PP} = 18.7 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFV	SMCJ45CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 50.00...57.50 В; V_{WM} = 45.0 В; I_{PP} = 20.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFW	SMCJ48C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.30...67.50 В; V_{WM} = 48.0 В; I_{PP} = 17.5 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFX	SMCJ48CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.30...61.30 В; V_{WM} = 48.0 В; I_{PP} = 19.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFY	SMCJ51C	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.70...71.80 В; V_{WM} = 51.0 В; I_{PP} = 16.5 А	DO-214AB, SMC	x•x
BFZ	SMCJ51CA	VISH	VS	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.70...65.20 В; V_{WM} = 51.0 В; I_{PP} = 18.2 А	DO-214AB, SMC	x•x



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
BG	SMBJ13CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.40...16.50 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 27.9 А	DO-214AA, SMB	x•x
BGD	SMCJ54C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60.00...76.00 В; V_{WM} = 54.0 В; I_{PP} = 15.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGE	SMCJ54CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60.00...69.00 В; V_{WM} = 54.0 В; I_{PP} = 17.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGF	SMCJ58C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.40...81.60 В; V_{WM} = 58.0 В; I_{PP} = 14.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGG	SMCJ58CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.40...74.60 В; V_{WM} = 58.0 В; I_{PP} = 16.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGH	SMCJ60C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.70...84.50 В; V_{WM} = 60.0 В; I_{PP} = 14.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGK	SMCJ60CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.70...76.70 В; V_{WM} = 60.0 В; I_{PP} = 15.5 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGL	SMCJ64C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.10...90.10 В; V_{WM} = 64.0 В; I_{PP} = 13.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGM	SMCJ64CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.10...81.80 В; V_{WM} = 64.0 В; I_{PP} = 14.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGN	SMCJ70C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.80...98.60 В; V_{WM} = 70.0 В; I_{PP} = 12.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGP	SMCJ70CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.80...89.50 В; V_{WM} = 70.0 В; I_{PP} = 13.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGP	TPSMA20A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 19.00...21.00 В; V_{WM} = 17.10 В; I_{PP} = 14.4 А	DO-214AC, SMA	K•A
BGQ	SMCJ75C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.30...106.00 В; V_{WM} = 75.0 В; I_{PP} = 11.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGR	SMCJ75CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.30...95.80 В; V_{WM} = 75.0 В; I_{PP} = 12.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGS	SMCJ78C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.70...110.00 В; V_{WM} = 78.0 В; I_{PP} = 10.8 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGT	SMCJ78CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.70...99.70 В; V_{WM} = 78.0 В; I_{PP} = 11.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGU	SMCJ85C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.40...119.20 В; V_{WM} = 85.0 В; I_{PP} = 9.9 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGV	SMCJ85CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.40...108.20 В; V_{WM} = 85.0 В; I_{PP} = 10.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGW	SMCJ90C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 100.00...126.50 В; V_{WM} = 90.0 В; I_{PP} = 9.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGX	SMCJ90CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 100.00...115.50 В; V_{WM} = 90.0 В; I_{PP} = 10.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGY	SMCJ100C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111.00...141.00 В; V_{WM} = 100.0 В; I_{PP} = 8.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BGZ	SMCJ100CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111.00...128.00 В; V_{WM} = 100.0 В; I_{PP} = 9.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
BH	SMBJ14C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.60...19.80 В; V_{WM} = 14.0 В; I_{PP} = 23.3 А	DO-214AA, SMB	x•x
BHD	SMCJ110C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 122.00...154.50 В; V_{WM} = 110.0 В; I_{PP} = 7.7 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHE	SMCJ110CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 122.00...140.50 В; V_{WM} = 110.0 В; I_{PP} = 8.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHF	SMCJ120C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 133.00...169.00 В; V_{WM} = 120.0 В; I_{PP} = 7.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHG	SMCJ120CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 133.00...153.00 В; V_{WM} = 120.0 В; I_{PP} = 7.9 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHH	SMCJ130C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144.00...182.50 В; V_{WM} = 130.0 В; I_{PP} = 6.5 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHK	SMCJ130CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144.00...165.50 В; V_{WM} = 130.0 В; I_{PP} = 7.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHL	SMCJ150C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 167.00...211.50 В; V_{WM} = 150.0 В; I_{PP} = 5.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHM	SMCJ150CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 167.00...192.50 В; V_{WM} = 150.0 В; I_{PP} = 6.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHN	SMCJ160C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 178.00...226.00 В; V_{WM} = 160.0 В; I_{PP} = 5.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHP	SMCJ160CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 178.00...205.00 В; V_{WM} = 160.0 В; I_{PP} = 5.8 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHP	TPSMA22	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 19.80...24.20 В; V_{WM} = 17.80 В; I_{PP} = 12.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
BHQ	SMCJ170C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 189.00...239.50 В; V_{WM} = 170.0 В; I_{PP} = 4.9 А	DO-214AB, SMC	x•x
BHR	SMCJ170CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 189.00...217.50 В; V_{WM} = 170.0 В; I_{PP} = 5.5 А	DO-214AB, SMC	x•x
BK	SMBJ14CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.60...17.90 В; V_{WM} = 14.0 В; I_{PP} = 25.8 А	DO-214AA, SMB	x•x
BKP	TPSMA22A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20.90...23.10 В; V_{WM} = 18.80 В; I_{PP} = 13.1 А	DO-214AC, SMA	K•A
BL	SMBJ15C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 16.70...21.10 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 22.3 А	DO-214AA, SMB	x•x
BLP	TPSMA24	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 21.60...26.40 В; V_{WM} = 19.40 В; I_{PP} = 11.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
BM	SMBJ15CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 16.70...19.20 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 24.0 А	DO-214AA, SMB	x•x
BMP	TPSMA24A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 22.80...25.20 В; V_{WM} = 20.50 В; I_{PP} = 12.0 А	DO-214AC, SMA	K•A
BN	SMBJ16C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 17.80...22.60 В; V_{WM} = 16.0 В; I_{PP} = 20.8 А	DO-214AA, SMB	x•x
BNP	TPSMA27	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 24.30...29.70 В; V_{WM} = 21.80 В; I_{PP} = 10.2 А	DO-214AC, SMA	K•A
BOP	TPSMA30	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 27.00...33.00 В; V_{WM} = 24.30 В; I_{PP} = 9.2 А	DO-214AC, SMA	K•A
BP	SMBJ16CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 17.80...20.50 В; V_{WM} = 16.0 В; I_{PP} = 23.1 А	DO-214AA, SMB	x•x
BPP	TPSMA27A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 25.70...28.40 В; V_{WM} = 23.10 В; I_{PP} = 10.7 А	DO-214AC, SMA	K•A
BQ	SMBJ17C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 18.90...23.90 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 19.7 А	DO-214AA, SMB	x•x
BR	SMBJ17CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 18.90...21.70 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 21.7 А	DO-214AA, SMB	x•x
BRP	TPSMA30A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.50...31.50 В; V_{WM} = 25.60 В; I_{PP} = 9.7 А	DO-214AC, SMA	K•A
BS	SMBJ18C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20.00...25.30 В; V_{WM} = 18.0 В; I_{PP} = 18.6 А	DO-214AA, SMB	x•x
BSP	TPSMA33	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 29.70...36.30 В; V_{WM} = 26.80 В; I_{PP} = 8.4 А	DO-214AC, SMA	K•A
BT	SMBJ18CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20.00...23.30 В; V_{WM} = 18.0 В; I_{PP} = 20.5 А	DO-214AA, SMB	x•x

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
BTP	TPSMA33A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=31.40...34.70$ В; $V_{WM}=28.20$ В; $I_{PP}=8.8$ А	DO-214AC, SMA	K•A
BU	SMBJ20C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=22.20...28.10$ В; $V_{WM}=20.0$ В; $I_{PP}=16.7$ А	DO-214AA, SMB	x•x
BUP	TPSMA36	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=32.40...39.60$ В; $V_{WM}=29.10$ В; $I_{PP}=7.7$ А	DO-214AC, SMA	K•A
BV	SMBJ20CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=22.20...25.50$ В; $V_{WM}=20.0$ В; $I_{PP}=18.5$ А	DO-214AA, SMB	x•x
BVP	TPSMA36A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=34.20...37.80$ В; $V_{WM}=30.80$ В; $I_{PP}=8.0$ А	DO-214AC, SMA	K•A
BW	SMBJ22C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=24.40...30.90$ В; $V_{WM}=22.0$ В; $I_{PP}=15.2$ А	DO-214AA, SMB	x•x
BWP	TPSMA39	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=35.10...42.90$ В; $V_{WM}=31.60$ В; $I_{PP}=7.1$ А	DO-214AC, SMA	K•A
BX	SMBJ22CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=24.40...28.00$ В; $V_{WM}=22.0$ В; $I_{PP}=16.9$ А	DO-214AA, SMB	x•x
BXP	TPSMA39A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=37.10...41.00$ В; $V_{WM}=33.30$ В; $I_{PP}=7.4$ А	DO-214AC, SMA	K•A
BY	SMBJ24C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=26.70...33.80$ В; $V_{WM}=24.0$ В; $I_{PP}=14.0$ А	DO-214AA, SMB	x•x
BYP	TPSMA43	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=38.70...47.30$ В; $V_{WM}=34.80$ В; $I_{PP}=6.5$ А	DO-214AC, SMA	K•A
BZ	SMBJ24AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=26.70...30.70$ В; $V_{WM}=24.0$ В; $I_{PP}=15.4$ А	DO-214AA, SMB	x•x
BZP	TPSMA43A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=40.90...45.20$ В; $V_{WM}=36.80$ В; $I_{PP}=6.7$ А	DO-214AC, SMA	K•A
C2	SMBYT03-200	STM	frd	$V_R<200$ В; $I_F<3$ А; $V_F(I_F=3$ А$)<1.4$ В; $I_R<0.6$ мА; $t_{RR}<60$ нс	DO-214AB, SMC	K•A
C3	SMBYT03-300	STM	frd	$V_R<300$ В; $I_F<3$ А; $V_F(I_F=3$ А$)<1.4$ В; $I_R<0.6$ мА; $t_{RR}<60$ нс	DO-214AB, SMC	K•A
C4	SMBYT03-400	STM	frd	$V_R<400$ В; $I_F<3$ А; $V_F(I_F=3$ А$)<1.4$ В; $I_R<0.6$ мА; $t_{RR}<60$ нс	DO-214AB, SMC	K•A
CD	SMBJ26C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=28.90...36.80$ В; $V_{WM}=26.0$ В; $I_{PP}=12.4$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CE	SMBJ26CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=28.90...33.20$ В; $V_{WM}=26.0$ В; $I_{PP}=14.2$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CF	SMBJ28C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=31.10...39.40$ В; $V_{WM}=28.0$ В; $I_{PP}=12.0$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CG	SMBJ28CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=31.10...35.80$ В; $V_{WM}=28.0$ В; $I_{PP}=13.2$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CH	SMB30C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=33.30...42.20$ В; $V_{WM}=30.0$ В; $I_{PP}=11.2$ А	DO-214AC, SMA	x•x
CK	SMBJ30CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=33.30...38.30$ В; $V_{WM}=30.0$ В; $I_{PP}=12.4$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CL	SMBJ33C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=36.70...46.90$ В; $V_{WM}=33.0$ В; $I_{PP}=10.2$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CM	SMBJ33CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=36.70...42.20$ В; $V_{WM}=33.0$ В; $I_{PP}=11.3$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CN	SMBJ36C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=40.00...50.70$ В; $V_{WM}=36.0$ В; $I_{PP}=9.3$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CP	SMBJ36CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=40.00...46.00$ В; $V_{WM}=36.0$ В; $I_{PP}=10.3$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CQ	SMBJ40C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=44.40...56.30$ В; $V_{WM}=40.0$ В; $I_{PP}=8.4$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CR	SMBJ40CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=44.40...51.10$ В; $V_{WM}=40.0$ В; $I_{PP}=9.3$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CS	SMBJ43C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=47.80...60.50$ В; $V_{WM}=43.0$ В; $I_{PP}=7.8$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CT	SMBJ43CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=47.80...54.90$ В; $V_{WM}=43.0$ В; $I_{PP}=8.6$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CU	SMBJ45C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=50.00...63.30$ В; $V_{WM}=45.0$ В; $I_{PP}=7.5$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CV	SMBJ45CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=50.00...57.50$ В; $V_{WM}=45.0$ В; $I_{PP}=8.3$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CW	SMBJ48C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=53.30...67.50$ В; $V_{WM}=48.0$ В; $I_{PP}=7.0$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CX	SMBJ48CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=53.30...61.30$ В; $V_{WM}=48.0$ В; $I_{PP}=7.7$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CY	SMBJ51C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=56.70...71.80$ В; $V_{WM}=51.0$ В; $I_{PP}=6.6$ А	DO-214AA, SMB	x•x
CZ	SMBJ51CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=56.70...65.20$ В; $V_{WM}=51.0$ В; $I_{PP}=7.3$ А	DO-214AA, SMB	x•x
D20	SMBYW04-200	STM	frd	$V_R<200$ В; $I_F<4$ А; $V_F(I_F=4$ А$)<0.85$ В; $I_R<0.5$ мА; $t_{RR}<35$ нс	DO-214AB, SMC	K•A
DD	SMBJ54C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=60.00...76.00$ В; $V_{WM}=54.0$ В; $I_{PP}=6.2$ А	DO-214AA, SMB	x•x
DDP	TPSMC6.8	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0$ мА$)=6.12...7.48$ В; $V_{WM}=5.50$ В; $I_{PP}=139$ А	DO-214AB, SMC	K•A
DE	SMBJ54CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=60.00...69.00$ В; $V_{WM}=54.0$ В; $I_{PP}=6.9$ А	DO-214AA, SMB	x•x
DEP	TPSMC6.8A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0$ мА$)=6.45...7.14$ В; $V_{WM}=5.80$ В; $I_{PP}=143$ А	DO-214AB, SMC	K•A
DF	SMBJ58C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=64.40...81.60$ В; $V_{WM}=58.0$ В; $I_{PP}=5.8$ А	DO-214AA, SMB	x•x
DFP	TPSMC7.5	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0$ мА$)=6.75...8.25$ В; $V_{WM}=6.05$ В; $I_{PP}=128$ А	DO-214AB, SMC	K•A
DG	SMBJ58CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=64.40...74.60$ В; $V_{WM}=58.0$ В; $I_{PP}=6.4$ А	DO-214AA, SMB	x•x
DGP	TPSMC7.5A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0$ мА$)=7.13...7.88$ В; $V_{WM}=6.40$ В; $I_{PP}=133$ А	DO-214AB, SMC	K•A
DH	SMBJ60C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=66.70...84.50$ В; $V_{WM}=60.0$ В; $I_{PP}=5.6$ А	DO-214AA, SMB	x•x
DHP	TPSMC8.2	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0$ мА$)=7.38...9.02$ В; $V_{WM}=6.63$ В; $I_{PP}=120$ А	DO-214AB, SMC	K•A
DK	SMBJ60CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=66.70...76.70$ В; $V_{WM}=60.0$ В; $I_{PP}=6.2$ А	DO-214AA, SMB	x•x
DKP	TPSMC8.2A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0$ мА$)=7.79...8.61$ В; $V_{WM}=7.02$ В; $I_{PP}=124$ А	DO-214AB, SMC	K•A
DL	SMBJ64C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=71.10...90.10$ В; $V_{WM}=64.0$ В; $I_{PP}=5.3$ А	DO-214AA, SMB	x•x
DLP	TPSMC9.1	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=8.19...10.0$ В; $V_{WM}=7.37$ В; $I_{PP}=109$ А	DO-214AB, SMC	K•A
DM	SMBJ64CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=71.10...81.80$ В; $V_{WM}=64.0$ В; $I_{PP}=5.8$ А	DO-214AA, SMB	x•x
DMP	TPSMC9.1A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0$ мА$)=8.65...9.55$ В; $V_{WM}=7.78$ В; $I_{PP}=112$ А	DO-214AB, SMC	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
DN	SMBJ70C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.80...98.60 В; V_{WM} = 70.0 В; I_{PP} = 4.8 А	DO-214AA, SMB	x • x
DNP	TPSMC10	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.00...11.0В; V_{WM} = 8.10В; I_{PP} = 100 А	DO-214AB, SMC	K • A
DOP	TPSMC11	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.90...12.1В; V_{WM} = 8.92В; I_{PP} = 92.6 А	DO-214AB, SMC	K • A
DP	SMBJ70CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.80...89.50 В; V_{WM} = 70.0 В; I_{PP} = 5.3 А	DO-214AA, SMB	x • x
DPP	TPSMC10A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.50...10.5В; V_{WM} = 8.55В; I_{PP} = 103 А	DO-214AB, SMC	K • A
DQ	SMBJ75C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.30...106.00 В; V_{WM} = 75.0 В; I_{PP} = 4.5 А	DO-214AA, SMB	x • x
DR	SMBJ75CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.30...95.80 В; V_{WM} = 75.0 В; I_{PP} = 4.9 А	DO-214AA, SMB	x • x
DRP	TPSMC11A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.5...11.6В; V_{WM} = 9.40В; I_{PP} = 96.2 А	DO-214AB, SMC	K • A
DS	SMBJ78C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.70...110.00 В; V_{WM} = 78.0 В; I_{PP} = 4.3 А	DO-214AA, SMB	x • x
DSP	TPSMC12	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.8...13.2В; V_{WM} = 9.72В; I_{PP} = 86.7 А	DO-214AB, SMC	K • A
DT	SMBJ78CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.70...99.70 В; V_{WM} = 78.0 В; I_{PP} = 4.7 А	DO-214AA, SMB	x • x
DTP	TPSMC12A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.4...12.6В; V_{WM} = 10.2В; I_{PP} = 89.8 А	DO-214AB, SMC	K • A
DU	SMBJ85C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.40...119.20 В; V_{WM} = 85.0 В; I_{PP} = 3.9 А	DO-214AA, SMB	x • x
DUP	TPSMC13	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.7...14.3В; V_{WM} = 10.5В; I_{PP} = 78.9 А	DO-214AB, SMC	K • A
DV	SMBJ85CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.40...108.20 В; V_{WM} = 85.0 В; I_{PP} = 4.4 А	DO-214AA, SMB	x • x
DVP	TPSMC13A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.4...13.7В; V_{WM} = 11.1В; I_{PP} = 82.4 А	DO-214AB, SMC	K • A
DW	SMBJ90C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 100.0...126.50 В; V_{WM} = 90.0 В; I_{PP} = 3.8 А	DO-214AA, SMB	x • x
DWP	TPSMC15	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.5...16.5В; V_{WM} = 12.1В; I_{PP} = 68.2 А	DO-214AB, SMC	K • A
DX	SMBJ90CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 100.0...115.50 В; V_{WM} = 90.0 В; I_{PP} = 4.1 А	DO-214AA, SMB	x • x
DXP	TPSMC15A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.3...15.8В; V_{WM} = 12.8В; I_{PP} = 70.8 А	DO-214AB, SMC	K • A
DY	SMBJ100C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111.0...141.00 В; V_{WM} = 100.0 В; I_{PP} = 3.4 А	DO-214AA, SMB	x • x
DYP	TPSMC16	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.4...17.6В; V_{WM} = 12.9В; I_{PP} = 63.8 А	DO-214AB, SMC	K • A
DZ	SMBJ100CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111.0...128.00 В; V_{WM} = 100.0 В; I_{PP} = 3.7 А	DO-214AA, SMB	x • x
DZP	TPSMC16A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.2...16.8В; V_{WM} = 13.6В; I_{PP} = 66.7 А	DO-214AB, SMC	K • A
EA	ES1A	GS	fd	V_R = 50 В; I_F = 1 А; C_D = 7 пФ	DO-214AC, SMA	K • A
EA	ES2A	GS	fd	V_R = 50 В; I_F = 2 А; C_D = 18 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
EA	ES3A	GS	fd	V_R = 50 В; I_F = 3 А; C_D = 45 пФ	DO-214AB, SMC	K • A
EB	ES1B	GS	fd	V_R = 100 В; I_F = 1 А; C_D = 7 пФ	DO-214AC, SMA	K • A
EB	ES2B	GS	fd	V_R = 100 В; I_F = 2 А; C_D = 18 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
EB	ES3B	GS	fd	V_R = 100 В; I_F = 3 А; C_D = 45 пФ	DO-214AB, SMC	K • A
EC	ES1C	GS	fd	V_R = 150 В; I_F = 1 А; C_D = 7 пФ	DO-214AC, SMA	K • A
EC	ES2C	GS	fd	V_R = 150 В; I_F = 2 А; C_D = 18 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
EC	ES3C	GS	fd	V_R = 150 В; I_F = 3 А; C_D = 45 пФ	DO-214AB, SMC	K • A
ED	ES1D	GS	fd	V_R = 200 В; I_F = 1 А; C_D = 7 пФ	DO-214AC, SMA	K • A
ED	ES2D	GS	fd	V_R = 200 В; I_F = 2 А; C_D = 18 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
ED	ES3D	GS	fd	V_R = 200 В; I_F = 3 А; C_D = 45 пФ	DO-214AB, SMC	K • A
ED	SMBJ110C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 122.0...154.50 В; V_{WM} = 110.0 В; I_{PP} = 3.0 А	DO-214AA, SMB	x • x
EDP	TPSMC18	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 16.2...19.8В; V_{WM} = 14.5В; I_{PP} = 56.6 А	DO-214AB, SMC	K • A
EE	SMBJ110CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 122.0...140.00 В; V_{WM} = 110.0 В; I_{PP} = 3.4 А	DO-214AA, SMB	x • x
EEP	TPSMC18A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 17.1...18.9В; V_{WM} = 15.3В; I_{PP} = 59.5 А	DO-214AB, SMC	K • A
EF	SMBJ120C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10 мА) = 133.0...169.00 В; V_{WM} = 120.0 В; I_{PP} = 2.8 А	DO-214AA, SMB	x • x
EFP	TPSMC20	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 18.0...22.0В; V_{WM} = 16.2В; I_{PP} = 51.5 А	DO-214AB, SMC	K • A
EG	SMBJ120CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 133.0...153.00 В; V_{WM} = 120.0 В; I_{PP} = 3.1 А	DO-214AA, SMB	x • x
EGP	TPSMC20A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 19.0...21.0В; V_{WM} = 17.1В; I_{PP} = 54.2 А	DO-214AB, SMC	K • A
EH	SMBJ130C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144.0...182.50 В; V_{WM} = 130.0 В; I_{PP} = 2.6 А	DO-214AA, SMB	x • x
EHP	TPSMC22	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 19.8...24.2В; V_{WM} = 17.8В; I_{PP} = 47.0 А	DO-214AB, SMC	K • A
EK	SMBJ130CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144.0...165.50 В; V_{WM} = 130.0 В; I_{PP} = 2.9 А	DO-214AA, SMB	x • x
EKP	TPSMC22A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20.9...23.1В; V_{WM} = 18.8В; I_{PP} = 49.0 А	DO-214AB, SMC	K • A
EL	SMBJ150C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 167.0...211.50 В; V_{WM} = 150.0 В; I_{PP} = 2.2 А	DO-214AA, SMB	x • x
ELP	TPSMC24	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 21.6...26.4В; V_{WM} = 19.4В; I_{PP} = 43.2 А	DO-214AB, SMC	K • A
EM	SMBJ150CA	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 167.0...192.50 В; V_{WM} = 150.0 В; I_{PP} = 2.5 А	DO-214AA, SMB	x • x
EMP	TPSMC24A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 22.8...25.2В; V_{WM} = 20.5В; I_{PP} = 45.2 А	DO-214AB, SMC	K • A
EN	SMBJ160C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 178.0...226.00 В; V_{WM} = 160.0 В; I_{PP} = 2.1 А	DO-214AA, SMB	x • x

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
ENP	TPSMC27	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.3...29.7 В; V_{WM} = 21.8 В; I_{PP} = 38.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
EP	SMBJ160CA	VISH	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 178.0...205.00 В; V_{WM} = 160.0 В; I_{PP} = 2.3 А	DO-214AA, SMB	x•x
EPP	TPSMC27A	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 25.7...28.4 В; V_{WM} = 23.1 В; I_{PP} = 40.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
EQ	SMBJ170C	VISH	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 189.0...239.50 В; V_{WM} = 170.0 В; I_{PP} = 2.0 А	DO-214AA, SMB	x•x
EQP	TPSMC30	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 27.0...33.0 В; V_{WM} = 24.3 В; I_{PP} = 34.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
ER	SMBJ170CA	VISH	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 189.0...217.50 В; V_{WM} = 170.0 В; I_{PP} = 2.2 А	DO-214AA, SMB	x•x
ERP	TPSMC30A	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.5...31.5 В; V_{WM} = 25.6 В; I_{PP} = 36.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
ESP	TPSMC33	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 29.7...36.3 В; V_{WM} = 26.8 В; I_{PP} = 31.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
ETP	TPSMC33A	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.4...34.7 В; V_{WM} = 28.2 В; I_{PP} = 32.8 А	DO-214AB, SMC	K•A
EUP	TPSMC36	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 32.4...39.6 В; V_{WM} = 29.1 В; I_{PP} = 28.8 А	DO-214AB, SMC	K•A
EVP	TPSMC36A	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 34.2...37.8 В; V_{WM} = 30.8 В; I_{PP} = 30.1 А	DO-214AB, SMC	K•A
EWP	TPSMC39	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 35.1...42.9 В; V_{WM} = 31.6 В; I_{PP} = 26.6 А	DO-214AB, SMC	K•A
EXP	TPMSC39A	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 37.1...41.0 В; V_{WM} = 33.3 В; I_{PP} = 27.8 А	DO-214AB, SMC	K•A
EYP	TPSMC43	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 38.7...47.3 В; V_{WM} = 34.8 В; I_{PP} = 24.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
EZP	TPSMC43A	GS	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 40.9...45.2 В; V_{WM} = 36.8 В; I_{PP} = 25.3 А	DO-214AB, SMC	K•A
FBB	SMCJ6.0CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.67 В; V_{WM} = 6.0 В; I_{PP} = 145.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBC	SMCJ6.5CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.22...8.30 В; V_{WM} = 6.5 В; I_{PP} = 133.9 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBCA	SMCJ5.0CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.25 В; V_{WM} = 5.0 В; I_{PP} = 163.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBD	SMCJ8.5CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.82 В; V_{WM} = 8.5 В; I_{PP} = 104.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBF	SMCJ10CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 11.10...14.10 В; V_{WM} = 10.0 В; I_{PP} = 79.8 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBH	SMCJ12CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.30...16.90 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 68.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBI	SMCJ13CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.40...18.20 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 63.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBJ	SMCJ15CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.70...21.10 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 55.8 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBL	SMCJ18CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.00...25.30 В; V_{WM} = 18.0 В; I_{PP} = 46.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBM	SMCJ20CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.20...25.50 В; V_{WM} = 20.0 В; I_{PP} = 46.3 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBN	SMCJ22CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.40...28.00 В; V_{WM} = 22.0 В; I_{PP} = 42.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBO	SMCJ24CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 26.70...30.70 В; V_{WM} = 24.0 В; I_{PP} = 38.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBP	SMCJ26CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.90...33.20 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 35.6 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBQ	SMCJ28CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.10...35.80 В; V_{WM} = 28.0 В; I_{PP} = 33.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBR	SMCJ30CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 33.30...42.40 В; V_{WM} = 30.0 В; I_{PP} = 28.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBS	SMCJ33CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 36.70...42.20 В; V_{WM} = 33.0 В; I_{PP} = 28.1 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBU	SMCJ40CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 44.40...51.10 В; V_{WM} = 40.0 В; I_{PP} = 23.2 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBW	SMCJ48CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 53.30...61.30 В; V_{WM} = 48.0 В; I_{PP} = 19.4 А	DO-214AB, SMC	x•x
FBZ	SMCJ58CA	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 64.40...74.60 В; V_{WM} = 58.0 В; I_{PP} = 16.0 А	DO-214AB, SMC	x•x
FUA	SMCJ5.0A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.25 В; V_{WM} = 5.0 В; I_{PP} = 163.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUB	SMCJ6.0A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.67 В; V_{WM} = 6.0 В; I_{PP} = 145.6 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUC	SMCJ6.5A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.22...8.30 В; V_{WM} = 6.5 В; I_{PP} = 133.9 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUD	SMCJ8.5A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.82 В; V_{WM} = 8.5 В; I_{PP} = 104.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUF	SMCJ10A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 11.10...12.80 В; V_{WM} = 10.0 В; I_{PP} = 88.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUH	SMCJ12A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.30...15.30 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 75.3 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUI	SMCJ13A	STM		V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.40...16.50 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 69.7 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUJ	SMCJ15A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.70...19.20 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 61.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUL	SMCJ18A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.00...23.30 В; V_{WM} = 18.0 В; I_{PP} = 51.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUM	SMCJ20A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.20...28.10 В; V_{WM} = 20.0 В; I_{PP} = 41.9 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUN	SMCJ22A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.40...28.00 В; V_{WM} = 22.0 В; I_{PP} = 42.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUO	SMCJ24A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 26.70...30.70 В; V_{WM} = 24.0 В; I_{PP} = 38.6 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUP	SMCJ26A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.90...36.80 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 32.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUQ	SMCJ28A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.10...35.80 В; V_{WM} = 28.0 В; I_{PP} = 33.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUR	SMCJ30A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 33.30...42.40 В; V_{WM} = 30.0 В; I_{PP} = 28.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUS	SMCJ33A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 36.70...42.20 В; V_{WM} = 33.0 В; I_{PP} = 28.1 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUU	SMCJ40A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 44.40...51.10 В; V_{WM} = 40.0 В; I_{PP} = 23.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUW	SMCJ48A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 53.30...61.30 В; V_{WM} = 48.0 В; I_{PP} = 19.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
FUZ	SMCJ58A	STM	VS	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 64.40...74.60 В; V_{WM} = 58.0 В; I_{PP} = 16.0 А	DO-214AB, SMC	K•A

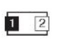


DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
GA	GF1A	VISH	dr	V_R < 50 В; I_F < 1 A; V_F(I_F = 1 A) < 1.1 В	DO-214BA	K•A
GA	GF1A	GS	dr	V_R < 50 В; I_F < 1 A; V_F(I_F = 1 A) < 1.1 В	DO-214BA	K•A
GB	GF1B	VISH	dr	V_R < 100 В; I_F < 1 A; V_F(I_F = 1 A) < 1.1 В	DO-214BA	K•A
GB	GF1B	GS	dr	V_R < 100 В; I_F < 1 A; V_F(I_F = 1 A) < 1.1 В	DO-214BA	K•A
GBB	SMCJ70CA	STM	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 77.80...89.50 В; V_{WM} = 70.0 В; I_{PP} = 13.3 A	DO-214AB, SMC	x•x
GBCA	SMCJ60CA	STM	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 66.70...76.70 В; V_{WM} = 60.0 В; I_{PP} = 15.5 A	DO-214AB, SMC	x•x
GBE	SMCJ85CA	STM	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 94.40...108.20 В; V_{WM} = 85.0 В; I_{PP} = 10.4 A	DO-214AB, SMC	x•x
GBG	SMCJ100CA	STM	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 111.00...141.00 В; V_{WM} = 100.0 В; I_{PP} = 8.4 A	DO-214AB, SMC	x•x
GBI	SMCJ130CA	STM	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 144.00...182.50 В; V_{WM} = 130.0 В; I_{PP} = 6.5 A	DO-214AB, SMC	x•x
GBL	SMCJ154CA	STM	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 171 В; V_{WM} = 154.0 В; I_{PP} = 6.1 A	DO-214AB, SMC	x•x
GBM	SMCJ170CA	STM	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 189.00...217.50 В; V_{WM} = 170.0 В; I_{PP} = 5.5 A	DO-214AB, SMC	x•x
GBN	SMCJ188CA	STM	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 209 В; V_{WM} = 188.0 В; I_{PP} = 4.6 A	DO-214AB, SMC	x•x
GD	GF1D	VISH	dr	V_R < 200 В; I_F < 1 A; V_F(I_F = 1 A) < 1.1 В	DO-214BA	K•A
GD	GF1D	GS	dr	V_R < 200 В; I_F < 1 A; V_F(I_F = 1 A) < 1.1 В	DO-214BA	K•A
GDD	SMCJ5.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.55 В; V_{WM} = 5.0 В; I_{PP} = 156.2 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDE	1SMC5.0AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.4...7.0 В; V_{WM} = 9.2 В; I_{PP} = 163 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDE	SMCJ5.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.25 В; V_{WM} = 5.0 В; I_{PP} = 163.0 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDF	SMCJ6.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.67...8.45 В; V_{WM} = 6.0 В; I_{PP} = 131.6 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDG	1SMC6.0AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.37 В; V_{WM} = 10.3 В; I_{PP} = 145.6 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDG	SMCJ6.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.67 В; V_{WM} = 6.0 В; I_{PP} = 145.6 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDH	SMCJ6.5	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.22...9.14 В; V_{WM} = 6.5 В; I_{PP} = 122.0 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDK	1SMC6.5AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.22...7.98 В; V_{WM} = 11.2 В; I_{PP} = 133.9 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDK	SMCJ6.5A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.22...8.30 В; V_{WM} = 6.5 В; I_{PP} = 133.9 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDL	SMCJ7.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.78...9.86 В; V_{WM} = 7.0 В; I_{PP} = 112.8 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDM	1SMC7.0AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.78...8.6 В; V_{WM} = 12 В; I_{PP} = 125 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDM	SMCJ7.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.78...8.95 В; V_{WM} = 7.0 В; I_{PP} = 125.0 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDN	SMCJ7.5	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.33...10.80 В; V_{WM} = 7.5 В; I_{PP} = 104.9 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDP	1SMC7.5AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.21 В; V_{WM} = 12.9 В; I_{PP} = 116.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDP	SMCJ7.5A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.58 В; V_{WM} = 7.5 В; I_{PP} = 116.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDQ	SMCJ8.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.89...11.30 В; V_{WM} = 8.0 В; I_{PP} = 100.0 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDR	1SMC8.0AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.89...9.83 В; V_{WM} = 13.6 В; I_{PP} = 110.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDR	SMCJ8.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.89...10.23 В; V_{WM} = 8.0 В; I_{PP} = 110.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDS	SMCJ8.5	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 9.44...11.92 В; V_{WM} = 8.5 В; I_{PP} = 94.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDT	1SMC8.5AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.4 В; V_{WM} = 14.4 В; I_{PP} = 104.2 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDT	SMCJ8.5A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.82 В; V_{WM} = 8.5 В; I_{PP} = 104.2 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDU	SMCJ9.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 10.00...12.80 В; V_{WM} = 9.0 В; I_{PP} = 88.7 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDV	1SMC9.0AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 10...11.1 В; V_{WM} = 15.4 В; I_{PP} = 97.4 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDV	SMCJ9.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 10.00...11.50 В; V_{WM} = 9.0 В; I_{PP} = 97.4 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDW	SMCJ10	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 11.10...14.10 В; V_{WM} = 10.0 В; I_{PP} = 79.8 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDX	1SMC10AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 11.1...12.3 В; V_{WM} = 17 В; I_{PP} = 88.2 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDX	SMCJ10A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 11.10...12.80 В; V_{WM} = 10.0 В; I_{PP} = 88.2 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDY	SMCJ11	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.20...15.40 В; V_{WM} = 11.0 В; I_{PP} = 74.6 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDZ	1SMC11AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.2...13.5 В; V_{WM} = 18.2 В; I_{PP} = 82.4 A	DO-214AB, SMC	K•A
GDZ	SMCJ11A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.20...14.40 В; V_{WM} = 11.0 В; I_{PP} = 82.4 A	DO-214AB, SMC	K•A
GED	SMCJ12	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.30...16.90 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 68.2 A	DO-214AB, SMC	K•A
GEE	1SMC12AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.3...14.7 В; V_{WM} = 19.9 В; I_{PP} = 75.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
GEE	SMCJ12A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.30...15.30 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 75.3 A	DO-214AB, SMC	K•A
GEF	SMCJ13	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.40...18.20 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 63.0 A	DO-214AB, SMC	K•A
GEG	1SMC13AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.4...15.9 В; V_{WM} = 21.5 В; I_{PP} = 69.7 A	DO-214AB, SMC	K•A
GEG	SMCJ13A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.40...16.50 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 69.7 A	DO-214AB, SMC	K•A
GEH	SMCJ14	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.60...19.80 В; V_{WM} = 14.0 В; I_{PP} = 58.1 A	DO-214AB, SMC	K•A
GEK	1SMC14AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.6...17.2 В; V_{WM} = 23.2 В; I_{PP} = 64.7 A	DO-214AB, SMC	K•A
GEK	SMCJ14A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.60...17.90 В; V_{WM} = 14.0 В; I_{PP} = 64.7 A	DO-214AB, SMC	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
GEL	SMCJ15	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=16.70...21.10\,В$; $V_{WM}=15.0\,В$; $I_{PP}=55.8\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEM	1SMC15AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=16.7...18.5\,В$; $V_{WM}=24.4\,В$; $I_{PP}=61.5\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEM	SMCJ15A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=16.70...19.20\,В$; $V_{WM}=15.0\,В$; $I_{PP}=61.5\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEN	SMCJ16	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=17.80...22.60\,В$; $V_{WM}=16.0\,В$; $I_{PP}=52.1\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEP	1SMC16AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=17.8...19.7\,В$; $V_{WM}=26\,В$; $I_{PP}=57.7\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEP	SMCJ16A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=17.80...20.50\,В$; $V_{WM}=16.0\,В$; $I_{PP}=57.7\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEQ	SMCJ17	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=18.90...23.90\,В$; $V_{WM}=17.0\,В$; $I_{PP}=49.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GER	1SMC17AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=18.9...20.9\,В$; $V_{WM}=27.6\,В$; $I_{PP}=53.3\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GER	SMCJ17A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=18.90...21.70\,В$; $V_{WM}=17.0\,В$; $I_{PP}=53.3\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GES	SMCJ18	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=20.00...25.30\,В$; $V_{WM}=18.0\,В$; $I_{PP}=46.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GET	1SMC18AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=20...22.1\,В$; $V_{WM}=29.2\,В$; $I_{PP}=51.4\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GET	SMCJ18A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=20.00...23.30\,В$; $V_{WM}=18.0\,В$; $I_{PP}=51.4\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEU	SMCJ20	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=22.20...28.10\,В$; $V_{WM}=20.0\,В$; $I_{PP}=41.9\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEV	1SMC20AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=22.2...24.5\,В$; $V_{WM}=32.4\,В$; $I_{PP}=46.3\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEV	SMCJ20A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=22.20...25.50\,В$; $V_{WM}=20.0\,В$; $I_{PP}=46.3\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEW	SMCJ22	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=24.40...30.90\,В$; $V_{WM}=22.0\,В$; $I_{PP}=38.1\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEX	1SMC22AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=24.4...26.9\,В$; $V_{WM}=35.5\,В$; $I_{PP}=42.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEX	SMCJ22A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=24.40...28.00\,В$; $V_{WM}=22.0\,В$; $I_{PP}=42.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEY	SMCJ24	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=26.70...33.80\,В$; $V_{WM}=24.0\,В$; $I_{PP}=34.9\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEZ	1SMC24AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=26.7...29.5\,В$; $V_{WM}=38.9\,В$; $I_{PP}=38.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GEZ	SMCJ24A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=26.70...30.70\,В$; $V_{WM}=24.0\,В$; $I_{PP}=38.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFD	SMCJ26	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=28.90...36.80\,В$; $V_{WM}=26.0\,В$; $I_{PP}=32.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFE	1SMC26AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=28.9...31.9\,В$; $V_{WM}=42.1\,В$; $I_{PP}=35.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFE	SMCJ26A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=28.90...33.20\,В$; $V_{WM}=26.0\,В$; $I_{PP}=35.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFF	SMCJ28	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=31.10...39.40\,В$; $V_{WM}=28.0\,В$; $I_{PP}=30.0\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFG	1SMC28AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=31.1...34.4\,В$; $V_{WM}=45.4\,В$; $I_{PP}=33\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFG	SMCJ28A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=31.10...35.80\,В$; $V_{WM}=28.0\,В$; $I_{PP}=33.0\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFH	SMCJ30	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=33.30...42.40\,В$; $V_{WM}=30.0\,В$; $I_{PP}=28.0\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFK	1SMC30AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=33.3...36.8\,В$; $V_{WM}=48.4\,В$; $I_{PP}=31\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFK	SMCJ30A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=33.30...38.30\,В$; $V_{WM}=30.0\,В$; $I_{PP}=31.0\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFL	SMCJ33	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=36.70...46.90\,В$; $V_{WM}=33.0\,В$; $I_{PP}=25.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFM	1SMC33AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=36.7...40.6\,В$; $V_{WM}=53.3\,В$; $I_{PP}=28.1\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFM	SMCJ33A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=36.70...42.20\,В$; $V_{WM}=33.0\,В$; $I_{PP}=28.1\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFN	SMCJ36	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=40.00...50.70\,В$; $V_{WM}=36.0\,В$; $I_{PP}=23.3\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFP	1SMC36AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=40.0...44.2\,В$; $V_{WM}=58.1\,В$; $I_{PP}=25.8\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFP	SMCJ36A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=40.00...46.00\,В$; $V_{WM}=36.0\,В$; $I_{PP}=25.8\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFQ	SMCJ40	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=44.40...56.30\,В$; $V_{WM}=40.0\,В$; $I_{PP}=21.0\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFR	1SMC40AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=44.4...49.1\,В$; $V_{WM}=64.5\,В$; $I_{PP}=32.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFR	SMCJ40A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=44.40...51.10\,В$; $V_{WM}=40.0\,В$; $I_{PP}=23.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFS	SMCJ43	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=47.80...60.50\,В$; $V_{WM}=43.0\,В$; $I_{PP}=19.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFT	1SMC43AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=47.8...52.8\,В$; $V_{WM}=69.4\,В$; $I_{PP}=21.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFT	SMCJ43A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=47.80...54.90\,В$; $V_{WM}=43.0\,В$; $I_{PP}=21.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFU	SMCJ45	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=50.00...63.30\,В$; $V_{WM}=45.0\,В$; $I_{PP}=18.7\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFV	1SMC45AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=50.0...55.3\,В$; $V_{WM}=72.2\,В$; $I_{PP}=20.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFV	SMCJ45A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=50.00...57.50\,В$; $V_{WM}=45.0\,В$; $I_{PP}=20.6\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFW	SMCJ48	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=53.30...67.50\,В$; $V_{WM}=48.0\,В$; $I_{PP}=17.5\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFX	1SMC48AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=53.3...58.9\,В$; $V_{WM}=77.4\,В$; $I_{PP}=19.4\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFX	SMCJ48A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=53.30...61.30\,В$; $V_{WM}=48.0\,В$; $I_{PP}=19.4\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFY	SMCJ51	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=56.70...71.80\,В$; $V_{WM}=51.0\,В$; $I_{PP}=16.5\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFZ	1SMC51AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=56.7...62.7\,В$; $V_{WM}=82.4\,В$; $I_{PP}=18.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GFZ	SMCJ51A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\,мА)=56.70...65.20\,В$; $V_{WM}=51.0\,В$; $I_{PP}=18.2\,А$	DO-214AB, SMC	K•A
GG	GF1G	VISH	dr	$V_R<400\,В$; $I_F<1\,А$; $V_F(I_F=1\,А)<1.1\,В$	DO-214BA	K•A
GG	GF1G	GS	dr	$V_R<400\,В$; $I_F<1\,А$; $V_F(I_F=1\,А)<1.1\,В$	DO-214BA	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
GGD	SMCJ54	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60.00...76.00 В; V_{WM} = 54.0 В; I_{PP} = 15.6 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGE	1SMC54AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60.0...66.3 В; V_{WM} = 87.1 В; I_{PP} = 17.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGE	SMCJ54A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60.00...69.00 В; V_{WM} = 54.0 В; I_{PP} = 17.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGF	SMCJ58	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.40...81.60 В; V_{WM} = 58.0 В; I_{PP} = 14.6 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGG	1SMC58AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.4...71.2 В; V_{WM} = 93.6 В; I_{PP} = 16.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGG	SMCJ58A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.40...74.60 В; V_{WM} = 58.0 В; I_{PP} = 16.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGH	SMCJ60	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.70...84.50 В; V_{WM} = 60.0 В; I_{PP} = 14.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGK	1SMC60AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.7...73.7 В; V_{WM} = 96.8 В; I_{PP} = 15.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGK	SMCJ60A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.70...76.70 В; V_{WM} = 60.0 В; I_{PP} = 15.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGL	SMCJ64	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.10...90.10 В; V_{WM} = 64.0 В; I_{PP} = 13.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGM	1SMC64AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.1...78.6 В; V_{WM} = 103 В; I_{PP} = 14.6 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGM	SMCJ64A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.10...81.80 В; V_{WM} = 64.0 В; I_{PP} = 14.6 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGN	SMCJ70	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.80...98.60 В; V_{WM} = 70.0 В; I_{PP} = 12.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGP	1SMC70AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.8...86 В; V_{WM} = 113 В; I_{PP} = 13.3 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGP	SMCJ70A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.80...89.50 В; V_{WM} = 70.0 В; I_{PP} = 13.3 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGQ	SMCJ75	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.30...106.00 В; V_{WM} = 75.0 В; I_{PP} = 11.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGR	1SMC75AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.3...92.1 В; V_{WM} = 121 В; I_{PP} = 12.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGR	SMCJ75A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.30...95.80 В; V_{WM} = 75.0 В; I_{PP} = 12.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGS	SMCJ78	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.70...110.00 В; V_{WM} = 78.0 В; I_{PP} = 10.8 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGT	1SMC78AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.7...95.8 В; V_{WM} = 126 В; I_{PP} = 11.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGT	SMCJ78A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.70...99.70 В; V_{WM} = 78.0 В; I_{PP} = 11.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGU	SMCJ85	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.40...119.20 В; V_{WM} = 85.0 В; I_{PP} = 9.9 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGV	SMCJ85A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.40...108.20 В; V_{WM} = 85.0 В; I_{PP} = 10.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGW	SMCJ90	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 100.00...126.50 В; V_{WM} = 90.0 В; I_{PP} = 9.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGX	SMCJ90A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 100.00...115.50 В; V_{WM} = 90.0 В; I_{PP} = 10.3 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGY	SMCJ100	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111.00...141.00 В; V_{WM} = 100.0 В; I_{PP} = 8.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GGZ	SMCJ100A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111.00...128.00 В; V_{WM} = 100.0 В; I_{PP} = 9.3 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHD	SMCJ110	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 122.00...154.50 В; V_{WM} = 110.0 В; I_{PP} = 7.7 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHE	SMCJ110A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 122.00...140.50 В; V_{WM} = 110.0 В; I_{PP} = 8.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHF	SMCJ120	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 133.00...169.00 В; V_{WM} = 120.0 В; I_{PP} = 7.0 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHG	SMCJ120A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 133.00...153.00 В; V_{WM} = 120.0 В; I_{PP} = 7.9 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHH	SMCJ130	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144.00...182.50 В; V_{WM} = 130.0 В; I_{PP} = 6.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHK	SMCJ130A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144.00...165.50 В; V_{WM} = 130.0 В; I_{PP} = 7.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHL	SMCJ150	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 167.00...211.50 В; V_{WM} = 150.0 В; I_{PP} = 5.6 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHM	SMCJ150A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 167.00...192.50 В; V_{WM} = 150.0 В; I_{PP} = 6.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHN	SMCJ160	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 178.00...226.00 В; V_{WM} = 160.0 В; I_{PP} = 5.2 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHP	SMCJ160A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 178.00...205.00 В; V_{WM} = 160.0 В; I_{PP} = 5.8 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHQ	SMCJ170	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 189.00...239.50 В; V_{WM} = 170.0 В; I_{PP} = 4.9 А	DO-214AB, SMC	K•A
GHR	SMCJ170A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 189.00...217.50 В; V_{WM} = 170.0 В; I_{PP} = 5.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
GJ	GF1J	VISH	dr	V_R < 600 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214BA	K•A
GJ	GF1J	GS	dr	V_R < 600 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214BA	K•A
GK	GF1K	VISH	dr	V_R < 800 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.2 В	DO-214BA	K•A
GK	GF1K	GS	dr	V_R < 800 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.2 В	DO-214BA	K•A
GM	GF1M	VISH	dr	V_R < 1000 В; I_F < 1А; V_F (I_F = 1 А) < 1.2 В	DO-214BA	K•A
GM	GF1M	GS	dr	V_R < 1000 В; I_F < 1А; V_F (I_F = 1 А) < 1.2 В	DO-214BA	K•A
GUA	SMCJ60A	STM	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.70...76.70 В; V_{WM} = 60.0 В; I_{PP} = 15.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
GUB	SMCJ70A	STM	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.80...89.50 В; V_{WM} = 70.0 В; I_{PP} = 13.3 А	DO-214AB, SMC	K•A
GUE	SMCJ85A	STM	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.40...108.20 В; V_{WM} = 85.0 В; I_{PP} = 10.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GUG	SMCJ100A	STM	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111.00...141.00 В; V_{WM} = 100.0 В; I_{PP} = 8.4 А	DO-214AB, SMC	K•A
GUI	SMCJ130A	STM	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144.00...182.50 В; V_{WM} = 130.0 В; I_{PP} = 6.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
GUL	SMCJ154A	STM	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 171 В, V_{WM} = 154.0 В; I_{PP} = 6.1 А	DO-214AB, SMC	K•A
GUM	SMCJ170A	STM	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 189.00...217.50 В; V_{WM} = 170.0 В; I_{PP} = 5.5 А	DO-214AB, SMC	K•A
GUN	SMCJ188A	STM	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 209 В, V_{WM} = 188.0 В; I_{PP} = 4.6 А	DO-214AB, SMC	K•A





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
HD	SMAJ5.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.30 В; V_{WM} = 9.6 В; I_{PP} = 41.6 А	DO-214AC, SMA	К • А
HE	SMAJ5.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.4...7.0 В; V_{WM} = 9.2 В; I_{PP} = 43.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
HF	SMAJ6.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.67...8.15 В; V_{WM} = 11.4 В; I_{PP} = 35.1 А	DO-214AC, SMA	К • А
HG	SMAJ6.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.37 В; V_{WM} = 10.3 В; I_{PP} = 38.8 А	DO-214AC, SMA	К • А
HH	SMAJ6.5	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.22...8.82 В; V_{WM} = 12.3 В; I_{PP} = 32.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
HK	SMAJ6.5A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.22...7.98 В; V_{WM} = 11.2 В; I_{PP} = 35.7 А	DO-214AC, SMA	К • А
HL	SMAJ7.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.78...9.51 В; V_{WM} = 13.3 В; I_{PP} = 30.1 А	DO-214AC, SMA	К • А
HM	SMAJ7.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 7.78...8.60 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 33.3 А	DO-214AC, SMA	К • А
HN	SMAJ7.5	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.33...10.3 В; V_{WM} = 14.3 В; I_{PP} = 28.0 А	DO-214AC, SMA	К • А
HP	SMAJ7.5A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.21 В; V_{WM} = 12.9 В; I_{PP} = 31.0 А	DO-214AC, SMA	К • А
HQ	SMAJ8.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.89...10.9 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 26.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
HR	SMAJ8.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 8.89...9.83 В; V_{WM} = 13.6 В; I_{PP} = 29.4 А	DO-214AC, SMA	К • А
HS	SMAJ8.5	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 9.44...11.5 В; V_{WM} = 15.9 В; I_{PP} = 25.1 А	DO-214AC, SMA	К • А
HT	SMAJ8.5A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.4 В; V_{WM} = 14.4 В; I_{PP} = 27.7 А	DO-214AC, SMA	К • А
HU	SMAJ9.0	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 10.0...12.2 В; V_{WM} = 16.9 В; I_{PP} = 23.6 А	DO-214AC, SMA	К • А
HV	SMAJ9.0A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 10.0...11.1 В; V_{WM} = 15.4 В; I_{PP} = 26.0 А	DO-214AC, SMA	К • А
HW	SMAJ10	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 11.1...13.6 В; V_{WM} = 18.8 В; I_{PP} = 21.2 А	DO-214AC, SMA	К • А
HX	SMAJ10A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 11.1...12.3 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 23.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
HY	SMAJ11	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.2...14.9 В; V_{WM} = 20.1 В; I_{PP} = 20.0 А	DO-214AC, SMA	К • А
HZ	SMAJ11A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.2...13.5 В; V_{WM} = 18.2 В; I_{PP} = 22.0 А	DO-214AC, SMA	К • А
ID	SMAJ12	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.3...16.3 В; V_{WM} = 22.0 В; I_{PP} = 18.1 А	DO-214AC, SMA	К • А
IE	SMAJ12A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.3...14.7 В; V_{WM} = 19.9 В; I_{PP} = 20.1 А	DO-214AC, SMA	К • А
IF	SMAJ13	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.4...17.6 В; V_{WM} = 23.8 В; I_{PP} = 16.8 А	DO-214AC, SMA	К • А
IG	SMAJ13A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.4...15.9 В; V_{WM} = 21.5 В; I_{PP} = 18.6 А	DO-214AC, SMA	К • А
IH	SMAJ14	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.6...19.1 В; V_{WM} = 25.8 В; I_{PP} = 15.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
IK	SMAJ14A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.6...17.2 В; V_{WM} = 23.2 В; I_{PP} = 17.2 А	DO-214AC, SMA	К • А
IL	SMAJ15	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.7...20.4 В; V_{WM} = 26.9 В; I_{PP} = 14.8 А	DO-214AC, SMA	К • А
IM	SMAJ15A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.7...18.5 В; V_{WM} = 24.4 В; I_{PP} = 16.4 А	DO-214AC, SMA	К • А
IN	SMAJ16	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.8...21.8 В; V_{WM} = 28.8 В; I_{PP} = 13.8 А	DO-214AC, SMA	К • А
IP	SMAJ16A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.8...19.7 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 15.3 А	DO-214AC, SMA	К • А
IQ	SMAJ17	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.9...23.1 В; V_{WM} = 30.5 В; I_{PP} = 13.1 А	DO-214AC, SMA	К • А
IR	SMAJ17A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.9...20.9 В; V_{WM} = 27.6 В; I_{PP} = 14.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
IS	SMAJ18	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.0...24.4 В; V_{WM} = 32.2 В; I_{PP} = 12.4 А	DO-214AC, SMA	К • А
IT	SMAJ18A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.0...22.1 В; V_{WM} = 29.2 В; I_{PP} = 13.7 А	DO-214AC, SMA	К • А
IU	SMAJ20	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.2...27.1 В; V_{WM} = 35.8 В; I_{PP} = 11.1 А	DO-214AC, SMA	К • А
IV	SMAJ20A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.2...24.5 В; V_{WM} = 32.4 В; I_{PP} = 12.3 А	DO-214AC, SMA	К • А
IW	SMAJ22	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.4...29.8 В; V_{WM} = 39.4 В; I_{PP} = 10.1 А	DO-214AC, SMA	К • А
IX	SMAJ22A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.4...26.9 В; V_{WM} = 35.5 В; I_{PP} = 11.2 А	DO-214AC, SMA	К • А
IY	SMAJ24	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 26.7...32.6 В; V_{WM} = 43.0 В; I_{PP} = 9.3 А	DO-214AC, SMA	К • А
IZ	SMAJ24A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 26.7...29.5 В; V_{WM} = 38.9 В; I_{PP} = 10.3 А	DO-214AC, SMA	К • А
JD	SMAJ26	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.9...31.9 В; V_{WM} = 46.6 В; I_{PP} = 8.6 А	DO-214AC, SMA	К • А
JE	SMAJ26A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.9...25.3 В; V_{WM} = 42.1 В; I_{PP} = 9.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
JF	SMAJ28	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.1...38.0 В; V_{WM} = 50.0 В; I_{PP} = 8.0 А	DO-214AC, SMA	К • А
JG	SMAJ28A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.1...34.4 В; V_{WM} = 45.4 В; I_{PP} = 8.8 А	DO-214AC, SMA	К • А
JH	SMAJ30	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 33.3...40.7 В; V_{WM} = 53.5 В; I_{PP} = 7.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
JK	SMAJ30A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 33.3...36.8 В; V_{WM} = 48.4 В; I_{PP} = 8.3 А	DO-214AC, SMA	К • А
JL	SMAJ33	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 36.7...44.9 В; V_{WM} = 59.0 В; I_{PP} = 6.8 А	DO-214AC, SMA	К • А
JM	SMAJ33A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 36.7...40.6 В; V_{WM} = 53.3 В; I_{PP} = 7.5 А	DO-214AC, SMA	К • А
JN	SMAJ36	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 40.0...48.9 В; V_{WM} = 64.3 В; I_{PP} = 6.2 А	DO-214AC, SMA	К • А
JP	SMAJ36A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 40.0...44.2 В; V_{WM} = 58.1 В; I_{PP} = 6.9 А	DO-214AC, SMA	К • А
JQ	SMAJ40	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 44.4...54.3 В; V_{WM} = 71.4 В; I_{PP} = 5.6 А	DO-214AC, SMA	К • А
JR	SMAJ40A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 44.4...49.1 В; V_{WM} = 64.5 В; I_{PP} = 6.2 А	DO-214AC, SMA	К • А
JS	SMAJ43	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 47.8...58.4 В; V_{WM} = 76.7 В; I_{PP} = 5.2 А	DO-214AC, SMA	К • А

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
JT	SMAJ43A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 47.8...52.8В; V_{WM} = 69.4В; I_{PP} = 5.7А	DO-214AC, SMA	K•A
JU	SMAJ45	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 50.0...61.1В; V_{WM} = 80.3В; I_{PP} = 5.0А	DO-214AC, SMA	K•A
JV	SMAJ45A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 50.0...55.3В; V_{WM} = 72.7В; I_{PP} = 5.5А	DO-214AC, SMA	K•A
JW	SMAJ48	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.3...65.1В; V_{WM} = 85.5В; I_{PP} = 4.7А	DO-214AC, SMA	K•A
JX	SMAJ48A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.3...58.9В; V_{WM} = 77.4В; I_{PP} = 5.2А	DO-214AC, SMA	K•A
JY	SMAJ51	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.7...69.3В; V_{WM} = 91.1В; I_{PP} = 4.4А	DO-214AC, SMA	K•A
JZ	SMAJ51A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.7...62.7В; V_{WM} = 82.4В; I_{PP} = 4.9А	DO-214AC, SMA	K•A
KD	SMBJ5.0	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.40...7.55В; V_{WM} = 5.0В; I_{PP} = 62.5А	DO-214AA, SMB	K•A
KDP	TPSMB6.8	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.12...7.48В; V_{WM} = 5.50В; I_{PP} = 55.6А	DO-214AA, SMB	K•A
KE	1SMB5.0AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.4...7.0В; V_{WM} = 9.2В; I_{PP} = 65.2А	DO-214AA, SMB	K•A
KE	SMBJ5.0A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.40...7.23В; V_{WM} = 5.0В; I_{PP} = 65.2А	DO-214AA, SMB	K•A
KEP	TPSMB6.8A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.45...7.14В; V_{WM} = 5.80В; I_{PP} = 57.1А	DO-214AA, SMB	K•A
KF	SMBJ6.0	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.67...8.45В; V_{WM} = 6.0В; I_{PP} = 52.6А	DO-214AA, SMB	K•A
KFP	TPSMB7.5	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.75...8.25В; V_{WM} = 6.05В; I_{PP} = 51.3А	DO-214AA, SMB	K•A
KG	1SMB6.0AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.67...7.37В; V_{WM} = 10.3В; I_{PP} = 58.3А	DO-214AA, SMB	K•A
KG	SMBJ6.0A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 6.67...7.67В; V_{WM} = 6.0В; I_{PP} = 58.3А	DO-214AA, SMB	K•A
KGP	TPSMB7.5A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.13...7.88В; V_{WM} = 6.40В; I_{PP} = 53.1А	DO-214AA, SMB	K•A
KH	SMBJ6.5	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.22...9.14В; V_{WM} = 6.5В; I_{PP} = 48.7А	DO-214AA, SMB	K•A
KHP	TPSMB8.2	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.38...9.02В; V_{WM} = 6.63В; I_{PP} = 48.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KK	1SMB6.5AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.22...7.98В; V_{WM} = 11.2В; I_{PP} = 53.6А	DO-214AA, SMB	K•A
KK	SMBJ6.5A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.22...8.30В; V_{WM} = 6.5В; I_{PP} = 53.6А	DO-214AA, SMB	K•A
KKP	TPSMB8.2A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.79...8.61В; V_{WM} = 7.02В; I_{PP} = 49.6А	DO-214AA, SMB	K•A
KL	SMBJ7.0	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.78...9.86В; V_{WM} = 7.0В; I_{PP} = 45.1А	DO-214AA, SMB	K•A
KLP	TPSMB9.1	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.19...10.0В; V_{WM} = 7.37В; I_{PP} = 43.5А	DO-214AA, SMB	K•A
KM	1SMB7.0AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.78...8.6В; V_{WM} = 12.0В; I_{PP} = 50.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KM	SMBJ7.0A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0мА) = 7.78...8.95В; V_{WM} = 7.0В; I_{PP} = 50.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KMP	TPSMB9.1A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.65...9.55В; V_{WM} = 7.78В; I_{PP} = 44.8А	DO-214AA, SMB	K•A
KN	SMBJ7.5	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...10.80В; V_{WM} = 7.5В; I_{PP} = 42.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KNP	TPSMB10	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.00...11.0В; V_{WM} = 8.10В; I_{PP} = 40.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KP	1SMB7.5AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.21В; V_{WM} = 12.9В; I_{PP} = 46.5А	DO-214AA, SMB	K•A
KP	SMBJ7.5A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.58В; V_{WM} = 7.5В; I_{PP} = 46.5А	DO-214AA, SMB	K•A
KPP	TPSMB10A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.50...10.5В; V_{WM} = 8.55В; I_{PP} = 41.4А	DO-214AA, SMB	K•A
KQ	SMBJ8.0	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...11.30В; V_{WM} = 8.0В; I_{PP} = 40.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KQP	TPSMB11	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.90...12.1В; V_{WM} = 8.92В; I_{PP} = 37.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KR	1SMB8.0AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...9.83В; V_{WM} = 13.6В; I_{PP} = 44.1А	DO-214AA, SMB	K•A
KR	SMBJ8.0A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...10.23В; V_{WM} = 8.0В; I_{PP} = 44.1А	DO-214AA, SMB	K•A
KRP	TPSMB11A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.5...11.6В; V_{WM} = 9.40В; I_{PP} = 38.5А	DO-214AA, SMB	K•A
KS	SMBJ8.5	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...11.92В; V_{WM} = 8.5В; I_{PP} = 37.7А	DO-214AA, SMB	K•A
KSP	TPSMB12	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.8...13.2В; V_{WM} = 9.72В; I_{PP} = 34.7А	DO-214AA, SMB	K•A
KT	1SMB8.5AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.4В; V_{WM} = 14.4В; I_{PP} = 41.7А	DO-214AA, SMB	K•A
KT	SMBJ8.5A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.82В; V_{WM} = 8.5В; I_{PP} = 41.7А	DO-214AA, SMB	K•A
KTP	TPSMB12A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.4...12.6В; V_{WM} = 10.2В; I_{PP} = 35.9А	DO-214AA, SMB	K•A
KU	SMBJ9.0	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.00...12.80В; V_{WM} = 9.0В; I_{PP} = 35.5А	DO-214AA, SMB	K•A
KUP	TPSMB13	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.7...14.3В; V_{WM} = 10.5В; I_{PP} = 31.6А	DO-214AA, SMB	K•A
KV	1SMB9.0AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.0...11.1В; V_{WM} = 15.4В; I_{PP} = 39А	DO-214AA, SMB	K•A
KV	SMBJ9.0A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.00...11.50В; V_{WM} = 9.0В; I_{PP} = 39.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KVP	TPSMB13A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.4...13.7В; V_{WM} = 11.1В; I_{PP} = 33.0А	DO-214AA, SMB	K•A
KW	SMBJ10	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.10...14.10В; V_{WM} = 10.0В; I_{PP} = 31.9А	DO-214AA, SMB	K•A
KWP	TPSMB15	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.5...16.5В; V_{WM} = 12.1В; I_{PP} = 27.3А	DO-214AA, SMB	K•A
KX	1SMB10AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.1...12.3В; V_{WM} = 17В; I_{PP} = 35.3А	DO-214AA, SMB	K•A
KX	SMBJ10A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.10...12.80В; V_{WM} = 10.0В; I_{PP} = 35.3А	DO-214AA, SMB	K•A
KXC	1SMB10CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.1...12.27В; V_{WM} = 17В; I_{PP} = 35.3А	DO-214AA, SMB	x•x
KXP	TPSMB15A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.3...15.8В; V_{WM} = 12.8В; I_{PP} = 28.3А	DO-214AA, SMB	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
KY	SMBJ11	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.20...15.40 В; V_{WM} = 11.0 В; I_{PP} = 29.9 А	DO-214AA, SMB	К•А
KYP	TPSMB16	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.4...17.6 В; V_{WM} = 12.9 В; I_{PP} = 25.5 А	DO-214AA, SMB	К•А
KZ	1SMB11AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.2...13.5 В; V_{WM} = 18.2 В; I_{PP} = 33 А	DO-214AA, SMB	К•А
KZ	SMBJ11A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.20...14.40 В; V_{WM} = 11.0 В; I_{PP} = 33.0 А	DO-214AA, SMB	К•А
KZC	1SMB11CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 12.2...13.5 В; V_{WM} = 18.2 В; I_{PP} = 33 А	DO-214AA, SMB	х•х
KZP	TPSMB16A	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.2...16.8 В; V_{WM} = 13.6 В; I_{PP} = 26.7 А	DO-214AA, SMB	К•А
LD	SMBJ12	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.30...16.90 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 27.3 А	DO-214AA, SMB	К•А
LDP	TPSMB18	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.2...19.8 В; V_{WM} = 14.5 В; I_{PP} = 22.6 А	DO-214AA, SMB	К•А
LE	1SMB12AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.3...14.7 В; V_{WM} = 19.9 В; I_{PP} = 30.2 А	DO-214AA, SMB	К•А
LE	SMBJ12A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.30...15.30 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 30.2 А	DO-214AA, SMB	К•А
LEC	1SMB12CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 13.3...14.7 В; V_{WM} = 19.9 В; I_{PP} = 30.2 А	DO-214AA, SMB	х•х
LEP	TPSMB18A	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.1...18.9 В; V_{WM} = 15.3 В; I_{PP} = 23.8 А	DO-214AA, SMB	К•А
LF	SMBJ13	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.40...18.20 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 25.2 А	DO-214AA, SMB	К•А
LFP	TPSMB20	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.0...22.0 В; V_{WM} = 16.2 В; I_{PP} = 20.6 А	DO-214AA, SMB	К•А
LG	1SMB13AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.4...15.9 В; V_{WM} = 21.5 В; I_{PP} = 27.9 А	DO-214AA, SMB	К•А
LG	SMBJ13A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.40...16.50 В; V_{WM} = 13.0 В; I_{PP} = 27.9 А	DO-214AA, SMB	К•А
LGC	1SMB13CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 14.4...15.9 В; V_{WM} = 21.5 В; I_{PP} = 27.9 А	DO-214AA, SMB	х•х
LH	SMBJ14	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.60...19.80 В; V_{WM} = 14.0 В; I_{PP} = 23.3 А	DO-214AA, SMB	К•А
LHP	TPSMB22	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 19.8...24.2 В; V_{WM} = 17.8 В; I_{PP} = 18.8 А	DO-214AA, SMB	К•А
LK	1SMB14AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.6...17.2 В; V_{WM} = 23.2 В; I_{PP} = 25.8 А	DO-214AA, SMB	К•А
LK	SMBJ14A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.60...17.90 В; V_{WM} = 14.0 В; I_{PP} = 25.8 А	DO-214AA, SMB	К•А
LKC	1SMB14CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.6...17.2 В; V_{WM} = 23.2 В; I_{PP} = 25.8 А	DO-214AA, SMB	х•х
LKP	TPSMB22A	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.9...23.1 В; V_{WM} = 18.8 В; I_{PP} = 19.6 А	DO-214AA, SMB	К•А
LL	SMBJ15	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.70...21.10 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 22.3 А	DO-214AA, SMB	К•А
LLP	TPSMB24	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 21.6...26.4 В; V_{WM} = 19.4 В; I_{PP} = 17.3 А	DO-214AA, SMB	К•А
LM	1SMB15AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.7...18.5 В; V_{WM} = 24.4 В; I_{PP} = 24 А	DO-214AA, SMB	К•А
LM	SMBJ15A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.70...19.20 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 24.0 А	DO-214AA, SMB	К•А
LMC	1SMB15CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.7...18.5 В; V_{WM} = 24.4 В; I_{PP} = 24 А	DO-214AA, SMB	х•х
LMP	TPSMB24A	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.8...25.2 В; V_{WM} = 20.5 В; I_{PP} = 18.1 А	DO-214AA, SMB	К•А
LN	SMBJ16	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.80...22.60 В; V_{WM} = 16.0 В; I_{PP} = 20.8 А	DO-214AA, SMB	К•А
LNP	TPSMB27	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.3...29.7 В; V_{WM} = 21.8 В; I_{PP} = 15.3 А	DO-214AA, SMB	К•А
LP	1SMB16AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.8...19.7 В; V_{WM} = 26 В; I_{PP} = 23.1 А	DO-214AA, SMB	К•А
LP	SMBJ16A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.80...20.50 В; V_{WM} = 16.0 В; I_{PP} = 23.1 А	DO-214AA, SMB	К•А
LPC	1SMB16CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.8...19.7 В; V_{WM} = 26 В; I_{PP} = 23.1 А	DO-214AA, SMB	х•х
LPP	TPSMB27A	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 25.7...28.4 В; V_{WM} = 23.1 В; I_{PP} = 16.0 А	DO-214AA, SMB	К•А
LQ	SMBJ17	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.90...23.90 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 19.7 А	DO-214AA, SMB	К•А
LQP	TPSMB30	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 27.0...33.0 В; V_{WM} = 24.3 В; I_{PP} = 13.8 А	DO-214AA, SMB	К•А
LR	1SMB17AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.9...20.9 В; V_{WM} = 27.6 В; I_{PP} = 21.7 А	DO-214AA, SMB	К•А
LR	SMBJ17A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.90...21.70 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 21.7 А	DO-214AA, SMB	К•А
LRC	1SMB17CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.9...20.9 В; V_{WM} = 27.6 В; I_{PP} = 21.7 А	DO-214AA, SMB	х•х
LRP	TPSMB30A	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.5...31.5 В; V_{WM} = 25.6 В; I_{PP} = 14.5 А	DO-214AA, SMB	К•А
LS	SMBJ18	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.00...25.30 В; V_{WM} = 18.0 В; I_{PP} = 18.6 А	DO-214AA, SMB	К•А
LSP	TPSMB33	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 29.7...36.3 В; V_{WM} = 26.8 В; I_{PP} = 12.6 А	DO-214AA, SMB	К•А
LT	1SMB18AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.0...22.1 В; V_{WM} = 29.2 В; I_{PP} = 20.5 А	DO-214AA, SMB	К•А
LT	SMBJ18A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.00...23.30 В; V_{WM} = 18.0 В; I_{PP} = 20.5 А	DO-214AA, SMB	К•А
LTC	1SMB18CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.0...22.1 В; V_{WM} = 29.2 В; I_{PP} = 20.5 А	DO-214AA, SMB	х•х
LTP	TPSMB33A	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.4...34.7 В; V_{WM} = 28.2 В; I_{PP} = 13.1 А	DO-214AA, SMB	К•А
LU	SMBJ20	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.20...28.10 В; V_{WM} = 20.0 В; I_{PP} = 16.7 А	DO-214AA, SMB	К•А
LUP	TPSMB36	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 32.4...39.6 В; V_{WM} = 29.1 В; I_{PP} = 11.5 А	DO-214AA, SMB	К•А
LV	1SMB20AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.2...24.5 В; V_{WM} = 32.4 В; I_{PP} = 18.5 А	DO-214AA, SMB	К•А
LV	SMBJ20A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.20...25.50 В; V_{WM} = 20.0 В; I_{PP} = 18.5 А	DO-214AA, SMB	К•А
LVC	1SMB20CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.2...24.5 В; V_{WM} = 32.4 В; I_{PP} = 18.5 А	DO-214AA, SMB	х•х
LVP	TPSMB36A	GS	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 34.2...37.8 В; V_{WM} = 30.8 В; I_{PP} = 12.0 А	DO-214AA, SMB	К•А

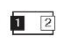
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
LW	SMBJ22	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 24.40...30.90 В; V_{WM} = 22.0 В; I_{PP} = 15.2 А	DO-214AA, SMB	K • A
LWP	TPSMB39	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 35.1...42.9В; V_{WM} = 31.6В; I_{PP} = 10.6 А	DO-214AA, SMB	K • A
LX	1SMB22AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 24.4...26.9В; V_{WM} = 35.5В; I_{PP} = 16.9 А	DO-214AA, SMB	K • A
LX	SMBJ22A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 24.40...28.00 В; V_{WM} = 22.0 В; I_{PP} = 16.9 А	DO-214AA, SMB	K • A
LXC	1SMB22CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 24.4...26.9В; V_{WM} = 35.5В; I_{PP} = 16.9 А	DO-214AA, SMB	x • x
LXP	TPSMB39A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 37.1...41.0В; V_{WM} = 33.3В; I_{PP} = 11.1 А	DO-214AA, SMB	K • A
LY	SMBJ24	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 26.70...33.80 В; V_{WM} = 24.0 В; I_{PP} = 14.0 А	DO-214AA, SMB	K • A
LYP	TPSMB43	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 38.7...47.3В; V_{WM} = 34.8В; I_{PP} = 9.7А	DO-214AA, SMB	K • A
LZ	1SMB24AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 26.7...29.5В; V_{WM} = 38.9В; I_{PP} = 15.4 А	DO-214AA, SMB	K • A
LZ	SMBJ24A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 26.70...30.70 В; V_{WM} = 24.0 В; I_{PP} = 15.4 А	DO-214AA, SMB	K • A
LZC	1SMB24CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 26.7...29.5В; V_{WM} = 38.9В; I_{PP} = 15.4 А	DO-214AA, SMB	x • x
LZP	TPSMB43A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 40.9...45.2В; V_{WM} = 36.8В; I_{PP} = 10.1 А	DO-214AA, SMB	K • A
MD	SMBJ26	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.90...36.80 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 12.4 А	DO-214AA, SMB	K • A
ME	1SMB26AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.9...31.9В; V_{WM} = 42.1В; I_{PP} = 14.2 А	DO-214AA, SMB	K • A
ME	SMBJ26A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.90...33.20 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 14.2 А	DO-214AA, SMB	K • A
MEC	1SMB26CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.9...31.9В; V_{WM} = 42.1В; I_{PP} = 14.2 А	DO-214AA, SMB	x • x
MF	SMBJ28	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 31.10...39.40 В; V_{WM} = 28.0 В; I_{PP} = 12.0 А	DO-214AA, SMB	K • A
MG	1SMB28AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 31.1...34.4В; V_{WM} = 45.4В; I_{PP} = 13.2 А	DO-214AA, SMB	K • A
MG	SMBJ28A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 31.10...35.80 В; V_{WM} = 28.0 В; I_{PP} = 13.2 А	DO-214AA, SMB	K • A
MGC	1SMB28CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 31.1...34.4В; V_{WM} = 45.4В; I_{PP} = 13.2 А	DO-214AA, SMB	x • x
MH	SMB30	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 33.30...42.20 В; V_{WM} = 30.0 В; I_{PP} = 11.2 А	DO-214AC, SMA	K • A
MK	1SMB30AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 33.3...36.8В; V_{WM} = 48.4В; I_{PP} = 12.4 А	DO-214AA, SMB	K • A
MK	SMBJ30A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 33.30...38.30 В; V_{WM} = 30.0 В; I_{PP} = 12.4 А	DO-214AA, SMB	K • A
MKC	1SMB30CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 33.3...36.8В; V_{WM} = 48.4В; I_{PP} = 12.4 А	DO-214AA, SMB	x • x
ML	SMBJ33	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 36.70...46.90 В; V_{WM} = 33.0 В; I_{PP} = 10.2 А	DO-214AA, SMB	K • A
MM	1SMB33AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 36.7...40.6В; V_{WM} = 53.3В; I_{PP} = 11.3 А	DO-214AA, SMB	K • A
MM	SMBJ33A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 36.70...42.20 В; V_{WM} = 33.0 В; I_{PP} = 11.3 А	DO-214AA, SMB	K • A
MMC	1SMB33CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 36.7...40.6В; V_{WM} = 53.3В; I_{PP} = 11.3 А	DO-214AA, SMB	x • x
MN	SMBJ36	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 40.00...50.70 В; V_{WM} = 36.0 В; I_{PP} = 9.3 А	DO-214AA, SMB	K • A
MP	1SMB36AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 40.0...44.2В; V_{WM} = 58.1В; I_{PP} = 10.3 А	DO-214AA, SMB	K • A
MP	SMBJ36A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 40.00...46.00 В; V_{WM} = 36.0 В; I_{PP} = 10.3 А	DO-214AA, SMB	K • A
MPC	1SMB36CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 40.0...44.2В; V_{WM} = 58.1В; I_{PP} = 10.3 А	DO-214AA, SMB	x • x
MQ	SMBJ40	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 44.40...56.30 В; V_{WM} = 40.0 В; I_{PP} = 8.4 А	DO-214AA, SMB	K • A
MR	1SMB40AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 44.4...49.1В; V_{WM} = 64.5В; I_{PP} = 9.3А	DO-214AA, SMB	K • A
MR	SMBJ40A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 44.40...51.10 В; V_{WM} = 40.0 В; I_{PP} = 9.3 А	DO-214AA, SMB	K • A
MRC	1SMB40CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 44.4...49.1В; V_{WM} = 64.5В; I_{PP} = 9.3А	DO-214AA, SMB	x • x
MS	SMBJ43	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 47.80...60.50 В; V_{WM} = 43.0 В; I_{PP} = 7.8 А	DO-214AA, SMB	K • A
MT	1SMB43AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 47.8...52.8В; V_{WM} = 69.4В; I_{PP} = 8.6А	DO-214AA, SMB	K • A
MT	SMBJ43A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 47.80...54.90 В; V_{WM} = 43.0 В; I_{PP} = 8.6 А	DO-214AA, SMB	K • A
MTC	1SMB43CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 47.8...52.8В; V_{WM} = 69.4В; I_{PP} = 8.6А	DO-214AA, SMB	x • x
MU	SMBJ45	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 50.00...63.30 В; V_{WM} = 45.0 В; I_{PP} = 7.5 А	DO-214AA, SMB	K • A
MV	1SMB45AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 50.0...55.3В; V_{WM} = 72.7В; I_{PP} = 8.3А	DO-214AA, SMB	K • A
MV	SMBJ45A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 50.00...57.50 В; V_{WM} = 45.0 В; I_{PP} = 8.3 А	DO-214AA, SMB	K • A
MVC	1SMB45CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 50.0...55.3В; V_{WM} = 72.7В; I_{PP} = 8.3А	DO-214AA, SMB	x • x
MW	SMBJ48	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.30...67.50 В; V_{WM} = 48.0 В; I_{PP} = 7.0 А	DO-214AA, SMB	K • A
MX	1SMB48AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.3...58.9В; V_{WM} = 77.4В; I_{PP} = 7.7А	DO-214AA, SMB	K • A
MX	SMBJ48A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.30...61.30 В; V_{WM} = 48.0 В; I_{PP} = 7.7 А	DO-214AA, SMB	K • A
MXC	1SMB48CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.3...58.9В; V_{WM} = 77.4В; I_{PP} = 7.7А	DO-214AA, SMB	x • x
MY	SMBJ51	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.70...71.80 В; V_{WM} = 51.0 В; I_{PP} = 6.6 А	DO-214AA, SMB	K • A
MZ	1SMB51AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.7...62.7В; V_{WM} = 82.4В; I_{PP} = 7.3А	DO-214AA, SMB	K • A
MZ	SMBJ51A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.70...65.20 В; V_{WM} = 51.0 В; I_{PP} = 7.3 А	DO-214AA, SMB	K • A
MZC	1SMB51CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.7...62.7В; V_{WM} = 82.4В; I_{PP} = 7.3А	DO-214AA, SMB	x • x
ND	SMBJ54	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60.00...76.00 В; V_{WM} = 54.0 В; I_{PP} = 6.2 А	DO-214AA, SMB	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
NE	1SMB54AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 60.0...66.3В; V_{WM} = 87.1В; I_{PP} = 6.9А	DO-214AA, SMB	K•A
NE	SMBJ54A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 60.00...69.00В; V_{WM} = 54.0В; I_{PP} = 6.9А	DO-214AA, SMB	K•A
NEC	1SMB54CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 60.0...66.3В; V_{WM} = 87.1В; I_{PP} = 6.9А	DO-214AA, SMB	x•x
NF	SMBJ58	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 64.40...81.60В; V_{WM} = 58.0В; I_{PP} = 5.8А	DO-214AA, SMB	K•A
NG	1SMB58AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 64.4...71.2В; V_{WM} = 93.6В; I_{PP} = 6.4А	DO-214AA, SMB	K•A
NG	SMBJ58A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 64.40...74.60В; V_{WM} = 58.0В; I_{PP} = 6.4А	DO-214AA, SMB	K•A
NGC	1SMB58CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 64.4...71.18В; V_{WM} = 93.6В; I_{PP} = 6.4А	DO-214AA, SMB	K•A
NH	SMBJ60	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 66.70...84.50В; V_{WM} = 60.0В; I_{PP} = 5.6А	DO-214AA, SMB	K•A
NK	1SMB60AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 66.7...73.7В; V_{WM} = 96.8В; I_{PP} = 6.2А	DO-214AA, SMB	K•A
NK	SMBJ60A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 66.70...76.70В; V_{WM} = 60.0В; I_{PP} = 6.2А	DO-214AA, SMB	K•A
NKC	1SMB60CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 66.7...73.72В; V_{WM} = 96.8В; I_{PP} = 6.2А	DO-214AA, SMB	x•x
NL	SMBJ64	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 71.10...90.10В; V_{WM} = 64.0В; I_{PP} = 5.3А	DO-214AA, SMB	K•A
NM	1SMB64AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 71.1...78.6В; V_{WM} = 103В; I_{PP} = 5.8А	DO-214AA, SMB	K•A
NM	SMBJ64A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 71.10...81.80В; V_{WM} = 64.0В; I_{PP} = 5.8А	DO-214AA, SMB	K•A
NMC	1SMB64CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 71.1...78.58В; V_{WM} = 103В; I_{PP} = 5.8А	DO-214AA, SMB	x•x
NN	SMBJ70	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 77.80...98.60В; V_{WM} = 70.0В; I_{PP} = 4.8А	DO-214AA, SMB	K•A
NP	1SMB70AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 77.8...86В; V_{WM} = 113В; I_{PP} = 5.3А	DO-214AA, SMB	K•A
NP	SMBJ70A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 77.80...89.50В; V_{WM} = 70.0В; I_{PP} = 5.3А	DO-214AA, SMB	K•A
NPC	1SMB70CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 77.8...85.99В; V_{WM} = 113В; I_{PP} = 5.3А	DO-214AA, SMB	x•x
NQ	SMBJ75	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 83.30...106.00В; V_{WM} = 75.0В; I_{PP} = 4.5А	DO-214AA, SMB	K•A
NR	1SMB75AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 83.3...92.1В; V_{WM} = 121В; I_{PP} = 4.9А	DO-214AA, SMB	K•A
NR	SMBJ75A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 83.30...95.80В; V_{WM} = 75.0В; I_{PP} = 4.9А	DO-214AA, SMB	K•A
NRC	1SMB75CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 83.3...92.07В; V_{WM} = 121В; I_{PP} = 4.9А	DO-214AA, SMB	x•x
NS	SMBJ78	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 86.70...110.00В; V_{WM} = 78.0В; I_{PP} = 4.3А	DO-214AA, SMB	K•A
NT	1SMB78AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 86.7...95.83В; V_{WM} = 126В; I_{PP} = 4.7А	DO-214AA, SMB	K•A
NT	SMBJ78A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 86.70...99.70В; V_{WM} = 78.0В; I_{PP} = 4.7А	DO-214AA, SMB	K•A
NTC	1SMB78CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 86.7...95.83В; V_{WM} = 126В; I_{PP} = 4.7А	DO-214AA, SMB	x•x
NU	SMBJ85	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 94.40...119.20В; V_{WM} = 85.0В; I_{PP} = 3.9А	DO-214AA, SMB	K•A
NV	1SMB85AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 94.4...104В; V_{WM} = 137В; I_{PP} = 4.4А	DO-214AA, SMB	K•A
NV	SMBJ85A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 94.40...108.20В; V_{WM} = 85.0В; I_{PP} = 4.4А	DO-214AA, SMB	K•A
NW	SMBJ90	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 100.0...126.50В; V_{WM} = 90.0В; I_{PP} = 3.8А	DO-214AA, SMB	K•A
NX	1SMB90AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 100...111В; V_{WM} = 146В; I_{PP} = 4.1А	DO-214AA, SMB	K•A
NX	SMBJ90A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 100.0...115.50В; V_{WM} = 90.0В; I_{PP} = 4.1А	DO-214AA, SMB	K•A
NY	SMBJ100	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 111.0...141.00В; V_{WM} = 100.0В; I_{PP} = 3.4А	DO-214AA, SMB	K•A
NZ	1SMB100AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 111...123В; V_{WM} = 162В; I_{PP} = 3.7А	DO-214AA, SMB	K•A
NZ	SMBJ100A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 111.0...128.00В; V_{WM} = 100.0В; I_{PP} = 3.7А	DO-214AA, SMB	K•A
PD	SMBJ110	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 122.0...154.50В; V_{WM} = 110.0В; I_{PP} = 3.0А	DO-214AA, SMB	K•A
PE	1SMB110AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 122...135В; V_{WM} = 177В; I_{PP} = 3.4А	DO-214AA, SMB	K•A
PE	SMBJ110A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 122.0...140.00В; V_{WM} = 110.0В; I_{PP} = 3.4А	DO-214AA, SMB	K•A
PF	SMBJ120	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 10 мА) = 133.0...169.00В; V_{WM} = 120.0В; I_{PP} = 2.8А	DO-214AA, SMB	K•A
PG	1SMB120AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 133...147В; V_{WM} = 193В; I_{PP} = 3.1А	DO-214AA, SMB	K•A
PG	SMBJ120A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 133.0...153.00В; V_{WM} = 120.0В; I_{PP} = 3.1А	DO-214AA, SMB	K•A
PH	SMBJ130	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 144.0...182.50В; V_{WM} = 130.0В; I_{PP} = 2.6А	DO-214AA, SMB	K•A
PK	1SMB130AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 144...159В; V_{WM} = 209В; I_{PP} = 2.9А	DO-214AA, SMB	K•A
PK	SMBJ130A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 144.0...165.50В; V_{WM} = 130.0В; I_{PP} = 2.9А	DO-214AA, SMB	K•A
PL	SMBJ150	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 167.0...211.50В; V_{WM} = 150.0В; I_{PP} = 2.2А	DO-214AA, SMB	K•A
PM	1SMB150AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 167...185В; V_{WM} = 243В; I_{PP} = 2.5А	DO-214AA, SMB	K•A
PM	SMBJ150A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 167.0...192.50В; V_{WM} = 150.0В; I_{PP} = 2.5А	DO-214AA, SMB	K•A
PN	SMBJ160	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 178.0...226.00В; V_{WM} = 160.0В; I_{PP} = 2.1А	DO-214AA, SMB	K•A
PP	1SMB160AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 178...197В; V_{WM} = 259В; I_{PP} = 2.3А	DO-214AA, SMB	K•A
PR	1SMB170AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 189...209В; V_{WM} = 275В; I_{PP} = 2.2А	DO-214AA, SMB	K•A
QE	1SMA5.0AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.4...7.0В; V_{WM} = 9.2В; I_{PP} = 43.5А	DO-214AC, SMA	K•A
QG	1SMA6.0AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.37В; V_{WM} = 10.3В; I_{PP} = 38.8А	DO-214AC, SMA	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
QK	1SMA6.5AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.22...7.98 В; V_{WM} = 11.2 В; I_{PP} = 35.7 А	DO-214AC, SMA	K • A
QM	1SMA7.0AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.78...8.6 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 33.3 А	DO-214AC, SMA	K • A
QP	1SMA7.5AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.21 В; V_{WM} = 12.9 В; I_{PP} = 31.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
QR	1SMA8.0AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...9.83 В; V_{WM} = 13.6 В; I_{PP} = 29.4 А	DO-214AC, SMA	K • A
QT	1SMA8.5AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.4 В; V_{WM} = 14.4 В; I_{PP} = 27.8 А	DO-214AC, SMA	K • A
QV	1SMA9.0AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10...11.1 В; V_{WM} = 15.4 В; I_{PP} = 26.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
QX	1SMA10AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.1...12.3 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 23.5 А	DO-214AC, SMA	K • A
QXC	1SMA10CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.1...12.27 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 23.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
QZ	1SMA11AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.2...13.5 В; V_{WM} = 18.2 В; I_{PP} = 22.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
QZC	1SMA11CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.2...13.48 В; V_{WM} = 18.2 В; I_{PP} = 22.0 А	DO-214AC, SMA	x • x
RA	RGF1A	VISH	dr	V_R < 50 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.3 В; C_D = 8.5 пФ	DO-214BA	K • A
RB	RGF1B	VISH	dr	V_R < 100 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.3 В; C_D = 8.5 пФ	DO-214BA	K • A
RD	RGF1D	VISH	dr	V_R < 200 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.3 В; C_D = 8.5 пФ	DO-214BA	K • A
RD	SMAJ54	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60.0...73.3 В; V_{WM} = 96.3 В; I_{PP} = 4.2 А	DO-214AC, SMA	K • A
RE	1SMA12AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.3...14.7 В; V_{WM} = 19.9 В; I_{PP} = 20.1 А	DO-214AC, SMA	K • A
RE	SMAJ54A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60.0...66.3 В; V_{WM} = 87.1 В; I_{PP} = 4.6 А	DO-214AC, SMA	K • A
REC	1SMA12CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.3...14.7 В; V_{WM} = 19.9 В; I_{PP} = 20.1 А	DO-214AC, SMA	x • x
RF	SMAJ58	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.4...78.7 В; V_{WM} = 103 В; I_{PP} = 3.9 А	DO-214AC, SMA	K • A
RG	1SMA13AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.4...15.9 В; V_{WM} = 21.5 В; I_{PP} = 18.6 А	DO-214AC, SMA	K • A
RG	RGF1G	VISH	dr	V_R < 400 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.3 В; C_D = 8.5 пФ	DO-214BA	K • A
RG	SMAJ58A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.4...71.2 В; V_{WM} = 93.6 В; I_{PP} = 4.3 А	DO-214AC, SMA	K • A
RGC	1SMA13CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.4...15.92 В; V_{WM} = 21.5 В; I_{PP} = 18.6 А	DO-214AC, SMA	x • x
RH	SMAJ60	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.7...81.5 В; V_{WM} = 107 В; I_{PP} = 3.7 А	DO-214AC, SMA	K • A
RJ	RGF1J	VISH	dr	V_R < 600 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.3 В; C_D = 8.5 пФ	DO-214BA	K • A
RK	1SMA14AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.6...17.24 В; V_{WM} = 23.2 В; I_{PP} = 17.2 А	DO-214AC, SMA	K • A
RK	RGF1K	VISH	dr	V_R < 800 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.3 В; C_D = 8.5 пФ	DO-214BA	K • A
RK	SMAJ60A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66...73.7 В; V_{WM} = 96.8 В; I_{PP} = 4.1 А	DO-214AC, SMA	K • A
RKC	1SMA14CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.6...17.24 В; V_{WM} = 23.2 В; I_{PP} = 17.2 А	DO-214AC, SMA	x • x
RL	SMAJ64	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.1...86.4 В; V_{WM} = 114 В; I_{PP} = 3.5 А	DO-214AC, SMA	K • A
RM	1SMA15AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 16.7...18.5 В; V_{WM} = 24.4 В; I_{PP} = 16.4 А	DO-214AC, SMA	K • A
RM	RGF1M	VISH	dr	V_R < 1000 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.3 В; C_D = 8.5 пФ	DO-214BA	K • A
RM	SMAJ64A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.1...78.6 В; V_{WM} = 103 В; I_{PP} = 3.9 А	DO-214AC, SMA	K • A
RMC	1SMA15CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 16.7...18.46 В; V_{WM} = 24.4 В; I_{PP} = 16.4 А	DO-214AC, SMA	x • x
RN	SMAJ70	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.8...95.1 В; V_{WM} = 125 В; I_{PP} = 3.2 А	DO-214AC, SMA	K • A
RP	1SMA16AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 17.8...19.7 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 15.4 А	DO-214AC, SMA	K • A
RP	SMAJ70A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.8...86.0 В; V_{WM} = 113 В; I_{PP} = 3.5 А	DO-214AC, SMA	K • A
RPBF	MMT05B230T3	ON	TSPD	V_{BR} = 190 В; I_{PPS} > 50 А; C_T < 75 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
RPBG	MMT05B260T3	ON	TSPD	V_{BR} = 240 В; I_{PPS} > 50 А; C_T < 75 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
RPBJ	MMT05B310T3	ON	TSPD	V_{BR} = 280 В; I_{PPS} > 50 А; C_T < 75 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
RPC	1SMA16CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 17.8...19.67 В; V_{WM} = 26.0 В; I_{PP} = 15.4 А	DO-214AC, SMA	x • x
RPDF	MMT10B230T3	ON	TSPD	V_{BR} = 190 В; I_{PPS} > 100 А; C_T < 200 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
RPDG	MMT10B260T3	ON	TSPD	V_{BR} = 240 В; I_{PPS} > 100 А; C_T < 200 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
RPDJ	MMT10B310T3	ON	TSPD	V_{BR} = 280 В; I_{PPS} > 100 А; C_T < 200 пФ	DO-214AA, SMB	K • A
RQ	SMAJ75	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.3...102 В; V_{WM} = 134 В; I_{PP} = 3.0 А	DO-214AC, SMA	K • A
RR	1SMA17AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 18.9...20.9 В; V_{WM} = 27.6 В; I_{PP} = 14.5 А	DO-214AC, SMA	K • A
RR	SMAJ75A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.3...92.1 В; V_{WM} = 121 В; I_{PP} = 3.3 А	DO-214AC, SMA	K • A
RRC	1SMA17CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 18.9...20.9 В; V_{WM} = 27.6 В; I_{PP} = 14.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
RS	SMAJ78	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.7...106 В; V_{WM} = 139 В; I_{PP} = 2.9 А	DO-214AC, SMA	K • A
RT	1SMA18AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20...22.1 В; V_{WM} = 29.2 В; I_{PP} = 13.7 А	DO-214AC, SMA	K • A
RT	SMAJ78A	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.7...95.8 В; V_{WM} = 126 В; I_{PP} = 2.2 А	DO-214AC, SMA	K • A
RTC	1SMA18CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20...22.11 В; V_{WM} = 29.2 В; I_{PP} = 13.7 А	DO-214AC, SMA	x • x
RU	SMAJ85	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.4...115 В; V_{WM} = 151 В; I_{PP} = 2.6 А	DO-214AC, SMA	K • A
RV	1SMA20AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 22.2...24.5 В; V_{WM} = 32.4 В; I_{PP} = 12.3 А	DO-214AC, SMA	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
RV	SMAJ85A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 94.4...104 В; V_{WM} = 137 В; I_{PP} = 2.9 А	DO-214AC, SMA	K•A
RVC	1SMA20CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.2...24.54 В; V_{WM} = 32.4 В; I_{PP} = 12.3 А	DO-214AC, SMA	x•x
RW	SMAJ90	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 100...122 В; V_{WM} = 160 В; I_{PP} = 2.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
RX	1SMA22AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.4...26.9 В; V_{WM} = 35.5 В; I_{PP} = 11.3 А	DO-214AC, SMA	K•A
RX	SMAJ90A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 100...111 В; V_{WM} = 146 В; I_{PP} = 2.7 А	DO-214AC, SMA	K•A
RXC	1SMA22CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.4...26.97 В; V_{WM} = 35.5 В; I_{PP} = 11.3 А	DO-214AC, SMA	x•x
RY	SMAJ100	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 111...136 В; V_{WM} = 179 В; I_{PP} = 2.2 А	DO-214AC, SMA	K•A
RZ	1SMA24AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 26.7...29.5 В; V_{WM} = 38.9 В; I_{PP} = 10.3 А	DO-214AC, SMA	K•A
RZ	SMAJ100A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 111...123 В; V_{WM} = 162 В; I_{PP} = 2.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
RZC	1SMA24CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 26.7...29.51 В; V_{WM} = 38.9 В; I_{PP} = 10.3 А	DO-214AC, SMA	x•x
S1A	S1A	FAIR	dr	V_R < 50 В; I_F < 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
S1A	SMB4001	MCC	dr	V_R < 50 В; I_F = 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В; C_D = 12 пФ	DO-214AA, SMB	K•A
S1B	S1B	FAIR	dr	V_R < 100 В; I_F < 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
S1B	SMB4002	MCC	dr	V_R < 100 В; I_F = 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В; C_D = 12 пФ	DO-214AA, SMB	K•A
S1D	S1D	FAIR	dr	V_R < 200 В; I_F < 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
S1D	SMB4003	MCC	dr	V_R < 200 В; I_F = 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В; C_D = 12 пФ	DO-214AA, SMB	K•A
S1G	S1G	FAIR	dr	V_R < 400 В; I_F < 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
S1G	SMB4004	MCC	dr	V_R < 400 В; I_F = 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В; C_D = 12 пФ	DO-214AA, SMB	K•A
S1J	S1J	FAIR	dr	V_R < 600 В; I_F < 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
S1J	SMB4005	MCC	dr	V_R < 600 В; I_F = 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В; C_D = 12 пФ	DO-214AA, SMB	K•A
S1K	S1K	FAIR	dr	V_R < 800 В; I_F < 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
S1K	SMB4006	MCC	dr	V_R < 800 В; I_F = 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В; C_D = 12 пФ	DO-214AA, SMB	K•A
S1M	S1M	FAIR	dr	V_R < 1000 В; I_F < 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В	DO-214AC, SMA	K•A
S1M	SMB4007	MCC	dr	V_R < 1000 В; I_F = 1 А; V_F(I_F = 1 А) < 1.1 В; C_D = 12 пФ	DO-214AA, SMB	K•A
SD	SMAJ110	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 122...149 В; V_{WM} = 196 В; I_{PP} = 2.0 А	DO-214AC, SMA	K•A
SE	1SMA26AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.9...31.9 В; V_{WM} = 42.1 В; I_{PP} = 9.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
SE	SMAJ110A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 122...135 В; V_{WM} = 177 В; I_{PP} = 2.3 А	DO-214AC, SMA	K•A
SEC	1SMA26CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.9...31.94 В; V_{WM} = 42.1 В; I_{PP} = 9.5 А	DO-214AC, SMA	x•x
SF	SMAJ120	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 133...163 В; V_{WM} = 214 В; I_{PP} = 1.9 А	DO-214AC, SMA	K•A
SG	1SMA28AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.1...34.4 В; V_{WM} = 45.4 В; I_{PP} = 8.8 А	DO-214AC, SMA	K•A
SG	SMAJ120A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 133...147 В; V_{WM} = 193 В; I_{PP} = 2.0 А	DO-214AC, SMA	K•A
SGC	1SMA28CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.1...34.37 В; V_{WM} = 45.4 В; I_{PP} = 8.8 А	DO-214AC, SMA	x•x
SH	SMAJ130	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 144...176 В; V_{WM} = 231 В; I_{PP} = 1.7 А	DO-214AC, SMA	K•A
SK	1SMA30AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 33.3...36.8 В; V_{WM} = 48.4 В; I_{PP} = 8.3 А	DO-214AC, SMA	K•A
SK	SMAJ130A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 144...159 В; V_{WM} = 209 В; I_{PP} = 1.9 А	DO-214AC, SMA	K•A
SKC	1SMA30CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 33.3...36.81 В; V_{WM} = 48.4 В; I_{PP} = 8.3 А	DO-214AC, SMA	x•x
SL	SMAJ150	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 167...204 В; V_{WM} = 268 В; I_{PP} = 1.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
SM	1SMA33AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 36.7...40.6 В; V_{WM} = 53.3 В; I_{PP} = 7.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
SM	SMAJ150A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 167...185 В; V_{WM} = 243 В; I_{PP} = 1.6 А	DO-214AC, SMA	K•A
SMC	1SMA33CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 36.7...40.56 В; V_{WM} = 53.3 В; I_{PP} = 7.5 А	DO-214AC, SMA	x•x
SN	SMAJ160	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 178...218 В; V_{WM} = 287 В; I_{PP} = 1.4 А	DO-214AC, SMA	K•A
SP	1SMA36AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 40...44.2 В; V_{WM} = 58.1 В; I_{PP} = 6.9 А	DO-214AC, SMA	K•A
SP	SMAJ160A	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 178...197 В; V_{WM} = 259 В; I_{PP} = 1.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
SPC	1SMA36CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 40...44.21 В; V_{WM} = 58.1 В; I_{PP} = 6.9 А	DO-214AC, SMA	x•x
SQ	SMAJ170	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 189...231 В; V_{WM} = 304 В; I_{PP} = 1.3 А	DO-214AC, SMA	K•A
SR	1SMA40AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 44.4...49.1 В; V_{WM} = 64.5 В; I_{PP} = 6.2 А	DO-214AC, SMA	K•A
SR	SMAJ170	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 189...209 В; V_{WM} = 275 В; I_{PP} = 1.4 А	DO-214AC, SMA	K•A
SRC	1SMA40CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 44.4...49.07 В; V_{WM} = 64.5 В; I_{PP} = 6.2 А	DO-214AC, SMA	x•x
ST	1SMA43AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 47.8...52.8 В; V_{WM} = 69.4 В; I_{PP} = 5.8 А	DO-214AC, SMA	K•A
STC	1SMA43CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 47.8...52.83 В; V_{WM} = 69.4 В; I_{PP} = 5.8 А	DO-214AC, SMA	x•x
SV	1SMA45AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 50...55.3 В; V_{WM} = 72.2 В; I_{PP} = 5.5 А	DO-214AC, SMA	K•A
SVC	1SMA45CAT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 50...55.3 В; V_{WM} = 72.2 В; I_{PP} = 5.5 А	DO-214AC, SMA	x•x
SX	1SMA48AT3	ON	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 53.3...58.9 В; V_{WM} = 77.4 В; I_{PP} = 5.2 А	DO-214AC, SMA	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
SXC	1SMA48CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 53.3...58.91 В; V_{WM} = 77.4 В; I_{PP} = 5.2 А	DO-214AC, SMA	x • x
SZ	1SMA51AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.7...62.7 В; V_{WM} = 82.4 В; I_{PP} = 4.9 А	DO-214AC, SMA	K • A
SZC	1SMA51CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 56.7...62.67 В; V_{WM} = 82.4 В; I_{PP} = 4.9 А	DO-214AC, SMA	x • x
TD	SMAJ5.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.40...7.30 В; V_{WM} = 9.6 В; I_{PP} = 41.6 А	DO-214AC, SMA	x • x
TE	1SMA54AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60...66.3 В; V_{WM} = 87.1 В; I_{PP} = 4.6 А	DO-214AC, SMA	K • A
TE	SMAJ5.0AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.4...7.0 В; V_{WM} = 9.2 В; I_{PP} = 43.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
TEC	1SMA54CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 60...66.32 В; V_{WM} = 87.1 В; I_{PP} = 4.6 А	DO-214AC, SMA	x • x
TF	SMAJ6.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.67...8.15 В; V_{WM} = 11.4 В; I_{PP} = 35.1 А	DO-214AC, SMA	x • x
TG	1SMA58AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.4...71.5 В; V_{WM} = 93.6 В; I_{PP} = 4.3 А	DO-214AC, SMA	K • A
TG	SMAJ6.0AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 6.67...7.37 В; V_{WM} = 10.3 В; I_{PP} = 38.8 А	DO-214AC, SMA	x • x
TGC	1SMA58CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 64.4...71.5 В; V_{WM} = 93.6 В; I_{PP} = 4.3 А	DO-214AC, SMA	x • x
TH	SMAJ6.5C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.22...8.82 В; V_{WM} = 12.3 В; I_{PP} = 32.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
TK	1SMA60AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.7...73.7 В; V_{WM} = 96.8 В; I_{PP} = 4.1 А	DO-214AC, SMA	K • A
TK	SMAJ6.5AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.22...7.98 В; V_{WM} = 11.2 В; I_{PP} = 35.7 А	DO-214AC, SMA	x • x
TKC	1SMA60CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 66.7...73.72 В; V_{WM} = 96.8 В; I_{PP} = 4.1 А	DO-214AC, SMA	x • x
TL	SMAJ7.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.78...9.51 В; V_{WM} = 13.3 В; I_{PP} = 30.1 А	DO-214AC, SMA	x • x
TM	1SMA64AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.1...78.6 В; V_{WM} = 103 В; I_{PP} = 3.9 А	DO-214AC, SMA	K • A
TM	SMAJ7.0AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 10.0 мА) = 7.78...8.60 В; V_{WM} = 12.0 В; I_{PP} = 33.3 А	DO-214AC, SMA	x • x
TMC	1SMA64CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 71.1...78.58 В; V_{WM} = 103 В; I_{PP} = 3.9 А	DO-214AC, SMA	x • x
TN	SMAJ7.5C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...10.3 В; V_{WM} = 14.3 В; I_{PP} = 28.0 А	DO-214AC, SMA	x • x
TP	1SMA70AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.8...86 В; V_{WM} = 113 В; I_{PP} = 3.5 А	DO-214AC, SMA	K • A
TP	SMAJ7.5AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.33...9.21 В; V_{WM} = 12.9 В; I_{PP} = 31.0 А	DO-214AC, SMA	x • x
TPC	1SMA70CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 77.8...85.99 В; V_{WM} = 113 В; I_{PP} = 3.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
TQ	SMAJ8.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...10.9 В; V_{WM} = 15.0 В; I_{PP} = 26.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
TR	1SMA75AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.3...92.1 В; V_{WM} = 121 В; I_{PP} = 3.3 А	DO-214AC, SMA	K • A
TR	SMAJ8.0AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 8.89...9.83 В; V_{WM} = 13.6 В; I_{PP} = 29.4 А	DO-214AC, SMA	x • x
TRC	1SMA75CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 83.3...92.1 В; V_{WM} = 121 В; I_{PP} = 3.3 А	DO-214AC, SMA	x • x
TS	1SMA78AT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.7...95.83 В; V_{WM} = 126 В; I_{PP} = 3.2 А	DO-214AC, SMA	K • A
TS	SMAJ8.5C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...11.5 В; V_{WM} = 15.9 В; I_{PP} = 25.1 А	DO-214AC, SMA	x • x
TSC	1SMA78CAT3	ON	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.7...95.83 В; V_{WM} = 126 В; I_{PP} = 3.2 А	DO-214AC, SMA	x • x
TT	SMAJ8.5AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 9.44...10.4 В; V_{WM} = 14.4 В; I_{PP} = 27.7 А	DO-214AC, SMA	x • x
TU	SMAJ9.0C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.0...12.2 В; V_{WM} = 16.9 В; I_{PP} = 23.6 А	DO-214AC, SMA	x • x
TV	SMAJ9.0AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 10.0...11.1 В; V_{WM} = 15.4 В; I_{PP} = 26.0 А	DO-214AC, SMA	x • x
TW	SMAJ10C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.1...13.6 В; V_{WM} = 18.8 В; I_{PP} = 21.2 А	DO-214AC, SMA	x • x
TX	SMAJ10AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 11.1...12.3 В; V_{WM} = 17.0 В; I_{PP} = 23.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
TY	SMAJ11C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.2...14.9 В; V_{WM} = 20.1 В; I_{PP} = 20.0 А	DO-214AC, SMA	x • x
TZ	SMAJ11AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 12.2...13.5 В; V_{WM} = 18.2 В; I_{PP} = 22.0 А	DO-214AC, SMA	x • x
U1A	MURS105T3	ON	dr	V_R < 50 В; I_F = 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 0.71 В; t_{RR} < 35 нс	DO-214AA, SMB	K • A
U1B	MURS110T3	ON	dr	V_R < 100 В; I_F = 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 0.71 В; t_{RR} < 35 нс	DO-214AA, SMB	K • A
U1C	MURS115T3	ON	dr	V_R < 150 В; I_F = 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 0.71 В; t_{RR} < 35 нс	DO-214AA, SMB	K • A
U1D	MURS120T3	ON	dr	V_R < 200 В; I_F = 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 0.71 В; t_{RR} < 35 нс	DO-214AA, SMB	K • A
U1G	MURS140T3	ON	dr	V_R < 400 В; I_F = 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.05 В; t_{RR} < 75 нс	DO-214AA, SMB	K • A
U1J	MURS160T3	ON	dr	V_R < 600 В; I_F = 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.05 В; t_{RR} < 75 нс	DO-214AA, SMB	K • A
UA	US1A	GS	fd	V_R = 50 В; I_F = 1 А; C_D = 17 пФ	DO-214AC, SMA	K • A
UB	US1B	GS	fd	V_R = 100 В; I_F = 1 А; C_D = 17 пФ	DO-214AC, SMA	K • A
UD	SMAJ12C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.3...16.3 В; V_{WM} = 22.0 В; I_{PP} = 18.1 А	DO-214AC, SMA	x • x
UD	US1D	GS	fd	V_R = 200 В; I_F = 1 А; C_D = 17 пФ	DO-214AC, SMA	K • A
UE	SMAJ12AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 13.3...14.7 В; V_{WM} = 19.9 В; I_{PP} = 20.1 А	DO-214AC, SMA	x • x
UF	SMAJ13C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.4...17.6 В; V_{WM} = 23.8 В; I_{PP} = 16.8 А	DO-214AC, SMA	x • x
UG	SMAJ13AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 14.4...15.9 В; V_{WM} = 21.5 В; I_{PP} = 18.6 А	DO-214AC, SMA	x • x
UG	US1G	GS	fd	V_R = 400 В; I_F = 1 А; C_D = 17 пФ	DO-214AC, SMA	K • A
UH	SMAJ14C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 15.6...19.1 В; V_{WM} = 25.8 В; I_{PP} = 15.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
UJ	US1J	GS	fd	V_R = 600 В; I_F = 1 А; C_D = 15 пФ	DO-214AC, SMA	K • A

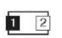
  

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
UK	SMAJ14AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 15.6...17.2В; V_{WM} = 23.2В; I_{PP} = 17.2А	DO-214AC, SMA	x•x
UL	SMAJ15C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.7...20.4В; V_{WM} = 26.9В; I_{PP} = 14.8А	DO-214AC, SMA	x•x
UM	SMAJ15AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 16.7...18.5В; V_{WM} = 24.4В; I_{PP} = 16.4А	DO-214AC, SMA	x•x
UN	SMAJ16C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.8...21.8В; V_{WM} = 28.8В; I_{PP} = 13.8А	DO-214AC, SMA	x•x
UP	SMAJ16AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 17.8...19.7В; V_{WM} = 26.0В; I_{PP} = 15.3А	DO-214AC, SMA	x•x
UQ	SMAJ17C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.9...23.1В; V_{WM} = 30.5В; I_{PP} = 13.1А	DO-214AC, SMA	x•x
UR	SMAJ17AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 18.9...20.9В; V_{WM} = 27.6В; I_{PP} = 14.5А	DO-214AC, SMA	x•x
US	SMAJ18C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.0...24.4В; V_{WM} = 32.2В; I_{PP} = 12.4А	DO-214AC, SMA	x•x
UT	SMAJ18AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 20.0...22.1В; V_{WM} = 29.2В; I_{PP} = 13.7А	DO-214AC, SMA	x•x
UU	SMAJ20C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.2...27.1В; V_{WM} = 35.8В; I_{PP} = 11.1А	DO-214AC, SMA	x•x
UV	SMAJ20AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 22.2...24.5В; V_{WM} = 32.4В; I_{PP} = 12.3А	DO-214AC, SMA	x•x
UW	SMAJ22C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.4...29.8В; V_{WM} = 39.4В; I_{PP} = 10.1А	DO-214AC, SMA	x•x
UX	SMAJ22AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 24.4...26.9В; V_{WM} = 35.5В; I_{PP} = 11.2А	DO-214AC, SMA	x•x
UY	SMAJ24C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 26.7...32.6В; V_{WM} = 43.0В; I_{PP} = 9.3А	DO-214AC, SMA	x•x
UZ	SMAJ24AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 26.7...29.5В; V_{WM} = 38.9В; I_{PP} = 10.3А	DO-214AC, SMA	x•x
VD	SMAJ26C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.9...31.9В; V_{WM} = 46.6В; I_{PP} = 8.6А	DO-214AC, SMA	x•x
VE	SMAJ26AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 28.9...25.3В; V_{WM} = 42.1В; I_{PP} = 9.5А	DO-214AC, SMA	x•x
VF	SMAJ28C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.1...38.0В; V_{WM} = 50.0В; I_{PP} = 8.0А	DO-214AC, SMA	x•x
VG	SMAJ28AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 31.1...34.4В; V_{WM} = 45.4В; I_{PP} = 8.8А	DO-214AC, SMA	x•x
VH	SMAJ30C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 33.3...40.7В; V_{WM} = 53.5В; I_{PP} = 7.5А	DO-214AC, SMA	x•x
VK	SMAJ30AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 33.3...36.8В; V_{WM} = 48.4В; I_{PP} = 8.3А	DO-214AC, SMA	x•x
VL	SMAJ33C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 36.7...44.9В; V_{WM} = 59.0В; I_{PP} = 6.8А	DO-214AC, SMA	x•x
VM	SMAJ33AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 36.7...40.6В; V_{WM} = 53.3В; I_{PP} = 7.5А	DO-214AC, SMA	x•x
VN	SMAJ36C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 40.0...48.9В; V_{WM} = 64.3В; I_{PP} = 6.2А	DO-214AC, SMA	x•x
VP	SMAJ36AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 40.0...44.2В; V_{WM} = 58.1В; I_{PP} = 6.9А	DO-214AC, SMA	x•x
VQ	SMAJ40C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 44.4...54.3В; V_{WM} = 71.4В; I_{PP} = 5.6А	DO-214AC, SMA	x•x
VR	SMAJ40AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 44.4...49.1В; V_{WM} = 64.5В; I_{PP} = 6.2А	DO-214AC, SMA	x•x
VS	SMAJ43C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 47.8...58.4В; V_{WM} = 76.7В; I_{PP} = 5.2А	DO-214AC, SMA	x•x
VT	SMAJ43AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 47.8...52.8В; V_{WM} = 69.4В; I_{PP} = 5.7А	DO-214AC, SMA	x•x
VU	SMAJ45C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 50.0...61.1В; V_{WM} = 80.3В; I_{PP} = 5.0А	DO-214AC, SMA	x•x
VV	SMAJ45AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 50.0...55.3В; V_{WM} = 72.7В; I_{PP} = 5.5А	DO-214AC, SMA	x•x
VW	SMAJ48C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 53.3...65.1В; V_{WM} = 85.5В; I_{PP} = 4.7А	DO-214AC, SMA	x•x
VX	SMAJ48AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 53.3...58.9В; V_{WM} = 77.4В; I_{PP} = 5.2А	DO-214AC, SMA	x•x
VY	SMAJ51C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 56.7...69.3В; V_{WM} = 91.1В; I_{PP} = 4.4А	DO-214AC, SMA	x•x
VZ	SMAJ51AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 56.7...62.7В; V_{WM} = 82.4В; I_{PP} = 4.9А	DO-214AC, SMA	x•x
WD	SMAJ54C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 60.0...73.3В; V_{WM} = 96.3В; I_{PP} = 4.2А	DO-214AC, SMA	x•x
WE	SMAJ54AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 60.0...66.3В; V_{WM} = 87.1В; I_{PP} = 4.6А	DO-214AC, SMA	x•x
WF	SMAJ58C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 64.4...78.7В; V_{WM} = 103В; I_{PP} = 3.9А	DO-214AC, SMA	x•x
WG	SMAJ58AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 64.4...71.2В; V_{WM} = 93.6В; I_{PP} = 4.3А	DO-214AC, SMA	x•x
WH	SMAJ60C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 66.7...81.5В; V_{WM} = 107В; I_{PP} = 3.7А	DO-214AC, SMA	x•x
WK	SMAJ60AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 66...73.7В; V_{WM} = 96.8В; I_{PP} = 4.1А	DO-214AC, SMA	x•x
WL	SMAJ64C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 71.1...86.4В; V_{WM} = 114В; I_{PP} = 3.5А	DO-214AC, SMA	x•x
WM	SMAJ64AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 71.1...78.6В; V_{WM} = 103В; I_{PP} = 3.9А	DO-214AC, SMA	x•x
WN	SMAJ70C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 77.8...95.1В; V_{WM} = 125В; I_{PP} = 3.2А	DO-214AC, SMA	x•x
WO	BZX284-B2V4	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.35...2.45 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-110	K•A
WP	BZX284-B2V7	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.65...2.75 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-110	K•A
WP	SMAJ70AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 77.8...86.0В; V_{WM} = 113В; I_{PP} = 3.5А	DO-214AC, SMA	x•x
WQ	BZX284-B3V0	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.94...3.06 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-110	K•A
WQ	SMAJ75C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 83.3...102В; V_{WM} = 134В; I_{PP} = 3.0А	DO-214AC, SMA	x•x
WR	BZX284-B3V3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.23...3.37 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-110	K•A
WR	SMAJ75AC	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 83.3...92.1В; V_{WM} = 121В; I_{PP} = 3.3А	DO-214AC, SMA	x•x
WS	BZX284-B3V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.53...3.67 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-110	K•A
WS	SMAJ78C	VISH	vs	V_{BR}(I_T = 1.0 мА) = 86.7...106В; V_{WM} = 139В; I_{PP} = 2.9А	DO-214AC, SMA	x•x



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
WT	BZX284-B3V9	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.82...3.98 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-110	K • A
WT	SMAJ78AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 86.7...95.8 В; V_{WM} = 126 В; I_{PP} = 2.2 А	DO-214AC, SMA	x • x
WU	BZX284-B4V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.21...4.39 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-110	K • A
WU	SMAJ85C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.4...115 В; V_{WM} = 151 В; I_{PP} = 2.6 А	DO-214AC, SMA	x • x
WV	BZX284-B4V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.61...4.79 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-110	K • A
WV	SMAJ85AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 94.4...104 В; V_{WM} = 137 В; I_{PP} = 2.9 А	DO-214AC, SMA	x • x
WW	BZX284-B5V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.0...5.2 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-110	K • A
WW	SMAJ90C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 100...122 В; V_{WM} = 160 В; I_{PP} = 2.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
WX	BZX284-B5V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.49...5.71 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-110	K • A
WX	SMAJ90AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 100...111 В; V_{WM} = 146 В; I_{PP} = 2.7 А	DO-214AC, SMA	x • x
WY	BZX284-B6V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 6.08...6.32 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	K • A
WY	SMAJ100C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111...136 В; V_{WM} = 179 В; I_{PP} = 2.2 А	DO-214AC, SMA	x • x
WZ	BZX284-B6V8	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 6.66...6.94 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-110	K • A
WZ	SMAJ100AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 111...123 В; V_{WM} = 162 В; I_{PP} = 2.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
XA	BZX284-B7V5	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 7.35...7.65 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	K • A
XB	BZX284-B8V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 8.04...8.36 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	K • A
XC	BZX284-B9V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 8.92...9.28 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	K • A
XD	BZX284-B10	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 9.8...10.2 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	K • A
XD	SMAJ110C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 122...149 В; V_{WM} = 196 В; I_{PP} = 2.0 А	DO-214AC, SMA	x • x
XE	BZX284-B11	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 10.8...11.2 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	K • A
XE	SMAJ110AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 122...135 В; V_{WM} = 177 В; I_{PP} = 2.3 А	DO-214AC, SMA	x • x
XF	BZX284-B12	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 11.8...12.2 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	K • A
XF	SMAJ120C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 133...163 В; V_{WM} = 214 В; I_{PP} = 1.9 А	DO-214AC, SMA	x • x
XG	BZX284-B13	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 12.7...13.3 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	K • A
XG	SMAJ120AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 133...147 В; V_{WM} = 193 В; I_{PP} = 2.0 А	DO-214AC, SMA	x • x
XH	BZX284-B15	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 14.7...15.3 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-110	K • A
XH	SMAJ130C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144...176 В; V_{WM} = 231 В; I_{PP} = 1.7 А	DO-214AC, SMA	x • x
XI	BZX284-B16	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 15.7...16.3 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-110	K • A
XJ	BZX284-B18	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 17.6...18.4 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-110	K • A
XK	BZX284-B20	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 19.6...20.4 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-110	K • A
XK	SMAJ130AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 144...159 В; V_{WM} = 209 В; I_{PP} = 1.9 А	DO-214AC, SMA	x • x
XL	BZX284-B22	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 21.6...22.4 В; Z_{ZT} < 25 Ом	SOD-110	K • A
XL	SMAJ150C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 167...204 В; V_{WM} = 268 В; I_{PP} = 1.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
XM	BZX284-B24	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 23.5...24.5 В; Z_{ZT} < 30 Ом	SOD-110	K • A
XM	SMAJ150AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 167...185 В; V_{WM} = 243 В; I_{PP} = 1.6 А	DO-214AC, SMA	x • x
XN	BZX284-B27	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5мА) = 26.5...27.5 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-110	K • A
XN	SMAJ160C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 178...218 В; V_{WM} = 287 В; I_{PP} = 1.4 А	DO-214AC, SMA	x • x
XO	BZX284-B30	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 29.4...30.6 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-110	K • A
XP	BZX284-B33	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 32.3...33.7 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-110	K • A
XP	SMAJ160AC	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 178...197 В; V_{WM} = 259 В; I_{PP} = 1.5 А	DO-214AC, SMA	x • x
XQ	BZX284-B36	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 35.3...36.7 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-110	K • A
XQ	SMAJ170C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 189...231 В; V_{WM} = 304 В; I_{PP} = 1.3 А	DO-214AC, SMA	x • x
XR	BZX284-B39	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 38.2...39.8 В; Z_{ZT} < 75 Ом	SOD-110	K • A
XR	SMAJ170C	VISH	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 189...209 В; V_{WM} = 275 В; I_{PP} = 1.4 А	DO-214AC, SMA	x • x
XS	BZX284-B43	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 42.1...43.9 В; Z_{ZT} <80 Ом	SOD-110	K • A
XT	BZX284-B47	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 46.1...47.9 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-110	K • A
XU	BZX284-B51	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 50.0...52.0 В; Z_{ZT} < 110 Ом	SOD-110	K • A
XV	BZX284-B56	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 54.9...57.1 В; Z_{ZT} < 120 Ом	SOD-110	K • A
XW	BZX284-B62	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 60.8...63.2 В; Z_{ZT} < 140 Ом	SOD-110	K • A
XX	BZX284-B68	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 66.6...69.4 В; Z_{ZT} < 160 Ом	SOD-110	K • A
XY	BZX284-B75	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 73.5...76.5 В; Z_{ZT} < 175 Ом	SOD-110	K • A
YO	BZX284-C2V4	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.2...2.8 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-110	K • A
YP	BZX284-C2V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.5...2.9 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-110	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
YQ	BZX284-C3V0	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.8...3.2 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-110	К•А
YR	BZX284-C3V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.1...3.5 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-110	К•А
YS	BZX284-C3V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.4...3.8 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-110	К•А
YT	BZX284-C3V9	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-110	К•А
YU	BZX284-C4V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4...4.6 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-110	К•А
YV	BZX284-C4V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.4...5 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-110	К•А
YW	BZX284-C5V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-110	К•А
YX	BZX284-C5V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.2...6 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-110	К•А
YY	BZX284-C6V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	К•А
YZ	BZX284-C6V8	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-110	К•А
Z100	U2Z100	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 3 мА) = 90...110 В; Z_{ZT}(I_{ZT} = 3 мА) < 300 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z12	U2Z12	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 10.8...13.2 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z13	U2Z13	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 11.7...14.3 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z15	U2Z15	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 13.5...16.5 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z16	U2Z16	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 14.4...17.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z18	U2Z18	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 16.2...19.8 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z20	U2Z20	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 18.0...22.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z22	U2Z22	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 19.8...24.2 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z24	U2Z24	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 21.6...26.4 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z27	U2Z27	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 24.3...29.7 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z30	U2Z30	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 27.0...33.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z33	U2Z33	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 29.7...36.3 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z36	U2Z36	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 9 мА) = 32.4...39.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 9 мА) < 30 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z43	U2Z43	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 7 мА) = 38.7...47.3 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 7 мА) < 40 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z47	U2Z47	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 6 мА) = 42.3...51.7 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 6 мА) < 65 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z51	U2Z51	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 6 мА) = 45.9...56.1 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 6 мА) < 65 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z68	U2Z68	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 61.2...74.8 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 4 мА) < 120 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z75	U2Z75	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 4 мА) = 67.5...82.5 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 4 мА) < 150 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
Z82	U2Z82	TOSH	dz	V_Z (I_{ZT} = 3 мА) = 73.8...90.2 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 3 мА) < 170 Ом	DO-214AA, SMB	К•А
ZA	BZX284-C7V5	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 7...7.9 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	К•А
ZB	BZX284-C8V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	К•А
ZC	BZX284-C9V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 8.5...9.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	К•А
ZD	BZX284-C10	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 9.4...10.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	К•А
ZE	BZX284-C11	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	К•А
ZF	BZX284-C12	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	К•А
ZG	BZX284-C13	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 12.4...14.1 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-110	К•А
ZH	BZX284-C15	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-110	К•А
ZHK	SM2Z5V1	STM	dz	V_Z = 5.1 В; P_S = 2 Вт	DO-214AC, SMA	К•А
ZHK	SMAZ5V1	VISH	dz	V_Z (I_Z = 100 мА) = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} = 5.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHL	SM2Z5V6	STM	dz	V_Z = 5.6 В; P_S = 2 Вт	DO-214AC, SMA	К•А
ZHL	SMAZ5V6	VISH	dz	V_Z (I_Z = 100 мА) = 5.2...6.0 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHN	SMAZ6V2	VISH	dz	V_Z (I_Z = 100 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHO	SMAZ6V8	VISH	dz	V_Z (I_Z = 100 мА) = 6.4...7.21 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHQ	SMAZ7V5	VISH	dz	V_Z (I_Z = 100 мА) = 7.0...7.9 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHR	SMAZ8V2	VISH	dz	V_Z (I_Z = 100 мА) = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHT	SMAZ9V1	VISH	dz	V_Z (I_Z = 50 мА) = 8.5...9.6 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHU	SMAZ10	VISH	dz	V_Z (I_Z = 50 мА) = 9.4...10.6 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHW	SM2Z12	STM	dz	V_Z = 12.0 В; P_S = 2 Вт	DO-214AC, SMA	К•А
ZHW	SMAZ12	VISH	dz	V_Z (I_Z = 50 мА) = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} = 7.0 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZHZ	SMAZ15	VISH	dz	V_Z (I_Z = 50 мА) = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} = 10 Ом	DO-214AC, SMA	К•А
ZI	BZX284-C16	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-110	К•А
ZJ	BZX284-C18	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-110	К•А
ZJA	SMAZ16	VISH	dz	V_Z (I_Z = 25 мА) = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} = 15 Ом	DO-214AC, SMA	К•А



1 2 DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2
ZJF	SM2Z18	STM	dz	V_Z = 18.0 В; P_S = 2 Вт	DO-214AC, SMA	K • A
ZJF	SMAZ18	VISH	dz	V_Z (I_Z = 25 мА) = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} = 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJG	SMAZ20	VISH	dz	V_Z (I_Z = 25 мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} = 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJK	SMAZ22	VISH	dz	V_Z (I_Z = 25 мА) = 20.8...23.3 В; Z_{ZT} = 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJL	SMAZ24	VISH	dz	V_Z (I_Z = 25 мА) = 22.8...25.6 В; Z_{ZT} = 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJN	SMAZ27	VISH	dz	V_Z (I_Z = 25 мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} = 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJQ	SM2Z30	STM	dz	V_Z = 30.0 В; P_S = 2 Вт	DO-214AC, SMA	K • A
ZJQ	SMAZ30	VISH	dz	V_Z (I_Z = 25 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} = 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJR	SMAZ33	VISH	dz	V_Z (I_Z = 25 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} = 15 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJS	SMAZ36	VISH	dz	V_Z (I_Z = 10 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} = 40 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJT	SMAZ39	VISH	dz	V_Z (I_Z = 10 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} = 40 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZJV	SMAZ47	VISH	dz	V_Z (I_Z = 10 мА) = 44...50 В; Z_{ZT} = 45 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZK	BZX284-C20	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-110	K • A
ZKM	SMAZ68	VISH	dz	V_Z (I_Z = 10 мА) = 64...72 В; Z_{ZT} = 80 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZKQ	SMAZ100	VISH	dz	V_Z (I_Z = 5.0 мА) = 94...106 В; Z_{ZT} = 200 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZKR	SM2Z150	STM	dz	V_Z = 150 В; P_S = 2 Вт	DO-214AC, SMA	K • A
ZKR	SMAZ150	VISH	dz	V_Z (I_Z = 5.0 мА) = 138...156 В; Z_{ZT} = 300 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZKW	SMAZ200	VISH	dz	V_Z (I_Z = 5.0 мА) = 188...212 В; Z_{ZT} = 350 Ом	DO-214AC, SMA	K • A
ZL	BZX284-C22	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 21.6...22.4 В; Z_{ZT} < 25 Ом	SOD-110	K • A
ZLGP	TPSMB20A	GS	vs	V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 19.0...21.0 В; V_{WM} = 17.1 В; I_{PP} = 21.7 А	DO-214AA, SMB	K • A
ZM	BZX284-C24	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 22.8...23.3 В; Z_{ZT} < 30 Ом	SOD-110	K • A
ZN	BZX284-C27	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-110	K • A
ZO	BZX284-C30	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-110	K • A
ZP	BZX284-C33	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-110	K • A
ZQ	BZX284-C36	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-110	K • A
ZR	BZX284-C39	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 75 Ом	SOD-110	K • A
ZS	BZX284-C43	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 40...46 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-110	K • A
ZT	BZX284-C47	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 44...50 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-110	K • A
ZU	BZX284-C51	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 48...54 В; Z_{ZT} < 110 Ом	SOD-110	K • A
ZV	BZX284-C56	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 52...60 В; Z_{ZT} < 120 Ом	SOD-110	K • A
ZW	BZX284-C62	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 58...66 В; Z_{ZT} < 140 Ом	SOD-110	K • A
ZX	BZX284-C68	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 64...72 В; Z_{ZT} < 160 Ом	SOD-110	K • A
ZY	BZX284-C75	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 70...79 В; Z_{ZT} < 175 Ом	SOD-110	K • A

SOD123/323, DO215/216

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
40	ZLLS400	ZETEX	shd	V_R < 40 В; I_F < 0.52 А; V_F(I_F = 0.4 А) < 0.5 В; I_R < 10 мкА; C_D < 15 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
46	BAT46J	STM	shd	V_R < 100 В; I_F < 150 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
86	BAT54J	STM	shd	V_R < 30 В; I_F < 300 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 0.9 В; I_R < 1 мкА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс	SOD-323, SC-76	К•А
0 2	GDZ2V0B	VISH	dz	V_Z = 2.0 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	К•А
1 (кра)	BB669	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1\,В}$ = 51...61.5 пФ; $C_{28\,В}$ = 2.5...2.9	SOD-323, SC-76	К•А
1 2	GDZ2V2B	VISH	dz	V_Z = 2.2 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	К•А
1B	MA2J111	PAN	di	V_R < 80 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.2 В; t_{RR} < 3 нс	SOD-323, SC-76	К•А
1C	MA2J112	PAN	di	V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 200 мА) < 1.1 В; t_{RR} < 10 нс	SOD-323, SC-76	К•А
1D	MA2J113	PAN	di	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 200 мА) < 1.1 В; t_{RR} < 10 нс	SOD-323, SC-76	К•А
1E	MA2J114	PAN	dr	V_R < 150 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 200 мА) < 1.2 В	SOD-323, SC-76	К•А
1F	MA2J115	PAN	dr	V_R < 200 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 200 мА) < 1.2 В	SOD-323, SC-76	К•А
1H	MA2J116	PAN	dl	V_R < 40 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.2 В; t_{RR} < 100 нс	SOD-323, SC-76	К•А
1P	CMDZ18L	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 18 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К•А
2	BB419	SIEM	var	V_R < 28 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{3\,В}$ = 26...32 пФ; $C_{3\,В}/C_{25\,В}$ = 5...6.5	SOD-123	К•А
2 (бел)	BB439	INF	var	V_R > 28 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.02 мкА; $C_{2\,В}$ = 31.5...37.5 пФ; $C_{25\,В}$ = 4.3...6 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
2 (син)	BAR64-03W	INF	pin	V_R < 150 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.1 В; C_D < 0.35 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
2 2	GDZ2V4B	VISH	dz	V_Z = 2.4 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	К•А
20B	1PMT5920B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 60.5 мА) = 6.2 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
21B	1PMT5921B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 55.1 мА) = 6.8 В; Z_{ZT} = 2.5 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
22B	1PMT5922B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 50.0 мА) = 7.5 В; Z_{ZT} = 3.0 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
23B	1PMT5923B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 45.7 мА) = 8.2 В; Z_{ZT} = 3.5 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
24B	1PMT5924B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 41.2 мА) = 9.1 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
25B	1PMT5925B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 37.5 мА) = 10 В; Z_{ZT} = 4.5 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
27B	1PMT5927B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 31.2 мА) = 12 В; Z_{ZT} = 6.5 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
29B	1PMT5929B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 25.0 мА) = 15 В; Z_{ZT} = 9.0 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
2P	CMDZ20L	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 20 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К•А
3 (бел)	BAT60A	INF	shd	V_R < 10 В; I_F < 3 А; V_F(I_F = 10 мА) < 0.15 В; I_R < 2.6 мА; C_D = 20 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
3 2	GDZ2V7B	VISH	dz	V_Z = 2.7 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 110 Ом	SOD-323, SC-76	К•А
30B	1PMT5930B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 23.4 мА) = 16 В; Z_{ZT} = 10 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
31B	1PMT5931B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 20.8 мА) = 18 В; Z_{ZT} = 12 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
33B	1PMT5933B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 17.0 мА) = 22 В; Z_{ZT} = 17.5 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
34B	1PMT5934B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 15.6 мА) = 24 В; Z_{ZT} = 19 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
35B	1PMT5935B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 13.9 мА) = 27 В; Z_{ZT} = 23 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
36B	1PMT5936B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 12.5 мА) = 30 В; Z_{ZT} = 28 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
39B	1PMT5939B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 9.6 мА) = 39 В; Z_{ZT} = 45 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
3P	CMDZ22L	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 22 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К•А
4 (бел)	BAS140W	INF	shd	V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_F(I_F = 40 мА) < 1 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
4 (жел)	BB644	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1\,В}$ = 39...44.5 пФ; $C_{28\,В}$ = 2.4...2.75	SOD-323, SC-76	К•А
4 2	GDZ3V0B	VISH	dz	V_Z = 3.0 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 120 Ом	SOD-323, SC-76	К•А
41B	1PMT5941B	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 8.0 мА) = 47 В; Z_{ZT} = 67 Ом	DO-216AA, PWRM	К•А
4K	MMSD3000T1	MOT	di	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.95 В; C_D < 2 пФ; t_{RR} < 3 нс	SOD-123	К•А
4P	CMDZ24L	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 24 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К•А
5 (бел)	BBY53-03W	INF	var	V_R < 6 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1\,В}$ = 4.8...5.8 пФ; $C_{3\,В}$ = 1.85...3.1 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
5 (кра)	BBY57-03W	INF	var	V_R < 10 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.001 мкА; $C_{1\,В}$ = 16.5...18.6 пФ; $C_{4\,В}$ = 4...5.5 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
5 (син)	BAT60B	INF	shd	V_R < 10 В; I_F < 3 А; V_F(I_F = 10 мА) = 0.24 В; I_R = 10 мкА; C_D = 25 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
5 2	GDZ3V3B	VISH	dz	V_Z = 3.3 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 1210 Ом	SOD-323, SC-76	К•А
5D	MMSD914T1	ON	di	V_R < 100 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 1 В; C_D < 4 пФ	SOD-123	К•А
5I	MMSD4148T1	ON	di	V_R < 100 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 1 В; C_D < 4 пФ	SOD-123	К•А




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
5P	CMDZ27L	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 27 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
6 (кра)	BBY56-03W	INF	var	V_R < 10 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.005 мкА; $C_{1В}$ = 37...43 пФ; $C_{4В}$ = 12.1 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
6 2	GDZ3V6B	VISH	dz	V_Z = 3.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
6P	CMDZ30L	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 30 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
6S	MMSD71RKT1	ON	di	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; C_D < 2 пФ	SOD-123	K • A
7 (бел)	BAS170W	INF	shd	V_R < 70 В; I_F < 70 мА; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 2.0 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
7 (бел)	BBY55-03W	INF	var	V_R < 16 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 17.5...19.6 пФ; $C_{10В}$ = 5.5...6.5 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
7 2	GDZ3V9B	VISH	dz	V_Z = 3.9 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
76	BAS70J	STM	shd	V_R < 70 В; I_F < 70 мА; V_F (I_F = 1 мА) < 0.41 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 2.0 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
7N	CMDZ1L8	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 1.8 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
7P	CMDZ33L	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 33 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
8 (жел)	BBY58-03W	INF	var	V_R < 10 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 17.5...19.3 пФ; $C_{4В}$ = 5.5...6.6 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
8 2	GDZ4V3B	VISH	dz	V_Z = 4.3 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
8N	CMDZ2L0	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 2.0 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
8P	CMDZ36L	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 36 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
9 2	GDZ4V7B	VISH	dz	V_Z = 4.7 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
913B	1PMT5913BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 113.6 мА) = 3.3 В; Z_{ZT} = 10.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
914B	1PMT5914BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 104.2 мА) = 3.6 В; Z_{ZT} = 9.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
915B	1PMT5915BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 96.1 мА) = 3.9 В; Z_{ZT} = 7.5 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
916B	1PMT5916BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 87.2 мА) = 4.3 В; Z_{ZT} = 6.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
917B	1PMT5917BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 79.8 мА) = 4.7 В; Z_{ZT} = 5.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
918B	1PMT5918BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 73.5 мА) = 5.1 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
919B	1PMT5919BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 66.9 мА) = 5.6 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
920B	1PMT5920BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 60.5 мА) = 6.2 В; Z_{ZT} = 2.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
921B	1PMT5921BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 55.1 мА) = 6.8 В; Z_{ZT} = 2.5 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
922B	1PMT5922BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 50.0 мА) = 7.5 В; Z_{ZT} = 3.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
923B	1PMT5923BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 45.7 мА) = 8.2 В; Z_{ZT} = 3.5 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
924B	1PMT5924BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 41.2 мА) = 9.1 В; Z_{ZT} = 4.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
925B	1PMT5925BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 37.5 мА) = 10 В; Z_{ZT} = 4.5 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
926B	1PMT5926BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 34.1 мА) = 11 В; Z_{ZT} = 5.5 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
927B	1PMT5927BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 31.2 мА) = 12 В; Z_{ZT} = 6.5 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
928B	1PMT5928BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 28.8 мА) = 13 В; Z_{ZT} = 7.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
929B	1PMT5929BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 25.0 мА) = 15 В; Z_{ZT} = 9.0 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
930B	1PMT5930BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 23.4 мА) = 16 В; Z_{ZT} = 10 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
931B	1PMT5931BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 20.8 мА) = 18 В; Z_{ZT} = 12 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
932B	1PMT5932BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 18.7 мА) = 20 В; Z_{ZT} = 14 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
933B	1PMT5933BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 17.0 мА) = 22 В; Z_{ZT} = 17.5 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
934B	1PMT5934BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 15.6 мА) = 24 В; Z_{ZT} = 19 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
935B	1PMT5935BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 13.9 мА) = 27 В; Z_{ZT} = 23 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
936B	1PMT5936BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 12.5 мА) = 30 В; Z_{ZT} = 26 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
937B	1PMT5937BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 11.4 мА) = 33 В; Z_{ZT} = 33 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
938B	1PMT5938BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 10.4 мА) = 36 В; Z_{ZT} = 38 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
939B	1PMT5939BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 9.6 мА) = 39 В; Z_{ZT} = 45 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
940B	1PMT5940BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 8.7 мА) = 43 В; Z_{ZT} = 53 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
941B	1PMT5941BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 8.0 мА) = 47 В; Z_{ZT} = 67 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
942B	1PMT5942BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 7.3 мА) = 51 В; Z_{ZT} = 70 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
943B	1PMT5943BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 6.7 мА) = 56 В; Z_{ZT} = 86 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
944B	1PMT5944BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 6.0 мА) = 62 В; Z_{ZT} = 100 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
945B	1PMT5945BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.5 мА) = 68 В; Z_{ZT} = 120 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
946B	1PMT5946BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 75 В; Z_{ZT} = 140 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
947B	1PMT5947BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 4.6 мА) = 82 В; Z_{ZT} = 160 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A
948B	1PMT5948BT3	MOT	dz	V_Z (I_{ZT} = 4.1 мА) = 91 В; Z_{ZT} = 200 Ом	DO-216AA, PWRM	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
9N	CMDZ2L2	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT} = 0.5$ мА$) = 2.2$ В; $P_D < 250$ мВт	SOD-323, SC-76	К•А
9P	CMDZ39L	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT} = 0.5$ мА$) = 39$ В; $P_D < 250$ мВт	SOD-323, SC-76	К•А
A	1SS355	ROHM	di	$V_R < 80$ В; $I_F < 225$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1.2$ В; $I_R < 0.1$ мкА; $t_{RR} < 4$ нс	SOD-323, SC-76	К•А
A	BAT14098	SIEM	shd	$V_R < 4$ В; $I_F < 90$ мА; $V_F(I_F = 10$ мА$) < 0.55$ В; $C_D < 0.35$ пФ	SOD-123	К•А
A	BA597	INF	pin	$V_R > 50$ В; $I_F < 100$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) = 0.9$ В; $I_R < 0.02$ мкА	SOD-323, SC-76	К•А
A1	MMSZ10T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5$ мА$) = 9.5...10.5$ В; $I_R < 0.1$ мкА	SOD-123	К•А
A2	1N4148W	VIS	sd	$V_R = 75$ В; $I_F = 150$ мА; $P_D = 400$ мВт; $t_{RR} < 4$ нс	SOD-123	К•А
A2	BA592	PHIL	dtv	$V_R < 35$ В; $I_F < 10$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1.0$ В; $I_R < 0.02$ мкА	SOD-323, SC-76	К•А
A2	BB208-03	PHIL	var	$V_R > 10$ В; $I_R(V_R = 10$ В$) < 0.01$ мкА; $C_{1\,В} = 19.9...23.2$ пФ; $C_{7.5\,В} = 4.5...5.4$ пФ	SOD-323, SC-76	К•А
A2	MMSZ11T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5$ мА$) = 10.45...11.55$ В; $I_R < 0.1$ мкА	SOD-123	К•А
A3	1N4448W	VIS	sd	$V_R = 75$ В; $I_F = 150$ мА; $P_D = 500$ мВт; $t_{RR} < 4$ нс	SOD-123	К•А
A3	BAP64-03	PHIL	pin	$V_R > 175$ В; $I_F < 100$ мА; $V_F(I_F = 50$ мА$) < 1.1$ В; $I_R < 0.1$ мкА	SOD-323, SC-76	К•А
A3	MMSZ12T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5$ мА$) = 11.4...12.6$ В; $I_R < 0.1$ мкА	SOD-123	К•А
A4	1N4150W	VIS	sd	$V_R < 50$ В; $I_F = 400$ мА; $P_D = 410$ мВт; $t_{RR} < 4$ нс	SOD-123	К•А
A4	1N4150W	WTE	sd	$V_R < 50$ В; $I_F = 400$ мА; $P_D = 410$ мВт; $t_{RR} < 4$ нс	SOD-123	К•А
A4	MMSZ13T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5$ мА$) = 12.35...13.65$ В; $I_R < 0.05$ мкА	SOD-123	К•А
A5	1N4151W	VIS	sd	$V_R < 75$ В; $I_F = 500$ мА; $P_D = 410$ мВт; $t_{RR} < 2$ нс	SOD-123	К•А
A5	1N4151W	WTE	sd	$V_R < 75$ В; $I_F = 300$ мА; $P_D = 500$ мВт; $t_{RR} < 2$ нс	SOD-123	К•А
A5	BAP51-03	PHIL	pin	$V_R > 50$ В; $I_F < 50$ мА; $V_F(I_F = 50$ мА$) < 1.1$ В; $I_R < 1$ мкА	SOD-323, SC-76	К•А
A5	MMSZ15T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5$ мА$) = 14.25...15.75$ В; $I_R < 0.05$ мкА	SOD-123	К•А
A6	BAS16D	GS	di	$V_R < 75$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 150$ мА$) < 1.25$ В; $I_R < 50$ мкА; $C_D < 2$ пФ; $t_{RR} < 6$ нс	SOD-123	К•А
A6	BAS16D	VISH	di	$V_R < 75$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 150$ мА$) < 1.25$ В; $I_R < 50$ мкА; $C_D < 2$ пФ; $t_{RR} < 6$ нс	SOD-123	К•А
A6	BAS16WS	GS	di	$V_R < 75$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 150$ мА$) < 1.25$ В; $I_R < 50$ мкА; $C_D < 2$ пФ; $t_{RR} < 6$ нс	SOD-323, SC-76	К•А
A6	BAS316	PHIL	fd	$V_R < 85$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 50$ мА$) < 1.0$ В; $C_D < 1.5$ пФ; $t_{RR} < 4$ нс	SOD-323, SC-76	К•А
A8	BAP50-03	PHIL	pin	$V_R > 50$ В; $I_F < 50$ мА; $V_F(I_F = 50$ мА$) < 1.1$ В; $I_R < 0.1$ мкА	SOD-323, SC-76	К•А
A8	BAV19W	VISH	di	$V_R < 100$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $I_R < 0.1$ мкА; $C_D = 1.5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
A8	BAV19W	DIODS	di	$V_R < 100$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $C_D < 5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
A8	BAV19W	WTE	di	$V_R < 100$ В; $I_F < 400$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $C_D < 5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
A8	BAV19W	TSC	di	$V_R < 100$ В; $I_F < 400$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $C_D < 5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
A8	BAV19W	MCC	di	$V_R < 100$ В; $I_F < 400$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $C_D < 5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
A80	BAV20W	WTE	di	$V_R < 150$ В; $I_F < 400$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $C_D < 5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
A82	BAV21W	WTE	di	$V_R < 200$ В; $I_F < 400$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $C_D < 5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
A9	BAV20W	VISH	di	$V_R < 150$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $I_R < 0.1$ мкА; $C_D = 1.5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
AA	BAV21W	VISH	di	$V_R < 200$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 100$ мА$) < 1$ В; $I_R < 0.1$ мкА; $C_D = 1.5$ пФ; $t_{RR} < 50$ нс	SOD-123	К•А
AA	ZMV829A	ZETEX	var	$V_R < 25$ В; $I_F < 200$ мА; $I_R < 0.02$ мкА; $C_{2\,В} = 7.38...9.02$ пФ; $C_{2\,В}/C_{20\,В} = 4.3...5.8$	SOD-323, SC-76	К•А
AB	ZMV830A	ZETEX	var	$V_R < 25$ В; $I_F < 200$ мА; $I_R < 0.02$ мкА; $C_{2\,В} = 9...11$ пФ; $C_{2\,В}/C_{20\,В} = 4.5...6.0$	SOD-323, SC-76	К•А
AC	ZMV831A	ZETEX	var	$V_R < 25$ В; $I_F < 200$ мА; $I_R < 0.02$ мкА; $C_{2\,В} = 13.5...16.5$ пФ; $C_{2\,В}/C_{20\,В} = 4.5...6.0$	SOD-323, SC-76	К•А
AD	ZMV832A	ZETEX	var	$V_R < 25$ В; $I_F < 200$ мА; $I_R < 0.02$ мкА; $C_{2\,В} = 19.8...24.2$ пФ; $C_{2\,В}/C_{20\,В} = 5...6.5$	SOD-323, SC-76	К•А
AE	ZMV833A	ZETEX	var	$V_R < 25$ В; $I_F < 200$ мА; $I_R < 0.02$ мкА; $C_{2\,В} = 29.7...36.3$ пФ; $C_{2\,В}/C_{20\,В} = 5...6.5$	SOD-323, SC-76	К•А
AF	ZMV834A	ZETEX	var	$V_R < 25$ В; $I_F < 200$ мА; $I_R < 0.02$ мкА; $C_{2\,В} = 42.3...51.7$ пФ; $C_{2\,В}/C_{20\,В} = 5...6.5$	SOD-323, SC-76	К•А
AG	ZMV835A	ZETEX	var	$V_R < 25$ В; $I_F < 200$ мА; $I_R < 0.02$ мкА; $C_{2\,В} = 61.2...74.8$ пФ; $C_{2\,В}/C_{20\,В} = 5...6.5$	SOD-323, SC-76	К•А
AH	ZMV930	ZETEX	var	$V_R < 12$ В; $I_F < 100$ мА; $I_R < 0.1$ мкА; $C_{2.5\,В} = 4.3...5.5$ пФ	SOD-323, SC-76	К•А
AJ	ZMV931	ZETEX	var	$V_R < 12$ В; $I_F < 100$ мА; $I_R < 0.1$ мкА; $C_{2.5\,В} = 6.5...7.8$ пФ	SOD-323, SC-76	К•А
AK	ZMV932	ZETEX	var	$V_R < 12$ В; $I_F < 100$ мА; $I_R < 0.1$ мкА; $C_{2.5\,В} = 8.5...10.5$ пФ	SOD-323, SC-76	К•А
AL	ZMV933	ZETEX	var	$V_R < 12$ В; $I_F < 100$ мА; $I_R < 0.1$ мкА; $C_{2.5\,В} = 18...27$ пФ	SOD-323, SC-76	К•А
AM	ZMV933A	ZETEX	var	$V_R < 12$ В; $I_F < 100$ мА; $I_R < 0.1$ мкА; $C_{2.5\,В} = 20.25...24.75$ пФ	SOD-323, SC-76	К•А
AN	ZMV934	ZETEX	var	$V_R < 12$ В; $I_F < 100$ мА; $I_R < 0.1$ мкА; $C_{2.5\,В} = 40...65$ пФ	SOD-323, SC-76	К•А
AO	ZMV934A	ZETEX	var	$V_R < 12$ В; $I_F < 100$ мА; $I_R < 0.1$ мкА; $C_{2.5\,В} = 47.25...57.75$ пФ	SOD-323, SC-76	К•А
AP	CMDZ2L4	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT} = 0.5$ мА$) = 2.4$ В; $P_D < 250$ мВт	SOD-323, SC-76	К•А
AR	CMDZ43L	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT} = 0.5$ мА$) = 43$ В; $P_D < 250$ мВт	SOD-323, SC-76	К•А
B	BAS16-03W	INF	di	$V_R < 80$ В; $I_F < 250$ мА; $V_F(I_F = 150$ мА$) < 1.25$ В; $I_R < 50$ мкА	SOD-323, SC-76	К•А
B	BAT15098	SIEM	shd	$V_R < 4$ В; $I_F < 110$ мА; $V_F(I_F = 10$ мА$) < 0.32$ В; $C_D < 0.35$ пФ	SOD-123	К•А




DO215, SOD123/323 DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
B0	BZX399C4V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 4.09...4.52 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B1	BZX399C1V8	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 1.715...1.89 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B2	BZX399C2V0	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 1.9...2.1 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B3	BZX399C2V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 2.09...2.31 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B4	BZX399C2V4	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 2.28...2.52 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B5	BZX399C2V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 2.57...2.84 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B6	BZX399C3V0	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 2.85...3.15 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B7	BZX399C3V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 3.14...3.47 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B8	BZX399C3V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 3.42...3.78 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
B9	BZX399C3V9	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 3.71...4.1 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BA	BZX399C4V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 4.47...4.94 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BB	BZX399C5V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 4.85...5.36 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BC	BZX399C5V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 5.32...5.88 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BD	BZX399C6V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 5.89...6.51 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BD	ZHCS400	ZETEX	shd	V_R < 40 В; I_F < 400 мА; V_F(I_F = 400 мА) < 0.5 В; I_R < 40 мкА; C_D = 20 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
BE	BZX399C6V8	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 6.46...7.14 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BF	BZX399C7V5	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 7.13...7.88 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BG	BZX399C8V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 7.79...8.61 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BH	BZX399C9V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 8.65...9.56 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BJ	BZX399C10	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 9.5...10.5 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BK	BZX399C11	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 10.45...11.55 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BL	BZX399C12	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 11.4...12.6 В; P_D < 300 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BM	BZX399C13	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 12.35...13.65 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BN	BZX399C15	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 14.25...15.75 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BP	BZX399C16	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 15.2...16.8 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BP	CMDZ2L5	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 2.5 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BQ	BZX399C18	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 17.1...18.9 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BR	BZX399C20	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 19...21 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BR	CMDZ47L	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 47 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
BS	BZX399C22	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 20.9...23.1 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BT	BZX399C24	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 22.8...25.2 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BU	BZX399C27	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 25.65...28.35 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BV	BZX399C30	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 28.5...31.5 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BW	BZX399C33	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 31.35...34.65 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BX	BZX399C36	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 34.2...37.8 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BY	BZX399C39	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 37.05...40.95 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
BZ	BZX399C43	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 40.85...45.15 В; P_D < 300 мВ	SOD-323, SC-76	K • A
C	KV1832E	TOKO	var	C = 4...17 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
C (бел)	BAT165	INF	shd	V_R < 40 В; I_F < 750 мА; V_F(I_F = 750 мА) < 0.7 В; C_D < 12 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
C (бел)	BAT65	SIEM	shd	V_R < 30 В; I_F < 500 мА; V_F(I_F = 250 мА) < 0.7 В; I_R < 10 мкА; C_D < 12 пФ	SOD-123	K • A
C1	1SS352	TOSH	di	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.5 мкА	SOD-323, SC-76	K • A
C1	MMSZ5221BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 2.28...2.52 В; I_R < 100 мкА	SOD-123	K • A
C2	MMSZ5222BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 2.37...2.63 В; I_R < 100 мкА	SOD-123	K • A
C3	MMSZ5223BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 2.57...2.84 В; I_R < 75 мкА	SOD-123	K • A
C4	MMSZ5224BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 2.66...2.94 В; I_R < 75 мкА	SOD-123	K • A
C48	CMHD4448	CNTRL	di	V_R < 75 В; I_F < 500 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 1 В; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOD-123	K • A
C5	MMSZ5225	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 3 В; I_R < 50 мкА	SOD-123	K • A
C5	MMSZ5225BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 2.85...3.15 В; I_R < 50 мкА	SOD-123	K • A
CA	MMSZ4691	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 5.89...6.51 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K • A
CA	MMSZ4691T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 5.89...6.51 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K • A
CA	ZMV829B	ZETEX	var	V_R < 25 В; I_F < 200 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 7.79...8.61 пФ; $C_{2В}/C_{20В}$ = 4.3...5.8	SOD-323, SC-76	K • A
CB	ZMV830B	ZETEX	var	V_R < 25 В; I_F < 200 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 9.5...10.5 пФ; $C_{2В}/C_{20В}$ = 4.5...6.0	SOD-323, SC-76	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
CC	MMSZ4678T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=1.71...1.89$В; $I_R<7.5$ мкА	SOD-123	K•A
CC	ZMV831B	ZETEX	var	$V_R<25$ В; $I_F<200$ мА; $I_R<0.02$ мкА; $C_{2В}=14.25...15.75$ пФ; $C_{2В}/C_{20В}=4.5...6.0$	SOD-323, SC-76	K•A
CC1	CMHZ5221B	CSI	dz	$V_Z=2.4$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CC2	CMHZ5222B	CSI	dz	$V_Z=2.5$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CC3	CMHZ5223B	CSI	dz	$V_Z=2.7$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CC4	CMHZ5224B	CSI	dz	$V_Z=2.8$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CC5	CMHZ5225B	CSI	dz	$V_Z=3.0$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CD	MMSZ4679T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=1.90...2.10$В; $I_R<5$ мкА	SOD-123	K•A
CD	ZMV832B	ZETEX	var	$V_R<25$ В; $I_F<200$ мА; $I_R<0.02$ мкА; $C_{2В}=20.9...23.1$ пФ; $C_{2В}/C_{20В}=5...6.5$	SOD-323, SC-76	K•A
CD1	CMHZ5226B	CSI	dz	$V_Z=3.3$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CD2	CMHZ5227B	CSI	dz	$V_Z=3.6$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CD3	CMHZ5228B	CSI	dz	$V_Z=3.9$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CD4	CMHZ5229B	CSI	dz	$V_Z=4.3$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CD5	CMHZ5230B	CSI	dz	$V_Z=4.7$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CE	MMSZ4680T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=2.09...2.31$В; $I_R<4$ мкА	SOD-123	K•A
CE	ZMV833B	ZETEX	var	$V_R<25$ В; $I_F<200$ мА; $I_R<0.02$ мкА; $C_{2В}=31.35...34.65$ пФ; $C_{2В}/C_{20В}=5...6.5$	SOD-323, SC-76	K•A
CE1	CMHZ5231B	CSI	dz	$V_Z=5.1$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CE2	CMHZ5232B	CSI	dz	$V_Z=5.6$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CE3	CMHZ5233B	CSI	dz	$V_Z=6.0$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CE4	CMHZ5234B	CSI	dz	$V_Z=6.2$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CE5	CMHZ5235B	CSI	dz	$V_Z=6.8$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CF	MMSZ4681	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=2.28...2.52$В; $I_R<2$ мкА	SOD-123	K•A
CF	MMSZ4681T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=2.28...2.52$В; $I_R<2$ мкА	SOD-123	K•A
CF	ZMV834B	ZETEX	var	$V_R<25$ В; $I_F<200$ мА; $I_R<0.02$ мкА; $C_{2В}=44.65...49.35$ пФ; $C_{2В}/C_{20В}=5...6.5$	SOD-323, SC-76	K•A
CF1	CMHZ5236B	CSI	dz	$V_Z=7.5$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CF2	CMHZ5237B	CSI	dz	$V_Z=8.2$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CF3	CMHZ5238B	CSI	dz	$V_Z=8.7$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CF4	CMHZ5239B	CSI	dz	$V_Z=9.1$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CF5	CMHZ5240B	CSI	dz	$V_Z=10$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CG	ZMV835B	ZETEX	var	$V_R<25$ В; $I_F<200$ мА; $I_R<0.02$ мкА; $C_{2В}=64.6...71.4$ пФ; $C_{2В}/C_{20В}=5...6.5$	SOD-323, SC-76	K•A
CH	MMSZ4682	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=2.57...2.84$В; $I_R<1$ мкА	SOD-123	K•A
CH	MMSZ4682T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=2.57...2.84$В; $I_R<1$ мкА	SOD-123	K•A
CH1	CMHZ5241B	CSI	dz	$V_Z=11$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CH2	CMHZ5242B	CSI	dz	$V_Z=12$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CH3	CMHZ5243B	CSI	dz	$V_Z=13$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CH4	CMHZ5244B	CSI	dz	$V_Z=14$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CH5	CMHZ5245B	CSI	dz	$V_Z=15$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CJ	MMSZ4683	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=2.85...3.15$В; $I_R<0.8$ мкА	SOD-123	K•A
CJ	MMSZ4683T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=2.85...3.15$В; $I_R<0.8$ мкА	SOD-123	K•A
CJ1	CMHZ5246B	CSI	dz	$V_Z=16$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CJ2	CMHZ5247B	CSI	dz	$V_Z=17$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CJ3	CMHZ5248B	CSI	dz	$V_Z=18$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CJ4	CMHZ5249B	CSI	dz	$V_Z=19$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CJ5	CMHZ5250B	CSI	dz	$V_Z=20$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CK	MMSZ4684	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=3.14...3.47$В; $I_R<7.5$ мкА	SOD-123	K•A
CK	MMSZ4684T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=50$ мкА$)=3.14...3.47$В; $I_R<7.5$ мкА	SOD-123	K•A
CK1	CMHZ5251B	CSI	dz	$V_Z=22$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CK2	CMHZ5252B	CSI	dz	$V_Z=24$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CK3	CMHZ5253B	CSI	dz	$V_Z=25$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CK4	CMHZ5254B	CSI	dz	$V_Z=27$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CK5	CMHZ5255B	CSI	dz	$V_Z=28$ В (5%); $P_D<500$ мВт	SOD-123	K•A
CL1	MMSZ2V4ET1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА$)=2.28...2.52$В; $I_R<50$ мкА	SOD-123	K•A




DO215, SOD123/323 DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
CL2	MMSZ2V7ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.57...2.84 В; I_R < 20 мкА	SOD-123	K•A
CL3	MMSZ3V0ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.85...3.15 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CL4	MMSZ3V3ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.14...3.47 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
CL5	MMSZ3V6ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.42...3.78 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
CL6	MMSZ3V9ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.71...4.10 В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
CL7	MMSZ4V3ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.09...4.52 В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
CL8	MMSZ4V7ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.47...4.94 В; I_R < 2 мкА	SOD-123	K•A
CL9	MMSZ5V1ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.85...5.36 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
CM	MMSZ4685	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 3.42...3.78 В; I_R < 7.5 мкА	SOD-123	K•A
CM	MMSZ4685T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 3.42...3.78 В; I_R < 7.5 мкА	SOD-123	K•A
CM1	CMHZ5256B	CSI	dz	V_Z = 30 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CM1	MMSZ5V6ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.32...5.88 В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
CM2	CMHZ5257B	CSI	dz	V_Z = 33 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CM2	MMSZ6V2ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.89...6.51 В; I_R < 2 мкА	SOD-123	K•A
CM3	CMHZ5258B	CSI	dz	V_Z = 36 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CM3	MMSZ6V8ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 6.46...7.14 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
CM4	CMHZ5259B	CSI	dz	V_Z = 39 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CM4	MMSZ7V5ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 7.13...7.88 В; I_R < 0.7 мкА	SOD-123	K•A
CM5	CMHZ5260B	CSI	dz	V_Z = 43 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CM5	MMSZ8V2ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 7.79...8.61 В; I_R < 0.5 мкА	SOD-123	K•A
CM6	MMSZ9V1ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 8.65...9.56 В; I_R < 0.2 мкА	SOD-123	K•A
CM7	MMSZ10ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 9.5...10.5 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	K•A
CM8	MMSZ11ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 10.45...11.55 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	K•A
CM9	MMSZ12ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 11.4...12.6 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	K•A
CN	MMSZ4686	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 3.71...4.10 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
CN	MMSZ4686T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 3.71...4.10 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
CN1	CMHZ5261B	CSI	dz	V_Z = 47 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CN1	MMSZ13ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 12.35...13.65 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CN2	CMHZ5262B	CSI	dz	V_Z = 51 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CN2	MMSZ15ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 14.25...15.75 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CN3	CMHZ5263B	CSI	dz	V_Z = 56 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CN3	MMSZ16ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 15.2...16.8 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CN4	CMHZ5264B	CSI	dz	V_Z = 60 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CN4	MMSZ18ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 17.1...18.9 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CN5	CMHZ5265B	CSI	dz	V_Z = 62 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CN5	MMSZ20ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 19.0...21.0 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CN6	MMSZ22ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 20.9...23.1 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CN7	MMSZ24ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 22.8...25.2 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CN8	MMSZ27ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 25.65...28.35 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CN9	MMSZ30ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 28.50...31.5 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CO3	CMHD2003	CNTRL	di	V_R < 250 В; I_F < 250 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1 В; C_D = 1.5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K•A
CP	CMDZ2L7	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 2.7 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K•A
CP	MMSZ4687	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 4.09...4.52 В; I_R < 4 мкА	SOD-123	K•A
CP	MMSZ4687T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 4.09...4.52 В; I_R < 4 мкА	SOD-123	K•A
CP1	CMHZ5266B	CSI	dz	V_Z = 68 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CP1	MMSZ33ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 31.35...34.65 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CP2	CMHZ5267B	CSI	dz	V_Z = 75 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CP2	MMSZ36ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 34.2...37.8 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CP3	CMHZ5268B	CSI	dz	V_Z = 82 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CP3	MMSZ39ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 37.05...41.0 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CP4	CMHZ5269B	CSI	dz	V_Z = 87 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CP4	MMSZ43ET1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 40.85...45.15 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
CP5	CMHZ5270B	CSI	dz	V_Z = 91 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CP5	MMSZ47ET1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 5 мА) = 44.65...49.35 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CP6	MMSZ51ET1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 5 мА) = 48.45...53.55 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CP7	MMSZ56ET1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 5 мА) = 53.20...58.80 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
CR1	CMHZ5271B	CSI	dz	V_Z = 100 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CR2	CMHZ5272B	CSI	dz	V_Z = 110 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CR3	CMHZ5273B	CSI	dz	V_Z = 120 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CR4	CMHZ5274B	CSI	dz	V_Z = 130 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CR5	CMHZ5275B	CSI	dz	V_Z = 140 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CS1	CMHZ5276B	CSI	dz	V_Z = 150 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CS2	CMHZ5277B	CSI	dz	V_Z = 160 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CS3	CMHZ5278B	CSI	dz	V_Z = 170 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CS4	CMHZ5279B	CSI	dz	V_Z = 180 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CS5	CMHZ5280B	CSI	dz	V_Z = 190 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CT	MMSZ4688	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 4.47...4.94 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CT	MMSZ4688T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 4.47...4.94 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CT1	CMHZ5281B	CSI	dz	V_Z = 200 В (5%); P_D < 500 мВт	SOD-123	K•A
CU	MMSZ4689	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 4.85...5.36 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CU	MMSZ4689T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 4.85...5.36 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CV	MMSZ4690	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 5.32...5.88 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CV	MMSZ4690T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 5.32...5.88 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CX	MMSZ4692	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 6.46...7.14 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CX	MMSZ4692T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 6.46...7.14 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CY	MMSZ4693	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 7.13...7.88 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CY	MMSZ4693T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 7.13...7.88 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
CZ	MMSZ4694	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 7.79...8.61 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
CZ	MMSZ4694T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 7.79...8.61 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
D	1SS376	ROHM	di	V_R < 250 В; I_F < 300 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.2 В; t_{RR} < 100 нс	SOD-323, SC-76	K•A
D	BAS21-03W	INF	di	V_R < 200 В; I_F < 250 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-323, SC-76	K•A
D1	MMSZ5226	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 3.3 В; I_R < 25 мкА	SOD-123	K•A
D1	MMSZ5226BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 3.14...3.47 В; I_R < 25 мкА	SOD-123	K•A
D2	MMSZ5227	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 3.6 В; I_R < 15 мкА	SOD-123	K•A
D2	MMSZ5227BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 3.42...3.78 В; I_R < 15 мкА	SOD-123	K•A
D3	MMSZ5228	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 3.9 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
D3	MMSZ5228BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 3.71...4.10 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K•A
D4	MMSZ5229	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 4.3 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
D4	MMSZ5229BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 4.09...4.52 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
D5	MMSZ5230	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 4.7 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
D5	MMSZ5230BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 4.47...4.94 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
D76	BAR18J	SGS	shd	V_{BR} > 70 В; $V_F(I_F$ = 1 мА) < 0.41 В; I_R < 200 нА; C_T < 1.7 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
DA	MMSZ4708	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 20.9...23.1 В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
DA	MMSZ4708T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 20.9...23.1 В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
DC	MMSZ4695	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 8.27...9.14 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
DC	MMSZ4695T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 8.27...9.14 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
DD	MMSZ4696	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 8.65...9.56 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
DD	MMSZ4696T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 8.65...9.56 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
DE	MMSZ4697	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 9.5...10.5 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
DE	MMSZ4697T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 9.5...10.5 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
DF	MMSZ4698	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 10.5...11.6 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DF	MMSZ4698T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 10.5...11.6 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DH	MMSZ4699	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 11.4...12.6 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DH	MMSZ4699T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$ = 50 мкА) = 11.4...12.6 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
DJ	MMSZ4700	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 12.4...13.7В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DJ	MMSZ4700T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 12.4...13.7В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DK	MMSZ4701	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 13.3...14.7В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DK	MMSZ4701T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 13.3...14.7В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DM	MMSZ4702	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 14.3...15.8В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DM	MMSZ4702T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 14.3...15.8В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DN	MMSZ4703	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 15.2...16.8В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DN	MMSZ4703T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 15.2...16.8В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DP	CMDZ2L8	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 2.8В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K•A
DP	MMSZ4704	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 16.2...17.9В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DP	MMSZ4704T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 16.2...17.9В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DT	MMSZ4705	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 17.1...18.9В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DT	MMSZ4705T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 17.1...18.9В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DU	MMSZ4706	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 18.1...20.0В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DU	MMSZ4706T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 18.1...20.0В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K•A
DV	MMSZ4707	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 19.0...21.0В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
DV	MMSZ4707T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 19.0...21.0В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
DY	MMSZ4710	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 23.8...26.3В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
DY	MMSZ4710T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 23.8...26.3В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
DZ	MMSZ4709	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 22.8...25.2В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
DZ	MMSZ4709T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 22.8...25.2В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
E	1SS380	ROHM	di	V_R < 40В; I_F < 225мА; V_F (I_F = 100мА) < 1.2В; I_R < 0.01 мкА	SOD-323, SC-76	K•A
E1	MMSZ5231	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 5.1В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
E1	MMSZ5231BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 4.85...5.36В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
E2	MMSZ5232	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 5.6В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
E2	MMSZ5232BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 5.32...5.88В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
E3	MMSZ5233	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 6.0В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
E3	MMSZ5233BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 5.70...6.30В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
E4	MMSZ5234	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 6.2В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
E4	MMSZ5234BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 5.89...6.51В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
E5	MMSZ5235	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 6.8В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
E5	MMSZ5235BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 6.46...7.14В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
EA	MMSZ4711	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 25.7...28.4В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EA	MMSZ4711T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 25.7...28.4В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EC	MMSZ4712	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 26.6...29.4В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EC	MMSZ4712T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 26.6...29.4В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
ED	MMSZ4713	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 28.5...31.5В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
ED	MMSZ4713T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 28.5...31.5В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EE	MMSZ4714	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 31.4...34.7В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EE	MMSZ4714T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 31.4...34.7В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EF	MMSZ4715	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 34.2...37.8В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EF	MMSZ4715T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 34.2...37.8В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EH	MMSZ4716	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 37.1...41.0В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EH	MMSZ4716T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 37.05...40.95В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EJ	MMSZ4717	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 40.9...45.2В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
EJ	MMSZ4717T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мкА) = 40.85...45.15В; I_R < 0.01 мкА	SOD-123	K•A
F	KV1831E	TOKO	var	C = 2.5...22 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
F1	MMSZ5236	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 7.5В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
F1	MMSZ5236BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 7.13...7.88В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
F2	MMSZ5237	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 8.2В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A
F2	MMSZ5237BT1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 7.79...8.61В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
F3	MMSZ5238	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 20 мА) = 8.7В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
F3	MMSZ5238BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=8.27...9.14$ В; $I_R<3$ мкА	SOD-123	K•A
F4	MMSZ5239	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=9.1$ В; $I_R<5$ мкА	SOD-123	K•A
F4	MMSZ5239BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=8.65...9.56$ В; $I_R<3$ мкА	SOD-123	K•A
F5	1SS403	TOSH	di	$V_R<200$ В; $I_F<300$ мА; $V_F(I_F=100$ мА$)<1.2$ В; $I_R<1$ мкА; $t_{RR}<60$ нс	SOD-323, SC-76	K•A
F5	MMSZ5240	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=10$ В; $I_R<3$ мкА	SOD-123	K•A
F5	MMSZ5240BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=9.5...10.5$ В; $I_R<3$ мкА	SOD-123	K•A
FP	CMDZ3L3	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}=0.5$ мА$)=3.3$ В; $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
G	BAR63-03W	INF	pin	$V_R<50$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=100$ мА$)<1.2$ В; $I_R<0.01$ мкА	SOD-323, SC-76	K•A
G	KV1181E	TOKO	var	$C=2...16$ пФ	SOD-323, SC-76	K•A
GP	CMDZ3L6	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}=0.5$ мА$)=3.6$ В; $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
H	BBY51-03W	INF	var	$V_R<7$ В; $I_F<20$ мА; $I_R<0.01$ мкА; $C_{1\,В}=5.05...5.75$ пФ; C4V$=2.5...3.7$ пФ	SOD-323, SC-76	K•A
H1	MMSZ5241	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=11$ В; $I_R<3$ мкА	SOD-123	K•A
H1	MMSZ5241BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=10.45...11.55$ В; $I_R<2$ мкА	SOD-123	K•A
H2	MMSZ5242	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=12$ В; $I_R<3$ мкА	SOD-123	K•A
H2	MMSZ5242BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=11.4...12.6$ В; $I_R<1$ мкА	SOD-123	K•A
H3	MMSZ5243	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=9.5$ мА$)=13$ В; $I_R<0.5$ мкА	SOD-123	K•A
H3	MMSZ5243BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=9.5$ мА$)=12.35...13.65$ В; $I_R<0.5$ мкА	SOD-123	K•A
H4	MMSZ5244	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=8.5$ мА$)=14$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
H4	MMSZ5244BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=8.5$ мА$)=13.30...14.70$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
H5	MMSZ5245	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=8.5$ мА$)=15$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
H5	MMSZ5245BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=8.5$ мА$)=14.25...15.75$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
HP	CMDZ3L9	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}=0.5$ мА$)=3.9$ В; $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
I (бел)	BBY52-03W	INF	var	$V_R<7$ В; $I_F<20$ мА; $I_R<0.01$ мкА; $C_{1\,В}=1.4...2.2$ пФ; $C_{4\,В}=0.85...1.45$ пФ	SOD-323, SC-76	K•A
J1	MMSZ5246	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=7.8$ мА$)=16$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
J1	MMSZ5246BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=7.8$ мА$)=15.2...16.8$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
J2	MMSZ5247	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=7.4$ мА$)=17$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
J2	MMSZ5247BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=7.0$ мА$)=16.15...17.85$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
J3	MMSZ5248	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=7.0$ мА$)=18$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
J3	MMSZ5248BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=7.0$ мА$)=17.1...18.9$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
J4	MMSZ5249	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=6.6$ мА$)=19$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
J5	MMSZ5250	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=6.2$ мА$)=20$ В; $I_R<01$ мкА	SOD-123	K•A
J5	MMSZ5250BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=6.2$ мА$)=19.0...21.0$ В; $I_R<01$ мкА	SOD-123	K•A
JP	CMDZ4L3	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}=0.5$ мА$)=4.3$ В; $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
K	BAT68-03W	INF	shd	$V_R<8$ В; $I_F<130$ мА; $V_F(I_F=10$ мА$)<0.5$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<1.0$ пФ	SOD-323, SC-76	K•A
K1	MMSZ5251	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.6$ мА$)=22$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K1	MMSZ5251BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.6$ мА$)=20.9...23.1$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K2	MMSZ5252	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.2$ мА$)=24$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K2	MMSZ5252BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.2$ мА$)=22.8...25.2$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K3	MMSZ5253	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=25$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K3	MMSZ5253BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=23.75...26.25$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K4	MMSZ5254	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=4.6$ мА$)=27$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K4	MMSZ5254BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=25.65...28.35$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K5	MMSZ5255	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=4.5$ мА$)=28$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
K5	MMSZ5255BT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=4.5$ мА$)=26.6...29.4$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOD-123	K•A
KP	CMDZ4L7	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}=0.5$ мА$)=4.7$ В; $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
L	BAT62-03W	INF	shd	$V_R<40$ В; $I_F<20$ мА; $V_F(I_F=2$ мА$)<1$ В; $I_R<10$ мкА; $C_D<0.6$ пФ	SOD-323, SC-76	K•A
L2	BAT42W	WTE	shd	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<0.65$ мВ; $C_D=10$ пФ	SOD-123	K•A
L2	BAT42W	VISH	shd	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<0.65$ мВ; $C_D=10$ пФ	SOD-123	K•A
L2	BAT42WS	WTE	shd	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<0.65$ мВ; $C_D=10$ пФ	SOD-323, SC-76	K•A
L2	BAT42WS	PANJIT	shd	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=10$ мА$)<0.4$ мВ	SOD-323, SC-76	K•A
L3	BAT43W	WTE	shd	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<0.45$ мВ; $C_D=10$ пФ	SOD-123	K•A
L3	BAT43W	VISH	shd	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<0.45$ мВ; $C_D=10$ пФ	SOD-123	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
L3	BAT43WS	WTE	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 15 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
L3	BAT43WS	PANJIT	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 2 мА) < 0.33 мВ	SOD-323, SC-76	К • А
L4	BAT54WS	PANJIT	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 1 мА) < 0.32 мВ	SOD-323, SC-76	К • А
L6	BAT46W	VISH	shd	V_R < 100 В; I_F < 150 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-123	К • А
L6	BAT46W	TSC	shd	V_R < 100 В; I_F < 150 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-123	К • А
L7	BAT17W	VISH	shd	V_R < 4 В; I_F < 30 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.6 В; I_R < 0.25 мкА; C_D < 0.75 пФ	SOD-123	К • А
LP	CMDZ5L1	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 5.1 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К • А
M	BB512	SIEM	var	V_R < 12 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{1В}$ = 440...520 пФ; $C_{1В}/C_{8В}$ > 15	SOD-123	К • А
M (син)	BAR65-03W	INF	pin	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.0 В; C_D < 0.9 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
M1	MMSZ5256	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 4.2 мА) = 30 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M1	MMSZ5256BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 4.2 мА) = 28.5...31.5 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M2	MMSZ5257	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 3.8 мА) = 33 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M2	MMSZ5257BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 3.8 мА) = 31.35...34.65 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M3	MMSZ5258	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 3.4 мА) = 36 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M3	MMSZ5258BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 3.4 мА) = 34.2...37.8 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M4	MMSZ5259	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 3.2 мА) = 39 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M4	MMSZ5259BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 3.2 мА) = 37.05...40.95 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M5	MMSZ5260	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 3.0 мА) = 43 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
M5	MMSZ5260BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 3.0 мА) = 40.85...45.15 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N1	MMSZ5261	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.7 мА) = 47 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N1	MMSZ5261BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.7 мА) = 44.65...49.35 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N2	MMSZ5262	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.5 мА) = 51 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N2	MMSZ5262BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.5 мА) = 48.45...53.55 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N3	MMSZ5263	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.2 мА) = 56 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N3	MMSZ5263BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.2 мА) = 53.20...58.80 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N4	MMSZ5264	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.1 мА) = 60 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N4	MMSZ5264BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.1 мА) = 57.00...63.00 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N5	MMSZ5265	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2.0 мА) = 62 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
N5	MMSZ5265BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 2 мА) = 58.90...65.10 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
NP	CMDZ5L6	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 5.6 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К • А
O (бел)	BAT14-03W	SIEM	shd	V_R < 4 В; I_F < 90 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.66 мВ; C_D < 0.35 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
OP	CMDZ6L2	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 6.2 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К • А
P	BA586	INF	pin	V_R < 50 В; I_F < 50 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.15 В; I_R < 0.05 мкА; C_D < 0.2 пФ	SOD-123	К • А
P	KV1841E	TOKO	var	C = 7...15 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P (бел)	BAT15-03W	INF	shd	V_R < 4 В; I_F < 110 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.41 В; C_D < 0.35 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P1	BB131	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 8...17 пФ; $C_{28В}$ = 0.7...1.055 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P1	MMSZ5266	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 1.8 мА) = 68 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
P1	MMSZ5266BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 1.8 мА) = 64.60...71.40 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
P2	BB132	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 60...75 пФ; $C_{28В}$ = 2.3...2.75 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P2	MMSZ5267	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 1.7 мА) = 75 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
P2	MMSZ5267BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 1.7 мА) = 71.25...78.75 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
P3	BB133	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 38...46 пФ; $C_{28В}$ = 2.2...2.6 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P3	BB133	LRC	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 38...46 пФ; $C_{28В}$ = 2.2...2.6 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P3	MMSZ5268BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 1.5 мА) = 77.9...86.1 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
P4	BB134	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 17.5...21 пФ; $C_{28В}$ = 1.7...2.1 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P4	BB134	LRC	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 17.5...21 пФ; $C_{28В}$ = 1.7...2.1 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P4	MMSZ5269BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 1.4 мА) = 82.65...91.35 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
P5	BB135	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 17.5...21 пФ; $C_{28В}$ = 1.7...2.1 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P5	BB135	LRC	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 17.5...21 пФ; $C_{28В}$ = 1.7...2.1 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P5	MMSZ5270BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 1.4 мА) = 86.45...95.55 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К • А
P6	BB146	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5В}$ = 35...43 пФ; $C_{28В}$ = 1.7...2.1 пФ	SOD-323, SC-76	К • А
P7	BB147	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.02 мкА; $C_{0.5В}$ = 92...112 пФ; $C_{28В}$ = 2.4...2.8 пФ	SOD-323, SC-76	К • А

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
P8	BB148	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.02 мкА; $C_{1В}$ = 36.8...41.8 пФ; $C_{28В}$ = 2.4...2.75 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
P9	BB149	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.02 мкА; $C_{1В}$ = 18...19.5 пФ; $C_{28В}$ = 1.9...2.25 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
P9	BB149	LRC	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.02 мкА; $C_{0.5В}$ = 18...19.5 пФ; $C_{28В}$ = 1.9...2.25 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PA	BB151	PHIL	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 15.4...17 пФ; $C_{3В}$ = 9.9...11.3 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PB	BB152	PHIL	var	V_R > 32 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 52...62 пФ; $C_{28В}$ = 2.48...2.89 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PC	BB153	PHIL	var	V_R > 32 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 34.65...42.35 пФ; $C_{28В}$ = 2.361...2.754 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PE	BB155	PHIL	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.01 мкА; C0.34V = 45.2...49.8 пФ; C2.82V = 24.55...26.7 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PF	BB156	PHIL	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 14.4...17.6 пФ; $C_{4В}$ = 7.6...9.6 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PG	BB157	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 37.5...43.8 пФ; $C_{28В}$ = 2.42...2.76 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PH	BB158	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 36.8...41.8 пФ; $C_{28В}$ = 2.4...2.75 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PJ	BB159	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 18...19.5 пФ; $C_{28В}$ = 1.9...2.25 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PK	BB164	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 62...76 пФ; $C_{28В}$ = 2.9...3.4 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PL	BB149A	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.02 мкА; $C_{1В}$ = 18.22...21.26 пФ; $C_{28В}$ = 1.951...2.225 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PM	BB154	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 18.5...21.25 пФ; $C_{28В}$ = 1.9...2.2 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PN	BB190	PHIL	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 18...20 пФ; $C_{4В}$ = 10.1...11.6 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
PP	CMDZ6L8	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 6.8 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К•А
QP	CMDZ7L5	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 7.5 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К•А
R (бел)	BA595	INF	pin	V_R > 50 В; I_F < 50 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.1 В; I_R < 0. 02 мкА	SOD-323, SC-76	К•А
R2	MMSZ5272BT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 1.1 мА) = 104.5...115.5 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-123	К•А
RP	CMDZ8L2	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 8.2 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К•А
S	BA582	INF	dtv	V_R < 35 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.02 мкА; C_D < 1.1 пФ	SOD-123	К•А
S	BB515	SIEM	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 17.5...20 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 8.2...9.8	SOD-123	К•А
S	BB619	SIEM	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 36...42 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ > 13.5	SOD-123	К•А
S	BB619C	SIEM	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 36...42 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ > 13.5	SOD-123	К•А
S	BB620	SIEM	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 62...76 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 19.5...25	SOD-123	К•А
S (бел)	BB535	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 17.5...20 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 8.2...9.8	SOD-323, SC-76	К•А
S (жел)	BB639	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 36...40 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 14.7	SOD-323, SC-76	К•А
S (жел)	BB639C	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 36.5...42 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 15.3	SOD-323, SC-76	К•А
S (кра)	BB640	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 62...76 пФ; $C_{28В}$ = 2.8...3.3	SOD-323, SC-76	К•А
S (син)	BA592	INF	dtv	V_R < 35 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.02 мкА	SOD-323, SC-76	К•А
S2	1SS315	TOSH	shd	V_R < 5 В; I_F < 30 мА; V_F(I_F = 2 мА) = 0.25 В; I_R(V_R = 0.5 В) < 25 мкА; C_T = 0.6 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
S3	1SS357	TOSH	shd	V_R > 40 В; V_F(I_F = 100 мА) < 0.6 В; I_R(V_R = 40 В) < 5 мкА	SOD-323, SC-76	К•А
S4	1SS367	TOSH	shd	V_R > 10 В; V_F(I_F = 100 мА) < 0.5 В; I_R(V_R = 10 В) < 20 мкА	SOD-323, SC-76	К•А
S5	1SS404	TOSH	shd	V_R > 20 В; V_F(I_F = 300 мА) < 0.45 В; I_R(V_R = 20 В) < 50 мкА; C_T = 46 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
S6	SD103AW	VISH	shd	V_R < 40 В; V_F(I_F = 200 мА) < 0.6 В; C_D = 50 пФ	SOD-123	К•А
S7	BAT42W	DIODS	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 0.65 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-123	К•А
S7	BAT42W	TSC	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 0.65 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-123	К•А
S7	BAT42WS	DIODS	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 0.65 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
S7	SD103BW	VISH	shd	V_R < 30 В; V_F(I_F = 200 мА) < 0.6 В; C_D = 50 пФ	SOD-123	К•А
S8	BAT43W	DIODS	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 15 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-123	К•А
S8	BAT43W	TSC	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 15 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-123	К•А
S8	BAT43WS	DIODS	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 15 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-323, SC-76	К•А
S8	SD103CW	VISH	shd	V_R < 20 В; V_F(I_F = 200 мА) < 0.6 В; C_D = 50 пФ	SOD-123	К•А
S9	BAT46W	DIODS	shd	V_R < 100 В; I_F < 150 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOD-123	К•А
SA	SD101AW	VISH	shd	V_R < 60 В; I_F < 30 мА; V_F(I_F = 15 мА) < 1.0 В; C_D < 2 пФ	SOD-123	К•А
SB	BAT54T1	ON	shd	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 30 мА) < 0.5 В; t_{RR} < 5 нс	SOD-123	К•А
SB	SD101BW	VISH	shd	V_R < 50 В; I_F < 30 мА; V_F(I_F = 15 мА) < 0.95 В; C_D < 2.1 пФ	SOD-123	К•А
SC	SD101CW	VISH	shd	V_R < 40 В; I_F < 30 мА; V_F(I_F = 15 мА) < 0.9 В; C_D < 2.2 пФ	SOD-123	К•А
SP	CMDZ9L1	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 9.1 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К•А
T	BB811	SIEM	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{1В}$ = 7.8...9.8 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 7.8...9.5	SOD-123	К•А




DO215, SOD123/323 DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
T (син)	BAR67-03W	INF	pin	V_R < 150 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.2 В; C_D < 0.9 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
T 1	GDZ5V1B	VISH	dz	V_Z = 5.1 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 80 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T 2	GDZ5V6B	VISH	dz	V_Z = 5.6 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 60 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T 3	GDZ6V2B	VISH	dz	V_Z = 6.2 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 60 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T 4	GDZ6v8B	VISH	dz	V_Z = 6.8 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 40 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T 5	GDZ7V5B	VISH	dz	V_Z = 7.5 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 30 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T 6	GDZ8V2B	VISH	dz	V_Z = 8.2 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 30 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T 7	GDZ9V1B	VISH	dz	V_Z = 9.1 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 30 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T 8	GDZ10B	VISH	dz	V_Z = 10 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 30 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T 9	GDZ11B	VISH	dz	V_Z = 11 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 30 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T A	GDZ12B	VISH	dz	V_Z = 12 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 30 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T B	GDZ13B	VISH	dz	V_Z = 13 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 37 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T C	GDZ15B	VISH	dz	V_Z = 15 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 42 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T D	GDZ16B	VISH	dz	V_Z = 16 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 50 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T E	GDZ18B	VISH	dz	V_Z = 18 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 65 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T H	GDZ20B	VISH	dz	V_Z = 20 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 85 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T K	GDZ22B	VISH	dz	V_Z = 22 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T L	GDZ24B	VISH	dz	V_Z = 24 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 120 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T M	GDZ27B	VISH	dz	V_Z = 27 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 150 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T N	GDZ30B	VISH	dz	V_Z = 30 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 200 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T P	GDZ33B	VISH	dz	V_Z = 33 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 250 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T T	GDZ36B	VISH	dz	V_Z = 36 В; Z_{ZT}(I_Z = 5 мА) = 300 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
T1	MMSZ2V4T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.28...2.52 В; I_R < 50 мкА	SOD-123	K • A
T2	1SV215	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 26...32 пФ; $C_{25В}$ = 2.5...3.2 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
T2	BAV19W	DIODS	di	V_R < 100 В; I_F < 250 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T2	BAV20W	DIODS	di	V_R < 150 В; I_F < 250 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T2	BAV20W	TSC	di	V_R < 150 В; I_F < 400 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T2	BAV20W	MCC	di	V_R < 150 В; I_F < 400 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T2	MMSZ2V7T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.57...2.84 В; I_R < 20 мкА	SOD-123	K • A
T3	1SV245	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 3.31...4.55 пФ; $C_{25В}$ = 0.61...0.77 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
T3	BAV19W	DIODS	di	V_R < 100 В; I_F < 250 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T3	BAV20W	DIODS	di	V_R < 150 В; I_F < 250 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T3	BAV21W	DIODS	di	V_R < 200 В; I_F < 250 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T3	BAV21W	TSC	di	V_R < 200 В; I_F < 400 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T3	BAV21W	MCC	di	V_R < 200 В; I_F < 400 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOD-123	K • A
T3	MMSZ3V0T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.85...3.15 В; I_R < 10 мкА	SOD-123	K • A
T4	1N4148W	DIODS	sd	V_R = 75 В; I_F = 300 мА; P_D = 350 мВт; t_{RR} < 4 нс	SOD-123	K • A
T4	1SV216	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 10.5...16 пФ; $C_{10В}$ = 3.3...5.7 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
T4	MMSZ3V3T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.14...3.47 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K • A
T5	1N4448W	DIODS	sd	V_R = 75 В; I_F = 500 мА; P_D = 400 мВт; t_{RR} < 4 нс	SOD-123	K • A
T5	MMSZ3V6T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.42...3.78 В; I_R < 5 мкА	SOD-123	K • A
T6	1SV217	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 33...39 пФ; $C_{25В}$ = 2.6...3.2 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
T7	1SV230	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 13.9...16.1 пФ; $C_{20В}$ = 1.7...2.1 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
T8	1SV229	TOSH	var	V_R > 15 В; I_R(V_R = 15 В) < 0.003 мкА; $C_{2В}$ = 14...16 пФ; $C_{10В}$ = 5.5...6.5 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
T9	1SV232	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 28...32 пФ; $C_{25В}$ = 2.75...3.1 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
TA	1SV231	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 41...49.5 пФ; $C_{25В}$ = 2.7...3.4 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
TC	1SV239	TOSH	var	V_R > 15 В; I_R(V_R = 15 В) < 0.003 мкА; $C_{2В}$ = 3.8...4.7 пФ; $C_{10В}$ = 1.5...2 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
TD	1SV262	TOSH	var	V_R > 34 В; I_R(V_R = 32 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 33...38 пФ; $C_{25В}$ = 2.6...3 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
TE	1SV269	TOSH	var	V_R > 34 В; I_R(V_R = 32 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 29...34 пФ; $C_{25В}$ = 2.5...2.9 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
TF	1SV270	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 15...17 пФ; $C_{4В}$ = 7.3...8.7 пФ	SOD-323, SC-76	K • A
TG	1SV271	TOSH	pin	V_R > 50 В; I_F < 50 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-323, SC-76	K • A
TH	1SV293	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 18...20 пФ; $C_{4В}$ = 10.1...11.6 пФ	SOD-323, SC-76	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
TI	1SV214	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 14.16...16.25 пФ; $C_{25В}$ = 2.11...2.43 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
TJ	1SV288	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 41...49.5 пФ; $C_{25В}$ = 2.5...3.2 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
TK	1SV287	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 4.2...5.7 пФ; $C_{25В}$ = 0.53...0.68 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
TL	1SV276	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 15...17 пФ; $C_{4В}$ = 7...8.5 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
TO	1SV277	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 4...4.9 пФ; $C_{4В}$ = 1.85...2.35 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
TP	CMDZ10L	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 10 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K•A
TT	1SV302	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 42...51 пФ; $C_{25В}$ = 2.1...3.1 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
TV	1SV304	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 17.3...19.3 пФ; $C_{4В}$ = 5.3...6.6 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
TX	1SV307	TOSH	pin	V_R > 30 В; I_F < 50 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-323, SC-76	K•A
TY	1SS314	TOSH	di	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 2 мА) < 0.85 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-323, SC-76	K•A
U (бел)	BB545	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 18.5...21.5 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 9...11	SOD-323, SC-76	K•A
U1	MMSZ3V9T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.71...4.10 В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
U2	MMSZ4V3T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.09...4.52 В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
U3	MMSZ4V7T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.47...4.94 В; I_R < 2 мкА	SOD-123	K•A
U4	MMSZ5V1T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.85...5.36 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
U5	MMSZ5V6T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.32...5.88 В; I_R < 3 мкА	SOD-123	K•A
UP	CMDZ11L	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 11 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K•A
V1	1SV310	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 9.7...11.1 пФ; $C_{4В}$ = 4.45...5.45 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
V1	MMSZ6V2T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.89...6.51 В; I_R < 2 мкА	SOD-123	K•A
V2	1SV328	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 5.7...6.7 пФ; $C_{4В}$ = 1.85...2.45 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
V2	MMSZ6V8T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.46...7.14 В; I_R < 1 мкА	SOD-123	K•A
V3	MMSZ7V5T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.13...7.88 В; I_R < 0.7 мкА	SOD-123	K•A
V4	MMSZ8V2T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.79...8.61 В; I_R < 0.5 мкА	SOD-123	K•A
V5	MMSZ9V1T1	ON	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 8.65...9.56 В; I_R < 0.2 мкА	SOD-123	K•A
V6	1SV313	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{0.5В}$ = 7.3...8.4 пФ; $C_{2.5В}$ = 2.75...3.4 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
V7	1SV322	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 26.5...29.5 пФ; $C_{4В}$ = 6...7.1 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
V8	1SV324	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 44...49.5 пФ; $C_{4В}$ = 9.2...12 пФ	SOD-323, SC-76	K•A
VP	CMDZ12L	CSI	dz	V_Z(I_{ZT} = 0.5 мА) = 12 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K•A
W1	BZT52B2V4	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.35...2.45 В; Z_{ZT} < 85 Ом	SOD-123	K•A
W1	BZT52C2V4	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.2...2.8 В; Z_{ZT} < 85 Ом	SOD-123	K•A
W1	BZT52C2V7S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.5...2.9 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W1	BZX384B2V4	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.35...2.45 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W1	BZX384C2V4	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.2...2.6 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W2	BZT52B2V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.65...2.75 В; Z_{ZT} < 83 Ом	SOD-123	K•A
W2	BZT52C2V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.5...2.9 В; Z_{ZT} < 83 Ом	SOD-123	K•A
W2	BZT52C3V0S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.8...3.2 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W2	BZX384B2V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.65...2.75 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W2	BZX384C2V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.5...2.9 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W3	BZT52B3V0	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.94...3.06 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	K•A
W3	BZT52C3V0	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.8...3.2 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	K•A
W3	BZT52C3V3S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.1...3.5 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W3	BZX384B3V0	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.94...3.06 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W3	BZX384C3V0	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.8...3.2 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W4	BZT52B3V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.23...3.37 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	K•A
W4	BZT52C3V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.1...3.5 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	K•A
W4	BZT52C3V6S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.4...3.8 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W4	BZX384B3V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.23...3.37 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W4	BZX384C3V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.1...3.5 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-323, SC-76	K•A
W5	BZT52B3V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.53...3.67 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	K•A
W5	BZT52C3V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.4...3.8 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	K•A
W5	BZT52C3V9S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	K•A




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
W5	BZX384B3V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.53...3.67 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W5	BZX384C3V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.4...3.8 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W6	BZT52B3V9	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.82...3.98 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	К • А
W6	BZT52C3V9	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	К • А
W6	BZT52C4V3S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4...4.6 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W6	BZX384B3V9	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.82...3.98 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W6	BZX384C3V9	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W7	BZT52B4V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.21...4.39 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	К • А
W7	BZT52C4V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4...4.6 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-123	К • А
W7	BZT52C4V7S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.4...5 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W7	BZX384B4V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.21...4.39 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W7	BZX384C4V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.0...4.6 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W8	BZT52B4V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.61...4.79 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
W8	BZT52C4V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.4...5 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
W8	BZT52C5V1S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W8	BZX384B4V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.61...4.79 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W8	BZX384C4V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.4...5.0 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W9	BZT52B5V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.0...5.2 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-123	К • А
W9	BZT52C5V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-123	К • А
W9	BZT52C5V6S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.2...6 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W9	BZX384B5V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.0...5.2 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
W9	BZX384C5V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WA	BZT52B5V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.49...5.71 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-123	К • А
WA	BZT52C5V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.2...6 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-123	К • А
WA	BZT52C6V2S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WA	BZX384B5V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.49...5.71 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WA	BZX384C5V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.2...6 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WA	SMZG3789A	GS	dz	V_Z(I_Z = 37.5 мА) = 10 В ± 10%; Z_{ZT} = 5.0 Ом	DO-215AA	К • А
WB	BZT52B6V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.08...6.32 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-123	К • А
WB	BZT52C6V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-123	К • А
WB	BZT52C6V8S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WB	BZX384B6V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.08...6.32 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WB	BZX384C6V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WB	SMZG3789B	GS	dz	V_Z(I_Z = 37.5 мА) = 10 В ± 5%; Z_{ZT} = 5.0 Ом	DO-215AA	К • А
WC	BZT52B6V8	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.66...6.94 В; Z_{ZT} < 8 Ом	SOD-123	К • А
WC	BZT52C6V8	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} < 8 Ом	SOD-123	К • А
WC	BZT52C7V5S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7...7.9 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WC	BZX384B6V8	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.66...6.94 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WC	BZX384C6V8	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WC	SMZG3790A	GS	dz	V_Z(I_Z = 34.1 мА) = 11 В ± 10%; Z_{ZT} = 6.0 Ом	DO-215AA	К • А
WD	BZT52B7V5	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.35...7.65 В; Z_{ZT} < 7 Ом	SOD-123	К • А
WD	BZT52C7V5	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7...7.9 В; Z_{ZT} < 7 Ом	SOD-123	К • А
WD	BZT52C8V2S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WD	BZX384B7V5	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.35...7.65 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WD	BZX384C7V5	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7...7.5 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WD	SMZG3790B	GS	dz	V_Z(I_Z = 34.1 мА) = 11 В ± 5%; Z_{ZT} = 6.0 Ом	DO-215AA	К • А
WE	BZT52B8V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 8.04...8.36 В; Z_{ZT} < 7 Ом	SOD-123	К • А
WE	BZT52C8V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} < 7 Ом	SOD-123	К • А
WE	BZT52C9V1S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 8.5...9.6 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WE	BZX384B8V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 8.04...8.36 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WE	BZX384C8V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WE	SMZG3791A	GS	dz	V_Z(I_Z = 31.2 мА) = 12 В ± 10%; Z_{ZT} = 7.0 Ом	DO-215AA	К • А

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
WF	BZT52B9V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.92...9.28В; Z_{ZT}<10 Ом	SOD-123	K•A
WF	BZT52C10S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6В; Z_{ZT}<15Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WF	BZT52C9V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.5...9.6В; Z_{ZT}<10Ом	SOD-123	K•A
WF	BZX384B9V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.92...9.28В; Z_{ZT}<15Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WF	BZX384C9V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.5...9.6В; Z_{ZT}<15Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WF	SMZG3791B	GS	dz	V_Z(I_Z=31.2 мА)=12В±5%; Z_{ZT}=7.0Ом	DO-215AA	K•A
WG	BZT52B10	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.8...10.2В; Z_{ZT}<15Ом	SOD-123	K•A
WG	BZT52C10	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6В; Z_{ZT}<15Ом	SOD-123	K•A
WG	BZT52C11S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.4...11.6В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WG	BZT52C12S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.4...12.7В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WG	BZT52C20S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2В; Z_{ZT}<50Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WG	BZX384B10	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.8...10.2В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WG	BZX384C10	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WG	SMZG3792A	GS	dz	V_Z(I_Z=28.8 мА)=13В±10%; Z_{ZT}=7.5Ом	DO-215AA	K•A
WH	BZT52B11	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.8...11.2В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-123	K•A
WH	BZT52C11	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.4...11.6В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-123	K•A
WH	BZX384B11	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.8...11.2В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WH	BZX384C11	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.4...11.6В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WH	SMZG3792B	GS	dz	V_Z(I_Z=28.8 мА)=13В±5%; Z_{ZT}=7.5Ом	DO-215AA	K•A
WI	BZT52B12	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.8...12.2В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-123	K•A
WI	BZT52C12	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.4...12.7В; Z_{ZT}<20Ом	SOD-123	K•A
WI	BZT52C13S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.4...14.1В; Z_{ZT}<25Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WI	BZX384B12	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.8...12.2В; Z_{ZT}<25Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WI	BZX384C12	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.4...12.7В; Z_{ZT}<25Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WI	SMZG3793A	GS	dz	V_Z(I_Z=25.0 мА)=15В±10%; Z_{ZT}=9.0Ом	DO-215AA	K•A
WJ	BZT52C15S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=13.8...15.6В; Z_{ZT}<30Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WJ	SMZG3793B	GS	dz	V_Z(I_Z=25.0 мА)=15В±5%; Z_{ZT}=9.0Ом	DO-215AA	K•A
WK	BZT52B13	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.7...13.3В; Z_{ZT}<25Ом	SOD-123	K•A
WK	BZT52C13	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.4...14.1В; Z_{ZT}<25Ом	SOD-123	K•A
WK	BZT52C16S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.3...17.1В; Z_{ZT}<40Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WK	BZX384B13	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.7...13.3В; Z_{ZT}<30Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WK	BZX384C13	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.4...14.1В; Z_{ZT}<30Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WK	SMZG3794A	GS	dz	V_Z(I_Z=23.4 мА)=16В±10%; Z_{ZT}=10.0Ом	DO-215AA	K•A
WL	BZT52B15	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=14.7...15.3В; Z_{ZT}<30Ом	SOD-123	K•A
WL	BZT52C15	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=13.8...15.6В; Z_{ZT}<30Ом	SOD-123	K•A
WL	BZT52C18S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1В; Z_{ZT}<50Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WL	BZX384B15	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=14.7...15.3В; Z_{ZT}<30Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WL	BZX384C15	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=13.8...15.6В; Z_{ZT}<30Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WL	SMZG3794B	GS	dz	V_Z(I_Z=23.4 мА)=16В±5%; Z_{ZT}=10.0Ом	DO-215AA	K•A
WM	BZT52B16	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.7...16.3В; Z_{ZT}<40Ом	SOD-123	K•A
WM	BZT52C16	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.3...17.1В; Z_{ZT}<40Ом	SOD-123	K•A
WM	BZX384B16	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.7...16.3В; Z_{ZT}<40Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WM	BZX384C16	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.3...17.1В; Z_{ZT}<40Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WN	BZT52B18	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=17.6...18.4В; Z_{ZT}<50Ом	SOD-123	K•A
WN	BZT52C18	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1В; Z_{ZT}<50Ом	SOD-123	K•A
WN	BZT52C22S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=21.6...22.4В; Z_{ZT}<55Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WN	BZX384B18	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=17.6...18.4В; Z_{ZT}<45Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WN	BZX384C18	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1В; Z_{ZT}<45Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WO	BZT52B20	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=19.6...20.4В; Z_{ZT}<50Ом	SOD-123	K•A
WO	BZT52C20	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2В; Z_{ZT}<50Ом	SOD-123	K•A
WO	BZT52C24S	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.8...23.3В; Z_{ZT}<80Ом	SOD-323, SC-76	K•A
WO	BZX384B20	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=19.6...20.4В; Z_{ZT}<55Ом	SOD-323, SC-76	K•A




DO215, SOD123/323 DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
WO	BZX384C20	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} < 55 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WP	BZT52B22	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 21.6...22.4 В; Z_{ZT} < 55 Ом	SOD-123	К • А
WP	BZT52C22	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 21.6...22.4 В; Z_{ZT} < 55 Ом	SOD-123	К • А
WP	BZT52C27S	DIODS	dz	V_Z (I_{ZT} = 2мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WP	BZX384B22	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 21.6...22.4 В; Z_{ZT} < 55 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WP	BZX384C22	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 20.8...23.3 В; Z_{ZT} < 55 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WQ	BZT52C30S	DIODS	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WR	BZT52B24	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 23.5...24.5 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
WR	BZT52C24	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 22.8...23.3 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
WR	BZT52C33S	DIODS	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WR	BZX384B24	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 23.5...24.5 В; Z_{ZT} < 70 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WR	BZX384C24	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 22.8...25.6 В; Z_{ZT} < 70 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WS	BZT52B27	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5мА) = 26.5...27.5 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
WS	BZT52C27	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
WS	BZT52C36S	DIODS	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WS	BZX384B27	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2мА) = 26.5...27.5 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WS	BZX384C27	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WT	BZT52B30	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 29.4...30.6 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
WT	BZT52C30	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
WT	BZT52C39S	DIODS	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 130 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WT	BZX384B30	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 29.4...30.6 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WT	BZX384C30	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WU	BZT52B33	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 32.3...33.7 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
WU	BZT52C33	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-123	К • А
WU	BZX384B33	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 32.3...33.7 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WU	BZX384C33	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WW	BZT52B36	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 35.3...36.7 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-123	К • А
WW	BZT52C36	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-123	К • А
WW	BZX384B36	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 35.3...36.7 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WW	BZX384C36	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WX	BZT52B39	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 38.2...39.8 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-123	К • А
WX	BZT52C2V4S	DIODS	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.2...2.6 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WX	BZT52C39	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-123	К • А
WX	BZX384B39	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 38.2...39.8 В; Z_{ZT} < 130 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WX	BZX384C39	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 130 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WY	BZT52B43	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 42.1...43.9 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-123	К • А
WY	BZT52C2V0S	DIODS	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 1.91...2.09 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WY	BZT52C43	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 40...46 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-123	К • А
WY	BZX384B43	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 42.1...43.9 В; Z_{ZT} < 150 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WY	BZX384C43	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 40...46 В; Z_{ZT} < 130 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WZ	BZT52B47	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 46.1...47.9 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-123	К • А
WZ	BZT52C47	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 44...50 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-123	К • А
WZ	BZX384B47	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 46.1...47.9 В; Z_{ZT} < 170 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
WZ	BZX384C47	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 44...50 В; Z_{ZT} < 150 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
X (бел)	BB833	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{1\,В}$ = 8.5...10 пФ; $C_{28\,В}$ = 0.6...0.9	SOD-323, SC-76	К • А
X (жел)	BB835	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{1\,В}$ = 8.5...10 пФ; $C_{28\,В}$ = 0.5...0.75	SOD-323, SC-76	К • А
X1	BZT52B51	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 50.0...52.0 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-123	К • А
X1	BZT52C51	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 48...54 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-123	К • А
X1	BZX384B51	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 50.0...52.0 В; Z_{ZT} < 180 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
X1	BZX384C51	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 48...54 В; Z_{ZT} < 180 Ом	SOD-323, SC-76	К • А
X1	CMDZ5221B	CSI	dz	V_Z = 2.4 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	К • А
X1	MMSZ16T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 15.2...16.8 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	К • А

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
X2	BZT52B56	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.5$ мА$)=54.9...57.1$В; $Z_{ZT}<135$ Ом	SOD-123	K•A
X2	BZT52C56	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.5$ мА$)=52...60$В; $Z_{ZT}<135$ Ом	SOD-123	K•A
X2	BZX384B56	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА$)=54.9...57.1$В; $Z_{ZT}<200$ Ом	SOD-323, SC-76	K•A
X2	BZX384C56	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА$)=52...60$В; $Z_{ZT}<200$ Ом	SOD-323, SC-76	K•A
X2	CMDZ5222B	CSI	dz	$V_Z=2.5$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
X2	MMSZ18T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА$)=17.1...18.9$В; $I_R<0.05$ мкА	SOD-123	K•A
X3	BZT52B62	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.5$ мА$)=60.8...63.2$В; $Z_{ZT}<135$ Ом	SOD-123	K•A
X3	BZT52C62	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.5$ мА$)=58...66$В; $Z_{ZT}<135$ Ом	SOD-123	K•A
X3	BZX384B62	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА$)=60.8...63.2$В; $Z_{ZT}<215$ Ом	SOD-323, SC-76	K•A
X3	BZX384C62	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА$)=58...66$В; $Z_{ZT}<215$ Ом	SOD-323, SC-76	K•A
X3	CMDZ5223B	CSI	dz	$V_Z=2.7$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
X3	MMSZ20T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА$)=19.0...21.0$В; $I_R<0.05$ мкА	SOD-123	K•A
X4	BZT52B68	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.5$ мА$)=66.6...69.4$В; $Z_{ZT}<200$ Ом	SOD-123	K•A
X4	BZT52C68	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.5$ мА$)=64...72$В; $Z_{ZT}<200$ Ом	SOD-123	K•A
X4	BZX384B68	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА$)=66.6...69.4$В; $Z_{ZT}<240$ Ом	SOD-323, SC-76	K•A
X4	BZX384C68	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА$)=64...72$В; $Z_{ZT}<240$ Ом	SOD-323, SC-76	K•A
X4	CMDZ5224B	CSI	dz	$V_Z=2.8$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
X4	MMSZ22T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА$)=20.9...23.1$В; $I_R<0.05$ мкА	SOD-123	K•A
X5	BZT52B75	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.5$ мА$)=73.5...76.5$В; $Z_{ZT}<250$ Ом	SOD-123	K•A
X5	BZT52C75	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.5$ мА$)=70...79$В; $Z_{ZT}<250$ Ом	SOD-123	K•A
X5	BZX384B75	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА$)=73.5...76.5$В; $Z_{ZT}<255$ Ом	SOD-323, SC-76	K•A
X5	BZX384C75	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2$ мА$)=70...79$В; $Z_{ZT}<255$ Ом	SOD-323, SC-76	K•A
X5	CMDZ5225B	CSI	dz	$V_Z=3.0$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
X5	MMSZ24T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА$)=22.8...25.2$В; $I_R<0.05$ мкА	SOD-123	K•A
X6	CMDZ5226B	CSI	dz	$V_Z=3.3$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
X7	CMDZ5227B	CSI	dz	$V_Z=3.6$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
X8	CMDZ5228B	CSI	dz	$V_Z=3.9$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
X9	CMDZ5229B	CSI	dz	$V_Z=4.3$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XA	CMDZ5230B	CSI	dz	$V_Z=4.7$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XA	SMZG3795A	GS	dz	$V_Z(I_Z=20.8$ мА$)=18$В $\pm10\%$; $Z_{ZT}=12.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XB	CMDZ5231B	CSI	dz	$V_Z=5.1$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XB	SMZG3795B	GS	dz	$V_Z(I_Z=20.8$ мА$)=18$В $\pm5\%$; $Z_{ZT}=12.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XC	CMDZ5232B	CSI	dz	$V_Z=5.6$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XC	SMZG3796A	GS	dz	$V_Z(I_Z=18.7$ мА$)=20$В $\pm10\%$; $Z_{ZT}=14.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XD	CMDZ5233B	CSI	dz	$V_Z=6.0$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XD	SMZG3796B	GS	dz	$V_Z(I_Z=18.7$ мА$)=20$В $\pm5\%$; $Z_{ZT}=14.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XE	CMDZ5234B	CSI	dz	$V_Z=6.2$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XE	SMZG3797A	GS	dz	$V_Z(I_Z=17.0$ мА$)=22$В $\pm10\%$; $Z_{ZT}=17.5$ Ом	DO-215AA	K•A
XF	CMDZ5235B	CSI	dz	$V_Z=6.8$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XF	SMZG3797B	GS	dz	$V_Z(I_Z=17.0$ мА$)=22$В $\pm5\%$; $Z_{ZT}=17.5$ Ом	DO-215AA	K•A
XG	CMDZ5236B	CSI	dz	$V_Z=7.5$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XG	SMZG3798A	GS	dz	$V_Z(I_Z=15.6$ мА$)=24$В $\pm10\%$; $Z_{ZT}=19.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XH	CMDZ5237B	CSI	dz	$V_Z=8.2$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XH	MMSD701T1	ON	shd	$V_R<70$ В; $V_F(I_F=10$ мА$)<1$В; $C_D<1$ пФ	SOD-123	K•A
XH	SMZG3798B	GS	dz	$V_Z(I_Z=15.6$ мА$)=24$В $\pm5\%$; $Z_{ZT}=19.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XI	SMZG3799A	GS	dz	$V_Z(I_Z=13.9$ мА$)=27$В $\pm10\%$; $Z_{ZT}=23.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XJ	CMDZ5238B	CSI	dz	$V_Z=8.7$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XJ	SMZG3799B	GS	dz	$V_Z(I_Z=13.9$ мА$)=27$В $\pm5\%$; $Z_{ZT}=23.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XK	CMDZ5239B	CSI	dz	$V_Z=9.1$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XK	SMZG3800A	GS	dz	$V_Z(I_Z=12.5$ мА$)=30$В $\pm10\%$; $Z_{ZT}=26.0$ Ом	DO-215AA	K•A
XL	CMDZ5240B	CSI	dz	$V_Z=10$ В (5%); $P_D<250$ мВт	SOD-323, SC-76	K•A
XL	SMZG3800B	GS	dz	$V_Z(I_Z=12.5$ мА$)=30$В $\pm5\%$; $Z_{ZT}=26.0$ Ом	DO-215AA	K•A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
XN	CMDZ5241B	CSI	dz	V_Z = 11 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XO	CMDZ5242B	CSI	dz	V_Z = 12 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XP	CMDZ13L	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 13 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XP	CMDZ5243B	CSI	dz	V_Z = 13 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XQ	CMDZ5244B	CSI	dz	V_Z = 14 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XR	CMDZ5245B	CSI	dz	V_Z = 15 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XS	CMDZ5246B	CSI	dz	V_Z = 16 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XT	CMDZ5247B	CSI	dz	V_Z = 17 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XT	MMSD301T1	ON	shd	V_R < 30 В; V_F (I_F = 10 мА) < 0.6 В; C_D < 1.5 пФ	SOD-123	K • A
XU	CMDZ5248B	CSI	dz	V_Z = 18 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XV	CMDZ5249B	CSI	dz	V_Z = 19 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XX	CMDZ5250B	CSI	dz	V_Z = 20 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XY	CMDZ5251B	CSI	dz	V_Z = 22 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
XZ	CMDZ5252B	CSI	dz	V_Z = 24 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y1	CMDZ5253B	CSI	dz	V_Z = 25 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y1	MMSZ27T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 25.65...28.35 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Y2	CMDZ5254B	CSI	dz	V_Z = 27 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y2	MMSZ30T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 28.50...31.5 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Y3	CMDZ5255B	CSI	dz	V_Z = 28 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y3	MMSZ33T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 31.35...34.65 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Y4	CMDZ5256B	CSI	dz	V_Z = 30 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y4	MMSZ36T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 34.2...37.8 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Y5	CMDZ5257B	CSI	dz	V_Z = 33 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y5	MMSZ39T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 37.05...41.0 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Y6	CMDZ5258B	CSI	dz	V_Z = 36 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y7	CMDZ5259B	CSI	dz	V_Z = 39 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y8	CMDZ5260B	CSI	dz	V_Z = 43 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Y9	CMDZ5261B	CSI	dz	V_Z = 47 В (5%); P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
YA	SMZG3801A	GS	dz	V_Z (I_Z = 11.4 мА) = 33 В ± 10%; Z_{ZT} = 33.0 Ом	DO-215AA	K • A
YB	SMZG3801B	GS	dz	V_Z (I_Z = 11.4 мА) = 33 В ± 5%; Z_{ZT} = 33.0 Ом	DO-215AA	K • A
YC	SMZG3802A	GS	dz	V_Z (I_Z = 10.4 мА) = 36 В ± 10%; Z_{ZT} = 38.0 Ом	DO-215AA	K • A
YD	SMZG3802B	GS	dz	V_Z (I_Z = 10.4 мА) = 36 В ± 5%; Z_{ZT} = 38.0 Ом	DO-215AA	K • A
YE	SMZG3803A	GS	dz	V_Z (I_Z = 9.6 мА) = 39 В ± 10%; Z_{ZT} = 45.0 Ом	DO-215AA	K • A
YF	SMZG3803B	GS	dz	V_Z (I_Z = 9.6 мА) = 39 В ± 5%; Z_{ZT} = 45.0 Ом	DO-215AA	K • A
YG	SMZG3804A	GS	dz	V_Z (I_Z = 8.7 мА) = 43 В ± 10%; Z_{ZT} = 53.0 Ом	DO-215AA	K • A
YH	SMZG3804B	GS	dz	V_Z (I_Z = 8.7 мА) = 43 В ± 5%; Z_{ZT} = 53.0 Ом	DO-215AA	K • A
YI	SMZG3805A	GS	dz	V_Z (I_Z = 8.0 мА) = 47 В ± 10%; Z_{ZT} = 67.0 Ом	DO-215AA	K • A
YJ	SMZG3805B	GS	dz	V_Z (I_Z = 8.0 мА) = 47 В ± 5%; Z_{ZT} = 67.0 Ом	DO-215AA	K • A
YK	SMZG3806A	GS	dz	V_Z (I_Z = 7.3 мА) = 51 В ± 10%; Z_{ZT} = 70.0 Ом	DO-215AA	K • A
YL	SMZG3806B	GS	dz	V_Z (I_Z = 7.3 мА) = 51 В ± 5%; Z_{ZT} = 70.0 Ом	DO-215AA	K • A
YP	CMDZ15L	CSI	dz	V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 15 В; P_D < 250 мВт	SOD-323, SC-76	K • A
Z0	PDZ2.4B	PHIL	dz	V_Z = 2.4 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
Z1	MMSZ43T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 40.85...45.15 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Z1	PDZ2.7B	PHIL	dz	V_Z = 2.7 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 100 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
Z2	MMSZ47T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 44.65...49.35 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Z2	PDZ3.0B	PHIL	dz	V_Z = 3.0 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 95 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
Z3	MMSZ51T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 48.45...53.55 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Z3	PDZ3.3B	PHIL	dz	V_Z = 3.3 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 95 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
Z4	MMSZ56T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 53.20...58.80 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Z4	PDZ3.6B	PHIL	dz	V_Z = 3.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 90 Ом	SOD-323, SC-76	K • A
Z5	MMSZ62T1	ON	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 57.00...63.00 В; I_R < 0.05 мкА	SOD-123	K • A
Z5	PDZ3.9B	PHIL	dz	V_Z = 3.9 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) = 90 Ом	SOD-323, SC-76	K • A

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
Z6	MMSZ68T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\,мА)=64.60...71.40\,В$; $I_R<0.05\,мкА$	SOD-123	K•A
Z6	PDZ4.3B	PHIL	dz	$V_Z=4.3\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=90\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
Z7	MMSZ75T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\,мА)=71.25...78.75\,В$; $I_R<0.05\,мкА$	SOD-123	K•A
Z7	PDZ4.7B	PHIL	dz	$V_Z=4.7\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=90\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
Z8	PDZ5.1B	PHIL	dz	$V_Z=5.1\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=60\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
Z9	PDZ5.6B	PHIL	dz	$V_Z=5.6\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=50\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZA	PDZ6.2B	PHIL	dz	$V_Z=6.2\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=50\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZA	SMZG3807A	GS	dz	$V_Z(I_Z=6.7\,мА)=56\,В\pm10\%$; $Z_{ZT}=86.0\,Ом$	DO-215AA	K•A
ZB	PDZ6.8B	PHIL	dz	$V_Z=6.8\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=40\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZB	SMZG3807B	GS	dz	$V_Z(I_Z=6.7\,мА)=56\,В\pm5\%$; $Z_{ZT}=86.0\,Ом$	DO-215AA	K•A
ZC	PDZ7.5B	PHIL	dz	$V_Z=7.5\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=10\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZC	SMZG3808A	GS	dz	$V_Z(I_Z=6.0\,мА)=62\,В\pm10\%$; $Z_{ZT}=100.0\,Ом$	DO-215AA	K•A
ZD	PDZ8.2B	PHIL	dz	$V_Z=8.2\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=10\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZD	SMZG3808B	GS	dz	$V_Z(I_Z=6.0\,мА)=62\,В\pm5\%$; $Z_{ZT}=100.0\,Ом$	DO-215AA	K•A
ZE	PDZ9.1B	PHIL	dz	$V_Z=9.1\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=10\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZE	SMZG3809A	GS	dz	$V_Z(I_Z=5.5\,мА)=68\,В\pm10\%$; $Z_{ZT}=120.0\,Ом$	DO-215AA	K•A
ZF	PDZ10B	PHIL	dz	$V_Z=10\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=10\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZF	SMZG3809B	GS	dz	$V_Z(I_Z=5.5\,мА)=68\,В\pm5\%$; $Z_{ZT}=120.0\,Ом$	DO-215AA	K•A
ZG	PDZ11B	PHIL	dz	$V_Z=11\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=10\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZH	PDZ12B	PHIL	dz	$V_Z=12\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=10\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZJ	PDZ13B	PHIL	dz	$V_Z=13\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=10\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZK	PDZ15B	PHIL	dz	$V_Z=15\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=15\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZL	PDZ16B	PHIL	dz	$V_Z=16\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=20\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZM	PDZ18B	PHIL	dz	$V_Z=18\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=20\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZN	PDZ20B	PHIL	dz	$V_Z=20\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=20\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZP	CMDZ16L	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}=0.5\,мА)=16\,В$; $P_D<250\,мВт$	SOD-323, SC-76	K•A
ZP	PDZ22B	PHIL	dz	$V_Z=22\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=25\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZQ	PDZ24B	PHIL	dz	$V_Z=24\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=30\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZR	PDZ27B	PHIL	dz	$V_Z=27\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=40\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZS	PDZ30B	PHIL	dz	$V_Z=30\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=40\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZT	PDZ33B	PHIL	dz	$V_Z=33\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=40\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A
ZU	PDZ36B	PHIL	dz	$V_Z=36\,В$; $Z_{ZT}(I_Z=5\,мА)=60\,Ом$	SOD-323, SC-76	K•A



SOD523 SCD80 SOD219AB SMF

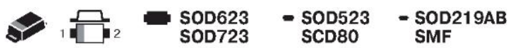
SOD523/623/723, DO219, SMF

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
1	BA277	PHIL	dtv	V_R < 35 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 1.0 В; I_R < 0.05 мкА; C_D < 1.2 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
2	BB182	PHIL	var	V_R > 32 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 52...62 пФ; $C_{28В}$ = 2.48...2.89 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
2	BB182	LRC	var	V_R > 32 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 52...62 пФ; $C_{28В}$ = 2.48...2.89 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
5	BA892	PHIL	dtv	V_R < 35 В; I_F < 10 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.02 мкА	SOD-523, SC-79	К•А
7	BBY55-02V	INF	var	V_R < 16 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 17.5...19.6 пФ; $C_{10В}$ = 5.5...6.5 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
8	BB178	PHIL	var	V_R > 32 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 34.65...42.35 пФ; $C_{28В}$ = 2.361...2.754 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
8	BB178	LRC	var	V_R > 32 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 34.65...42.35 пФ; $C_{28В}$ = 2.361...2.754 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
8	BBY58-02V	INF	var	V_R < 10 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 17.5...19.3 пФ; $C_{4В}$ = 5.5...6.6 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
9	BB179	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 18.22...21.26 пФ; $C_{28В}$ = 1.951...2.225 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
9	BB179	LRC	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 18.22...21.26 пФ; $C_{28В}$ = 1.951...2.225 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
64	BAT64-02W	INF	shd	V_R < 40 В; I_F < 250 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 0.75 В; I_R < 2 мкА; C_D < 6 пФ	SCD-80	К•А
66	BBY56-02W	INF	var	V_R < 10 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.005 мкА; $C_{1В}$ = 37...43 пФ; $C_{4В}$ = 12.1 пФ	SCD-80	К•А
77	BBY55-02W	INF	var	V_R < 16 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 17.5...19.6 пФ; $C_{10В}$ = 5.5...6.5 пФ	SCD-80	К•А
81	ZMV831BV2	ZETEX	var	V_R < 25 В; I_F < 200 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 14.25...15.75 пФ; $C_{2В}/C_{20В}$ = 4.5...6.0	SOD-523, SC-79	К•А
82	ZMV832BV2	ZETEX	var	V_R < 25 В; I_F < 200 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 20.9...23.1 пФ; $C_{2В}/C_{20В}$ = 5...6.5	SOD-523, SC-79	К•А
88	BBY58-02W	INF	var	V_R < 10 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 17.5...19.3 пФ; $C_{4В}$ = 5.5...6.6 пФ	SCD-80	К•А
91	ZV931V2	ZETEX	var	V_R < 12 В; I_F < 100 мА; I_R < 0.1 мкА; $C_{2.5В}$ = 6.5...7.8 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
92	ZV932V2	ZETEX	var	V_R < 12 В; I_F < 100 мА; I_R < 0.1 мкА; $C_{2.5В}$ = 8.5...10.5 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
93	ZV933V2	ZETEX	var	V_R < 12 В; I_F < 100 мА; I_R < 0.1 мкА; $C_{2.5В}$ = 18...27 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
0	BZX584C5V6-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.2...6 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
0	JDS2S03S	TOSH	di	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 2 мА) < 0.85 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 1.2 пФ	SOD-623	К•А
1	BZX584C16-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
1	BZX584C22-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 21.6...22.4 В; Z_{ZT} < 55 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
1	BZX584C5V1-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
1	BZX584C6V2-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
2	BZX584C18-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} < 45 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
2	BZX584C2V4-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.2...2.6 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
2	BZX584C6V8-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
3	BZX584C2V7-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.5...2.9 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
3	BZX584C7V5-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7...7.9 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
4	BB664-02V	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 39...44.5 пФ; $C_{28В}$ = 2.4...2.75	SOD-523, SC-79	К•А
4	BZX584C15-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} < 30 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
4	BZX584C20-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} < 55 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
4	BZX584C3V0-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 2.8...3.2 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
44	BB664	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 39...44.5 пФ; $C_{28В}$ = 2.4...2.75	SCD-80	К•А
5	BBY57-02V	INF	var	V_R < 10 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 16.5...18.6 пФ; $C_{4В}$ = 3.5...5.5 пФ	SOD-523, SC-79	К•А
5	BZX584C13-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 12.4...14.1 В; Z_{ZT} < 30 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
5	BZX584C24-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 22.8...23.3 В; Z_{ZT} < 70 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
5	BZX584C3V3-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.1...3.5 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
55	BBY57-02W	INF	var	V_R < 10 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 16.5...18.6 пФ; $C_{4В}$ = 3.5...5.5 пФ	SCD-80	К•А
6	BAS16-02V	INF	di	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 50 мкА	SOD-523, SC-79	К•А
6	BZX584C3V6-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.4...3.8 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
62	BAT62-02W	INF	shd	V_R < 40 В; I_F < 20 мА; V_F(I_F = 2 мА) < 1 В; I_R < 10 мкА; C_D < 0.6 пФ	SCD-80	К•А
7	BZX584C12-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} < 25 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
7	BZX584C27-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
7	BZX584C3V9-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	К•А
73	BAS70-02W	INF	shd	V_R < 70 В; I_F < 70 мА; V_F(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 2.0 пФ	SCD-80	К•А
8	BZX584C4V3-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4.0...4.6 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	К•А





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
9	BZX584C33-02V	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 2 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
9	BZX584C4V7-02V	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.4...5.0 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
A	1SS400	ROHM	di	V_R < 80 В; I_F < 225 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.1 мкА; t_{RR} < 4 нс	SOD-523, SC-79	K • A
A	BA892-02L	INF	dtv	V_R < 35 В; I_F < 10 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.02 мкА	SOD-523, SC-79	K • A
A	JDV2S06S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; C_{1B} = 15...17 пФ; C_{4B} = 7.0...8.5	SOD-623	K • A
A, 4	1SS400	WEIT	di	V_R < 80 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.1 мкА; t_{RR} < 4 нс	SOD-523, SC-79	K • A
A1	BB208-02	PHIL	var	V_R > 10 В; I_R (V_R = 10 В) < 0.01 мкА; C_{1B} = 19.9...23.2 пФ; $C_{7.5B}$ = 4.5...5.4 пФ	SOD-523, SC-79	K • A
A2	BB184	PHIL	var	V_R > 13 В; I_R (V_R = 10 В) < 0.01 мкА; C_{1B} = 12.7...15.3 пФ; C_{10B} = 1.87...2.13 пФ	SOD-523, SC-79	K • A
A6	BAS16-02W	INF	di	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 50 мкА	SCD-80	K • A
AA	BA892	INF	dtv	V_R < 35 В; I_F < 10 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.02 мкА	SCD-80	K • A
B	BB555	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 17.5...20 пФ; C_{1B}/C_{28B} = 8.2...9.8	SCD-80	K • A
B	JDV2S09S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; C_{1B} = 9.7...11.1 пФ; C_{4B} = 4.45...5.45	SOD-623	K • A
BB	BB555-02V	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 17.5...20 пФ; C_{1B}/C_{28B} = 8.2...9.8	SOD-523, SC-79	K • A
C	BB179B	PHIL	var	V_R > 32 В; I_R (V_R = 30 В) < 0.01 мкА; C_{1B} = 18.22...20 пФ; C_{28B} = 1.9...2.25 пФ	SOD-523, SC-79	K • A
C	BB565-02V	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 18.5...21.5 пФ; C_{1B}/C_{28B} = 9...11	SOD-523, SC-79	K • A
C	JDV2S08S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; C_{1B} = 17.3...19.3 пФ; C_{4B} = 5.3...6.6	SOD-623	K • A
C0	BZX585-B5V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.49...5.71 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C1	1SS387	TOSH	di	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.5 мкА; t_{RR} < 4 нс	SOD-523, SC-79	K • A
C1	BZX585-B2V4	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.35...2.45 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C2	BZX585-B2V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.65...2.75 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C3	BZX585-B3V0	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.94...3.06 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C4	BZX585-B3V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.23...3.37 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C5	BZX585-B3V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.53...3.67 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C6	BZX585-B3V9	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.82...3.98 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C7	BZX585-B4V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.21...4.39 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C8	BZX585-B4V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.61...4.79 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
C9	BZX585-B5V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.0...5.2 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
CC	BB565	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 18.5...21.5 пФ; C_{1B}/C_{28B} = 9...11	SCD-80	K • A
D	JDV2S07S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; C_{1B} = 4.0...4.9 пФ; C_{4B} = 1.85...2.35	SOD-623	K • A
D0	BZD27C3V6P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 3.4...3.8 В; Z_{ZT} < 8 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D1	BZD27C3V9P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} < 8 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D2	BZD27C4V3P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 4...4.6 В; Z_{ZT} < 7 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D3	BZD27C4V7P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 4.4...5 В; Z_{ZT} < 7 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D4	BZD27C5V1P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} < 6 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D5	BZD27C5V6P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 5.2...6 В; Z_{ZT} < 4 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D6	BZD27C6V2P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} < 3 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D7	BZD27C6V8P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} < 3 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D8	BZD27C7V5P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 7...7.9 В; Z_{ZT} < 2 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
D9	BZD27C8V2P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 100 мА) = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} < 2 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
DE	BB659	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 36...40 пФ; C_{1B}/C_{28B} = 14.7	SCD-80	K • A
E	BB689-02V	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 51...61.5 пФ; C_{28B} = 2.5...2.9	SOD-523, SC-79	K • A
E	JDV2S13S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; C_{1B} = 5.7...6.7 пФ; C_{4B} = 1.85...2.45	SOD-623	K • A
E0	BZD27C9V1P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 8.5...9.6 В; Z_{ZT} < 4 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
E0	BZX585-B15	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 14.7...15.3 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
E1	BZD27C10P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 9.4...10.6 В; Z_{ZT} < 4 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
E1	BZX585-B6V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 6.08...6.32 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
E2	BZD27C11P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} < 7 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
E2	BZX585-B6V8	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 6.66...6.94 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
E3	BZD27C12P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} < 7 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
E3	BZX585-B7V5	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 7.35...7.65 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
E4	BZD27C13P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 12.4...14.1 В; Z_{ZT} < 10 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
E4	BZX585-B8V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 8.04...8.36 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
E5	BZD27C15P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 50 мА) = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
E5	BZX585-B9V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 8.92...9.28 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
E6	BZD27C16P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
E6	BZX585-B10	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 9.8...10.2 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
E7	BZD27C18P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
E7	BZX585-B11	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 10.8...11.2 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
E8	BZD27C20P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
E8	BZX585-B12	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 11.8...12.2 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
E9	BZD27C22P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 20.8...23.3 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
E9	BZX585-B13	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 12.7...13.3 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
EE	BB689	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1 В}$ = 51...61.5 пФ; $C_{28 В}$ = 2.5...2.9	SCD-80	K•A
F	BAS20-02W	SIEM	di	V_R < 150 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 5.0 пФ; t_{RR} < 50 нс	SCD-80	K•A
F	BBY65-02V	INF	var	V_R < 15 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1 В}$ = 20.25 пФ; C4.7V = 2.6...2.8 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
F	JDV2S10S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{0.5 В}$ = 7.3...8.4 пФ; $C_{2.5 В}$ = 2.75...3.4	SOD-623	K•A
F0	BZD27C24P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 22.8...25.6 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F0	BZX585-C5V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 5.32...5.88 В; Z_{ZT} < 40 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F0	CMOZ5V6	CSI	dz	V_Z = 5.6 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F1	BZD27C27P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F1	BZX585-C2V4	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.28...2.52 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F1	CMOZ2V4	CSI	dz	V_Z = 2.4 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F1A	CMOZ2V6	CSI	dz	V_Z = 2.6 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F2	BZD27C30P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F2	BZX585-C2V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.57...2.84 В; Z_{ZT} < 100 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F2	CMOZ2V7	CSI	dz	V_Z = 2.7 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F3	BZD27C33P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 25 мА) = 31...35 В; Z_{ZT} < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F3	BZX585-C3V0	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 2.85...3.15 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F3	CMOZ3V0	CSI	dz	V_Z = 3.0 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F4	BZD27C36P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 40 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F4	BZX585-C3V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.14...3.47 В; Z_{ZT} < 95 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F4	CMOZ3V3	CSI	dz	V_Z = 3.3 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F5	BZD27C39P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 40 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F5	BZX585-C3V6	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.42...3.78 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F5	CMOZ3V6	CSI	dz	V_Z = 3.6 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F6	BZD27C43P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 40...46 В; Z_{ZT} < 45 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F6	BZX585-C3V9	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 3.71...4.10 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F6	CMOZ3V9	CSI	dz	V_Z = 3.9 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F7	BZD27C47P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 44...50 В; Z_{ZT} < 45 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F7	BZX585-C4V3	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.09...4.52 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F7	CMOZ4V3	CSI	dz	V_Z = 4.3 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F8	BZD27C51P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 48...54 В; Z_{ZT} < 60 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F8	BZX585-C4V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.47...4.94 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F8	CMOZ4V7	CSI	dz	V_Z = 4.7 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
F9	BZD27C56P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 52...60 В; Z_{ZT} < 60 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
F9	BZX585-C5V1	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5 мА) = 4.85...5.36 В; Z_{ZT} < 60 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
F9	CMOZ5V1	CSI	dz	V_Z = 5.1 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
FA	JDV2S01E	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{1 В}$ = 2.85...3.45 пФ; $C_{4 В}$ = 1.35...1.81	SOD-523, SC-79	K•A
FB	JDV2S02E	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{1 В}$ = 1.8...2.3 пФ; $C_{4 В}$ = 0.83...1.23	SOD-523, SC-79	K•A
FE	JDV2S05E	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{1 В}$ = 3.85...4.55 пФ; $C_{4 В}$ = 1.94...2.48	SOD-523, SC-79	K•A
FH	JDV2S14E	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{1 В}$ = 44...49.5 пФ; $C_{4 В}$ = 9.2...12	SOD-523, SC-79	K•A
G	BAR63-02V	INF	pin	V_R < 50 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.01 мкА	SOD-523, SC-79	K•A
G	JDV2S01S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{1 В}$ = 2.85...3.45 пФ; $C_{4 В}$ = 1.35...1.81	SOD-623	K•A
G0	BZD27C62P	VISH	dz	V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 58...66 В; Z_{ZT} < 80 Ом	DO-219AB, SMF	K•A





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
G1	BZD27C68P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 64...72 В; Z_{ZT} < 80 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
G2	BZD27C75P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 70...79 В; Z_{ZT} < 100 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
G3	BZD27C82P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 10 мА) = 77...87 В; Z_{ZT} < 100 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
G4	BZD27C91P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 85...96 В; Z_{ZT} < 200 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
G5	BZD27C100P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 94...106 В; Z_{ZT} < 200 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
G6	BZD27C110P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 104...116 В; Z_{ZT} < 250 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
G7	BZD27C120P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 114...127 В; Z_{ZT} < 250 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
G8	BZD27C130P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 124...141 В; Z_{ZT} < 300 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
G9	BZD27C150P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 138...156 В; Z_{ZT} < 300 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
GG	BAR63-02W	INF	pin	V_R < 50 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.01 мкА	SCD-80	K • A
H	BB141	PHIL	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6В)< 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 3.9...4.5 пФ; $C_{4В}$ = 2.22...2.55 пФ	SOD-523, SC-79	K • A
H	BB141	LRC	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6В)< 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 3.9...4.5 пФ; $C_{4В}$ = 2.22...2.55 пФ	SOD-523, SC-79	K • A
H	BB659C-02V	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 36.5...42 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 15.3	SOD-523, SC-79	K • A
H	JDV2S02S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 1.8...2.3 пФ; $C_{4В}$ = 0.83...1.23	SOD-623	K • A
H0	BZD27C160P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 153...171 В; Z_{ZT} < 350 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
H0	BZX585-C15	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 14.25...15.75 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H0	CMOZ15V	CSI	dz	V_Z = 15 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H1	BZD27C180P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 168...191 В; Z_{ZT} < 400 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
H1	BZX585-C6V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 5.89...6.51 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H1	CMOZ6V2	CSI	dz	V_Z = 6.2 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H2	BZD27C200P	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 188...212 В; Z_{ZT} < 500 Ом	DO-219AB, SMF	K • A
H2	BZX585-C6V8	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 6.46...7.14 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H2	CMOZ6V8	CSI	dz	V_Z = 6.8 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H3	BZX585-C7V5	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.13...7.88 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H3	CMOZ7V5	CSI	dz	V_Z = 7.5 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H4	BZX585-C8V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.79...8.61 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H4	CMOZ8V2	CSI	dz	V_Z = 8.2 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H5	BZX585-C9V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 8.65...9.56 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H5	CMOZ9V1	CSI	dz	V_Z = 9.1 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H6	BZX585-C10	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 9.5...10.5 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H6	CMOZ10V	CSI	dz	V_Z = 10 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H7	BZX585-C11	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 10.45...11.55 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H7	CMOZ11V	CSI	dz	V_Z = 11 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H8	BZX585-C12	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 11.4...12.6 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H8	CMOZ12V	CSI	dz	V_Z = 12 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
H9	BZX585-C13	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 12.35...13.65 В; Z_{ZT} < 10 Ом	SOD-523, SC-79	K • A
H9	CMOZ13V	CSI	dz	V_Z = 13 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
HH	BB659C	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 36.5...42 пФ; $C_{1В}/C_{28В}$ = 15.3	SCD-80	K • A
II	BBY51-02W	INF	var	V_R < 7 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 5.05...5.75 пФ; C4V = 2.5...3.7 пФ	SCD-80	K • A
J0	CMOZ39V	CSI	dz	V_Z = 39 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J1	CMOZ16V	CSI	dz	V_Z = 16 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J2	CMOZ18V	CSI	dz	V_Z = 18 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J3	CMOZ20V	CSI	dz	V_Z = 20 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J4	CMOZ22V	CSI	dz	V_Z = 22 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J5	CMOZ24V	CSI	dz	V_Z = 24 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J6	CMOZ27V	CSI	dz	V_Z = 27 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J7	CMOZ30V	CSI	dz	V_Z = 30 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J8	CMOZ33V	CSI	dz	V_Z = 33 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
J9	CMOZ36V	CSI	dz	V_Z = 36 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K • A
K	BB142	PHIL	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6В)< 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 4...4.9 пФ; $C_{4В}$ = 1.85...2.35 пФ	SOD-523, SC-79	K • A
K	BB142	LRC	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6В)< 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 4...4.9 пФ; $C_{4В}$ = 1.85...2.35 пФ	SOD-523, SC-79	K • A
K	BB679-02V	INF	var	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 43.5...51.5 пФ; $C_{28В}$ = 2.4...2.8	SOD-523, SC-79	K • A



SOD623 SOD523 SOD219AB
SOD723 SCD80 SMF

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
K	BZX584C30-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2 мА) = 28...32 В; Z_{ZT} < 80 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
K	JDV2S05S	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 3.85...4.55 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 1.94...2.48	SOD-623	K•A
K1	CMOZ43V	CSI	dz	V_Z = 43 В (5%); P_D < 350 мВт	SOD-523, SC-79	K•A
K3	BB145C	PHIL	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 15 В) < 0.003 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 6.4...7.2 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 2.55...2.85 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
KK	BBY52-02W	INF	var	V_R < 7 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 1.4...2.2 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 0.85...1.45 пФ	SCD-80	K•A
L	BB143	PHIL	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6 В) < 0.01 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 4.75...5.75 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 2.05...2.55 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
L	BB143	LRC	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6 В) < 0.01 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 4.75...5.75 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 2.05...2.55 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
L	BBY53-02V	INF	var	V_R < 6 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 4.8...5.8 пФ; $C_{3\text{В}}$ = 1.85...3.1 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
L	BZX584C47-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2 мА) = 44...50 В; Z_{ZT} < 170 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
L2	BB202	PHIL	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6 В) < 0.01 мкА; C0.2V = 28.2...33.5 пФ; C2.3V = 7.2...11.2 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
LL	BBY53-02W	INF	var	V_R < 6 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 4.8...5.8 пФ; $C_{3\text{В}}$ = 1.85...3.1 пФ	SCD-80	K•A
M	BAR64-02W	SIEM	pin	V_R < 200 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.1 В; C_D < 0.35 пФ	SCD-80	K•A
M	BZX584C51-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2 мА) = 48...54 В; Z_{ZT} < 180 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
N	BAR65-02V	INF	pin	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.0 В; C_D < 0.9 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
n	BAT15-02V	INF	shd	V_R < 4 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.41 В; C_D < 0.35 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
N	BB181	PHIL	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5\text{В}}$ = 8...17 пФ; $C_{28\text{В}}$ = 0.7...1.055 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
N	BB181	LRC	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{0.5\text{В}}$ = 8...17 пФ; $C_{28\text{В}}$ = 0.7...1.055 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
O	BAR64-02V	INF	pin	V_R < 150 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.1 В; C_D < 0.35 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
P	BZX584C11-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
P	BZX584C36-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2 мА) = 34...38 В; Z_{ZT} < 90 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
R	BZX584C10-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 9.4...10.6 В; Z_{ZT} < 20 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
R	BZX584C39-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2 мА) = 37...41 В; Z_{ZT} < 130 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
RA	BA895	INF	pin	V_R > 50 В; I_F < 50 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.1 В; I_R < 0.02 мкА	SCD-80	K•A
RR	BBY59-02V	INF	var	V_R < 15 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 26.6...29 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 6.1...7.8 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
S	BAP64-02	PHIL	pin	V_R > 175 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.1 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-523, SC-79	K•A
S	BZX584C43-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 2 мА) = 40...46 В; Z_{ZT} < 150 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
S	BZX584C9V1-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 8.5...9.6 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
S3	1SS388	TOSH	shd	V_R < 40 В; V_F(I_F = 50 мА) < 0.6 В; I_R(V_R = 10 В) < 5 мкА; C_T < 25 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
S4	1SS389	TOSH	shd	V_R < 10 В; V_F(I_F = 100 мА) < 0.5 В; I_R(V_R = 10 В) < 20 мкА; C_T < 40 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
T	BAR67-02V	INF	pin	V_R < 150 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.2 В; C_D < 0.9 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
T	BAR67-02W	SIEM	pin	V_R < 150 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.2 В; C_D < 0.9 пФ	SCD-80	K•A
t	BAT64-02V	INF	shd	V_R < 40 В; I_F < 250 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 0.75 В; I_R < 2 мкА; C_D < 6 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
T	BZX584C8V2-02V	VISH	dz	V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} < 15 Ом	SOD-523, SC-79	K•A
T1	1SV278	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 14.16...16.25 пФ; $C_{25\text{В}}$ = 2.11...2.43 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
T3	1SV309	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 3.31...4.55 пФ; $C_{25\text{В}}$ = 0.61...0.77 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
T7	1SV286	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 14.5...16.1 пФ; $C_{20\text{В}}$ = 1.56...1.86 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
T8	1SV279	TOSH	var	V_R > 15 В; I_R(V_R = 15 В) < 0.003 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 14...16 пФ; $C_{10\text{В}}$ = 5.5...6.5 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TC	1SV280	TOSH	var	V_R > 15 В; I_R(V_R = 15 В) < 0.003 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 3.8...4.7 пФ; $C_{10\text{В}}$ = 1.5...2 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TD	1SV282	TOSH	var	V_R > 34 В; I_R(V_R = 32 В) < 0.01 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 33...38 пФ; $C_{25\text{В}}$ = 2.6...3 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TE	1SV283	TOSH	var	V_R > 34 В; I_R(V_R = 32 В) < 0.01 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 29...34 пФ; $C_{25\text{В}}$ = 2.5...2.9 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TF	1SV281	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 15...17 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 7.3...8.7 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TJ	1SV290	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 41...49.5 пФ; $C_{25\text{В}}$ = 2.5...3.2 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TK	1SV291	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 4.2...5.7 пФ; $C_{25\text{В}}$ = 0.53...0.68 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TL	1SV284	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 15...17 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 7...8.5 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TO	1SV285	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 4...4.9 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 1.85...2.35 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TT	1SV303	TOSH	var	V_R > 30 В; I_R(V_R = 28 В) < 0.01 мкА; $C_{2\text{В}}$ = 42...51 пФ; $C_{25\text{В}}$ = 2.1...3.1 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TV	1SV305	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 17.3...19.3 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 5.3...6.6 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
TX	1SV308	TOSH	pin	V_R > 30 В; I_F < 50 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-523, SC-79	K•A
TY	1SS381	TOSH	di	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 2 мА) < 0.85 В; I_R < 0.1 мкА	SOD-523, SC-79	K•A
U	BB145	PHIL	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6 В) < 0.01 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 6.4...7.4 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 2.75...3.25 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
U	BB145	LRC	var	V_R > 6 В; I_R(V_R = 6 В) < 0.01 мкА; $C_{1\text{В}}$ = 6.4...7.4 пФ; $C_{4\text{В}}$ = 2.75...3.25 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
V.6	JDV2S10T	TOSH	var	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{0.5\text{В}}$ = 7.3...8.4 пФ; $C_{2.5\text{В}}$ = 2.75...3.4	SOD-523, SC-79	K•A

SOD623 SOD723 SOD523 SCD80 SOD219AB SMF





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
V1	1SV311	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R (V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 9.7...11.1 пФ; $C_{4В}$ = 4.45...5.45 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
V2	1SV329	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R (V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 5.7...6.7 пФ; $C_{4В}$ = 1.85...2.45 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
V6	1SV314	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R (V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{0.5В}$ = 7.3...8.4 пФ; $C_{2.5В}$ = 2.75...3.4 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
V7	1SV323	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R (V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 26.5...29.5 пФ; $C_{4В}$ = 6...7.1 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
V8	1SV325	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R (V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 44...49.5 пФ; $C_{4В}$ = 9.2...12 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
V9	1SV331	TOSH	var	V_R > 10 В; I_R (V_R = 10 В) < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 17...19 пФ; $C_{4В}$ = 4.25...5.43 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
W5	GZF3V6C	VISH	dz	V_Z = 3.4...3.8 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 8 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
W6	GZF3V9C	VISH	dz	V_Z = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 8 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
W7	GZF4V3C	VISH	dz	V_Z = 4.0...4.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 7 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
W8	GZF4V7C	VISH	dz	V_Z = 4.4...5.0 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 7 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
W9	GZF5V1C	VISH	dz	V_Z = 4.8...5.4 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 6 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WA	GZF5V6C	VISH	dz	V_Z = 5.2...6.0 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 4 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WB	GZF6V2C	VISH	dz	V_Z = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 3 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WC	GZF6V8C	VISH	dz	V_Z = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 3 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WD	GZF7V5C	VISH	dz	V_Z = 7.0...7.9 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 2 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WE	GZF8V2C	VISH	dz	V_Z = 7.7...8.7 В; Z_{ZT} (I_Z = 100 мА) < 2 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WF	GZF9V1C	VISH	dz	V_Z = 8.5...9.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 50 мА) < 4 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WG	GZF10C	VISH	dz	V_Z = 9.4...10.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 50 мА) < 4 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WH	GZF11C	VISH	dz	V_Z = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 50 мА) < 7 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WI	GZF12C	VISH	dz	V_Z = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} (I_Z = 50 мА) < 7 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WK	GZF13C	VISH	dz	V_Z = 12.4...14.1 В; Z_{ZT} (I_Z = 50 мА) < 10 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WL	GZF15C	VISH	dz	V_Z = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 50 мА) < 10 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WM	GZF16C	VISH	dz	V_Z = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} (I_Z = 25 мА) < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WN	GZF18C	VISH	dz	V_Z = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} (I_Z = 25 мА) < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WO	GZF20C	VISH	dz	V_Z = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} (I_Z = 25 мА) < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WP	GZF22C	VISH	dz	V_Z = 20.8...23.3 В; Z_{ZT} (I_Z = 25 мА) < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WR	GZF24C	VISH	dz	V_Z = 22.8...25.6 В; Z_{ZT} (I_Z = 25 мА) < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WS	GZF27C	VISH	dz	V_Z = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} (I_Z = 25 мА) < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WT	GZF30C	VISH	dz	V_Z = 28...32 В; Z_{ZT} (I_Z = 25 мА) < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WU	GZF33C	VISH	dz	V_Z = 31...35 В; Z_{ZT} (I_Z = 25 мА) < 15 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WW	GZF36C	VISH	dz	V_Z = 34...38 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 40 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WX	GZF39C	VISH	dz	V_Z = 37...41 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 40 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WY	GZF43C	VISH	dz	V_Z = 40...46 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 45 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
WZ	GZF47C	VISH	dz	V_Z = 44...50 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 45 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
X	BB187	PHIL	var	V_R > 32 В; I_R (V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 29.3...34.2 пФ; $C_{25В}$ = 2.57...2.92 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
X	BB187	LRC	var	V_R > 32 В; I_R (V_R = 30 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 29.3...34.2 пФ; $C_{25В}$ = 2.57...2.92 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
X1	GZF51C	VISH	dz	V_Z = 48...54 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 60 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
X2	GZF56C	VISH	dz	V_Z = 52...60 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 60 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
X3	GZF62C	VISH	dz	V_Z = 58...66 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 80 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
X4	GZF68C	VISH	dz	V_Z = 64...72 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 80 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
X5	GZF75C	VISH	dz	V_Z = 70...79 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 100 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
X6	GZF82C	VISH	dz	V_Z = 77...87 В; Z_{ZT} (I_Z = 10 мА) < 100 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
X7	GZF91C	VISH	dz	V_Z = 85...96 В; Z_{ZT} (I_Z = 5 мА) < 200 Ом	DO-219AB, SMF	K•A
y	BAS52-02V	INF	shd	V_R < 45 В; I_F < 750 мА; V_F (I_F = 200 мА) < 0.6 В; I_R < 80 мкА; C_D < 10 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
Y	BB182B	PHIL	var	V_R > 34 В; I_R (V_R = 32 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 47...53 пФ; $C_{25В}$ = 2.65...3 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
Y	BB182B	LRC	var	V_R > 34 В; I_R (V_R = 32 В) < 0.01 мкА; $C_{2В}$ = 47...53 пФ; $C_{25В}$ = 2.65...3 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
Z	BB145B	PHIL	var	V_R > 6 В; I_R (V_R = 6В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 6.4...7.2 пФ; $C_{4В}$ = 2.55...2.95 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
Z	BB145B	LRC	var	V_R > 6 В; I_R (V_R = 6В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 6.4...7.2 пФ; $C_{4В}$ = 2.55...2.95 пФ	SOD-523, SC-79	K•A
Z1	BB145B-01	PHIL	var	V_R > 6 В; I_R (V_R = 6В) < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 6.4...7.2 пФ; $C_{4В}$ = 2.55...2.95 пФ	SOD-723	K•A

TSLP-2 TSLP-3, SOT883 TSLP-4 µDFN-6






SOT883, TSLP, µDFN

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3...
62	BAT62-07L4	INF	shd x2	V_R < 40В; I_F < 20 мА; V_F (I_F = 2 мА) < 1 В; I_R < 10 мкА; C_D < 0.6 пФ	TSLP-4	K1•K2•A2•A1
83	BAT68-02L	INF	shd	V_R < 8 В; I_F < 130 мА; V_F (I_F = 10 мА) < 0.5 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 1.0 пФ	TSLP-2	K•A
88	BBY58-02L	INF	var	V_R < 10В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 17.5...19.3 пФ; C_{4B} = 5.5...6.6 пФ	TSLP-2	K•A
55	BBY57-02L	INF	var	V_R < 10В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 16.5...18.6 пФ; C_{4B} = 3.5...5.5 пФ	TSLP-2	K•A
6A	BAS16-07L4	INF	di x 2	V_R < 80В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 50 мкА	TSLP-4	K1•K2•A2•A1
A4	BAV70L3	INF	di x2	V_R < 80В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1 В; I_R (V_R = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} <4 нс	TSLP-3	A1•A2•K1, K2
A6	BAS16-02L	INF	di	V_R < 80В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 50 мкА	TSLP-2	K•A
AA	BA892-02L	INF	dtv	V_R < 35В; I_F < 10 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.02 мкА	TSLP-2	K•A
AA	MAX4599ELT	MAX	asw	SPDT; R_{ON} < 65 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5В	µDFN-6	IN•V+•GND•NC•COM•NO
AB	MAX4594ELT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 12 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5В	µDFN-6	COM•NO•GND•IN•n.c.•V+
AC	MAX4595ELT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 12 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5В	µDFN-6	COM•NC•GND•IN•n.c.•V+
AD	MAX4596ELT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 12 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5В	µDFN-6	IN•COM•GND•NO•n.c.•V+
AE	MAX4597ELT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 12 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5В	µDFN-6	IN•COM•GND•NC•n.c.•V+
B8	BBY58-07L4	INF	var	V_R < 10В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 17.5...19.3 пФ; C_{4B} = 5.5...6.6 пФ	TSLP-4	K1•K2•A2•A1
D4	BC847AM	PHIL	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц	SOT-883, SC-101	B•E•C
D5	BC847BM	PHIL	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 200...450; f_T > 100 МГц	SOT-883, SC-101	B•E•C
D6	BC847CM	PHIL	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 200...450; f_T > 100 МГц	SOT-883, SC-101	B•E•C
DE	PDTA114TM	PHIL	Dpnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 200; R_1 10 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DF	PDTA114YM	PHIL	Dpnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DH	PDTA124EM	PHIL	Dpnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DL	PDTA143EM	PHIL	Dpnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DN	PDTA143XM	PHIL	Dpnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DP	PDTA143ZM	PHIL	Dpnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DR	PDTA144EM	PHIL	Dpnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DS	PDTC114EM	PHIL	Dnpn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DT	PDTC114TM	PHIL	Dnpn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 200; R_1 10 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DU	PDTC114YM	PHIL	Dnpn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
DX	PDTC124EM	PHIL	Dnpn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
E1	PDTC143EM	PHIL	Dnpn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
E2	PDTC143XM	PHIL	Dnpn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
E3	PDTC143ZM	PHIL	Dnpn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
E7	PDTC144EM	PHIL	Dnpn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм	SOT-883, SC-101	B•E•C
F	BAS70-02L	INF	shd	V_R < 70В; I_F < 70 мА; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 2.0 пФ	TSLP-2	K•A
FF	BAS40-02L	INF	shd	V_R < 40В; I_F < 120 мА; V_F (I_F = 40 мА) < 1 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ	TSLP-2	K•A
G	BAR63-02L	INF	pin	V_R < 50В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.01 мкА	TSLP-2	K•A
II	BBY51-02L	INF	var	V_R < 7 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 5.05...5.75 пФ; C4V = 2.5...3.7 пФ	TSLP-2	K•A
K	BBY52-02L	INF	var	V_R < 7 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 1.4...2.2 пФ; C_{4B} = 0.85...1.45 пФ	TSLP-2	K•A
L	BAT62-02L	INF	shd	V_R < 40В; I_F < 20 мА; V_F (I_F = 2 мА) < 1 В; I_R < 10 мкА; C_D < 0.6 пФ	TSLP-2	K•A
L0	RN1101FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7/4.7 кОм	SOT-823	B•E•C

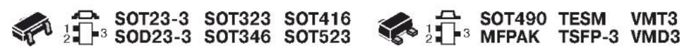


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3...
L1	RN1102FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT-823	B•E•C
L2	RN1103FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT-823	B•E•C
L3	RN1104FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT-823	B•E•C
L4	RN1105FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT-823	B•E•C
L5	RN1106FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT-823	B•E•C
L6	RN1107FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT-823	B•E•C
L7	RN1108FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT-823	B•E•C
L8	RN1109FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT-823	B•E•C
L9	RN1110FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT-823	B•E•C
LF	RN1111FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT-823	B•E•C
LH	RN1112FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT-823	B•E•C
LJ	RN1113FS	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT-823	B•E•C
LL	BBY53-02L	INF	var	V_R<6 В; I_F<20 мА; I_R<0.01 мкА; $C_{1В}$=4.8...5.8 пФ; $C_{3В}$=1.85...3.1 пФ	TSLP-2	K•A
LL	BBY53-03L	INF	var	V_R<6 В; I_F<20 мА; I_R<0.01 мкА; $C_{1В}$=4.8...5.8 пФ; $C_{3В}$=1.85...3.1 пФ	TSLP-3	A•n.c.•K
MM	BAR64-02L	INF	pin	V_R<150 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; C_D<0.35 пФ	TSLP-2	K•A
NN	BAR65-02L	INF	pin	V_R<30 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; C_D<0.9 пФ	TSLP-2	K•A
NP	BAT15-02L	INF	shd	V_R<4 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.41 В; C_D<0.35 пФ	TSLP-2	K•A
P3s	BAR63-07L4	INF	pin x2	V_R<50 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.01 мкА	TSLP-4	K1•K2•A2•A1
U0	RN2101FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	SOT-823	B•E•C
U1	RN2102FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT-823	B•E•C
U2	RN2103FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT-823	B•E•C
U3	RN2104FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT-823	B•E•C
U4	RN2105FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT-823	B•E•C
U5	RN2106FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT-823	B•E•C
U6	RN2107FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT-823	B•E•C
U7	RN2108FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT-823	B•E•C
U8	RN2109FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT-823	B•E•C
U9	RN2110FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1=4.7 кОм	SOT-823	B•E•C
UF	RN2111FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1=10 кОм	SOT-823	B•E•C
UH	RN2112FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1=22 кОм	SOT-823	B•E•C
UJ	RN2113FS	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1=47 кОм	SOT-823	B•E•C
WC	BCR133L3	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T=130 МГц	TSLP-3	B•E•C
WD	BCR141L3	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>50; f_T>130 МГц	TSLP-3	B•E•C
WE	BCR148L3	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>100 МГц	TSLP-3	B•E•C
WH	BCR108L3	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>170 МГц	TSLP-3	B•E•C
WI	BCR158L3	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T=100 МГц	TSLP-3	B•E•C
WJs	BCR135L3	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>150 МГц	TSLP-3	B•E•C
WM	BCR183L3	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30;	TSLP-3	B•E•C
WP	BCR192L3	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T>200 МГц	TSLP-3	B•E•C
WU	BCR162L3	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>200 МГц	TSLP-3	B•E•C

SOT23-3, SOT323/523…

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
-28	PDTA114WU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>60; 47 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
-20	PDTC114WU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>60; 47 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
9	BC849	MOT	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
11	MMBD1501	NS	dl	V_R<180 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
11	MMBD1501	FAIR	dl	V_R<200 В; I_F=200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
13	MMBD1503	NS	dl×2	V_R<180 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
13	MMBD1503	FAIR	dl×2	V_R<200 В; I_F=200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
14	DTA114ECA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
14	MMBD1504	FAIR	dl×2	V_R<200 В; I_F=200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
15	DTA124ECA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
15	MMBD1505	FAIR	dl×2	V_R<200 В; I_F=200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
22	MMBT4209	NS	pnp	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>35; f_T=850 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
23	MMBT3646	NS	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=300 мА; P_D=625 мВт; h_{21}>15	SOT23,SOD23	B•E•C
24	DTC114ECA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
24	MMBD1201	FAIR	di	V_R<100 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<3 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
25	DTC124ECA	ROHM	Dnpn	RV_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
29	MMBD1401	NS	d	V_R<175 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
29	MMBD1401	NS	d	V_R<175 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
31	MMBD1402	NS	d	V_R<175 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
32	MMBD1403	NS	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
33	MMBD1404	NS	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
34	MMBD1405	NS	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
43	DTA143EE	MOT	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
45	BAS40-05	DIOT	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K2,K1
45	BAS40-05	MCS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K2,K1
45	BAS40-05	TSC	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K2,K1
45	BAS40-05	GS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K2,K1
46	BAS40-06	DIOT	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
46	BAS40-06	MCS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
46	BAS40-06	TSC	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
46	BAS40-06	GS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
69	DTA114YE	MOT	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
69	DTC115EE	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
69	DTC115EUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
72	2N7002	SIL	nFET	V_{DS}=60 В; I_D=115 мА; P_D=300 мВт; V_{GSTH}=1...2.5 В; C_{ISS}<50 пФ	SOT23,SOD23	G•S•D
73	MA4CS101A	M/A	shd	V_R=70 В; I_F<15 мА; V_F(I_F=15 мА)<1 В; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
74	MA4CS101B	M/A	shd×2	V_R=70 В; I_F<15 мА; V_F(I_F=15 мА)<1 В; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
78	MMBT4258	FAIR	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=200 мА; P_D=225 мВт; h_{21}=30...120; f_T>700 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
83	MA4CS102A	M/A	shd	V_R=8 В; I_F<30 мА; V_F(I_F=10 мА)<500 мВ; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
83	MMBT4400	FAIR	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=1 А; P_D=350 мВт; h_{21}=50...150	SOT23,SOD23	B•E•C
84	MA4CS102B	M/A	shd×2	V_R=8 В; I_F<30 мА; V_F(I_F=10 мА)<500 мВ; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
85	MA4CS102C	M/A	shd×2	V_R=8 В; I_F<30 мА; V_F(I_F=10 мА)<500 мВ; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
85	MMBD1701	FAIR	dl	V_R<30 В; I_F=50 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; C_D<1 пФ; t_{RR}<0.7 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
86	MMBD1702	FAIR	dl	V_R<30 В; I_F=50 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; C_D<1 пФ; t_{RR}<0.7 нс	SOT23,SOD23	n.c.•A•K

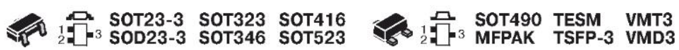
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
87	MMBD1703	FAIR	dl-2	V_R<30 В; I_F=50 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; C_D<1 пФ; t_{RR}<0.7 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
88	MMBD1704	FAIR	dl-2	V_R<30 В; I_F=50 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; C_D<1 пФ; t_{RR}<0.7 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
89	MMBD1705	FAIR	dl-2	V_R<30 В; I_F=50 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; C_D<1 пФ; t_{RR}<0.7 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
91	DTA113TKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1 1 к	SOT346,SC59	B•E•C
95	DTA124TCA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
101	PZM10NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.45...9.87 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
102	PZM10NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.77...10.21 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
103	PZM10NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.11...10.55 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
111	PZM11NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.44...10.88 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
112	PZM11NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.76...11.22 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
113	PZM11NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.10...11.56 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
121	PZM12NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.42...11.90 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
122	PZM12NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.74...12.24 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
123	PZM12NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.08...12.60 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
131	PZM13NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.47...13.03 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
132	PZM13NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.91...13.49 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
133	PZM13NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=13.37...13.96 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
142	DTA123JUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
151	PZM15NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=13.84...14.46 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
152	PZM15NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=14.34...14.98 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
153	PZM15NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=14.85...15.52 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
161	PZM16NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.37...16.01 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
162	PZM16NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.85...16.51 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
163	PZM16NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.35...17.09 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
181	PZM18NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.94...17.70 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
182	PZM18NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=17.56...18.35 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
183	PZM18NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.21...19.03 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
201	PZM20NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.86...19.70 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
202	PZM20NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=19.52...20.39 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
203	PZM20NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.21...21.08 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
221	PZM22NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.88...21.77 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<25 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
222	PZM22NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=21.54...22.47 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<25 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
223	PZM22NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.23...23.17 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<25 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
241	PZM24NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.93...23.96 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<30 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
242	PZM24NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=23.72...24.78 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<30 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
243	PZM24NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=24.54...25.57 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<30 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
271	PZM2.7NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.5...2.75 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<100 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
272	PZM2.7NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.65...2.9 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<100 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
301	PZM3.0NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.8...3.05 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
302	PZM3.0NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.95...3.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
331	PZM3.3NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.1...3.35 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
332	PZM3.3NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.25...3.5 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
358	FDN358P	FAIR	DpMOS	V_{DS}=-30 В; I_D=1.5 А; P_D=500 мВт; $R_{DS(on)}$=0.125 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
361	PZM3.6NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.4...3.65 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
362	PZM3.6NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.55...3.8 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
391	PZM3.9NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.7...3.97 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
392	PZM3.9NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.87...4.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
431	PZM4.3NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.01...4.21 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
432	PZM4.3NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.15...4.34 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
433	PZM4.3NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.28...4.48 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
471	PZM4.7NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.42...4.61 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<80 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
472	PZM4.7NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.55...4.75 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<80 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
473	PZM4.7NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.69...4.90 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<80 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
500	SSTPAD500	SIL	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; V_F(I_F=1 мА)<1.5 В; I_R<500 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
511	PZM5.1NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.84...5.04 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<60 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
512	PZM5.1NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.98...5.20 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<60 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
513	PZM5.1NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.14...5.37 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<60 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
561	PZM5.6NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.31...5.55 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
562	PZM5.6NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.49...5.73 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
563	PZM5.6NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.67...5.92 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
605	NDS0605	FAIR	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=180 мА; P_D=360 мВт; $R_{DS(on)}$<15 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
610	NDS0610	FAIR	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=120 мА; P_D=360 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
621	PZM6.2NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.86...6.12 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
622	PZM6.2NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.06...6.33 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
623	PZM6.2NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.26...6.53 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
634	FMMT634	ZETEX	dnpn	V_{CBO}=120 В; I_C=900 мА; P_D=625 мВт; f_T>140 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
681	PZM6.8NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.47...6.73 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
682	PZM6.8NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.86...7.14 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
683	PZM6.8NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.65...6.93 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
701	2N7001	MOT	nFET	P_D=250 мВт; V_{BRDSS}>240 В; $R_{DS(on)}$=45 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
702	2N7002	ON	nFET	V_{DS}=60 В; I_D=115 мА; P_D=300 мВт; V_{GSTH}=1...2.5 В; C_{ISS}<50 пФ	SOT23,SOD23	G•S•D
703	2N7003	MOT	nFET	V_{DS}=500 В; I_D=10 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$<300 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
712	NDS7002A	NS	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=0.28 А	SOT23,SOD23	G•S•D
751	PZM7.5NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.06...7.36 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
752	PZM7.5NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.28...7.60 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
753	PZM7.5NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.52...7.84 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
821	PZM8.2NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.76...8.10 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
822	PZM8.2NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.02...8.36 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
823	PZM8.2NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.28...8.64 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
852	S852T	VISH	npn	V_{CBO}=12 В; I_C=8 мА; P_D=30 мВт; h_{21}=40...150; f_T=5.2 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
911	PZM9.1NB1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.56...8.93 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
912	PZM9.1NB2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.85...9.23 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
913	PZM9.1NB3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.15...9.55 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
01	PDTA143EE	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
01	PDTA143EK	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
010	SSTPAD10	SIL	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; V_F(I_F=1 мА)<1.5 В; I_R<10 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
011	SO2369R	STM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=40...120; f_T>400 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
02	DTC123TKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
02	PDTC143EE	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
02	PDTC143EK	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
020	SSTPAD20	SIL	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; V_F(I_F=1 мА)<1.5 В; I_R<20 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
028	SO3572R	SGS	npn	V_{CBO}=15 В; P_D=200 мВт; f_T>1 ГГц	SOT23,SOD23	E•B•C
02p	BST82	PHIL	nMOS	V_{DS}=80 В; I_D=175 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$=7 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
03	DTC143TE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
03	DTC143TKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
03	DTC143TUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
03	PDTA114EE	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
03	PDTA114EEF	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
-03	PDTA114EU	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
03W	SO2907AW	STM	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
04	DTC114TE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>100...600; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
04	DTC114TKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100...600; f_T>250 МГц; R_2=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
04	DTC114TUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100...600; f_T>250 МГц; R_2=10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
04	PDTC114EK	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
-04	PMSS3904	PHIL	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>180 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
04	DTC114TCA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>100...600; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
044	SO3571R	SGS	npn	V_{CBO}=15 В; P_D=200 мВт; f_T>1.2 ГГц	SOT23,SOD23	E•B•C
047	SO3570R	SGS	npn	V_{CBO}=15 В; P_D=200 мВт; f_T>1.5 ГГц	SOT23,SOD23	E•B•C
05	DTC124TE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
05	DTC124TKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
05	DTC124TUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
05	PDTA124EE	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
05	PDTA124EK	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
05	SSTPAD5	SIL	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<5 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
050	SSTPAD50	SIL	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<50 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
06	DTC144TE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
06	DTC144TKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
06	DTC144TUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
06	PDTC124EE	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
06	PDTC124EK	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
07	PDTA144EE	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
07	PDTA144EEF	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
07	PDTA144EK	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
08	PDTC144EE	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
08	PDTC144EEF	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
08	PDTC144EK	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
081	SO2369AR	SGS	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=40...120; f_T>500 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
09	DTC115TH	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
09	DTC115TKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=100 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
09	DTC115TUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
09	PDTC114EE	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
09	PDTC114EEF	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
0A	DTC125TKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=200 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
0A	DTC125TUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=200 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
10	MRF9411LT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
100	SSTPAD100	SIL	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<100 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
10A	MMBZ10VAL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=9.5...10.5 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
10A	PZM10NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=9.77...10.21 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
10V	PZM10NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=9.45...10.55 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
10X	02CZ10	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=9.40...10.60 В; $I_L(V_R$=8.0 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<120 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
11	MRF9511LT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=100 мА; P_D=322 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
11	PDTA114TE	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
111	DTA113ZUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
113	DTA143ZUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
11A	PZM11NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.76...11.22 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
11V	PZM11NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.44...11.56 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
11X	02CZ11	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.40...11.60 В; $I_L(V_R$=8.5 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<120 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
12	DTA123EE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
12	DTA123EKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
12	DTA123EUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
12	PDTC114YEF	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
121	DTC113ZUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
123	DTC143ZUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
12A	MMBD1502A	NS		V_R<180 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
12A	MMBZ10VAL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=11.4...12.6 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
12A	PZM12NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=11.74...12.24 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
12E	ZC2812E	ZETEX	shd×2	V_R<15 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
12V	PZM12NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=11.42...12.60 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
12X	02CZ12	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=11.40...12.60 В; $I_L(V_R$=9.0 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<110 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
13	BAS125	SIEM	shd	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<1.0 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
13	DTA143ECA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
13	DTA143EE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
13	DTA143EKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
13	DTA143EUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
13	MA4CS103A	M/A	shd	V_R=20 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<1 В; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
132	DTA123JE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
132	DTA123JUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
13A	PZM13NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=12.91...13.49 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
13E	ZC2813E	ZETEX	shd×2	V_R<15 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
13s	BAS125	INF	shd	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<0.015 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
13s	BAS125W	SIEM	shd	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<0.15 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
13V	PZM13NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=12.47...13.96 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
13X	02CZ13	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=12.40...14.10 В; $I_L(V_R$=10 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<110 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
14	BAS125-04	SIEM	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<1.0 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
14	BAS125-04W	SIEM	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<0.15 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
14	DTA114EE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
14	DTA114EKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
14	DTA114EUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
14	MMBD1504	NS	dl×2	V_R<180 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
142	DTC123JUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
14s	BAS125-04	INF	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<0.015 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
14s	BAS125-04W	INF	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<0.015 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
15	BAS125-05	SIEM	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<1.0 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
15	BAS125-05W	SIEM	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<0.15 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
15	DTA124EE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
15	DTA124EKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
15	DTA124EUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
15	MMBD1505	NS	dl×2	V_R<180 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
15	MMBT3960	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; P_D=300 мВт; h_{21}=30...300	SOT23,SOD23	B•E•C
156	DTA144VUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
15A	MMBZ15VAL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=14.25...15.75 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
15A	PZM15NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=14.34...14.98 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
15s	BAS125-05	INF	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<1.0 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
15s	BAS125-05W	INF	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<1.0 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K2,K1
15V	PZM15NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=13.84...15.52 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
15X	02CZ15	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=13.80...15.60 В; $I_L(V_R$=11 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<110 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
16	BAS125-06W	SIEM	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<0.15 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
16	DTA144EE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
16	DTA144EKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
16	DTA144EUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
166	DTC144VUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
16s	BAS125-06	SIEM	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<1.0 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
16s	BAS125-06W	INF	shd×2	V_R<25 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=35 мА)<0.9 В; I_R<1.0 мкА; C_D<1.1 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
16V	PZM16NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=15.37...17.09 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
16X	02CZ16	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=15.30...17.10 В; $I_L(V_R$=12 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<150 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
179	DTA115UU	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>27; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
179	FMMT5179	ZETEX	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=25...250; f_T>1100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
18	PDTC143ZK	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
181	BFQ181	SIEM	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=20 мА; P_D=200 мВт	SOT23,SOD23	B•E•C
182	BFQ182	SIEM	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=35 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>8 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
183	DTC115UU	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>27; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
18A	CMPZ5221B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.28...2.52 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<100 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18A	MMBZ18VAL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=17.1...18.9 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
18A	MMBZ5221BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.28...2.52 В; I_R<100 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18B	CMPZ5222B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.375...2.625 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<100 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18B	MMBZ5222BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.37...2.63 В; I_R<100 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18C	CMPZ5223B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.565...2.835 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<75 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18C	MMBZ5223BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.57...2.84 В; I_R<75 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18D	CMPZ5224B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.66...2.94 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<75 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18D	MMBZ5224BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.66...2.94 В; I_R<75 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18E	CMPZ5225B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.85...3.15 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<50 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<29 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18E	MMBZ5225B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.85...3.15 В; I_R<50 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18E	MMBZ5225BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.85...3.15 В; I_R<50 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18F	MMBZ5260B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=3 мА)=40.85...45.15 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
18V	PZM18NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=16.94...19.03 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
18X	02CZ18	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=16.80...19.10 В; $I_L(V_R$=14 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<150 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
19	DTA115EE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100; P_D=150 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
19	DTA115EKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=30; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
19	DTA115EUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=20 мАЫ; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
19	PDTA143ZK	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
1A	BC846A	CDIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1A	BC846A	TOSH	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1A	BC846A	DIODS	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1A	BC846A	VISH	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1A	BC846AF	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
1A	BC846ALT1	MOT	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1A	BC846AT	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1A	BC846AWT1	MOT	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1A	BC846AWT1	LRC	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1A	BC846AWT1	ON	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1A	FMMT3904	MOT	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1A	FMMT3904	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1A	IRLML2402	IR	nMOS	HEXFET; V_{DS}=20 В; I_D=0.9 А; P_D=540 мВт; $R_{DS(on)}$<0.35 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
1A	KST3904	SAMS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1A	MMBT3904	VISH	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1A	TMPT3904	ALLEG	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
-1A	PMST3904	PHIL	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300	SOT323,SC70	B•E•C
1A-	BC846AW	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1AG	2SC3339GR	TOSH	npn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1AL	2SC3339BL	TOSH	npn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=350...700; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1AM	MMBT3904LT1	MOT	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1AO	2SC3339O	TOSH	npn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...140; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Ap	BC846A	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1AQ	2SB779Q	PAN	pnp	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=90...155; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1AR	2SB779R	PAN	pnp	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=130...220; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1AR	BC846AR	PHIL	npn	V_{CBO}=65 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
1As	BC846A	INF	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1As	BC846AT	INF	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1As	BC846AW	INF	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1At	BC846A	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1At	BC846AW	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1AY	2SC3339Y	TOSH	npn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1B	BC846B	CDIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1B	BC846B	TOSH	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1B	BC846B	DIODS	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1B	BC846B	VISH	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1B	BC846B	ZETEX	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1B	BC846BF	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
1B	BC846BLT1	MOT	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1B	BC846BT	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1B	BC846BWT1	LRC	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1B	BC846BWT1	ON	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1B	IRLML2803	IR	nMOS	HEXFET; V_{DS}=30 В; I_D=0.9 А; P_D=540 мВт; $R_{DS(on)}$<0.4 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
1B	KST2222	SAMS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>75; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1B	TMPT2222	ALLEG	npn	V_{CBO}=60 В; I_{CBO}<10 нА; h_{21}=100...300; $V_{CE(sat)}$<0.4 В; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
-1B	PMST2222	PHIL	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1B-	BC846BW	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1BG	2SC3340GR	TOSH	npn	V_{CEO}=120 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1BL	2SC3340BL	TOSH	npn	V_{CEO}=120 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=350...700; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Bp	BC846B	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1BR	BC846BR	PHIL	npn	V_{CBO}=65 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=330; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
1Bs	BC846B	SIEM	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Bs	BC846BT	INF	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C

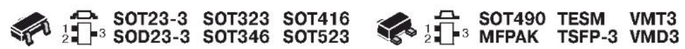
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1Bs	BC846BW	INF	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Bt	BC846B	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Bt	BC846BW	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1BZ	FMMT2222	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1C	FMMTA20	ZETEX	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1C	IRLML6302	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=20 В; I_D=0.62 А; P_D=540 мВт; $R_{DS(on)}$<0.9 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
1C	KST20	SAMS	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=40...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1C	MMBTA20LT1	MOT	npn	V_{CEO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=225 мВт; h_{21}=40...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1CL	2SC4082L	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=27...56; f_T=1500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1CM	2SC4082M	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T=1500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1CN	2SC4082N	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T=1500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1CO	2SC3341O	TOSH	npn	V_{CEO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=70...140.; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1CP	2SC4082P	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T=1500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Cp	BAP50-05	PHIL	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.1 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
1CQ	2SC4082Q	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T=1500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1CY	2SC3341Y	TOSH	npn	V_{CEO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...240.; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1D	BC846	CDIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1D	IRLML5103	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=30 В; I_D=0.61 А; P_D=540 мВт; $R_{DS(on)}$<1 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
1D	KST42	SAMS	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1D	MBTA42	TOSH	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T=50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1D	MMBTA42	VISH	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1D	MMBTA42LT1	ON	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=500 мА; P_D=225 мВт; h_{21}>25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1D	SMBTA20	VISH	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1D	TMPTA42	ALLEG	npn	V_{CBO}=300 В; I_{CBO}<100 нА; h_{21}>40; $V_{CE(sat)}$<0.5 В; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1D-	BC846W	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1D-	BC846W	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1DL	2SC4083L	ROHM	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=27...56; f_T=3200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1DM	2SC4083M	ROHM	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T=3200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1DN	2SC4083N	ROHM	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T=3200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1DP	2SC4083P	ROHM	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T=3200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Dp	BC846	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1DQ	2SC4083Q	ROHM	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T=3200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1DR	2SD1328R	PAN	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...350	SOT346,SC59	B•E•C
1DR	MSD1328R	MOT	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА	SOT346,SC59	B•E•C
1DS	2SD1328S	PAN	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=300...500	SOT346,SC59	B•E•C
1DT	2SD1328T	PAN	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=400...800	SOT346,SC59	B•E•C
1Dt	BC846	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Dt	BC846W	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Dt	BC846W	PHIL	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1E	BC847A	CDIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1E	BC847A	DIODS	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1E	BC847A	TOSH	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1E	BC847A	VISH	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1E	BC847AF	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
1E	BC847ALT1	MOT	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1E	BC847AT	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1E	BC847AT	DIODS	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT523	B•E•C
1E	BC847AWT1	LRC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1E	BC847AWT1	ON	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1E	FMMTA43	ZETEX	npn	V_{CBO}=200 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...200; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1E	IRLML6402	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=20 В; I_D=2.2 А; P_D=1.3 Вт; $R_{DS(on)}$<0.135 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
1E	KST43	SAMS	npn	V_{CBO}=200 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1E	TMPTA43	ALLEG	npn	V_{CBO}=200В; I_{CBO}<100нА; h_{21}>40; $V_{CE(sat)}$<0.5В; f_T>50МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1E-	BC847AW	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=110...220; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1EL	2SC4084L	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=27...56; f_T>200МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1EM	2SC4084M	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=39...82; f_T>200МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1EN	2SC4084N	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=56...120; f_T>200МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1EP	2SC4084P	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=82...180; f_T>200МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Ep	BC847A	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=110...220; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1EQ	2SC4084Q	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=120...270; f_T>200МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1ER	BC847AR	PHIL	npn	V_{CBO}=45В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=220; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
1Es	BC847A	INF	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=110...220; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Es	BC847A	INF	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=110...220; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Es	BC847AT	INF	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=110...220; f_T=250МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1Es	BC847AW	INF	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=110...220; f_T>=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Et	BC847A	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=110...220; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Et	BC847AW	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=110...220; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1F	BC847B	CDIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1F	BC847B	DIODS	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=200...450; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1F	BC847B	TOSH	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=200...450; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1F	BC847B	VISH	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1F	BC847B	ZETEX	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1F	BC847BF	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT490,SC89	B•E•C
1F	BC847BLT1	MOT	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1F	BC847BT	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1F	BC847BT	DIODS	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT523	B•E•C
1F	BC847BWT1	LRC	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1F	BC847BWT1	ON	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1F	BC847CT	DIODS	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT523	B•E•C
1F	IRLML6401	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=12В; I_D=3.4А; P_D=1.3Вт; $R_{DS(on)}$<0.125Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
1F	KST5550	SAMS	npn	V_{CBO}=160В; I_C=600мА; P_D=350мВт; h_{21}=60...250; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1F	MMBT5550	MOT	npn	V_{CBO}=160В; I_C=600мА; P_D=300мВт; h_{21}=60...250	SOT23,SOD23	B•E•C
1F-	BC847BW	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1FF	CMPT5551	CSI	npn	V_{CBO}=180В; I_C=600мА; P_D=350мВт; h_{21}=80...250; f_T=100...300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1FP	2SK321P	PAN	nFET	V_{GS}=15В; I_D=5мА; P_D=200мВт; g_F>15мСм; I_{DSS}=5...16мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1Fp	BC847B	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1FQ	2SK321Q	PAN	nFET	V_{GS}=15В; I_D=5мА; P_D=200мВт; g_F>15мСм; I_{DSS}=14...24мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1FR	2SK321R	PAN	nFET	V_{GS}=15В; I_D=5мА; P_D=200мВт; g_F>15мСм; I_{DSS}=20...32мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1FR	BC847BR	PHIL	npn	V_{CBO}=45В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=330; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
1FS	2SK321S	PAN	nFET	V_{GS}=15В; I_D=5мА; P_D=200мВт; g_F>15мСм; I_{DSS}=28...42мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1Fs	BC847B	INF	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=200...450; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Fs	BC847BT	INF	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T=250МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1Fs	BC847BW	INF	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Ft	BC847B	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Ft	BC847BW	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1FZ	FMBT5550	ZETEX	npn	V_{CBO}=140В	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	BC847C	CDIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	BC847C	VISH	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	BC847C	ZETEX	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	BC847C	DIODS	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=420...800; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	BC847CF	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT490,SC89	B•E•C
1G	BC847CLT1	MOT	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	BC847CT	PHIL	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1G	BC847CWT1	LRC	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C

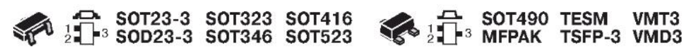
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1G	BC847CWT1	ON	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1G	FMMTA06	ZETEX	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	IRLML2502	IR	nMOS	HEXFET; V_{DS}=30 В; I_D=3.4 А; P_D=1.25 Вт; $R_{DS(on)}$<0.08 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
1G	KST06	SAMS	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	MMBTA06	VISH	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=300 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	MMBTA06	MOT	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=300 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G	TMPTA06	ALLEG	npn	V_{CBO}=80 В; I_{CBO}<100 нА; h_{21}>50; $V_{CE(sat)}$<0.25 В; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1G-	BC847CW	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1G-	BC847CW	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Gp	BC847C	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1GR	BC847CR	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=600; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
1Gs	BC847C	INF	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Gs	BC847CT	INF	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1Gs	BC847CW	INF	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Gt	BC847C	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Gt	BC847CW	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1GT	SOA06	STM	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1GZ	BC847C	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1H	2SK123	PAN	nFET	V_{DS}>20 В; I_D=2 мА; P_D=200 мВт; g_F>0.7 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
1H	BC847	CDIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1H	FMMTA05	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1H	IRLML5203	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=30 В; I_D=2.4 А; P_D=1.25 Вт; $R_{DS(on)}$<0.165 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
1H	KST05	SAMS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1H	MMBTA05	VISH	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=30 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1H	MMBTA05	MOT	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=30 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1H	TMPTA05	ALLEG	npn	V_{CBO}=60 В; I_{CBO}<100 нА; h_{21}>50; $V_{CE(sat)}$<0.25 В; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1H-	BC847W	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Hp	BC847	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Ht	BC847	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Ht	BC847W	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1HT	SOA05	SGS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=625 мВт; h_{21}>100; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1J	BC848A	CDIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1J	BC848A	TOSH	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1J	BC848A	DIODS	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1J	BC848A	VISH	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1J	BC848AF	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
1J	BC848ALT1	MOT	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1J	BC848AW	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1J	BC848AWT1	LRC	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1J	BC848AWT1	ON	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1J	FMMT2369	ZETEX	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120	SOT23,SOD23	B•E•C
1J	PMST2369	PHIL	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=40...120	SOT323,SC70	B•E•C
1JA	MMBT2369ALT1	MOT	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>40	SOT23,SOD23	B•E•C
1Jp	BC848A	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1JR	BC848AR	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
1Js	BC848A	INF	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Js	BC848AT	INF	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1Js	BC848AW	INF	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Jt	BC848A	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1JZ	BC848A	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	BC848B	CDIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	BC848B	TOSH	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1K	BC848B	DIODS	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=200...450; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	BC848B	VISH	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	BC848B	ZETEX	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	BC848B	ITT	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	BC848BF	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT490,SC89	B•E•C
1K	BC848BLT1	MOT	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	BC848BW	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1K	BC848BWT1	LRC	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1K	BC848BWT1	ON	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1K	FMMT4400	ZETEX	npn	V_{CB0}=60В; I_C=600мА; P_D=330мВт; h_{21}=50...150; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	KST6428	SAMS	npn	V_{CB0}=60В; I_C=200мА; P_D=350мВт; h_{21}=250...650; f_T=100...700МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	MMBT6428	MOT	npn	V_{CB0}=60В; I_C=200мА; P_D=300мВт; h_{21}=250...650; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1K	PMST6428	PHIL	npn	V_{CB0}=60В; I_C=200мА; P_D=200мВт; h_{21}=250...650; f_T=100...700МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1KP	2SK316P	PAN	nFET	V_{GS}=10В; I_D=5мА; P_D=200мВт; g_F>15мСм; I_{DSS}=5...16мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1Kp	BC848B	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1KQ	2SK316Q	PAN	nFET	V_{GS}=10В; I_D=5мА; P_D=200мВт; g_F>15мСм; I_{DSS}=14...24мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1KR	BC848BR	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=330; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
1Ks	BC848B	INF	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=200...450; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Ks	BC848BT	INF	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T=250МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1Ks	BC848BW	INF	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Kt	BC848B	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1KZ	FMMT4400	ZETEX	npn	V_{CB0}=60В; I_C=600мА; P_D=330мВт; h_{21}=50...150; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	BC848C	ITT	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	BC848C	CDIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	BC848C	DIODS	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=420...800; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	BC848C	TOSH	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=420...800; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	BC848C	VISH	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	BC848CF	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT490,SC89	B•E•C
1L	BC848CLT1	MOT	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	BC848CW	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1L	BC848CWT1	LRC	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1L	BC848CWT1	ON	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1L	FMMT4401	ZETEX	npn	V_{CB0}=60В; I_C=600мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...300; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	MMBT6429	MOT	npn	V_{CB0}=55В; I_C=200мА; P_D=300мВт; h_{21}=500...1250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1L	PMST6429	PHIL	npn	V_{CB0}=55В; I_C=200мА; P_D=200мВт; h_{21}=500...1250; f_T=100...700МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1LM	2SC4103M	ROHM	npn	V_{CB0}=30В; I_C=30мА; P_D=200мВт; h_{21}=39...82; f_T>110МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1LN	2SC4103N	ROHM	npn	V_{CB0}=30В; I_C=30мА; P_D=200мВт; h_{21}=56...120; f_T>110МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1LP	2SC4103P	ROHM	npn	V_{CB0}=30В; I_C=30мА; P_D=200мВт; h_{21}=82...180; f_T>110МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1LP	2SK247P	PAN	nFET	V_{GS}=15В; I_D=20мА; P_D=150мВт; g_F>3мСм; I_{DSS}=0.5...1.5мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1Lp	BC848C	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1LQ	2SC4103Q	ROHM	npn	V_{CB0}=30В; I_C=30мА; P_D=200мВт; h_{21}=120...270; f_T>110МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1LQ	2SK247Q	PAN	nFET	V_{GS}=15В; I_D=20мА; P_D=150мВт; g_F>3мСм; I_{DSS}=1...3мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1LR	2SK247R	PAN	nFET	V_{GS}=15В; I_D=20мА; P_D=150мВт; g_F>3мСм; I_{DSS}=2...6мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1LR	BC848CR	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=600; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
1LS	2SK247S	PAN	nFET	V_{GS}=15В; I_D=20мА; P_D=150мВт; g_F>3мСм; I_{DSS}=4...12мА	SOT23,SOD23	S•D•G
1Ls	BC848C	INF	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=420...800; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Ls	BC848CT	INF	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=420...800; f_T=250МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1Ls	BC848CW	INF	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Lt	BC848C	PHIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1M	BC848	CDIL	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=110...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1M	BC848C	DIODS	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=420...800; f_T=300МГц	SOT523	B•E•C
1M	FMMTA13	ZETEX	npn	V_{CB0}=40В; I_C=300мА; P_D=330мВт; h_{21}>10000	SOT23,SOD23	B•E•C

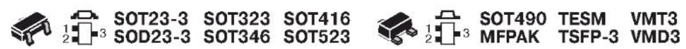
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1M	KST13	SAMS	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=300 мА; P_D=350 мВт; $h_{21}>5000$; $f_T>125$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1M	MMBTA13	VISH	dnpn	V_{CBO}=30 В; I_C=300 мА; P_D=350 мВт; $h_{21}<10000$; $f_T<125$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1M	MMBTA13LT1	MOT	dnpn	V_{CBO}=30 В; I_C=300 мА; P_D=300 мВт; $h_{21}>5000$; $f_T>125$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1M-	BC848W	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...800; $f_T>100$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1MN	2SC4128N	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; $f_T>230$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1MP	2SC4128P	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; $f_T>230$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1MP	2SJ84P	PAN	pFET	V_{DS}=15 В; I_D=10 мА; P_D=200 мВт; g_F=9 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
1Mp	BC848	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...800; $f_T>100$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1MQ	2SJ84Q	PAN	pFET	V_{DS}=15 В; I_D=10 мА; P_D=200 мВт; g_F=9 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
1MR	2SJ84R	PAN	pFET	V_{DS}=15 В; I_D=10 мА; P_D=200 мВт; g_F=9 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
1Mt	BC848W	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...800; $f_T>100$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1N	FMMTA14	ZETEX	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=300 мА; P_D=330 мВт; $h_{21}>20000$	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	KST14	SAMS	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=300 мА; P_D=350 мВт; $h_{21}>10000$; $f_T>125$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	MMBT3904	VISH	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	MMBTA14	VISH	dnpn	V_{CBO}=30 В; I_C=300 мА; P_D=350 мВт; $h_{21}<20000$; $f_T<125$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	MMBTA14LT1	MOT	dnpn	V_{CBO}=30 В; I_C=300 мА; P_D=300 мВт; $h_{21}>10000$; $f_T>125$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	TMPTA14	ALLEG	npn	V_{CBO}=30 В; $I_{CBO}<100$ нА; $h_{21}>20$ к; $V_{CE(sat)}<1.5$ В; $f_T>125$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1N5	ZTX11N15DF	ZETEX	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=3 А	SOT23,SOD23	B•E•C
1OP	2SK662P	PAN	nFET	V_{DS}=30 В; I_D=20 мА; P_D=150 мВт; $g_F>4$ мСм; I_{DSS}=0.5...3 мА	SOT323,SC70	S•D•G
1OQ	2SK662Q	PAN	nFET	V_{DS}=30 В; I_D=20 мА; P_D=150 мВт; $g_F>4$ мСм; I_{DSS}=2...6 мА	SOT323,SC70	S•D•G
1OR	2SK662R	PAN	nFET	V_{DS}=30 В; I_D=20 мА; P_D=150 мВт; $g_F>4$ мСм; I_{DSS}=4...12 мА	SOT323,SC70	S•D•G
1P	FMMT2222A	ZETEX	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...360; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	KST2222A	SAMS	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; $h_{21}>75$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	MBT2222A	TOSH	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; $h_{21}>40$; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	MMBT2222A	VISH	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; $f_T>200$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	MMBT2222ALT1	MOT	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=600 мА; P_D=300 мВт; $h_{21}>35$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	MMBT2222LT1	ON	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=225 мВт; $h_{21}>30$	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	TMPT2222A	ALLEG	npn	V_{CBO}=75 В; $I_{CBO}<10$ нА; h_{21}=100...300; $V_{CE(sat)}<0.3$ В; $f_T>250$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
-1P	PMST2222A	PHIL	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; $f_T>300$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Q	FMMT5088	ZETEX	npn	V_{CBO}=35 В; I_C=50 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=300...900; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Q	KST5088	SAMS	npn	V_{CBO}=35 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=300...900; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Q	MMBT5088	VISH	npn	V_{CBO}=35 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=300...900; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Q	MMBT5088	MOT	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=350...1400; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Q	TMPT5088	ALLEG	npn	V_{CBO}=35 В; $I_{CBO}<50$ нА; h_{21}=300...900; $V_{CE(sat)}<0.5$ В	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	FMMT5089	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=400...1200; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	KST5089	SAMS	npn	V_{CBO}=35 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=400...1200; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	MMBT5089	VISH	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=400...1200; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	MMBT5089	MOT	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=450...1800; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	TMPT5089	ALLEG	npn	V_{CBO}=30 В; $I_{CBO}<50$ нА; h_{21}=400...1200; $V_{CE(sat)}<0.5$ В	SOT23,SOD23	B•E•C
1S	MMBT2369A	FAIR	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=225 мВт; $h_{21}>40$	SOT23,SOD23	B•E•C
1S	MSC3130	MOT	npn	V_{CBO}=10 В; f_T=1.4 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
1SP	2SC3130P	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=75...130; f_T=1.9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1SP	2SC3935P	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=75...130; f_T=1.9 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
1SP	2SC4809P	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=125 мВт; h_{21}=75...130; f_T=1.4...2.7 ГГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1SQ	2SC3130Q	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T=1.9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1SQ	2SC3935Q	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T=1.9 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
1SQ	2SC4809Q	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=125 мВт; h_{21}=110...220; f_T=1.4...2.7 ГГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1SR	2SC4809R	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=125 мВт; h_{21}=200...400; f_T=1.4...2.7 ГГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1T	2SC3933T	PAN	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...200; $f_T>750$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1T1	MMST5101	ROHM	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; h_{21}=200...400; $f_T>125$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1T1	SST5101	ROHM	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; h_{21}=200...400; $f_T>125$ МГц	SOT346,SC59	B•E•C
1U	2SC3110	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; $h_{21}>40$; f_T=4.5 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1U	2SC3934	PAN	npn	V_{CB0}=15В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}>40; f_T=4.5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
1U	KST2484	SAMS	npn	V_{CB0}=60В; I_C=50мА; P_D=350мВт; h_{21}>250	SOT23,SOD23	B•E•C
1U	MMBT2484LT1	MOT	npn	V_{CB0}=60В; I_C=200мА; P_D=225мВт; h_{21}>250	SOT23,SOD23	B•E•C
1V	BF820	CDIL	npn	V_{CB0}=300В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1V	MMBT6427	MOT	dnpn	V_{CB0}=40В; I_C=500мА; P_D=225мВт; h_{21}>10000	SOT23,SOD23	E•B•C
1V	TMPT6427	ALLEG	npn	V_{CB0}=40В; I_{CB0}<50нА; h_{21}=10000...100000; $V_{CE(sat)}$<1.2В; f_T>130МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1V-	BF820W	PHIL	npn	V_{CB0}=300В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Vp	BF820	PHIL	npn	V_{CB0}=300В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1VR	2SD1149R	PAN	npn	V_{CB0}=100В; I_C=20мА; P_D=200мВт; h_{21}=400...800	SOT346,SC59	B•E•C
1VR	2SD1824R	PAN	npn	V_{CB0}=100В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=400...800; f_T=90МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1VS	2SD1149S	PAN	npn	V_{CB0}=100В; I_C=20мА; P_D=200мВт; h_{21}=600...1200	SOT346,SC59	B•E•C
1VS	2SD1824S	PAN	npn	V_{CB0}=100В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=600...1200; f_T=90МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1VT	2SD1149T	PAN	npn	V_{CB0}=100В; I_C=20мА; P_D=200мВт; h_{21}=800...2000	SOT346,SC59	B•E•C
1VT	2SD1824T	PAN	npn	V_{CB0}=100В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=1000...2000; f_T=90МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Vt	BF820	PHIL	npn	V_{CB0}=300В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Vt	BF820W	PHIL	npn	V_{CB0}=300В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1W	BF821	CDIL	pnp	V_{CB0}=300В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1W	FMMT3903	ZETEX	npn	V_{CB0}=60В; I_C=200мА; P_D=330мВт; h_{21}=50...150; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1W-	BF822W	PHIL	npn	V_{CB0}=250В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1Wp	BF821	PHIL	pnp	V_{CB0}=300В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Wt	BF821	PHIL	pnp	V_{CB0}=300В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Wt	BF822W	PHIL	npn	V_{CB0}=250В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1X	BF822	CDIL	npn	V_{CB0}=250В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1X	MMBT930L	MOT	npn	V_{CB0}=45В; I_C=30мА; P_D=225мВт; h_{21}=100...300; f_T>30МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Xp	BF822	PHIL	npn	V_{CB0}=250В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Xt	BF822	PHIL	npn	V_{CB0}=250В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Y	BF823	CDIL	pnp	V_{CB0}=250В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Y	KST3903	SAMS	pnp	V_{CB0}=60В; I_C=200мА; P_D=350мВт; h_{21}=50...150; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Y	MMBT3903	MOT	npn	V_{CB0}=60В; I_C=200мА; P_D=350мВт; h_{21}>15	SOT23,SOD23	B•E•C
1Yp	BF823	PHIL	pnp	V_{CB0}=250В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Yt	BF823	PHIL	pnp	V_{CB0}=250В; I_C=50мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>60МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1Z	BAS7006	ZETEX	shd×2	V_R<70В; V_F(I_F=1мА)<0.41В; I_R<0.2мкА; C_D<2.0пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
1Z	BAS70-06	ZETEX	shd×2	V_R<70В; I_F<70мА; V_F(I_F=1мА)<410мВ; C_D<2пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
1Z	MMBT6517	MOT	npn	V_{CB0}=350В; I_C=500мА; P_D=300мВт; h_{21}=20...200; f_T>40МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
1ZR	2SD1030R	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=400...800	SOT346,SC59	B•E•C
1ZR	2SD1823R	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=400...800; f_T=120МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1ZR	2SD2345R	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=125мВт; h_{21}=400...800; f_T=120МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1ZS	2SD1030S	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=600...1200	SOT346,SC59	B•E•C
1ZS	2SD1823S	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=600...1200; f_T=120МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1ZS	2SD2345S	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=125мВт; h_{21}=600...1200; f_T=120МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
1ZT	2SD1030T	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=1000...2000	SOT346,SC59	B•E•C
1ZT	2SD1823T	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=1000...2000; f_T=120МГц	SOT323,SC70	B•E•C
1ZT	2SD2345T	PAN	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=125мВт; h_{21}=1000...2000; f_T=120МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
2.0X	02CZ2.0	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=1.85...2.15В; I_L(V_R=0.5В)<120мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5мА)<1000Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
2.2X	02CZ2.2	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=2.05...2.38В; I_L(V_R=1.0В)<120мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5мА)<1000Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
2.4X	02CZ2.4	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=2.28...2.60В; I_L(V_R=1.0В)<120мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5мА)<1000Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
2.7X	02CZ2.7	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=2.50...2.90В; I_L(V_R=1.0В)<120мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5мА)<1000Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
200	SSTPAD200	SIL	dl	V_R=55В; I_F<10мА; V_F(I_F=1мА)<1.5В; I_R<200пА; C_T<2пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
20A	MMBZ20VAL	ON	dz×2	V_Z(I_{ZT}=1мА)=19...21В; V_F(I_F=10мА)<0.9В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2

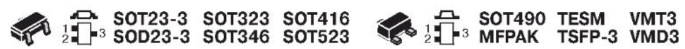
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
20p	BF545A	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=6.5 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
20t	BF545A	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=6.5 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
20V	PZM20NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=18.86...21.08 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
20W	BF545A	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=6.5 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
20W	SO2222AW	SGS	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
20X	02CZ20	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=18.80...21.20 В; $I_L(V_R$=15 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<200 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
210	KTY82-210	PHIL	rts	T_{AMB}=-55...150 °C; R_{25}=1980...2020 Ом	SOT23,SOD23	CONT1• CONT2•SUB
21p	BF545B	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=15 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
21t	BF545B	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=15 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
21W	BF545B	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=15 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
22	DTC123EE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
22	DTC123EKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
22	DTC123EUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
22	MMBT4209	MOT	pnp	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>35; f_T=850 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
220	KTY82-220	PHIL	rts	T_{AMB}=-55...150 °C; R_{25}=1960...2040 Ом	SOT23,SOD23	CONT1• CONT2•SUB
221	KTY82-221	PHIL	rts	T_{AMB}=-55...150 °C; R_{25}=1960...2000 Ом	SOT23,SOD23	CONT1• CONT2•SUB
222	KTY82-222	PHIL	rts	T_{AMB}=-55...150 °C; R_{25}=2000...2040 Ом	SOT23,SOD23	CONT1• CONT2•SUB
22p	BF545C	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=25 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
22t	BF545C	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=25 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
22V	PZM22NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=20.88...23.17 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<25 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
22W	BF545C	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=25 мА; P_D=250 мВт; g_F=3...6.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
22X	02CZ22	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=20.80...23.30 В; $I_L(V_R$=17 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<200 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
23	DTC143EE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
23	DTC143EKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
23	DTC143EUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
23	PDTA114TK	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
24	DTC114EE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
24	DTC114EKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
24	DTC114EUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
24	MMBT3646	ON	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=300 мА; P_D=625 мВт; h_{21}>15	SOT23,SOD23	B•E•C
24	PDTC114TE	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
24	PDTC114TK	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
24p	BF556A	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=7 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
24t	BF556A	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=7 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
24V	PZM24NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=22.93...25.57 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<30 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
24W	BF556A	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=7 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
24X	02CZ24	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=22.80...25.60 В; $I_L(V_R$=19 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<200 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
25	DTC124EE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
25	DTC124EKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
25	DTC124EUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
25	MMBD1202	ON	di	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<3 нс	SOT23,SOD23	n.c.•A•K





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
25	PDTA143XK	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT346,SC59	B·E·C
250	KTY82-250	PHIL	rts	T_{AMB}=-55...150°C; R_{25}=1900...2100 Ом	SOT23,SOD23	CONT1·CONT2·SUB
251	KTY82-251	PHIL	rts	T_{AMB}=-55...150°C; R_{25}=1900...2000 Ом	SOT23,SOD23	CONT1·CONT2·SUB
252	KTY82-252	PHIL	rts	T_{AMB}=-55...150°C; R_{25}=2000...2100 Ом	SOT23,SOD23	CONT1·CONT2·SUB
25p	BF556B	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=13 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
25t	BF556B	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=13 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
25W	BF556B	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=13 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
26	DTC144EE	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT416,SC75A	B·E·C
26	DTC144EKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT346,SC59	B·E·C
26	DTC144EUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT323,SC70	B·E·C
26	MMBD1203	FAIR	di×2	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<3 нс	SOT23,SOD23	A1·K2·K1,A2
26	PDTC143XK	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT346,SC59	B·E·C
26p	BF556C	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=18 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
26t	BF556C	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=18 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
26W	BF556C	PHIL	nFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}=18 мА; P_D=250 мВт; g_F>4.5 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
27	MMBD1204	FAIR	di×2	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<3 нс	SOT23,SOD23	A1·A2·K1,K2
27A	MMBZ20VAL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=25.65...28.35 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1·K2·A1,A2
27V	PZM27NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=25.1...28.9 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<40 Ом	SOT346,SC59	A·n.c.·K
27X	02CZ27	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=25.10...28.90 В; $I_L(V_R$=21 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<250 Ом	SOT346,SC59	A·n.c.·K
28	MMBD1205	FAIR	di×2	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<3 нс	SOT23,SOD23	K1·K2·A1,A2
28p	BF861A	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=6.5 мА; P_D=250 мВт; g_F>12 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
28t	BF861A	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=6.5 мА; P_D=250 мВт; g_F>12 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
28W	BF861A	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=6.5 мА; P_D=250 мВт; g_F>12 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
29	DTC115EE	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT416,SC75A	B·E·C
29	DTC115EKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=20 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT346,SC59	B·E·C
29	DTC115EUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT323,SC70	B·E·C
29	MMBD1401	FAIR	d	V_R<175 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A·n.c.·K
29p	BF861B	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=15 мА; P_D=250 мВт; g_F>16 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
29t	BF861B	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=15 мА; P_D=250 мВт; g_F>16 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
29W	BF861B	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=15 мА; P_D=250 мВт; g_F>16 мС	SOT23,SOD23	S·D·G
2A	FMMT3906	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2A	KST3906	SAMS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2A	MMBT3906	VISH	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2A	MMBT3906LT1	MOT	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2A	MMBT3906WT1	MOT	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
2A	TMPT3906	ALLEG	pnp	V_{CB0}=40 В; h_{21}=100...300; $V_{CE(sat)}$<0.25 В; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2A4	PZM2.4NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=2.3...2.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<100 Ом	SOT346,SC59	K1·K2·A1,A2
2A7	PZM2.7NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=2.65...2.9 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<100 Ом	SOT346,SC59	K1·K2·A1,A2
2AQ	2SD1304Q	PAN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=160...260	SOT23,SOD23	B·E·C
2AR	2SD1304R	PAN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=210...340	SOT23,SOD23	B·E·C
2AS	2SD1304S	PAN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=290...460	SOT23,SOD23	B·E·C
2B	BC849B	ITT	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2B	BC849B	CDIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2B	BC849B	TOSH	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2B	BC849B	ZETEX	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
2B	FMMT2907	ZETEX	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
2B	KST2907	SAMS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>75; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2B	MMBT2907	VISH	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2B	MMBT2907	MOT	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2B	TMPT2907	ALLEG	pnp	V_{CB0}=60 В; $I_{CB0}<20$ нА; h_{21}=100...300; $V_{CE(sat)}<0.4$ В; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2B-	BC849BW	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2BP	2SK374P	PAN	nFET	V_{GS}=55 В; I_D=10 мА; P_D=200 мВт; g_F>2.5 мСм; I_{DSS}=1...3 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
2BP	2SK663P	PAN	nFET	V_{DS}=55 В; I_D=30 мА; P_D=150 мВт; g_F>2.5 мСм; I_{DSS}=1...3 мА	SOT323,SC70	S•D•G
2Bp	BC849B	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2BQ	2SK374Q	PAN	nFET	V_{GS}=55 В; I_D=10 мА; P_D=200 мВт; g_F>2.5 мСм; I_{DSS}=2...6.5 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
2BQ	2SK663Q	PAN	nFET	V_{DS}=55 В; I_D=30 мА; P_D=150 мВт; g_F>2.5 мСм; I_{DSS}=2...6.5 мА	SOT323,SC70	S•D•G
2BR	2SK374R	PAN	nFET	V_{GS}=55 В; I_D=10 мА; P_D=200 мВт; g_F>2.5 мСм; I_{DSS}=5...12 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
2BR	2SK663R	PAN	nFET	V_{DS}=55 В; I_D=30 мА; P_D=150 мВт; g_F>2.5 мСм; I_{DSS}=5...12 мА	SOT323,SC70	S•D•G
2BR	BC849BR	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=330; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
2BS	2SK374S	PAN	nFET	V_{GS}=55 В; I_D=10 мА; P_D=200 мВт; g_F>2.5 мСм; I_{DSS}=10...20 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
2Bs	BC849B	INF	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Bs	BC849BT	INF	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
2Bs	BC849BW	INF	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2Bt	BC849B	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Bt	BC849BW	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2BZ	FMMT2907	ZETEX	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	ITT	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	CDIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	TOSH	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	ZETEX	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	ITT	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	TMPTA70	ALLEG	pnp	$I_{CB0}<100$ нА; h_{21}=40...100; $V_{CE(sat)}<0.25$ В; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2C-	BC849CW	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2Cp	BC849C	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2CR	BC849CR	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=600; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
2Cs	BC849C	INF	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Cs	BC849CT	INF	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
2Cs	BC849CW	INF	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2Ct	BC849C	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Ct	BC849CW	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2CZ	FMMTA70	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	BC849	CDIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	BC849W	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2D	KST92	SAMS	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	MBTA92	TOSH	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T=50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	MMBT4125	MOT	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=50...150	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	MMBTA92	VISH	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	MMBTA92	MOT	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Dp	BC849	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Dt	BC849	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2E	FMMTA93	ZETEX	pnp	V_{CB0}=200 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=30...150; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2E	KST93	SAMS	pnp	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2E	MMBTA93	MOT	pnp	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	BC850B	ITT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	BC850B	CDIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	FMMT2907A	ZETEX	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	KST2907A	SAMS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	MBT2907A	TOSH	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
2F	MMBT2907A	VISH	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=75...300; f_T<200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	MMBT2907ALT1	MOT	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	MMBT2907AWT1	MOT	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2F	TMPT2907A	ALLEG	pnp	V_{CB0}=60 В; I_{CB0}<10 нА; h_{21}=100...300; $V_{CE(sat)}$<0.4 В; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2F-	BC850BW	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2Fp	BC850B	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2FR	2SB792AR	PAN	pnp	V_{CB0}=185 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=130...220; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2FR	BC850BR	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=330; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
2FS	2SB792AS	PAN	pnp	V_{CB0}=185 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=185...330; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Fs	BC850B	INF	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Fs	BC850BT	INF	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
2Fs	BC850BW	INF	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2Ft	BC850B	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Ft	BC850BW	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2FZ	BC850B	ZETEX	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G	BC850C	ITT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G	BC850C	CDIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G	BC850C	ITT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G	FMMTA56	ZETEX	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G	KST56	SAMS	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G	MMBTA56	VISH	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T<50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G	MMBTA56	MOT	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T<100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G	TMPTA56	ALLEG	pnp	V_{CB0}=80 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}>50; $V_{CE(sat)}$<0.25 В; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2G-	BC850CW	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2Gp	BC850C	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2GR	BC850CR	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=600; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
2Gs	BC850C	INF	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Gs	BC850CT	INF	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
2Gt	BC850C	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Gt	BC850CW	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2GT	SOA56	STM	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2H	BC850	CDIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2H	BC850W	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2H	FMMTA55	ZETEX	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2H	KST55	SAMS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2H	MMBTA55	VISH	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=225 мВт; h_{21}=50; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2H	MMBTA55	MOT	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=225 мВт; h_{21}=50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2H	TMPTA55	ALLEG	pnp	V_{CB0}=60 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}>50; $V_{CE(sat)}$<0.25 В; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Hp	BC850	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2HT	SOA55	STM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=625 мВт; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2J	MMBT3640LT1	MOT	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=80 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=30...120; f_T>500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2K	FMMT4402	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...150; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2K	MMBT8598LT1	MOT	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=225 мВт; h_{21}>50; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2L	FMMT4403	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2L	KST5401	SAMS	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=60...240; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2L	MMBT5401	VISH	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=60...240; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2L	MMBT5401	MOT	pnp	V_{CB0}=150 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=40...200; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2L	TMPT5401	ALLEG	pnp	V_{CB0}=160 В; I_{CB0}<50 нА; h_{21}=60...240; $V_{CE(sat)}$<0.2 В; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2m	FMMT5087	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...800; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2N	MMBT404ALT1	MOT	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=150 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...400	SOT23,SOD23	B•E•C
2N0	ZXT11N20DF	ZETEX	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=2.5 А; P_D=625 мВт; h_{21}=300...900; f_T=160 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2NQ	2SD1478Q	PAN	dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=4000...10000	SOT346,SC59	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
2NR	2SD1478R	PAN	dnpn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=8000...20000	SOT346,SC59	B•E•C
2OQ	2SD1478AQ	PAN	dnpn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=4000...10000	SOT346,SC59	B•E•C
2OR	2SD1478AR	PAN	dnpn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=8000...20000	SOT346,SC59	B•E•C
2P	FMMT2222R	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...360; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2P	KST5086	SAMS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=150...500; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2P	MMBT5086	MOT	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=225 мВт; h_{21}=150...600; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2P	TMPT5086	ALLEG	pnp	V_{CBO}=50 В; I_{CBO}<50 нА; h_{21}=150...500; $V_{CE(sat)}$<0.3 В; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Q	FMMT5209	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>30 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Q	KST5087	SAMS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=250...800; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Q	MMBT5087	MOT	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=225 мВт; h_{21}=250...900; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Q	TMPT5087	ALLEG	pnp	V_{CBO}=50 В; I_{CBO}<50 нА; h_{21}=250...800; $V_{CE(sat)}$<0.3 В; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2R	FMMT5210	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...600; f_T>30 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2R	HSMS-8102	HP	shd×2	V_{BR}>4 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.35 В; C_D<0.26 пФ; R_D=14 Ом	SOT23,SOD23	K1•A2•A1,K2
2T	HT2	ZETEX	npn	V_{CBO}=90 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>25	SOT23,SOD23	B•E•C
2T	KST4403	SAMS	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2T	MMBT4403	VISH	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2T	MMBT4403LT1	MOT	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=600 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2T	SO4403	STM	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2T	TMPT4403	ALLEG	pnp	V_{CBO}=40 В; h_{21}=100...300; $V_{CE(sat)}$<0.4 В; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2U	KST63	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2U	MMBTA63LT1	MOT	dpnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2V	KST64	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2V	MMBTA64LT1	MOT	dpnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2V4	PZM2.4NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=2.3...2.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<100 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
2V7	PZM2.7NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=2.5...2.9 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<100 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
2W	2SC3704	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=80 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=50...300; f_T=6 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2W	2SC3937	PAN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=80 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...300; f_T=6 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
2W	FMMT3905	ZETEX	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...150; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2W	MMBT8599LT1	MOT	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2W	TMPT4402	ALLEG	pnp	V_{CBO}=40 В; h_{21}=50...150; $V_{CE(sat)}$<0.4 В; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2X	2SC3707	PAN	npn	V_{CBO}=10 В; I_C=10 мА; P_D=50 мВт; h_{21}=50...150; f_T=4 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2X	KST4401	SAMS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2X	MMBT4401	VISH	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2X	MMBT4401LT1	MOT	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2X	SO4401	STM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2X	TMPT4401	ALLEG	npn	V_{CBO}=60 В; I_{CBO}<100 нА; h_{21}=100...300; $V_{CE(sat)}$<0.4 В; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2YQ	2SC3757Q	PAN	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=60...120; f_T=450 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2YQ	2SC3938Q	PAN	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=300 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T=450 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2YQ	2SC4691Q	PAN	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=125 мВт; h_{21}=60...120; f_T=450 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
2YR	2SC3757R	PAN	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=90...200; f_T=450 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2YR	2SC3938R	PAN	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=300 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...200; f_T=450 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
2YR	2SC4691R	PAN	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=125 мВт; h_{21}=90...200; f_T=450 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
2Z	BAS7004	ZETEX	shd×2	V_R<70 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.2 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
2Z	MMBT6520	MOT	pnp	V_{CBO}=350 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=20...200; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
2Z5	BAS7005	ZETEX	shd×2	V_R<70 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.2 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
2Z5	BAS70-05	ZETEX	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
3.0X	02CZ3.0	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=2.80...3.20 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<50 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<1000 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
3.3X	02CZ3.3	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=3.10...3.50 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<20 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<1000 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
3.6X	02CZ3.6	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=3.40...3.80 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<10 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<1000 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
3.9X	02CZ3.9	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=3.70...4.10 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<10 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<1000 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
301	FDV301N	FAIR	DnMOS	V_{DS}=25 В; I_D=220 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$=5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
302	FDV302P	FAIR	DpMOS	V_{DS}=-25 В; I_D=120 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$=13 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
303	FDV303N	FAIR	DnMOS	V_{DS}=25 В; I_D=680 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$=0.45 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
304	FDV304P	FAIR	DpMOS	V_{DS}=-25 В; I_D=460 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$=1.1 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
305	AT30533	HP	npn	V_{CB0}=11 В; I_C=8 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=70...300; f_T=10 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
30p	BF861C	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=25 мА; P_D=250 мВт; g_F>20 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
30t	BF861C	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=25 мА; P_D=250 мВт; g_F>20 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
30V	PZM30NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=28.0...32.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<40 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
30W	BF861C	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=25 мА; P_D=250 мВт; g_F>20 мС	SOT23,SOD23	S•D•G
30X	02CZ30	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=28.00...32.00 В; $I_L(V_R$=23 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<250 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
31	MMBD1402	ON	d	V_R<175 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
310	AT31033	HP	npn	V_{CB0}=11 В; I_C=16 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...300; f_T=10 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
31p	BFR505	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=18 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
31t	BFR505	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=18 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
31W	BFR505	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=18 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
32	MMBD1403	FAIR	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
32	MMBD1403	ON	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
320	AT32033	HP	npn	V_{CB0}=11 В; I_C=32 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=70...300; f_T=10 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
32p	BFR520	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=70 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=60...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
32t	BFR520	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=70 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=60...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
32W	BFR520	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=70 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=60...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
33	DTA143XE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
33	DTA143XKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
33	DTA143XUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
33	MMBD1404	FAIR	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
33	MMBD1404	ON	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
33	PDTC114YE	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
331	NDS331N	FAIR	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=1.3 А; P_D=500 мВт; $R_{DS(on)}$<0.4 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
332	NDS332P	FAIR	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=1 А; P_D=500 мВт; $R_{DS(on)}$<0.74 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
335	NDS335N	FAIR	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=1.7 А; P_D=500 мВт; $R_{DS(on)}$<0.25 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
336	NDS336P	FAIR	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=1.2 А; P_D=500 мВт; $R_{DS(on)}$<0.49 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
337	NDS337N	FAIR	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=2.5 А; P_D=500 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
338	NDS338P	FAIR	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=1.6 А; P_D=500 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
33A	MMBZ33VAL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=31.35...34.65 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
33p	BFR540	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=120 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
33t	BFR540	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=120 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
33V	PZM33NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=31.0...35.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<40 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
33W	BFR540	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=120 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
33X	02CZ33	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=31.00...35.00 В; $I_L(V_R$=25 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<250 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
34	MMBD1405	FAIR	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
34	MMBD1405	ON	d×2	V_R<175 В; I_F<600 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
34	PDTC143XE	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
340	FDV340P	FAIR	DpMOS	V_{DS}=-20 В; I_D=70 мА	SOT23,SOD23	G•S•D
35	DTA124XE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
35	DTA124XKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
35	DTA124XUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
35	PDTA143XE	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
351	NDS351N	FAIR	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=1.1 А; P_D=500 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
352	NDS352P	FAIR	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=0.5 А; P_D=500 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
355	NDS355N	FAIR	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=1.6 А; P_D=500 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
356	NDS356P	FAIR	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=1.1 А; P_D=500 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
357	NDS357N	FAIR	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=2.5 А; P_D=500 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
358	NDS358P	FAIR	pMOS	V_{DS}=30 В; I_D=1.6 А; P_D=500 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
36	PDTA114YE	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
36	PDTC124EEF	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
360	FDN360P	FAIR	DpMOS	V_{DS}=-30 В; I_D=2 А; P_D=500 мВт; $R_{DS(on)}$=0.08 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
36V	PZM36NB	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=34.0...38.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<60 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
36X	02CZ36	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=34.00...38.00 В; I_L(V_R=27 В)<0.5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5 мА)<250 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
37	PDTA114YEF	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
37	PDTA143ZE	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
38	PDTC143ZE	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
38p	PMBFJ108	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>80 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<8 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
38t	PMBFJ108	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>80 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<8 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
38W	PMBFJ108	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>80 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<8 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
39p	PMBFJ109	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>40 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<12 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
39t	PMBFJ109	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>40 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<12 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
39V	PZM39NB	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=37.0...41.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<75 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
39W	PMBFJ109	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>40 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<12 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
39X	02CZ39	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=37.00...41.00 В; I_L(V_R=30 В)<0.5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5 мА)<250 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
3A	BC856A	CDIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A	BC856A	TOSH	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=125...250; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A	BC856A	VISH	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A	BC856A	ZETEX	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A	BC856A	DIODS	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A	BC856A	ITT	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A	BC856AF	PHIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
3A	BC856ALT1	MOT	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A	BC856AT	PHIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
3A	KST24	SAMS	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>30; f_T>620 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A	MMBTH24	MOT	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>30; f_T>400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3A-	BC856AW	PHIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3A0	PZM3.0NB2A	PHIL	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.95...3.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
3A3	PZM3.3NB2A	PHIL	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.25...3.5 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
3A6	PZM3.6NB2A	PHIL	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.55...3.8 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
3A9	PZM3.9NB2A	PHIL	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.87...4.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
3Ap	BC856A	PHIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3AR	BC856AR	PHIL	pnp	V_{CBO}=65 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
3As	BC856A	INF	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3As	BC856AT	INF	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T=250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
3As	BC856AW	INF	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3At	BC856A	PHIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3At	BC856AW	PHIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3B	BC856B	CDIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3B	BC856B	TOSH	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=220...475; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3B	BC856B	DIODS	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3B	BC856B	VISH	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3B	BC856B	ITT	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3B	BC856BF	PHIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
3B	BC856BLT1	MOT	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
3B	BC856BT	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
3B	FMMT918	ZETEX	npn	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}>20; f_T>600МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3B	TMPT918	ALLEG	npn	V_{CBO}=30В; I_{CBO}<10нА; h_{21}>20; $V_{CE(sat)}$<0.4В; f_T>600МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3B-	BC856BW	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Bp	BC856B	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3BR	BC856BR	PHIL	pnp	V_{CBO}=65В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=475; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
3Bs	BC856B	INF	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=220...475; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Bs	BC856BT	INF	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220...475; f_T=250МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
3Bs	BC856BW	INF	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220...475; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Bt	BC856B	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Bt	BC856BW	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3C	FMMTA20R	ZETEX	npn	V_{CBO}=40В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=40...400; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3D	BC856	CDIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=125...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3D	MMBTH81LT1	MOT	pnp	V_{CBO}=20В; P_D=300мВт; h_{21}>60; f_T>600МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3D-	BC856W	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=125...800; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Dp	BC856	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=125...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Dt	BC856	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=125...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Dt	BC856W	PHIL	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=125...800; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3E	BC857A	CDIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=110...220; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3E	BC857A	TOSH	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=125...250; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3E	BC857A	VISH	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=110...220; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3E	BC857A	DIODS	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=110...220; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3E	BC857AF	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=125...250; f_T>100МГц	SOT490,SC89	B•E•C
3E	BC857ALT1	MOT	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=125...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3E	BC857AT	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=125...250; f_T>100МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
3E	FMMTA42	ZETEX	npn	V_{CBO}=300В; I_C=200мА; P_D=330мВт; h_{21}>40; f_T>50МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3E	KST10	SAMS	npn	V_{CBO}=30В; P_D=350мВт; h_{21}>60; f_T>650МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3E	MMBTH10	MOT	npn	V_{CBO}=30В; P_D=300мВт; h_{21}>60; f_T>650МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3E-	BC857AW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=125...250; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3EM	MMBTH10LT1	MOT	npn	V_{CBO}=30В; P_D=300мВт; h_{21}>60; f_T>650МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Ep	BC857A	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=125...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3ER	BC857AR	PHIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
3Es	BC857A	INF	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=125...250; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Es	BC857AW	INF	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=125...250; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Et	BC857A	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=125...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Et	BC857AW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=125...250; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3EZ	FMMTH10	ZETEX	npn	V_{CBO}=30В; I_C=25мА; P_D=330мВт; h_{21}>60; f_T>650МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3F	BC857B	CDIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3F	BC857B	DIODS	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3F	BC857B	TOSH	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=220...475; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3F	BC857B	VISH	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3F	BC857B	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=220...475; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3F	BC857BF	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT490,SC89	B•E•C
3F	BC857BLT1	MOT	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3F	BC857BT	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
3F-	BC857BW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Fp	BC857B	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3FR	BC857BR	PHIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=475; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
3Fs	BC857B	INF	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=220...475; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Fs	BC857B	SIEM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=220...475; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Fs	BC857BW	SIEM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220...475; f_T=250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Ft	BC857B	PHIL	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=220...475; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

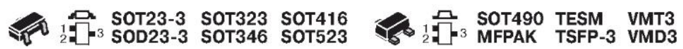
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
3Ft	BC857BW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3G	BC857C	CDIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3G	BC857C	TOSH	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3G	BC857C	DIODS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3G	BC857C	VISH	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3G	BC857C	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3G	BC857CF	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
3G	BC857CT	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
3G	BC857CT	DIODS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT523	B•E•C
3G	MMBTH11	FAIR	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=3225 мВт; h_{21}>60; f_T<650 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3G-	BC857CW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Gp	BC857C	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3GR	BC857CR	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
3Gs	BC857C	INF	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Gs	BC857CW	INF	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Gt	BC857C	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Gt	BC857CW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3H	BC857	CDIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3H	BC857W	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3H	MMBTH30	NS	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>200; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Hp	BC857	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3J	BC858A	CDIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3J	BC858A	VISH	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3J	BC858A	ZETEX	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3J	BC858A	DIODS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3J	BC858AF	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
3J	BC858ALT1	MOT	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3J	BC858AW	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3J	MMBTH69	MOT	pnp	V_{CBO}=15 В; P_D=300 мВт; h_{21}=30...300; f_T>2000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3J	RB706F-40	ROHM	shd×2	V_R<40 В; I_F<30 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<370 мВ; C_D=2 пФ	SOT323,SC70	A1•K1,A2•K2
3Jp	BC858A	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3JR	BC858AR	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
3Js	BC858A	INF	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Js	BC858AW	SIEM	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Jt	BC858A	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3K	BC858B	CDIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3K	BC858B	TOSH	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=220...475; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3K	BC858B	DIODS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3K	BC858B	VISH	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3K	BC858B	ZETEX	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3K	BC858BF	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
3K	BC858BLT1	MOT	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3K	BC858BW	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Kp	BC858B	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3KR	BC858BR	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=475; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
3Ks	BC858B	SIEM	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Ks	BC858BW	SIEM	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Kt	BC858B	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3L	BC858C	CDIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3L	BC858C	TOSH	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3L	BC858C	VISH	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3L	BC858C	ZETEX	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
3L	BC858C	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3L	BC858CF	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
3L	BC858CLT1	MOT	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3L	BC858CW	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Lp	BC858C	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3LR	BC858CR	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
3Ls	BC858C	SIEM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Ls	BC858CW	SIEM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3Lt	BC858C	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3M	2SC4808	PAN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=80 мА; P_D=125 мВт; h_{21}=50...300; f_T>5 ГГц	SOT416,SC75A	B•E•C
3M	2SC4835	PAN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=80 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...200; f_T>5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
3M	BC858	CDIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3M	BC858W	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
3m	FMMT5087R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...600; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Mp	BC858	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3Mt	BC858	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3N	2SK620	PAN	nMOS	V_{DS}=50 В; I_D=100 мА; P_D=150 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
3N	2SK664	PAN	nMOS	V_{DS}=50 В; I_D=100 мА; P_D=150 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
3N	MMBT3906	VISH	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3N	MMBT4402	NS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>30; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3O	2SK621	PAN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=150 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
3O	2SK665	PAN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=150 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
3P	FMMT2222AR	ZETEX	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...360; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3P	FMT2222AR	ZETEX	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=500 мВт; h_{21}>30	SOT23,SOD23	E•B•C
3R	MMBT5571	NS	pnp	f_T=850 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3R	PDTA124EEF	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
3S	2SC4805	PAN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=65 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...300; f_T>7 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
3S	MMBT5551	ON	npn	V_{CB0}=180 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=80...250; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3S	MMBT5551	VISH	npn	V_{CB0}=180 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=80...250; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3S	MMBT5551	NS	npn	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=80...250	SOT23,SOD23	B•E•C
3T	HT3	ZETEX	pnp	V_{CB0}=90 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>30	SOT23,SOD23	B•E•C
3U	2SC3967U	PAN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=40...200; f_T=1.5 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
3V	BC857AT	DIODS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT523	B•E•C
3V0	PZM3.0NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=2.8...3.2 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<95 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
3V3	PZM3.3NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=3.1...3.5 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<95 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
3V6	PZM3.6NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=3.4...3.8 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
3V9	PZM3.9NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=3.7...4.1 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
3W	BC857BT	DIODS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>150 МГц	SOT523	B•E•C
3W	FMMTA12	ZETEX	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=300 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>20000	SOT23,SOD23	B•E•C
4.3X	02CZ4.3	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.00...4.50 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<1000 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
4.7X	02CZ4.7	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.40...4.90 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<1000 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
40p	PMBFJ110	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>10 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<18 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
40t	PMBFJ110	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>10 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<18 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
40W	PMBFJ110	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}>10 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<18 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
41	PDTA143XEF	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
413	FMMT413	ZETEX	npn	V_{CB0}=150 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
415	FMMT415	ZETEX	npn	V_{CB0}=260 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>25; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
417	FMMT417	ZETEX	npn	V_{CB0}=320 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>25; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
41A	FMMT491A	ZETEX	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=300...900; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
41p	PMBFJ111	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>20 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
41t	PMBFJ111	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>20 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
41W	PMBFJ111	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>20 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G

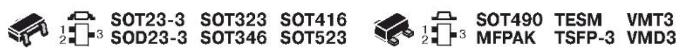
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
42	BAT54AW	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<320 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A2,A1
42p	PMBFJ112	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>5 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
42t	PMBFJ112	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>5 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
42W	PMBFJ112	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>5 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
43	BAS40	VISH	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
43	BAS40	DIOT	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
43	BAS40	MCS	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
43	BAS40	TSC	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
43	BAS40	GS	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
43	BAT54CW	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<320 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
43	DTC143XE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
43	DTC143XKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
43	DTC143XUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
43p	BAS40	PHIL	shd	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
43s	BAS40	INF	shd	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
43s	BAS40	SIEM	shd	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
43V	PZM43NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=40.0...46.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
43X	02CZ43	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=40.00...45.00 В; $I_r(V_R$=33 В)<0.5 мкА	SOT346,SC59	A•n.c.•K
44	BAS4004	VISH	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44	BAS40-04	DIOT	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44	BAS40-04	MCS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44	BAS40-04	TSC	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44	BAS40-04	GS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44	BAT54SW	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<320 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
449	FMMT449	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
44p	BAS4004	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44s	BAS4004	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44s	BAS40-04	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44s	BAS40-04	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
44s	BAS4004W	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5.0 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
44s	BAS40-04W	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
45	BAS4005	VISH	shd×2	V_R=40 В; I_F=200 мА; P_D=200 мВт; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
45	DTC124XE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
45	DTC124XKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
45	DTC124XUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
451	FMMT451	ZETEX	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=50...150; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
455	FMMT455	ZETEX	npn	V_{CBO}=160 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
458	FMMT458	ZETEX	npn	V_{CBO}=400 В; I_C=225 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
459	TMPD459	ALLEG	dl	I_F<500 мА; V_{BR}>200 В; $V_F(I_F$=3 мА) 1.0 В; I_R<25 нА; C_D<6.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
45p	BAS4005	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
45s	BAS4005	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,A2
45s	BAS40-05	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K2,K1
45s	BAS4005W	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5.0 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,A2
45s	BAS40-05W	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K2,K1
46	BAS4006	VISH	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
46	PDTA114TEF	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
46p	BAS4006	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
46s	BAS4006	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
46s	BAS40-06	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
46s	BAS4006W	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5.0 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
46s	BAS40-06W	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; V_F(I_F=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
47	PDTC114YK	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
47p	PMBFJ113	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>2 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
47t	PMBFJ113	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>2 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
47V	PZM47NB	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=44.0...50.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
47W	PMBFJ113	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_{DSS}>2 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
47X	02CZ47	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=44.00...49.00 В; I_L(V_R=36 В)<0.5 мкА	SOT346,SC59	A•n.c.•K
489	FMMT489	ZETEX	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
48p	PMBFJ308	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=12...60 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
48t	PMBFJ308	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=12...60 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
48W	PMBFJ308	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=12...60 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
491	FMMT491	ZETEX	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
493	FMMT493	ZETEX	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
494	FMMT494	ZETEX	npn	V_{CB0}=140 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
495	FMMT495	ZETEX	npn	V_{CB0}=170 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
497	FMMT497	ZETEX	npn	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=80...300; f_T>75 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
49p	PMBFJ309	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=12...30 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
49t	PMBFJ309	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=12...30 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
49W	PMBFJ309	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=12...30 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
4A	BC859A	CDIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4A	BC859AW	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4A	FMMV109	ZETEX	bd	V_R<30 В; $C_{3\,В}$=26...32 пФ; C3 В/$C_{25\,В}$=5...6.5; Q>250	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4A	MMBV109	ZETEX	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{3\,В}$=26...32 пФ; $C_{3\,В}$/$C_{25\,В}$=5.0...6.5	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4A3	PZM4.3NB2A	PHIL	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.15...4.34 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
4A7	PZM4.7NB2A	PHIL	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.55...4.75 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<80 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
4Ap	BC859A	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4AR	BC859AR	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=250; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
4As	BC859A	SIEM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4As	BC859AW	INF	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4At	BC859A	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4B	BC859B	CDIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4B	BC859B	TOSH	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=220...475; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4B	BC859B	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4B	BC859B	ITT	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4B-	BC859BW	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Bp	BC859B	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4BR	BC859BR	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=475; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
4Bs	BC859B	INF	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Bs	BC859BW	SIEM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Bt	BC859B	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Bt	BC859BW	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4C	BC859C	ITT	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4C	BC859C	CDIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4C	BC859C	TOSH	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4C	BC859C	ITT	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4C	FMMV3102	ZETEX	bd	V_R<30 В; $C_{3\,В}$=20...25 пФ; C3 В/$C_{25\,В}$>4.5; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4C	MMVB3102	MOT	var	C_T=6...35 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4C-	BC859CW	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Cp	BC859C	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4CR	BC859CR	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
4Cs	BC859C	INF	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
4Cs	BC859CW	INF	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Ct	BC859C	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Ct	BC859CW	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4D	BC859	CDIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4D	HD3A	ZETEX	fid	V_R<75 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=10 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4D	MMBV3401LT1	ON	pin	V_{BR}>35 В; I_R<0.1 мкА; C_T<1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4D-	BC859W	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Dp	BC859	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Dt	BC859W	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4E	BC860A	CDIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4E	BC860AW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4E	FMMTA92	ZETEX	pnp	V_{CBO}=300 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Ep	BC860A	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4ER	BC860AR	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=250; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
4Et	BC860A	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4EZ	FMMV105G	ZETEX	bd	V_R<30 В; $C_{25В}$=1.8...2.8 пФ; С3 В/$C_{25В}$=4...6; Q>350	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4F	BC860B	CDIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4F	BC860B	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4F-	BC860BW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Fp	BC860B	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4FR	BC860BR	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=475; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
4Fs	BC860B	INF	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Fs	BC860BW	INF	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Ft	BC860B	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Ft	BC860BW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4G	BC860C	CDIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4G	FMMT2484	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=50 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...500	SOT23,SOD23	B•E•C
4G-	BC860CW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Gp	BC860C	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4GR	BC860CR	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
4Gs	BC850CW	INF	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Gs	BC860C	INF	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Gs	BC860CW	INF	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Gt	BC860C	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Gt	BC860CW	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4GZ	BC860C	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4H	BC860	CDIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4H	MMBV2103LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{4В}$=9...11 пФ; $C_{2В}/C_{30В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4H-	BC860W	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4Hp	BC860	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Ht	BC860	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4Ht	BC860W	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...800; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
4J	FMMT38A	ZETEX	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=300 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>500	SOT23,SOD23	B•E•C
4J	MMBV2109LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{4В}$=29.7...36.3 пФ; $C_{2В}/C_{30В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4M	MMBD101	MOT	shd	V_R<4 В; V_F(I_F=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4Ms	BAT240A	INF	shd×2	V_R<240 В; I_F<400 мА; V_F(I_F=50 мА)<470 мВ; C_D=11.5 пФ	SOT23,SOD23	K1,A2•K2•A1
4P	FMMT2907R	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4R	MMBV3700LT1	ON	pin	V_{BR}>200 В; I_R<0.1 мкА; C_T<1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4T	MMBD301LT1	ON	shd	V_R>30 В; V_F(I_F=10 мА)<0.6 В; C_T<1.5 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4U	MMBV2105LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{4В}$=13.5...16.5 пФ; $C_{2В}/C_{30В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4V	BCW65AR	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4V	MMBV2106LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{2В}/C_{30В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
4V3	PZM4.3NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.01...4.48 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<90 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
4V7	PZM4.7NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.42...4.90 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<80 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
4W	BCW67AR	ZETEX	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
4W	MMBV2107LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{4\,В}$=19.8...24.2 пФ; $C_{2\,В}/C_{30\,В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4X	MMBV2108LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{4\,В}$=24.3...29.7 пФ; $C_{2\,В}/C_{30\,В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4Y	MMBV2102LT1	MOT	var	V_R>30 В; C_T=8.2 пФ; $C_{2\,В}/C_{30\,В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4Z	MMBV2104LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{2\,В}/C_{30\,В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5.1X	02CZ5.1	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.80...5.40 В; $I_L(V_R$=1.5 В)<1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<1000 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
5.6X	02CZ5.6	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=5.30...6.00 В; $I_L(V_R$=2.5 В)<1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<900 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
50	PDTA143EEF	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
50p	PMBFJ310	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=24...60 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
50t	PMBFJ310	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=24...60 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
50W	PMBFJ310	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=24...60 мА; P_D=250 мВт; g_F>10 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
51	PDTC143EEF	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
517	FMMT6517	ZETEX	npn	V_{CB0}=350 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=30...200; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
51V	PZM51NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=48.0...54.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<110 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
52	DTA123YE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
52	DTA123YKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
52	DTA123YUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
52	PDTA143ZEF	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
520	FMMT6520	ZETEX	pnp	V_{CB0}=350 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=30...200; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
53	BAT17	SIEM	shd	V_R<4 В; I_F<30 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
53	BAT17W	SIEM	shd	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<0.75 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
53	PDTC143ZEF	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
53s	BAT17	INF	shd	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<450 мВ; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•C
53s	BAT17W	INF	shd	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<0.75 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
54	BAT1704	SIEM	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
54	BAT1704W	SIEM	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<0.75 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
54	DTA114YE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
54	DTA114YKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
54	DTA114YUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
54	PDTA114YK	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
54	PDTC143XEF	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
549	FMMT549	ZETEX	pnp	V_{CB0}=35 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
54s	BAT17-04	INF	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<450 мВ; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
54s	BAT17-04W	INF	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<0.75 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
55	BAT1705	SIEM	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
55	BAT1705W	SIEM	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<0.75 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
551	FMMT551	ZETEX	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=50...150; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
555	FMMT555	ZETEX	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=50...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
558	FMMT558	ZETEX	pnp	V_{CB0}=400 В; I_C=150 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
55s	BAT17-05	INF	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<450 мВ; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
55s	BAT17-05W	INF	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<450 мВ; C_D<1 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
56	BAT1706	SIEM	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
56	BAT1706W	SIEM	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<0.75 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
56s	BAT17-06	INF	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
56s	BAT17-06W	SIEM	shd×2	V_R<4 В; I_F<130 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; I_R<0.25 мкА; C_D<0.75 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
56V	PZM56NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=52.0...60.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<120 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
576	FMMT576	ZETEX	pnp	V_{CB0}=200 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=50...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
589	FMMT589	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
59	DTA114YE	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
591	FMMT591	ZETEX	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
593	FMMT593	ZETEX	pnp	V_{CBO}=120 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
596	FMMT596	ZETEX	pnp	V_{CBO}=220 В; I_C=300 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=85...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
597	FMMT597	ZETEX	pnp	V_{CBO}=300 В; I_C=200 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=100...300; f_T>75 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
59A	FMMT549A	ZETEX	pnp	V_{CBO}=35 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=150...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5A	BC807-16	CDIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5A	BC807-16LT1	MOT	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...250; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5A	BC807-16W	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...250; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5A	BSS123	MOT	nMOS	V_{DS}=100 В; I_D=170 мА; P_D=330 мВт; g_F=90 мСм; $R_{DS(on)}$=14 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
5A	FMMD6050	ZETEX	fid	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5A	MMBD6050LT1	MOT	di	V_R>70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.1 В; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5A1	PZM5.1NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.98...5.20 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<60 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
5A6	MMBZ5V6AL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=5.32...5.88 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
5A6	PZM5.6NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=5.49...5.73 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<40 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
5Ap	BC807-16	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5AR	BC807-16R	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
5As	BC807-16	SIEM	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5As	BC807-16W	SIEM	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T=200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5AZ	BC807-16	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5B	BC80725	CDIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5B	BC807-25	STM	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5B	BC80725LT1	MOT	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=160...400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5B	BC80725W	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=160...400; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5B	FMMD6100	ZETEX	fid×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
5B	KST4123	SAMS	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=50...150; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5B	MMBT4123	SAMS	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=50...150	SOT23,SOD23	B•E•C
5B	MMBT4123	MOT	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=50...150	SOT23,SOD23	B•E•C
5BM	MMBD6100LT1	MOT	di×2	V_R>70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.1 В; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
5Bp	BC80725	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5Bs	BC80725	SIEM	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5Bs	BC80725W	SIEM	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T=200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5Bt	BC80725	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5BZ	BC80725	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5C	BAT54CLT1	ON	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=30 мА)<500 мВ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
5C	BC807-40	CDIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5C	BC807-40	STM	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5C	BC80740LT1	MOT	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=250...600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5C	BC807-40W	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=250...600; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5C	FMMD7000	ZETEX	fid×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.1 В; I_R<0.3 мкА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<15 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
5Cp	BC807-40	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5CR	BC807-40R	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}>600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
5Cs	BC807-40	SIEM	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5Cs	BC807-40W	INF	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...630; f_T=200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5CZ	BC807-40	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5D	BC807	CDIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5D	BC807W	PHIL	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5D	DAN212N3	CYS	di	V_R<70 В; I_F<200 мА; P_D<250 мВт; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
5D	FMMD914	ZETEX	fid	V_R<75В; I_F<225мА; $V_F(I_F$=10мА)<1.0В; I_R<0.025мкА; C_D<4.0пФ; t_{RR}<8нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5D	HD2A	ZETEX	fid×2	V_R<35В; I_F<100мА; $V_F(I_F$=10мА)<1.0В; I_R<1.0мкА; C_D<4.0пФ; t_{RR}<6нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
5D	MMBD914LT1	MOT	di	V_R>100В; I_F<200мА; $V_F(I_F$=10мА)<1В; C_D<4пФ; t_{RR}<4нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5D	TMPD4148	ALLEG	d	I_F<600мА; V_{BR}>100В; $V_F(I_F$=10мА)<1.0В; I_R<25нА; t_{RR}<4.0нс; C_D<4.0пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5D	TMPD914	ALLEG	d	I_F<600мА; V_{BR}>100В; $V_F(I_F$=10мА)<1.0В; I_R<25нА; t_{RR}<4.0нс; C_D<6.0пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5Dp	BC807	PHIL	pnp	V_{CB0}=45В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=100...600; f_T>80МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5DZ	BC807	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...600; f_T=100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5E	BC808-16	CDIL	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5E	BC808-16W	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...250; f_T>80МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5E	FMMTA43R	ZETEX	npn	V_{CB0}=200В; I_C=200мА; P_D=330мВт; h_{21}=50...200; f_T>50МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5Ep	BC808-16	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=100...250; f_T>80МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5ER	BC808-16R	PHIL	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=310мВт; h_{21}>250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
5Es	BC808-16	SIEM	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5Es	BC808-16W	INF	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=100...250; f_T=200МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5Et	BC808-16	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=100...250; f_T>80МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5EZ	BC808-16	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5F	BC808-25	CDIL	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5F	BC808-25W	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=200мВт; h_{21}=160...400; f_T>80МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5Fp	BC808-25	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=160...400; f_T>80МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5FR	BC808-25R	PHIL	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=310мВт; h_{21}>400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
5Fs	BC808-25	SIEM	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5Fs	BC808-25W	INF	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=160...400; f_T=200МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5FZ	BC80825	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5G	BC808-40	CDIL	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5G	BC808-40W	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=200мВт; h_{21}=250...600; f_T>80МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5Gp	BC808-40	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=250...600; f_T>80МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5GR	BC808-40R	PHIL	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=310мВт; h_{21}>100; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
5Gs	BC808-40	SIEM	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5Gs	BC808-40W	INF	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=250...630; f_T=200МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5Gt	BC808-40	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=250...600; f_T>80МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5GZ	BC808-40	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...600; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5H	BC808	CDIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=100...600; f_T>80МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5H	BC808W	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...600; f_T>80МГц	SOT323,SC70	B•E•C
5H	MMBD4148	VISH	di	V_R<75В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=10мА)<1.0В; I_R<5.0мкА; C_D<4пФ; t_{RR}<6нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5H	MMBD4148	NS	di	V_R<75В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=10мА)<1.0В; I_R<5.0мкА; C_D<4пФ; t_{RR}<6нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5H	MMBD701LT1	MOT	shd	V_R>70В; $V_F(I_F$=10мА)<1В; C_D<1пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5Hp	BC808	PHIL	pnp	V_{CB0}=25В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=100...600; f_T>80МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5HZ	BC808	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...600; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5J	FMMT38B	ZETEX	npn	V_{CB0}=80В; I_C=300мА; P_D=330мВт; h_{21}>2000	SOT23,SOD23	B•E•C
5K	MMBV809LT1	ON	var	V_R>20В; I_F=20мА; C_{2B}=4.5...6.1пФ; C_{2B}/C_{8B}=1.8...2.6	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5L	MMBV609LT1	ON	var×2	V_R>20В; I_F=100мА; C_{3B}=26...32пФ; C_{3B}/C_{8B}=1.8...2.4	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
5N	MMBD452LT1	MOT	shd×2	V_R>30В; $V_F(I_F$=10мА)<0.45В; C_T<1.5пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
5P	FMMT2907AR	ZETEX	pnp	V_{CB0}=60В; I_C=600мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...300; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5T	BCW66GR	ZETEX	npn	V_{CB0}=75В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5T	BCW66GR	SIEM	npn	V_{CB0}=75В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T=170МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
5T	BCW68GR	ZETEX	pnp	V_{CB0}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5V	BCW65BR	ZETEX	npn	V_{CB0}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
5V1	PZM5.1NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=4.84...5.37В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<60Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
5V6	PZM5.6NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=5.31...5.92В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<40Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
5W	BCW67BR	ZETEX	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6.2X	02CZ6.2	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=5.80...6.60 В; $I_L(V_R$=3.0 В)<1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<500 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
6.8	DF3A6.8FU	TOSH	pz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=6.4...7.2 В; $I_R(V_R$=5.0 В)<0.5 мкА	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
6.8X	02CZ6.8	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=6.40...7.20 В; $I_L(V_R$=5.0 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<150 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
614	FMMT614	ZETEX	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=500 мА; P_D=500 мВт; h_{21}>15000	SOT23,SOD23	B•E•C
617	FMMT617	ZETEX	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=3000 мА; P_D=625 мВт	SOT23,SOD23	B•E•C
618	FMMT618	ZETEX	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=2500 мА; P_D=625 мВт; h_{21}=300...450; f_T>140 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
619	FMMT619	ZETEX	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=2000 мА; P_D=625 мВт; h_{21}=300...450; f_T>160 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
61A	MMBF4117	FAIR	nFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; g_F=3 мС	SOT23,SOD23	D•S•G
61C	MMBF4118	FAIR	nFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; g_F=5 мС	SOT23,SOD23	D•S•G
61E	MMBF4119	FAIR	nFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; g_F=10 мС	SOT23,SOD23	D•S•G
61J	MMBF4091	FAIR	nFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	S•D•G
61K	MMBF4092	FAIR	nFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT23,SOD23	S•D•G
61L	MMBF4093	FAIR	nFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$<80 Ом	SOT23,SOD23	S•D•G
61S	MMBF5458	FAIR	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=10 мА; P_D=350 мВт; I_{DSS}<9 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
61S	MMBFJ270	FAIR	pFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; I_{DSS}<15 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
61T	MMBF5459	NS	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=10 мА; P_D=350 мВт; I_{DSS}<16 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
61U	MMBF5461	FAIR	pFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=10 мА; P_D=300 мВт; I_{DSS}<9 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
61V	MMBF5462	FAIR	pFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=10 мА; P_D=300 мВт; I_{DSS}<16 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
62	DTC123YE	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
62	DTC123YKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
62	DTC123YUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
624	FMMT624	ZETEX	npn	V_{CB0}=125 В; I_C=1000 мА; P_D=625 мВт; h_{21}=300...450; f_T>155 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
625	FMMT625	ZETEX	npn	V_{CB0}=150 В; I_C=1000 мА; P_D=625 мВт; h_{21}=300...450; f_T>135 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
62P	MMBFJ201	FAIR	nFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; I_{DSS}<1 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
62Q	MMBFJ202	FAIR	nFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; I_{DSS}<4.5 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
62T	MMBFJ271	FAIR	pFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; I_{DSS}<50 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
62V	PZM62NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=58.0...66.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<140 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
63	BAS40W	PHIL	shd	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
63Q	MMBFJ304	NS	nFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт	SOT23,SOD23	D•S•G
63s	BAT64	INF	shd	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
63s	BAT64W	INF	shd	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT323,SC70	A1•n.c.•K
64	BAS4004W	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
64	DTC114YE	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
64	DTC114YKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
64	DTC114YUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
64s	BAT6404	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
64s	BAT64-04	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
64s	BAT64-04W	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
65	BAS4005W	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
65s	BAT6405	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
65s	BAT64-05	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
65s	BAT64-05W	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
66	BAS4006W	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
66s	BAT6406	SIEM	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
66s	BAT64-06	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
66s	BAT64-06W	INF	shd×2	V_R<40 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.75 В; I_R<2 мкА; C_D<6 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
68V	PZM68NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=64.0...72.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<160 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
69	DTC114YE	MOT	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C





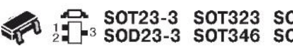
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
69	DTC115TE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6A	BC817-16	CDIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6A	BC817-16	VISH	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6A	BC817-16LT1	MOT	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...250; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6A	BC817-16W	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6A	DTA114EET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6A	MMBF4416	MOT	nFET	V_{DS}=30 В; I_G<10 мА; P_D=300 мВт; NF<4 дБ	SOT23,SOD23	D•S•G
6A	MUN2111T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>35; 10 кОм/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6A	MUN5111T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>35; 10 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6A2	MMBZ6V2AL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=5.89...6.51 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
6A2	PZM6.2NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=6.06...6.33 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
6A8	MMBZ6V8AL	ON	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=6.46...7.14 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
6A8	PZM6.8NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=6.65...6.93 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
6Ap	BC817-16	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6AR	BC817-16R	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}>250; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
6As	BC817-16	SIEM	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6As	BC817-16W	SIEM	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T>170 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6At	BC817-16	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6AZ	BC817-16	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6B	BC817-25	CDIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6B	BC817-25	VISH	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6B	BC817-25LT1	MOT	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=160...400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6B	BC817-25W	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6B	DTA124EET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6B	MMBF5484	MOT	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=10 мА; P_D=200 мВт; I_{DSS}<5 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
6B	MUN2112T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6B	MUN5112T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6BG	CMPF4416A	CSI	nFET	V_{GSS}>35 В; I_{DSS}=5...15 мА; $V_{GS(off)}$=2.5...6 В; NF=2 дВ	SOT23,SOD23	D•S•G
6Bp	BC817-25	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6BR	BC817-25R	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}>400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
6Bs	BC817-25	SIEM	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6Bs	BC817-25W	INF	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T=170 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6BZ	BC817-25	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6C	BC817-40	CDIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6C	BC817-40	VISH	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6C	BC817-40LT1	MOT	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=250...600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6C	BC817-40W	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=250...600; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6C	DTA144EET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6C	MMBFU310LT1	MOT	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=10 мА; P_D=225 мВт; I_{DSS}<60 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
6C	MUN2113T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6C	MUN5113T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6Cp	BC817-40	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6CR	BC817-40R	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}>600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
6Cs	BC817-40	SIEM	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6Cs	BC817-40W	INF	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...630; f_T=170 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6Ct	BC817-40	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6CZ	BC817-40	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...600; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6D	BC817	CDIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6D	DTA114YET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
6D	MMBF5457	FAIR	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=10 мА; P_D=350 мВт; I_{DSS} <5 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
6D	MUN2114T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 10 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6D	MUN5114T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 10 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6D-	BC817W	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6Dp	BC817	PHIL	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6Dt	BC817W	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6DZ	BC817	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6E	BC818-16	CDIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6E	BC818-16W	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6E	DTA114TET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6E	FMMTA93R	ZETEX	pnp	V_{CBO}=200 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=30...150; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6E	MMBF5460	MOT	pFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=10 мА; P_D=300 мВт; I_{DSS} <5 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
6E	MMBF5460	FAIR	pFET	V_{DG}=40 В; I_{GF}=10 мА; P_D=300 мВт; I_{DSS} <5 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
6E	MUN2115T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>160; R_1 10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6E	MUN5115T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>160; R_1 10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6Ep	BC818-16	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6ER	BC818-16R	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=250; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
6Es	BC818-16	SIEM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6Es	BC818-16W	INF	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T=170 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6Et	BC818-16	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...250; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6EZ	BC818-16	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6F	BC818-25	CDIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6F	BC818-25	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6F	BC818-25W	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6F	DTA143TET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6F	MMBF4860	MOT	nFET	V_{DS}=30 В; I_G<50 мА; P_D=300 мВт	SOT23,SOD23	D•S•G
6F	MUN2116T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>160; R_1 4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6F	MUN5116T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>160; R_1 4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6Fp	BC818-25	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6FR	BC818-25R	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
6Fs	BC818-25	INF	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6Fs	BC818-25W	INF	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...400; f_T>170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6FZ	BC818-25	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6FZ	BC818-25	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6G	BC818-40	CDIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6G	BC818-40W	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=250...600; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6G	CMPF4393	CSI	nFET	V_{GSS}>40 В; I_{DSS}=5...30 мА; $V_{GS(off)}$=0.5...3 В; $R_{DS(on)}$<100 Ом; t_{OFF}<50 нс	SOT23,SOD23	D•S•G
6G	FMMV2103	ZETEX	bd	V_R<30 В; $C_{4В}$=9...11 пФ; $C_{2В}/C_{30В}$=2.6...3.3; Q>400	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
6G	MMBF4393	FAIR	nFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$ <100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6G	MMBF4393LT1	ON	nFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$ <100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6G	MUN2130T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>3; 1 кОм/1 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6G	MUN5130T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>3; 1 кОм/1 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6Gp	BC818-40	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6GR	BC818-40R	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
6Gs	BC818-40	INF	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6Gs	BC818-40W	INF	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...630; f_T=170 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
6Gt	BC818-40	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6GZ	BC818-40	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6H	BC818	CDIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6H	BC818W	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C



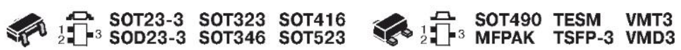

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
6H	DTA123EET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6H	FMMV2104	ZETEX	bd	V_R<30 В; C_{4B}=10.8...13.2 пФ; C_{2B}/C_{30B}=2.6...3.3; Q>400	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
6H	MMBF5486	MOT	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=10 мА; P_D=300 мВт; I_{DSS}<20 мА	SOT23,SOD23	D•S•G
6H	MUN2131T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6H	MUN5131T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6Hp	BC818	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6HZ	BC818	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6J	CMPF4391	CSI	nFET	V_{GSS}>40 В; I_{DSS}=50...150 мА; $V_{GS(off)}$=4...10 В; $R_{DS(on)}$<30 Ом; t_{OFF}<20 нс	SOT23,SOD23	D•S•G
6J	DTA143EET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6J	FMMV2105	ZETEX	bd	V_R<30 В; C_{4B}=13.5...16.5 пФ; C_{2B}/C_{30B}=2.6...3.3; Q>400	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
6J	MMBF4391	FAIR	nFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6J	MMBF4391LT1	ON	nFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6J	MUN2132T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6J	MUN5132T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6K	CMPF4392	CSI	nFET	V_{GSS}>40 В; I_{DSS}=25...75 мА; $V_{GS(off)}$=2...5 В; $R_{DS(on)}$<60 Ом; t_{OFF}<35 нс	SOT23,SOD23	D•S•G
6K	DTA143ZET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6K	MMBF4392	FAIR	nFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$<60 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6K	MMBF4392LT1	ON	nFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$<60 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6K	MUN2133T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6K	MUN5133T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6L	DTA124XET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6L	FMMV2107	ZETEX	bd	V_R<30 В; C_{4B}=19.8...24.2 пФ; C_{2B}/C_{30B}=2.7...3.3; Q>350	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
6L	MMBF5459	FAIR	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=10 мА; P_D=350 мВт; I_{DSS}<16 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
6L	MUN2134T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 22 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6L	MUN5134T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 22 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6M	DTA123JET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6M	FMMV2108	ZETEX	bd	V_R<30 В; C_{4B}=24.3...29.7 пФ; C_{2B}/C_{30B}=2.7...3.3; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
6M	MMBF5485	NS	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=10 мА; P_D=300 мВт	SOT23,SOD23	D•S•G
6M	MUN5135T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6N	DTA115EET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100; P_D=150 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6N	FMMV2109	ZETEX	bd	V_R<30 В; C_{4B}=29.3...36.3 пФ; C_{2B}/C_{30B}=2.7...3.3; Q>280	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
6N	MMBF4861	NS	nFET	V_{DG}=30 В; P_D=350 мВт; $R_{DS(on)}$<60 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6N	MUN2136T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 100 кОм/100 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6N	MUN5136T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 100 кОм/100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6P	BCX71HR	ZETEX	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6P	BCX71HR	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
6P	DTA144WET1	MOT	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
6P	MMBFJ111	FAIR	nFET	V_{DG}=35 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	S•D•G
6P	MUN2137T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
6P	MUN5137T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
6Q	MMBFJ305	NS	nFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт	SOT23,SOD23	D•S•G
6R	FMMV2101	ZETEX	bd	V_R<30 В; C_{4B}=6.1...7.5 пФ; C_{2B}/C_{30B}=2.5...3.3; Q>450	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
6R	MMBFJ112	FAIR	nFET	V_{DG}=35 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT23,SOD23	S•D•G
6S	MMBFJ113	FAIR	nFET	V_{DG}=35 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; $R_{DS(on)}$<100 Ом	SOT23,SOD23	S•D•G
6T	BCW68GR	SIEM	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
6T	MMBFJ310	NS	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт	SOT23,SOD23	D•S•G
6T	MUN2140T1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>120; R_1 47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
6t3	1PS70SB40	PHIL	shd	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<5 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
6t4	1PS70SB44	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<10 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
6t5	1PS70SB45	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<10 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
6t6	1PS70SB46	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<120 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<380 мВ; C_D<10 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
6U	MMBFJ309	NS	nFET	V_{DG}=25 В; I_{GF}=50 мА; P_D=350 мВт	SOT23,SOD23	D•S•G
6V	BCW65CR	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6V2	PZM6.2NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=5.86...6.53 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
6V8	PZM6.8NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=6.47...7.14 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<15 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
6W	BCW67CR	ZETEX	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
6W	MMBFJ175	FAIR	pFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; $R_{DS(on)}$<125 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6X	MMBFJ176	FAIR	pFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; $R_{DS(on)}$<250 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6Y	MMBFJ177	FAIR	pFET	V_{DG}=30 В; I_{GF}=50 мА; P_D=225 мВт; $R_{DS(on)}$<300 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
6Z	MMBF170LT1	MOT	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=500 мА; P_D=225 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
7.5X	02CZ7.5	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=7.00...7.90 В; $I_L(V_R$=6.0 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=0.5 мА)<120 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
702	2N7002	VISH	nFET	V_{DS}=60 В; I_D=115 мА; P_D=200 мВт; V_{GS}<2.5 В; C_{CC}=60 пФ	SOT23,SOD23	G•S•D
702W	L2N7002LT1	LRC	nFET	V_{DS}=60 В; I_D=115 мА; P_D=300 мВт; V_{GSTH}=1...2.5 В; C_{ISS}<50 пФ	SOT23,SOD23	G•S•D
717	FMMT717	ZETEX	pnp	V_{CBO}=12 В; I_C=2500 мА; P_D=625 мВт	SOT23,SOD23	B•E•C
718	FMMT718	ZETEX	pnp	V_{CBO}=20 В; I_C=1500 мА; P_D=625 мВт; h_{21}=300...450; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
720	FMMT720	ZETEX	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=1500 мА; P_D=625 мВт; h_{21}=300...450; f_T>190 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
722	FMMT722	ZETEX	pnp	V_{CBO}=70 В; I_C=1500 мА; P_D=625 мВт; h_{21}=300...450; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
723	FMMT723	ZETEX	pnp	V_{CBO}=100 В; I_C=1000 мА; P_D=625 мВт; h_{21}=300...450; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
73	BAS70	VISH	shd	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
73	BAS70	GS	shd	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
73	BAS70	DIOT	shd	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
73	BAS70	MCS	shd	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
73-	BAS70W	PHIL	shd	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
73p	BAS70	PHIL	shd	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
73p	BAS70W	PHIL	shd	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
73s	BAS70	INF	shd	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
73t	BAS70W	PHIL	shd	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
74	BAS7004	VISH	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
74	BAS70-04	GS	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
74	BAS70-04	DIOT	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
74	BAS70-04	MCS	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
74	DTA114WE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>24; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
74	DTA114WKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>24; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
74	DTA114WUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>24; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
74-	BAS70-04W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
74p	BAS7004	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
74p	BAS7004W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
74s	BAS7004	SIEM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<0.1 В; I_R<2.0 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
74s	BAS70-04	INF	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
74s	BAS70-04T	INF	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT416,SC75A	A1•K2•K1,A2
74s	BAS7004W	SIEM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
74s	BAS70-04W	INF	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
74t	BAS70-04W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
75	BAS7005	VISH	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75	BAS70-05	GS	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75	BAS70-05	DIOT	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
75	BAS70-05	MCS	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75-	BAS70-05W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75p	BAS70-05	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75p	BAS7005W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ; t_{RR}<0.1 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75s	BAS7005	SIEM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75s	BAS70-05	INF	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75s	BAS7005W	SIEM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75s	BAS70-05W	INF	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75t	BAS70-05	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75t	BAS70-05W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75V	PZM75NB	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=70.0...79.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<175 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
76	BAS7006	VISH	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76	BAS70-06	GS	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76	BAS70-06	DIOT	shd×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76	BAS70-06	MCS	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76	DTA144WE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
76	DTA144WKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
76	DTA144WUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
76-	BAS70-06W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
76p	BAS70-06	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76p	BAS7006W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ; t_{RR}<0.1 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A2,A1
76s	BAS7006	SIEM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76s	BAS70-06	INF	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76s	BAS7006W	SIEM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
76s	BAS70-06W	INF	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
76t	BAS70-06	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76t	BAS70-06W	PHIL	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; V_F(I_F=1 мА)<410 мВ; C_D<2 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
7A	MMBR901LT1	MOT	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=30 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=30...200	SOT23,SOD23	B•E•C
7A	MMBR901LT3	MOT	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=30 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=30...200	SOT23,SOD23	B•E•C
7A5	PZM7.5NB2A	PHIL	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.28...7.60 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
7B	MMBR920LT2	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=35 мА; P_D=268 мВт; h_{21}=25...250; f_T=4500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7D	HD4A	ZETEX	fid×2	V_R<35 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=10 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
7D	MMBR931LT1	MOT	npn	V_{CBO}=10 В; I_C=5 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...150	SOT23,SOD23	B•E•C
7E	FMMTA42R	ZETEX	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7E	MMBR2060	MOT	npn	V_{CE}=30 В; I_C=50 мА; f_T=1 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7F	MMBR4957LT1	MOT	pnp	V_{CE}=30 В; I_C=30 мА; P_D=278 мВт; f_T=1.2 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7G	MMBR5031LT1	MOT	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=20 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=25...300; f_T=1000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7H	KST5179	SAMS	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>25; f_T>900 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7H	MMBR5179LT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=375 мВт; h_{21}>25; f_T=1400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7J	FMMT38C	ZETEX	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=300 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>5000	SOT23,SOD23	B•E•C
7K	MMBR2857LT1	MOT	npn	V_{CE}=15 В; I_C=40 мА; f_T=4 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7M	BCW66HR	ZETEX	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7M	MMBR521LT1	MOT	pnp	V_{CBO}=20 В; I_C=70 мА; P_D=333 мВт; h_{21}=25...125; f_T=3400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7N	BCW68HR	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7N	MMBR941BLT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...200; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7N	MMBR941BLT3	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...200; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7P	BCW66FR	ZETEX	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7P	BCW66FR	SGS	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=800 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
7P	MMBR911LT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=60 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=30...200; f_T=6000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7R	MMBR536	MOT	pnp	V_{CBO}=10 В; I_C=10 мА	SOT23,SOD23	B•E•C

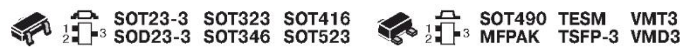
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
7T	BCW68FR	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7V5	PZM7.5NB	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.06...7.84 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
7X	MMBR571LT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=80 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...300; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7Y	MMBR941LT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
7Y	MMBR941LT3	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=50...250; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
-7Y	PDTB123YT	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; 2.2 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
7Z	MMBR951LT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=100 мА; P_D=322 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8.2	01BZA8.2	TOSH	pz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.7...8.7 В; I_R(V_R=6.5 В)<0.5 мкА	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
8.2X	02CZ8.2	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.70...8.70 В; I_L(V_R=6.5 В)<0.5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5 мА)<120 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
81A	FMMZ5250	ZETEX	dz	V_Z=20 В; Z_{ZT}(I_Z=6.2 мА)=25 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81A	PMBZ5250B	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=6.2 мА)=20 В; I_L(V_R=15 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=6.2 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81A	TMPZ5250	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=6.2 мА)=19.0...21.0 В; I_L(V_R=15.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=6.2 мА)<25 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81A	MMBZ5250B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=6.2 мА)=19.0...21.0 В; I_R<01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81A	MMBZ5250BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=6.2 мА)=19.0...21.0 В; I_R<01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81B	FMMZ5251	ZETEX	dz	V_Z=22 В; Z_{ZT}(I_Z=5.6 мА)=29 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81B	PMBZ5251B	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.6 мА)=22 В; I_L(V_R=17 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.6 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81B	TMPZ5251	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5.5 мА)=20.9...23.1 В; I_L(V_R=17.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.5 мА)<29 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81B	MMBZ5251B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5.6 мА)=20.9...23.1 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81B	MMBZ5251BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=5.6 мА)=20.9...23.1 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81C	FMMZ5252	ZETEX	dz	V_Z=24 В; Z_{ZT}(I_Z=5.2 мА)=33 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81C	PMBZ5252B	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.2 мА)=24 В; I_L(V_R=18 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.2 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81C	TMPZ5252	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5.2 мА)=22.8...25.2 В; I_L(V_R=18.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.2 мА)<33 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81C	MMBZ5252B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5.2 мА)=22.8...25.2 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81C	MMBZ5252BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=5.2 мА)=22.8...25.2 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81D	FMMZ5253	ZETEX	dz	V_Z=25 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=35 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81D	PMBZ5253B	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=25 В; I_L(V_R=19 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81D	TMPZ5253	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=23.8...26.3 В; I_L(V_R=19.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<35 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81D	MMBZ5253B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=23.75...26.25 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81D	MMBZ5253BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=23.75...26.25 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81E	FMMZ5254	ZETEX	dz	V_Z=27 В; Z_{ZT}(I_Z=4.6 мА)=41 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81E	PMBZ5254B	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=4.6 мА)=27 В; I_L(V_R=21 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=4.6 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81E	TMPZ5254	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=4.6 мА)=25.7...28.4 В; I_L(V_R=21.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=4.6 мА)<41 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81E	MMBZ5254B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=25.65...28.35 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81E	MMBZ5254BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=25.65...28.35 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81F	FMMZ5255	ZETEX	dz	V_Z=28 В; Z_{ZT}(I_Z=4.5 мА)=44 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81F	PMBZ5255B	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=4.5 мА)=28 В; I_L(V_R=21 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=4.5 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81F	TMPZ5255	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=4.5 мА)=26.6...29.4 В; I_L(V_R=21.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=4.5 мА)<44 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81F	MMBZ5255B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=4.5 мА)=26.6...29.4 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81F	MMBZ5255BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=4.5 мА)=26.6...29.4 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81G	FMMZ5256	ZETEX	dz	V_Z=30 В; Z_{ZT}(I_Z=4.2 мА)=49 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81G	PMBZ5256B	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=4.2 мА)=30 В; I_L(V_R=23 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=4.2 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
81G	TMPZ5256	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=4.2 мА)=28.5...31.5 В; I_L(V_R=23.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=4.2 мА)<49 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81G	MMBZ5256B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=4.2 мА)=28.5...31.5 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81G	MMBZ5256BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=4.2 мА)=28.5...31.5 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81H	FMMZ5257	ZETEX	dz	V_Z=33 В; Z_{ZT}(I_Z=3.8 мА)=58 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81H	PMBZ5257B	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=3.8 мА)=33 В; I_L(V_R=25 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=3.8 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81H	TMPZ5257	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=3.8 мА)=31.4...34.7 В; I_L(V_R=25.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=3.8 мА)<58 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81H	MMBZ5257B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=3.8 мА)=31.35...34.65 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81H	MMBZ5257BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=3.8 мА)=31.35...34.65 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81J	MMBZ5258B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=3.4 мА)=34.2...37.8 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81J	MMBZ5258BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=3.4 мА)=34.2...37.8 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81K	MMBZ5259B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=3.2 мА)=37.05...41.0 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81K	MMBZ5259BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=3.2 мА)=37.05...41.0 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81L	MMBZ5260BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=3 мА)=40.85...45.15 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81M	MMBZ5261B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2.7 мА)=44.65...49.35 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81M	MMBZ5261BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=2.7 мА)=44.65...49.35 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81N	MMBZ5262B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2.5 мА)=48.45...53.55 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81N	MMBZ5262BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=2.5 мА)=48.45...53.55 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81P	MMBZ5263B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2.2 мА)=53.20...58.80 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81P	MMBZ5263BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=2.2 мА)=53.20...58.80 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81Q	MMBZ5264B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2.1 мА)=57.00...63.00 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81Q	MMBZ5264BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=2.1 мА)=57.00...63.00 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81R	MMBZ5265B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=58.90...65.10 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81R	MMBZ5265BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=58.90...65.10 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81S	MMBZ5266B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=1.8 мА)=64.60...71.40 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81S	MMBZ5266BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=1.8 мА)=64.60...71.40 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81T	MMBZ5267B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=1.7 мА)=71.25...78.75 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81T	MMBZ5267BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=1.7 мА)=71.25...78.75 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81U	MMBZ5268BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=1.5 мА)=77.90...86.10 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81V	MMBZ5269BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=1.4 мА)=82.65...91.35 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
81W	MMBZ5270BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=1.4 мА)=86.45...95.55 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
83	BAT68	SIEM	shd	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
83s	BAT68	INF	shd	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
83s	BAT68W	INF	shd×2	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
84	BAT6804	SIEM	shd×2	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
84	DTC114WE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>24; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
84	DTC114WKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>24; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
84	DTC114WUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>24; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
84s	BAT68-04	INF	shd×2	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
84s	BAT68-04W	INF	shd×2	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
85	BAT6805	SIEM	shd×2	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
85A	MMBD1701A	FAIR	dl	V_R<30 В; I_F=50 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; C_D<1 пФ; t_{RR}<1 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
85s	BAT68-05	INF	shd×2	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
85s	BAT68-05W	INF	shd×2	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
86	BAT6806	SIEM	shd×2	V_R<8 В; I_F<130 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.5 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
86	DTC144WE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
86	DTC144WKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
86	DTC144WUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50В; $I_{C(max)}$=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>56; f_T>250МГц; R_1/R_2=47/22кОм	SOT323,SC70	B•E•C
86s	BAT68-06	INF	shd×2	V_R<8В; I_F<130мА; $V_F(I_F$=10мА)<0.5В; I_R<0.1мкА; C_D<1.0пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
86s	BAT68-06W	INF	shd×2	V_R<8В; I_F<130мА; $V_F(I_F$=10мА)<0.5В; I_R<0.1мкА; C_D<1.0пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
87A	MMBD1703A	FAIR	dl×2	V_R<30В; I_F=50мА; $V_F(I_F$=50мА)<1.1В; C_D<1пФ; t_{RR}<1нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
88A	MMBD1704A	FAIR	dl×2	V_R<30В; I_F=50мА; $V_F(I_F$=50мА)<1.1В; C_D<1пФ; t_{RR}<1нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
89A	MMBD1705A	FAIR	dl×2	V_R<30В; I_F=50мА; $V_F(I_F$=50мА)<1.1В; C_D<1пФ; t_{RR}<1нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
8A	2DA1774Q	DIODS	pnp	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=120...270; f_T=140МГц	SOT523	B•E•C
8A	DTC114EET1	MOT	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>30; f_T>250МГц; R_1/R_2=10/10кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8A	MUN2211T1	ON	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>35; 10кОм/10кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8A	MUN5211T1	ON	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>35; 10кОм/10кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8A	MMBZ5226B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=3.13...3.47В; I_R<25мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8A	MMBZ5226BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=3.13...3.47В; I_R<25мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8A2	PZM8.2NB2A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=8.02...8.36В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<10Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
8AA	BC846A	SAMS	npn	V_{CB0}=80В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=110...220; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8AA	BC846A	FAIR	npn	V_{CB0}=80В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=110...220; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8AAx	STM809L	STM	mrc	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8AB	BC846B	SAMS	npn	V_{CB0}=80В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8AB	BC846B	FAIR	npn	V_{CB0}=80В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=200...450; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8ABx	STM809M	STM	mrc	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8AC	BC846C	SAMS	npn	V_{CB0}=80В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8AC	BC846C	FAIR	npn	V_{CB0}=80В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8ACx	STM809T	STM	mrc	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8ADx	STM809S	STM	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8AEx	STM809R	STM	mrc	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8AFx	STM810L	STM	mrc	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8AGx	STM810M	STM	mrc	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8AHx	STM810T	STM	mrc	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8AJx	STM810S	STM	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8AKx	STM810R	STM	mrc	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT23,SOD23	VSS•RST•V_{CC}
8B	2DA1774R	DIODS	pnp	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=180...390; f_T=140МГц	SOT523	B•E•C
8B	DTC124EET1	MOT	Dnpn	V_{CB0}=50В; $I_{C(max)}$=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; f_T>250МГц; R_1/R_2=22/22кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8B	MUN2212T1	ON	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>60; 22кОм/22кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8B	MUN5212T1	ON	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>60; 22кОм/22кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8B	MMBZ5227B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=3.42...3.78В; I_R<15мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8B	MMBZ5227BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=3.42...3.78В; I_R<15мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8BA	BC847A	FAIR	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=110...220; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8BB	BC847B	SAMS	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8BB	BC847B	FAIR	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8BC	BC847C	SAMS	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8BC	BC847C	FAIR	npn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8C	2DA1774S	DIODS	pnp	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=270...560; f_T=140МГц	SOT523	B•E•C
8C	DTC144EET1	MOT	Dnpn	V_{CB0}=50В; $I_{C(max)}$=100; P_D=150мВт; h_{21}>68; f_T>250МГц; R_1/R_2=47/47кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8C	MUN2213T1	ON	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>80; 47кОм/47кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8C	MUN5213T1	ON	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>80; 47кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8C	MMBZ5228B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=3.70...4.10В; I_R<10мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8C	MMBZ5228BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=3.70...4.10В; I_R<10мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8CA	BC848A	SAMS	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=110...220; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8CA	BC848A	FAIR	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=110...220; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8CB	BC848B	SAMS	npn	V_{CB0}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
8CB	BC848B	FAIR	npn	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8CC	BC848C	SAMS	npn	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8CC	BC848C	FAIR	npn	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8D	2DC4617Q	DIODS	npn	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=120...270; f_T=180МГц	SOT523	B•E•C
8D	DTC114YET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>68; f_T>250МГц; R_1/R_2=10/47кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8D	MMBZ5229B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=4.08...4.52В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8D	MMBZ5229BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=4.08...4.52В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8D	MUN2214T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>80; 10кОм/47кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8D	MUN5214T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>80; 10кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8D	TMPZ5229	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=4.08...4.52В; $I_L(V_R$=1.0В)<5.0мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20мА)<22Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8DA	BC849A	SAMS	npn	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=110...220; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8DA	BC849A	FAIR	npn	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=110...220; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8DB	BC849B	FAIR	npn	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=200...450; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8DC	BC849C	FAIR	npn	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=420...800; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8E	2DC4617R	DIODS	npn	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=180...390; f_T=180МГц	SOT523	B•E•C
8E	DTC114TET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>100...600; f_T>250МГц; R_1=10кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8E	MMBZ5230B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=4.46...4.94В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8E	MMBZ5230BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=4.46...4.94В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8E	MUN2215T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>160; R_1 10кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8E	MUN5215T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>160; R_1 10кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8E	FMMTA92R	ZETEX	pnp	V_{CBO}=300В; I_C=200мА; P_D=330мВт; h_{21}>25; f_T>50МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
8EA	BC850A	FAIR	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}=110...220; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8EB	BC850B	FAIR	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=200...450; f_T=300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8EC	BC850C	FAIR	npn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
8F	2DC4617S	DIODS	npn	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=270...560; f_T=180МГц	SOT523	B•E•C
8F	DTC143TET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=100...600; f_T>250МГц; R_1=4.7кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8F	MMBZ5231B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=4.84...5.36В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8F	MMBZ5231BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=4.84...5.36В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8F	MUN2216T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>160; R_1 4.7кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8F	MUN5216T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>160; R_1 4.7кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8G	FMMZ5232	ZETEX	dz	V_Z=5.6В; $Z_{ZT}(I_Z$=20мА)=11Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8G	MMBZ5232B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=5.32...5.88В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8G	MMBZ5232BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=5.32...5.88В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8G	MUN2230T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>3; 1кОм/1кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8G	MUN5230T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>3; 1кОм/1кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8H	DTC123EET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>20; f_T>250МГц; R_1/R_2=2.2/2.2кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8H	FMMZ5233	ZETEX	dz	V_Z=6В; $Z_{ZT}(I_Z$=20мА)=7Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8H	MMBZ5233B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=5.70...6.30В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8H	MMBZ5233BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=5.70...6.30В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8H	MUN2231T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>8; 2.2кОм/2.2кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8H	MUN5231T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>8; 2.2кОм/2.2кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8J	DTC143EET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>20; f_T>250МГц; R_1/R_2=4.7/4.7кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8J	FMMZ5234	ZETEX	dz	V_Z=6.2В; $Z_{ZT}(I_Z$=20мА)=7Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8J	MMBZ5234B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=5.89...6.51В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8J	MMBZ5234BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=5.89...6.51В; I_R<5мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8J	MUN2232T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=230мВт; h_{21}>15; 4.7кОм/4.7кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8J	MUN5232T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>15; 4.7кОм/4.7кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8K	DTC143ZET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>80; f_T>250МГц; R_1/R_2=4.7/47кОм	SOT416,SC75A	B•E•C

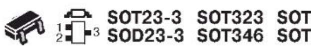
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
8K	FMMZ5235	ZETEX	dz	V_Z=6.8 В; $Z_{ZT}(I_Z$=20 мА)=5 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8K	MMBZ5235B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=6.46...7.14 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8K	MMBZ5235BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=6.46...7.14 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8K	MUN2233T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=230 мВт; h_{21}>80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8K	MUN5233T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8L	DTC124XET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8L	FMMZ5236	ZETEX	dz	V_Z=7.5 В; $Z_{ZT}(I_Z$=20 мА)=6 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8L	MMBZ5236B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=7.12...7.88 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8L	MMBZ5236BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=7.12...7.88 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8L	MUN2234T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=230 мВт; h_{21}>80; 22 кОм/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8L	MUN5234T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 22 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8M	DTC123JET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8M	FMMZ5237	ZETEX	dz	V_Z=8.2 В; $Z_{ZT}(I_Z$=20 мА)=8 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8M	MMBZ5237B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=7.79...8.61 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8M	MMBZ5237BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=7.79...8.61 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8M	MUN5235T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8N	DTC115EET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_1/R_2=100/100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8N	FMMZ5238	ZETEX	dz	V_Z=8.7 В; $Z_{ZT}(I_Z$=20 мА)=8 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8N	MMBZ5238B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.26...9.14 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8N	MMBZ5238BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.26...9.14 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8N	MUN2236T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=230 мВт; h_{21}>80; 100 кОм/100 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8N	MUN5236T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 100 кОм/100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8P	DTC144WET1	MOT	Dnpn	V_{CBO}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
8P	FMMZ5239	ZETEX	dz	V_Z=9.1 В; $Z_{ZT}(I_Z$=20 мА)=10 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8P	MMBZ5239B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.65...9.56 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8P	MMBZ5239BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.65...9.56 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8P	MUN2237T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=230 мВт; h_{21}>80; 41 кОм/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8P	MUN5237T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
8Q	FMMZ5240	ZETEX	dz	V_Z=10 В; $Z_{ZT}(I_Z$=20 мА)=17 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Q	MMBZ5240B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=9.5...10.5 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Q	MMBZ5240BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=9.5...10.5 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8R	FMMZ5241	ZETEX	dz	V_Z=11 В; $Z_{ZT}(I_Z$=20 мА)=22 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8R	MMBZ5241B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=10.4...11.55 В; I_R<2 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8R	MMBZ5241BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=10.4...11.55 В; I_R<2 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8S	FMMZ5242	ZETEX	dz	V_Z=12 В; $Z_{ZT}(I_Z$=20 мА)=30 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8S	MMBZ5242B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=11.4...12.6 В; I_R<1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8S	MMBZ5242BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=11.4...12.6 В; I_R<1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8T	FMMZ5243	ZETEX	dz	V_Z=13 В; $Z_{ZT}(I_Z$=9.5 мА)=13 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8T	MMBZ5243B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=9.5 мА)=12.35...13.65 В; I_R<0.5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8T	MMBZ5243BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=9.5 мА)=12.35...13.65 В; I_R<0.5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8T	MUN2240T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=230 мВт; h_{21}>160; R_1 47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8U	FMMZ5244	ZETEX	dz	V_Z=14 В; $Z_{ZT}(I_Z$=9 мА)=15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8U	MMBZ5244B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=8.5 мА)=13.30...14.70 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8U	MMBZ5244BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=8.5 мА)=13.30...14.70 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8U	MUN2241T1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=230 мВт; h_{21}>160; R_1 100 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
8V	FMMZ5245	ZETEX	dz	V_Z=15 В; $Z_{ZT}(I_Z$=8.5 мА)=16 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8V	MMBZ5245B	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=8.5 мА)=14.25...15.75 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8V	MMBZ5245BLT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=8.5 мА)=14.25...15.75 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8V2	PZM8.2NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=7.76...8.64 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K





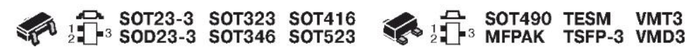
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
8W	FMMZ5246	ZETEX	dz	V_Z=16 В; Z_{ZT}(I_Z=7.8 мА)=17 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8W	MMBZ5246B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=7.8 мА)=15.2...16.8 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8W	MMBZ5246BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=7.8 мА)=15.2...16.8 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8X	FMMZ5247	ZETEX	dz	V_Z=17 В; Z_{ZT}(I_Z=7.4 мА)=19 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8X	MMBZ5247B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=7.0 мА)=16.15...17.85 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8X	MMBZ5247BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=7.0 мА)=16.15...17.85 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Y	FMMZ5248	ZETEX	dz	V_Z=18 В; Z_{ZT}(I_Z=7 мА)=21 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Y	MMBZ5248B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=7.0 мА)=17.1...18.9 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Y	MMBZ5248BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=7.0 мА)=17.1...18.9 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Z	FMMZ5249	ZETEX	dz	V_Z=19 В; Z_{ZT}(I_Z=6.6 мА)=23 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Z	MMBZ5249B	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=6.2 мА)=18.05...19.95 В; I_R<01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Z	MMBZ5249BLT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=6.2 мА)=18.05...19.95 В; I_R<01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
8Z	TMPZ5249	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=6.6 мА)=18.1...20.0 В; I_L(V_R=14.0 В)<0.1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=6.6 мА)<23 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
9.1X	02CZ9.1	TOSH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.50...9.60 В; I_L(V_R=7.0 В)<0.5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5 мА)<120 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
91A	FMMT591A	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}=300...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
93	DTA143TE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
93	DTA143TKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
93	DTA143TUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
94	DTA114TE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
94	DTA114TKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
94	DTA114TUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
94	DTC114TET1	MOT	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>100...600; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
95	DTA124TE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
95	DTA124TH	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
95	DTA124TKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
95	DTA124TUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
96	DTA144TCA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
96	DTA144TE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
96	DTA144TKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
96	DTA144TUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
99	DTA115TE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
99	DTA115TKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=100 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
99	DTA115TUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
9A	DTA125TKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=200 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
9A	DTA125TU	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц; R_1=200 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
9A	FMMT2369AR	ZETEX	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120	SOT23,SOD23	B•E•C
9A1	MMBZ9V1AL	ON	dz×2	V_Z(I_{ZT}=1 мА)=8.65...9.56 В; V_F(I_F=10 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
9A1	PZM9.1NB2A	PHIL	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.85...9.23 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
9AA	BC856A	SAMS	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9AB	BC856B	SAMS	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9AC	BC856C	SAMS	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9BA	BC857A	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9BB	BC857B	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9BC	BC857C	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
9CA	BC858A	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9CB	BC858B	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9CC	BC858C	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9DA	BC859A	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9DB	BC859B	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9DC	BC859C	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9EA	BC860A	SAMS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9EB	BC860B	SAMS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9EC	BC860C	SAMS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9FA	BC807-16	SAMS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9FB	BC80725	SAMS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9FC	BC807-40	SAMS	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9GA	BC808-16	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9GB	BC808-25	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9GC	BC808-40	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9P	BCX70HR	ZETEX	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
9R	FMMT2369R	ZETEX	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120	SOT23,SOD23	B•E•C
9V1	PZM9.1NB	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.56...9.55 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT346,SC59	A•n.c.•K
A	IRLML2402	IR	nMOS	HEXFET; V_{DS}=20 В; I_D=0.9 А; P_D=540 мВт; $R_{DS(on)}$<0.35 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
A	MRF947T1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=188 мВт; h_{21}>50; f_T=8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
A0	HSMS2800	HP	shd	V_{BR}>70 В; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R(V_R=50 В)<200 нА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A0	HSMS280B	HP	shd	V_{BR}>70 В; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R(V_R=50 В)<200 нА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
A03	SST203	CALOG	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=4...20 мА; g_F=1.5 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
A1	BAW56	ALLEG	d×2	I_F<70 мА; V_{BR}>70 В; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; I_R<2500 нА; t_{RR}<6.0 нс; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A1	BAW56	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A1	BAW56	ZETEX	di×2	V_R<70 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.1 В; I_R<2.5 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A1	BAW56	FAIR	di×2	V_R<85 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=50 мА)<1 В; I_R<2.5 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A1	BAW56W	PHIL	di×2	V_R<75 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A2,A1
A1	BAW56WT1	ON	di×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
A1	HSMS2801	HP	shd	V_{BR}>70 В; V_F(I_F=15 мА)<1.0 В; I_R(V_R=50 В)<200 нА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
A11	MMBD1501A	NS	dl	V_R<180 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A11	MMBD1501A	FAIR	dl	V_R<200 В; I_F=200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A13	MMBD1503A	NS	dl×2	V_R<180 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A13	MMBD1503A	FAIR	dl×2	V_R<200 В; I_F=200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A14	MMBD1504A	NS	dl×2	V_R<180 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A14	MMBD1504A	FAIR	dl×2	V_R<200 В; I_F=200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A15	MMBD1505A	NS	dl×2	V_R<180 В; I_F<600 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A15	MMBD1505A	FAIR	dl×2	V_R<200 В; I_F=200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.1 В; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A16	ZC934A	ZETEX	var	V_R<12 В; C_D(V_R=2.5 В)=47.25...57.75 пФ; $C_{1В}/C_{4В}$<3.8; Q>80	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A17	ZC933A	ZETEX	var	V_R<12 В; C_D(V_R=2.5 В)=20.25...24.75 пФ; $C_{1В}/C_D$(4 В)<3.5; Q>150	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A1s	BAW56	INF	di×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A1s	BAW56T	INF	di×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	K1•K2•A1,A2
A1s	BAW56W	INF	di×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
A1t	BAW56T	PHIL	di×2	V_R<75 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	K1•K2•A1,A2
A1X	MBAW56	MOT	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A2	BAS16T	DIODS	di	V_R<85 В; I_F<155 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT523	A•n.c.•K
A2	BAT18	SIEM	cpin	V_R<35 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.02 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A2	BAT18	PHIL	dtv	V_R<35 В; I_F<100 мА; R_D<0.7 Ом; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A2	FMMD2836	ZETEX	fid×2	V_R<75 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
A2	HSMS2802	HP	shd×2	V_{BR} > 70 В; $V_F(I_F$ = 15 мА) < 1.0 В; $I_R(V_R$ = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A2	HSMS280C	HP	shd×2	V_{BR} > 70 В; $V_F(I_F$ = 15 мА) < 1.0 В; $I_R(V_R$ = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
A2	MMBD4148	VISH	di	V_R < 75 В; I_F < 300 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 1.0 В; I_R < 5.0 мкА; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A2s	BAT18	INF	cpin	V_R < 35 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.02 мкА; C_D < 1.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A2X	MMBD2836LT1	MOT	di×2	V_R < 75 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1 В; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A3	1PS300	PHIL	fd×2	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1.0 В; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
A3	1SS181	TOSH	di×2	V_R < 80 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.5 мкА; t_{RR} < 4 нс	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
A3	1SS300	TOSH	di×2	V_R < 80 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.2 В; t_{RR} < 4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
A3	1SS360	TOSH	di×2	V_R < 80 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.5 мкА; t_{RR} < 4 нс	SOT416,SC75A	K1•K2•A1,A2
A3	1SS360F	TOSH	di×2	V_R < 80 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.5 мкА; t_{RR} < 4 нс	SOT490,SC89	K1•K2•A1,A2
A3	HSMS2803	HP	shd×2	V_{BR} > 70 В; $V_F(I_F$ = 15 мА) < 1.0 В; $I_R(V_R$ = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A3	HSMS280E	HP	shd×2	V_{BR} > 70 В; $V_F(I_F$ = 15 мА) < 1.0 В; $I_R(V_R$ = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
A3	KDS120	KEC	di×2	V_R = 80 В; I_F = 100 мА; I_R = 0.5 мкА; C_T = 2.2 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
A3	MMBD1005LT1	MOT	di×2	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.95 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A3	MMBD4448	VISH	fid	V_R < 75 В; I_F < 500 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 5.0 мкА; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A3p	BAT17	PHIL	shd	V_R < 4 В; I_F < 30 мА; $V_F(I_F$ = 1 мА) < 450 мВ; C_D < 1 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A3p	BAT17	PHIL	shd	V_R < 4 В; I_F < 30 мА; $V_F(I_F$ = 1 мА) < 450 мВ; C_D < 1 пФ	SOT23,SOD23	A1•n.c.•K
A3t	BAT17	PHIL	shd	V_R < 4 В; I_F < 30 мА; $V_F(I_F$ = 1 мА) < 450 мВ; C_D < 1 пФ	SOT23,SOD23	A1•n.c.•K
A3X	MMBD2835LT1	MOT	di×2	V_R < 35 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1 В; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A4	BAV70	ALLEG	di×2	I_F < 100 мА; V_{BR} > 70 В; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.86 В; I_R < 5000 нА; t_{RR} < 6.0 нс; C_D < 1.5 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	VISH	di×2	V_R < 70 В; I_F < 300 мА; $V_F(I_F$ = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 5.0 мкА; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	ZETEX	di×2	V_R < 70 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1.1 В; I_R < 5.0 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	MCC	di×2	V_R < 75 В; I_F < 150 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.855 В; C_D < 2 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	Nat	di×2	V_R < 70 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.855 В; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	ZOWIE	di×2	V_R < 70 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.855 В; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	PANJIT	di×2	V_R < 75 В; I_F < 150 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 1 В; C_D = 4 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70TT1	ON	di×2	V_R < 70 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1 В; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70W	PHIL	di×2	V_R < 70 В; I_F < 175 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1.0 В; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
A4	HSMS2804	HP	shd×2	V_{BR} > 70 В; $V_F(I_F$ = 15 мА) < 1.0 В; $I_R(V_R$ = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	HSMS280F	HP	shd×2	V_{BR} > 70 В; $V_F(I_F$ = 15 мА) < 1.0 В; $I_R(V_R$ = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
A4p	BAV70	PHIL	di×2	V_R < 70 В; I_F < 215 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1.0 В; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4s	BAV70	INF	di×2	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1 В; $I_R(V_R$ = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4s	BAV70F	INF	di×2	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1 В; $I_R(V_R$ = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	TSFP-3,VESM	A1•A2•K1,K2
A4s	BAV70T	INF	di×2	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1 В; $I_R(V_R$ = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
A4s	BAV70W	INF	di×2	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1 В; $I_R(V_R$ = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
A4X	MBAV70	MOT	di×2	V_R < 70 В; I_F < 300 мА; $V_F(I_F$ = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 5.0 мкА; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A5	FMMD2837	ZETEX	fid×2	V_R < 35 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 4.0 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A5	MMBD2837LT1	MOT	di×2	V_R < 30 В; I_F < 150 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1 В; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A5p	BRY61	PHIL	pnpn	V_{GA} = 70 В; I_A = 175 мА; P_D = 250 мВт; t_R < 80 нс	SOT23,SOD23	A•K•G
A5t	BRY61	PHIL	pnpn	V_{GA} = 70 В; I_A = 175 мА; P_D = 250 мВт; t_R < 80 нс	SOT23,SOD23	A•K•G
A6	BAS16	ALLEG	di	I_F < 600 мА; V_{BR} > 75 В; $V_F(I_F$ = 1 мА) < 0.72 В; I_R < 1000 нА; t_{RR} < 6.0 нс; C_D < 2.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A6	BAS16	FAIR	di	V_R < 85 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A6	BAS16	DIOT	di	V_R < 85 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A6	BAS16	ZETEX	di	V_R < 75 В; I_F < 250 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) < 1.0 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

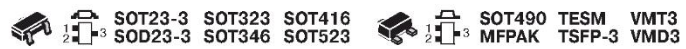
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
A6	BAS16	VISH	fid	V_R<75 В; I_F<500 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<1.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A6	BAS16	PANJIT	di	V_R<75 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.855 В; I_R<1 мкА; C_D<2 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A6	BAS16T	PHIL	di	V_R<75 В; I_F<155 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<50 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	A•n.c.•K
A6	BAS16TT1	ON	di	V_R<75 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<1 мкА; t_{RR}<6 нс	SOT416,SC75A	A•n.c.•K
A6	BAS16W	PANJIT	di	V_R<75 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.855 В; I_R<1 мкА; C_D<2 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
A6	BAS16W	PHIL	di	V_R<75 В; I_F<175 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.0 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
A6A	MMUN2111LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>35; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6B	MMUN2112LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6C	MMUN2113LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6D	MMUN2114LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 100 кОм/100 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6E	MMUN2115LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>160; R_1 10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6F	MMUN2116LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>160; R_1 4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6G	MMUN2130LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>3; 1 кОм/1 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6H	MMUN2131LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6J	MMUN2132LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6K	MMUN2133LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6L	MMUN2134LT1	ON	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=246 мВт; h_{21}>80; 22 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A6p	BAS16	PHIL	fd	V_R<75 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.0 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A6s	BAS16	SIEM	di	V_R<75 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.0 В; I_R<1.0 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A6s	BAS16	INF	di	V_R<80 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<50 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A6s	BAS16W	INF	di	V_R<80 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<50 мкА	SOT323,SC70	A•n.c.•K
A7	BAV99	ALLEG	di×2	I_F<70 мА; V_{BR}>70 В; $V_F(I_F$=50 мА)<1.1 В; I_R<2500 нА; t_{RR}<6.0 нс; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99	ZETEX	di×2	V_R<70 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.1 В; I_R<2.5 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99	DIOT	di×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99	ZOWIE	di×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99	MCC	di×2	V_R<75 В; I_F<150 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<2.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99	Nat	di×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99	JGD	di×2	V_R<75 В; I_F<300 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99W	DIOT	di×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•K1,A2•K2
A7	BAV99W	PHIL	fd×2	V_R<75 В; I_F<150 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.0 В; C_D<1.S5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
A7	BAV99WT1	ON	di×2	V_R<70 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•K1,A2•K2
A7	DAN217U	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; P_D<200 мВт; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
A7p	BAV99	PHIL	di×2	V_R<75 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.0 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7s	BAV99	INF	di×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.15 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A7s	BAV99F	INF	di×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.15 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	TSFP-3,VESM	A1•K2•K1,A2
A7s	BAV99T	INF	di×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.15 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	A1•K2•K1,A2
A7s	BAV99W	INF	di×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.15 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
A8	BAS19	ALLEG	d	I_F<200 мА; V_{BR}>100 В; $V_F(I_F$=200 мА)<1.25 В; I_R<100 нА; t_{RR}<50 нс; C_D<5.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A8	BAS19	PANJIT	di	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A8	BAS19	JGD	di	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A8	BAS19	VISH	di	V_R<100 В; I_F<400 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.25 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
A8	BAS19	ZETEX	di	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A8	BAS19W	PANJIT	di	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
A8	SI2308DS	VISH	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=1.6 А; P_D=800 мВт; $R_{DS(on)}$<0.22 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
A80	BAS20	PANJIT	di	V_R<150 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A80	BAS20W	PANJIT	di	V_R<150 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
A81	BAS20	JGD	di	V_R<150 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A81	BAS20	VISH	di	V_R<150 В; I_F<400 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.25 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A81	BAS20	ZETEX	di	V_R<150 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A82	BAS21	ALLEG	di	I_F<200 мА; V_{BR}>200 В; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<100 нА; t_{RR}<50 нс; C_D<5.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A82	BAS21	PANJIT	di	V_R<200 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A82	BAS21	VISH	di	V_R<200 В; I_F<400 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.25 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A82	BAS21	ZETEX	di	V_R<200 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A82	BAS21W	PANJIT	di	V_R<200 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
A82	CMPD2003	CSI	di	I_F<250 мА; V_R=200 В; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<100 нА; t_{RR}<50 нс; C_T<5.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A8A	MMUN2211LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>35; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8B	MMUN2212LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8C	MMUN2213LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8D	MMUN2214LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 100 кОм/100 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8E	MMUN2215LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>160; R_1 10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8F	MMUN2216LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>160; R_1 4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8G	MMUN2230LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>3; 1 кОм/1 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8H	MMUN2231LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8J	MMUN2232LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8K	MMUN2233LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8L	MMUN2234LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; 22 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8R	MMUN2238LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>160; R_1 2.2 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A8U	MMUN2241LT1	ON	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>160; R_1 100 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
A9	1SS294	TOSH	shd	V_R>40 В; $V_F(I_F$=100 мА)<0.6 В; $I_R(V_R$=40 В)<5 мкА; C_T<25 пФ	SOT346,SC59	A•n.c.•K
A9	1SS322	TOSH	shd	V_R<40 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.6 В; C_D=18 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
A9	FMMD2835	ZETEX	fid×2	V_R<35 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A9	SI2309DS	VISH	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=0.85 А; P_D=800 мВт; $R_{DS(on)}$<0.55 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
A91	BAS17	PHIL	dz	V_R<5 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.96 В; I_R<5 мкА; C_D<140 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
AA	BCW60A	ALLEG	npn	V_{CBO}=32 В; I_{CBO}<20 нА; h_{21}=120...220; $V_{CE(sat)}$<0.35 В; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AA	BCW60A	CDIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AA	BCW60A	SAMS	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...220; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AA	BCW60A	ZETEX	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AAA	MAX6806XR46	MAX	vd	V_{TR}=4.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT323,SC70	RST•GND•V_{CC}
AAA	MMBF4856LT1	MOT	nFET	V_{DG}=40 В; I_{DSS}=50 мА; P_D=225 мВт	SOT23,SOD23	D•S•G
AAAA	MAX809LUR	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
AAB	MAX6806XR26	MAX	vd	V_{TR}=2.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT323,SC70	RST•GND•V_{CC}
AAC	MAX6806XR23	MAX	vd	V_{TR}=2.3 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT323,SC70	RST•GND•V_{CC}
AAD	CMPD4448	CSI	dih	I_F=250 мА; V_R=75 В; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<25 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_T<4.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
AAD	MAX6807XR46	MAX	vd	V_{TR}=4.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT323,SC70	RST•GND•V_{CC}
AAD	TMPD4448	ALLEG	d	I_F<600 мА; V_{BR}>100 В; $V_F(I_F=100\ мА)$<1.0 В; I_R<25 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_D<4.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
AAE	MAX6807XR26	MAX	vd	V_{TR}=2.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT323,SC70	RST•GND•V_{CC}
AAF	MAX6808XR46	MAX	vd	V_{TR}=4.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT323,SC70	RST•GND•V_{CC}
AAG	MAX6808XR26	MAX	vd	V_{TR}=2.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT323,SC70	RST•GND•V_{CC}
AAG	MMBR951ALT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=100 мА; P_D=322 мВт; h_{21}=75...150; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AAH	MAX6326XR22	MAX	mrc	V_{TR}=2.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAI	MAX6327XR22	MAX	mrc	V_{TR}=2.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAJ	MAX6328XR22	MAX	mrc	V_{TR}=2.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAN	MAX809LXR	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAO	MAX809MXR	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAp	BCW60A	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AAP	MAX809TXR	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAQ	2SD1757KQ	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AAQ	MAX809SXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAR	2SD1757KR	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AAR	MAX809RXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAR	TMPD4153	ALLEG	d	I_F<600 мА; V_{BR}>75 В; $V_F(I_F=1\ мА)$<0.67 В; I_R<50 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_D<4.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
AAS	2SD1757KS	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AAs	BCW60A	SIEM	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AAS	MAX809ZXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAT	MAX810LXR	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAU	MAX810MXR	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAV	MAX810TXR	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAW	MAX810RXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAX	MAX810SXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAY	MAX810ZXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AAZ	MAX803LXR	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AB	BCW60B	ALLEG	npn	V_{CBO}=32 В; I_{CBO}<20 нА; h_{21}=180...310; $V_{CE(sat)}$<0.35 В; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AB	BCW60B	CDIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...320; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AB	BCW60B	SAMS	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=180...310; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AB	BCW60B	ZETEX	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ABA	CMPD4150	CSI	dih	I_F=250 мА; V_R=50 В; $V_F(I_F=100\ мА)$=0.82...0.92 В; I_R<100 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_T<4.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ABA	MAX803MXR	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ABA	TMPD4150	ALLEG	d	I_F<600 мА; V_{BR}>75 В; $V_F(I_F=1\ мА)$<0.62 В; I_R<100 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_D<2.5 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ABAA	MAX809MUR	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
ABB	MAX803TXR	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ABC	MAX803SXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ABC	TMPD4154	ALLEG	d	I_F<600 мА; V_{BR}>35 В; $V_F(I_F=30\ мА)$<1.0 В; I_R<100 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_D<4.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ABD	MAX803RXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ABE	MAX803ZXR	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ABF	LM4041AIX3-1.2	MAX	vref	V_{OUT}=1.225 В; ACC=0.1 %	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABG	LM4041BIX3-1.2	MAX	vref	V_{OUT}=1.225 В; ACC=0.2 %	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABH	LM4041CIX3-1.2	MAX	vref	V_{OUT}=1.225 В; ACC=0.5 %	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABI	LM4041DIX3-1.2	MAX	vref	V_{OUT}=1.225 В; ACC=1.0 %	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABJ	LM4040AIX3-2.1	MAX	vref	V_{OUT}=2.048 В; ACC=0.1 %	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABK	LM4040BIX3-2.1	MAX	vref	V_{OUT}=2.048 В; ACC=0.2 %	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABL	LM4040CIX3-2.1	MAX	vref	V_{OUT}=2.048 В; ACC=0.5 %	SOT323,SC70	+•-•n.c.



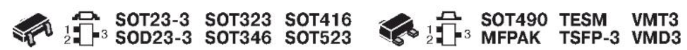


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
ABM	LM4040DIX3-2.1	MAX	vref	V_{OUT}=2.048 В; ACC=1.0%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABN	LM4040AIX3-2.5	MAX	vref	V_{OUT}=2.500 В; ACC=0.1%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABO	LM4040BIX3-2.5	MAX	vref	V_{OUT}=2.500 В; ACC=0.2%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABp	BCW60B	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...320; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ABP	LM4040CIX3-2.5	MAX	vref	V_{OUT}=2.500 В; ACC=0.5%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABQ	LM4040DIX3-2.5	MAX	vref	V_{OUT}=2.500 В; ACC=1.0%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABR	LM4040AIX3-3.0	MAX	vref	V_{OUT}=3.000 В; ACC=0.1%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABs	BCW60B	SIEM	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ABS	LM4040BIX3-3.0	MAX	vref	V_{OUT}=3.000 В; ACC=0.2%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABt	BCW60B	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...320; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ABT	LM4040CIX3-3.0	MAX	vref	V_{OUT}=3.000 В; ACC=0.5%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABU	LM4040DIX3-3.0	MAX	vref	V_{OUT}=3.000 В; ACC=1.0%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABV	LM4040AIX3-4.1	MAX	vref	V_{OUT}=4.096 В; ACC=0.1%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABW	LM4040BIX3-4.1	MAX	vref	V_{OUT}=4.096 В; ACC=0.2%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABX	LM4040CIX3-4.1	MAX	vref	V_{OUT}=4.096 В; ACC=0.5%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABY	LM4040DIX3-4.1	MAX	vref	V_{OUT}=4.096 В; ACC=1.0%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ABZ	LM4040AIX3-5.0	MAX	vref	V_{OUT}=5.000 В; ACC=0.1%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
AC	2SD1101	REN	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=700 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240	SOT23,SOD23	B•E•C
AC	BCW60C	ALLEG	npn	V_{CBO}=32 В; I_{CBO}<20 нА; h_{21}=250...460; $V_{CE(sat)}$<0.35 В; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AC	BCW60C	CDIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AC	BCW60C	SAMS	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=250...460; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AC	BCW60C	ZETEX	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ACA	LM4040BIX3-5.0	MAX	vref	V_{OUT}=5.000 В; ACC=0.2%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ACAA	MAX809TUR	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
ACB	LM4040CIX3-5.0	MAX	vref	V_{OUT}=5.000 В; ACC=0.5%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ACC	LM4040DIX3-5.0	MAX	vref	V_{OUT}=5.000 В; ACC=1.0%	SOT323,SC70	+•-•n.c.
ACD	MAX6808XR32	MAX	vd	V_{TR}=3.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT323,SC70	RST•GND•V_{CC}
ACE	MAX6326XR31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACF	MAX6347XR46	MAX	mrc	V_{TR}=4.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACH	MAX6326XR23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACI	MAX6326XR26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACJ	MAX6328XR26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACK	MAX6346XR44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACL	2SC3837KL	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=27...56; f_T=1500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ACL	MAX6347XR44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACM	2SC3837KM	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T=1500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ACM	MAX6348XR44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACN	2SC3837KN	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T=1500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ACN	2SC4725N	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T=1500 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
ACN	2SC5661N	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T=1500 МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
ACN	MAX6348XR46	MAX	mrc	V_{TR}=4.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACO	MAX6346XR46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACP	2SC3837KP	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T=1500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ACP	2SC4725P	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T=1500 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
ACP	2SC5661P	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T=1500 МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
ACp	BCW60C	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ACP	MAX6326XR29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACQ	2SC3837KQ	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T=1500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ACQ	MAX6327XR23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACQ	MAX6377XR24	MAX	vd	V_{TR}=2.40 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ACR	MAX6327XR26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACs	BCW60C	SIEM	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
ACS	MAX6327XR29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACt	BCW60C	PHIL	npn	V_{CBO}=32В; I_C=200мА; P_D=250мВт; h_{21}=250...460; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ACT	MAX6327XR31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACU	MAX6328XR23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACV	MAX6328XR29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACW	MAX6328XR31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ACZ	MAX6375XR26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
AD	BCW60D	ALLEG	npn	V_{CBO}=32В; I_{CBO}<20нА; h_{21}=380...630; $V_{CE(sat)}$<0.35В; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AD	BCW60D	CDIL	npn	V_{CBO}=32В; I_C=100мА; P_D=350мВт; h_{21}=380...630; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AD	BCW60D	SAMS	npn	V_{CBO}=32В; I_C=100мА; P_D=350мВт; h_{21}=380...630; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AD	BCW60D	ZETEX	npn	V_{CBO}=32В; I_C=200мА; P_D=330мВт; h_{21}=380...630; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ADA	MAX6376XR29	MAX	vd	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADAA	MAX809SUR	MAX	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<100мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
ADB	MAX6377XR23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADC	MAX6377XR29	MAX	vd	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADD	MAX6378XR46	MAX	vd	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADE	MAX6379XR44	MAX	vd	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADF	MAX6380XR46	MAX	vd	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADH	MAX6375XR22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADI	MAX6375XR23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADJ	MAX6375XR29	MAX	vd	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADK	MAX6375XR31	MAX	vd	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADL	2SC3838KL	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=27...56; f_T=3200МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ADL	MAX6376XR22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADM	2SC3838KM	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=39...82; f_T=3200МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ADM	MAX6376XR23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADN	2SC3838KN	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=56...120; f_T=3200МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ADN	2SC4726N	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=56...120; f_T=3200МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
ADN	2SC5662N	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=56...120; f_T=3200МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
ADN	MAX6376XR26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADO	MAX6376XR31	MAX	vd	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADP	2SC3838KP	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=82...180; f_T=3200МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ADP	2SC4726P	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=82...180; f_T=3200МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
ADP	2SC5662P	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=82...180; f_T=3200МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
ADp	BCW60D	PHIL	npn	V_{CBO}=32В; I_C=200мА; P_D=250мВт; h_{21}=380...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ADP	MAX6377XR22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADQ	2SC3838KQ	ROHM	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=120...270; f_T=3200МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ADQ	MAX6377XR26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADR	MAX6377XR31	MAX	vd	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADs	BCW60D	SIEM	npn	V_{CBO}=32В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=380...630; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ADS	MAX6378XR44	MAX	vd	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADt	BCW60D	PHIL	npn	V_{CBO}=32В; I_C=200мА; P_D=250мВт; h_{21}=380...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ADT	MAX6379XR46	MAX	vd	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADU	MAX6380XR44	MAX	vd	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADW	MAX6380XR42	MAX	vd	V_{TR}=4.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADX	MAX6375XR28	MAX	vd	V_{TR}=2.80В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT323,SC70	GND•OUT•V_{CC}
ADY	MAX6381XR16D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.58В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<13мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
ADZ	MAX6382XR26D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<13мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AEA	MAX6383XR17D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.67В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<13мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AEB	MAX6381XR46D2	MAX	mrc	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<13мкА	SOT323,SC70	GND•RST•V_{CC}
AEL	2SC3839KL	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=27...56; f_T>200МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AEM	2SC3839KM	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=39...82; f_T>200МГц	SOT346,SC59	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
AEN	2SC3839KN	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AEP	2SC3839KP	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AEQ	2SC3839KQ	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AFAA	MAX809RUR	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
AFP	2SD1781KP	ROHM	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AFQ	2SD1781KQ	ROHM	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AFR	2SD1781KR	ROHM	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AFs	BCW60FF	SIEM	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AG	BCX70G	ALLEG	npn	V_{CB0}=45 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=120...220; $V_{CE(sat)}$<0.35 В; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AG	BCX70G	CDIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AG	BCX70G	SAMS	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...220; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AG	BCX70G	ZETEX	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AG	BRA144ECM	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>70; 47 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
AG	BRA144EMP	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>70; 47 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
AGAA	MAX810LUR	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
AGp	BCX70G	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AGs	BCX70G	SIEM	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AGt	BCX70G	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AH	1SS345	SANYO	shd	V_R>55 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.35 В; $I_R(V_R$=40 В)<50 мкА; C_T<120 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c•K
AH	BCX70H	ALLEG	npn	V_{CB0}=45 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=180...310; $V_{CE(sat)}$<0.35 В; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AH	BCX70H	CDIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AH	BCX70H	SAMS	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=180...310; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AH	BCX70H	ZETEX	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AHAA	MAX810MUR	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
AHP	2SB1197KP	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AHp	BCX70H	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AHQ	2SB1197KQ	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AHR	2SB1197KR	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AHs	BCX70H	SIEM	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AHt	BCX70H	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AJ	BCX70J	ALLEG	npn	V_{CB0}=45 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=250...460; $V_{CE(sat)}$<0.35 В; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AJ	BCX70J	CDIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AJ	BCX70J	SAMS	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=250...460; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AJ	BCX70J	ZETEX	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AJAA	MAX810TUR	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
AJP	2SD1782KP	ROHM	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AJp	BCX70J	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...310; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AJQ	2SD1782KQ	ROHM	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AJR	2SD1782KR	ROHM	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AJs	BCX70J	SIEM	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AJt	BCX70J	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...310; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AK	BCX70K	ALLEG	npn	V_{CB0}=45 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=380...630; $V_{CE(sat)}$<0.35 В; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AK	BCX70K	CDIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=380...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AK	BCX70K	SAMS	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=380...630; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AK	BCX70K	ZETEX	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AKAA	MAX810SUR	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
AKP	2SB1198KP	ROHM	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AKp	BCX70K	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=380...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AKQ	2SB1198KQ	ROHM	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AKR	2SB1198KR	ROHM	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AKs	BCX70K	SIEM	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ALAA	MAX810RUR	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
ALM	2SC3802KM	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=39...82; f_T>110 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ALN	2SC3802KN	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>110 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ALP	2SC3802KP	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>110 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ALQ	2SC3802KQ	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>110 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AM	BSS64	MOT	npn	V_{CBO}=120 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=20...80; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AM	MMBT3904WT1	MOT	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
AMN	2SC4018KN	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>230 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AMP	2SC4018KP	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>230 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AMp	BSS64	PHIL	npn	V_{CBO}=120 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>20; f_T>60	SOT23,SOD23	B•E•C
AMs	BSS64	SIEM	npn	V_{CBO}=120 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=20...80; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AMt	BSS64	PHIL	npn	V_{CBO}=120 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>20; f_T>60	SOT23,SOD23	B•E•C
AN	2SC2413KN	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T=300 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AN	2SC2532	TOSH	npn	V_{CEO}=40 В; I_C=300 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>5000	SOT346,SC59	B•E•C
AN	2SC4098N	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T=300 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
AN	2SC4618N	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T>300 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
AN	2SC5659N	ROHM	npn	V_{CEO}=25 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=56...120; f_T>150 МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
AN	2SK3287	REN	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=300 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<3.44 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
AN	2SK3289	REN	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=300 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<3.44 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
ANM	2SC4061KM	ROHM	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=39...82; f_T>100 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ANN	2SC4061KN	ROHM	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>100 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ANP	2SC4061KP	ROHM	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>100 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ANs	BCW60FN	SIEM	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AO	BCW60AR	ITT	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
AP	2SC2413KP	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T=300 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AP	2SC4098P	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T=300 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
AP	2SC4618P	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T>300 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
AP	2SC5659P	ROHM	npn	V_{CEO}=25 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=82...180; f_T>150 МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
AP	2SJ575	REN	pMOS	V_{DS}=30 В; I_D=100 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<7.9 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
AP	2SJ576	REN	pMOS	V_{DS}=30 В; I_D=100 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<7.9 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
AP	BCW60BR	ITT	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
AP_	2SC4074K	ROHM	npn	V_{CBO}=18 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=270; f_T>1500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AQ	2SC2413KQ	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T=300 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AQ	2SC4098Q	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T=300 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
AQ	2SC4618Q	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T>300 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
AQ	2SC5659Q	ROHM	npn	V_{CEO}=25 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=120...270; f_T>150 МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
A-Q	2PD1820AQ	PHIL	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=85...170; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
A-Q	2PD1820AR	PHIL	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...240; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
AQP	2SB1051KP	ROHM	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=1000 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AQQ	2SB1051KQ	ROHM	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=1000 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AQR	2SB1051KR	ROHM	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=1000 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AR	BCW60CR	ZETEX	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AR	BCW60CR	ITT	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
AR	MSD709R	MOT	pnp	V_{CBO}=25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
AS	2SA1655	SANYO	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AS	BAT1805	SIEM	cpin×2	V_R<35 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.02 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
AS	BCW60DR	ITT	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
AS	MSD709S	MOT	pnp	V_{CBO}=25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
A-S	2PD1820AS	PHIL	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=170...340; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ASA	BC846UA	AUK	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ASB	BC846UB	AUK	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ASC	BC846UC	AUK	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ASG	KTA1504	KEC	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...400; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

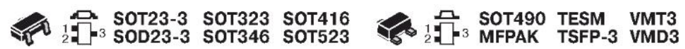




SOT490 TESM VMT3
MFPAK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
ASO	KTA1504	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...140; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ASs	BAT18-05	INF	cpin×2	V_R<35 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.02 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
ASY	KTA1504	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AT	BAT1806	SIEM	cpin×2	V_R<35 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.02 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
AtQ	2PD1820AQ	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=85...170; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
AtQ	2PD1820AR	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...240; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ATQ	2SC4326KQ	ROHM	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T>800 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ATR	2SC4326KR	ROHM	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=180...390; f_T>800 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
AtS	2PD1820AS	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=170...340; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ATS	2SC4326KS	ROHM	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=270...560; f_T>800 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
ATs	BAT18-06	SIEM	cpin×2	V_R<35 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.02 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
AU	BAT1804	SIEM	cpin×2	V_R<35 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.02 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
AUs	BAT18-04	INF	cpin×2	V_R<35 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.02 мкА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
AV	DAN212K	ROHM	di	V_R<70 В; I_F<200 мА; P_D<250 мВт; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
AW	BCX70GR	ZETEX	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AX	BCX70JR	ZETEX	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AX	BCX70JR	ITT	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
AY	BCX70KR	ITT	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
AY	MMBD1000LT1	MOT	di	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.95 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<3 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
AYAA	MAX6120EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.4...11 В; I_{CC}<70 мкА; V_{OUT}=1.2 В	SOT23,SOD23	VIN•VOUT•GND
AZO	KTA1505	KEC	pnp	V_{CB0}=35 В; I_C=500 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...140; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
AZY	KTA1505	KEC	pnp	V_{CB0}=35 В; I_C=500 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B	IRLML2803	IR	nMOS	HEXFET; V_{DS}=30 В; I_D=0.9 А; P_D=540 мВт; $R_{DS(on)}$<0.4 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
B	MRF957T1	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=227 мВт; h_{21}=50...200; f_T=9 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
B0	HSMS2810	HP	shd	V_{BR}>20 В; V_F(I_F=35 мА)<1.0 В; I_R(V_R=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
B0	HSMS281B	HP	shd	V_{BR}>20 В; V_F(I_F=35 мА)<1.0 В; I_R(V_R=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
B0	SST5460	SIL	pFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=1...5 мА; g_F=1 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
B1	HSMS2811	HP	shd	V_{BR}>20 В; V_F(I_F=35 мА)<1.0 В; I_R(V_R=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
B1	SST5461	SIL	pFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=>4 мА; g_F>1 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
B1O	KSC2715	SAMS	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...140; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B1R	KSC2715	SAMS	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...80; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B1Y	KSC2715	SAMS	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B2	BSV52	ZETEX	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T>500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B2	BSV52LT1	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...120; f_T>400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B2	HSMS2812	HP	shd×2	V_{BR}>20 В; V_F(I_F=35 мА)<1.0 В; I_R(V_R=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
B2	HSMS281C	HP	shd×2	V_{BR}>20 В; V_F(I_F=35 мА)<1.0 В; I_R(V_R=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
B2	SST5462	SIL	pFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=4...16 мА; g_F=2 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
B26	BF570	PHIL	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>490 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B2p	BSV52	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=40...120; f_T>400	SOT23,SOD23	B•E•C
B2t	BSV52	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=40...120; f_T>400	SOT23,SOD23	B•E•C
B3	1PS301	PHIL	fd×2	V_R<80 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
B3	1SS184	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
B3	1SS301	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
B3	1SS361	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
B3	1SS361F	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT490,SC89	A1•A2•K1,K2
B3	HSMS2813	HP	shd×2	V_{BR}>20 В; V_F(I_F=35 мА)<1.0 В; I_R(V_R=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
B3	HSMS281E	HP	shd×2	V_{BR}>20 В; V_F(I_F=35 мА)<1.0 В; I_R(V_R=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A2,A1
B3	MMBD717LT1	MOT	shd×2	V_R>20 В; V_F(I_F=1 мА)<0.37 В; C_T<2.5 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
B31	IDB31	GS	btd	V_{BO}=30...34 В; I_{TRM}=2 А; P_D=150 мВт	SOT23,SOD23	x•x•n.c.
B4	BSV52R	PHIL	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=40; f_T>400	SOT23,SOD23	E•B•C
B4	BSV52R	ZETEX	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T>500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
B4	HSMS2814	HP	shd×2	V_{BR}>20 В; $V_F(I_F$=35 мА)<1.0 В; $I_R(V_R$=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
B4	HSMS281F	HP	shd×2	V_{BR}>20 В; $V_F(I_F$=35 мА)<1.0 В; $I_R(V_R$=15 В)<200 нА; C_D<1.2 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K2,K1
B5s	BBY58-05W	INF	var	V_R<10 В; I_F<20 мА; I_R<0.01 мкА; C_{1B}=17.5...19.3 пФ; C_{4B}=5.5...6.6 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
B6	2SB815B6	SANYO	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=700 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...400; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B6	BAT54A	ZOWIE	shd×2	V_R<30 В; $V_F(I_F$=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
B6s	BBY58-06W	INF	var	V_R<10 В; I_F<20 мА; I_R<0.01 мкА; C_{1B}=17.5...19.3 пФ; C_{4B}=5.5...6.6 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
B7	2SB815B7	SANYO	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=700 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=300...600; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
B9	1SS311	TOSH	di	V_R<400 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<1.0 мкА	SOT346,SC59	A•n.c.•K
B9	1SS397	TOSH	di	V_R<400 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.3 В	SOT323,SC70	A•n.c.•K
B9	2SC4617	ON	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=125 мВт; h_{21}=120...560; f_T=180 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
BA	1SS154	TOSH	shd	V_R>6 В; I_F<30 мА; $V_F(I_F$=10 мА)=0.5 В; I_R<0.5 мкА	SOT346,SC59	n.c.•A•K
BA	BCW61A	ALLEG	pnp	V_{CB0}=32 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=120...220; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
BA	BCW61A	CDIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BA	BCW61A	SAMS	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...220	SOT23,SOD23	B•E•C
BA	BCW61A	ZETEX	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BA	DAN217	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; P_D<200 мВт; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
BAp	BCW61A	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BAs	BCW61A	SIEM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BAt	BCW61A	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BB	1SV128	TOSH	pin	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.95 В; I_R<0.1 мкА	SOT346,SC59	A•n.c.•K
BB	2SB831B	REN	pnp	V_{CB0}=25 В; I_C=700 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=85...170	SOT23,SOD23	B•E•C
BB	BCW61B	ALLEG	pnp	V_{CB0}=32 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=180...310; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
BB	BCW61B	CDIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BB	BCW61B	SAMS	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=180...310	SOT23,SOD23	B•E•C
BB	BCW61B	ZETEX	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BBp	BCW61B	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...310; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BBs	BCW61B	SIEM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BBt	BCW61B	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...310; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BBU	2SD2114KU	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=560...1200; f_T>350 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BBV	2SD2114KV	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=820...1800; f_T>350 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BBW	2SD2114KW	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=1200...2700; f_T>350 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BC	2SB831C	REN	pnp	V_{CB0}=25 В; I_C=700 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240	SOT23,SOD23	B•E•C
BC	BCW61C	ALLEG	pnp	V_{CB0}=32 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=250...460; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
BC	BCW61C	CDIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BC	BCW61C	SAMS	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=250...460; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BC	BCW61C	ZETEX	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BCp	BCW61C	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BCs	BCW61C	SIEM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BCt	BCW61C	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BD	1SS271	TOSH	shd×2	V_R>6 В; I_F<30 мА; $V_F(I_F$=10 мА)=0.5 В; I_R<0.5 мкА	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
BD	BCW61D	ALLEG	pnp	V_{CB0}=32 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=380...630; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
BD	BCW61D	CDIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BD	BCW61D	SAMS	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=380...630; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BD	BCW61D	ZETEX	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BDM	2SA1733KM	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=39...82; f_T>400 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BDM	2SA1808M	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=39...82; f_T>400 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BDN	2SA1733KN	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>400 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BDN	2SA1808N	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>400 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BDP	2SA1733KP	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>400 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BDP	2SA1808P	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>400 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BDp	BCW61D	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=380...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BDs	BCW61D	SIEM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C




SOT23-3 SOT323 SOT416 SOD23-3 SOT346 SOT523 SOT490 TESM VMT3 MFPAK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
BDt	BCW61D	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=380...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BE	1SV172	TOSH	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=50 мА)=0.95 В; I_R<0.1 мкА	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
BE	1SV252	TOSH	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=50 мА)<0.98 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
BE2	MMBZ5221ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=2.28...2.52 В; I_R<100 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BE7	MMBZ5226ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=3.13...3.47 В; I_R<25 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BE9	MMBZ5228ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=3.70...4.10 В; I_R<10 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BF	1SS268	TOSH	di×2	V_R>30 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=2 мА)<0.85 В; I_R<0.1 мкА	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
BF	1SS312	TOSH	di	V_R<30 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=2 мА)<0.85 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A•A•K
BF	1SS364	TOSH	di×2	V_R<30 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=2 мА)<0.85 В; I_R<0.1 мкА	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
BF	KDS112	KEC	di×2	V_R=30 В; I_F=50 мА; I_R=0.1 мкА; C_T=0.8 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
BF1	MMBZ5229ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=4.08...4.52 В; I_R<5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BF2	MMBZ5230ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=4.46...4.94 В; I_R<5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BF3	MMBZ5231ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=4.84...5.36 В; I_R<5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BF4	MMBZ5232ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=5.32...5.88 В; I_R<5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BF6	MMBZ5234ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=5.89...6.51 В; I_R<5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BF7	MMBZ5235ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=6.46...7.14 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BF8	MMBZ5236ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=7.12...7.88 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BF9	MMBZ5237ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=7.79...8.61 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BFR	2SC4642KR	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BFR	2SC4723R	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BFS	2SC4642KS	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BFS	2SC4723S	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>180 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BFs	BCW61FF	SIEM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BG	1SS269	TOSH	di×2	V_R>30 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=2 мА)<0.85 В; I_R<0.1 мкА	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
BG	1SS313	TOSH	di	V_R<30 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=2 мА)<0.85 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	K•K•A
BG	BCX71G	ALLEG	pnp	V_{CB0}=45 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=120...220; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
BG	BCX71G	CDIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BG	BCX71G	SAMS	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...220	SOT23,SOD23	B•E•C
BG	BCX71G	ZETEX	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BG	BRC144ECM	REN	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>70; 47 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
BG	BRC144EMP	REN	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>70; 47 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
BG2	MMBZ5239ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=8.65...9.56 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BG3	MMBZ5240ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=9.5...10.5 В; I_R<3 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BG5	MMBZ5242ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=11.4...12.6 В; I_R<1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BG6	MMBZ5243ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=9.5 мА)=12.35...13.65 В; I_R<0.5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BG7	MMBZ5244ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=8.5 мА)=13.30...14.70 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BG8	MMBZ5245ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=8.5 мА)=14.25...15.75 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BG9	MMBZ5246ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=7.8 мА)=15.2...16.8 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BGp	BCX71G	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BGs	BCX71G	SIEM	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BGt	BCX71G	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BH	1SS295	TOSH	shd×2	V_R>4 В; I_F<30 мА; V_F(I_F=2 мА)=0.32 В; I_R<25 мкА	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
BH	1SS350	SANYO	shd	V_R>5 В; V_F(I_F=1 мА)<0.23 В; I_R(V_R=0.5 В)<25 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c•K
BH	BCX71H	ALLEG	pnp	V_{CB0}=45 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=180...310; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
BH	BCX71H	CDIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...310; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BH	BCX71H	SAMS	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=140...310	SOT23,SOD23	B•E•C
BH	BCX71H	ZETEX	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BH2	MMBZ5248ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=7.0 мА)=17.1...18.9 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BH4	MMBZ5250ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=6.2 мА)=19.0...21.0 В; I_R<01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BH6	MMBZ5252ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=5.2 мА)=22.8...25.2 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BH7	MMBZ5253ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=23.75...26.25 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BH8	MMBZ5254ELT1	ON	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=25.65...28.35 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
BH9	MMBZ5255ELT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=4.5 мА)=26.6...29.4 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BHM	2SC4699KM	ROHM	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=39...82; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BHM	2SC4700M	ROHM	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=200 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BHN	2SC4699KN	ROHM	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BHN	2SC4700N	ROHM	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=200 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BHP	2SC4699KP	ROHM	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BHP	2SC4700P	ROHM	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=200 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BHp	BCX71H	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...310; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BHs	BCX71H	SIEM	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BHt	BCX71H	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=180...310; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BJ	BCX71J	ALLEG	pnp	V_{CBO}=45 В; I_{CBO}<20 нА; h_{21}=250...460; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
BJ	BCX71J	CDIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BJ	BCX71J	SAMS	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=250...460	SOT23,SOD23	B•E•C
BJ	BCX71J	ZETEX	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BJ1	MMBZ5256ELT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=4.2 мА)=28.5...31.5 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BJ2	MMBZ5257ELT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=3.8 мА)=31.35...34.65 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BJ3	MMBZ5258ELT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=3.4 мА)=34.2...37.8 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BJ7	MMBZ5262ELT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2.5 мА)=48.45...53.55 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BJ8	MMBZ5263ELT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2.2 мА)=53.20...58.80 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BJp	BCX71J	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BJs	BCX71J	SIEM	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BJt	BCX71J	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BJU	2SD2226KU	ROHM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=560...1200; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BJU	2SD2351U	ROHM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=560...1200; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BJV	2SD2226KV	ROHM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=820...1800; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BJV	2SD2351V	ROHM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=820...1800; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BJW	2SD2226KW	ROHM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=1200...2700; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BJW	2SD2351W	ROHM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=1200...2700; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BK	BCX71K	ALLEG	pnp	V_{CBO}=45 В; I_{CBO}<20 нА; h_{21}=380...630; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
BK	BCX71K	CDIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=380...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BK	BCX71K	SAMS	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=380...630	SOT23,SOD23	B•E•C
BK	BCX71K	ZETEX	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BK1	MMBZ5265ELT1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=58.90...65.10 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
BKp	BCX71K	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=380...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BKs	BCX71K	SIEM	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BKt	BCX71K	PHIL	pnp	V_{CBO}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=380...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BLL	2SC4771KL	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=27...56; f_T>600 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BLL	2SC4772L	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=27...56; f_T>600 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BLM	2SC4771KM	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=39...82; f_T>600 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BLM	2SC4772M	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T>600 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BLN	2SC4771KN	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>600 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BLN	2SC4772N	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T>600 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BLP	2SC4771KP	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>600 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BLP	2SC4772P	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T>600 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BM	BSS63L	MOT	pnp	V_{CBO}=100 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>30; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BMp	BSS63	PHIL	pnp	V_{CBO}=110 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BMQ	2SC4713KQ	ROHM	npn	V_{CBO}=12 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T=800 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BMQ	2SC4774Q	ROHM	npn	V_{CBO}=12 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T=800 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BMR	2SC4713KR	ROHM	npn	V_{CBO}=12 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T=800 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BMR	2SC4774R	ROHM	npn	V_{CBO}=12 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=180...390; f_T=800 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BMS	2SC4713KS	ROHM	npn	V_{CBO}=12 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T=800 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BMS	2SC4774S	ROHM	npn	V_{CBO}=12 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=270...560; f_T=800 МГц	SOT323,SC70	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
BMs	BSS63	SIEM	pnp	V_{CB0}=100 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>30; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BMt	BSS63	PHIL	pnp	V_{CB0}=110 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BN	2SK3290	REN	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=500 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<1.25 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
BNs	BCW61FN	SIEM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BO	BCW61AR	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BP	2SJ574	REN	pMOS	V_{DS}=30 В; I_D=300 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<3.1 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
BQ	2PB709AQ	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...260; f_T>70 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BQ	2SC2412KQ	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BQ	2SC2412KQLT1	LRC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T=180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BQ	2SC4081Q	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>180 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BQ	2SC4617	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T>180 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
BQ	2SC5658Q	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T>180 МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
BR	2PB709AR	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=290...460; f_T>80 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BR	2SC2412KR	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BR	2SC2412KRLT1	LRC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T=180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BR	2SC4081R	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BR	2SC4617	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
BR	2SC5658R	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
BR	BCW60DR	ZETEX	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BR	MSB1218ART1	MOT	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=210...340	SOT323,SC70	B•E•C
BS	2PB709AS	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=160...260; f_T>60 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BS	2SC2412KS	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
BS	2SC2412KSLT1	LRC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T=180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
BS	2SC4081S	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>180 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BS	2SC4617	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=270...560; f_T>180 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
BS	2SC5658S	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=270...560; f_T>180 МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
BS	MSB1218AST1	MOT	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=290...460	SOT323,SC70	B•E•C
BSA	BC848AU	AUK	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BSA	BC848AUF	AUK	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BSB	BC848BU	AUK	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BSB	BC848BUF	AUK	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BSC	BC848CU	AUK	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BSC	BC848CUF	AUK	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
BV	1SV247	SANYO	pin	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.95 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A•n.c.•K
C	IRLML6302	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=20 В; I_D=0.62 А; P_D=540 мВт; $R_{DS(on)}$<0.9 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
C0	HSMS2820	HP	shd	V_{BR}>15 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.7 В; $I_R(V_R$=1 В)<100 нА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C0	HSMS282B	HP	shd	V_{BR}>15 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.7 В; $I_R(V_R$=1 В)<100 нА; C_T<1.0 пФ; R_D=12 Ом	SOT323,SC70	A•n.c.•K
C1	BCW29	ALLEG	pnp	V_{CB0}=30 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=120...260; $V_{CE(sat)}$<0.3 В	SOT23,SOD23	B•E•C
C1	BCW29	CDIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...260; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1	BCW29	SAMS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...260	SOT23,SOD23	B•E•C
C1	BCW29	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...260; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1	HSMS2821	HP	shd	V_{BR}>15 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.7 В; $I_R(V_R$=1 В)<100 нА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
C1	MMBZ5221BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.28...2.52 В; I_R<100 мкА	SOT523	A•n.c.•K
C1	SST111	SIL	nFET	V_{GS}=35 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>20 мА; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C1A	CMPT3904	CSI	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1D	CMPTA42	CSI	npn	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1G	CMPTA06	CSI	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1G	KSA1623	SAMS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...400; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1J	CMPT2369	CSI	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=40...120; f_T>500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1K	CMPT6428	CSI	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=250...650; f_T=100...700 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1L	CMPT6429	CSI	npn	V_{CB0}=55 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=500...1250; f_T=100...700 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1L	KSA1623	SAMS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=300...600; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
C1M	CMPTA13	CSI	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1N	CMPTA14	CSI	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1O	KSA1623	SAMS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=90...180; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1p	BCW29	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1P	CMPT2222A	CSI	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}<35; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•cmp•C
C1Q	CMPT5088	CSI	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=300...900; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1R	CMPT5089	CSI	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=400...1200; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1t	BCW29	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1U	CMPT2484	CSI	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=250...800	SOT23,SOD23	B•E•C
C_{1B}	CMPT6427	CSI	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=10 к...100 к; f_T>130 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1X	CMPT930	CSI	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=30 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>30 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1Y	KSA1623	SAMS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=135...270; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C1Z	CMPT6517	CSI	npn	V_{CB0}=350 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=20...200; f_T=40...200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2	BCW30	ALLEG	pnp	V_{CB0}=30 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=215...500; $V_{CE(sat)}$<0.3 В	SOT23,SOD23	B•E•C
C2	BCW30	CDIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=215...500; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2	BCW30	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=215...500; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2	HSMS2822	HP	shd×2	V_{BR}>15 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.7 В; $I_R(V_R$=1 В)<100 нА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
C2	HSMS282C	HP	shd×2	V_{BR}>15 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.7 В; $I_R(V_R$=1 В)<100 нА; C_T<1.0 пФ; R_D=12 Ом	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
C2	SST112	SIL	nFET	V_{GS}=35 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>5 мА; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C29	CMPTA29	CSI	npn	V_{CB0}=100 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2A	CMPT3906	CSI	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2A	ZDC833A	ZETEX	var×2	V_R<25 В; C_{2B}=29.7...33.6 пФ; C_{2B}/C_{20B}=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
C2D	CMPTA92	CSI	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2F	CMPT2907A	CSI	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2G	CMPTA56	CSI	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2J	CMPT3640	CSI	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=80 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=30...120; f_T>500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2L	CMPT5401	CSI	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=60...240; f_T=100...300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2p	BCW30	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2P	CMPT5086	CSI	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=150...500; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2Q	CMPT5087	CSI	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=250...800; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2R	CMPT3646	CSI	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=30...120; f_T>350 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2t	BCW30	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2T	CMPT4403	CSI	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2U	CMPTA63	CSI	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C_{2B}	CMPTA64	CSI	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>20000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2W	CMPT8599	CSI	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2X	CMPT4401	CSI	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C2Z	CMPT6520	CSI	pnp	V_{CB0}=350 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=20...200; f_T=40...200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C3	1PS302	PHIL	fd×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.0 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
C3	1SS226	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
C3	1SS302	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
C3	1SS362	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<80 мА; $V_F(I_F$=80 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	A1•K2•K1,A2
C3	HSMS2823	HP	shd×2	V_{BR}>15 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.7 В; $I_R(V_R$=1 В)<100 нА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
C3	HSMS282E	HP	shd×2	V_{BR}>15 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.7 В; $I_R(V_R$=1 В)<100 нА; C_T<1.0 пФ; R_D=12 Ом	SOT323,SC70	K1•K2•A2,A1
C3	KST4126	SAMS	pnp	V_{CB0}=25 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...360; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C3	MMBZ5223BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=2.57...2.84 В; I_R<75 мкА	SOT523	A•n.c.•K
C3	SST113	SIL	nFET	V_{GS}=35 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>2 мА; $R_{DS(on)}$<100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C38	SST5638	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>50 мА; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C39	SST5639	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>25 мА; $R_{DS(on)}$<60 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C3A	CMPT3019	CSI	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C3B	CMPT918	CSI	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>20; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C3E	CMPTH10	CSI	npn	V_{CB0}=30 В; P_D=350 мВт; h_{21}>60; f_T>650 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C



SOT23-3 SOT323 SOT416 SOD23-3 SOT346 SOT523 SOT490 TESM VMT3 MFPAK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
C3Z	CMPTA44	CSI	npn	V_{CB0}=450 В; I_C=300 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=50...200; f_T>20 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C4	BCW29R	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C4	BCW29R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...260; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
C4	HSMS2824	HP	shd×2	V_{BR}>15 В; V_F(I_F=30 мА)<0.7 В; I_R(V_R=1 В)<100 нА; C_D<1.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
C4	HSMS282F	HP	shd×2	V_{BR}>15 В; V_F(I_F=30 мА)<0.7 В; I_R(V_R=1 В)<100 нА; C_T<1.0 пФ; R_D=12 Ом	SOT323,SC70	A1•A2•K2,K1
C40	SST5640	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>5 мА; $R_{DS(on)}$<100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C41	SST4091	SIL	nFET	V_{DS}=35 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=30 мА; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C42	SST4092	SIL	nFET	V_{DS}=35 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=30 мА; $R_{DS(on)}$<50 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C43	SST4093	SIL	nFET	V_{DS}=35 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=30 мА; $R_{DS(on)}$<80 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C4A	CMPT4033	CSI	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C5	BCW30R	PHIL	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
C5	BCW30R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=215...500; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C5	MMBA811C5	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=135...270	SOT23,SOD23	B•E•C
C5	MMBZ5225BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=2.85...3.15 В; I_R<50 мкА	SOT523	A•n.c.•K
C56	SST4856	SIL	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>50 мА; $R_{DS(on)}$<25 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C57	SST4857	SIL	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>20 мА; $R_{DS(on)}$<40 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C58	SST4858	SIL	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>8 мА; $R_{DS(on)}$<60 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C59	SST4859	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>50 мА; $R_{DS(on)}$<25 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C5A	ZDC834A	ZETEX	var×2	V_R<25 В; I_F<200 мА; I_R<0.02 мкА; $C_{2В}$=42.3...51.7 пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5.0...6.5	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
C5C	CMPD7000	CSI	fid×2	I_O=200 мА; V_{RRM}=100 В; V_F(I_F=100 мА)=0.75...1.10 В; I_R<300 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_T<1.5 пФ	SOT23,SOD23	A2•K1•K2,A1
C5D	CMPD914	CSI	fid	I_F=250 мА; V_R=75 В; V_F(I_F=10 мА)<1.0 В; I_R<25 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_T<4.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C6	MMBA811C6	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=200...400	SOT23,SOD23	B•E•C
C6	MMBA811C6	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...400	SOT23,SOD23	B•E•C
C60	SST4860	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>20 мА; $R_{DS(on)}$<40 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C61	SST4861	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>8 мА; $R_{DS(on)}$<60 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
C7	MMBA811C7	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=300...600	SOT23,SOD23	B•E•C
C7	MMBA811C7	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=300...600	SOT23,SOD23	B•E•C
C77	BCF29R	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
C7H	CMPT5179	CSI	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>25; f_T>900 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C7p	BCF29	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C8	BCF30	SGS	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C8	MMBA811C8	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=450...900	SOT23,SOD23	B•E•C
C8	MMBA811C8	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=450...900	SOT23,SOD23	B•E•C
C8A	CMPZ5226B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=3.135...3.465 В; I_L(V_R=1.0 В)<25 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<28 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8B	CMPZ5227B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=3.42...3.78 В; I_L(V_R=1.0 В)<15 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<24 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8C	CMPZ5228B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=3.705...4.095 В; I_L(V_R=1.0 В)<10 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<23 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8D	CMPZ5229B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=4.085...4.515 В; I_L(V_R=1.0 В)<5.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<22 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8E	CMPZ5230B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=4.465...4.935 В; I_L(V_R=2.0 В)<5.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<19 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8F	CMPZ5231B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=4.845...5.355 В; I_L(V_R=2.0 В)<5.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<17 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8G	CMPZ5232B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=5.320...5.880 В; I_L(V_R=3.0 В)<5.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<11 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8H	CMPZ5233B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=5.700...6.300 В; I_L(V_R=3.5 В)<5.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<7.0 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8J	CMPZ5234B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=5.890...6.510 В; I_L(V_R=4.0 В)<5.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<7.0 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8K	CMPZ5235B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=6.460...7.140 В; I_L(V_R=5.0 В)<3.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<5.0 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8L	CMPZ5236B	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=20 мА)=7.125...7.875 В; I_L(V_R=6.0 В)<3.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=20 мА)<6.0 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

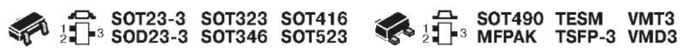
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
C8M	CMPZ5237B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=7.790...8.610 В; $I_L(V_R$=6.5 В)<3.0 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<8.0 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8N	CMPZ5238B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.265...9.135 В; $I_L(V_R$=6.5 В)<3.0 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<8.0 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8p	BCF30	PHIL	pnp	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
C8P	CMPZ5239B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.645...9.555 В; $I_L(V_R$=6.5 В)<3.0 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8Q	CMPZ5240B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=9.500...10.50 В; $I_L(V_R$=8.0 В)<3.0 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<17 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8R	CMPZ5241B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=10.45...11.55 В; $I_L(V_R$=8.4 В)<2.0 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<22 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8S	CMPZ5242B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=11.40...12.60 В; $I_L(V_R$=9.1 В)<1.0 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8T	CMPZ5243B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=9.5 мА)=12.35...13.65 В; $I_L(V_R$=9.9 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=9.5 мА)<13 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C8U	CMPZ5244B	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=9.0 мА)=13.30...14.70 В; $I_L(V_R$=10 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=9.0 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
C9	1SS307	TOSH	di	V_R<30 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.3 В; I_R<0.01 мкА	SOT346,SC59	A•n.c.•K
C9	BCF30R	PHIL	pnp	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
CA	BCW61AR	ZETEX	pnp	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CA	BCW61AR	PHIL	pnp	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
CA	MMBZ4691	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=5.89...6.51 В; I_R<10 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CA	RN1444A	TOSH	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...700; f_T=30 МГц; R_1=2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
CA	SST4391	SIL	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>50 мА; g_F=6 мСм; $R_{DS(on)}$=30 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
CA2	CMPD2836	CSI	fid×2	I_O=200 мА; V_{RRM}=75 В; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<100 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_T<4.0 пФ	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
CA6	CMPD2838	CSI	fid×2	I_O=200 мА; V_{RRM}=75 В; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<100 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_T<4.0 пФ	SOT23,SOD23	A2•A1•K2,K1
CAR	2SA1885R	ROHM	pnp	V_{CEO}=15 В; I_C=100 мА; h_{21}=180...390; f_T>650 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
CAS	2SA1885S	ROHM	pnp	V_{CEO}=15 В; I_C=100 мА; h_{21}=270...560; f_T>650 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
CB	BCW61BR	ZETEX	pnp	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CB	BCW61BR	PHIL	pnp	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
CB	RN1444B	TOSH	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=350...1200; f_T=30 МГц; R_1=2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
CB	SST4392	SIL	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>25 мА; g_F=6 мс; $R_{DS(on)}$=60 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
CC	2SA1122B	REN	pnp	V_{CBO}=55 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=160...320	SOT23,SOD23	B•E•C
CC	2SA2081C	REN	pnp	V_{CBO}=55 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=160...320	SOT323,SC70	B•E•C
CC	BCW61CR	ZETEX	pnp	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CC	BCW61CR	PHIL	pnp	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
CC	BF554	SIEM	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=60...250; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CC	SST4393	SIL	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>5 мА; g_F=6 мс; $R_{DS(on)}$=100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
CC	ZMDC831B	ZETEX	var×2	V_R<25 В; I_F<200 мА; I_R<0.02 мкА; C_{2B}=14.25...15.75 пФ; C_{2B}/C_{20B}=4.5...6	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
CC10	CMPZDC27V	CSI	dz×2	V_Z=27 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CC11	CMPZDC30V	CSI	dz×2	V_Z=30 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CC12	CMPZDC33V	CSI	dz×2	V_Z=33 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CC13	CMPZDC36V	CSI	dz×2	V_Z=36 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CC14	CMPZDC39V	CSI	dz×2	V_Z=39 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CC15	CMPZDC43V	CSI	dz×2	V_Z=43 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CC16	CMPZDC47V	CSI	dz×2	V_Z=47 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCW3	CMPZDC2V4	CSI	dz×2	V_Z=2.4 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCW4	CMPZDC2V7	CSI	dz×2	V_Z=2.7 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCW5	CMPZDC3V0	CSI	dz×2	V_Z=3.0 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCW6	CMPZDC3V3	CSI	dz×2	V_Z=3.3 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCW7	CMPZDC3V6	CSI	dz×2	V_Z=3.6 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCW8	CMPZDC3V9	CSI	dz×2	V_Z=3.9 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
CCW9	CMPZDC4V3	CSI	dz×2	V_Z=4.3 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY1	CMPZDC11V	CSI	dz×2	V_Z=11 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY2	CMPZDC12V	CSI	dz×2	V_Z=12 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY3	CMPZDC13V	CSI	dz×2	V_Z=13 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY4	CMPZDC15V	CSI	dz×2	V_Z=15 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY5	CMPZDC16V	CSI	dz×2	V_Z=16 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY6	CMPZDC18V	CSI	dz×2	V_Z=18 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY7	CMPZDC20V	CSI	dz×2	V_Z=20 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY8	CMPZDC22V	CSI	dz×2	V_Z=22 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCY9	CMPZDC24V	CSI	dz×2	V_Z=24 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ1	CMPZDC4V7	CSI	dz×2	V_Z=4.7 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ2	CMPZDC5V1	CSI	dz×2	V_Z=5.1 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ3	CMPZDC5V6	CSI	dz×2	V_Z=5.6 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ4	CMPZDC6V2	CSI	dz×2	V_Z=6.2 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ5	CMPZDC6V8	CSI	dz×2	V_Z=6.8 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ6	CMPZDC7V5	CSI	dz×2	V_Z=7.5 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ7	CMPZDC8V2	CSI	dz×2	V_Z=8.2 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ8	CMPZDC9V1	CSI	dz×2	V_Z=9.1 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CCZ9	CMPZDC10V	CSI	dz×2	V_Z=10 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
CD	2SA1122C	REN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
CD	2SA2081D	REN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT323,SC70	B•E•C
CD	BCW61DR	ZETEX	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CD	BCW61DR	PHIL	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
CD	ZMDC832B	ZETEX	var×2	V_R<25 В; I_F<200 мА; I_R<0.02 мкА; C_{2B}=20.9...23.1 пФ; C_{2B}/C_{20B}=5...6.5	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
CDs	BSS81B	SIEM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CE	2SA1122D	REN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=400...800	SOT23,SOD23	B•E•C
CE	BSS79B	ZETEX	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CEs	BSS79B	SIEM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CF	BSS79C	ZETEX	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CF	MMBZ4681	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=2.28...2.52 В; I_R<2 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CFs	BSS79C	SIEM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CG	2SA1587G	TOSH	pnp	V_{CB0}=120 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>200...400; f_T>=100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CG	BCX71GR	ZETEX	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CG	BCX71GR	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
CG	BRA124ECM	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; 22 к/22 к	SOT323,SC70	B•E•C
CG	BRA124EMP	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; 22 к/22 к	SOT23,SOD23	B•E•C
CGs	BSS81C	SIEM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CH	1SS351	SANYO	shd×2	V_R>5 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.23 В; $I_R(V_R$=0.5 В)<25 мкА	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
CH	BSS80B	ZETEX	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CH	BSS82BL	MOT	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CH	MMBZ4682	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=2.57...2.84 В; I_R<1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CHA	2SC4667A	TOSH	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=200 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>600...1800; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CHB	2SC4667B	TOSH	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=200 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>1200...3600; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CHs	BSS80B	SIEM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CJ	BSS80C	ZETEX	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CJ	MMBZ4683	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=2.85...3.15 В; I_R<0.8 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CJs	BSS80C	SIEM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CK	BCX71JR	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
CK	BCX71KR	ZETEX	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CK	MMBZ4684	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=3.14...3.47 В; I_R<7.5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CKB	CMPT8099	CSI	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CL	2SA1587B	TOSH	pnp	V_{CB0}=120 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>350...700; f_T=100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C

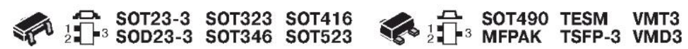
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
CL	BSS82B	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CLs	BSS82B	SIEM	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...120; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CM	BSS82C	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CM	MMBZ4685	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=3.42...3.78 В; I_R<7.5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CMs	BSS82C	SIEM	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CN	2SK3348	REN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<3.2 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
CN	MMBZ4686	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=3.71...4.10 В; I_R<5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CP	2SC2411KP	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
CP	2SC4097P	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CP	2SJ586	REN	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<8.5 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
CP	MMBZ4687	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=4.09...4.52 В; I_R<4 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CQ	2PB1219Q	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=85...170; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CQ	2SC2411KQ	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
CQ	2SC4097Q	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CQ	MSD710Q	MOT	pnp	V_{CBO}=25 В; I_C=150 мА	SOT346,SC59	B•E•C
CR	2PB1219R	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...240; f_T>120 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CR	2SC2411KR	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
CR	2SC4097R	ROHM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CR	BCW60A	ZETEX	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
CR	MSD701R	MOT	pnp	V_{CBO}=25 В; I_C=150 мА	SOT346,SC59	B•E•C
CS	2PB1219S	PHIL	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=170...340; f_T>140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
CT	MMBZ4688	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=4.47...4.94 В; I_R<10 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CU	MMBZ4689	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=4.85...5.36 В; I_R<10 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CV	1SV234	SANYO	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.95 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
CV	1SV246	SANYO	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.95 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
CV	MMBZ4690	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=5.32...5.88 В; I_R<10 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CWAA	MAX809LUR	MAX	mrc	V_{TR}=4.00 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<100 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
CX	MMBZ4692	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=6.46...7.14 В; I_R<10 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CY	MMBZ4693	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=7.13...7.88 В; I_R<10 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CZ	MMBZ4694	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=7.79...8.61 В; I_R<1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D	IRLML5103	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=30 В; I_D=0.61 А; P_D=540 мВт; $R_{DS(on)}$<1 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
D	MRF577T1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=80 мА; P_D=232 мВт; h_{21}=50...300; f_T=7000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
D0	HSMP3800	HP	pin	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.0 Ом; C_D<0.37 пФ; R_H>1000 Ом; R_L<8 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D1	AZ23B2V7	VISH	dz×2	V_Z=2.65...2.75 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<83 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D1	AZ23C2V7	VISH	dz×2	V_Z=2.5...2.9 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<83 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D1	AZ23C2V7	TSC	dz×2	V_Z=2.5...2.9 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<83 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D1	BCW31	ALLEG	npn	V_{CBO}=30 В; I_{CBO}<100 нА; h_{21}=110...220; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
D1	BCW31	CDIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D1	BCW31	SAMS	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=110...220	SOT23,SOD23	B•E•C
D1	BCW31	ZETEX	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D1	HSMP3801	HP	pin	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.0 Ом; C_D<0.37 пФ; R_H>1000 Ом; R_L<8 Ом	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
D10	AZ23B6V2	VISH	dz×2	V_Z=6.08...6.32 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D10	AZ23C6V2	VISH	dz×2	V_Z=5.8...6.6 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D10	AZ23C6V2	TSC	dz×2	V_Z=5.8...6.6 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D11	AZ23B6V8	VISH	dz×2	V_Z=6.66...6.94 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<8 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D11	AZ23C6V8	VISH	dz×2	V_Z=6.4...7.2 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<8 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D11	AZ23C6V8	TSC	dz×2	V_Z=6.4...7.2 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<8 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D12	AZ23B7V5	VISH	dz×2	V_Z=7.35...7.65 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<7 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D12	AZ23C7V5	VISH	dz×2	V_Z=7.0...7.9 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<7 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D12	AZ23C7V5	TSC	dz×2	V_Z=7.0...7.9 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<7 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D13	AZ23B8V2	VISH	dz×2	V_Z=8.04...8.36 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<7 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D13	AZ23C8V2	VISH	dz×2	V_Z=7.7...8.7 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<7 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
D13	AZ23C8V2	TSC	dz×2	V_Z=7.7...8.7 В; R_Z(I_Z=5мА)<7 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D14	AZ23B9V1	VISH	dz×2	V_Z=8.92...9.28 В; R_Z(I_Z=5 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D14	AZ23C9V1	VISH	dz×2	V_Z=8.5...9.6 В; R_Z(I_Z=5мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D14	AZ23C9V1	TSC	dz×2	V_Z=8.5...9.6 В; R_Z(I_Z=5мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D15	AZ23B10	VISH	dz×2	V_Z=9.8...10.2 В; R_Z(I_Z=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D15	AZ23C10	VISH	dz×2	V_Z=9.4...10.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D15	AZ23C10	TSC	dz×2	V_Z=9.4...10.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D16	AZ23B11	VISH	dz×2	V_Z=10.8...11.2 В; R_Z(I_Z=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D16	AZ23C11	VISH	dz×2	V_Z=10.4...11.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D16	AZ23C11	TSC	dz×2	V_Z=10.4...11.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D17	AZ23B12	VISH	dz×2	V_Z=11.8...12.2 В; R_Z(I_Z=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D17	AZ23C12	VISH	dz×2	V_Z=11.4...12.7 В; R_Z(I_Z=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D17	AZ23C12	TSC	dz×2	V_Z=11.4...12.7 В; R_Z(I_Z=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D18	AZ23B13	VISH	dz×2	V_Z=12.7...13.3 В; R_Z(I_Z=5 мА)<25 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D18	AZ23C13	VISH	dz×2	V_Z=12.4...14.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<25 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D18	AZ23C13	TSC	dz×2	V_Z=12.4...14.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<25 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D19	AZ23B15	VISH	dz×2	V_Z=14.7...15.3 В; R_Z(I_Z=5 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D19	AZ23C15	VISH	dz×2	V_Z=13.8...15.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D19	AZ23C15	TSC	dz×2	V_Z=13.8...15.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D1G	KSA812	SAMS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...400; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D1L	KSA812	SAMS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=300...600; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D1O	KSA812	SAMS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D1p	BCW31	PHIL	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D1t	BCW31	PHIL	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D1Y	KSA812	SAMS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=135...270; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D2	AZ23B3V0	VISH	dz×2	V_Z=2.94...3.06 В; R_Z(I_Z=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D2	AZ23C3V0	VISH	dz×2	V_Z=2.8...3.2В; R_Z(I_Z=5мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D2	AZ23C3V0	TSC	dz×2	V_Z=2.8...3.2В; R_Z(I_Z=5мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D2	BCW32	ALLEG	npn	V_{CB0}=30 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=200...450; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
D2	BCW32	CDIL	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D2	BCW32	ZETEX	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D2	HSMP3802	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.0 Ом; C_D<0.37 пФ; R_H>1000 Ом; R_L<8 Ом	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
D20	AZ23B16	VISH	dz×2	V_Z=15.7...16.3 В; R_Z(I_Z=5 мА)<40 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D20	AZ23C16	VISH	dz×2	V_Z=15.3...17.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<40 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D20	AZ23C16	TSC	dz×2	V_Z=15.3...17.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<40 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D21	AZ23B18	VISH	dz×2	V_Z=17.6...18.4 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D21	AZ23C18	VISH	dz×2	V_Z=16.8...19.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D21	AZ23C18	TSC	dz×2	V_Z=16.8...19.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D22	AZ23B20	VISH	dz×2	V_Z=19.6...20.4 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D22	AZ23C20	VISH	dz×2	V_Z=18.8...21.2 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D22	AZ23C20	TSC	dz×2	V_Z=18.8...21.2 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D23	AZ23B22	VISH	dz×2	V_Z=21.6...22.4 В; R_Z(I_Z=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D23	AZ23C22	VISH	dz×2	V_Z=20.8...23.3 В; R_Z(I_Z=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D23	AZ23C22	TSC	dz×2	V_Z=20.8...23.3 В; R_Z(I_Z=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D24	AZ23B24	VISH	dz×2	V_Z=23.5...24.5 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D24	AZ23C24	VISH	dz×2	V_Z=22.8...25.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D24	AZ23C24	TSC	dz×2	V_Z=22.8...25.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D25	AZ23B27	VISH	dz×2	V_Z=26.5...27.5 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D25	AZ23C27	VISH	dz×2	V_Z=25.1...28.9 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D25	AZ23C27	TSC	dz×2	V_Z=25.1...28.9 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D26	AZ23B30	VISH	dz×2	V_Z=29.4...30.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D26	AZ23C30	VISH	dz×2	V_Z=28...32 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2

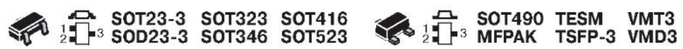
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
D26	AZ23C30	TSC	dz×2	V_Z=28...32 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D27	AZ23B33	VISH	dz×2	V_Z=32.3...33.7 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D27	AZ23C33	VISH	dz×2	V_Z=31...35 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D27	AZ23C33	TSC	dz×2	V_Z=31...35 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D28	AZ23B36	VISH	dz×2	V_Z=35.3...36.7 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D28	AZ23C36	VISH	dz×2	V_Z=34...38 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D28	AZ23C36	TSC	dz×2	V_Z=34...38 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D28	BAS70W	STM	shd	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
D29	AZ23B39	VISH	dz×2	V_Z=38.2...39.8 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D29	AZ23C39	VISH	dz×2	V_Z=37...41 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D29	AZ23C39	TSC	dz×2	V_Z=37...41 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D29	BAS70-06W	STM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
D2p	BCW32	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D2t	BCW32	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D3	1SS187	TOSH	di	V_R<80 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT346,SC59	K•n.c.•A
D3	AZ23B3V3	VISH	dz×2	V_Z=3.23...3.37 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D3	AZ23C3V3	VISH	dz×2	V_Z=3.1...3.5 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D3	AZ23C3V3	TSC	dz×2	V_Z=3.1...3.5 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D3	BCW33	ALLEG	npn	V_{CBO}=30 В; I_{CBO}<100 нА; h_{21}=420...800; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
D3	BCW33	CDIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D3	BCW33	ZETEX	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D30	AZ23B43	VISH	dz×2	V_Z=42.1...43.9 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D30	AZ23C43	VISH	dz×2	V_Z=40...46 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D30	AZ23C43	DIODS	dz×2	V_Z=40...46 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D30	AZ23C43	TSC	dz×2	V_Z=40...46 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D30	BAS70-05W	STM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
D31	AZ23B47	VISH	dz×2	V_Z=46.1...47.9 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D31	AZ23C47	VISH	dz×2	V_Z=44...50 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D31	AZ23C47	DIODS	dz×2	V_Z=44...50 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D31	AZ23C47	TSC	dz×2	V_Z=44...50 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D31	BAS70-04W	STM	shd×2	V_R<70 В; I_F<70 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
D32	AZ23B51	VISH	dz×2	V_Z=50...52 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D32	AZ23C51	VISH	dz×2	V_Z=48...54 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D32	AZ23C51	DIODS	dz×2	V_Z=48...54 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D32	AZ23C51	TSC	dz×2	V_Z=48...54 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D3B	RB420D	ROHM	shd	V_R<40 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<450 мВ; C_D=6 пФ	SOT346,SC59	A•n.c.•K
D3E	RB411D	ROHM	shd	V_R<20 В; I_F<500 мА; $V_F(I_F$=500 мА)<500 мВ; C_D=20 пФ	SOT346,SC59	A•n.c.•K
D3J	RB706D-40	ROHM	shd×2	V_R<40 В; I_F<30 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<370 мВ; C_D=2 пФ	SOT346,SC59	A1•K1,A2•K2
D3p	BCW33	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D3t	BCW33	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D4	AZ23B3V6	VISH	dz×2	V_Z=3.53...3.67 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D4	AZ23C3V6	VISH	dz×2	V_Z=3.4...3.8 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D4	AZ23C3V6	TSC	dz×2	V_Z=3.4...3.8 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D4	BCW31R	PHIL	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
D4	BCW31R	ZETEX	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D4	HSMP3804	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.0 Ом; C_D<0.37 пФ; R_H>1000 Ом; R_L<8 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
D46	BAT46W	STM	shd	V_R<100 В; I_F<150 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.45 мВ; C_D=10 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
D49	CMPD5001S	CSI	dih×2	I_F=400 мА; V_R=120 В; $V_F(I_F$=100 мА)<0.9 В; I_R<100 нА; t_{RR}<50 нс; C_T<35 пФ	SOT23,SOD23	A2•K1•K2,A1
D5	AZ23B3V9	VISH	dz×2	V_Z=3.82...3.98 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D5	AZ23C3V9	VISH	dz×2	V_Z=3.7...4.1 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D5	AZ23C3V9	TSC	dz×2	V_Z=3.7...4.1 В; $R_Z(I_Z$=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2




SOT23-3 SOT323 SOT416 SOD23-3 SOT346 SOT523 **SOT490 TESM VMT3 MFPAK TSFP-3 VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
D5	BCW32R	PHIL	npn	V_{CB0}=32В; I_C=100мА; P_D=350мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
D5	BCW32R	ZETEX	npn	V_{CB0}=32В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=200...450; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D53	CMPD2004	CSI	fid	I_F<225мА; V_R=240В; $V_F(I_F$=100мА)<1.0В; I_R<100нА; t_{RR}<50нс; C_T<5.0пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D58	FLLD258	ZETEX	d×2	V_R<100В; I_F<250мА; $V_F(I_F$=200мА)<1.4В; I_R<5мкА; C_D<4пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
D5s	BBY57-05W	INF	var	V_R<10В; I_F<20мА; I_R<0.01мкА; C_{1B}=16.5...18.6пФ; C_{4B}=3.5...5.5пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
D6	AZ23B4V3	VISH	dz×2	V_Z=4.21...4.39В; $R_Z(I_Z$=5мА)<95Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D6	AZ23C4V3	VISH	dz×2	V_Z=4.0...4.6В; $R_Z(I_Z$=5мА)<95Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D6	AZ23C4V3	TSC	dz×2	V_Z=4.0...4.6В; $R_Z(I_Z$=5мА)<95Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D6	BCW33R	PHIL	npn	V_{CB0}=32В; I_C=100мА; P_D=350мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
D6	BCW33R	ZETEX	npn	V_{CB0}=32В; I_C=100мА; P_D=330мВт; h_{21}=420...800; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D6	MMBC1622D6	MOT	npn	V_{CB0}=40В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=200...400	SOT23,SOD23	B•E•C
D63	FLLD263	ZETEX	d×2	V_R<100В; I_F<250мА; $V_F(I_F$=200мА)<1.4В; I_R<5мкА; C_D<4пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D7	AZ23B4V7	VISH	dz×2	V_Z=4.61...4.79В; $R_Z(I_Z$=5мА)<78Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D7	AZ23C4V7	VISH	dz×2	V_Z=4.4...5.0В; $R_Z(I_Z$=5мА)<78Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D7	AZ23C4V7	TSC	dz×2	V_Z=4.4...5.0В; $R_Z(I_Z$=5мА)<78Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D7	MMBC1622D7	MOT	npn	V_{CB0}=40В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}=300...600	SOT23,SOD23	B•E•C
D73	BAT54W	STM	shd	V_R<30В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<1мкА; C_D<10пФ; t_{RR}<5нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
D74	BAT54AW	STM	shd×2	V_R<30В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<4.0мкА; C_D<10пФ; t_{RR}<5нс	SOT323,SC70	K1•K2•A2,A1
D76	BAR18	ALLEG	shd	V_{BR}>70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.41В; I_R<200нА; C_T<1.7пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D76	BAR18	STM	shd	V_{BR}>70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.41В; I_R<200нА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D76	CMPD6263	CSI	shd	I_F=15мА; V_{RRM}=70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.395...0.410В; I_R<200нА; C_T<2.0пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D77	BAT54CW	STM	shd×2	V_R<30В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<1мкА; C_D<10пФ; t_{RR}<5нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
D77	BCF32R	PHIL	npn	V_{CB0}=20В; I_C=200мА; P_D=200мВт; h_{21}=200; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
D78	BAT54SW	STM	shd×2	V_R<30В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<1мкА; C_D<10пФ; t_{RR}<5нс	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
D7p	BCF32	PHIL	npn	V_{CB0}=32В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D7t	BCF32	PHIL	npn	V_{CB0}=32В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...450; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D8	AZ23B5V1	VISH	dz×2	V_Z=5.0...5.2В; $R_Z(I_Z$=5мА)<60Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D8	AZ23C5V1	VISH	dz×2	V_Z=4.8...5.4В; $R_Z(I_Z$=5мА)<60Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D8	AZ23C5V1	TSC	dz×2	V_Z=4.8...5.4В; $R_Z(I_Z$=5мА)<60Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D81	BCF33R	PHIL	npn	V_{CB0}=20В; I_C=200мА; P_D=200мВт; h_{21}=420; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
D84	BAT54A	STM	shd×2	V_R<30В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<4.0мкА; C_D<10пФ; t_{RR}<5нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D86	BAT54	STM	shd	V_R<30В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<1мкА; C_D<10пФ; t_{RR}<5нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D87	BAT54C	STM	shd×2	V_R<30В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<4.0мкА; C_D<10пФ; t_{RR}<5нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
D88	BAT54S	STM	shd×2	V_R<30В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<4.0мкА; C_D<10пФ; t_{RR}<5нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
D8p	BCF33	PHIL	npn	V_{CB0}=32В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=420...800; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
D9	1SS401	TOSH	shd	V_R>20В; $V_F(I_F$=300мА)<0.45В; $I_R(V_R$=20В)<50мкА; C_T=46пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
D9	AZ23B5V6	VISH	dz×2	V_Z=5.49...5.71В; $R_Z(I_Z$=5мА)<40Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D9	AZ23C5V6	VISH	dz×2	V_Z=5.2...6.0В; $R_Z(I_Z$=5мА)<40Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D9	AZ23C5V6	TSC	dz×2	V_Z=5.2...6.0В; $R_Z(I_Z$=5мА)<40Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
D94	BAR42	STM	shd	V_{BR}>30В; $V_F(I_F$=50мА)<0.65В; I_R<100мкА; C_T=7пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D95	BAR43	STM	shd	V_{BR}>30В; $V_F(I_F$=15мА)<0.45В; I_R<100мкА; C_T=7пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D95	CMPSH3	CSI	shd	I_F=100мА; V_{RRM}=30В; $V_F(I_F$=100мА)<1.0В; I_R<500нА; C_T=7.0пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
D96	BAS70-04	STM	shd×2	V_{BR}>70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.41В; I_R<200нА	SOT23,SOD23	A2•K1•K2,A1
D96	CMPD6263S	CSI	shd×2	I_F=15мА; V_{RRM}=70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.395...0.410В; I_R<200нА; C_T<2.0пФ	SOT23,SOD23	A2•K1•K2,A1
D97	BAS70-05	STM	shd×2	V_{BR}>70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.41В; I_R<200нА	SOT23,SOD23	A2•A1•K2,K1
D97	CMPD6263C	CSI	shd×2	I_F=15мА; V_{RRM}=70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.395...0.410В; I_R<200нА; C_T<2.0пФ	SOT23,SOD23	A2•A1•K2,K1
D98	BAS70-06	STM	shd×2	V_{BR}>70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.41В; I_R<200нА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
D98	CMPD6263A	CSI	shd×2	I_F=15мА; V_{RRM}=70В; $V_F(I_F$=1мА)<0.395...0.410В; I_R<200нА; C_T<2.0пФ	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1

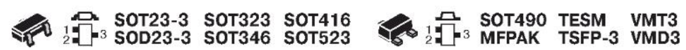
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
DA	BCW67A	ALLEG	pnp	V_{CBO}=45В; I_{CBO}<20нА; h_{21}=100...250; $V_{CE(sat)}$<0.7В; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DA	BCW67A	CDIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DA	BCW67A	ZETEX	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DA	MMBZ4708	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=20.9...23.1В; I_R<0.01мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DA2	CMPD5001	CSI	dih	I_F=400мА; V_R=120В; $V_F(I_F$=100мА)<0.9В; I_R<100нА; t_{RR}<50нс; C_T<35пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DA5	BAR43S	STM	shd×2	V_{BR}>30В; $V_F(I_F$=15мА)<0.45В; I_R<100мкА; C_T=7пФ	SOT23,SOD23	A2•K1•K2,A1
DA5	CMPSH3S	CSI	shd×2	I_F=100мА; V_{RRM}=30В; $V_F(I_F$=100мА)<1.00В; I_R<500нА; C_T=2.0пФ; t_{RR}<5.0нс	SOT23,SOD23	A2•K1•K2,A1
DAs	BCW67A	SIEM	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DB	BCW67B	ALLEG	pnp	V_{CBO}=45В; I_{CBO}<20нА; h_{21}=160...400; $V_{CE(sat)}$<0.7В; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DB	BCW67B	CDIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DB	BCW67B	ZETEX	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DB	BCW67B	SGS	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DB1	BAR43A	STM	shd×2	V_{BR}>30В; $V_F(I_F$=15мА)<0.45В; I_R<100мкА; C_T=7пФ	SOT23,SOD23	K2•K1•A1,A2
DB1	CMPSH3A	CSI	shd×2	I_F=100мА; V_{RRM}=30В; $V_F(I_F$=100мА)<1.00В; I_R<500нА; C_T=2.0пФ; t_{RR}<5.0нс	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
DB2	BAR43C	STM	shd×2	V_{BR}>30В; $V_F(I_F$=15мА)<0.45В; I_R<100мкА; C_T=7пФ	SOT23,SOD23	A2•A1•K1,K2
DB2	CMPSH3C	CSI	shd×2	I_F=100мА; V_{RRM}=30В; $V_F(I_F$=100мА)<1.00В; I_R<500нА; C_T=2.0пФ; t_{RR}<5.0нс	SOT23,SOD23	A2•A1•K2,K1
DB6	BAT46AW	STM	shd×2	V_R<100В; I_F<150мА; $V_F(I_F$=10мА)<0.45мВ; C_D=10пФ	SOT323,SC70	K2•K1•A1,A2
DB6	CMPD2004S	CSI	fih×2	I_F<225мА; V_R=240В; $V_F(I_F$=100мА)<1.0В; I_R<100нА; t_{RR}<50нс; C_T<5.0пФ	SOT23,SOD23	A2•K1•K2,A1
DBs	BCW67B	SIEM	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DC	BCW67C	CDIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DC	BCW67C	ZETEX	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DC	BCW67C	SGS	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DC	MMBZ4695	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=8.27...9.14В; I_R<1мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DCs	BCW67C	SIEM	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DD	2SC2463D	REN	npn	V_{CBO}=55В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
DD	MMBZ4696	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=8.65...9.56В; I_R<1мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DE	2SA1037AKLNE	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=390...820; f_T>140МГц	SOT346,SC59	B•E•C
DE	2SC2463E	REN	npn	V_{CBO}=55В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=400...800	SOT23,SOD23	B•E•C
DE	MMBZ4697	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=9.5...10.5В; I_R<1мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DF	BCW68F	ALLEG	pnp	V_{CBO}=60В; I_{CBO}<20нА; h_{21}=100...250; $V_{CE(sat)}$<0.7В; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DF	BCW68F	CDIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DF	BCW68F	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DF	BCW68F	SGS	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DF	MMBZ4698	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=10.5...11.6В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DFs	BCW68F	SIEM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BCW68G	ALLEG	pnp	V_{CBO}=60В; I_{CBO}<20нА; h_{21}=160...400; $V_{CE(sat)}$<0.7В; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BCW68G	CDIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BCW68G	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BCW68G	SGS	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BRC124ECM	REN	Dnpn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 22к/22к	SOT323,SC70	B•E•C
DG	BRC124EMP	REN	Dnpn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 22к/22к	SOT23,SOD23	B•E•C
DGs	BCW68G	SIEM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	BCW68G	MOT	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	BCW68H	CDIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	BCW68H	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	BCW68H	SGS	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	MMBD2000T1	MOT	di	V_R<30В; I_F<200мА; $V_F(I_F$=10мА)<0.95В; C_D<2пФ; t_{RR}<3нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
DH	MMBZ4699	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=11.4...12.6В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
DHs	BCW68H	SIEM	pnp	V_{CB0}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DI	2SC3867	REN	npn	VCBE=20В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=20...200; f_T>1.4ГГц	SOT346,SC59	E•B•C
DI	MMBD2005T1	MOT	di×2	V_R<30В; I_F<200мА; $V_F(I_F$=10мА)<0.95В	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
DJ	MMBZ4700	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=12.4...13.7В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DK	MMBZ4701	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=13.3...14.7В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DKs	BCX42	SIEM	pnp	V_{CB0}=125В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}>63; f_T=150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DM	MMBZ4702	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=14.3...15.8В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DN	2SK3349	REN	nMOS	V_{DS}=20В; I_D=50мА; P_D=100мВт; $R_{DS(on)}$<7.2Ом	SOT416,SC75A	G•S•D
DN	MMBZ4703	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=15.2...16.8В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DP	2SJ587	REN	pMOS	V_{DS}=20В; I_D=50мА; P_D=100мВт; $R_{DS(on)}$<8.5Ом	SOT416,SC75A	G•S•D
DP	MMBD2010	MOT	di×2	V_R<30В; I_F<200мА; $V_F(I_F$=10мА)<0.95В; C_D<2пФ; t_{RR}<3нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
DP	MMBZ4704	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=16.2...17.9В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DQ	2PB1219AQ	PHIL	pnp	V_{CE0}=60В; I_C=500мА; P_D=200мВт; h_{21}=85...170; f_T>100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
DQ	2PB710AQ	PHIL	pnp	V_{CE0}=50В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=85...170; f_T>100МГц	SOT346,SC59	B•E•C
DR	2PB1219AR	PHIL	pnp	V_{CE0}=60В; I_C=500мА; P_D=200мВт; h_{21}=120...240; f_T>120МГц	SOT323,SC70	B•E•C
DR	2PB710AR	PHIL	pnp	V_{CE0}=50В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=120...240; f_T>120МГц	SOT346,SC59	B•E•C
DR	2SA1037AKLNR	ROHM	pnp	V_{CB0}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=180...390; f_T>140МГц	SOT346,SC59	B•E•C
DR	BCW60BR	ZETEX	npn	V_{CB0}=32В; I_C=200мА; P_D=330мВт; h_{21}=180...310; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
DS	2PB1219AS	PHIL	pnp	V_{CE0}=60В; I_C=500мА; P_D=200мВт; h_{21}=170...340; f_T>140МГц	SOT323,SC70	B•E•C
DS	2PB710AS	PHIL	pnp	V_{CE0}=50В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}=170...340; f_T>140МГц	SOT346,SC59	B•E•C
DS	2SA1037AKLNS	ROHM	pnp	V_{CB0}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=270...560; f_T>140МГц	SOT346,SC59	B•E•C
DT	BCW67AR	SGS	pnp	V_{CB0}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
DT	MMBZ4705	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=17.1...18.9В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DU	BCW67BR	SGS	pnp	V_{CB0}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
DU	MMBZ4706	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=18.1...20.0В; I_R<0.05мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DV	MMBZ4707	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=19.0...21.0В; I_R<0.01мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DW	BCW67CR	SGS	pnp	V_{CB0}=45В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
DX	BCW68FR	SGS	pnp	V_{CB0}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=100...250; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
DY	BCW68GR	SGS	pnp	V_{CB0}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=160...400; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
DY	MMBZ4710	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=23.8...26.3В; I_R<0.01мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
DZ	BCW68HR	SGS	pnp	V_{CB0}=60В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}=250...630; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
DZ	MMBZ4709	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=22.8...25.2В; I_R<0.01мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
E	1SS780	ROHM	sw	40В; 100мА lo leakage	SOT416,SC75	A•K
E	IRLML6402	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=20В; I_D=2.2А; P_D=1.3Вт; $R_{DS(on)}$<0.135Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
E0	HSMP3810	HP	pin	I_F<1А; V_{BR}>100В; R_S<3.0Ом; C_D<0.35пФ; R_H>1500Ом; R_L<10Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
E0	HSMP381B	HP	pin	I_F<1А; V_{BR}>100В; R_T<3.0Ом; CT<0.35пФ; R_H>1500Ом; R_L<10Ом	SOT323,SC70	A•n.c.•K
E1	BFS17	ZETEX	npn	V_{CB0}=25В; I_C=25мА; P_D=330мВт; h_{21}=25...150; f_T>1000МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E1	BFS17	TELEF	npn	V_{CB0}=25В; I_C=25мА; P_D=200мВт; h_{21}=20...150; f_T>1000МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E1	BFS17LT1	MOT	npn	V_{CB0}=15В; I_C=50мА; P_D=200мВт; h_{21}=20...150; f_T>1000МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E1	HSMP3811	HP	pin	I_F<1А; V_{BR}>100В; R_S<3.0Ом; C_D<0.35пФ; R_H>1500Ом; R_L<10Ом	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
E1	MMBZ5231BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20мА)=4.85...5.36В; I_R<5мкА	SOT523	A•n.c.•K
E11	DTA113ZE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>33; f_T>250МГц; R_1/R_2=1/10кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
E11	DTA113ZKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>33; f_T>250МГц; R_1/R_2=1/10кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E13	DTA143ZE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>80; f_T>250МГц; R_1/R_2=4.7/47кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
E13	DTA143ZKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>80; f_T>250МГц; R_1/R_2=4.7/47кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E1H	BFS17H	ZETEX	npn	V_{CB0}=25В; I_C=25мА; P_D=330мВт; h_{21}=70...200; f_T>1000МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E1L	BFS17L	ZETEX	npn	V_{CB0}=25В; I_C=25мА; P_D=330мВт; h_{21}=25...100; f_T>1000МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E1O	KSC2859	SAMS	npn	V_{CB0}=35В; I_C=500мА; P_D=150мВт; h_{21}=70...140; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E1p	BFS17	PHIL	npn	V_{CB0}=25В; I_C=25мА; P_D=330мВт; h_{21}=25...150; f_T>1000МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E1p	BFS17W	PHIL	npn	V_{CB0}=25В; I_C=25мА; P_D=330мВт; h_{21}=25...150; f_T>1000МГц	SOT323,SC70	B•E•C

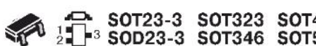
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
E1Y	KSC2859	SAMS	npn	V_{CBO}=35 В; I_C=500 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E2	BAL99	ZETEX	di	V_R<70 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.1 В; I_R<2.5 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	n.c.•K•A
E2	BFS17A	TELEF	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...150; f_T>1000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
E2	HSMP3812	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.0 Ом; C_D<0.37 пФ; R_H>1000 Ом; R_L<8 Ом	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
E2	HSMP381C	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_T<3.0 Ом; CT<0.35 пФ; R_H>1500 Ом; R_L<10 Ом	SOT323,SC70	A1•K2•A2,K1
E2	MMBZ5232BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=5.32...5.88 В; I_R<5 мкА	SOT523	A•n.c.•K
E21	DTC113ZE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
E21	DTC113ZKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E23	DTC143ZCA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
E23	DTC143ZE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
E23	DTC143ZKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E3	1SS190	TOSH	di	V_R<80 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT346,SC59	n.c.•K•A
E3	2SA1688	SANYO	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T>320 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
E3	BAR99	ZETEX	di	V_R<70 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.1 В; I_R<2.5 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K•n.c.•A
E3	HSMP3813	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.0 Ом; C_D<0.37 пФ; R_H>1000 Ом; R_L<8 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
E3	HSMP381E	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_T<3.0 Ом; CT<0.35 пФ; R_H>1500 Ом; R_L<10 Ом	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
E32	DTA123JE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
E32	DTA123JKA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E4	2SA1688	SANYO	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; f_T>320 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
E4	BFS17R	PHIL	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=25 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=25...150; f_T>1000 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
E4	BFS17R	TELEF	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...150; f_T>1000 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
E4	HSMP3814	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.0 Ом; C_D<0.37 пФ; R_H>1000 Ом; R_L<8 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
E4	HSMP381F	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_T<3.0 Ом; CT<0.35 пФ; R_H>1500 Ом; R_L<10 Ом	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
E4	MMBZ5234BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=5.89...6.51 В; I_R<5 мкА	SOT523	A•n.c.•K
E42	DTC123JE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
E42	DTC123JKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E42	DTC123JUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>80; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
E5	2SA1688	SANYO	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=135...270; f_T>320 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
E5	BFS17AR	TELEF	npn	V_{CBO}=25 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...150; f_T>1000 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
E5	MMBZ5235BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=6.46...7.14 В; I_R<3 мкА	SOT523	A•n.c.•K
E56	DTA144VE	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
E56	DTA144VKA	ROHM	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E56	DTA144VUA	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
E6	ZC2800E	ZETEX	shd	V_R<75 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.2 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
E66	DTC144VE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
E66	DTC144VKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E79	DTA115UK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>27; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
E8	PDTB123YK	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; 2.2 кОм/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E8	ZC2811E	ZETEX	shd	V_R<15 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.2 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
E89	DTC115UK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>27; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
E9	ZC5800E	ZETEX	shd	V_R<50 В; $V_F(I_F$=1 мА)<0.41 В; I_R<0.2 мкА; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
E92	DTB123TK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E94	DTB114TK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
E97	DTB163TK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100...600; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
EA	BCW65A	ALLEG	npn	V_{CBO}=60 В; I_{CBO}<20 нА; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





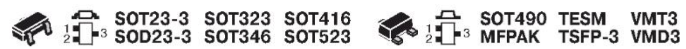
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
EA	BCW65A	CDIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EA	BCW65A	ZETEX	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EA	MMBZ4711	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=25.7...28.4 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
EAs	BCW65A	SIEM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EB	BCW65B	ALLEG	npn	V_{CB0}=60 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EB	BCW65B	CDIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EB	BCW65B	ZETEX	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EB	HSMP4810	HP	pin	I_F<1 А; P_D<250 мВт; V_{BR}>100 В; R_S<3.0 Ом; C_D<0.40 пФ; L_T=1.0 нГ	SOT23,SOD23	K•K•A
EB	MSC1022-B	MOT	pnp	V_{CB0}=20 В; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EBAA	MAX6125EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.7...12.6 В; I_{CC}<130 мкА; V_{OUT}=2.5 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
EBs	BCW65B	SIEM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EC	2SC2732	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; f_T>700 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
EC	2SC4462	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>30; f_T>700 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
EC	BCW65C	CDIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EC	BCW65C	ZETEX	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EC	MMBZ4712	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=26.6...29.4 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
EC	MSC1022-C	MOT	pnp	V_{CB0}=20 В; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ECAA	MAX6141EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.7...12.6 В; I_{CC}<130 мкА; V_{OUT}=4.096 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
ECs	BCW65C	SIEM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ED	MMBZ4713	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=28.5...31.5 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
EDAA	MAX6145EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.7...12.6 В; I_{CC}<130 мкА; V_{OUT}=4.5 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
EDAA	MAX6330SUR	MAX	reg+ mrc	V_{TR}=2.78 В; V_{OUT}=3.0 В; I_{OUT}>50 мА	SOT23,SOD23	GND•RST• SHUNT
EE	MMBZ4714	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=31.4...34.7 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
EEAA	MAX6150EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.7...12.6 В; I_{CC}<130 мкА; V_{OUT}=5.0 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
EF	BCW66F	ALLEG	npn	V_{CB0}=75 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EF	BCW66F	CDIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EF	BCW66F	ZETEX	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EF	MMBZ4715	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=34.2...37.8 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
EFAA	MAX6520EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.4...11 В; TC_{VOUT}<50 ppm/°C; V_{OUT}=1.2 В	SOT23,SOD23	VIN•VOUT• GND
EFs	BCW66F	SIEM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EG	BCW66G	ALLEG	npn	V_{CB0}=75 В; I_{CB0}<20 нА; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EG	BCW66G	CDIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EG	BCW66G	ZETEX	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EG	BRA114ECM	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; 10к/10к	SOT323,SC70	B•E•C
EG	BRA114EMP	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; 10к/10к	SOT23,SOD23	B•E•C
EGs	BCW66G	SIEM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EH	1SS365	SANYO	di	V_R<10 В; I_F<35 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.58 В; I_R<10 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c•K
EH	BCW66H	CDIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EH	BCW66H	ZETEX	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EH	MMBZ4716	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=37.1...41.0 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
EHAA	MAX6326UR22	MAX	mrc	V_{TR}=2.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
EHs	BCW66H	SIEM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EIAA	MAX6327UR22	MAX	mrc	V_{TR}=2.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
EJ	MMBZ4717	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=40.9...45.2 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
EJAA	MAX6328UR22	MAX	mrc	V_{TR}=2.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
EK	BCX41	ZETEX	npn	V_{CB0}=125 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>63; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EKAA	MAX6330LUR	MAX	reg+ mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{OUT}=5.0 В; I_{OUT}>50 мА	SOT23,SOD23	GND•RST• SHUNT
EKs	BCX41	SIEM	npn	V_{CB0}=125 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>63; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ELAA	MAX6331LUR	MAX	reg+ mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{OUT}=5.0 В; I_{OUT}>50 мА	SOT23,SOD23	GND•RST• SHUNT

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
EMAA	MAX6330TUR	MAX	reg+ mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{OUT}=3.3 В; I_{OUT}>50 мА	SOT23,SOD23	GND•RST•SHUNT
EN	2SK3288	REN	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=100 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<7 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
EN	2SK3378	REN	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=100 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<7 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
ENAA	MAX6331TUR	MAX	reg+ mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{OUT}=3.3 В; I_{OUT}>50 мА	SOT23,SOD23	GND•RST•SHUNT
EO	KTC3265	KEC	npn	V_{CBO}=35 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...200; f_T>120 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EPAA	MAX6331SUR	MAX	reg+ mrc	V_{TR}=2.78 В; V_{OUT}=3.0 В; I_{OUT}>50 мА	SOT23,SOD23	GND•RST•SHUNT
ET	BCW65AR	SIEM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
EU	BCW65BR	SIEM	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T=170 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
EW	BCW65CR	SIEM	npn	V_{CBO}=32 В; I_C=800 мА; h_{21}>240; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
EWAA	MAX6326UR23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
EX	BCW65FR	SIEM	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=800 мА; h_{21}>100; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
EXAA	MAX6326UR24	MAX	mrc	V_{TR}=2.4 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
EY	BCW65GR	SIEM	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=800 мА; h_{21}>160; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
EY	KTC3265	KEC	npn	V_{CBO}=35 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=160...320; f_T>120 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
EYAA	MAX6326UR25	MAX	mrc	V_{TR}=2.5 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
EZ	BCW65HR	SIEM	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=800 мА; h_{21}>240; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
EZAA	MAX6326UR26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
F	IRLML6401	IR	pMOS	HEXFET; V_{DS}=12 В; I_D=3.4 А; P_D=1.3 Вт; $R_{DS(on)}$<0.125 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
F	MRF927T1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=10 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
F0	HSMP3820	HP	pin	I_F<1 А; V_{BR}>50 В; R_S<0.6 Ом; C_D<0.8 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
F02	DTD123TK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F03	DTB143TK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100...600; f_T>200 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F04	DTD114TK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F07	DTD163TK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
F1	HSMP3821	HP	pin	I_F<1 А; V_{BR}>50 В; R_S<0.6 Ом; C_D<0.8 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
F1	KST1009F1	SAMS	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=30...60; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F1	MMBC1009F1	MOT	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=30...60	SOT23,SOD23	B•E•C
F1	MMBZ5236BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=7.13...7.88 В; I_R<3 мкА	SOT523	A•n.c.•K
F11	DTB113EK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>200 МГц; R_1/R_2=1/1 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F12	DTB123EK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>39; f_T>200 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F13	DTB143EC	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>47; f_T>200 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
F13	DTB143EK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>47; f_T>200 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F14	DTB114EK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F1O	KSA1182	SAMS	pnp	V_{CBO}=35 В; I_C=500 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...140; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F1p	BFS18	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=35...125; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F1Y	KSA1182	SAMS	pnp	V_{CBO}=35 В; I_C=500 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F2	BFS19	SGS	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=30 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=65...225; f_T=260 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F2	HSMP3822	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>50 В; R_S<0.6 Ом; C_D<0.8 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
F2	KST1009F2	SAMS	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=40...80; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F2	MMBZ5237BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=7.79...8.61 В; I_R<3 мкА	SOT523	A•n.c.•K
F21	DTD113EK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>200 МГц; R_1/R_2=1/1 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F22	DTD123EK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>39; f_T>200 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F23	DTD143EC	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>47; f_T>200 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
F23	DTD143EK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>47; f_T>200 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
F23	DTD143ES	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 47; f_T > 200 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
F23	DTD143TK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T > 200 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F24	DTD114EK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 56; f_T > 200 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F2p	BFS19	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=65...225; f_T=260 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F2t	BFS19	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=65...225; f_T=260 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F3	1SS193	TOSH	di	V_R < 80 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$=100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.5 мкА; t_{RR} < 4 нс	SOT346,SC59	A•n.c.•K
F3	2SC4399	SANYO	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T > 320 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
F3	HSMP3823	HP	pin×2	I_F < 1 А; V_{BR} > 50 В; R_S < 0.6 Ом; C_D < 0.8 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
F3	KST1009F3	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=60...120; f_T > 150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F3	MMBC1009F3	MOT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=60...120	SOT23,SOD23	B•E•C
F4	2SC4399	SANYO	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; f_T > 320 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
F4	BFS18R	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=110 мВт; h_{21}=35; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
F4	HSMP3824	HP	pin×2	I_F < 1 А; V_{BR} > 50 В; R_S < 0.6 Ом; C_D < 0.8 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
F4	KST1009F4	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=90...180; f_T > 150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F4	MMBZ5239BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.65...9.56 В; I_R < 3 мкА	SOT523	A•n.c.•K
F5	1SS250	TOSH	di	V_R < 200 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$=100 мА) < 1.2 В; I_R < 1.0 мкА; t_{RR} < 60 нс	SOT346,SC59	A•n.c.•K
F5	1SS370	TOSH	di	V_R < 200 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F$=100 мА) < 1.2 В; t_{RR} < 60 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
F5	2SC4399	SANYO	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=135...270; f_T > 320 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
F5	BFS19R	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=225; f_T=260 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
F5	KST1009F5	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=135...270; f_T > 150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F5	MMBZ5240BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=9.5...10.5 В; I_R < 3 мкА	SOT523	A•n.c.•K
F52	DTB123YC	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T > 200 МГц; R_1=2.2 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
F52	DTB123YK	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 56; f_T > 200 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F62	DTD123YK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 56; f_T > 200 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F7	BAV99RWT1	ON	di×2	V_R < 70 В; I_F < 215 мА; $V_F(I_F$=150 мА) < 1.25 В; I_R < 2 мкА; t_{RR} < 4 нс	SOT323,SC70	A1•K1,A2•K2
F8	BF824W	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 25; f_T > 400 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
F8p	BF824	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=25 мА; P_D=250 мВт; f_T=450	SOT23,SOD23	B•E•C
F8t	BF824	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=25 мА; P_D=250 мВт; f_T=450	SOT23,SOD23	B•E•C
F9	1SS321	TOSH	shd×2	V_R > 10 В; $V_F(I_F$=50 мА) < 1.0 В; $I_R(V_R$=10 В) < 0.5 мкА; C_T < 4.5 пФ	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
F9	2SA1774	ON	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...560; f_T=140 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
F92	DTB123TK	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T > 200 МГц; R_1=2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
F93	DTB143TK	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 100...600; f_T > 200 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
FA	2SC5851A	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=35...75; f_T=230 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FA	HSMP4820	HP	pin	I_F < 1 А; P_D < 250 мВт; V_{BR} > 50 В; R_S < 0.6 Ом; C_D < 1.0 пФ; L_T=1.0 нГ	SOT23,SOD23	A•A•K
FAAA	MAX6326UR27	MAX	mrc	V_{TR}=2.7 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FB	2SC5851B	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T=230 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FBAA	MAX6326UR28	MAX	mrc	V_{TR}=2.8 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FC	2SC5851C	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...200; f_T=230 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FCAA	MAX6326UR29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FD	BCV26	SGS	dpnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21} > 10000; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FDAA	MAX6326UR31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FDp	BCV26	PHIL	dpnp	V_{CB0}=40 В; I_C=300 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 20000; f_T=220 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FDs	BCV26	INF	dpnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21} > 10000; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FDt	BCV26	PHIL	dpnp	V_{CB0}=40 В; I_C=300 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 20000; f_T=220 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FE	BCV46	SGS	dpnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21} > 400; f_T > 200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FEAA	MAX6326UR30	MAX	mrc	V_{TR}=3.0 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}

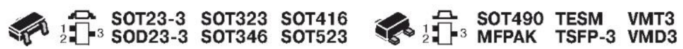
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FEp	BCV46	PHIL	dpnp	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; P_D=250мВт; $h_{21}>4000$; f_T=220МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FEs	BCV46	INF	dpnp	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; P_D=360мВт; $h_{21}>4000$; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FEt	BCV46	PHIL	dpnp	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; P_D=250мВт; $h_{21}>4000$; f_T=220МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FF	BCV27	SGS	dnpn	V_{CBO}=40В; I_C=500мА; P_D=330мВт; $h_{21}>100$; $f_T>170$МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FF	JDV3C11	TOSH	var×2	$V_R<20$В; $I_R<0.01$мкА; $C_{1В}$=65.8...74.2пФ; $C_{4.5В}$=11.5...14.3	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
FFAA	MAX6327UR23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FFMA	MAX6327UR31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FFNA	MAX6327UR30	MAX	mrc	V_{TR}=3.0В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FFp	BCV27	PHIL	dnpn	V_{CBO}=40В; I_C=300мА; P_D=250мВт; $h_{21}>20000$; f_T=220МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FFs	BCV27	INF	dnpn	V_{CBO}=40В; I_C=500мА; P_D=360мВт; $h_{21}>10000$; f_T=170МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FFt	BCV27	PHIL	dnpn	V_{CBO}=40В; I_C=300мА; P_D=250мВт; $h_{21}>20000$; f_T=220МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FG	BRC114ECM	REN	Dnpn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; $h_{21}>30$; 10к/10к	SOT323,SC70	B•E•C
FG	BRC114EMP	REN	Dnpn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; $h_{21}>30$; 10к/10к	SOT23,SOD23	B•E•C
FGAA	MAX6327UR24	MAX	mrc	V_{TR}=2.4В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FGp	BCV47	PHIL	dnpn	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; P_D=250мВт; $h_{21}>4000$; f_T=220МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FGs	BCV47	INF	dnpn	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; P_D=360мВт; $h_{21}>4000$; f_T=170МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FGt	BCV47	PHIL	dnpn	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; P_D=250мВт; $h_{21}>4000$; f_T=220МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FH	1SS366	SANYO	shd×2	$V_R>10$В; $V_F(I_F$=10мА$)<0.58$В; $I_R(V_R$=10В$)<10$мкА	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
FH	1SS375	SANYO	shd×2	$V_R>10$В; $V_F(I_F$=10мА$)<0.58$В; $I_R(V_R$=10В$)<10$мкА	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
FHAA	MAX6327UR25	MAX	mrc	V_{TR}=2.5В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FHs	BFN24	SIEM	npn	V_{CBO}=250В; I_C=200мА; P_D=360мВт; $h_{21}>40$; f_T=70МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FIAA	MAX6327UR26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FJAA	MAX6327UR27	MAX	mrc	V_{TR}=2.7В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FJs	BFN26	SIEM	npn	V_{CBO}=300В; I_C=200мА; P_D=360мВт; $h_{21}>30$; f_T=70МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FKAA	MAX6327UR28	MAX	mrc	V_{TR}=2.8В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FKs	BFN25	SIEM	pnp	V_{CBO}=250В; I_C=200мА; P_D=360мВт; $h_{21}>40$; f_T=100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FLAA	MAX6327UR29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FLs	BFN27	SIEM	pnp	V_{CBO}=300В; I_C=200мА; P_D=360мВт; $h_{21}>30$; f_T=100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FO	2SC2716O	TOSH	npn	V_{CEO}=35В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=70...140; $f_T>80$МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FOAA	MAX6328UR23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FPAA	MAX6328UR24	MAX	mrc	V_{TR}=2.4В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FQ	2SA1037AKQ	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=120...270; $f_T>140$МГц	SOT346,SC59	B•E•C
FQ	2SA1576AQ	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=120...270; $f_T>140$МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FQ	2SA1774	ROHM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=120...270; $f_T>140$МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
FQ	2SA2029Q	ROHM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=120...270; $f_T>140$МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
F-Q	2PA1576Q	PHIL	pnp	V_{CEO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=120...270; f_T=100МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FQAA	MAX6328UR25	MAX	mrc	V_{TR}=2.5В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FR	2SA1034R	PAN	pnp	V_{CBO}=35В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=180...360; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FR	2SA1037AKR	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=180...390; $f_T>140$МГц	SOT346,SC59	B•E•C
FR	2SA1531R	PAN	pnp	V_{CBO}=35В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=180...360; f_T=80МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FR	2SA1576AR	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=180...390; $f_T>140$МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FR	2SA1774	ROHM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=180...390; $f_T>140$МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
FR	2SA2029R	ROHM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=180...390; $f_T>140$МГц	VMT3,VMD3	B•E•C
FR	2SC2716R	TOSH	npn	V_{CEO}=35В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21}=40...80; $f_T>80$МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
F-R	2PA1576R	PHIL	pnp	V_{CEO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=180...390; $f_T>100$МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FRAA	MAX6328UR26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; $I_{CC}<1.75$мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FS	2SA1034S	PAN	pnp	V_{CBO}=35В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=260...520; f_T=200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FS	2SA1037AKS	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=270...560; $f_T>140$МГц	SOT346,SC59	B•E•C
FS	2SA1531S	PAN	pnp	V_{CBO}=35В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=260...520; f_T=80МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FS	2SA1576AS	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=270...560; $f_T>140$МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FS	2SA1774	ROHM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=200мВт; h_{21}=270...560; $f_T>140$МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
FS	2SA2029S	ROHM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=150мА; P_D=150мВт; h_{21}=270...560; $f_T>140$МГц	VMT3,VMD3	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
F-S	2PA1576S	PHIL	pnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FS-	2SC5890	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=75 мА; P_D=700 мВт; h_{21}=100...200; f_T>5.5 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FSAA	MAX6328UR27	MAX	mrc	V_{TR}=2.7 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FT	2SA1034T	PAN	pnp	V_{CB0}=35 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=360...700; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FT	2SA1531T	PAN	pnp	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=360...700; f_T=80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FTAA	MAX6328UR28	MAX	mrc	V_{TR}=2.8 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FtQ	2PA1576Q	PHIL	pnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T=100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FtR	2PA1576R	PHIL	pnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FtS	2PA1576S	PHIL	pnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
FUAA	MAX6328UR29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FV	1SV248	SANYO	pin	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.92 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A•n.c.•K
FV	1SV250	SANYO	pin	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.92 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
FVAA	MAX6328UR31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FWAA	MAX6328UR30	MAX	mrc	V_{TR}=3.0 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FY	2SC2716Y	TOSH	npn	V_{CE0}=35 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
FZAP	MAX6012AEUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6 В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=1.247 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZAQ	MAX6025AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6 В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=2.500 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZAR	MAX6041AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6 В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=4.096 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZAS	MAX6045AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6 В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=4.500 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZAT	MAX6050AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6 В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=5.000 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZAU	MAX6021AEUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6 В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=2.048 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZAV	MAX6346UR33	MAX	mrc	V_{TR}=3.3 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZAW	MAX6346UR34	MAX	mrc	V_{TR}=3.4 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZAX	MAX6346UR35	MAX	mrc	V_{TR}=3.5 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZAY	MAX6346UR36	MAX	mrc	V_{TR}=3.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZAZ	MAX6346UR37	MAX	mrc	V_{TR}=3.7 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBA	MAX6346UR38	MAX	mrc	V_{TR}=3.8 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBB	MAX6346UR39	MAX	mrc	V_{TR}=3.9 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBC	MAX6346UR40	MAX	mrc	V_{TR}=4.0 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBD	MAX6346UR41	MAX	mrc	V_{TR}=4.1 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBE	MAX6346UR42	MAX	mrc	V_{TR}=4.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBF	MAX6346UR43	MAX	mrc	V_{TR}=4.3 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBG	MAX6346UR44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBH	MAX6346UR45	MAX	mrc	V_{TR}=4.5 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBI	MAX6346UR46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBJ	MAX6347UR33	MAX	mrc	V_{TR}=3.3 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBK	MAX6347UR34	MAX	mrc	V_{TR}=3.4 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBL	MAX6347UR35	MAX	mrc	V_{TR}=3.5 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBM	MAX6347UR36	MAX	mrc	V_{TR}=3.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBN	MAX6347UR37	MAX	mrc	V_{TR}=3.7 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBO	MAX6347UR38	MAX	mrc	V_{TR}=3.8 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBP	MAX6347UR39	MAX	mrc	V_{TR}=3.9 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBQ	MAX6347UR40	MAX	mrc	V_{TR}=4.0 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBR	MAX6347UR41	MAX	mrc	V_{TR}=4.1 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBS	MAX6347UR42	MAX	mrc	V_{TR}=4.2 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBT	MAX6347UR43	MAX	mrc	V_{TR}=4.3 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBU	MAX6347UR44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBV	MAX6347UR45	MAX	mrc	V_{TR}=4.5 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBW	MAX6347UR46	MAX	mrc	V_{TR}=4.6 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBX	MAX6348UR33	MAX	mrc	V_{TR}=3.3 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBY	MAX6348UR34	MAX	mrc	V_{TR}=3.4 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZBZ	MAX6348UR35	MAX	mrc	V_{TR}=3.5 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}

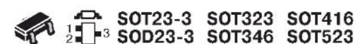
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FZCA	MAX6348UR36	MAX	mrc	V_{TR}=3.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCB	MAX6348UR37	MAX	mrc	V_{TR}=3.7В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCC	MAX6348UR38	MAX	mrc	V_{TR}=3.8В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCD	MAX6348UR39	MAX	mrc	V_{TR}=3.9В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCE	MAX6348UR40	MAX	mrc	V_{TR}=4.0В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCF	MAX6348UR41	MAX	mrc	V_{TR}=4.1В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCG	MAX6348UR42	MAX	mrc	V_{TR}=4.2В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCH	MAX6348UR43	MAX	mrc	V_{TR}=4.3В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCI	MAX6348UR44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCJ	MAX6348UR45	MAX	mrc	V_{TR}=4.5В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCK	MAX6348UR46	MAX	mrc	V_{TR}=4.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCL	MAX6332UR16D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCM	MAX6332UR18D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.8В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCN	MAX6332UR22D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.2В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCO	MAX6333UR16D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCP	MAX6333UR18D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.8В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCQ	MAX6333UR20D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.0В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCR	MAX6333UR22D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.2В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCS	MAX6333UR23D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.3В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCT	MAX6334UR16D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCU	MAX6334UR18D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.8В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCV	MAX6334UR22D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.2В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZCW	MAX6001EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В; I_{OUT}=±400 мкА; V_{OUT}=1.250В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZCW	MAZ6001UR	MAX	vref	V_{OUT}=1.250В	SOT23,SOD23	+·-·n.c.
FZCX	MAX6002EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; I_{OUT}=±400 мкА; V_{OUT}=2.500В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZCX	MAZ6002UR	MAX	vref	V_{OUT}=2.500В	SOT23,SOD23	+·-·n.c.
FZCY	MAX6004EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; I_{OUT}=±400 мкА; V_{OUT}=4.096В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZCY	MAZ6004UR	MAX	vref	V_{OUT}=4.096В	SOT23,SOD23	+·-·n.c.
FZCZ	MAX6005EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; I_{OUT}=±400 мкА; V_{OUT}=5.000В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZCZ	MAZ6005UR	MAX	vref	V_{OUT}=5.000В	SOT23,SOD23	+·-·n.c.
FZDA	MAX6012BEUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В; TC_{VOUT}<30ppm/°C; V_{OUT}=1.247В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDB	MAX6025BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30ppm/°C; V_{OUT}=2.500В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDC	MAX6041BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30ppm/°C; V_{OUT}=4.096В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDD	MAX6045BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30ppm/°C; V_{OUT}=4.500В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDE	MAX6050BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30ppm/°C; V_{OUT}=5.000В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDF	MAX6021BEUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В; TC_{VOUT}<30ppm/°C; V_{OUT}=2.048В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDK	MAX6003EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; I_{OUT}=±400 мкА; V_{OUT}=3.000В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDK	MAZ6003UR	MAX	vref	V_{OUT}=3.000В	SOT23,SOD23	+·-·n.c.
FZDL	MAX6332UR20D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.0В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZDM	MAX6332UR23D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.3В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZDN	MAX6334UR20D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.0В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZDO	MAX6334UR23D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.3В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}
FZDP	MAX6806UR46	MAX	vd	V_{TR}=4.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<80 мкА	SOT23,SOD23	RST·GND·V_{CC}
FZDQ	MAX6806UR26	MAX	vd	V_{TR}=2.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<80 мкА	SOT23,SOD23	RST·GND·V_{CC}
FZDR	MAX6806UR23	MAX	vd	V_{TR}=2.3В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<80 мкА	SOT23,SOD23	RST·GND·V_{CC}
FZDS	MAX6807UR46	MAX	vd	V_{TR}=4.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<80 мкА	SOT23,SOD23	RST·GND·V_{CC}
FZDT	MAX6807UR26	MAX	vd	V_{TR}=2.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<80 мкА	SOT23,SOD23	RST·GND·V_{CC}
FZDU	MAX6808UR46	MAX	vd	V_{TR}=4.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<80 мкА	SOT23,SOD23	RST·GND·V_{CC}
FZDV	MAX6808UR26	MAX	vd	V_{TR}=2.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<80 мкА	SOT23,SOD23	RST·GND·V_{CC}
FZDW	MAX6030AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<20ppm/°C; V_{OUT}=3.000В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDX	MAX6030BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30ppm/°C; V_{OUT}=3.000В	SOT23,SOD23	IN·OUT·GND
FZDY	MAX6334UR17D3	MAX	mrc	V_{TR}=1.7В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND·RST·V_{CC}





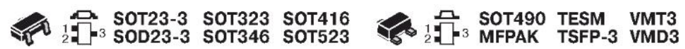
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FZEA	MAX6333UR25D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZEB	LM4041AIM3-1.2	MAX	vref	V_{OUT}=1.225 В; ACC=0.1 %	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEC	LM4041BIM3-1.2	MAX	vref	V_{OUT}=1.225 В; ACC=0.2 %	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZED	LM4041CIM3-1.2	MAX	vref	V_{OUT}=1.225 В; ACC=0.5 %	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEE	LM4041DIM3-1.2	MAX	vref	V_{OUT}=1.225 В; ACC=1.0 %	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEF	LM4040AIM3-2.1	MAX	vref	V_{OUT}=2.048 В; ACC=0.1%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEG	LM4040BIM3-2.1	MAX	vref	V_{OUT}=2.048 В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEH	LM4040CIM3-2.1	MAX	vref	V_{OUT}=2.048 В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEI	LM4040DIM3-2.1	MAX	vref	V_{OUT}=2.048 В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEJ	LM4040AIM3-2.5	MAX	vref	V_{OUT}=2.500 В; ACC=0.1%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEK	LM4040BIM3-2.5	MAX	vref	V_{OUT}=2.500 В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEL	LM4040CIM3-2.5	MAX	vref	V_{OUT}=2.500 В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEM	LM4040DIM3-2.5	MAX	vref	V_{OUT}=2.500 В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEN	LM4040AIM3-3.0	MAX	vref	V_{OUT}=3.000 В; ACC=0.1%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEO	LM4040BIM3-3.0	MAX	vref	V_{OUT}=3.000 В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEP	LM4040CIM3-3.0	MAX	vref	V_{OUT}=3.000 В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEQ	LM4040DIM3-3.0	MAX	vref	V_{OUT}=3.000 В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZER	LM4040AIM3-4.1	MAX	vref	V_{OUT}=4.096 В; ACC=0.1%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZES	LM4040BIM3-4.1	MAX	vref	V_{OUT}=4.096 В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZET	LM4040CIM3-4.1	MAX	vref	V_{OUT}=4.096 В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEU	LM4040DIM3-4.1	MAX	vref	V_{OUT}=4.096 В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEV	LM4040AIM3-5.0	MAX	vref	V_{OUT}=5.000 В; ACC=0.1%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEW	LM4040BIM3-5.0	MAX	vref	V_{OUT}=5.000 В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEX	LM4040CIM3-5.0	MAX	vref	V_{OUT}=5.000 В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEY	LM4040DIM3-5.0	MAX	vref	V_{OUT}=5.000 В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZEZ	MAZ803LUR	MAX	mrc	V_{TR}=5.0 В	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZFA	MAZ803MUR	MAX	mrc	V_{TR}=5.0 В	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZFB	MAZ803TUR	MAX	mrc	V_{TR}=3.3 В	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZFC	MAZ803SUR	MAX	mrc	V_{TR}=3.3 В	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZFD	MAZ803RUR	MAX	mrc	V_{TR}=3.0 В	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZFL	MAX6808UR32	MAX	vd	V_{TR}=3.2В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<80 мкА	SOT23,SOD23	RST•GND•V_{CC}
FZFM	MAX6066AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=2.500В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFN	MAX6066BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30 ppm/°C; V_{OUT}=2.500В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFP	MAX6061AEUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=1.248В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFQ	MAX6061BEUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В; TC_{VOUT}<30 ppm/°C; V_{OUT}=1.248В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFS	MAX6067AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=4.500В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFT	MAX6067BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30 ppm/°C; V_{OUT}=4.500В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFV	MAX6063AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=3.000В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFW	MAX6063BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30 ppm/°C; V_{OUT}=3.000В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFY	MAX6062AEUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В;R[-33]C TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=2.048В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZFZ	MAX6062BEUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В; TC_{VOUT}<30 ppm/°C; V_{OUT}=2.048В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGB	MAX6064AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=4.096В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGC	MAX6064BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30 ppm/°C; V_{OUT}=4.096В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGE	MAX6065AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<20 ppm/°C; V_{OUT}=5.000В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGF	MAX6065BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30 ppm/°C; V_{OUT}=5.000В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGH	MAX6006AEUR	MAX	vref	ACC=0.2%; I_{OUT}=±400 мкА; V_{OUT}=1.25В	SOT23,SOD23	OUT•GND•i.c.
FZGH	MAZ6006AUR	MAX	vref	V_{OUT}=1.250В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGI	MAX6006BEUR	MAX	vref	ACC=0.5%; I_{OUT}=±400 мкА; V_{OUT}=1.25В	SOT23,SOD23	OUT•GND•i.c.
FZGI	MAZ6006BUR	MAX	vref	V_{OUT}=1.250В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGJ	MAZ6006CUR	MAX	vref	V_{OUT}=1.250В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGK	MAX6007AEUR	MAX	vref	ACC=0.2%; I_{OUT}=±400 мкА; V_{OUT}=2.048 В	SOT23,SOD23	OUT•GND•i.c.
FZGK	MAZ6007AUR	MAX	vref	V_{OUT}=2.480В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FZGL	MAX6007BEUR	MAX	vref	ACC=0.5%; I_{OUT}=±400мкА; V_{OUT}=2.048В	SOT23,SOD23	OUT•GND•i.c.
FZGL	MAZ6007BUR	MAX	vref	V_{OUT}=2.480В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGM	MAZ6007CUR	MAX	vref	V_{OUT}=2.480В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGN	MAX6008AEUR	MAX	vref	ACC=0.2%; I_{OUT}=±400мкА; V_{OUT}=2.5В	SOT23,SOD23	OUT•GND•i.c.
FZGN	MAZ6008AUR	MAX	vref	V_{OUT}=2.500В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGO	MAX6008BEUR	MAX	vref	ACC=0.5%; I_{OUT}=±400мкА; V_{OUT}=2.5В	SOT23,SOD23	OUT•GND•i.c.
FZGO	MAZ6008BUR	MAX	vref	V_{OUT}=2.500В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGP	MAZ6008CUR	MAX	vref	V_{OUT}=2.500В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGQ	MAX6009AEUR	MAX	vref	ACC=0.2%; I_{OUT}=±400мкА; V_{OUT}=3.0В	SOT23,SOD23	OUT•GND•i.c.
FZGQ	MAZ6009AUR	MAX	vref	V_{OUT}=3.000В; ACC=0.2%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGR	MAX6009BEUR	MAX	vref	ACC=0.5%; I_{OUT}=±400мкА; V_{OUT}=3.0В	SOT23,SOD23	OUT•GND•i.c.
FZGR	MAZ6009BUR	MAX	vref	V_{OUT}=3.000В; ACC=0.5%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGS	MAZ6009CUR	MAX	vref	V_{OUT}=3.000В; ACC=1.0%	SOT23,SOD23	+•-•n.c.
FZGT	MAX6101EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В; I_{CC}<125мкА; V_{OUT}=1.250В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGU	MAX6102EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; I_{CC}<125мкА; V_{OUT}=2.500В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGV	MAX6103EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; I_{CC}<125мкА; V_{OUT}=3.000В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGW	MAX6104EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; I_{CC}<125мкА; V_{OUT}=4.096В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGX	MAX6105EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; I_{CC}<125мкА; V_{OUT}=5.000В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZGY	MAX6334UR16D2	MAX	mrc	V_{TR}=1.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZHA	MAX6333UR24D1	MAX	mrc	V_{TR}=2.4В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<7 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZHC	MAX6375UR26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHD	MAX6375UR22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHE	MAX6375UR23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHF	MAX6375UR29	MAX	vd	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHG	MAX6375UR31	MAX	vd	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHH	MAX6376UR22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHI	MAX6376UR23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHJ	MAX6376UR26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHK	MAX6376UR29	MAX	vd	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHL	MAX6376UR31	MAX	vd	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHM	MAX6377UR22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHN	MAX6377UR23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHO	MAX6377UR26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHP	MAX6377UR29	MAX	vd	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHQ	MAX6377UR31	MAX	vd	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHR	MAX6377UR27	MAX	vd	V_{TR}=2.70В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHS	MAX6377UR24	MAX	vd	V_{TR}=2.40В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHT	MAX6377UR28	MAX	vd	V_{TR}=2.80В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHU	MAX6378UR44	MAX	vd	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHV	MAX6378UR46	MAX	vd	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHW	MAX6379UR44	MAX	vd	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHX	MAX6379UR46	MAX	vd	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHY	MAX6380UR44	MAX	vd	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZHZ	MAX6380UR46	MAX	vd	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZIA	MAX6380UR42	MAX	vd	V_{TR}=4.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	SOT23,SOD23	OUT•GND•V_{CC}
FZIB	MAX6068AEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<20ppm/°C; V_{OUT}=1.800В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZIC	MAX6068BEUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6В; TC_{VOUT}<30ppm/°C; V_{OUT}=1.800В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZID	MAX6100EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6В; I_{CC}<125мкА; V_{OUT}=1.800В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZIE	MAX6800UR26D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<12мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIF	MAX6800UR29D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<12мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIG	MAX6800UR31D3	MAX	mrc	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<12мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIH	MAX6800UR44D3	MAX	mrc	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<12мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FZII	MAX6800UR46D3	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIK	MAX6801UR26D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIL	MAX6801UR29D2	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIM	MAX6801UR29D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIN	MAX6801UR31D3	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIO	MAX6801UR44D3	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIP	MAX6801UR46D3	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIQ	MAX6802UR26D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIS	MAX6802UR31D3	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIT	MAX6802UR44D3	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZIU	MAX6802UR46D3	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<12 мкА	SOT23,SOD23	GND•RST•V_{CC}
FZJR	MAX6106EUR	MAX	vref	V_{IN}=2.5...12.6 В; I_{CC}<125 мкА; V_{OUT}=2.048 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
FZMV	MAX6107EUR	MAX	vref	V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6 В; I_{CC}<125 мкА; V_{OUT}=4.500 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
G	IRLML2502	IR	nMOS	HEXFET; V_{DS}=30 В; I_D=3.4 А; P_D=1.25 Вт; $R_{DS(on)}$<0.08 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
G	MRF947AT1	MOT	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=188 мВт; h_{21}=75...150; f_T=8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
G0	HSMP3890	HP	pin	I_F<1 А; P_D<250 мВт; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; C_D<0.30 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G0	HSMP389B	HP	pin	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; CT<0.30 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
G08	DTD133HK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_1/R_2=3.3/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
G1	BFS20	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=25 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...85; f_T>450 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G1	MMBT5551	MOT	npn	V_{CBO}=160 В; I_C=600 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=80...250	SOT23,SOD23	B•E•C
G1	MMBZ5226BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=3.14...3.47 В; I_R<25 мкА	SOT523	A•n.c.•K
G10	NDS0610	NS	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=120 мА; P_D=360 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
G11	DTB113ZK	ROHM	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
G17	MMBZ4617	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=2.4 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1400 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G18	MMBZ4618	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=2.7 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1500 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G19	MMBZ4619	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=3.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1600 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G1E	BC847A	ROHM	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G1F	BC847B	ROHM	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G1G	BC847C	ROHM	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G1J	BC848A	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G1K	BC848B	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G1K	BC848BW	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T=200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
G1L	BC848C	ROHM	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G1p	BFS20	PHIL	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=25 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T=450 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G1t	HSMP3891	HP	pin	I_F<1 А; P_D<250 мВт; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; C_D<0.30 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
G2	HSMP3892	HP	pin×2	I_F<1 А; P_D<250 мВт; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; C_D<0.30 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
G2	HSMP389C	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; CT<0.30 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
G2	MMBZ5227BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=3.42...3.78 В; I_R<15 мкА	SOT523	A•n.c.•K
G20	MMBZ4620	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=3.3 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1650 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G21	DTD113ZK	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
G21	DTD113ZU	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
G21	MMBZ4621	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=3.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1700 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G22	MMBZ4622	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=3.9 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1650 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G23	MMBZ4623	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=4.3 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1600 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G24	MMBZ4624	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=4.7 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1550 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G25	MMBZ4625	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.1 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1500 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G26	MMBZ4626	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1400 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G27	MMBZ4627	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.2 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<1200 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G3	1SS196	TOSH	di	V_R<80 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT346,SC59	n.c.•A•K
G3	BAR63	SIEM	pin	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.05 мкА; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
G3	HSMP3893	HP	pin×2	I_F<1 А; P_D<250 мВт; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; C_D<0.30 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2

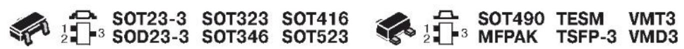
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
G3	HSMP389E	HP	pin-2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; СТ<0.30 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
G3	MMBZ5228BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=3.71...4.10 В; I_R<10 мкА	SOT523	А•n.c.•К
-G3	PMST5551	PHIL	npn	V_{CB0}=180 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=80...250; f_T=100...300 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
G3C	DTB122JK	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>47; f_T>250 МГц; R_1/R_2=0.22/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
G3E	BC857A	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G3F	BC857B	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G3FQ	2SA1037AKQLT1	LRC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>140 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G3FR	2SA1037AKRLT1	LRC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>140 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G3FS	2SA1037AKSLT1	LRC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>140 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G3J	BC858A	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G3K	BC858B	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G3K	BC858BW	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
G3L	BC858C	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G4	BAR6304	SIEM	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.05 мкА; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
G4	BFS20R	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=25 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T=450 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G4	HSMP3894	HP	pin-2	I_F<1 А; P_D<250 мВт; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; C_D<0.30 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
G4	HSMP389F	HP	pin-2	I_F<1 А; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; СТ<0.30 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
G4	MMBZ5229BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=4.09...4.52 В; I_R<5 мкА	SOT523	А•n.c.•К
G4C	DTD122JK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>47; f_T>200 МГц; R_1/R_2=0.22/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
G4C	DTD122JK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>47; f_T>200 МГц; R_1/R_2=0.22/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
G4s	BAR63-04	INF	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
G4s	BAR63-04W	INF	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.01 мкА	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
G5	BAR6305	SIEM	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.05 мкА; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
G5	MMBZ5230BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=4.47...4.94 В; I_R<5 мкА	SOT523	А•n.c.•К
G5s	BAR63-05	INF	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
G5s	BAR63-05W	INF	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.01 мкА	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
G6	BAR6306	SIEM	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.05 мкА; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
G6A	BC817-16	TOSH	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...250; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G6B	BC817-25	TOSH	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=160...400; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G6s	BAR63-06	INF	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.01 мкА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
G6s	BAR63-06W	INF	pin-2	V_R<50 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; I_R<0.01 мкА	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
G7	BF579	VIS	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...90; f_T=1750 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
G98	DTB133HK	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_1/R_2=3.3/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
GA	HSMP4890	HP	pin	I_F<1 А; P_D<250 мВт; V_{BR}>100 В; R_S<2.5 Ом; C_D<0.375 пФ; L_T=1.0 нГ	SOT23,SOD23	А•А•К
GAB	BCW60B	ROHM	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GAC	BCW60C	ROHM	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GAD	BCW60D	ROHM	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GAH	BCX70H	ROHM	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GAJ	BCX70J	ROHM	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GAK	BCX70K	ROHM	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GBB	BCW61B	ROHM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GBC	BCW61C	ROHM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GBG	BCX71G	ROHM	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...220; f_T=250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GBH	BCX71H	ROHM	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=180...310; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GBJ	BCX71J	ROHM	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GC	2SC2734	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=20...200; f_T>1.4 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
GC	2SC4264	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=20...200; f_T>1.4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
GC1	BCW29	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...260	SOT23,SOD23	B•E•C
GC2	BCW30	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=215...500; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
GD1	BCW31	ROHM	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GD2	BCW32	ROHM	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GD3	BCW33	ROHM	npn	V_{CB0}=32 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GE	2SA1455KE	ROHM	pnp	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390...820; f_T>140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
GEC	BCW65C	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GEs	BFR35AP	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=40...200; f_T=5000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GFs	BFR92P	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=40...200; f_T=5000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GG	BF579R	VIS	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...90; f_T=1750 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
GG	BFR93P	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GG	BRA143ECM	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; 4.7 к/4.7 к	SOT323,SC70	B•E•C
GG	BRA143EMP	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; 4.7 к/4.7 к	SOT23,SOD23	B•E•C
GH1	BCW69	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...260; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GH2	BCW70	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=215...500; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GK1	BCW71	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GK2	BCW72	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GLP	MMBT1010LT1	MOT	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>300	SOT23,SOD23	B•E•C
GLP	MSD1010T1	ETL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>300	SOT346,SC59	B•E•C
GMA	BFS17	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=25 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=25...150; f_T>1000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GR	2SA1455KR	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
GS	2SA1455KS	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
GT1	BC846AT	CNTRL	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT523	B•E•C
GT1	BCX17	ROHM	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GT2	BC846BT	CNTRL	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT523	B•E•C
GT2	BCX18	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GT3	BC847AT	CNTRL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT523	B•E•C
GT4	BC847BT	CNTRL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT523	B•E•C
GT5	BC847CT	CNTRL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT523	B•E•C
GU1	BCX19	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GU2	BCX20	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
GV	1SV249	SANYO	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.92 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
GV	1SV251	SANYO	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.92 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
H	MRF947BT1	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=188 мВт; h_{21}=100...200; f_T=8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
H02	DTC323TK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
H02	DTC323TU	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=2.2 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
H03	DTC343TK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
H04	DTC314TK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
H04	DTC314TU	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
H07	DTC363TK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц; R_1=6.8 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
H1	BCW69	ALLEG	pnp	V_{CB0}=50 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=120...260; $V_{CE(sat)}$<0.3 В	SOT23,SOD23	B•E•C
H1	BCW69	CDIL	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H1	BCW69	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...260; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H1	MMBZ5241BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=10.45...11.55 В; I_R<2 мкА	SOT523	A•n.c.•K
H1	SST4416	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=5...15 мА; g_F=4.5 мСм; $R_{DS(on)}$=150 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
H1O	KSC2755	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...140; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H1p	BCW69	PHIL	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H1R	KSC2755	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...80; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H1t	BCW69	PHIL	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H1Y	KSC2755	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H2	BCW70	ALLEG	pnp	V_{CB0}=50 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=215...500; $V_{CE(sat)}$<0.3 В	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
H2	BCW70	CDIL	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H2	BCW70	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=215...500; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H2	MMBZ5242BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=11.4...12.6 В; I_R<1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
H21	2SJ463A	NEC	pMOS	V_{DS}=30 В; I_D=100 мА; P_D=150 мВт; $R_{DS(on)}$<23 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
H27	DTC363EK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>200 МГц; R_1/R_2=6.8/6.8 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
H27	DTC363EU	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>200 МГц; R_1/R_2=6.8/6.8 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
H2O	KSC2756	SAMS	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; f_T>850 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H2p	BCW70	PHIL	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H2R	KSC2756	SAMS	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T>850 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H2t	BCW70	PHIL	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H2Y	KSC2756	SAMS	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>850 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H3	2SA956H3	NEC	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=80...130; fT>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H3	BCW89	CDIL	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H3	BCW89	ZETEX	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...260; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H3	KDV153	KEC	bd	V_R=20 В; I_R=10 нА; C2 В=15 пФ; C10 В=5 пФ; R_S<0.6 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
H3	MMBZ5243BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=9.5 мА)=12.35...13.65 В; I_R<0.5 мкА	SOT523	A•n.c.•K
H31	BCW89R	PHIL	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...260; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
H3O	KSC2757	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; f_T>1100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H3p	BCW89	PHIL	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H3R	KSC2757R	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T>1100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H3t	BCW89	PHIL	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H3Y	KSC2757Y	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>1100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H4	2SA956H4	NEC	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...170; fT>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H4	BCW69R	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...260; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
H4	BCW69R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...260; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H4	SST5484	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=1...5 мА; g_F=2 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
H4Z	KSC2758	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...240; f_T>1000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H5	2SA956H5	NEC	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=150...240; fT>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H5	BCW70R	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
H5	BCW70R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=215...500; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H5	MMBZ5245BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=8.5 мА)=14.25...15.75 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
H5	SST5485	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=4...10 мА; g_F=3.5 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
H5O	KSC2223	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H5R	KSC2223	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...80; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H5Y	KSC2223	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H6	2SA956H6	NEC	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...320; fT>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H6	BCW89R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...260; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H6	BCW89R	PHIL	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...260; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
H6	SST5486	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=8...20 мА; g_F=4 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
H6O	KSC2759	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T>2000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H6R	KSC2759	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...80; f_T>2000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H6Y	KSC2759	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; f_T>2000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H71	BCF70R	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
H7p	BCF70	PHIL	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=215...500; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H8Z	KSC2734	SAMS	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=20...200; f_T>3500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
H9	1SS344	TOSH	shd	V_R>20 В; $V_F(I_F$=500 мА)<0.55 В; $I_R(V_R$=20 В)<20 мкА; C_T<120 пФ	SOT346,SC59	A•n.c.•K
H9Z	KSC3120	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...200; f_T>2400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HA	2SA1883	SANYO	pnp	V_{CB0}=15 В; I_C=200 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...140; f_T>450 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
HA	2SC2804	TOSH	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=200 мВт; f_T>900 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HA	2SD1464	REN	npn	V_{CB0}=180 В; I_C=50 мА; P_D=1 Вт; h_{21}=60...120; f_T=140 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
HAO	KSC3123	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; $f_T>$1400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HAR	KSC3123	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; $f_T>$1400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HAY	KSC3123	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; $f_T>$1400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HB	2SD1464	REN	npn	V_{CB0}=180 В; I_C=50 мА; P_D=1 Вт; h_{21}=100...200; f_T=140 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HBs	BFN22	SIEM	npn	V_{CB0}=250 В; I_C=50 мА; P_D=360 мВт; $h_{21}>$50; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HC	2SC2733	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; $h_{21}>$60; $f_T>$600 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
HC	2SC4463	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=100 мВт; $h_{21}>$60; $f_T>$600 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HCs	BFN23	SIEM	pnp	V_{CB0}=250 В; I_C=50 мА; P_D=360 мВт; $h_{21}>$50; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HE	2SC3906KE	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390...820; $f_T>$140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
HE	2SC4102E	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390...820; $f_T>$140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HG	BRC143ECM	REN	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; $h_{21}>$20; 4.7 к/4.7 к	SOT323,SC70	B•E•C
HG	BRC143EMP	REN	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; $h_{21}>$20; 4.7 к/4.7 к	SOT23,SOD23	B•E•C
HP	2SA1036KP	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; $f_T>$200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
HP	2SA1577P		pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; $f_T>$200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HQ	2SA1036KQ	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; $f_T>$200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
HQ	2SA1577Q	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; $f_T>$200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HQ	2SC3928Q	IDC	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HR	2SA1035R	PAN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...360; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HR	2SA1036KR	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; $f_T>$200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
HR	2SA1531AR	PAN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=180...360; f_T=80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HR	2SA1577R	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; $f_T>$200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HR	2SC3906KR	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; $f_T>$140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
HR	2SC3928R	IDC	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HR	2SC4102R	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; $f_T>$140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HS	2SA1035S	PAN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=260...520; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HS	2SA1531AS	PAN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=260...520; f_T=80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HS	2SC3906KS	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; $f_T>$140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
HS	2SC3928S	IDC	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HS	2SC4102S	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; $f_T>$140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HT	2SA1035T	PAN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=360...700; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
HT	2SA1531AT	PAN	pnp	V_{CB0}=55 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=360...700; f_T=80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
HT	2SC3928T	IDC	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390...820; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
I	MRF947RT3	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=188 мВт; $h_{21}>$50; f_T=8000 МГц	SOT323,SC70	E•B•C
I0	SST110	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; $I_{DSS}>$10 мА; $R_{DS(on)}<$18 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
I8	SST108	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; $I_{DSS}>$80 мА; $R_{DS(on)}<$8 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
I9	1SS336	TOSH	di×2	$V_R<$80 В; $I_F<$200 мА; $V_F(I_F$=200 мА$)<$1.2 В; $I_R<$0.5 мкА; $t_{RR}<$20 нс	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
I9	SST109	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; $I_{DSS}>$40 мА; $R_{DS(on)}<$12 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
ID	2SC3127	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; $f_T>$3.5 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
IE	2SC3722KE	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390...820; $f_T>$140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
IGD	2SK1215D	REN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=100 мВт; $g_F>$8 мСм; I_{DSS}=4...8 мА	SOT323,SC70	D•G•S
IGD	2SK360D	REN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=150 мВт; $g_F>$8 мСм; I_{DSS}=4...8 мА	SOT23,SOD23	D•G•S
IGE	2SK1215E	REN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=100 мВт; $g_F>$8 мСм; I_{DSS}=6...10 мА	SOT323,SC70	D•G•S
IGE	2SK360E	REN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=150 мВт; $g_F>$8 мСм; I_{DSS}=6...10 мА	SOT23,SOD23	D•G•S
IGF	2SK1215F	REN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=100 мВт; $g_F>$8 мСм; I_{DSS}=8...12 мА	SOT323,SC70	D•G•S
IGF	2SK360F	REN	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=150 мВт; $g_F>$8 мСм; I_{DSS}=8...12 мА	SOT23,SOD23	D•G•S
IJ	2SC3374	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=20...200; $f_T>$400 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
IL	2SC3493	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=30...200; $f_T>$700 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
IL	2SC4263	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=20 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=30...200; $f_T>$700 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
IO	KTA1298	KEC	pnp	V_{CB0}=35 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...200; $f_T>$120 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
IP	2SC3793	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...200; $f_T>$1.4 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
IP	2SC4262	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=50...200; $f_T>$1.4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
IR	2SB792R	PAN	pnp	V_{CB0}=150 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=130...220; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
IR	2SC3722KR	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
IR54	BAT54	IR	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
IR54C	BAT54C	IR	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
IR54S	BAT54S	IR	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
IRD	2SA1484D	HIT	pnp	V_{CB0}=90 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
IRE	2SA1484E	HIT	pnp	V_{CB0}=90 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=400...800	SOT23,SOD23	B•E•C
IS	2SB792S	PAN	pnp	V_{CB0}=150 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=185...330; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
IS	2SC3513	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...250; f_T>4.5 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
IS	2SC3722KS	ROHM	npn	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
IS	2SC4537	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=50...250; f_T>4.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
IT	2SB792T	PAN	pnp	V_{CB0}=150 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=260...450; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
IY	KTA1298	KEC	pnp	V_{CB0}=35 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=160...320; f_T>120 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
J0	HSMS2840	HP	shd	V_{BR}>25 В; V_F(I_F=30 мА)<0.7 В; I_R(V_R=1 В)<100 нА; C_T<1.0 пФ; R_D=12 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J01	SO2906R	SGS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=150 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...120; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
J03	SO2907AR	SGS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
J05	SO2907R	SGS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
J06	SO2894R	SGS	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...150; f_T>400 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
J1	BSS138L	MOT	nMOS	V_{DS}=50 В; I_D=200 мА; P_D=360 мВт; g_F=120 мСм; $R_{DS(on)}$=6 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
J1	HSMS2841	HP	shd	V_{BR}>25 В; V_F(I_F=30 мА)<0.7 В; I_R(V_R=1 В)<100 нА; C_T<1.0 пФ; R_D=12 Ом	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
J1	MMBZ5246BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=7.8 мА)=15.2...16.8 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
J12	SO2906AR	SGS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...120; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
J1A	ZC830A	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=10±10% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=4.5...6; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J1B	ZC830B	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=10±5% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=4.5...6; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J1O	KSA1298	SAMS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...200; f_T>120 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
J1S	ZC830	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=10±20% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=4.5...6; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J1Y	KSA1298	SAMS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=160...320; f_T>120 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
J2A	ZC833A	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=33±10% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J2B	ZC833B	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=33±5% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J2S	ZC833	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=33±20% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J3	MMBZ5248BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=7.0 мА)=17.1...18.9 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
J32	SO5400R	SGS	pnp	V_{CB0}=130 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=40...180; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
J33	SO5401R	SGS	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=60...240; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
J39	SO692R	SGS	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
J3A	ZC831A	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=15±10% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=4.5...6; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J3B	ZC831B	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=15±5% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=4.5...6; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J3D	MSB81T1	MOT	pnp	f_T=0.6 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
J3S	ZC831	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=15±20% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=4.5...6; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J4A	MBV109T1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{3В}$=26...32 пФ; $C_{3В}/C_{25В}$=5.0...6.5	SOT323,SC70	A•n.c.•K
J4A	ZC832A	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=22±10% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J4B	ZC832B	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=22±5% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J4S	ZC832	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=22±20% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J5	MMBZ5250BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=6.2 мА)=19.0...21.0 В; I_R<01 мкА	SOT523	A•n.c.•K
J5A	ZC834A	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=47±10% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J5B	ZC834B	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=47±5% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J5S	ZC834	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=47±20% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J6	M1MA174	MOT	di	V_R<100 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=10 мА)<1 В; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
J6A	ZC835A	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=68±10% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>100	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J6B	ZC835B	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=68±5% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>100	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J6S	ZC835	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=68±20% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>100	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J7A	ZC836A	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=100±10% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>100	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J7B	ZC836B	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=100±5% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>100	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J7S	ZC836	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_{2В}$=100±20% пФ; $C_{2В}/C_{20В}$=5...6.5; Q>100	SOT23,SOD23	A•n.c.•K





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
J8	BCX71JR	ZETEX	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...460; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
J8	BCX71JR	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...460; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
J9	1SS337	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.2 В; I_R<0.5 мкА; t_{RR}<20 нс	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
J9A	ZC829A	ZETEX	var	V_R<25 В; I_F<200 мА; I_R<0.02 мкА; C_{2B}=7.38...9.02 пФ; C_{2B}/C_{20B}=4.3...5.8	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
J9B	ZC829B	ZETEX	var	V_R<25 В; I_F<200 мА; I_R<0.02 мкА; C_{2B}=7.79...8.61 пФ; C_{2B}/C_{20B}=4.3...5.8	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JA	BAV70W	WTE	di×2	V_R<75 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
JA	BAV74	ALLEG	di×2	I_F<70 мА; V_{BR}>50 В; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<100 нА; t_{RR}<4.0 нс; C_D<2.0 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JA	BAV74	ZETEX	di×2	V_R<50 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JA	BAV74	Nat	di×2	V_R<50 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JAp	BAV74	PHIL	di×2	V_R<50 В; I_F<215 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JAs	BAV74	SIEM	di×2	V_R<50 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JB	BAR74	ZETEX	di	V_R<50 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JC	2SC2735	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>40; f_T>600 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
JC	2SC4265	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>40; f_T>600 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
JC	BAL74	ZETEX	di	V_R<50 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
JC	BAL74W	PHIL	fd	V_R<75 В; I_F<175 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	n.c.•A•K
JC	BAW56W	PANJIT	di×2	V_R<75 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=10 мА)<1 В; C_D<4 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
JCp	BAL74	PHIL	fd	V_R<50 В; I_F<215 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
JCs	BAL74	INF	di	V_R<50 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
JD	BAW56	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
JD	BAW56T	DIODS	di×2	V_R<85 В; I_F<155 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT523	K1•K2•A1,A2
JE	BAV99	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
JE	BAV99	GS	di×2	V_R<70 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
JE	BAV99	TSC	di×2	V_R<75 В; I_F<215 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
JE	BAV99T	DIODS	di×2	V_R<85 В; I_F<155 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT523	A1•K2•K1,A2
JF	BAL99	VISH	di	V_R<70 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; I_R<2.5 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	n.c.•K•A
JF	BAL99	GS	di	V_R<70 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	n.c.•K•A
JF	BAL99W	PHIL	di	V_R<70 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	n.c.•K•A
JFp	BAL99	PHIL	di	V_R<70 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	n.c.•K•A
JFs	BAL99	INF	di	V_R<70 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; I_R<2.5 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	n.c.•K•A
JG	BAV99	WTE	di×2	V_R<75 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
JG	BAV99	PANJIT	di×2	V_R<75 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=10 мА)<1 В; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
JG	BRA123ECM	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; 2.2 к/2.2 к	SOT323,SC70	B•E•C
JG	BRA123EMP	REN	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; 2.2 к/2.2 к	SOT23,SOD23	B•E•C
JGs	BAR99	SIEM	di	V_R<70 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; I_R<2.5 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K•n.c.•A
JID	2SA1566D	REN	pnp	V_{CB0}=120 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
JIE	2SA1566E	REN	pnp	V_{CB0}=120 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=400...800	SOT23,SOD23	B•E•C
JJ	BAV70	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JJ	BAV70T	DIODS	di×2	V_R<85 В; I_F<155 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT523	A1•A2•K1,K2
JL	MRF949T1	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=144 мВт; h_{21}>50; f_T=9 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
JM	2SC2059KM	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T>500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
JM	2SC4099M	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T>500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
JM	2SC4649	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T>500 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
JN	2SC2059KN	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T>500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
JN	2SC4099N	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T>500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
JN	2SC4649	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T>500 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
JP	2SC2059KP	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T>500 МГц	SOT346,SC59	B•E•C

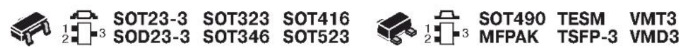
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
JP	2SC4099P	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T>500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
JP	2SC4649	ROHM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T>500 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
JPp	BAS19	PHIL	fd	V_R<100 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; C_D<5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JPs	BAS19	INF	di	V_R<100 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JRp	BAS20	PHIL	fd	V_R<150 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; C_D<5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JRs	BAS20	INF	di	V_R<150 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JS	BAS21	JGD	di	V_R<200 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JS3	2SA1857	SANYO	pnp	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=60...120; f_T>750 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
JS4	2SA1857	SANYO	pnp	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=90...180; f_T>750 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
JS5	2SA1857	SANYO	pnp	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=135...270; f_T>750 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
JSp	BAS21	PHIL	fd	V_R<200 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; C_D<5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JSs	BAS21	INF	di	V_R<200 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JV	1SV263	SANYO	pin	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<0.95 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A•n.c.•K
JV	1SV266	SANYO	pin	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)=0.91 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JVp	BAS116	PHIL	dl	V_R<75 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<1.0 В; $I_R(V_R$=75 В)<5 нА; C_D<2 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JVs	BAS116	SIEM	dl	V_R<75 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.1 В; I_R<5.0 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
JX	BAV170	MOT	dl×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.005 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JXp	BAV170	PHIL	dl×2	V_R<75 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<1.0 В; $I_R(V_R$=75 В)<5 нА; C_D<2 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JXs	BAV170	INF	dl×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.005 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JXt	BAV170	PHIL	dl×2	V_R<75 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<1.0 В; $I_R(V_R$=75 В)<5 нА; C_D<2 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
JYp	BAV199	PHIL	dl×2	V_R<75 В; I_F<160 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<1.0 В; $I_R(V_R$=75 В)<5 нА; C_D<2 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
JYs	BAV199	INF	dl×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.005 мкА; C_D=2.0 пФ; t_{RR}<1500 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
JYs	BAV199F	INF	dl×2	V_R<80 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.005 мкА; C_D=2.0 пФ; t_{RR}<1500 нс	TSFP-3,VESM	A1•K2•K1,A2
JZp	BAW156	PHIL	dl×2	V_R<75 В; I_F<160 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<1.0 В; $I_R(V_R$=75 В)<5 нА; C_D<3 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
JZs	BAW156	SIEM	dl×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<0.005 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
K	MRF917T1	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=60 мА; P_D=222 мВт; h_{21}=40...200; f_T=6 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
K0	HSMP3830	HP	pin	I_F<1 А; V_{BR}>200 В; R_S<1.5 Ом; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
K1	BCW71	ALLEG	npn	V_{CB0}=50 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=110...220; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
K1	BCW71	CDIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1	BCW71	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1	BCW71	ZETEX	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1	HSMP3831	HP	pin	I_F<1 А; V_{BR}>200 В; R_S<1.5 Ом; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
K1	MMBZ5251BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5.6 мА)=20.9...23.1 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
K1	VN10KT	SIL	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=310 мА; P_D=1000 мВт; g_F=100 мСм; $R_{DS(on)}$=7.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
K14	DTA114GE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_2=10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
K14	DTA114GKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_2=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K14	DTA114GUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_2=10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
K15	DTA124GKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_2=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K15	DTA124GUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_2=22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
K16	DTA144GKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_2=47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K16	DTA144GUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_2=47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
K19	DTA115GE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_2=100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
K19	DTA115GKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_2=100 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K19	DTA115GUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_2=100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
K1E	BC847A	DIODS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1E	BC848A	DIODS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1F	BC847B	DIODS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1F	BC848B	DIODS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1G	MMSTA05	DIODS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K1G	MMSTA06	DIODS	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K1H	MMSTA05	DIODS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K1J	BC848A	DIODS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1K	BC848B	DIODS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1L	BC848C	DIODS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1M	BC847C	DIODS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1M	BC848C	DIODS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1N	MMBT3904	VISH	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1O	KSA3265	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...200; f_T>120 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1p	BCW71	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1P	MMBT2222A	VISH	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1Q	BC846A	DIODS	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1Q	BC847A	DIODS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1Q	BC848A	DIODS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1R	BC846B	DIODS	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1R	BC847B	DIODS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1R	BC848B	DIODS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1t	BCW71	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K1Y	KSA3265	SAMS	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=160...320; f_T>120 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K2	BCW72	ALLEG	npn	V_{CB0}=50 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=200...450; $V_{CE(sat)}$<0.25 В	SOT23,SOD23	B•E•C
K2	BCW72	CDIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K2	BCW72	ZETEX	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K2	HSMP3832	HP	pin×2	I_F<1 A; V_{BR}>200 В; R_S<1.5 Ом; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
K2	MMBZ5252BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5.2 мА)=22.8...25.2 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
K24	DTC114GKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_2=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K24	DTC114GUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц; R_2=10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
K25	DTA124GKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_2=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K25	DTA124GUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_2=22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
K25	DTC124GKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_2=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K25	DTC124GUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц; R_2=22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
K26	DTC144GE	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_2=47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
K26	DTC144GKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_2=47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K26	DTC144GUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц; R_2=47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
K29	DTC115GE	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_2=100 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
K29	DTC115GKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_2=100 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K29	DTC115GUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>82; f_T>250 МГц; R_2=100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
K2D	MMSTA13	DIODS	dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K2E	MMSTA63	DIODS	dpnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K2F	MMBT2907A	VISH	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K2G	MMSTA55	DIODS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K2G	MMSTA56	DIODS	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K2H	MMSTA55	DIODS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K2p	BCW72	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K2t	BCW72	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

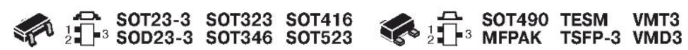
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
K2T	MMBT4403	VISH	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K2X	MMBT4401	VISH	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3	BCW81	CDIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3	HSMP3833	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>200 В; R_S<1.5 Ом; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
K31	BCW81R	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
K3A	BC856A	DIODS	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3A	BC857A	DIODS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3A	BC858A	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3A	KDV804S	KEC	bd×2	V_R=15 В; I_R=50 нА; C2B=42.7 пФ; C_{BB}=25 пФ; R_S<0.3 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
K3B	BC856B	DIODS	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3B	BC857B	DIODS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3B	BC858B	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3B	DTA1D3RE	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
K3B	DTA1D3RKA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.7/1 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
K3B	DTA1D3RUA	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K3B	KDV804S	KEC	bd×2	V_R=15 В; I_R=50 нА; C2B=43.7 пФ; C_{BB}=25 пФ; R_S<0.3 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
K3C	KDV804S	KEC	bd×2	V_R=15 В; I_R=50 нА; C2B=44.7 пФ; C_{BB}=25 пФ; R_S<0.3 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
K3D	KDV804S	KEC	bd×2	V_R=15 В; I_R=50 нА; C2B=45.7 пФ; C_{BB}=25 пФ; R_S<0.3 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
K3D	MMSTA13	DIODS	dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K3D	MMSTA14	DIODS	dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K3E	KDV804S	KEC	bd×2	V_R=15 В; I_R=50 нА; C2B=46.7 пФ; C_{BB}=25 пФ; R_S<0.3 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
K3E	MMSTA63	DIODS	dpnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K3E	MMSTA64	DIODS	dpnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K3G	BC857C	DIODS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3G	BC858C	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3J	BC858A	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3K	BC858B	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3L	BC858C	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=420...800; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3N	MMBT3906	VISH	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3p	BCW81	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3t	BCW81	PHIL	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=420...800; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3V	BC857A	DIODS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3V	BC858A	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3W	BC857B	DIODS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K3W	BC858B	DIODS	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K4	BCW71R	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=110...220; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
K4	BCW71R	ZETEX	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K4	HSMP3834	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>200 В; R_S<1.5 Ом; C_D<0.3 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
K4	MMBZ5254BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=25.65...28.35 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
K43	BAS40	DIODS	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
K44	BAS40-04	DIODS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1 В; I_R<1.0 мкА; C_D<5 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
K45	BAS40-05	DIODS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K2,K1
K46	BAS40-06	DIODS	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=40 мА)<1.0 В; I_R<0.2 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
K4B	DTC1D3RE	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
K4B	DTC1D3RKA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.7/1 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
K4B	DTC1D3RUA	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; $I_{C(max)}$=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
K5	BCW72R	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=200...450; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
K5	BCW72R	ZETEX	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=200...450; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K5	MMBZ5255BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=4.5 мА)=26.6...29.4 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
K51	BAV170	DIODS	dl×2	V_R<85 В; I_F<215 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<0.005 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<3000 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
K52	BAV199	DIODS	dl×2	$V_R<85$ В; $I_F<160$ мА; $V_F(I_F=150$ мА$)<1.25$ В; $I_R<0.005$ мкА; $C_D=2.0$ пФ; $t_{RR}<3000$ нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
K6	BCV71R	ZETEX	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=330$ мВт; $h_{21}=110...220$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K6	BCV71R	PHIL	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=330$ мВт; $h_{21}=110...220$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
K7	BCV71	CDIL	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=330$ мВт; $h_{21}=110...220$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K7	BCV71	ZETEX	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=330$ мВт; $h_{21}=110...220$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K72	2N7002	DIODS	nFET	$V_{DS}=60$ В; $I_D=115$ мА; $P_D=300$ мВт; $V_{GSTH}=1...2.5$ В; $C_{ISS}<50$ пФ	SOT23,SOD23	G•S•D
K73	BAS70	DIODS	shd	$V_R<70$ В; $I_F<70$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<2.0$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
K74	BAS70-04	DIODS	shd×2	$V_R<70$ В; $I_F<70$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<2.0$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
K75	BAS70-05	DIODS	shd×2	$V_R<70$ В; $I_F<70$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<2.0$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
K76	BAS70-06	DIODS	shd×2	$V_R<70$ В; $I_F<70$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<2.0$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
K7A	2N7002-01	DIODS	nFET	$V_{DS}=60$ В; $I_D=115$ мА; $P_D=300$ мВт; $V_{GSTH}=1...2$ В; $C_{ISS}<50$ пФ	SOT23,SOD23	G•S•D
K7C	BAS70	DIODS	shd	$V_R<70$ В; $I_F<70$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<2.0$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
K7D	BAS70-04	DIODS	shd×2	$V_R<70$ В; $I_F<70$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<2.0$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
K7E	BAS70-05	DIODS	shd×2	$V_R<70$ В; $I_F<70$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<2.0$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
K7E	BAS70-06	DIODS	shd×2	$V_R<70$ В; $I_F<70$ мА; $V_F(I_F=15$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<2.0$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
K7p	BCV71	PHIL	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=110...220$; $f_T>100$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K7t	BCV71	PHIL	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=110...220$; $f_T>100$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K8	BCV72	CDIL	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=330$ мВт; $h_{21}=200...450$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K8	BCV72	ZETEX	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=330$ мВт; $h_{21}=200...450$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K8p	BCV72	PHIL	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=200...450$; $f_T>100$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K8t	BCV72	PHIL	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=200...450$; $f_T>100$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K9	1SS348	TOSH	shd	$V_R>80$ В; $V_F(I_F=100$ мА$)<0.7$ В; $I_R(V_R=80$ В$)<5$ мкА; $C_T<100$ пФ	SOT346,SC59	A•n.c.•K
K9	BCV72R	ZETEX	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=330$ мВт; $h_{21}=200...450$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
K9	BCV72R	PHIL	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=330$ мВт; $h_{21}=200...450$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
K91	BCF81R	PHIL	npn	$V_{CB0}=45$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=350$ мВт; $h_{21}=420...800$; $f_T>100$ МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
K9p	BCF81	PHIL	npn	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=420...800$; $f_T>100$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
KA	RN1441A	TOSH	Dnpn	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=300$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=200...700$; $f_T=30$ МГц; $R_1=5.6$ кОм	SOT346,SC59	B•E•C
KA2	MMBD4148	VISH	di	$V_R<75$ В; $I_F<300$ мА; $V_F(I_F=10$ мА$)<1.0$ В; $I_R<5.0$ мкА; $C_D<4$ пФ; $t_{RR}<6$ нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KA3	MMBD4448	VISH	fid	$V_R<75$ В; $I_F<500$ мА; $V_F(I_F=100$ мА$)<1.0$ В; $I_R<5.0$ мкА; $C_D<4$ пФ; $t_{RR}<4$ нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KA6	BAS16	VISH	fid	$V_R<75$ В; $I_F<500$ мА; $V_F(I_F=150$ мА$)<1.25$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<4.0$ пФ; $t_{RR}<4$ нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KA8	BAS19	DIODS	fd	$V_R<100$ В; $I_F<250$ мА; $V_F(I_F=100$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<5.0$ пФ; $t_{RR}<50$ нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KA8	BAS19W	DIODS	fd	$V_R<100$ В; $I_F<400$ мА; $V_F(I_F=100$ мА$)<1.0$ В; $I_R<0.1$ мкА; $C_D<5$ пФ; $t_{RR}<50$ нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
KB	MMBT8099LT1	ON	npn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=500$ мА; $P_D=225$ мВт; $h_{21}=100...300$; $f_T>150$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
KB	RN1441B	TOSH	Dnpn	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=300$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=350...1200$; $f_T=30$ МГц; $R_1=5.6$ кОм	SOT346,SC59	B•E•C
KC	BFQ29P	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=30$ мА; $P_D=280$ мВт; $h_{21}=50...250$; $f_T=5000$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
KD1	AZ23C2V7	DIODS	dz×2	$V_Z=2.5...2.9$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<83$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD2	AZ23C3V0	DIODS	dz×2	$V_Z=2.8...3.2$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<95$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD3	AZ23C3V3	DIODS	dz×2	$V_Z=3.1...3.5$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<95$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD4	AZ23C3V6	DIODS	dz×2	$V_Z=3.4...3.8$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<95$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD5	AZ23C3V9	DIODS	dz×2	$V_Z=3.7...4.1$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<95$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD6	AZ23C4V3	DIODS	dz×2	$V_Z=4.0...4.6$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<95$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD7	AZ23C4V7	DIODS	dz×2	$V_Z=4.4...5.0$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<78$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD8	AZ23C5V1	DIODS	dz×2	$V_Z=4.8...5.4$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<60$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD9	AZ23C5V6	DIODS	dz×2	$V_Z=5.2...6.0$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<40$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KD9	AZ23C5V6W	DIODS	dz×2	$V_Z=5.32...5.88$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<40$ Ом	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
KDA	AZ23C6V2	DIODS	dz×2	$V_Z=5.8...6.6$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<10$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDB	AZ23C6V8	DIODS	dz×2	$V_Z=6.4...7.2$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<8$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDB	AZ23C6V8W	DIODS	dz×2	$V_Z=6.47...7.14$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<8$ Ом	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
KDC	AZ23C7V5	DIODS	dz×2	$V_Z=7.0...7.9$ В; $R_Z(I_Z=5$ мА$)<7$ Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
KDD	AZ23C8V2	DIODS	dz×2	V_Z=7.7...8.7 В; R_Z(I_Z=5 мА)<7 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDE	AZ23C9V1	DIODS	dz×2	V_Z=8.5...9.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDF	AZ23C10	DIODS	dz×2	V_Z=9.4...10.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDF	AZ23C10W	DIODS	dz×2	V_Z=9.4...10.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<15 Ом	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
KDG	AZ23C11	DIODS	dz×2	V_Z=10.4...11.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDH	AZ23C12	DIODS	dz×2	V_Z=11.4...12.7 В; R_Z(I_Z=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDI	AZ23C13	DIODS	dz×2	V_Z=12.4...14.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<25 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDJ	AZ23C15	DIODS	dz×2	V_Z=13.8...15.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDK	AZ23C16	DIODS	dz×2	V_Z=15.3...17.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<40 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDL	AZ23C18	DIODS	dz×2	V_Z=16.8...19.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDL	AZ23C18W	DIODS	dz×2	V_Z=16.8...19.1 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
KDM	AZ23C20	DIODS	dz×2	V_Z=18.8...21.2 В; R_Z(I_Z=5 мА)<50 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDN	AZ23C22	DIODS	dz×2	V_Z=20.8...23.3 В; R_Z(I_Z=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDO	AZ23C24	DIODS	dz×2	V_Z=22.8...25.6 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDP	AZ23C27	DIODS	dz×2	V_Z=25.1...28.9 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDQ	AZ23C30	DIODS	dz×2	V_Z=28...32 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDR	AZ23C33	DIODS	dz×2	V_Z=31...35 В; R_Z(I_Z=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDS	AZ23C36	DIODS	dz×2	V_Z=34...38 В; R_Z(I_Z=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KDT	AZ23C39	DIODS	dz×2	V_Z=37...41 В; R_Z(I_Z=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KE	2SK1062	TOSH	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=200 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=0.6 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KF	2SJ168	TOSH	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=200 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=1.3 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KG	BRC123ECM	REN	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; 2.2 к/2.2 к	SOT323,SC70	B•E•C
KG	BRC123EMP	REN	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>20; 2.2 к/2.2 к	SOT23,SOD23	B•E•C
KH	2SK1826	TOSH	nMOS	V_{DS}=50 В; I_D=50 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=20 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KH	2SK1827	TOSH	nFET	V_{DS}>50 В; I_D=50 мА; $R_{DS(on)}$<50 Ом; g_F>20 мСм; P_D=100 мВт	SOT323,SC70	G•S•D
KI	2SK1828	TOSH	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=50 мА; P_D=100 мВт; $R_{DS(on)}$=20 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KI	2SK1829	TOSH	nMOS	V_{DS}>20 В; I_D=50 мА; $R_{DS(on)}$<40 Ом; g_F>20 мСм; P_D=100 мВт	SOT323,SC70	G•S•D
KI	2SK1830	TOSH	nFET	V_{DS}=20 В; I_D=50 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=20 Ом	SOT416,SC75A	G•S•D
KID	2SC4050D	REN	npn	V_{CBO}=120 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
KIE	2SC4050E	REN	npn	V_{CBO}=120 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=400...800	SOT23,SOD23	B•E•C
KJ	2SK2036	TOSH	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=3.5 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KJ	2SK2037	TOSH	nMOS	V_{DS}>20 В; I_D=100 мА; $R_{DS(on)}$<6 Ом; g_F>35 мСм; P_D=100 мВт	SOT323,SC70	G•S•D
KJA	BAV70W	DIODS	di×2	V_R<75 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
KJC	BAW56W	DIODS	di×2	V_R<75 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
KJD	BAW56	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KJE	BAV99	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
KJE	BAV99	DIODS	di×2	V_R<75 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
KJF	BAL99	VISH	di	V_R<70 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; I_R<2.5 мкА; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	n.c.•K•A
KJG	BAV99W	DIODS	di×2	V_R<75 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
KJG	BAV99W	DIOT	di×2	V_R<70 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<2 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•K1,A2•K2
KJJ	BAV70	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KK	2SK2823	TOSH	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=7 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KK	2SK2824	TOSH	nMOS	V_{DS}>20 В; I_D=100 мА; $R_{DS(on)}$<28 Ом; g_F>35 мСм; P_D=100 мВт	SOT323,SC70	G•S•D
KK	2SK2825	TOSH	nFET	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=10 Ом	SOT416,SC75A	G•S•D
KL1	BAT54	DIOT	shd	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KL1	BAT54	DIODS	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KL1	BAT54	VISH	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<2 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KL2	BAS54A	VISH	shd×2	V_R=30 В; I_F=200 мА; P_D=200 мВт; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KL2	BAT54A	DIOT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
KL2	BAT54A	DIODS	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KL2	BAT54A	VISH	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<2.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
KL3	BAS54C	VISH	shd×2	V_R=30 В; I_F=200 мА; P_D=200 мВт; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KL3	BAT54B	VISH	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<2.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KL3	BAT54C	DIOT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KL3	BAT54C	DIODS	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KL4	BAS54S	VISH	shd×2	V_R=30 В; I_F=200 мА; P_D=200 мВт; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
KL4	BAT54S	DIOT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
KL4	BAT54S	DIODS	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
KL4	BAT54S	VISH	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<2.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
KM	2SK2009	TOSH	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=200 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=1.2 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KN	2SJ305	TOSH	pMOS	V_{DS}=30 В; I_D=200 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=2.4 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KP	2SK2033	TOSH	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=8 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KP	2SK2034	TOSH	nMOS	V_{DS}>20 В; I_D=100 мА; $R_{DS(on)}$<12 Ом; g_F>25 мСм; P_D=100 мВт	SOT323,SC70	G•S•D
KP	2SK2035	TOSH	nFET	V_{DS}=20 В; I_D=100 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=8 Ом	SOT416,SC75A	G•S•D
KQ	2SJ343	TOSH	pMOS	V_{DS}=50 В; I_D=50 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=20 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KQ	2SJ344	TOSH	pMOS	V_{DS}>50 В; I_D=50 мА; $R_{DS(on)}$<50 Ом; g_F>15 мСм; P_D=100 мВт	SOT323,SC70	G•S•D
KS	2SJ345	TOSH	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=50 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=20 Ом	SOT346,SC59	G•S•D
KS	2SJ346	TOSH	pMOS	V_{DS}>20 В; I_D=50 мА; $R_{DS(on)}$<40 Ом; g_F>15 мСм; P_D=100 мВт	SOT323,SC70	G•S•D
KS	2SJ347	TOSH	pFET	V_{DS}=20 В; I_D=50 мА; P_D=200 мВт; $R_{DS(on)}$=20 Ом	SOT416,SC75A	G•S•D
KT2	BAS19	DIODS	fd	V_R<100 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KT2	BAS19W	DIODS	fd	V_R<100 В; I_F<400 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
KT2	BAS20	DIODS	fd	V_R<150 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KT2	BAS20W	DIODS	fd	V_R<150 В; I_F<400 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
KT3	BAS19	DIODS	fd	V_R<100 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KT3	BAS19W	DIODS	fd	V_R<100 В; I_F<400 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
KT3	BAS20	DIODS	fd	V_R<150 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KT3	BAS20W	DIODS	fd	V_R<150 В; I_F<400 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
KT3	BAS21	DIODS	di	V_R<200 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KT3	BAS21	DIODS	di	V_R<200 В; I_F<400 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<5.0 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
KV	1SV264	SANYO	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=50 мА)<0.95 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
KV	1SV267	SANYO	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; V_F(I_F=50 мА)=0.91 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
KV1	DZ23C2V7	VISH	dz×2	V_Z=2.5...2.9 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=83 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV1	DZ23C2V7	DIODS	dz×2	V_Z=2.5...2.9 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=83 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV2	DZ23C3V0	VISH	dz×2	V_Z=2.8...3.2 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV2	DZ23C3V0	DIODS	dz×2	V_Z=2.8...3.2 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV3	DZ23C3V3	VISH	dz×2	V_Z=3.1...3.5 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV3	DZ23C3V3	DIODS	dz×2	V_Z=3.1...3.5 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV4	DZ23C3V6	VISH	dz×2	V_Z=3.4...3.8 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV4	DZ23C3V6	DIODS	dz×2	V_Z=3.4...3.8 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV5	DZ23C3V9	VISH	dz×2	V_Z=3.7...4.1 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV5	DZ23C3V9	DIODS	dz×2	V_Z=3.7...4.1 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV6	DZ23C4V3	VISH	dz×2	V_Z=4.0...4.6 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV6	DZ23C4V3	DIODS	dz×2	V_Z=4.0...4.6 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2

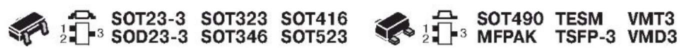
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
KV7	DZ23C4V7	VISH	dz×2	V_Z=4.4...5.0 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=78 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV7	DZ23C4V7	DIODS	dz×2	V_Z=4.0...4.6 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV8	DZ23C5V1	VISH	dz×2	V_Z=4.8...5.4 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=60 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV8	DZ23C5V1	DIODS	dz×2	V_Z=4.8...5.4 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=60 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV9	DZ23C5V6	VISH	dz×2	V_Z=5.2...6.0 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=40 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KV9	DZ23C5V6	DIODS	dz×2	V_Z=5.2...6.0 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=40 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVA	DZ23C6V2	VISH	dz×2	V_Z=5.8...6.6 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=10 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVA	DZ23C6V2	DIODS	dz×2	V_Z=5.8...6.6 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=10 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVB	DZ23C6V8	VISH	dz×2	V_Z=6.4...7.2 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=8 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVB	DZ23C6V8	DIODS	dz×2	V_Z=6.4...7.2 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=8 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVC	DZ23C7V5	VISH	dz×2	V_Z=7.0...7.9 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=7 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVC	DZ23C7V5	DIODS	dz×2	V_Z=7.0...7.9 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=7 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVD	DZ23C8V2	VISH	dz×2	V_Z=7.7...8.7 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=7 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVD	DZ23C8V2	DIODS	dz×2	V_Z=7.7...8.7 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=7 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVE	DZ23C9V1	VISH	dz×2	V_Z=8.5...9.6 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=10 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVE	DZ23C9V1	DIODS	dz×2	V_Z=8.5...9.6 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=10 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVF	DZ23C10	VISH	dz×2	V_Z=9.4...10 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=15 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVF	DZ23C10	DIODS	dz×2	V_Z=9.4...10 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=15 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVG	DZ23C11	VISH	dz×2	V_Z=10.4...11 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=20 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVG	DZ23C11	DIODS	dz×2	V_Z=10.4...11 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=20 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVH	DZ23C12	VISH	dz×2	V_Z=11.4...12 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=20 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVH	DZ23C12	DIODS	dz×2	V_Z=11.4...12 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=20 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVI	DZ23C13	VISH	dz×2	V_Z=12.4...14 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=25 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVI	DZ23C13	DIODS	dz×2	V_Z=12.4...14 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=25 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVJ	DZ23C15	VISH	dz×2	V_Z=13.8...15 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=30 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVJ	DZ23C15	DIODS	dz×2	V_Z=13.8...15 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=30 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVK	DZ23C16	VISH	dz×2	V_Z=15.3...17 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=40 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVK	DZ23C16	DIODS	dz×2	V_Z=15.3...17 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=40 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVL	DZ23C18	VISH	dz×2	V_Z=16.8...19 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=50 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVL	DZ23C18	DIODS	dz×2	V_Z=16.8...19 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=50 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVM	DZ23C20	VISH	dz×2	V_Z=18.8...21 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=50 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVM	DZ23C20	DIODS	dz×2	V_Z=18.8...21 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=50 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVN	DZ23C22	VISH	dz×2	V_Z=20.8...23 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=55 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVN	DZ23C22	DIODS	dz×2	V_Z=20.8...23 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=55 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVO	DZ23C24	VISH	dz×2	V_Z=22.8...25 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVO	DZ23C24	DIODS	dz×2	V_Z=22.8...25 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVP	DZ23C27	VISH	dz×2	V_Z=25.1...28 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVP	DZ23C27	DIODS	dz×2	V_Z=25.1...28 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVQ	DZ23C30	VISH	dz×2	V_Z=28...32 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVQ	DZ23C30	DIODS	dz×2	V_Z=28...32 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVR	DZ23C33	VISH	dz×2	V_Z=31...35 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVR	DZ23C33	DIODS	dz×2	V_Z=31...35 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVS	DZ23C36	VISH	dz×2	V_Z=34...38 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=90 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVS	DZ23C36	DIODS	dz×2	V_Z=34...38 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=90 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVT	DZ23C39	VISH	dz×2	V_Z=37...41 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=90 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVT	DZ23C39	DIODS	dz×2	V_Z=37...41 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=90 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVU	DZ23C43	VISH	dz×2	V_Z=40...46 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVU	DZ23C43	DIODS	dz×2	V_Z=40...46 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVV	DZ23C47	VISH	dz×2	V_Z=44...50 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVV	DZ23C47	DIODS	dz×2	V_Z=44...50 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVW	DZ23C51	VISH	dz×2	V_Z=48...54 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
KVW	DZ23C51	DIODS	dz×2	V_Z=48...54 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
KY1	BZX84C11	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.4...11.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KY2	BZX84C12	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.4...12.7 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<25 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KY3	BZX84C13	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.4...14.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KY4	BZX84C15	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=13.8...15.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<30 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KY5	BZX84C16	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.3...17.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KY6	BZX84C18	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<45 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KY7	BZX84C20	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KY8	BZX84C22	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.8...23.3 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KY9	BZX84C24	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.8...25.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<70 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KYA	BZX84C27	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=25.1...28.9 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KYB	BZX84C30	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=28.0...32.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KYC	BZX84C33	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=31.0...35.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KYD	BZX84C36	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=33.0...38.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KYE	BZX84C39	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=36.0...41.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<130 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KYF	BZX84C43	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=40.0...46.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<150 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KYG	BZX84C47	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=44.0...50.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<170 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KYH	BZX84C51	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=48.0...54.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=2 мА)<180 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ1	BZX84C4V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.4...5.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ2	BZX84C5V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.8...5.4 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<60 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ3	BZX84C5V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.2...6.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ4	BZX84C6V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.8...6.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ5	BZX84C6V8	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.4...7.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ6	BZX84C7V5	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.0...7.9 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ7	BZX84C8V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.7...8.9 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ8	BZX84C9V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.5...9.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZ9	BZX84C10	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZC	BZX84C2V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.51...2.89 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZD	BZX84C3V0	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.8...3.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZE	BZX84C3V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.1...3.5 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZF	BZX84C3V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.4...3.8 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZG	BZX84C3V9	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.7...4.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
KZH	BZX84C4V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.0...4.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L0	HSMP3860	HP	pin	I_F<1 A; V_{BR}>50 В; R_S(typ)=3.0 Ом; C_D(typ)=0.20 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L0	HSMP386B	HP	pin	I_F<1 A; V_{BR}>50 В; R_S(typ)=3.0 Ом; CT(typ)=0.20 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
L05	ZLLS500	ZETEX	shd	V_R<40 В; I_F<0.7 A; V_F(I_F=0.75 A)<0.63 В; I_R<10 мкА; C_D=16 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L0p	BAT721S	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L0t	BAT721S	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L0W	BAT721S	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L1	BSS65	ZETEX	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...150; f_T>400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L10	ZLLS1000	ZETEX	shd	V_R<40 В; I_F<1.16 A; I_R<20 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L14	DTB114GK	ROHM	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_2=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
L14	DTD114GK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_2=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
L2	BSS69	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...150; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L2	HSMP3862	HP	pin×2	I_F<1 A; V_{BR}>50 В; R_S(typ)=3.0 Ом; C_D(typ)=0.20 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L2	HSMP386C	HP	pin×2	I_F<1 A; V_{BR}>50 В; R_S(typ)=3.0 Ом; CT(typ)=0.20 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
L2	KTC4075	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=70...140; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
L20	BAS29	PHIL	di	V_R<90 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.0 В; C_D<35 пФ; t_{RR}<50	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L20	CMPD1001	CSI	dih	I_F<250 мА; V_R=90 В; V_F(I_F=10 мА)<0.75 В; I_R<100 нА; t_{RR}<50 нс; C_T<35 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L20	KSK211	SAMS	nFET	V_{DS}=18 В; P_D=200 мВт; I_{DSS}>1 мА; g_F>9 мСм	SOT23,SOD23	D•G•S
L21	BAS31	PHIL	di×2	V_R<90 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.0 В; C_D<35 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L21	CMPD1001S	CSI	dih×2	I_F<250 мА; V_R=90 В; V_F(I_F=10 мА)<0.75 В; I_R<100 нА; t_{RR}<50 нс; C_T<35 пФ	SOT23,SOD23	A2•K1•K2,A1
L22	BAS35	PHIL	dih×2	V_R<90 В; I_F<250 мА; V_F(I_F=200 мА)<1.0 В; C_D<35 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2

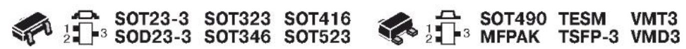
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
L22	CMPD1001A	CSI	dih×2	I_F<250 мА; V_R=90 В; V_F(I_F=10 мА)<0.75 В; I_R<100 нА; t_{RR}<50 нс; C_T<35 пФ	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
L24	DTD114GK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_2=10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
L24	DTD114GK	ROHM	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>200 МГц; R_2=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
L3	BSS70	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L3	HSMP3863	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>50 В; R_S(typ)=3.0 Ом; C_D(typ)=0.20 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L3	HSMP386E	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>50 В; R_S(typ)=3.0 Ом; CT(typ)=0.20 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
L3	KST1623L3	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=60...120; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L3	MMBC1623L3	MOT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=60...120	SOT23,SOD23	B•E•C
L31	BAV23S	PHIL	d×2	V_R<200 В; I_F<225 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; C_D<5 пФ; t_{RR}<50 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L4	BAT54	PANJIT	shd	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=100 мА)<1 В	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4	BAT54	TSC	shd	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4	BAT54	GS	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4	BAT54	DIOT	shd	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4	BAT54	VISH	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<2 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4	BAT54W	PHIL	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=1 мА)<320 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT323,SC70	A•n.c.•K
L4	HSMP3864	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>50 В; R_S(typ)=3.0 Ом; CT(typ)=0.20 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L4	HSMP386F	HP	pin×2	I_F<1 А; V_{BR}>50 В; R_S(typ)=3.0 Ом; CT(typ)=0.20 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
L4	KST1623L4	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=90...180; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L4	KTC4075	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
L4	MMBC1623L4	MOT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=90...180	SOT23,SOD23	B•E•C
L42	BAT54A	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L42	BAT54A	MCC	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L42	BAT54A	PANJIT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=100 мА)<1 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L42	BAT54A	TSC	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L42	BAT54A	GS	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L42	BAT54A	DIOT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L42	BAT54A	Nat	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L42	BAT54A	VISH	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<2.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L42	BAT54A	ZETEX	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<4.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L43	BAT54B	VISH	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<2.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	MCC	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	PANJIT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=100 мА)<1 В	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	TSC	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	GS	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	DIOT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	Nat	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	VISH	shd×2	V_R=30 В; I_F=200 мА; P_D=200 мВт; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L43	BAT54C	ZETEX	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<4.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L44	BAT54S	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L44	BAT54S	MCC	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L44	BAT54S	PANJIT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=100 мА)<1 В	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L44	BAT54S	TSC	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L44	BAT54S	GS	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L44	BAT54S	DIOT	shd×2	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L44	BAT54S	Nat	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L44	BAT54S	VISH	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<2.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L44	BAT54S	ZETEX	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<4.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L4p	BAT54	PHIL	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4P	BAT54	MCC	shd	V_R<30 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4p	BAT54	Nat	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4t	BAT54	PHIL	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
L4W	BAT54	PHIL	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L4Z	BAT54	ZETEX	shd	V_R<30 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<4.0 мкА; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L5	BSS65R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...150; f_T>400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L5	KST1623L5	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=135...270; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L5	MMBC1623L5	MOT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=1350...270	SOT23,SOD23	B•E•C
L52	BAS678	PHIL	fd	V_R<80 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.0 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L5p	BAS55	PHIL	fd	V_R<60 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.0 В; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L6	BAR17	INF	pin	V_R<100 В; I_F<140 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.0 В; I_R<0.05 мкА; C_D<0.37 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L6	BSS69R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...150; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L6	KST1623L6	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=200...400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L6	KTC4075	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=200...400; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
L6	MMBC1623L6	MOT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=200...400	SOT23,SOD23	B•E•C
L7	BAR141	INF	pin×2	V_R<100 В; I_F<140 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.05 В; I_R<0.1 мкА; C_D<0.2 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L7	BAT17	GS	shd	V_R<4 В; I_F<30 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<450 мВ; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•n.c.•K
L7	BAT17DS	GS	shd×2	V_R<4 В; I_F<30 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<450 мВ; C_D<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
L7	BSS70R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L7	KST1623L7	SAMS	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=300...600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L7	MMBC1623L7	MOT	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=300...600	SOT23,SOD23	B•E•C
L77	FMMTL717	ZETEX	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=1250 мА; P_D=500 мВт; h_{21}>50; f_T=205 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L78	FMMTL718	ZETEX	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=1000 мА; P_D=500 мВт; h_{21}>50; f_T=265 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
L7p	BAT721	PHIL	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L7t	BAT721	PHIL	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L7W	BAT721	PHIL	shd	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
L8	BAR151	INF	pin×2	V_R<100 В; I_F<140 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.05 В; I_R<0.1 мкА; C_D<0.2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,A2
L8	KTC4075	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=350...700; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
L8p	BAT721A	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L8t	BAT721A	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L8W	BAT721A	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L9	1SS349	TOSH	shd	V_R>20 В; $V_F(I_F$=1 А)<0.55 В; $I_R(V_R$=20 В)<50 мкА; C_T<=250 пФ	SOT346,SC59	A•n.c.•K
L9	BAR161	INF	pin×2	V_R<100 В; I_F<140 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.05 В; I_R<0.1 мкА; C_D<0.2 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
L9p	BAT721C	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L9t	BAT721C	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
L9W	BAT721C	PHIL	shd×2	V_R<40 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.42 В; I_R<15 мкА; C_D<50 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
LA	BF550	SIEM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=50...250; f_T=350 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LA	RN1442A	TOSH	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...700; f_T=30 МГц; R_1=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
LAp	BF550	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=25 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T=325 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LB	2SC2462B	REN	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...200	SOT23,SOD23	B•E•C
LB	2SC5850B	REN	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...200	SOT323,SC70	B•E•C
LB	RN1442B	TOSH	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=350...1200; f_T=30 МГц; R_1=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
LB	S525T	VISH	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=200 мВт; g_F=16 мСм	SOT23,SOD23	G•D•S
LBL	KTC4075	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=350...700; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LBs	BF999	SIEM	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=200 мВт; NF=1.0 дБ; I_{DSS}=5...18 мА; g_F=18 мСм	SOT23,SOD23	G•D•S
LC	2SC2462C	REN	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=160...320	SOT23,SOD23	B•E•C
LC	2SC5850C	REN	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=160...320	SOT323,SC70	B•E•C
LD	2SC2462D	REN	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
LD	2SC5850D	REN	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT323,SC70	B•E•C
LD	BF543	TELEF	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=200 мВт; g_F=70 мС; $R_{DS(on)}$=10 Ом	SOT23,SOD23	G•D•S
LD3	BAT54S	ZOWIE	shd×2	V_R<30 В; $V_F(I_F$=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
LDs	BF543	SIEM	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=30 мА; P_D=200 мВт; NF=1.0 дБ; g_F=12 мСм	SOT23,SOD23	G•D•S
LE	2SC2412KLNE	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390...820; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
LEp	BF660	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=30; f_T=650 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LEs	BF660	SIEM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}>30; f_T=700 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
LEs	BF660W	SIEM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}>30; f_T=700 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LG	2SC2712GR	TOSH	npn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=200...400; f_T>80 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
LG	2SC4116	TOSH	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>200...400; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LGR	KTC4075	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=200...400; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LGs	BF775A	SIEM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=50...250; f_T=5800 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LH	BF569	TELEF	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=25...90.; f_T>950 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LHp	BF569	PHIL	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=50; f_T=900 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LHs	BF569	SIEM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}>20; f_T>950 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LHs	BF569W	SIEM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}>20; f_T=950 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LK	BF799	SIEM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=35 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=40...250; f_T=1100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LKs	BF799W	SIEM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=35 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=40...250; f_T=1100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LL	2SC2712BL	TOSH	npn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=350...700; f_T>80 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
LL	2SC4116	TOSH	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>350...700; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LM	BF569R	TELEF	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=25...90.; f_T>950 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
LO	2SC2712O	TOSH	npn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...140; f_T>80 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
LO	2SC4116	TOSH	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>70...140; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LO	KTC4075	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=70...140; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LOs	BF775	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=40...250; f_T=4500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LOs	BF775W	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=40...200; f_T=5000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LR	2SC2412KLNR	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
LRs	BF517	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=25...250; f_T=2000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LS	2SC2412KLNS	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
LSs	BF770A	SIEM	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>40; f_T=5500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
LY	2SC2712Y	TOSH	npn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
LY	2SC4116	TOSH	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>120...240; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
LY	KTC4075	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
M1	MMBZ5256BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=4.2 мА)=28.5...31.5 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
M16	PMBF4416A	PHIL	nFET	V_{DS}=35 В; I_{DSS}=15 мА; P_D=250 мВт; g_F<7.5 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
M1B	MMBT2222ALT1	ON	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=225 мВт; h_{21}>30	SOT23,SOD23	B•E•C
M1E	MMBTA43LT1	MOT	npn	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=225 мВт; h_{21}>25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
M1J	MMBT2369LT1	MOT	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...120	SOT23,SOD23	B•E•C
M1p	BFR30	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=10 мА; P_D=250 мВт; g_F=4 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
M1T	ADM1811-10AKS	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M1T	ADM1811-10ART	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M1V	ADM1811-5AKS	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M1V	ADM1811-5ART	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M2	MMBZ5257BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=3.8 мА)=31.35...34.65 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
M2C	MMBTA70LT1	MOT	pnp	V_{CE0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
M2p	BFR31	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=5 мА; P_D=250 мВт; g_F=4.5 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
M3	KDV173	KEC	pin×2	V_R=50 В; I_R=0.1 мкА; C_T=0.25 пФ; R_S<7.0 Ом	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
M3	KST812M3	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=60...120	SOT23,SOD23	B•E•C
M3	MMBA812M3	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=60...120	SOT23,SOD23	B•E•C
M3	MMBA812M3	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=60...120	SOT23,SOD23	B•E•C
M3	MMBZ5258BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=3.4 мА)=34.2...37.8 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
M3A	MMBTH24LT1	MOT	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>30; f_T>400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
M3B	MMBT918LT1	MOT	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>20; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
M3J	MMBTH69LT1	MOT	pnp	V_{CB0}=15 В; P_D=300 мВт; h_{21}=30...300; f_T>2000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
M3p	BFT46	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=1.5 мА; P_D=250 мВт; g_F>0.5 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
M3T	ADM1813-10AKS	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M3T	ADM1813-10ART	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M3V	ADM1813-5AKS	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M3V	ADM1813-5ART	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND

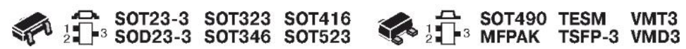



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
M4	BSR56	FAIR	nFET	V_{DS}=40 В; I_D=50 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<25 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
M4	KST812M4	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=90...180	SOT23,SOD23	B•E•C
M4	MMBA812M4	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=90...180	SOT23,SOD23	B•E•C
M4	MMBZ5259BT	DIODS	dz	V_Z(I_{ZT}=3.2 мА)=37.05...41.0 В; I_R<0.1 мкА	SOT523	A•n.c.•K
M4A	MMBV109LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{3В}$=26...32 пФ; $C_{3В}/C_{25В}$=5.0...6.5	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
M4B	MMBV432LT1	ON	var×2	V_R>14 В; I_F=200 мА; $C_{2В}$=43...48.1 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$=1.5...2	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
M4C	MMBV3102LT1	ON	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{3В}$=20...25 пФ; $C_{2В}/C_{25В}$=4.5...4.8	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
M4E	MMBV105GLT1	ON	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{3В}/C_{25В}$=4.0...6.5	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
M4F	ADM1815-10AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M4F	ADM1815-10ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M4F	MMBD353LT1	MOT	shd×2	V_R>7 В; V_F(I_F=10 мА)<0.6 В; C_T<1 пФ	SOT23,SOD23	K1•A2•A1,K2
M4G	MMBV2101LT1	MOT	var	V_R>30 В; I_F=200 мА; $C_{4В}$=6.1...7.5 пФ; $C_{2В}/C_{30В}$=2.5...3.2	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
M4P	BSR56	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_D=50 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<25 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
M4T	ADM1818-5AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M4T	ADM1818-5ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M4Y	ADM1810-5AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M4Y	ADM1810-5ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M4Z	ADM1810-10AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M4Z	ADM1810-10ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M5	KST812M5	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=135...270	SOT23,SOD23	B•E•C
M5	MMBA812M5	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=135...270	SOT23,SOD23	B•E•C
M5	MMBA812M5	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=135...270	SOT23,SOD23	B•E•C
M5	MMBD352WT1	MOT	shd×2	V_R>7 В; V_F(I_F=10 мА)<0.6 В; C_T<1 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•A2,K1
M54	ADM1816-10AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M54	ADM1816-10ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M59	ADM1818-20AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M59	ADM1818-20ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M5A	ADM1815-20AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M5A	ADM1815-20ART	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M5B	ADM1815-R22AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M5B	ADM1815-R22ART	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M5C	ADM1815-R23AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M5C	ADM1815-R23ART	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M5C	MMBD7000LT1	MOT	di×2	V_R>100 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.1 В; C_D<1.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
M5E	ADM1815-10AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M5E	ADM1815-10ART	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M5G	MMBD352LT1	MOT	shd×2	V_R>7 В; V_F(I_F=10 мА)<0.6 В; C_T<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•A2,K1
M5K	ADM1815-5AKS	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M5K	ADM1815-5ART	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M5P	BSR57	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_D=20 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<40 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
M6	BSS66	ZETEX	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...150; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
M6	KST812M6	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=200...400	SOT23,SOD23	B•E•C
M6	MMBA812M6	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=200...400	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
M6	MMBA812M6	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=200...400	SOT23,SOD23	B•E•C
M68	PMBFJ210	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=2...15 мА; P_D=250 мВт; g_F=4...12 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
M69	PMBFJ211	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=7...20 мА; P_D=250 мВт; g_F=6...12 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
M6A	ADM1816-20AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6A	ADM1816-20ART	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M6B	ADM1816-R22AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6B	ADM1816-R22ART	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M6C	ADM1816-R23AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6C	ADM1816-R23ART	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M6E	ADM1816-10AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6E	ADM1816-10ART	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M6H	ADM1816-20AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6H	ADM1816-20ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M6H	MMBD354LT1	MOT	shd×2	V_R>7 В; $V_F(I_F$=10 мА)<0.6 В; C_T<1 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
M6K	ADM1816-5AKS	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6K	ADM1816-5ART	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M6P	BSR58	PHIL	nFET	V_{DS}=40 В; I_D=8 мА; P_D=250 мВт; $R_{DS(on)}$<60 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
M6X	ADM1813-5AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6X	ADM1813-5ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M6Y	ADM1813-10AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6Y	ADM1813-10ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M6Z	ADM1811-5AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M6Z	ADM1811-5ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M7	BSS67	ZETEX	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
M7	KST812M7	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=300...600	SOT23,SOD23	B•E•C
M7	MMBA812M7	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=300...600	SOT23,SOD23	B•E•C
M7	MMBA812M7	MOT	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=300...600	SOT23,SOD23	B•E•C
M70	ADM1811-10AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M70	ADM1811-10ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M70	PMBFJ212	PHIL	nFET	V_{DS}=25 В; I_{DSS}=15...40 мА; P_D=250 мВт; g_F=7...12 мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
M71	ADM1812-10AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M71	ADM1812-10ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M72	ADM1812-5AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M72	ADM1812-5ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M73	ADM1815-5AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M73	ADM1815-5ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M74	ADM1815-R22AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M74	ADM1815-R22ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M75	ADM1815-R23AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M75	ADM1815-R23ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
M76	ADM1815-20AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M76	ADM1815-20ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M77	ADM1816-5AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M77	ADM1816-5ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M78	ADM1816-R22AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M78	ADM1816-R22ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M79	ADM1816-R23AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M79	ADM1816-R23ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M7A	ADM1817-20AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7A	ADM1817-20ART	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7B	ADM1817-R22AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7B	ADM1817-R22ART	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7C	ADM1817-R23AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7C	ADM1817-R23ART	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7E	ADM1817-10AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7E	ADM1817-10ART	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7F	ADM1817-5AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7F	ADM1817-5ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7G	ADM1817-10AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7G	ADM1817-10ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7H	ADM1817-20AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7H	ADM1817-20ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7J	ADM1817-R22AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7J	ADM1817-R22ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7K	ADM1817-5AKS	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7K	ADM1817-5ART	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7L	ADM1817-R23AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
M7L	ADM1817-R23ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
M7N	ADM1818-R23AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M7N	ADM1818-R23AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M7P	ADM1818-10AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M7P	ADM1818-10ARTZ	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M8	BSH103	PHIL	nMOS	V_{DS}=30 В; I_D=850 мА; P_D=500 мВт; $R_{DS(on)}$<0.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
M8	BSS66R	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...150; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
M8A	ADM1818-20AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M8A	ADM1818-20ART	AD	mrc	V_{TR}=2.55 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND

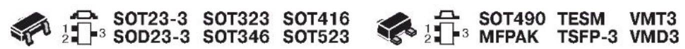
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
M8B	ADM1818-R22AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M8C	ADM1818-R22AKSZ	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M8C	ADM1818-R22ART	AD	mrc	V_{TR}=2.18 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M8C	ADM1818-R23ART	AD	mrc	V_{TR}=2.31 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M8E	ADM1818-10AKS	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M8E	ADM1818-10ART	AD	mrc	V_{TR}=2.88 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M8E	ADM1818-5AKS	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
M8K	ADM1818-5ART	AD	mrc	V_{TR}=3.06 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
M8p	BSN20	PHIL	nMOS	V_{DS}=50 В; I_D=110 мА	SOT23,SOD23	G•S•D
M9	BSS67R	ZETEX	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
MA	FMMTA06R	ZETEX	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
MA	M1MA151AT	MOT	di	V_R<40 В; I_F<100 мА	SOT346,SC59	K•n.c.•A
MA6	MMBD2838LT1	MOT	di×2	V_R<50 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=50 мА)<1 В; C_D<4 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
MB	2SA1052B	REN	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...200	SOT23,SOD23	B•E•C
MB	FMMTA56R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
MB	M1MA152AT	MOT	di	V_R<80 В; I_F<100 мА	SOT346,SC59	K•n.c.•A
MC	2SA1052C	REN	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=160...320	SOT23,SOD23	B•E•C
MC	2SA2080C	REN	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=160...320	SOT323,SC70	B•E•C
MC	ZVN3306F	ZETEX	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=150 мА; P_D=330 мВт; g_F=100 мСм; $R_{DS(on)}$=5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
MCs	BFS17P	SIEM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=20...150; f_T=2500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
MCs	BFS17W	SIEM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=50 мА; P_D=280 мВт; h21s=20...150; f_T>2500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
MD	2SA1052D	REN	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
MD	2SA2080D	REN	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT323,SC70	B•E•C
MF	ZVN3310F	ZETEX	nMOS	V_{DS}=100В; I_D=100 мА; P_D=330 мВт; g_F=150 мСм; $R_{DS(on)}$=5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
MH	M1MA141KT	MOT	di	V_R<40 В; I_F<100 мА	SOT323,SC70	A•n.c.•K
MH	M1MA151KT	MOT	di	V_R<40 В; I_F<100 мА	SOT346,SC59	A•n.c.•K
MI	M1MA142KT	MOT	di	V_R<80 В; I_F<100 мА	SOT323,SC70	A•n.c.•K
MI	M1MA152KT	MOT	di	V_R<80 В; I_F<100 мА	SOT346,SC59	A•n.c.•K
MJ1	MMBD355LT1	MOT	shd×2	V_R>7 В; V_F(I_F=10 мА)<0.6 В; C_T<1 пФ	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
ML	ZVP3306F	ZETEX	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=90 мА; P_D=330 мВт; g_F=25 мСм; $R_{DS(on)}$=80 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
MN	M1MA141WA	MOT	di×2	V_R<40 В; I_F<100 мА	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
MN	M1MA151WA	MOT	di×2	V_R<40 В; I_F<100 мА	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
MO	M1MA142WA	MOT	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
MO	M1MA152W	MOT	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
MR	ZVP3310F	ZETEX	pMOS	V_{DS}=100В; I_D=45 мА; P_D=330 мВт; g_F=60 мСм; $R_{DS(on)}$=14 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
MT	M1MA141WK	MOT	di×2	V_R<40 В; I_F<100 мА	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
MT	M1MA151WK	MOT	di×2	V_R<40 В; I_F<100 мА	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
MT	ZVP1320F	ZETEX	pMOS	V_{DS}=200В; I_D=35 мА; P_D=330 мВт; g_F=150 мСм; $R_{DS(on)}$=2.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
MTT	ADM1812-10AKS	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
MTT	ADM1812-10ART	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
MTV	ADM1812-5AKS	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•RST•GND
MTV	ADM1812-5ART	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	RST•V_{CC}•GND
MU	M1MA142WK	MOT	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
MU	M1MA152WK	MOT	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
MU	ZVN3320F	ZETEX	nMOS	V_{DS}=200В; I_D=60 мА; P_D=330 мВт; g_F=100 мСм; $R_{DS(on)}$=10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
MV	1SV272	SANYO	pin	V_R>50 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1 В; I_R<0.5 мкА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
MV	BS170F	ZETEX	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=150 мА; P_D=330 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D
MX	BS250F	ZETEX	pMOS	V_{DS}=45В; I_D=90 мА; P_D=330 мВт; g_F=200 мСм; $R_{DS(on)}$=5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
MY	VN10LF	ZETEX	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=150 мА; P_D=330 мВт	SOT23,SOD23	G•S•D




SOT23-3 SOT323 SOT416 SOD23-3 SOT346 SOT523 SOT490 TESM VMT3 MFPAK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
MZ	ZVN4106F	ZETEX	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=200 мА; P_D=330 мВт; g_F=75 мСм; $R_{DS(on)}$=25 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
MZT	ADM1810-10AKS	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
MZT	ADM1810-10ART	AD	mrc	V_{TR}=4.35 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
MZV	ADM1810-5AKS	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT323,SC70	V_{CC}•$\overline{RST}$•GND
MZV	ADM1810-5ART	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<16 мкА	SOT23,SOD23	$\overline{RST}$•V_{CC}•GND
N	BAV70	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
N	DAN202K	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<200 мВт; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
N	DAN202U	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<200 мВт; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
N	DAN222	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<150 мВт; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
N	DAN222M	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<150 мВт; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	VMT3,VMD3	A1•A2•K1,K2
N0	TN0200T	SIL	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=730 мА; P_D=350 мВт; I_{DSS}=8...20 мА; g_F=4 мСм	SOT23,SOD23	G•S•D
N0	TN0200T	NS	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=730 мА; P_D=350 мВт; I_{DSS}=8...20 мА; g_F=4 мСм	SOT23,SOD23	G•S•D
N01	DDTC113TCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 1 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N01	DDTC113TE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R1 1 к	SOT523	B•E•C
N01	DDTC113TKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 1 к	SOT346,SC59	B•E•C
N01	DDTC113TUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 1 к	SOT323,SC70	B•E•C
N02	DDTC113ZCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 1 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N02	DDTC113ZE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 1 к/10 к	SOT523	B•E•C
N02	DDTC113ZKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 1 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
N02	DDTC113ZUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 1 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
N03	DDTC123TCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 2.2 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N03	DDTC123TE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R_1 2.2 к	SOT523	B•E•C
N03	DDTC123TKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 2.2 к	SOT346,SC59	B•E•C
N03	DDTC123TUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 2.2 к	SOT323,SC70	B•E•C
N04	DDTC123ECA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/2.2 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N04	DDTC123EE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 2.2 к/2.2 к	SOT523	B•E•C
N04	DDTC123EKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/2.2 к	SOT346,SC59	B•E•C
N04	DDTC123EUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/2.2 к	SOT323,SC70	B•E•C
N05	DDTC123YCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N05	DDTC123YE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 2.2 к/10 к	SOT523	B•E•C
N05	DDTC123YKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
N05	DDTC123YUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
N05	SO2484	SGS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; f_T>60 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N06	DDTC123JCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N06	DDTC123JE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 2.2 к/47 к	SOT523	B•E•C
N06	DDTC123JKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
N06	DDTC123JUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
N07	DDTC143TCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 4.7 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N07	DDTC143TE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R_1 4.7 к	SOT523	B•E•C
N07	DDTC143TKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 4.7 к	SOT346,SC59	B•E•C
N07	DDTC143TUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 4.7 к	SOT323,SC70	B•E•C
N08	DDTC143ECA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/4.7 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N08	DDTC143EE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 4.7 к/4.7 к	SOT523	B•E•C
N08	DDTC143EKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/4.7 к	SOT346,SC59	B•E•C
N08	DDTC143EUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/4.7 к	SOT323,SC70	B•E•C
N08	SO930	SGS	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}<600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N09	DDTC123XCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N09	DDTC123XE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 4.7 к/10 к	SOT523	B•E•C
N09	DDTC123XKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
N09	DDTC123XUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
N1	MMBF201N	MOT	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=200 мА	SOT23,SOD23	G•S•D

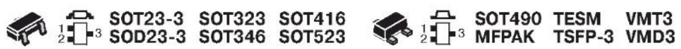
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
N1	MMBT100	FAIR	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=450; f_T > 250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N1	TN0201T	SIL	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=390 мА; P_D=350 мВт; g_F=450 мСм; $R_{DS(on)}$=0.75 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
N1	TN0201T	TEMIC	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=390 мА; P_D=350 мВт; g_F=450 мСм; $R_{DS(on)}$=0.75 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
N10	DDTC143FCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/22 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N10	DDTC143FE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 4.7 к/22 к	SOT523	B•E•C
N10	DDTC143FKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/22 к	SOT346,SC59	B•E•C
N10	DDTC143FUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/22 к	SOT323,SC70	B•E•C
N10	SO918	SGS	npn	V_{CE0}=15 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; f_T > 600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N11	DDTC143ZCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N11	DDTC143ZE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 4.7 к/47 к	SOT523	B•E•C
N11	DDTC143ZKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
N11	DDTC143ZUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
N11	SO2369	SGS	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=40...120; f_T > 400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N12	DDTC114TCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R1 10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N12	DDTC114TE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R1 10 к	SOT523	B•E•C
N12	DDTC114TKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R1 10 к	SOT346,SC59	B•E•C
N12	DDTC114TUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R1 10 к	SOT323,SC70	B•E•C
N12	SO2221	SGS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=40...120; f_T > 250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N12	TMPT2221	ALLEG	npn	V_{CB0}=60 В; I_{CB0} < 10 нА; h_{21}=40...120; $V_{CE(sat)}$ < 0.4 В; f_T > 250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N13	DDTC114ECA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N13	DDTC114EE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/10 к	SOT523	B•E•C
N13	DDTC114EKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
N13	DDTC114EUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
N13	SO2222	SGS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...300; f_T > 250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N14	DDTC114YCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N14	DDTC114YE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/47 к	SOT523	B•E•C
N14	DDTC114YKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
N14	DDTC114YUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
N15	DDTC114WCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/4.7 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N15	DDTC114WE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/4.7 к	SOT523	B•E•C
N15	DDTC114WKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/4.7 к	SOT346,SC59	B•E•C
N15	DDTC114WUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/4.7 к	SOT323,SC70	B•E•C
N16	DDTC124TCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 22 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N16	DDTC124TE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R_1 22 к	SOT523	B•E•C
N16	DDTC124TKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 22 к	SOT346,SC59	B•E•C
N16	DDTC124TUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 22 к	SOT323,SC70	B•E•C
N17	DDTC124ECA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 22 к/22 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N17	DDTC124EE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 22 к/22 к	SOT523	B•E•C
N17	DDTC124EKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 22 к/22 к	SOT346,SC59	B•E•C
N17	DDTC124EUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 22 к/22 к	SOT323,SC70	B•E•C
N18	DDTC124XCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 22 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N18	DDTC124XE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 22 к/47 к	SOT523	B•E•C
N18	DDTC124XKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 22 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
N18	DDTC124XUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 22 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
N18	SO1711	SGS	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21} > 35; f_T > 70 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N19	DDTC144TCA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N19	DDTC144TE	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R_1 47 к	SOT523	B•E•C
N19	DDTC144TKA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 47 к	SOT346,SC59	B•E•C
N19	DDTC144TUA	DIODS	Dnpn	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 47 к	SOT323,SC70	B•E•C
N2	BFS520	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=70 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=60...200; f_T=9 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
N2	MGSF1N02LT1	ON	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=750 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$ < 0.13 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
N2	MMBC1653N2	MOT	npn	V_{CB0}=150 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...130	SOT23,SOD23	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
N20	DDTC144ECA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N20	DDTC144EE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; 47 к/47 к	SOT523	B•E•C
N20	DDTC144EKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
N20	DDTC144EUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
N20	SO2222A	SGS	npn	$V_{CB0}=75$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=310$ мВт; $h_{21}=100...300$; $f_T>250$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N21	DDTC144VCA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N21	DDTC144VE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; 47 к/10 к	SOT523	B•E•C
N21	DDTC144VKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
N21	DDTC144VUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
N22	DDTC144WCA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/22 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N22	DDTC144WE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; 47 к/22 к	SOT523	B•E•C
N22	DDTC144WKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/22 к	SOT346,SC59	B•E•C
N22	DDTC144WUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 47 к/22 к	SOT323,SC70	B•E•C
N23	DDTC115TCA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_1 100 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N23	DDTC115TE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; R_1 100 к	SOT523	B•E•C
N23	DDTC115TKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_1 100 к	SOT346,SC59	B•E•C
N23	DDTC115TUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_1 100 к	SOT323,SC70	B•E•C
N24	DDTC115ECA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 100 к/100 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N24	DDTC115EE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; 100 к/100 к	SOT523	B•E•C
N24	DDTC115EKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 100 к/100 к	SOT346,SC59	B•E•C
N24	DDTC115EUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; 100 к/100 к	SOT323,SC70	B•E•C
N25	DDTC125TCA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_1 200 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N25	DDTC125TE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; R_1 200 к	SOT523	B•E•C
N25	DDTC125TKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_1 200 к	SOT346,SC59	B•E•C
N25	DDTC125TUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_1 200 к	SOT323,SC70	B•E•C
N26	DDTC114GCA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R2 10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N26	DDTC114GE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; R2 10 к	SOT523	B•E•C
N26	DDTC114GKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R2 10 к	SOT346,SC59	B•E•C
N26	DDTC114GUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R2 10 к	SOT323,SC70	B•E•C
N27	DDTC124GCA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_2 22 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N27	DDTC124GE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; R_2 22 к	SOT523	B•E•C
N27	DDTC124GKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; R_2 22 к	SOT346,SC59	B•E•C
N27	DDTC124GUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; R_2 22 к	SOT323,SC70	B•E•C
N27	SO1893	SGS	npn	$V_{CB0}=120$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=310$ мВт; $h_{21}=40...120$; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N28	DDTC144GCA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_2 47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N28	DDTC144GE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; R_2 47 к	SOT523	B•E•C
N28	DDTC144GKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_2 47 к	SOT346,SC59	B•E•C
N28	DDTC144GUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_2 47 к	SOT323,SC70	B•E•C
N28	SO3572	SGS	npn	$V_{CB0}=15$ В; $P_D=200$ мВт; $f_T>1$ ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N29	DDTC115GCA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_2 100 к	SOT23,SOD23	B•E•C
N29	DDTC115GE	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<150$ мВт; R_2 100 к	SOT523	B•E•C
N29	DDTC115GKA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_2 100 к	SOT346,SC59	B•E•C
N29	DDTC115GUA	DIODS	Dnpn	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D<200$ мВт; R_2 100 к	SOT323,SC70	B•E•C
N3	KDV152S	KEC	bd	$V_R=15$ В; $I_R=50$ нА; C2 В=45 пФ; $C_{8 В}=26$ пФ; $R_S<0.3$ Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
N3	MGSF1N03LT1	ON	nMOS	$V_{DS}=30$ В; $I_D=1.5$ А; $P_D=420$ мВт; $R_{DS(on)}<0.145$ Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
N3	MMBC1653N3	MOT	npn	$V_{CB0}=150$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=300$ мВт; $h_{21}=100...220$	SOT23,SOD23	B•E•C
N4	MMBC1653N4	MOT	npn	$V_{CB0}=150$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=300$ мВт; $h_{21}=150...330$	SOT23,SOD23	B•E•C
N44	SO3571	SGS	npn	$V_{CB0}=15$ В; $P_D=200$ мВт; $f_T>1.2$ ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N47	SO3570	SGS	npn	$V_{CB0}=15$ В; $P_D=200$ мВт; $f_T>1.5$ ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N5	MMBC1654N5	MOT	npn	$V_{CB0}=180$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=300$ мВт; $h_{21}=50...130$	SOT23,SOD23	B•E•C
N54	SO2221A	SGS	npn	$V_{CB0}=75$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=310$ мВт; $h_{21}=40...120$; $f_T>250$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N54	TMPT2221A	ALLEG	npn	$V_{CB0}=75$ В; $I_{CB0}<10$ нА; $h_{21}=40...120$; $V_{CE(sat)}<0.3$ В; $f_T>250$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

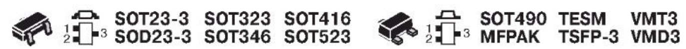
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
N6	BFS25A	PHIL	npn	I_C=6.5 мА; P_D=32 мВт; h_{21}>40; f_T=5.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
N6	MMBC1654N6	MOT	npn	V_{CBO}=180 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...220	SOT23,SOD23	B•E•C
N7	MMBC1654N7	MOT	npn	V_{CBO}=180 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=150...330	SOT23,SOD23	B•E•C
N71	SO3904	SGS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N72	SO3903	SGS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...150; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N79	SO5550	SGS	npn	V_{CBO}=160 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=60...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N80	SO5551	SGS	npn	V_{CBO}=180 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=80...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N81	SO2369A	SGS	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=40...120; f_T>500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N9	1SS372	TOSH	shd×2	V_R<10 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.5 В; C_D<40 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
N9	1SS374	TOSH	shd×2	V_R>10 В; $V_F(I_F$=100 мА)<0.5 В; $I_R(V_R$=10 В)<20 мкА; C_T<40 пФ	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
N9	DAN222	ON	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<150 мВт; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
N91	SO642	SGS	npn	V_{CBO}=300 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
N94	SO517	SGS	dpnp	V_{CBO}=40 В; I_C=400 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>30000; f_T>220 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
NA	FMMTA05R	ZETEX	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
NA	KRC401	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NA	RN1443A	TOSH	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...700; f_T=30 МГц; R_1=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
NA1	MMBT100A	FAIR	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=500 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=600; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
NB	BF599	SIEM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}>38; f_T=550 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
NB	DAP222U	ON	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<150 мВт; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
NB	FMMTA55R	ZETEX	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
NB	KRC402	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NB	RN1443B	TOSH	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=350...1200; f_T=30 МГц; R_1=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
NC	BF840	CDIL	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=65...220; f_T>380 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
NC	BF840	SIEM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=65...220; f_T=380 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
NC	KRC403	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NCp	BF840	PHIL	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=25 мА; P_D=250 мВт; I_B=4.5...15 мкА; f_T=380 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ND	2SD1306D	REN	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=700 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
ND	BF841	CDIL	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=35...125; f_T>380 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ND	BF841	SIEM	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=25 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=35...125; f_T=380 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ND	KRC404	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NDp	BF841	PHIL	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=25 мА; P_D=250 мВт; I_B=8...28 мкА; f_T=380 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
NE	2SD1306E	REN	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=700 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=400...800	SOT23,SOD23	B•E•C
NE	KRC405	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NF	KRC406	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NK	KRC410	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1=4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NM	KRC411	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1=10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NN	KRC412	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1=100 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NO	KRC413	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1=22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NP	KRC414	KEC	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1=47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
NS	TN0200TS	SIL	nMOS	V_{DS}=20 В; I_D=1200 мА; P_D=1000 мВт; g_F=2200 мСм; $R_{DS(on)}$=0.4 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
O05	SO2484R	SGS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; f_T>60 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O08	SO930R	SGS	npn	V_{CBO}=45 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}<600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O10	SO918R	SGS	npn	V_{CEO}=15 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O12	SO2221R	SGS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=40...120; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O13	SO2222R	SGS	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O20	SO2222AR	SGS	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O27	SO1893R	SGS	npn	V_{CBO}=120 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=40...120; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O54	SO2221AR	SGS	npn	V_{CBO}=75 В; I_C=800 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=40...120; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O79	SO5550R	SGS	npn	V_{CBO}=160 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=60...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O80	SO5551R	SGS	npn	V_{CBO}=180 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=80...250; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
O9	1SS377	TOSH	shd×2	V_R>10 В; $V_F(I_F$=100 мА)<0.5 В; $I_R(V_R$=10 В)<20 мкА; C_T<40 пФ	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
O9	1SS378	TOSH	shd×2	V_R<10 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.5 В; C_D<20 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
O9	1SS379	TOSH	di×2	V_R<80 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.3 В; I_R<0.01 мкА	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
O9	1SS385	TOSH	shd×2	V_R<10 В; V_F(I_F=100 мА)<0.5 В; I_R(V_R=10 В)<20 мкА; C_T<20 пФ	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
O9	1SS385F	TOSH	shd×2	V_R<10 В; V_F(I_F=100 мА)<0.5 В; I_R(V_R=10 В)<20 мкА; C_T<20 пФ	SOT490,SC89	A1•A2•K1,K2
O91	SO642R	SGS	npn	V_{CB0}=300 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
P	BAW56	VISH	di×2	V_R<70 В; I_F<300 мА; V_F(I_F=150 мА)<1.25 В; I_R<5.0 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
P	DAP202K	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<200 мВт; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
P	DAP202U	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<200 мВт; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
P	DAP222	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<150 мВт; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	K1•K2•A1,A2
P	DAP222M	ROHM	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<150 мВт; V_F(I_F=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	VMT3,VMD3	K1•K2•A1,A2
P0	HSMS2850	HP	shd	V_F(I_F=1 мА)<0.25 В; C_T=0.3 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
P0	HSMS285B	HP	shd	V_F(I_F=1 мА)<0.25 В; C_T=0.3 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
P0	TP0101T	SIL	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=600 мА; P_D=350 мВт; g_F=1300 мСм; $R_{DS(on)}$=0.65 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
P0	TP0101T	TEMIC	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=600 мА; P_D=350 мВт; g_F=1300 мСм; $R_{DS(on)}$=0.65 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
P01	DDTA113TCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 1 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P01	DDTA113TE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R_1 1 к	SOT523	B•E•C
P01	DDTA113TKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 1 к	SOT346,SC59	B•E•C
P01	DDTA113TUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 1 к	SOT323,SC70	B•E•C
p01	PDTA143ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p01	PDTA143EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P01	SO2906	SGS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=150 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...120; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P02	DDTA113ZCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 1 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P02	DDTA113ZE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 1 к/10 к	SOT523	B•E•C
P02	DDTA113ZKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 1 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
P02	DDTA113ZUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 1 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
p02	PDTC143ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p02	PDTC143EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P03	DDTA123TCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 2.2 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P03	DDTA123TE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R_1 2.2 к	SOT523	B•E•C
P03	DDTA123TKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 2.2 к	SOT346,SC59	B•E•C
P03	DDTA123TUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R_1 2.2 к	SOT323,SC70	B•E•C
p03	PDTA114ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P03	SO2907A	SGS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P04	DDTA123ECA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/2.2 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P04	DDTA123EE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 2.2 к/2.2 к	SOT523	B•E•C
P04	DDTA123EKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/2.2 к	SOT346,SC59	B•E•C
P04	DDTA123EUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/2.2 к	SOT323,SC70	B•E•C
p04	PMSS3904	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P05	DDTA123YCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P05	DDTA123YE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 2.2 к/10 к	SOT523	B•E•C
P05	DDTA123YKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
P05	DDTA123YUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
p05	PDTA124ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=30 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>56	SOT23,SOD23	B•E•C
p05	PDTA124ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p05	PDTA124EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P05	SO2907	SGS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P06	DDTA123JCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P06	DDTA123JE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 2.2 к/47 к	SOT523	B•E•C
P06	DDTA123JKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
P06	DDTA123JUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 2.2 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
p06	PDTC124EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
p06	PMSS3906	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

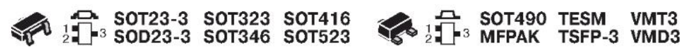
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
p06	PMSS3906	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
P06	SO2894	SGS	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...150; f_T>400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P07	DDTA143TCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 4.7 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P07	DDTA143TE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R1 4.7 к	SOT523	B•E•C
P07	DDTA143TKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 4.7 к	SOT346,SC59	B•E•C
P07	DDTA143TUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 4.7 к	SOT323,SC70	B•E•C
p07	PDTA144ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p07	PDTA144EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P08	DDTA143ECA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/4.7 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P08	DDTA143EE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 4.7 к/4.7 к	SOT523	B•E•C
P08	DDTA143EKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/4.7 к	SOT346,SC59	B•E•C
P08	DDTA143EUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/4.7 к	SOT323,SC70	B•E•C
p08	PDTC144ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p08	PDTC144EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P09	DDTA123XCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P09	DDTA123XE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 4.7 к/10 к	SOT523	B•E•C
P09	DDTA123XKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
P09	DDTA123XUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
p09	PDTB114ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>56; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p09	PDTC114EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P1	BFR92	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=273 мВт; h_{21}>40; f_T=4500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P1	BZX84C11T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.4...11.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом	SOT523	A•n.c.•K
P1	SST201	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=20...135 мА; $R_{DS(on)}$<85 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
P10	DDTA143FCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/422 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P10	DDTA143FE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 4.7 к/422 к	SOT523	B•E•C
P10	DDTA143FKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/422 к	SOT346,SC59	B•E•C
P10	DDTA143FUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/422 к	SOT323,SC70	B•E•C
p10	PDTD114ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>56; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P11	DDTA143ZCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P11	DDTA143ZE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 4.7 к/47 к	SOT523	B•E•C
P11	DDTA143ZKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
P11	DDTA143ZUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 4.7 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
p11	PDTA114TT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P12	DDTA114TCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P12	DDTA114TE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R1 10 к	SOT523	B•E•C
P12	DDTA114TKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 10 к	SOT346,SC59	B•E•C
P12	DDTA114TUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 10 к	SOT323,SC70	B•E•C
p12	PDTC114TT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P12	SO2906A	SGS	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=40...120; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p13	BB207	PHIL	var×2	V_R>15 В; $I_R(V_R$=15 В)<0.01 мкА; $C_{1\,В}$=76...86 пФ; $C_{7.5\,В}$=25.5...29.7 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
P13	DDTA114ECA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P13	DDTA114EE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 10 к/10 к	SOT523	B•E•C
P13	DDTA114EKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C
P13	DDTA114EUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/10 к	SOT323,SC70	B•E•C
P14	DDTA114YCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P14	DDTA114YE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 10 к/47 к	SOT523	B•E•C
P14	DDTA114YKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
P14	DDTA114YUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
P15	DDTA114WCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P15	DDTA114WE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 10 к/47 к	SOT523	B•E•C
P15	DDTA114WKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
P15	DDTA114WUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 10 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
P16	DDTA124TCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 22 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P16	DDTA124TE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R1 22 к	SOT523	B•E•C
P16	DDTA124TKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 22 к	SOT346,SC59	B•E•C
P16	DDTA124TUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 22 к	SOT323,SC70	B•E•C
p16	PDTC114ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P17	DDTA124ECA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 22 к/22 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P17	DDTA124EE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 22 к/22 к	SOT523	B•E•C
P17	DDTA124EKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 22 к/22 к	SOT346,SC59	B•E•C
P17	DDTA124EUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 22 к/22 к	SOT323,SC70	B•E•C
p17	PDTC124ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P18	DDTA124XCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 22 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P18	DDTA124XE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 22 к/47 к	SOT523	B•E•C
P18	DDTA124XKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 22 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
P18	DDTA124XUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 22 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
p18	PDTC143ZT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P19	DDTA144TCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P19	DDTA144TE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R1 47 к	SOT523	B•E•C
P19	DDTA144TKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 47 к	SOT346,SC59	B•E•C
P19	DDTA144TUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 47 к	SOT323,SC70	B•E•C
p19	PDTA143ZT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p1A	PMBT3904	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1A	PMST3904	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300	SOT323,SC70	B•E•C
p1B	PMBT2222	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1D	PMBTA42	PHIL	npn	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1E	PMBTA43	PHIL	npn	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1F	PMBT5550	PHIL	npn	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=60...250; f_T=100...300	SOT23,SOD23	B•E•C
p1F	PMST5550	PHIL	npn	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=60...250; f_T=100...300	SOT323,SC70	B•E•C
p1G	PMBTA06	PHIL	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1H	PMBTA05	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1J	PMBT2369	PHIL	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=40...120	SOT23,SOD23	B•E•C
p1K	PMBT6428	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...650; f_T=100...700 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1L	PMBT6429	PHIL	npn	V_{CB0}=55 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=500...1250; f_T=100...700 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1M	PMBTA13	PHIL	dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1N	PMBTA14	PHIL	dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1P	PMBT2222A	PHIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p1Q	PMBT5088	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=350...1400	SOT23,SOD23	B•E•C
p1Q	PMST5088	PHIL	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>300...900	SOT323,SC70	B•E•C
p1R	PMST5089	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>400...1200	SOT323,SC70	B•E•C
P1s	BFR92W	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=40...200; f_T=5000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
P2	BFR92A	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=273 мВт; h_{21}>40; f_T=4500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P2	BFR92ALT1	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=273 мВт; h_{21}>40; f_T=4500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P2	BZX84C12T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=11.4...12.7 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<25 Ом	SOT523	A•n.c.•K
P2	HSMS2852	HP	shd×2	$V_F(I_F$=1 мА)<0.25 В; C_T=0.3 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
P2	HSMS285C	HP	shd×2	$V_F(I_F$=1 мА)<0.25 В; C_T=0.3 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
P2	SST202	SIL	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=0.9...4.5 мА; g_F=1 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P20	DDTA144ECA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47 к/47 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P20	DDTA144EE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 47 к/47 к	SOT523	B•E•C
P20	DDTA144EKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47 к/47 к	SOT346,SC59	B•E•C
P20	DDTA144EUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47 к/47 к	SOT323,SC70	B•E•C
P21	DDTA144VCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47 к/10 к	SOT23,SOD23	B•E•C
P21	DDTA144VE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 47 к/10 к	SOT523	B•E•C
P21	DDTA144VKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47 к/10 к	SOT346,SC59	B•E•C

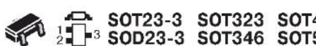
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
P21	DDTA144VUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47к/10к	SOT323,SC70	B•E•C
P22	DDTA144WCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47к/22к	SOT23,SOD23	B•E•C
P22	DDTA144WE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 47к/22к	SOT523	B•E•C
P22	DDTA144WKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47к/22к	SOT346,SC59	B•E•C
P22	DDTA144WUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 47к/22к	SOT323,SC70	B•E•C
P23	DDTA115TCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 100к	SOT23,SOD23	B•E•C
P23	DDTA115TE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R1 100к	SOT523	B•E•C
P23	DDTA115TKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 100к	SOT346,SC59	B•E•C
P23	DDTA115TUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 100к	SOT323,SC70	B•E•C
p23	PDTA114TU	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P24	DDTA115ECA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 100к/100к	SOT23,SOD23	B•E•C
P24	DDTA115EE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; 100к/100к	SOT523	B•E•C
P24	DDTA115EKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 100к/100к	SOT346,SC59	B•E•C
P24	DDTA115EUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; 100к/100к	SOT323,SC70	B•E•C
p24	PDTC114TU	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P25	DDTA125TCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 200к	SOT23,SOD23	B•E•C
P25	DDTA125TE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R1 200к	SOT523	B•E•C
P25	DDTA125TKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 200к	SOT346,SC59	B•E•C
P25	DDTA125TUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R1 200к	SOT323,SC70	B•E•C
P25	SO3906	SGS	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P26	DDTA114GCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 10к	SOT23,SOD23	B•E•C
P26	DDTA114GE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R2 10к	SOT523	B•E•C
P26	DDTA114GKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 10к	SOT346,SC59	B•E•C
P26	DDTA114GUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 10к	SOT323,SC70	B•E•C
P26	SO3905	SGS	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...150; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P27	DDTA124GCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 22к	SOT23,SOD23	B•E•C
P27	DDTA124GE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R2 22к	SOT523	B•E•C
P27	DDTA124GKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 22к	SOT346,SC59	B•E•C
P27	DDTA124GUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 22к	SOT323,SC70	B•E•C
p27	PDTC114YT	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P28	DDTA144GCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 47к	SOT23,SOD23	B•E•C
P28	DDTA144GE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R2 47к	SOT523	B•E•C
P28	DDTA144GKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 47к	SOT346,SC59	B•E•C
P28	DDTA144GUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 47к	SOT323,SC70	B•E•C
P29	DDTA115GCA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 100к	SOT23,SOD23	B•E•C
P29	DDTA115GE	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<150 мВт; R2 100к	SOT523	B•E•C
P29	DDTA115GKA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 100к	SOT346,SC59	B•E•C
P29	DDTA115GUA	DIODS	Dpnp	V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D<200 мВт; R2 100к	SOT323,SC70	B•E•C
p29	PDTA114YT	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p2A	PMBT3906	PHIL	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2A	PMST3906	PHIL	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
p2B	PMBT2907	PHIL	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2D	PMBTA92	PHIL	pnp	V_{CBO}=300 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2E	PMBTA93	PHIL	pnp	V_{CBO}=200 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2F	PMBT2907A	PHIL	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2G	PMBTA56	PHIL	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2H	PMBTA55	PHIL	pnp	V_{CBO}=60 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2L	PMBT5401	PHIL	pnp	V_{CBO}=160 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=60...240; f_T=100...300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2L	PMST5401	PHIL	pnp	V_{CBO}=160 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=60...240; f_T=100...300 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
P2p	BFR92AW	PHIL	npn	V_{CBO}=20 В; I_C=25 мА; P_D=273 мВт; h_{21}>40; f_T=4500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
p2T	PMBT4403	PHIL	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2T	PMST4403	PHIL	pnp	V_{CBO}=40 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
p2U	PMBTA63	PHIL	dpnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}>5000; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2V	PMBTA64	PHIL	dpnp	V_{CB0}=30В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}>10000; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2X	PMBT4401	PHIL	npn	V_{CB0}=40В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}=100...300; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
p2X	PMST4401	PHIL	npn	V_{CB0}=60В; I_C=600мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...300; f_T>250МГц	SOT323,SC70	B•E•C
P3	BZX84C13T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=12.4...14.1В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT523	A•n.c.•K
P3	TP0202T	SIL	pMOS	V_{DS}=20В; I_D=410мА; P_D=350мВт; g_F=600мСм; $R_{DS(on)}$=0.9Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
P3	TP0202T	TEMIC	pMOS	V_{DS}=20В; I_D=410мА; P_D=350мВт; g_F=600мСм; $R_{DS(on)}$=0.9Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
p30	PDTC114YU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>100; 10кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
p31	PDTA143XT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; 4.7кОм/10кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
p32	PDTC143XT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; 4.7кОм/10кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P32	SO5400	SGS	pnp	V_{CB0}=130В; I_C=600мА; P_D=200мВт; h_{21}=40...180; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P33	SO5401	SGS	pnp	V_{CB0}=160В; I_C=600мА; P_D=200мВт; h_{21}=60...240; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P38	SST4338	SIL	nFET	V_{DS}=50В; P_D=300мВт; I_{DSS}<0.6мА; g_F>0.6мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P39	SO692	SGS	pnp	V_{CB0}=300В; I_C=100мА; P_D=310мВт; h_{21}>40; f_T>50МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
P39	SST4339	SIL	nFET	V_{DS}=50В; P_D=300мВт; I_{DSS}<0.8мА; g_F>1.5мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P3W	MMBF2202PT1	MOT	pMOS	V_{DS}=20В; I_D=300мА; P_D=150мВт; $R_{DS(on)}$=3.5Ом	SOT323,SC70	G•S•D
P4	BFR92R	PHIL	npn	V_{CB0}=20В; I_C=30мА; P_D=280мВт; h_{21}=40...200; f_T=5000МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
P4	BZX84C15T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=13.8...15.6В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT523	A•n.c.•K
P4	SST204	SIL	nFET	V_{DS}=25В; P_D=350мВт; I_{DSS}=0.2...3мА; g_F=0.5мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P40	SST4340	SIL	nFET	V_{DS}=50В; P_D=300мВт; I_{DSS}<1.3мА; g_F>9мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P41	SST4341	SIL	nFET	V_{DS}=50В; P_D=300мВт; I_{DSS}<2мА; g_F>1.5мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
p46	PDTA143XU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; 4.7кОм/10кОм	SOT323,SC70	B•E•C
p47	PDTA143ZU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}>100; 4.7кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
p4F	PMBD353	PHIL	shd×2	V_R<4В; I_F<30мА; $V_F(I_F$=10мА)<600мВ; C_D<1пФ	SOT23,SOD23	K1•A2•A1,K2
P5	BFR92AR	PHIL	npn	V_{CB0}=20В; I_C=25мА; P_D=273мВт; h_{21}>40; f_T=4500МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
P5	BZX84C16T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=15.3...17.1В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<40Ом	SOT523	A•n.c.•K
P5	FMMT2369A	ZETEX	npn	V_{CB0}=40В; I_C=200мА; P_D=330мВт; h_{21}=40...120	SOT23,SOD23	B•E•C
p53	PDTC143XU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; 4.7кОм/10кОм	SOT323,SC70	B•E•C
p54	PDTC143ZU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}>100; 4.7кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
p55	PDTA114YU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>100; 10кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
P57	SST5457	SIL	nFET	V_{DS}=25В; P_D=310мВт; I_{DSS}=1...5мА; g_F<1мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P58	SST5458	SIL	nFET	V_{DS}=25В; P_D=310мВт; I_{DSS}=1...5мА; g_F<1.5мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P59	SST5459	SIL	nFET	V_{DS}=25В; P_D=350мВт; I_{DSS}=4...16мА; g_F<2мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
p5A	PMBD6050	PHIL	fd	V_R<70В; I_F<215мА; $V_F(I_F$=150мА)<1.25В; I_R<100нА; C_D<1.5пФ; t_{RR}<4нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p5B	PMBD6100	PHIL	fd×2	V_R<70В; I_F<215мА; $V_F(I_F$=100мА)=0.85...1.1В; I_R<100нА; C_D<1.5пФ; t_{RR}<4нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
p5C	PMBD7000	PHIL	fd×2	V_R<100В; I_F<215мА; $V_F(I_F$=100мА)=0.75...1.25В; I_R<500нА; C_D<1.5пФ; t_{RR}<4нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
p5D	PMBD914	PHIL	fd	V_R<70В; I_F<215мА; $V_F(I_F$=150мА)<1.25В; Iобр<1мкА; C_D<1.5пФ; t_{RR}<4нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p5G	PMBD352	PHIL	shd×2	V_R<4В; I_F<30мА; $V_F(I_F$=10мА)<600мВ; C_D<1пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
P6	BZX84C18T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=16.8...19.1В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<45Ом	SOT523	A•n.c.•K
P63	SST5463	SIL	pFET	V_{DS}=60В; P_D=310мВт; I_{DSS}>5мА; g_F=1...4мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P64	SST5464	SIL	pFET	V_{DS}=60В; P_D=310мВт; I_{DSS}=2...9мА; g_F<5мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
P65	SST5465	SIL	pFET	V_{DS}=60В; P_D=310мВт; I_{DSS}=4...16мА; g_F<6мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
p6A	PMBF4416	PHIL	nFET	V_{DS}=30В; I_{DSS}=15мА; P_D=250мВт; g_F<7.5мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
p6B	PMBF5484	PHIL	nFET	V_{DS}=25В; I_{DSS}=5мА; P_D=250мВт; g_F<6мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
p6G	PMBF4393	PHIL	nFET	V_{DS}=40В; I_{DSS}=5мА; P_D=250мВт; $R_{DS(on)}$<100Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
p6H	PMBF5486	PHIL	nFET	V_{DS}=25В; I_{DSS}=15мА; P_D=250мВт; g_F<8мСм	SOT23,SOD23	S•D•G
p6J	PMBF4391	PHIL	nFET	V_{DS}=40В; I_{DSS}=50мА; P_D=250мВт; $R_{DS(on)}$<30Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
p6K	PMBF4392	PHIL	nFET	V_{DS}=40В; I_{DSS}=25мА; P_D=250мВт; $R_{DS(on)}$<60Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
p6M	PMBF5485	PHIL	nFET	V_{DS}=25В; I_{DSS}=10мА; P_D=250мВт; g_F<7мСм	SOT23,SOD23	S•D•G

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
p6S	PMBFJ176	PHIL	pFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}>2 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<250 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
p6W	PMBFJ175	PHIL	pFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}>7 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<125 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
p6X	PMBFJ174	PHIL	pFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}>20 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<85 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
p6Y	PMBFJ177	PHIL	pFET	V_{DS}=30 В; I_{DSS}>1.5 мА; P_D=300 мВт; $R_{DS(on)}$<300 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
P7	BZX84C20T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=18.8...21.2 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<55 Ом	SOT523	A•n.c.•K
p7Y	PDTB123YT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; 2.2 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
P8	BZX84C22T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=20.8...23.3 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<55 Ом	SOT523	A•n.c.•K
P8A	FLLD261	ZETEX	d×2	V_R<100 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.4 В; I_R<5 мкА; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
P8A	FLLD261	FAIR	d×2	V_R<100 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=200 мА)<1.4 В; I_R<5 мкА; C_D<4 пФ	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
p8A	PMBZ5226B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=3.3 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<25 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<1600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8B	PMBZ5227B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=3.6 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<15 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<1700 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8C	PMBZ5228B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=3.9 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<10 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<1900 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8D	PMBZ5229B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=4.3 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<2000 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8E	PMBZ5230B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=4.7 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<2000 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8F	PMBZ5231B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=5.1 В; $I_L(V_R$=2.0 В)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<2000 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8G	PMBZ5232B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=5.6 В; $I_L(V_R$=3.0 В)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<1600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8H	PMBZ5233B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=6.0 В; $I_L(V_R$=3.5 В)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<1600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8J	PMBZ5234B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=6.2 В; $I_L(V_R$=4.0 В)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<1000 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8K	PMBZ5235B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=6.8 В; $I_L(V_R$=5.0 В)<3 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<750 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8L	PMBZ5236B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=7.5 В; $I_L(V_R$=6.0 В)<3 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<500 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8M	PMBZ5237B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.2 В; $I_L(V_R$=6.5 В)<3 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<500 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8N	PMBZ5238B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=8.7 В; $I_L(V_R$=6.5 В)<3 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8P	PMBZ5239B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=9.1 В; $I_L(V_R$=7.0 В)<3 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8Q	PMBZ5240B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=10 В; $I_L(V_R$=8.0 В)<3 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8R	PMBZ5241B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=11 В; $I_L(V_R$=8.4 В)<2 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8S	PMBZ5242B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=20 мА)=12 В; $I_L(V_R$=9.1 В)<1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=20 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8T	PMBZ5243B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=9.5 мА)=13 В; $I_L(V_R$=9.9 В)<0.5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=9.5 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8U	PMBZ5244B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=9.0 мА)=14 В; $I_L(V_R$=10 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=9.0 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8V	PMBZ5245B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=8.5 мА)=15 В; $I_L(V_R$=11 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=8.5 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8W	PMBZ5246B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=7.8 мА)=16 В; $I_L(V_R$=12 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=7.8 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8X	PMBZ5247B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=7.4 мА)=17 В; $I_L(V_R$=13 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=7.4 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8Y	PMBZ5248B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=7.0 мА)=18 В; $I_L(V_R$=14 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=7.0 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p8Z	PMBZ5249B	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=6.6 мА)=19 В; $I_L(V_R$=14 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=6.6 мА)<600 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
P9	BCX70KR	ZETEX	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
P9	BCX70KR	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=380...630; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
P9	BZX84C24T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=22.8...25.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<70 Ом	SOT523	A•n.c.•K
P9	DAP222	ON	di×2	V_R<80 В; I_F<300 мА; P_D<150 мВт; $V_F(I_F$=100 мА)<1.2 В; t_{RR}<4 нс	SOT416,SC75A	K1•K2•A1,A2
p9A	PLVA650A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=4.8...5.2 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<20 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<700 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p9B	PLVA653A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.1...5.5 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<250 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p9C	PLVA656A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.4...5.8 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p9D	PLVA659A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.7...6.1 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<500 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p9E	PLVA662A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.0...6.4 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<100 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p9F	PLVA665A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.3...6.7 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p9G	PLVA668A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.6...7.0 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<10 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
p9J	PLVA2650A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=4.8...5.2 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<20 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<700 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
p9K	PLVA2653A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.1...5.5 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<250 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
p9L	PLVA2656A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.4...5.8 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
p9M	PLVA2659A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.7...6.1 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<500 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
p9N	PLVA2662A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.0...6.4 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<100 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
p9O	PLVA2665A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.3...6.7 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
p9P	PLVA2668A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.6...7.0 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<10 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
PA	2SC4666	TOSH	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>600...1800; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
PA	BA885	INF	pin	V_R<50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.1 В; I_R<0.05 мкА; C_D<0.4 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
pA2	PMBD2836	PHIL	fd×2	V_R<75 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<100 нА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
pA3	PMBD2835	PHIL	fd×2	V_R<35 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<100 нА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
pA5	PMBD2837	PHIL	fd×2	V_R<30 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<100 нА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
pA6	PMBD2838	PHIL	fd×2	V_R<50 В; I_F<215 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<100 нА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
PB	2SC4666	TOSH	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>1200...3600; f_T=250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
PC	BA886	INF	pin	V_R<50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1.15 В; I_R<0.05 мкА; C_D<0.2 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
PC	MGSF1P02L	ON	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=750 мА; P_D=400 мВт; $R_{DS(on)}$<0.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
PD	2SA1171D	REN	pnp	V_{CB0}=90 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=250...500	SOT23,SOD23	B•E•C
PD	BSS84L	MOT	pMOS	V_{DS}=50 В; I_D=130 мА; P_D=360 мВт; g_F=50 мСм; $R_{DS(on)}$=10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
PDs	BA887	INF	pin	V_R<50 В; I_F<100 мА; I_R<0.02 мкА; C_D<0.27 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
PE	2SA1171E	REN	pnp	V_{CB0}=90 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=400...800	SOT23,SOD23	B•E•C
pG1	PMBT5551	PHIL	npn	V_{CB0}=180 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=80...250; f_T=100...300	SOT23,SOD23	B•E•C
PH	KRA307	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
PH2	SST4302	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=300 мВт; I_{DSS}>5 мА; g_F>1 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
PH3	SST4303	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=300 мВт; I_{DSS}>10 мА; g_F>2 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
PH4	SST4304	SIL	nFET	V_{DS}=30 В; P_D=300 мВт; I_{DSS}>15 мА; g_F>2 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
PI	KRA308	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
PIB	2SK1070B	REN	nFET	V_{GS}>22 В; I_D=50 мА; P_D=150 мВт; g_F>20 мСм; I_{DSS}=6...14 мА	SOT23,SOD23	S•D•G
PIC	2SK1070C	REN	nFET	V_{GS}>22 В; I_D=50 мА; P_D=150 мВт; g_F>20 мСм; I_{DSS}=12...22 мА	SOT23,SOD23	S•D•G

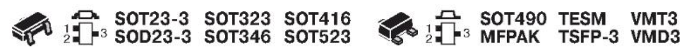
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
PID	2SK1070D	REN	nFET	$V_{GS}>22$ В; $I_D=50$ мА; $P_D=150$ мВт; $g_F>20$ мСм; $I_{DSS}=18...30$ мА	SOT23,SOD23	S·D·G
PIE	2SK1070E	REN	nFET	$V_{GS}>22$ В; $I_D=50$ мА; $P_D=150$ мВт; $g_F>20$ мСм; $I_{DSS}=27...40$ мА	SOT23,SOD23	S·D·G
PJ	KRA309	KEC	pnp	$V_{CBO}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=100$ мВт; $R_1/R_2=47/22$ кОм	SOT323,SC70	B·E·C
pJ1	BSH101	PHIL	nMOS	$V_{DS}=60$ В; $I_D=700$ мА; $P_D=500$ мВт; $R_{DS(on)}<0.6$ Ом	SOT23,SOD23	G·S·D
pJ2	BSH102	PHIL	nMOS	$V_{DS}=30$ В; $I_D=1$ А	SOT23,SOD23	G·S·D
pJ3	BSH103	PHIL	nMOS	$V_{DS}=30$ В; $I_D=850$ мА; $P_D=500$ мВт; $R_{DS(on)}<0.5$ Ом	SOT23,SOD23	G·S·D
PMs	BAR66	INF	pin×2	$V_R<150$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.2$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT23,SOD23	A1·K2·K1,A2
pO4	PMBS3904	PHIL	npn	$V_{CBO}=60$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=100...300$; $f_T>180$ МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
pO6	PMBS3906	PHIL	pnp	$V_{CBO}=40$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=100...300$; $f_T>150$ МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
POs	BAR64	SIEM	pin	$V_R<200$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT23,SOD23	A·n.c.·K
PPs	BAR6404	SIEM	pin×2	$V_R<200$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT23,SOD23	A1·K2·K1,A2
PPs	BAR64-04	INF	pin×2	$V_R<150$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT23,SOD23	A1·K2·K1,A2
PPs	BAR64-04W	INF	pin×2	$V_R<150$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT323,SC70	A1·K2·K1,A2
PPs	BAR64-04W	INF	pin×2	$V_R<150$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT416,SC75A	A1·K2·K1,A2
PRs	BAR6405	SIEM	pin×2	$V_R<200$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT23,SOD23	A1·A2·K1,K2
PRs	BAR64-05	INF	pin×2	$V_R<150$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT23,SOD23	A1·A2·K1,K2
PRs	BAR64-05W	INF	pin×2	$V_R<150$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT323,SC70	A1·A2·K1,K2
PS	TP0101TS	SIL	pMOS	$V_{DS}=20$ В; $I_D=1000$ мА; $P_D=1000$ мВт; $g_F=1300$ мСм; $R_{DS(on)}=0.65$ Ом	SOT23,SOD23	G·S·D
PSs	BAR6406	SIEM	pin×2	$V_R<200$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT23,SOD23	K1·K2·A1,A2
PSs	BAR64-06	INF	pin×2	$V_R<150$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT23,SOD23	K1·K2·A1,A2
PSs	BAR64-06W	INF	pin×2	$V_R<150$ В; $I_F<100$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)<1.1$ В; $C_D<0.35$ пФ	SOT323,SC70	K1·K2·A1,A2
PV	1SV294	SANYO	pin	$V_R>50$ В; $I_F<50$ мА; $V_F(I_F=50$ мА$)=0.92...0.97$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A·n.c.·K
pV3	BAT54A	PHIL	shd×2	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=30$ мА$)<500$ мВ; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	K1·K2·A1,A2
pV4	BAT54S	PHIL	shd×2	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=30$ мА$)<500$ мВ; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	A1·K2·K1,A2
pW1	BAT54C	PHIL	shd×2	$V_R<30$ В; $I_F<200$ мА; $V_F(I_F=30$ мА$)<500$ мВ; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<5$ нс	SOT23,SOD23	A1·A2·K1,K2
Q0	MCP100T-475/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=4.625$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST·VDD·VSS
Q2	MMBC1321Q2	MOT	npn	$V_{CBO}=30$ В; $I_C=10$ мА; $h_{21}=40...80$	SOT23,SOD23	B·E·C
Q3	MMBC1321Q3	MOT	npn	$V_{CBO}=30$ В; $I_C=10$ мА; $h_{21}=60...120$	SOT23,SOD23	B·E·C
Q4	MMBC1321Q4	MOT	npn	$V_{CBO}=30$ В; $I_C=10$ мА; $h_{21}=90...180$	SOT23,SOD23	B·E·C
Q5	MMBC1321Q5	MOT	npn	$V_{CBO}=30$ В; $I_C=10$ мА; $h_{21}=135...270$	SOT23,SOD23	B·E·C
QA	RN1421	TOSH	Dnpn	$V_{CEO}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=1/1$ кОм	SOT346,SC59	B·E·C
QAA	BC846AF	AUK	npn	$V_{CBO}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=110...220$; $f_T=150$ МГц	SOT490,SC89	B·E·C
QAB	BC846BF	AUK	npn	$V_{CBO}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=200...450$; $f_T=150$ МГц	SOT490,SC89	B·E·C
QAC	BC846CF	AUK	npn	$V_{CBO}=80$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=420...800$; $f_T=150$ МГц	SOT490,SC89	B·E·C
QB	RN1422	TOSH	Dnpn	$V_{CEO}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=2.2/2.2$ кОм	SOT346,SC59	B·E·C
QC	RN1423	TOSH	Dnpn	$V_{CEO}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=4.7/4.7$ кОм	SOT346,SC59	B·E·C
QD	RN1424	TOSH	Dnpn	$V_{CEO}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=10/10$ кОм	SOT346,SC59	B·E·C
QE	RN1425	TOSH	Dnpn	$V_{CEO}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=0.47/10$ кОм	SOT346,SC59	B·E·C
QF	RN1426	TOSH	Dnpn	$V_{CEO}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=1/10$ кОм	SOT346,SC59	B·E·C
QG	RN1427	TOSH	Dnpn	$V_{CEO}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=2.2/10$ кОм	SOT346,SC59	B·E·C
QI	2SC4196	REN	npn	$V_{CBO}=25$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=150$ мВт; $h_{21}=50...180$; $f_T>1.8$ ГГц	SOT346,SC59	B·E·C
QI	2SC4261	REN	npn	$V_{CBO}=25$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=100$ мВт; $h_{21}=50...180$; $f_T>1.8$ ГГц	SOT323,SC70	B·E·C
QJ	MCP100T-270/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=2.625$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST·VDD·VSS
QK	MCP100T-300/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=2.925$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST·VDD·VSS
QL	MCP100T-315/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=3.075$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST·VDD·VSS
QM	MCP100T-450/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=4.375$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST·VDD·VSS
QN	MCP100T-460/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=4.475$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST·VDD·VSS
QO	KTC4080	KEC	npn	$V_{CBO}=40$ В; $I_C=20$ мА; $P_D=100$ мВт; $h_{21}=70...140$; $f_T>550$ МГц	SOT323,SC70	B·E·C
QP	MCP100T-485/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=4.725$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST·VDD·VSS
QR	KTC4080	KEC	npn	$V_{CBO}=40$ В; $I_C=20$ мА; $P_D=100$ мВт; $h_{21}=40...80$; $f_T>550$ МГц	SOT323,SC70	B·E·C
QY	KTC4080	KEC	npn	$V_{CBO}=40$ В; $I_C=20$ мА; $P_D=100$ мВт; $h_{21}=100...200$; $f_T>550$ МГц	SOT323,SC70	B·E·C
R0	MCP101T-475/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=4.625$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST·VDD·VSS




SOT23-3 SOT323 SOT416 SOD23-3 SOT346 SOT523 SOT490 TESM VMT3 MFPAK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
R01	KSR1101	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>20; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R02	KSR1102	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>30; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R03	KSR1103	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>56; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R04	KSR1104	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>68; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R05	KSR1105	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>30; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R06	KSR1106	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>68; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R07	KSR1107	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>68; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R08	KSR1108	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>56; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R09	KSR1109	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=40В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...600; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1	BFR93	SGS	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=300мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1	BZX84C4V7T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=4.4...5.0В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<80Ом	SOT523	A•n.c.•K
R1	HSMS-8101	HP	shd	V_{BR}>4В; $V_F(I_F$=1мА)<0.35В; C_D<0.26пФ; R_D=14Ом	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
R1	TN2010T	SIL	nMOS	V_{DS}=200В; I_D=120мА; P_D=360мВт; g_F=300мСм; $R_{DS(on)}$=9.5Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
R10	KSR1110	SAMS	npn	V_{CBO}=40В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...600; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R11	KSR1111	SAMS	npn	V_{CBO}=40В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...600; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R12	KSR1112	SAMS	npn	V_{CBO}=40В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...600; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R13	2SC4885	NEC	npn	V_{CBO}=25В; I_C=50мА; P_D=120мВт; h_{21}=60...150; f_T>2.5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R13	KSR1113	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R14	KSR1114	SAMS	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}>68; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1A	MMBT3904	VISH	npn	V_{CBO}=60В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...300; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1A	MMST3904	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=200мА; h_{21}=100...300; f_T>250МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1A	SST3904	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=200мА; h_{21}=100...300; f_T>300МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1A	UMT3904	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=200мА; P_D=200мВт; h_{21}>100; f_T>300МГц	SOT323,SC70	B•E•C
R1B	MMST2222	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; h_{21}=100...300; f_T>250МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1B	SST2222	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; h_{21}=100...300; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1C	MMST1130	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=200мА; h_{21}=120...360	SOT346,SC59	B•E•C
R1C	MMSTA20	ROHM	npn	V_{CBO}=40В; I_C=200мА; h_{21}>120; f_T>125МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1C	SST1130	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=200мА; h_{21}=120...360	SOT23,SOD23	B•E•C
R1C	SSTA20	ROHM	npn	V_{CBO}=40В; I_C=200мА; h_{21}>120; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1G	MMBTA06	VISH	npn	V_{CBO}=80В; I_C=300мА; P_D=350мВт; h_{21}>50; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1G	MMSTA06	ROHM	npn	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; h_{21}>100; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1G	MMSTA06	ROHM	npn	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; h_{21}>100; f_T>100МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1G	SSTA06	ROHM	npn	V_{CBO}=80В; I_C=500мА; h_{21}>100; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1H	MMBTA05	VISH	npn	V_{CBO}=60В; I_C=30мА; P_D=350мВт; h_{21}>50; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1H	SSTA05	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=500мА; h_{21}>100; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1J	SST6427	ROHM	npn	V_{CBO}=40В; I_C=500мА; h_{21}=20000...200000	SOT23,SOD23	B•E•C
R1K	MMST6428	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=200мА; h_{21}=250...650; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1K	MMST6428	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=200мА; h_{21}=250...650; f_T>100МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1K	SST6428	ROHM	npn	V_{CBO}=60В; I_C=200мА; h_{21}=250...650; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1M	MMBTA13	VISH	dnpn	V_{CBO}=30В; I_C=300мА; P_D=350мВт; h_{21}>10000; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1M	MMSTA13	ROHM	dnpn	V_{CBO}=30В; I_C=500мА; h_{21}>10000; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1M	MMSTA13	ROHM	dnpn	V_{CBO}=30В; I_C=500мА; h_{21}>10000; f_T>125МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1M	SSTA13	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=500мА; h_{21}>10000; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1N	MMBTA14	VISH	dnpn	V_{CBO}=30В; I_C=300мА; P_D=350мВт; h_{21}>20000; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1N	MMSTA14	ROHM	dnpn	V_{CBO}=30В; I_C=500мА; h_{21}>20000; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1N	MMSTA14	ROHM	dnpn	V_{CBO}=30В; I_C=500мА; h_{21}>20000; f_T>125МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1N	SSTA14	ROHM	npn	V_{CBO}=30В; I_C=500мА; h_{21}>20000; f_T>125МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1O	MMST5088	ROHM	npn	V_{CBO}=35В; I_C=200мА; h_{21}=300...900; f_T>50МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1O	MMST5088	ROHM	npn	V_{CBO}=35В; I_C=200мА; h_{21}=300...900; f_T>50МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1P	MMBT2222A	VISH	npn	V_{CBO}=50В; I_C=800мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...300; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1P	MMST2222A	ROHM	npn	V_{CBO}=75В; I_C=600мА; h_{21}=100...300; f_T>250МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1P	SST2222A	ROHM	npn	V_{CBO}=75В; I_C=600мА; h_{21}=100...300; f_T>250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
R1P	UMT2222A	ROHM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=500 мВт; h_{21}>30	SOT323,SC70	B•E•C
R1Q	SST5088	ROHM	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=200 мА; h_{21}=300...900; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R1R	MMST5089	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=200 мА; h_{21}=400...1200; f_T>50 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R1R	SST5089	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=200 мА; h_{21}=400...1200; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2	2SC2351P	NEC	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=40...120; f_T=4.5 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2	2SC4225	NEC	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=70 мА; P_D=160 мВт; h_{21}=40...120; f_T=4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R2	BFR93A	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2	BFR93ALT1	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2	BZX84C5V1T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.8...5.4 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<60 Ом	SOT523	A•n.c.•K
R23	2SC3356Q	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=50...100; f_T=7 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R23	2SC4226	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...80; f_T>3 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R24	2SC3356R	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=80...160; f_T=7 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R24	2SC4226	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...140; f_T>3 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R25	2SC3356S	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T=7 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R25	2SC4226	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=125...250; f_T>3 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R2A	ADR380ART	AD	vref	V_{IN}=2.4...18 В; I_{OUT}=5 мА; V_{OUT}=2.048 В	SOT23,SOD23	VIN•VOUT•GND
R2A	MMBT3906	VISH	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2A	MMST3906	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2A	SST3906	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2A	UMT3906	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
R2B	MMST2907	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2B	SST2907	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2C	MMSTA70	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; h_{21}=160...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2C	MMSTA70	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; h_{21}=160...400; f_T>125 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2F	MMST2907A	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2F	SST2907A	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2F	UMT2907A	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
R2G	MMSTA56	ROHM	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2G	MMSTA56	ROHM	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2G	SSTA56	ROHM	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2H	SSTA55	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2K	MMST8598	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2K	MMST8598	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2O	MMST5087	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; h_{21}=250...800; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2O	MMST5087	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; h_{21}=250...800; f_T>40 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2P	MMST5086	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; h_{21}=150...500; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2P	MMST5086	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; h_{21}=150...500; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2P	MMST5086	ROHM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; h_{21}=150...500; f_T>40 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2Q	SST7157	ROHM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; h_{21}>100	SOT346,SC59	B•E•C
R2s	BFR93A	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2s	BFR93AW	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
R2T	MMBT4403	VISH	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2T	MMST4403	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2T	SST4403	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2T	UMT4403	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
R2U	MMSTA63	ROHM	dpnp	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2U	SSTA63	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2V	MMSTA64	ROHM	dpnp	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2V	MMSTA64	ROHM	dpnp	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2V	SSTA64	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2X	MMBT4401	VISH	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
R2X	MMST4401	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R2X	SST4401	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R2X	UMT4401	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
R2Z	SST4400	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; h_{21}=50...150; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R3	2SC2351Q	NEC	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...200; f_T=4.5 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R3	2SC4225	NEC	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=70 мА; P_D=160 мВт; h_{21}=100...200; f_T=4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R3	BZX84C5V6T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=5.2...6.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<40 Ом	SOT523	A•n.c.•K
R30A	REF3012AIDBZ	TI	vref	V_{IN}=1.8...5.5 В; I_{OUT}=25 мА; V_{OUT}=1.25 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
R30B	REF3020AIDBZ	TI	vref	V_{IN}=1.8...5.5 В; I_{OUT}=25 мА; V_{OUT}=2.048 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
R30C	REF3025AIDBZ	TI	vref	V_{IN}=1.8...5.5 В; I_{OUT}=25 мА; V_{OUT}=2.5 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
R30D	REF3033AIDBZ	TI	vref	V_{IN}=1.8...5.5 В; I_{OUT}=25 мА; V_{OUT}=3.3 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
R30E	REF3040AIDBZ	TI	vref	V_{IN}=1.8...5.5 В; I_{OUT}=25 мА; V_{OUT}=4.096 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
R30F	REF3030AIDBZ	TI	vref	V_{IN}=1.8...5.5 В; I_{OUT}=25 мА; V_{OUT}=3.0 В	SOT23,SOD23	IN•OUT•GND
R33	2SC3583Q	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=65 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=50...100; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R33	2SC4227	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=65 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...90; f_T>4.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R34	2SC3583R	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=65 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=80...160; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R34	2SC4227	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=65 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=70...150; f_T>4.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R35	2SC3583S	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=65 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T=9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R35	2SC4227	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=65 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=110...240; f_T>4.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R3A	ADR381ART	AD	vref	V_{IN}=2.8...18 В; I_{OUT}=5 мА; V_{OUT}=2.5 В	SOT23,SOD23	VIN•VOUT•GND
R3B	MMST918	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; h_{21}>20...650; f_T=600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R3B	SST918	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; h_{21}>75; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R4	BFR93R	TELEF	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500 МГц	SOT323,SC70	C•B•E
R4	BZX84C6V2T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=5.8...6.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<10 Ом	SOT523	A•n.c.•K
R43	2SC3585Q	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=35 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=50...100; f_T=10 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R43	2SC4228	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=35 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...100; f_T>5.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R44	2SC3585R	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=35 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=80...160; f_T=10 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R44	2SC4228	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=35 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=80...160; f_T>5.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R45	2SC3585S	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=35 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T=10 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R45	2SC4228	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=35 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=125...250; f_T>5.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R5	BFR93AR	SGS	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
R5	BZX84C6V8T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=6.4...7.2 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<15 Ом	SOT523	A•n.c.•K
R51	KSR2101	SAMS	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R52	KSR2102	SAMS	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R53	KSR2103	SAMS	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R54	KSR2104	SAMS	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R55	KSR2105	SAMS	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R56	KSR2106	SAMS	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R57	KSR2107	SAMS	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R58	KSR2108	SAMS	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>56; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R59	KSR2109	SAMS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R6	BZX84C7V5T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=7.0...7.9 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<15 Ом	SOT523	A•n.c.•K
R60	KSR2110	SAMS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R61	KSR2111	SAMS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R62	2SC3663	NEC	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=5 мА; P_D=50 мВт; h_{21}=50...250; f_T=4 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R62	KSR2112	SAMS	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...600; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R63	KSR2113	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R64	KSR2114	SAMS	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>68; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R65	SSTA65	ROHM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; h_{21}>50000; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R67	BFQ67R	VIS	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>65; f_T=8 ГГц	SOT23,SOD23	E•B•C
R6A	2SC4187	NEC	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=5 мА; P_D=50 мВт; h_{21}=50...100; f_T=4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
R6B	2SC4187	NEC	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=5 мА; P_D=50 мВт; h_{21}=80...160; f_T=4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R6C	2SC4187	NEC	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=5 мА; P_D=50 мВт; h_{21}=125...250; f_T=4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
R7	BFR106	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=700 мВт; h_{21}=25...250; f_T=5000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R7	BZX84C8V2T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=7.7...8.9 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<15 Ом	SOT523	A•n.c.•K
R7s	BFR106	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=700 мВт; h_{21}=25...250; f_T=5000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
R8	BZX84C9V1T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=8.5...9.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<15 Ом	SOT523	A•n.c.•K
R9	1SS392	TOSH	shd×2	V_R>40 В; $V_F(I_F$=100 мА)<0.6 В; $I_R(V_R$=40 В)<5 мкА; C_T<25 пФ	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
R9	1SS393	TOSH	shd×2	V_R<40 В; I_F<100 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<0.6 В; C_D=18 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
R9	BZX84C10T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=9.4...10.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом	SOT523	A•n.c.•K
R93	SSTTIS93	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=800 мА; h_{21}=100...300; f_T>50 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
R97	SSTIS97	ROHM	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; h_{21}=250...800	SOT23,SOD23	B•E•C
R97	SSTTIS97	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; h_{21}=250...700	SOT23,SOD23	B•E•C
RA	RN2421	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/1 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
RA4	BAV70	VISH	di×2	V_R=100 В; I_F=300 мА; P_D=350 мВт; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
RA6	BAS16	VISH	shd	V_R=100 В; I_F=500 мА; P_D=350 мВт; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
RA7	BAV99	VISH	di×2	V_R=100 В; I_F=300 мА; P_D=350 мВт; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
RA7	BAV99	ROHM	di×2	V_R<75 В; I_F<450 мА; $V_F(I_F$=150 мА)<1.25 В; I_R<2.5 мкА; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
RAA	ADR510ART	AD	vref	I_{IN}=0.1...10 мА; V_{OUT}=1 В	SOT23,SOD23	V+•V–•TRIM/n.c.
RAB	MMBD4448	VISH	shd	V_R=100 В; I_F=500 мА; P_D=350 мВт; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
RAF	SSTA29	ROHM	npn	V_{CB0}=100 В; I_C=500 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RAs	BFQ81	SIEM	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=30 мА; P_D=280 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5800 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RAT	MMSTA28	ROHM	dnpn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RAT	MMSTA28	ROHM	dnpn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RAT	SSTA28	ROHM	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RAV	BAS16	VISH	shd	V_R=100 В; I_F=500 мА; P_D=350 мВт; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
RB	BZX84C2V4T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5.0 мА)=2.2...2.6 В; $I_L(V_R$=1.0 В)<50 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<100 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT523	A•n.c.•K
RB	MSC1621	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RB	RN2422	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
RBA	ADR280AKS	AD	vref	V_{IN}=2.4...5.5 В; I_{IN}<16 мкА; V_{OUT}=1.2 В	SOT323,SC70	VOUT•VIN•GND
RBA	ADR280ART	AD	vref	V_{IN}=2.4...5.5 В; I_{IN}<16 мкА; V_{OUT}=1.2 В	SOT23,SOD23	VIN•VOUT•GND
RBA	BAV99	VISH	di×2	V_R=100 В; I_F=300 мА; P_D=350 мВт; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
RBQ	SST7208	ROHM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; h_{21}>100; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RBR	MMST6838	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; h_{21}>200; f_T>50 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RBR	SST6838	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=200 мА; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RBs	BF771	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=80 мА; P_D=580 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RBs	BF771W	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=80 мА; P_D=400 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RC	2SC2618C	REN	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=500 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...200	SOT23,SOD23	B•E•C
RC	BZX84C2V7T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=2.51...2.89 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<100 Ом	SOT523	A•n.c.•K
RC	RN2423	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
RCs	BFR193	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=80 мА; P_D=580 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RCs	BFR193T	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=80 мА; P_D=580 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
RCs	BFR193W	SIEM	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=80 мА; P_D=580 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RD	2SC2618D	REN	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=500 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=160...320	SOT23,SOD23	B•E•C
RD	BZX84C3V0T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5.0 мА)=2.8...3.2 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<100 Ом	SOT523	A•n.c.•K
RD	RN2424	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=800 мА; P_D=200 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
RDs	BFR180	SIEM	npn	V_{CB0}=10 В; I_C=4 мА; P_D=30 мВт; h_{21}=30...200; f_T=6200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RDs	BFR180W	SIEM	npn	V_{CB0}=10 В; I_C=4 мА; P_D=30 мВт; h_{21}=30...200; f_T=7000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RE	2SA1514KE	ROHM	pnp	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390...820; f_T>140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RE	2SA1579E	ROHM	pnp	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390...820; f_T>140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C

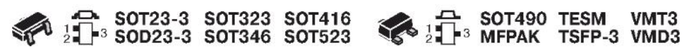




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
RE	BZX84C2V4T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=2.2...2.6$ В; $I_L(V_R=1.0$ В$)<50$ мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<100$ Ом; $I_{ZM}=200$ мА	SOT523	A•n.c.•K
RE	RN2425	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=0.47/10$ кОм	SOT346,SC59	B•E•C
REs	BFR280	SIEM	npn	$V_{CB0}=10$ В; $I_C=10$ мА; $P_D=80$ мВт; $h_{21}=30...200$; $f_T=7500$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
REs	BFR280W	SIEM	npn	$V_{CB0}=10$ В; $I_C=10$ мА; $P_D=80$ мВт; $h_{21}=30...200$; $f_T=7500$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
REs	BFR280W	SIEM	npn	$V_{CB0}=10$ В; $I_C=10$ мА; $P_D=80$ мВт; $h_{21}=30...200$; $f_T=7500$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RF	BFR181T	TELEF	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=20$ мА; $P_D=175$ мВт; $h_{21}>50$; $f_T=8$ ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RF	BZX84C3V6T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА$)=3.4...3.8$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5$ мА$)<95$ Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
RF	RN2426	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=1/10$ кОм	SOT346,SC59	B•E•C
RFQ	SST6839	ROHM	pnp	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=200$ мА; $h_{21}>100$; $f_T>50$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RFQ	SST6839	ROHM	pnp	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=200$ мА; $h_{21}>100$; $f_T>50$ МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RFs	BFR181	SIEM	npn	$V_{CB0}=15$ В; $I_C=20$ мА; $P_D=160$ мВт; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RFs	BFR181W	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=20$ мА; $P_D=175$ мВт; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RG	BZX84C3V9T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА$)=3.7...4.1$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5$ мА$)<90$ Ом	SOT523	A•n.c.•K
RG	RN2427	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T>250$ МГц; $R_1/R_2=2.2/10$ кОм	SOT346,SC59	B•E•C
RGs	BFR182	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=35$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RGs	BFR182T	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=35$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000$ МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
RGs	BFR182W	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=35$ мА; $P_D=250$ мВт; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RH	BZX84C4V3T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=5$ мА$)=4.0...4.6$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5$ мА$)<90$ Ом	SOT523	A•n.c.•K
RHs	BFR183	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=65$ мА; $P_D=450$ мВт; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RHs	BFR183T	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=65$ мА; $P_D=450$ мВт; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000$ МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
RHs	BFR183W	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=65$ мА; $P_D=450$ мВт; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RJ	MCP101T-270/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=2.625$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST•VDD•VSS
RK	MCP101T-300/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=2.925$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST•VDD•VSS
RKs	BFR194	SIEM	pnp	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=700$ мВт; $h_{21}=20...150$; $f_T=5000$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RKS	RK7002A	ROHM	nMOS	$V_{DS}=60$ В; $I_D=300$ мА; $P_D=200$ мВт; $R_{DS(on)}<1.5$ Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
RL	MCP101T-315/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=3.075$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST•VDD•VSS
RM	MCP101T-450/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=4.375$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST•VDD•VSS
RN	MCP101T-460/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=4.475$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST•VDD•VSS
RP	MCP101T-485/TT	MCHIP	mrc	$V_{TR}=4.725$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{DD}<60$ мкА	SOT23,SOD23	RST•VDD•VSS
RR	2SA1514KR	ROHM	pnp	$V_{CB0}=120$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=180...390$; $f_T>140$ МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RR	2SA1579R	ROHM	pnp	$V_{CB0}=120$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=180...390$; $f_T>140$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RRA	BC847AF	AUK	npn	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=110...220$; $f_T=150$ МГц	SOT490,SC89	B•E•C
RRB	BC847BF	AUK	npn	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=200...450$; $f_T=150$ МГц	SOT490,SC89	B•E•C
RRC	BC847CF	AUK	npn	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=420...800$; $f_T=150$ МГц	SOT490,SC89	B•E•C
RS	2SA1514KS	ROHM	pnp	$V_{CB0}=120$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=270...560$; $f_T>140$ МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RS	2SA1579S	ROHM	pnp	$V_{CB0}=120$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=200$ мВт; $h_{21}=270...560$; $f_T>140$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RSR	SST5210	ROHM	npn	$V_{CB0}=50$ В; $I_C=200$ мА; $h_{21}=200...600$; $f_T>30$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RT3	2SC4400	SANYO	npn	$V_{CB0}=40$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=150$ мВт; $h_{21}=60...120$; $f_T>750$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RT4	2SC4400	SANYO	npn	$V_{CB0}=40$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=150$ мВт; $h_{21}=90...180$; $f_T>750$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RT5	2SC4400	SANYO	npn	$V_{CB0}=40$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=150$ мВт; $h_{21}=135...270$; $f_T>750$ МГц	SOT323,SC70	B•E•C
RVX	MMST918	ROHM	npn	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=50$ мА; $h_{21}>20...650$; $f_T=600$ МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RVZ	MMST4126	ROHM	pnp	$V_{CB0}=25$ В; $I_C=200$ мА; $h_{21}=120...360$; $f_T>250$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RVZ	MMST4126	ROHM	pnp	$V_{CB0}=25$ В; $I_C=200$ мА; $h_{21}=120...360$; $f_T>250$ МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RX7	SST6426	ROHM	npn	$V_{CB0}=40$ В; $I_C=500$ мА; $h_{21}=300...300000$	SOT23,SOD23	B•E•C
RZC	MMST4124	ROHM	npn	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=200$ мА; $h_{21}=120...360$; $f_T>300$ МГц	SOT346,SC59	B•E•C
RZC	SST4124	ROHM	npn	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=200$ мА; $h_{21}=120...360$; $f_T>300$ МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
RZQ	MMST7157	ROHM	pnp	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=200$ мА; $h_{21}>100$	SOT23,SOD23	B•E•C
S0	HSMP3880	HP	pin	$I_F<1$ А; $P_D<250$ мВт; $V_{BR}>100$ В; $R_S<6.5$ Ом; $CT<0.40$ пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
S0	SST270	SIL	pFET	$V_{DS}=30$ В; $P_D=350$ мВт; $g_F=6$ мСм; $I_{DSS}=2...15$ мА	SOT23,SOD23	D•S•G
S1	BBY31	PHIL	var	$V_R<30$ В; $I_F<20$ мА; $I_R<10$ нА; $R_S<1.2$ Ом; $C_{1\,В}=16.5$ пФ; $C_{28\,В}=1.6...2$ пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
S1	HSMP3881	HP	pin	$I_F<1$ А; $P_D<250$ мВт; $V_{BR}>100$ В; $R_S<6.5$ Ом; $CT<0.40$ пФ	SOT23,SOD23	n.c.•A•K

SOT490 TESM VMT3 SOT416 SOT323 SOT23-3
MFPAK TSFP-3 VMD3 SOT523 SOT346 SOD23-3

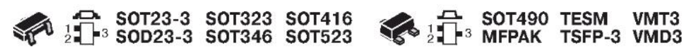
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
S1	SST271	SIL	pFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=6...50 мА; g_F=0.5 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
S12	BBY39	PHIL	var×2	V_R<30 В; I_F<20 мА; $C_{1\,В}$=16.5 пФ; $C_{28\,В}$=1.6...2 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
S13	BBY42	PHIL	var	V_R<30 В; I_F<20 мА; I_R<10 нА; R_S<1 Ом; $C_{1\,В}$>31 пФ; $C_{28\,В}$=2.4...3 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
S14	BB901	PHIL	var	V_R<28 В; I_F<20 мА; I_R<10 нА; R_S<3 Ом; $C_{28\,В}$<1.055 пФ; $C_{0.5\,В}/C_{28\,В}$>12	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
S14	SST5114	SIL	pFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=30...90 мА; $R_{DS(on)}$<75 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
S15	SST5115	SIL	pFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=15...60 мА; $R_{DS(on)}$<100 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
S16	SST5116	SIL	pFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=5...25 мА; $R_{DS(on)}$<150 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
S16	ZHCS1006	ZETEX	shd	V_R<60 В; I_F<0.9 А; $V_F(I_F$=1 А)<0.6 В; I_R<100 мкА; C_D<17 пФ; t_{RR}<12 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
s1A	SMBT3904	SIEM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1B	PXTA93	SIEM	pnp	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=1000 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1B	SMBT2222	SIEM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1C	SMBTA20	SIEM	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1D	SMBTA42	SIEM	npn	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1E	SMBTA43	SIEM	npn	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1G	SMBTA06	SIEM	npn	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>100; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1H	SMBTA05	SIEM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>100; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1K	SMBT6428	SIEM	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...650; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1L	SMBT6429	SIEM	npn	V_{CB0}=55 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=500...1250; f_T=200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1M	SMBTA13	SIEM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1N	SMBTA14	SIEM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1P	SMBT2222A	SIEM	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s1V	SMBT6427	SIEM	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21}=20000...200000; f_T>130 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
S2	BBY40	PHIL	var	V_R<30 В; I_F<20 мА; I_R<10 нА; R_S<0.7 Ом; $C_{3\,В}$=26...32 пФ; $C_{25\,В}$=4.3...6 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
S2	BFQ31	ZETEX	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>20; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
S2	KTA2014	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=70...140; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
s2A	SMBT3906	SIEM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2B	SMBT2907	SIEM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2C	SMBTA70	SIEM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=40...400; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2D	SMBTA92	SIEM	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21}>25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2E	SMBTA93	SIEM	pnp	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21}>25; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2F	SMBT2907A	SIEM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2G	SMBTA56	SIEM	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>100; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2H	SMBTA55	SIEM	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>100; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2P	SMBT5086	SIEM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=150...500; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2Q	SMBT5087	SIEM	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=250...800; f_T>40 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2U	SMBTA63	SIEM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
s2V	SMBTA64	SIEM	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=360 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
S3	BBY51	SIEM	var×2	V_R<7 В; I_F<20 мА; I_R<0.01 мкА; $C_{1\,В}$=4.5...6.1 пФ; $C_{1\,В}/C_{4\,В}$=1.55...2.2	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
S3	BFQ31R	ZETEX	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>20; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
S3s	BBY51	INF	var×2	V_R<7 В; IF<20 мА; I_R<0.01 мкА; $C_{1\,В}$=5.05...5.75 пФ; $C_{4\,В}$=2.5...3.7 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
S4	BFQ31A	ZETEX	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>100; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
S4	KTA2014	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
S4	SST174	SIL	pFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=20...135 мА; $R_{DS(on)}$<85 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
S5	BFQ31AR	ZETEX	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>100; f_T>600 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
S5	SST175	SIL	pFET	V_{DS}=30 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=7...70 мА; $R_{DS(on)}$<125 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
S50	BS850	GS	pFET	V_{DSS}=60 В; I_D=250 мА; P_D=310 мВт; V_{GS}<20 В	SOT23,SOD23	G•S•D
s56	ZHCS506	ZETEX	shd	V_R<60 В; I_F<0.5 А; $V_F(I_F$=0.5 А)<0.63 В; I_R<40 мкА; C_D<20 пФ; t_{RR}<10 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
s5A	SMBD6050	SIEM	di	V_R<70 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<10 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
s5B	SMBD6100	SIEM	di×2	V_R<70 В; I_F<250 мА; $V_F(I_F$=100 мА)<1.1 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.5 пФ; t_{RR}<15 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
s5C	SMBD7000	SIEM	di×2	V_R < 100 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.1 В; I_R < 0.5 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 15 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
s5D	SMBD914	SIEM	di	V_R < 70 В; I_F < 250 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.025 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
S5s	BAT15-05W	INF	shd	V_R < 4 В; I_F < 110 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.41 В; C_D < 0.35 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
S5s	BBY52	SIEM	var×2	V_R < 7 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 1.1...2.5 пФ; $C_{1В}/C_{4В}$ = 1.1...2.1	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
S6	KTA2014	KEC	pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 200...400; f_T > 80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
S6	SST176	SIL	pFET	V_{DS} = 30 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} = 2...35 мА; $R_{DS(on)}$ < 250 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
S6p	BF510	PHIL	nFET	V_{DS} = 20 В; I_{DS} < 3 мА; P_D = 250 мВт; g_F = 2.5 мс	SOT23,SOD23	G•D•S
S7	SST177	SIL	pFET	V_{DS} = 30 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} = 1.5...20 мА; $R_{DS(on)}$ < 300 Ом	SOT23,SOD23	D•S•G
S70	BS870	GS	nFET	V_{DSS} = 60 В; I_D = 250 мА; P_D = 310 мВт; V_{GS} < 20 В	SOT23,SOD23	G•S•D
S72	2N7002	VISH	nFET	V_{DS} = 60 В; I_D = 115 мА; P_D = 200 мВт; V_{GS} < 2.5 В; C_{ICC} = 60 пФ	SOT23,SOD23	G•S•D
S76	ZHCS756	ZETEX	shd	V_R < 60 В; I_F < 0.75 А; V_F(I_F = 0.75 А) < 0.61 В; I_R < 100 мкА; C_D < 17 пФ; t_{RR} < 12 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
S7p	BF511	PHIL	nFET	V_{DS} = 20 В; I_{DS} < 7 мА; P_D = 250 мВт; g_F = 4 мс	SOT23,SOD23	G•D•S
S7s	BBY53	INF	var×2	V_R < 6 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 4.8...5.8 пФ; $C_{3В}$ = 1.85...3.1 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
S7s	BBY53-05W	INF	var	V_R < 6 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; $C_{1В}$ = 4.8...5.8 пФ; $C_{3В}$ = 1.85...3.1 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
S8	BAT1504	SIEM	shd	V_R < 4 В; I_F < 110 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.48 В; C_D < 0.35 пФ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
S8p	BF512	PHIL	nFET	V_{DS} = 20 В; I_{DS} < 12 мА; P_D = 250 мВт; g_F = 6 мс	SOT23,SOD23	G•D•S
S8s	BAT15-04W	INF	shd	V_R < 4 В; I_F < 110 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.41 В; C_D < 0.35 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
S9	1SS394	TOSH	shd	V_R > 10 В; V_F(I_F = 100 мА) < 0.5 В; I_R(V_R = 10 В) < 20 мкА; C_T < 40 пФ	SOT346,SC59	A•n.c.•K
S9	1SS395	TOSH	shd	V_R < 10 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 0.5 В; C_D < 40 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
S9p	BF513	PHIL	nFET	V_{DS} = 20 В; I_{DS} < 18 мА; P_D = 250 мВт; g_F = 7 мс	SOT23,SOD23	G•D•S
SA	BSS123	ZETEX	nMOS	V_{DS} = 100 В; I_D = 170 мА; P_D = 330 мВт; g_F = 90 мСм; $R_{DS(on)}$ = 14 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
sA2	SMBD2836	SIEM	di×2	V_R < 50 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
sA3	SMBD2835	SIEM	di×2	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
sA4	SMBD2838	SIEM	di×2	V_R < 50 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
sA5	SMBD2837	SIEM	di×2	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 4 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SAs	BSS123	INF	nMOS	V_{DS} = 100 В; I_D = 170 мА; P_D = 360 мВт; g_F = 170 мСм; $R_{DS(on)}$ < 6 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
SB	2SA1121B	REN	pnp	V_{CB0} = 35 В; I_C = 500 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...120	SOT23,SOD23	B•E•C
SBp	BB200	PHIL	var×2	V_R > 18 В; I_R(V_R = 10 В) < 0.05 мкА; $C_{1В}$ = 65.8...74.2 пФ; $C_{4.5В}C_{4.5В}$ = 12...14.8 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SBs	BSS145	INF	nMOS	V_{DS} = 65В; I_D = 220 мА; P_D = 360 мВт; g_F > 120 мСм; $R_{DS(on)}$ = 3.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
SC	2SA1121C	REN	pnp	V_{CB0} = 35 В; I_C = 500 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 100...200	SOT23,SOD23	B•E•C
sC3	SMBT4126	SIEM	pnp	V_{CB0} = 25 В; I_C = 200 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 120...360; f_T > 300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
SCp	BB201	PHIL	var×2	V_R > 15 В; I_R(V_R = 15 В) < 0.2 мкА; $C_{1В}$ = 89...102 пФ; $C_{7.5В}$ = 25.5...29.7 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SD	2SA1121D	REN	pnp	V_{CB0} = 35 В; I_C = 500 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 160...320	SOT23,SOD23	B•E•C
SDs	BSS284	INF	pMOS	V_{DS} = 50 В; I_D = 130 мА; P_D = 360 мВт; g_F > 50 мСм; $R_{DS(on)}$ = 10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
SF0	BB804	PHIL	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 20 нА; R_S < 0.2 Ом; $C_{2В}$ = 42...43.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF0	BB804F0	SIEM	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 42...43.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF1	BB804	PHIL	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 20 нА; R_S < 0.2 Ом; $C_{2В}$ = 43...44.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF1	BB804F1	SIEM	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 43...44.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF2	BB804	PHIL	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 20 нА; R_S < 0.2 Ом; $C_{2В}$ = 44...45.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF2	BB804F2	SIEM	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 44...45.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF2	BB804W	PHIL	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 42...46.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF3	BB804	PHIL	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 20 нА; R_S < 0.2 Ом; $C_{2В}$ = 45...46.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF3	BB804F3	SIEM	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 45...46.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF4	BB804F4	SIEM	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 46...47.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SF5	BB804	PHIL	var×2	V_R < 18 В; I_F < 50 мА; I_R < 0.02 мкА; $C_{2В}$ = 42...46.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$ > 1.65	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SG	2SA1586	TOSH	pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 200...400; f_T > 80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C

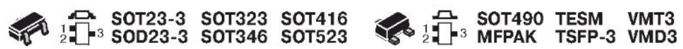
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
SGR	KTA2014	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=200...400; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SH1	BB814H1	INF	var×2	V_R<18 В; I_F<50 мА; I_R<0.02 мкА; $C_{2В}$=43...45 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$=2.05...2.25	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SH2	BB814H2	INF	var×2	V_R<18 В; I_F<50 мА; I_R<0.02 мкА; $C_{2В}$=44.5...46.5 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$=2.05...2.25	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SM	2SC3082KM	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=39...82; f_T>110 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
SM	2SC4100M	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=39...82; f_T>110 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SM	2SC4619	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=39...82; f_T>110 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
SMs	BB914	SIEM	var×2	V_R<18 В; I_F<50 мА; I_R<0.02 мкА; $C_{2В}$=42.5...45 пФ; $C_{2В}/C_{8В}$=2.28...2.42	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
SN	2SC3082KN	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>110 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
SN	2SC4100N	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=56...120; f_T>110 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SN	2SC4619	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=56...120; f_T>110 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
SO	2SA1586	TOSH	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}>70...140; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SO	KTA2014	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=70...140; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SP	2SC3082KP	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>110 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
SP	2SC4100P	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>110 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SP	2SC4619	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=82...180; f_T>110 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
SP	BSS84	ZETEX	pMOS	V_{DS}=50 В; I_D=130 мА; P_D=360 мВт; g_F=50 мСм; $R_{DS(on)}$=10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
SPs	BSS84	SIEM	pMOS	V_{DS}=50 В; I_D=130 мА; P_D=360 мВт; g_F>50мСм; $R_{DS(on)}$<10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
SQ	2SC3082KQ	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>110 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
SQ	2SC4100Q	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>110 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SQ	2SC4619	ROHM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=120...270; f_T>110 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
SR	2SC3929R	PAN	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=180...360; f_T=100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SRs	BSS131	INF	nMOS	V_{DS}=240 В; I_D=100 мА; P_D=360 мВт; g_F=140мСм; $R_{DS(on)}$=6 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
SS	2SC3929S	PAN	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=260...520; f_T=100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SS	BSS138	ZETEX	nMOS	V_{DS}=50 В; I_D=200 мА; P_D=360 мВт; g_F=120 мСм; $R_{DS(on)}$=6 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
sSF	SP0610T	SIEM	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=130 мА; P_D=360 мВт; g_F>80 мСм; $R_{DS(on)}$=10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
sSG	SN7002	SIEM	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=190 мА; P_D=360 мВт; $R_{DS(on)}$<7.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
sSH	BSS119	INF	nMOS	V_{DS}=100В; I_D=170 мА; P_D=360 мВт; g_F>100 мСм; $R_{DS(on)}$=6 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
sSJ	BSS7728	SIEM	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=150 мА; P_D=360 мВт; g_F=80 мСм; $R_{DS(on)}$=7.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
sSN	SN7002N	SIEM	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=160 мА; P_D=360 мВт; $R_{DS(on)}$<7.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
sSN	SN7002W	SIEM	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=180 мА; P_D=500 мВт; $R_{DS(on)}$<7.5 Ом	SOT323,SC70	G•S•D
SSs	BSS138	INF	nMOS	V_{DS}=50 В; I_D=220 мА; P_D=360 мВт; g_F>1200 мСм; $R_{DS(on)}$=3.5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
ST	2SC3929T	PAN	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=360...700; f_T=100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
STs	BSS139	INF	nMOS	V_{DS}=250В; I_D=40 мА; P_D=360 мВт; g_F>50 мСм; $R_{DS(on)}$<100 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
SY	2SA1586	TOSH	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
SY	KTA2014	KEC	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=120...240; f_T>80 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
sZC	SMBT4124	SIEM	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...360; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T0	HSMS2860	HP	shd	V_{BR}>5 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.6 В; C_T<0.30 пФ; R_D=10 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
T0	HSMS286B	HP	shd	$V_F(I_F$=1 мА)<0.35 В; C_T<0.30 пФ	SOT323,SC70	A•n.c.•K
t01	PDTA143ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t01	PDTA143EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t02	PDTC143ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t02	PDTC143EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t03	PDTA114ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t03	PDTA114EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t04	PMSS3904	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>180 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t05	PDTA124ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t05	PDTA124EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
T05	SSTPAD5	CALOG	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<5 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
t06	PDTC124EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t06	PMSS3906	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t07	PDTA144ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t07	PDTA144EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
t08	PDTC144ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t08	PDTC144EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t09	PDTC114EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
T0KFF	NDS0610	NS	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=120 мА; P_D=360 мВт; $R_{DS(on)}$<30 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
T1	BCX17	ALLEG	pnp	V_{CB0}=50 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=100...600; $V_{CE(sat)}$<0.62 В	SOT23,SOD23	B•E•C
T1	BCX17	CDIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T1	BCX17	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T1	BSS63	MOT	pnp	V_{CB0}=100 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>30; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T1	HSMS2862	HP	shd×2	V_{BR}>5 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.6 В; C_T<0.30 пФ; R_D=10 Ом	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
T10	SSTPAD10	CALOG	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<10 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
t11	PDTA114TT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
T11	SSTPAD100	CALOG	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<100 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
t12	PDTC114TT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t16	PDTC114ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t17	PDTC124ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t18	PDTC143ZT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t19	PDTA143ZT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t1A	PMST3904	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300	SOT323,SC70	B•E•C
T1B	LM61BIM3	NS	ats	T_{AMB}=-25...85 °C; V_{CC}=2.7...10 В; I_{OUT}<10 мА; ACC=±3°C	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
t1B	PMBT2222	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1B	PMST2222	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
T1C	LM61CIM3	NS	ats	T_{AMB}=-30...100 °C; V_{CC}=2.7...10 В; I_{OUT}<10 мА; ACC=±4°C	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
t1D	PMBTA42	PHIL	npn	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1D	PMSTA42	PHIL	npn	V_{CB0}=300 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t1E	PMBTA43	MOT	npn	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1E	PMSTA43	PHIL	npn	V_{CB0}=200 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t1F	PMBT5550	PHIL	npn	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=60...250; f_T=100...300	SOT23,SOD23	B•E•C
t1F	PMST5550	PHIL	npn	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=60...250; f_T=100...300	SOT323,SC70	B•E•C
t1H	MMBTA05	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=30 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>50; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1J	PMBT2369	PHIL	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=40...120	SOT23,SOD23	B•E•C
t1K	PMBT6428	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=250...650; f_T=100...700 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1L	PMBT6429	PHIL	npn	V_{CB0}=55 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=500...1250; f_T=100...700 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1M	PMBTA13	PHIL	dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1N	PMBTA14	PHIL	dnpn	V_{CB0}=30 В; I_C=300 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T1p	BCX17	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1P	PMBT2222A	PHIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t1P	PMST2222A	PHIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t1Q	PMBT5088	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=350...1400	SOT23,SOD23	B•E•C
t1Q	PMST5088	PHIL	npn	V_{CB0}=35 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>300...900	SOT323,SC70	B•E•C
t1R	PMST5089	PHIL	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>400...1200	SOT323,SC70	B•E•C
T1t	BCX17	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T2	BCX18	ALLEG	pnp	V_{CB0}=30 В; I_{CB0}<100 нА; h_{21}=100...600; $V_{CE(sat)}$<0.62 В	SOT23,SOD23	B•E•C
T2	BCX18	CDIL	pnp	V_{CB0}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T2	BCX18	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T2	HSMS286C	HP	shd×2	$V_F(I_F$=1 мА)<0.35 В; C_T<0.30 пФ	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
T2	TN2460T	SIL	nMOS	V_{DS}=240 В; I_D=51 мА; P_D=360 мВт; g_F=70 мСм; $R_{DS(on)}$=11 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
T20	SSTPAD20	CALOG	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<20 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
T21	SSTPAD200	CALOG	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<200 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
t23	PDTA114TU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t24	PDTC114TU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t27	PDTC114YT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
t28	PDTA114WU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>60; 47 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t29	PDTA114YT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
t2A	PMBT3906	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2A	PMST3906	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t2B	PMBT2907	PHIL	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2D	PMBTA92	PHIL	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2D	PMSTA92	PHIL	pnp	V_{CB0}=300 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t2E	PMBTA93	PHIL	pnp	V_{CB0}=200 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2E	PMSTA93	PHIL	pnp	V_{CB0}=200 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>40; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t2F	PMBT2907A	PHIL	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2G	PMBTA56	PHIL	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2G	PMSTA56	PHIL	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t2H	PMBTA55	PHIL	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>50 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2H	PMSTA55	PHIL	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; f_T>50 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t2L	PMBT5401	PHIL	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=60...240; f_T=100...300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2L	PMST5401	PHIL	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=60...240; f_T=100...300 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
T2p	BCX18	PHIL	pnp	V_{CB0}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T2t	BCX18	PHIL	pnp	V_{CB0}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T=100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2T	PMBT4403	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2T	PMST4403	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
t2U	PMBTA63	PHIL	dpnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>5000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2V	PMBTA64	PHIL	dpnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
t2X	PMBT4401	PHIL	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t2X	PMST4401	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
T3	BSS63	PHIL	pnp	V_{CB0}=100 В; I_C=800 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>30; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T3	HSMS2863	HP	shd×2	V_{BR}>5 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.6 В; C_T<0.30 пФ; R_D=10 Ом	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
T3	HSMS286E	HP	shd×2	$V_F(I_F$=1 мА)<0.35 В; C_T<0.30 пФ	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
t30	PDTC114YU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t31	PDTA143XT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
T32	2SC4182	NEC	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=160 мВт; h_{21}=60...105; f_T=1.1 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
t32	PDTC143XT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
T33	2SC4182	NEC	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=160 мВт; h_{21}=85...150; f_T=1.1 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T34	2SC4182	NEC	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=160 мВт; h_{21}=120...220; f_T=1.1 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T35	BSR20	CDIL	pnp	V_{CB0}=130 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T=400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T35	BSR20	PHIL	pnp	V_{CB0}=130 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>40; f_T=100...400 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T36	BSR20A	CDIL	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; f_T=300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T36	BSR20A	PHIL	pnp	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; f_T=100...300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T4	BCX17R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T4	BCX17R	PHIL	pnp	V_{CB0}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
T4	HSMS2864	HP	shd×2	V_{BR}>5 В; $V_F(I_F$=30 мА)<0.6 В; C_T<0.30 пФ; R_D=10 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
T4	HSMS286F	HP	shd×2	$V_F(I_F$=1 мА)<0.35 В; C_T<0.30 пФ	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
T42	2SC4184	NEC	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=160 мВт; h_{21}=40...80; f_T>1.2 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T43	2SC4184	NEC	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=160 мВт; h_{21}=60...120; f_T>1.2 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T44	2SC4184	NEC	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D=160 мВт; h_{21}=100...200; f_T>1.2 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
t46	PDTA143XU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t47	PDTA143ZU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
T4B	LM45BIM3	NS	ats	T_{AMB}=-20...100°C; V_{CC}=4...10 В; I_{OUT}<10 мА	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
T4C	LM45CIM3	NS	ats	T_{AMB}=-20...100°C; V_{CC}=4...10 В; I_{OUT}<10 мА	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
T5	BCX18R	ZETEX	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T5	BCX18R	PHIL	pnp	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
T50	SSTPAD50	CALOG	dl	V_R=55 В; I_F<10 мА; $V_F(I_F$=1 мА)<1.5 В; I_R<50 пА; C_T<2 пФ	SOT23,SOD23	K•K•A
t53	PDTC143XU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
t54	PDTC143ZU	PHIL	Dnpn	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}>100; 4.7кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
t55	PDTA114YU	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; h_{21}>100; 10кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
T5B	LM50BIM3	NS	ats	T_{AMB}=-40...125°C; V_{CC}=4.5...10В; I_{OUT}<10мА; ACC=±2°C	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
T5C	LM50CIM3	NS	ats	T_{AMB}=-40...125°C; V_{CC}=4.5...10В; I_{OUT}<10мА; ACC=±3°C	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
T6	BSS63R	PHIL	pnp	V_{CBO}=100В; I_C=800мА; P_D=330мВт; h_{21}>30; f_T=150МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
T61	ZUMT617	ZETEX	npn	V_{CBO}=15В; I_C=1.5А; P_D=385мВт; h_{21}>30; f_T=180МГц	SOT323,SC70	B•E•C
T62	2SC3841P	NEC	npn	V_{CBO}=25В; I_C=30мА; P_D=200мВт; h_{21}=40...80; f_T>2.5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T62	2SC4186	NEC	npn	V_{CBO}=25В; I_C=30мА; P_D=160мВт; h_{21}=40...80; f_T>2.5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T62	ZUMT618	ZETEX	npn	V_{CBO}=20В; I_C=1.25А; P_D=385мВт; h_{21}>20; f_T=210МГц	SOT323,SC70	B•E•C
T63	2SC3841Q	NEC	npn	V_{CBO}=25В; I_C=30мА; P_D=200мВт; h_{21}=60...120; f_T>2.5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T63	2SC4186	NEC	npn	V_{CBO}=25В; I_C=30мА; P_D=160мВт; h_{21}=60...120; f_T>2.5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T63	ZUMT619	ZETEX	npn	V_{CBO}=50В; I_C=1А; P_D=385мВт; h_{21}>20; f_T=215МГц	SOT323,SC70	B•E•C
T64	2SC3841R	NEC	npn	V_{CBO}=25В; I_C=30мА; P_D=200мВт; h_{21}=100...200; f_T>2.5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T64	2SC4186	NEC	npn	V_{CBO}=25В; I_C=30мА; P_D=160мВт; h_{21}=100...200; f_T>2.5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T6B	LM60BIM3	NS	ats	T_{AMB}=-25...125°C; V_{CC}=4.5...10В; I_{OUT}<10мА; ACC=±3°C	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
T6C	LM60CIM3	NS	ats	T_{AMB}=-40...125°C; V_{CC}=4.5...10В; I_{OUT}<10мА; ACC=±4°C	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
T7	BSR15	CDIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}>30; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T7	BSR15	SGS	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}>30; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T7	SST4117	SIL	nFET	V_{DS}=40В; P_D=350мВт; I_{DSS}=0.03...0.09мА; g_F=70мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
T71	BSR15R	SGS	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}>30; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
T71	ZUMT717	ZETEX	pnp	V_{CBO}=12В; I_C=1.25А; P_D=385мВт; h_{21}>30; f_T=220МГц	SOT323,SC70	B•E•C
T72	2SC4568	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=30мА; P_D=150мВт; h_{21}=40...80; f_T=5.5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T72	2SC4570	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=30мА; P_D=120мВт; h_{21}=40...80; f_T=5.5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T72	ZUMT718	ZETEX	pnp	V_{CBO}=20В; I_C=1А; P_D=385мВт; h_{21}>20; f_T=210МГц	SOT323,SC70	B•E•C
T73	2SC4568	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=30мА; P_D=150мВт; h_{21}=60...120; f_T=5.5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T73	2SC4570	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=30мА; P_D=120мВт; h_{21}=60...120; f_T=5.5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T73	ZUMT719	ZETEX	pnp	V_{CBO}=40В; I_C=1А	SOT323,SC70	B•E•C
T74	2SC4568	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=30мА; P_D=150мВт; h_{21}=100...200; f_T=5.5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T74	2SC4570	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=30мА; P_D=120мВт; h_{21}=100...200; f_T=5.5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T75	2SC4569	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=150мВт; h_{21}=40...80; f_T=5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T75	2SC4571	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=120мВт; h_{21}=40...80; f_T=5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T75	NE58230	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=120мВт; h_{21}=40...80; f_T=5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T76	2SC4569	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=150мВт; h_{21}=60...120; f_T=5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T76	2SC4571	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=120мВт; h_{21}=60...120; f_T=5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T76	NE58230	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=120мВт; h_{21}=60...120; f_T=5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T77	2SC4569	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=150мВт; h_{21}=100...200; f_T=5ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T77	2SC4571	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=120мВт; h_{21}=100...200; f_T=5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T77	NE58230	NEC	npn	V_{CBO}=20В; I_C=60мА; P_D=120мВт; h_{21}=100...200; f_T=5ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T7B	LM62BIM3	NS	ats	T_{AMB}=0...90°C; V_{CC}=2.7...10В; I_{OUT}<10мА; ACC=±2°C	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
T7C	LM62CIM3	NS	ats	T_{AMB}=0...90°C; V_{CC}=2.7...10В; I_{OUT}<10мА; ACC=±3°C	SOT23,SOD23	+Vs•Vo•GND
T7p	BSR15	PHIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}>30; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T7t	BSR15	PHIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}>30; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t7Y	PDTB123YT	PHIL	Dpnp	V_{CBO}=50В; I_C=500мА; P_D=250мВт; h_{21}>70; 2.2кОм/10кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
T8	BSR16	CDIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T8	BSR16	SGS	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T8	SST4118	SIL	nFET	V_{DS}=40В; P_D=350мВт; I_{DSS}=0.08...0.24мА; g_F=80мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
T81	BSR16R	SGS	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=600мА; P_D=250мВт; h_{21}>50; f_T>200МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
T82	2SC4954	NEC	npn	V_{CBO}=9В; I_C=10мА; P_D=60мВт; h_{21}=75...150; f_T=12ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T82	2SC4958	NEC	npn	V_{CBO}=9В; I_C=10мА; P_D=60мВт; h_{21}=75...150; f_T=12ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T83	2SC4955	NEC	npn	V_{CBO}=9В; I_C=30мА; P_D=180мВт; h_{21}=75...150; f_T=12ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T83	2SC4959	NEC	npn	V_{CBO}=9В; I_C=30мА; P_D=150мВт; h_{21}=75...100; f_T=12ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T84	2SC5177	NEC	npn	V_{CBO}=5В; I_C=10мА; P_D=30мВт; h_{21}=70...140; f_T>10ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C

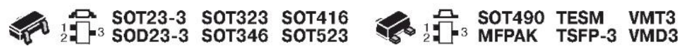
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
T84	2SC5179	NEC	npn	V_{CB0}=5 В; I_C=10 мА; P_D=30 мВт; h_{21}=70...140; f_T>10 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T86	2SC5182	NEC	npn	V_{CB0}=5 В; I_C=30 мА; P_D=90 мВт; h_{21}=70...140; f_T>9 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T86	2SC5184	NEC	npn	V_{CB0}=5 В; I_C=30 мА; P_D=90 мВт; h_{21}=70...140; f_T>9 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T88	2SC5191	NEC	npn	V_{CB0}=9 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=80...160; f_T>4 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T88	2SC5193	NEC	npn	V_{CB0}=9 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=80...160; f_T>4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
T8p	BSR16	PHIL	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T8t	BSR16	PHIL	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T9	1SS396	TOSH	shd×2	V_R>40 В; $V_F(I_F$=100 мА)<0.6 В; $I_R(V_R$=40 В)<5 мкА; C_T<25 пФ	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
T9	SST4119	SIL	nFET	V_{DS}=40 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=0.2...0.6 мА; g_F=100 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
T92	2SA1977	NEC	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...100; f_T>6 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T92	BSR18A	CDIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T92	BSR18A	FAIR	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T92	NE97733	NEC	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...100; f_T=8.5 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T92p	BSR18A	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T93	2SA1978	NEC	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...100; f_T>4 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
T93	NE97833	NEC	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...100; f_T=5.5 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
t9A	PLVA650A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=4.8...5.2 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<20 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<700 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
t9B	PLVA653A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.1...5.5 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<250 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
t9C	PLVA656A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.4...5.8 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
t9D	PLVA659A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.7...6.1 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<500 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
t9E	PLVA662A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.0...6.4 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<100 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
t9F	PLVA665A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.3...6.7 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
t9G	PLVA668A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.6...7.0 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<10 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
t9J	PLVA2650A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=4.8...5.2 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<20 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<700 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
t9K	PLVA2653A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.1...5.5 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<250 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
t9L	PLVA2656A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.4...5.8 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
t9M	PLVA2659A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.7...6.1 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<500 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
t9N	PLVA2662A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.0...6.4 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<100 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
t9O	PLVA2665A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.3...6.7 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
t9P	PLVA2668A	PHIL	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.6...7.0 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z)<10 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА)<100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
TA	2SC5431EB	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=60 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=60...90; f_T>3 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TA	KTC3295A	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=600...1800; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
TA	NE582M03	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=60 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=60...90; f_T=4.3 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TA5	MMBZ15VDA	VISH	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=14.7...15.3 В; $V_F(I_F$=200 мА)<0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
TA7	MMBZ27VDA	VISH	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=1 мА)=26.46...27.54 В; $V_F(I_F$=200 мА)<1.1 В	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
TAA	BC856AF	AUK	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T=150 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
TAB	BC856BF	AUK	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=200...450; f_T=150 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
TAC	BC856CF	AUK	pnp	V_{CB0}=80 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T=150 МГц	SOT490,SC89	B•E•C
TB	2SC5431FB	NEC	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=60 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=80...120; f_T>3 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TB	KTC3295B	KEC	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=1200...3600; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
TBD	BAT46CW	STM	shd×2	V_R<100 В; I_F<150 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.45 мВ; C_D=10 пФ	SOT323,SC70	A2•A1•K1,K2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
TBD	BAT46SW	STM	shd×2	V_R < 100 В; I_F < 150 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ	SOT323,SC70	A2•K1•A1,K2
TC	2SC2736	REN	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 30...200; f_T > 1.4 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
TC	2SC5432EB	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 80...110; f_T > 3 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TC5	MMBZ15VDC	VISH	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$ = 1 мА) = 14.3...15.8 В; $V_F(I_F$ = 200 мА) < 0.9 В	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
TC7	MMBZ27VDC	VISH	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$ = 1 мА) = 26.65...28.35 В; $V_F(I_F$ = 200 мА) < 1.1 В	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
TD	2SC5432FB	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 100...145; f_T > 3 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TE	2SC3906KE	ROHM	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 390...820; f_T > 140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
TE	2SC4102E	ROHM	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 390...820; f_T > 140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
TE	2SC5433EB	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 80...110; f_T > 4.5 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TF	2SC5433FB	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 100...145; f_T > 4.5 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
tG1	PMBT5551	PHIL	npn	V_{CB0} = 180 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 80...250; f_T = 100...300	SOT23,SOD23	B•E•C
tG3	PMST5551	PHIL	npn	V_{CB0} = 180 В; I_C = 600 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 80...250; f_T = 100...300 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
TH	2SC5434EB	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 80...110; f_T > 5.5 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TI	2SC4197	REN	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...180; f_T > 3 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
TI	2SC4260	REN	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 50...180; f_T > 3 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
TJ	2SC5434FB	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 100...145; f_T > 5.5 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TK	2SC5435EB	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 75...110; f_T = 12 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TL	2SC5435FB	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 95...140; f_T = 12 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TN	2SC5436EB	NEC	npn	V_{CB0} = 5 В; I_C = 30 мА; P_D = 90 мВт; h_{21} = 75...100; f_T > 9 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TO	TP0610T	TEMIC	pMOS	V_{DS} = 60 В; I_D = 120 мА; P_D = 360 мВт; g_F = 60 мСм; $R_{DS(on)}$ = 10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
TO	TP0610T	SIL	pMOS	V_{DS} = 60 В; I_D = 120 мА; P_D = 360 мВт; g_F = 60 мСм; $R_{DS(on)}$ = 10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
tO4	PMBS3904	PHIL	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
tO6	PMBS3906	PHIL	pnp	V_{CB0} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
TP	2SC5436FB	NEC	npn	V_{CB0} = 5 В; I_C = 30 мА; P_D = 90 мВт; h_{21} = 90...130; f_T > 9 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TR	2SC3906KR	ROHM	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
TR	2SC3929AR	PAN	npn	V_{CB0} = 55 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 180...360; f_T = 100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
TR	2SC4102R	ROHM	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
TS	2SC3906KS	ROHM	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
TS	2SC3929AS	PAN	npn	V_{CB0} = 55 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 260...520; f_T = 100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
TS	2SC4102S	ROHM	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
TS	2SC5437EB	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 80...110; f_T > 4 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TT	2SC3929AT	PAN	npn	V_{CB0} = 55 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 360...700; f_T = 100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
TT	2SC5437FB	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 100...145; f_T > 4 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
TV	2SC5599	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 3.5 ГГц	SOT416,SC75A	B•E•C
TV	2SC5600	NEC	npn	V_{CB0} = 5.5 В; I_C = 15 мА; f_T = 5.5 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
tV3	BAT54A	PHIL	shd×2	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 30 мА) < 500 мВ; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
tV4	BAT54S	PHIL	shd×2	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 30 мА) < 500 мВ; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
TW	2SC5602	NEC	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 12 ГГц	SOT416,SC75A	B•E•C
TW	2SC5603	NEC	npn	V_{CB0} = 6 В; I_C = 15 мА; f_T = 13.5 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
tW1	BAT54C	PHIL	shd×2	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; $V_F(I_F$ = 30 мА) < 500 мВ; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
U1	BCX19	ALLEG	npn	V_{CB0} = 50 В; I_{CB0} < 100 нА; h_{21} = 100...600; $V_{CE(sat)}$ < 0.62 В	SOT23,SOD23	B•E•C
U1	BCX19	CDIL	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U1	BCX19	ZETEX	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U1	BCX19	MOT	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U1p	BCX19	PHIL	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U1t	BCX19	PHIL	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U2	BCX20	ALLEG	npn	V_{CB0} = 30 В; I_{CB0} < 100 нА; h_{21} = 100...600; $V_{CE(sat)}$ < 0.62 В	SOT23,SOD23	B•E•C
U2	BCX20	ZETEX	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U2	BCX20	CDIL	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U2p	BCX20	PHIL	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U2t	BCX20	PHIL	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U3	BSS64	FAIR	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 200 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 20; f_T > 60 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
U35	BSR19	CDIL	npn	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; f_T=300	SOT23,SOD23	B•E•C
U35	BSR19	PHIL	npn	V_{CB0}=160 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; f_T=300	SOT23,SOD23	B•E•C
U36	BSR19A	CDIL	npn	V_{CB0}=180 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; f_T=300	SOT23,SOD23	B•E•C
U36	BSR19A	PHIL	npn	V_{CB0}=180 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; f_T=300	SOT23,SOD23	B•E•C
U4	BCX19R	ZETEX	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U4	BCX19R	PHIL	npn	V_{CB0}=45 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
U5	BCX20R	ZETEX	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=100...600; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U5	BCX20R	PHIL	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...600; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
U6	BSS64R	FAIR		V_{CB0}=120 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}>20; f_T>60 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
U7	BSR13	CDIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U7	BSR13	SGS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U71	BSR13R	SGS	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
U7p	BSR13	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U7t	BSR13	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U8	BSR14	CDIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U8	BSR14	SGS	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U81	BSR14R	SGS	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	E•B•C
U8p	BSR14	PHIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U8t	BSR14	PHIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=800 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U92	BSR17A	CDIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U92	BSR17A	FAIR	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U92p	BSR17A	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
U9p	BSR17	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=425 мВт; h_{21}=40; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
UA	2SB852KA	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>1000; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
UB	2SB852KB	ROHM	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>5000; f_T>200 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
UB	2SC5668	NEC	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=35 мА; P_D=115 мВт; h_{21}=50...100; f_T=21 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
UB	NE667M03	NEC	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=35 мА; P_D=115 мВт; h_{21}=50...100; f_T=21 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
UC	MSC2404-C	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; f_T=150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
UF	BB801	SIEM	var	V_R<30 В; I_F<50 мА; I_R<0.02 мкА; C_{28B}=0.85...1.2 пФ; C_{1B}/C_{28B}=7.8...9.5	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
UI	2SC4229	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...180; f_T>700 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
UI	2SC4259	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=20 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=50...180; f_T>700 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
UV	1SV315	SANYO	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
UV	1SV316	SANYO	pin×2	V_R>50 В; I_F<50 мА; $V_F(I_F$=50 мА)<1 В; I_R<0.1 мкА	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
V04	VN45350T	SIL	nMOS	V_{DS}=450 В; I_D=20 мА; P_D=800 мВт; $R_{DS(on)}$<350 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
V1	1SV160	TOSH	var	V_R>15 В; $I_R(V_R$=4 В)<0.1 мкА; C_T=14 пФ	SOT346,SC59	n.c.•A•K
V1	DZ23C2V7	VISH	dz×2	V_Z=2.5...2.9 В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=83 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V1	MRF959T1	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=75...150; f_T=9 ГГц	SOT416,SC75A	B•E•C
V1	VN50300T	SIL	nMOS	V_{DS}=500 В; I_D=22 мА; P_D=350 мВт; g_F=140 мСм; $R_{DS(on)}$=25 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
V10	DZ23C6V2	VISH	dz×2	V_Z=5.8...6.6 В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=10 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V11	DZ23C6V8	VISH	dz×2	V_Z=6.4...7.2 В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=8 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V12	DZ23C7V5	VISH	dz×2	V_Z=7.0...7.9 В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=7 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V13	DZ23C8V2	VISH	dz×2	V_Z=7.7...8.7 В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=7 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V13	ZC932	ZETEX	var	V_R<12 В; $C_D(V_R$=2.5 В)=8.5...10.5 пФ; C_{2B}/C_{20B}<3.1; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
V14	DZ23C9V1	VISH	dz×2	V_Z=8.5...9.6 В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=10 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V14	ZC931	ZETEX	var	V_R<12 В; $C_D(V_R$=2.5 В)=6.5...7.8 пФ; C_{1B}/C_{4B}=<3.6; Q>300	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
V15	ZC930	ZETEX	var	V_R<25 В; $C_D(V_R$=2.5 В)=4.3...5.5 пФ; C_{1B}/C_{4B}=<3.0; Q>200	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
V15	ZDZ23C10	VISH	dz×2	V_Z=9.4...10.В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=15 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V16	DZ23C11	VISH	dz×2	V_Z=10.4...11.В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=20 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V16	ZC934	ZETEX	var	V_R<12 В; $C_D(V_R$=2.5 В)=40...65 пФ; C_{1B}/C_{4B}<3.8; Q>80	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
V17	DZ23C12	VISH	dz×2	V_Z=11.4...12.В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=20 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V17	ZC933	ZETEX	var	V_R<12 В; $C_D(V_R$=2.5 В)=18...27 пФ; C_{1B}/C_{4B}<3.5; Q>150	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
V18	DZ23C13	VISH	dz×2	V_Z=12.4...14.В; $Z_{ZT}(I_Z$=5 мА)=25 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2





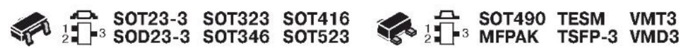
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
V19	DZ23C15	VISH	dz×2	V_Z=13.8...15 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=30 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V1p	BFT25	PHIL	npn	V_{CB0}=8 В; I_C=6.5 мА; P_D=30 мВт; h_{21}>20; f_T=2.3 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
V2	BFQ67	VIS	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>65; f_T=8 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
V2	DZ23C3V0	VISH	dz×2	V_Z=2.8...3.2 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V2	VN0605T	SIL	nMOS	V_{DS}=60 В; I_D=180 мА; P_D=360 мВт; g_F=80 мСм; $R_{DS(on)}$=5 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
V20	DZ23C16	VISH	dz×2	V_Z=15.3...17 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=40 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V21	DZ23C18	VISH	dz×2	V_Z=16.8...19 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=50 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V22	DZ23C20	VISH	dz×2	V_Z=18.8...21 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=50 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V23	DZ23C22	VISH	dz×2	V_Z=20.8...23 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=55 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V24	DZ23C24	VISH	dz×2	V_Z=22.8...25 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V25	DZ23C27	VISH	dz×2	V_Z=25.1...28 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V25	PMBT3640	PHIL	pnp	V_{CB0}=12 В; I_C=80 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=30...120; f_T>500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
V26	DZ23C30	VISH	dz×2	V_Z=28...32 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V27	DZ23C33	VISH	dz×2	V_Z=31...35 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=80 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V28	DZ23C36	VISH	dz×2	V_Z=34...38 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=90 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V29	DZ23C39	VISH	dz×2	V_Z=37...41 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=90 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V2p	BFQ67	PHIL	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>60; f_T=8 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
V3	1SV225	TOSH	var×2	V_R>32 В; I_R(V_R=30 В)<0.05 мкА; $C_{3\,В}$=18.5...21 пФ; $C_{30\,В}$=6.6...7.7 пФ	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
V3	DZ23C3V3	VISH	dz×2	V_Z=3.1...3.5 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V30	DZ23C43	VISH	dz×2	V_Z=40...46 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V30	DZ23C43	DIODS	dz×2	V_Z=40...46 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V31	DZ23C47	VISH	dz×2	V_Z=44...50 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V31	DZ23C47	DIODS	dz×2	V_Z=44...50 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V32	DZ23C51	VISH	dz×2	V_Z=48...54 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V32	DZ23C51	DIODS	dz×2	V_Z=48...54 В; Z_{ZT}(I_Z=2 мА)=100 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V4	1SV228	TOSH	var×2	V_R>15 В; I_R(V_R=15 В)<0.01 мкА; $C_{3\,В}$=28.5...32.5 пФ; $C_{8\,В}$=11.7...13.7 пФ	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
V4	DZ23C3V6	VISH	dz×2	V_Z=3.4...3.8 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V5	1SV242	TOSH	var×2	V_R>30 В; I_R(V_R=28 В)<0.01 мкА; $C_{1\,В}$=36...42 пФ; $C_{28\,В}$=2.43...3 пФ	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
V5	DZ23C3V9	VISH	dz×2	V_Z=3.7...4.1 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V6	DZ23C4V3	VISH	dz×2	V_Z=4.0...4.6 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=95 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V7	DZ23C4V7	VISH	dz×2	V_Z=4.4...5.0 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=78 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V8	DZ23C5V1	VISH	dz×2	V_Z=4.8...5.4 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=60 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
V9	DZ23C5V6	VISH	dz×2	V_Z=5.2...6.0 В; Z_{ZT}(I_Z=5 мА)=40 Ом	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
VA	2SC2776A	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=35...70; f_T=320 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
VB	2SC2776B	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=60...120; f_T=320 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
VB	MSC2295-B	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=70...140; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
VC	2SC2776C	REN	npn	V_{CB0}=30 В; I_C=30 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=100...200; f_T=320 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
VC	MSC2295-C	MOT	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=110...220; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
VO	VP0610T	SIL	pMOS	V_{DS}=60 В; I_D=120 мА; P_D=360 мВт; g_F=70 мСм; $R_{DS(on)}$=10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
W01	PDTA143ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W01	PDTA143EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W02	PDTC143ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W02	PDTC143EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W05	PDTA124ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W05	PDTA124EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W06	PDTC124EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W06	PMSS3906	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
W07	PDTA144ET	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W07	PDTA144EU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W08	PDTC144ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W08	PDTC144EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>80; 47 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W09	PDTC114EU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C

SOT490 TESM VMT3 SOT416 SOT323 SOT23-3
MFPAK TSFP-3 VMD3 SOT523 SOT346 SOD23-3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
W10	CMPZDA27V	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=25...29 В; I_L(V_R=18.9 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=6.2 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
W11	CMPZDA30V	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=2.0 мА)=28...32 В; I_L(V_R=21.0 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=5.6 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
W11	PDTA114TT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W12	CMPZDA33V	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=2.0 мА)=31...35 В; I_L(V_R=23.1 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=5.0 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
W12	PDTC114TT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
w13	BB207	PHIL	var×2	V_R>15 В; I_R(V_R=15 В)<0.01 мкА; $C_{1\,В}$=76...86 пФ; $C_{7.5\,В}$=25.5...29.7 пФ	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
W13	CMPZDA36V	CSI	dz×2	V_Z=36 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
W14	CMPZDA39V	CSI	dz×2	V_Z=39 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
W15	CMPZDA43V	CSI	dz×2	V_Z=43 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
W16	CMPZDA47V	CSI	dz×2	V_Z=47 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
W16	PDTC114ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=50 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W17	PDTC124ET	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>60; 22 кОм/22 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W18	PDTC143ZT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W19	PDTA143ZT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W1B	PMBT2222	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
W1J	PMBT2369	PHIL	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=40...120	SOT23,SOD23	B•E•C
W1P	PMBT2222A	PHIL	npn	V_{CB0}=75 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
W1s	BFT92	SIEM	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T=5000 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
W1s	BFT92W	SIEM	pnp	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>15; f_T>5000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
W23	PDTA114TU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W24	PDTC114TU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>200; R_1 10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W27	PDTC114YT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W29	PDTA114YT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W2F	PMBT2907A	PHIL	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
W3	BZX84-C2V4	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.2...2.6 В; I_L(V_R=1.0 В)<50 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W30	PDTC114YU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W31	PDTA143XT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W32	PDTC143XT	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W46	PDTA143XU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W47	PDTA143ZU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W5	BZX84-C3V0	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.8...3.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W52	S852TW	VISH	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=8 мА; P_D=30 мВт; h_{21}=40...150; f_T=5.2 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
W53	PDTC143XU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; 4.7 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W54	PDTC143ZU	PHIL	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>100; 4.7 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W55	PDTA114YU	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>100; 10 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
W6	BZX84C3V3	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.1...3.5 В; I_L(V_R=1.0 В)<5.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом; I_{ZM}<76 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W6	BZX84-C3V3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.1...3.5 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W7	BZX84C3V6	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.4...3.8 В; I_L(V_R=1.0 В)<5.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом; I_{ZM}<69 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W7	BZX84-C3V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.4...3.8 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W74	BAW74	ZETEX	di×2	V_R<50 В; I_F<150 мА; V_F(I_F=100 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<2.0 пФ; t_{RR}<4 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
W7Y	PDTB123YT	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; 2.2 кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
W8	BZX84C3V9	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.7...4.1 В; I_L(V_R=1.0 В)<3.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом; I_{ZM}<64 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W8	BZX84-C3V9	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.7...4.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W9	BZX84C4V3	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.0...4.6 В; I_L(V_R=1.0 В)<3.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом; I_{ZM}<58 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W9	BZX84C4V3LT1	MOT	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.0...4.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
W9A	PLVA650A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=4.8...5.2 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z) < 20 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА) < 700 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W9B	PLVA653A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.1...5.5 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z) < 5 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА) < 250 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W9C	PLVA656A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.4...5.8 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z) < 1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА) < 100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W9D	PLVA659A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=5.7...6.1 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z) < 500 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА) < 100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W9E	PLVA662A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.0...6.4 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z) < 100 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА) < 100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W9F	PLVA665A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.3...6.7 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z) < 50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА) < 100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
W9G	PLVA668A	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=250 мкА)=6.6...7.0 В; $I_L(V_R$=0.8*V_Z) < 10 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=250 мкА) < 100 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
WA	2SD1383KA	ROHM	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 1000; f_T > 250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
WB	2SD1383KB	ROHM	npn	V_{CB0}=40 В; I_C=300 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 5000; f_T > 250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
WB-	2SC5700	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=80 мВт; h_{21}=100...170; f_T > 10 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
WCs	BCR133	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 30; f_T > 130 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WCs	BCR133F	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 30; f_T=130 МГц	TSFP-3,VESM	B•E•C
WCs	BCR133T	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 30; f_T=130 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
WCs	BCR133W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 30; f_T=130 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WDs	BCR141	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 50; f_T > 130 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WDs	BCR141F	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 50; f_T > 130 МГц	TSFP-3,VESM	B•E•C
WDs	BCR141T	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 50; f_T > 130 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
WDs	BCR141W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 50; f_T=130 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WE1	BFS17W	TELEF	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...150; f_T > 1000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WE2	BFS17AW	TELEF	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=25 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=20...150; f_T > 1000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WEs	BCR148	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WEs	BCR148F	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 100 МГц	TSFP-3,VESM	B•E•C
WEs	BCR148T	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 100 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
Wes	BCR148W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 70; f_T=100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WFs	BCR112	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 20; f_T > 140 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WFs	BCR112W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 20; f_T > 140 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WGs	BCR116	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 160 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WGs	BCR116W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 70; f_T=160 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WHs	BCR108	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WHs	BCR108F	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 170 МГц	TSFP-3,VESM	B•E•C
WHs	BCR108T	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 170 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
WHs	BCR108W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 70; f_T=170 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WIs	BCR158	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WIs	BCR158F	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 70; f_T=100 МГц	TSFP-3,VESM	B•E•C
WIs	BCR158T	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 70; f_T=100 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
WIs	BCR158W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 70; f_T=200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WJs	BCR135	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WJs	BCR135F	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 150 МГц	TSFP-3,VESM	B•E•C
WJs	BCR135T	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 150 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
WJs	BCR135W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 70; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WK-	2SC5907	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=80 мА; P_D=80 мВт; h_{21}=120...170; f_T > 5 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
WKs	BCR119	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...630; f_T > 150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WKs	BCR119W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...630; f_T > 150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WL-	2SB1691	REN	pnp	V_{CB0}=60 В; I_C=1 А; P_D=800 мВт; h_{21}=200...500; f_T=310 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WLs	BCR146	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 50; f_T > 150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WLs	BCR146W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 50; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
WMs	BCR183	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>30; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WMs	BCR183F	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30;	TSFP-3,VESM	B•E•C
WMs	BCR183T	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30;	SOT416,SC75A	B•E•C
WMs	BCR183W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>30; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WNs	BCR185	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WNs	BCR185W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T=200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WO4	PMBS3904	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>180 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WO6	PMBS3906	PHIL	pnp	V_{CB0}=40 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=100...300; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WOs	BCR191	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>50; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WOs	BCR191W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WP2	BFR92A	TELEF	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=25 мА; P_D=273 мВт; h_{21}>40; f_T=4500 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WPs	BCR192	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WPs	BCR192F	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T>200 МГц	TSFP-3,VESM	B•E•C
WPs	BCR192T	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T>200 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
WPs	BCR192W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WR	MSD602R	MOT	npn	V_{CB0}=25 В; I_C=150 мА	SOT346,SC59	B•E•C
WR2	BFR93AW	TELEF	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=50...200; f_T=5500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WRE	BFR280TW	TELEF	npn	V_{CB0}=10 В; I_C=10 мА; P_D=80 мВт; h_{21}=30...200; f_T=7500 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WRF	BFR181TW	TELEF	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=20 мА; P_D=175 мВт; h_{21}>50; f_T=8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
WRG	BFR182TW	TELEF	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=35 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WRH	BFR183TW	TELEF	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=65 мА; P_D=450 мВт; h_{21}=50...200; f_T=8000 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WRs	BCR198	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>190 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WRs	BCR198W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T=190 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WSs	BCR169	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...630; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WSs	BCR169W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...630; f_T>150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WTs	BCR166	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>160 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WTs	BCR166W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T=160 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WU	BCR162T	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>200 МГц	SOT416,SC75A	B•E•C
WUs	BCR162	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WUs	BCR162F	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>20; f_T>200 МГц	TSFP-3,VESM	B•E•C
WUs	BCR162W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>20; f_T>200 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WV2	BFQ67W	VIS	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>65; f_T=8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
WV3	BAT54A	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
WV4	BAT54S	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
WVs	BCR129	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...630; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WW1	BAT54C	PHIL	shd×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=30 мА)<500 мВ; C_D<10 пФ; t_{RR}<5 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
WW3	CMPZDA2V4	CSI	dz×2	V_Z=2.4 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
WW4	CMPZDA2V7	CSI	dz×2	V_Z=2.7 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
WW5	CMPZDA3V0	CSI	dz×2	V_Z=3.0 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
WW6	CMPZDA3V3	CSI	dz×2	V_Z=3.3 В(5%); P_D<350 мВт	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
WW7	CMPZDA3V6	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=3.4...3.8 В; I_L(V_R=1.0 В)<2.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<95 Ом; I_{ZM}=45 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
WW8	CMPZDA3V9	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=3.7...4.1 В; I_L(V_R=1.0 В)<2.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=43 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
WW9	CMPZDA4V3	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=4.0...4.6 В; I_L(V_R=1.0 В)<1.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=40 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
WXs	BCR196	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>50; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WXs	BCR196W	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=70 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>50; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
WZ-	2SC5872	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=90...140; f_T=10 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
WZs	BCR142	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>70; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
WZs	BCR142W	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}>70; f_T=150 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
X_	2SB1051K	ROHM	pnp	V_{CB0}=32 В; I_C=1000 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=390; f_T>150 МГц	SOT346,SC59	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
X1p	BFT93	PHIL	Dpnp	V_{CB0}=15В; I_C=35мА; P_D=300мВт; h_{21}>20; f_T>5500МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
X1s	BFT93	SIEM	Dpnp	V_{CB0}=15В; I_C=35мА; P_D=300мВт; h_{21}>20; f_T>5500МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
X2	BZX84-C30	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2мА)=28.0...32.0В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2мА)<80Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
X2	BZX99-C13	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=12.35...13.65В; P_D<300мВ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
X3	BZX84-C33	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2мА)=31.0...35.0В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2мА)<80Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
X3	BZX99-C15	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=14.25...15.75В; P_D<300мВ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
X4	BFT93R	SIEM	Dpnp	V_{CB0}=15В; I_C=35мА; P_D=300мВт; h_{21}>20; f_T>5500МГц	SOT23,SOD23	C•B•E
X4	BZX84-C36	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2мА)=33.0...38.0В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2мА)<90Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
X42	2SK1001	NEC	nFET	V_{DS}=22В; I_D=10мА; P_D=250мВт; g_F>20мСм; I_{DSS}=10...50мА	SOT23,SOD23	D•S•G
X43	2SK1001	NEC	FET	V_{DS}=22В; I_D=10мА; P_D=250мВт; g_F>20мСм; I_{DSS}=10...50мА	SOT23,SOD23	D•S•G
X5	MMBV409LT1	MOT	var	V_R>20В; I_F=200мА; C_{3B}=26...32пФ; C_{3B}/C_{8B}=1.5...1.9	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
X6	2SD1048X6	SANYO	npn	V_{CB0}=20В; I_C=700мА; P_D=200мВт; h_{21}=200...400; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
X6	BZX84-C43	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2мА)=40.0...46.0В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2мА)<150Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
X7	2SD1048X7	SANYO	npn	V_{CB0}=20В; I_C=700мА; P_D=200мВт; h_{21}=300...600; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
X7	BZX84-C47	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2мА)=44.0...50.0В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2мА)<170Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
X8	2SD1048X8	SANYO	npn	V_{CB0}=20В; I_C=700мА; P_D=200мВт; h_{21}=450...900; f_T=250МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
X9	1SS398	TOSH	di×2	V_R<400В; I_F<100мА; $V_F(I_F$=100мА)<1.3В; I_R<1.0мкА	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
XA	BZX99-C4V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=4.47...4.94В; P_D<300мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XA	RN1101	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=4.7/4.7кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XA	RN1101F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=4.7/4.7кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XA	RN1101FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=4.7/4.7кОм	TESM	B•E•C
XA	RN1301	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=100мВт; f_T=250МГц; R_1/R_2=4.7кОм/4.7кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XA	RN1401	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; f_T=200МГц; R_1/R_2=4.7/4.7кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XAs	BCR503	INF	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}>40; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XB	2SC4416	REN	npn	V_{CB0}=25В; I_C=50мА; P_D=150мВт; h_{21}=50...180; f_T>3ГГц	SOT346,SC59	E•B•C
XB	BZX99-C5V1	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=4.85...5.36В; P_D<300мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XB	RN1102	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=10/10кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XB	RN1102F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=10/10кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XB	RN1102FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=10/10кОм	TESM	B•E•C
XB	RN1302	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=100мВт; f_T=250МГц; R_1/R_2=10кОм/10кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XB	RN1402	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; f_T=200МГц; R_1/R_2=10/10кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XBs	BCR553	INF	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}>40; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XC	BZX99-C5V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=5.32...5.88В; P_D<300мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XC	RN1103	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=22/22кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XC	RN1103F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=22/22кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XC	RN1103FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=22/22кОм	TESM	B•E•C
XC	RN1303	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=100мВт; f_T=250МГц; R_1/R_2=22кОм/22кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XC	RN1403	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; f_T=200МГц; R_1/R_2=22/22кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XCs	BCR533	INF	Dnpn	V_{CB0}=50В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}>70; f_T>100МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XD	BZX99-C6V2	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=5.89...6.51В; P_D<300мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XD	RN1104	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=47/47кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XD	RN1104F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=47/47кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XD	RN1104FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=47/47кОм	TESM	B•E•C
XD	RN1304	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=100мВт; f_T=250МГц; R_1/R_2=47кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XD	RN1404	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; f_T=200МГц; R_1/R_2=47/47кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XDs	BCR555	INF	Dpnp	V_{CB0}=50В; I_C=500мА; P_D=330мВт; h_{21}>70; f_T>150МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XE	BZX99-C6V8	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50мкА)=6.46...7.14В; P_D<300мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XE	RN1105	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=2.2/47кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XE	RN1105F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=2.2/47кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XE	RN1105FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=150мА; P_D=100мВт; f_T>250МГц; R_1/R_2=2.2/47кОм	TESM	B•E•C
XE	RN1305	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=100мВт; f_T=250МГц; R_1/R_2=2.2кОм/47кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XE	RN1405	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50В; I_C=100мА; P_D=200мВт; f_T=200МГц; R_1/R_2=2.2/47кОм	SOT346,SC59	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
XF	2SC4464	REN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=5 мА; P_D=50 мВт; h_{21}=40...250; f_T>2.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
XF	RN1106	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XF	RN1106F	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XF	RN1106FT	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	TESM	B•E•C
XF	RN1306	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XF	RN1406	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XFs	BCR512	INF	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>60; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XGs	BCR523	INF	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>70; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XH	RN1107	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XH	RN1107F	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XH	RN1107FT	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	TESM	B•E•C
XH	RN1307	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XH	RN1407	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XHs	BCR573	INF	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>70; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XI	RN1108	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XI	RN1108F	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XI	RN1108FT	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	TESM	B•E•C
XI	RN1308	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XI	RN1408	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; fT200 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XJ	RN1109	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XJ	RN1109F	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XJ	RN1109FT	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	TESM	B•E•C
XJ	RN1309	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XJ	RN1409	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XK	RN1110	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XK	RN1110F	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XK	RN1110FT	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=4.7 кОм	TESM	B•E•C
XK	RN1310	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XK	RN1410	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XKs	BCR519	INF	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...630; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XL	BZX99-C2V4	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=2.28...2.52 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XLs	BCR569	INF	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...630; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XM	2SC4591	REN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=40...250; f_T>6.5 ГГц	SOT346,SC59	B•E•C
XM	2SC4593	REN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=40...250; f_T>6.5 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
XM	BZX99-C2V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=2.57...2.84 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XM	RN1111	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XM	RN1111F	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XM	RN1111FT	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=10 кОм	TESM	B•E•C
XM	RN1311	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XM	RN1411	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XMs	BCR583	INF	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>70; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XN	BZX99-C3V0	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=2.85...3.15 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XN	RN1112	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XN	RN1112F	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XN	RN1112FT	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=22 кОм	TESM	B•E•C
XN	RN1312	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XN	RN1412	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XP	BZX99-C3V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=3.14...3.47 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XP	MMBD3000T1	MOT	di	V_R<30 В; I_F<200 мА; $V_F(I_F$=10 мА)<0.95 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<3 нс	SOT346,SC59	n.c.•A•K
XP	RN1113	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XP	RN1113F	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XP	RN1113FT	TOSH	Dnpn	V_{CEO}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1=47 кОм	TESM	B•E•C





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
XP	RN1313	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XP	RN1413	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1=47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XQ	2PD602AQ	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=85...170; f_T>140 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
XQ	MMBD3005T1	MOT	di×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.95 В	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
XQ	RN1114	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XQ	RN1114F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XQ	RN1114FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	TESM	B•E•C
XQ	RN1314	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=1 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XQ	RN1414	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XQ	RN2114FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=1 кОм/10 кОм	TESM	B•E•C
XR	2PD602AR	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=120...240; f_T>160 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
XR	BZX99-C3V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=50 мкА)=3.42...3.78 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XS	2PD602AS	PHIL	npn	V_{CB0}=60 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=170...340; f_T>180 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
XS	BZX99-C3V9	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=50 мкА)=3.71...4.1 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XS	MMBD3010	MOT	di×2	V_R<30 В; I_F<200 мА; V_F(I_F=10 мА)<0.95 В; C_D<2 пФ; t_{RR}<3 нс	SOT346,SC59	A1•A2•K1,K2
XS	RN1115	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XS	RN1115F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XS	RN1115FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	TESM	B•E•C
XS	RN1315	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=2.2 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XS	RN1415	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XS	RN2115FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=2.2 кОм/10 кОм	TESM	B•E•C
XT	2SC4674	REN	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=8 мА; P_D=50 мВт; h_{21}=50...250; f_T>4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
XT	BZX99-C4V3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=50 мкА)=4.09...4.52 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XT	RN1116	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XT	RN1116F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XT	RN1116FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	TESM	B•E•C
XT	RN1316	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XT	RN1416	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XT	RN2116FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/10 кОм	TESM	B•E•C
XU	2SC4680	REN	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>100	SOT346,SC59	B•E•C
XU	BZX99-C7V5	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=50 мкА)=7.13...7.88 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XU	RN1117	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XU	RN1117F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XU	RN1117FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	TESM	B•E•C
XU	RN1317	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XU	RN1417	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XU	RN2117FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10 кОм/4.7 кОм	TESM	B•E•C
XU-	2SC4680	REN	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>100;	SOT23,SOD23	B•E•C
XUs	BCR562	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>60; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XV	BZX99-C8V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=50 мкА)=7.79...8.61 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XVs	BCR521	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>20; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XW	BZX99-C9V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=50 мкА)=8.65...9.56 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XW	RN1118	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
XW	RN1118F	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
XW	RN1118FT	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=150 мА; P_D=100 мВт; f_T>250 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	TESM	B•E•C
XW	RN1318	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
XW	RN1418	TOSH	Dnpn	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
XW	RN2118FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47 кОм/10 кОм	TESM	B•E•C
XWs	BCR505	INF	Dnpn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>70; f_T>100 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XX	BZX99-C10	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=50 мкА)=9.5...10.5 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XXs	BCR571	INF	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>20; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
XY	BZX99-C11	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=50 мкА)=10.45...11.55 В; P_D<300 мВ	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
XZ	BZX99-C12	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=50 мкА)=11.4...12.6 В; P_D<300 мВт	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
XZ-	2SC5628	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=80 мВт; h_{21}=80...160; f_T>6 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
XZ-	2SC5629	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=80 мВт; h_{21}=80...160; f_T>2 ГГц	SOT416,SC75A	B•E•C
Y1	BZX84C11	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.4...11.6 В; $I_L(V_R$=8.0 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y1	BZX84C11	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.4...11.6 В; $I_L(V_R$=8.0 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом; I_{ZM}<23 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y1	BZX84C11	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.4...11.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y1	BZX84C11LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.4...11.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y10	BZX84C27	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=25.1...28.9 В; $I_L(V_R$=21.0 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y10	BZX84C27	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=25.1...28.9 В; $I_L(V_R$=18.9 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом; I_{ZM}<9 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y10	BZX84C27	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=25.1...28.9 В; $I_L(V_R$=18.9 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y10	BZX84C27	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=25.1...28.9 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y11	BZX84C30	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=28.0...32.0 В; $I_L(V_R$=18.9 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y11	BZX84C30	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=28.0...32.0 В; $I_L(V_R$=21.0 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом; I_{ZM}<8 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y11	BZX84C30	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=28.0...32.0 В; $I_L(V_R$=21.0 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y11	BZX84C30	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=28.0...32.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y11	BZX84C30LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=28.0...32.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y12	BZX84C33	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=31.0...35.0 В; $I_L(V_R$=23.1 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y12	BZX84C33	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=31.0...35.0 В; $I_L(V_R$=23.1 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом; I_{ZM}<7 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y12	BZX84C33	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=31.0...35.0 В; $I_L(V_R$=23.1 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y12	BZX84C33	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=31.0...35.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y12	BZX84C33LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=31.0...35.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y13	BZX84C36	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=34.0...38.0 В; $I_L(V_R$=25.2 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y13	BZX84C36	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=33.0...38.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y13	BZX84C36LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=33.0...38.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y14	BZX84C39	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=37.0...41.0 В; $I_L(V_R$=27.3 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<75 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y14	BZX84C39	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=36.0...41.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<130 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y14	BZX84C39LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=36.0...41.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<130 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y15	BZX84C43	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=40.0...46.0 В; $I_L(V_R$=30.1 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<150 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y15	BZX84C43	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=40.0...46.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<150 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y15	BZX84C43LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=40.0...46.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<150 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y16	BZX84C47	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=44.0...50.0 В; $I_L(V_R$=32.9 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<170 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y16	BZX84C47	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=44.0...50.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<170 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y16	BZX84C47LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=44.0...50.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<170 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y17	BZX84C51	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=48.0...54.0 В; $I_L(V_R$=35.7 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<180 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y17	BZX84C51	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=48.0...54.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<180 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y17	BZX84C51LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=48.0...54.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2 мА)<180 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y18	BZX84C56	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=52.0...60.0 В; $I_L(V_R$=39.2 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<200 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y18	BZX84C56LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=52.0...60.0 В; $I_L(V_R$=39.2 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<200 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y19	BZX84C62	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=58.0...66.0 В; $I_L(V_R$=43.4 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<215 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y19	BZX84C62LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2 мА)=58.0...66.0 В; $I_L(V_R$=43.4 В)<50 нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0 мА)<215 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Y1p	BZX84C11	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=10.4...11.6В; $I_L(V_R$=8.0В)<100нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<20Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y1t	BZX84C11	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=10.4...11.6В; $I_L(V_R$=8.0В)<100нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<20Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y2	BZX84C12	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=11.4...12.7В; $I_L(V_R$=8.0В)<0.1мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<25Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y2	BZX84C12	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=11.4...12.7В; $I_L(V_R$=8.0В)<0.1мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<25Ом; I_{ZM}<21мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y2	BZX84C12	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=11.4...12.7В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<25Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y2	BZX84C12LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=11.4...12.7В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<25Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y20	BZX84C68	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2мА)=64.60...72.0В; $I_L(V_R$=47.6В)<50нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0мА)<240Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y21	BZX84C75	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=2мА)=70.0...79.0В; $I_L(V_R$=52.5В)<50нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=2.0мА)<255Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y2p	BZX84C12	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=11.4...12.7В; $I_L(V_R$=8.0В)<100нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<25Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y2t	BZX84C12	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=11.4...12.7В; $I_L(V_R$=8.0В)<100нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<25Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y3	BZX84C13	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=12.4...14.1В; $I_L(V_R$=8.0В)<0.1мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y3	BZX84C13	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=12.4...14.1В; $I_L(V_R$=8.0В)<0.1мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом; I_{ZM}<19мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y3	BZX84C13	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=12.4...14.1В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y3	BZX84C13LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=12.4...14.1В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y36	BZX84-C13V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=12.4...14.1В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y3p	BZX84C13	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=12.4...14.1В; $I_L(V_R$=8.0В)<100нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<30Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y3t	BZX84C13	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=12.4...14.1В; $I_L(V_R$=8.0В)<100нА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<30Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y4	BZX84C15	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=13.8...15.6В; $I_L(V_R$=10.5В)<0.05мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y4	BZX84C15	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=13.8...15.6В; $I_L(V_R$=10.5В)<0.05мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом; I_{ZM}<17мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y4	BZX84C15	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=13.8...15.6В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y4	BZX84C15LT1	MOT	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=13.8...15.6В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<30Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y4p	BZX84C15	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=13.8...15.6В; $I_L(V_R$=10.5В)<0.05мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<30Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y4t	BZX84C15	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=13.8...15.6В; $I_L(V_R$=10.5В)<0.05мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<30Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y5	BZX84C16	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=15.3...17.1В; $I_L(V_R$=11.2В)<0.05мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<40Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y5	BZX84C16	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=15.3...17.1В; $I_L(V_R$=11.2В)<0.05мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<40Ом; I_{ZM}<16мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y5	BZX84C16	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=15.3...17.1В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5мА)<40Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y50	BZX84A2V4	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=2.37...2.43В; $I_L(V_R$=1.0В)<50мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<100Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y51	BZX84A2V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=2.67...2.73В; $I_L(V_R$=1.0В)<20мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<100Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y52	BZX84A3V0	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=2.97...3.03В; $I_L(V_R$=1.0В)<10мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<95Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y53	BZX84A3V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=3.26...3.34В; $I_L(V_R$=1.0В)<5мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<95Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y54	BZX84A3V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=3.56...3.64В; $I_L(V_R$=1.0В)<5мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<90Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y55	BZX84A3V9	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=3.86...3.94В; $I_L(V_R$=1.0В)<3мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<90Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y56	BZX84A4V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=4.25...4.35В; $I_L(V_R$=1.0В)<3мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<90Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y57	BZX84A4V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=4.65...4.75В; $I_L(V_R$=2.0В)<3мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<80Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y58	BZX84A5V1	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5мА)=5.04...5.16В; $I_L(V_R$=2.0В)<2мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<60Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

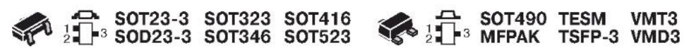
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Y59	BZX84A5V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.54...5.66 В; I_L(V_R=2.0 В)<1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y5p	BZX84C16	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.3...17.1 В; I_L(V_R=11.2 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y5t	BZX84C16	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.3...17.1 В; I_L(V_R=11.2 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y6	BZX84C18	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1 В; I_L(V_R=12.6 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<45 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y6	BZX84C18	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1 В; I_L(V_R=12.6 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<45 Ом; I_{ZM}<14 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y6	BZX84C18	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<45 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y6	BZX84C18LT1	MOT	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<45 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y60	BZX84A6V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.13...6.27 В; I_L(V_R=4.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<10 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y61	BZX84A6V8	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.73...6.87 В; I_L(V_R=4.0 В)<2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y62	BZX84A7V5	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.42...7.58 В; I_L(V_R=5.0 В)<1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y63	BZX84A8V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.11...8.29 В; I_L(V_R=5.0 В)<700 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y64	BZX84A9V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.00...9.20 В; I_L(V_R=6.0 В)<500 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y65	BZX84A10	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.9...10.1; I_L(V_R=7.0 В)<200 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<20 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y66	BZX84A11	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=10.8...11.11 В; I_L(V_R=8.0 В)<100 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<20 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y67	BZX84A12	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=11.88...12.12 В; I_L(V_R=8.0 В)<100 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<25 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y68	BZX84A13	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=12.87...13.13 В; I_L(V_R=8.0 В)<100 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y69	BZX84A15	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=14.9...152 В; I_L(V_R=10.5 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y6p	BZX84C18	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1 В; I_L(V_R=12.6 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<45 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y6t	BZX84C18	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=16.8...19.1 В; I_L(V_R=12.6 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<45 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y7	BZX84C20	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2 В; I_L(V_R=14.0 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y7	BZX84C20	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2 В; I_L(V_R=14.0 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом; I_{ZM}<12 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y7	BZX84C20	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y7	BZX84C20LT1	MOT	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y70	BZX84A16	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=15.84...16.16 В; I_L(V_R=11.2 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y71	BZX84A18	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=17.8...18.2 В; I_L(V_R=12.6 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<45 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y72	BZX84A20	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=19.8...20.2 В; I_L(V_R=14.0 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y73	BZX84A22	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=21.8...22.2 В; I_L(V_R=15.4 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y74	BZX84A24	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=23.8...24.2 В; I_L(V_R=16.8 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y75	BZX84A27	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=26.7...27.3 В; I_L(V_R=18.9 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y76	BZX84A30	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=29.7...30.3 В; I_L(V_R=21.0 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y77	BZX84A33	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=32.7...33.3 В; I_L(V_R=23.1 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y78	BZX84A36	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=35.6...36.4 В; I_L(V_R=25.2 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K




SOT23-3 SOT323 SOT416 SOD23-3 SOT346 SOT523 SOT490 TESM VMT3 MFPAK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Y79	BZX84A39	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=38.6...39.4 В; I_L(V_R=27.3 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<75 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y7p	BZX84C20	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2 В; I_L(V_R=14.0 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y7t	BZX84C20	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=18.8...21.2 В; I_L(V_R=14.0 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y8	BZX84C22	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.8...23.3 В; I_L(V_R=15.4 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y8	BZX84C22	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.8...23.3 В; I_L(V_R=15.4 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом; I_{ZM}<11 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y8	BZX84C22	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.8...23.3 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y8	BZX84C22LT1	MOT	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.8...23.3 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<55 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y80	BZX84A43	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=42.6...43.4 В; I_L(V_R=30.1 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<150 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y81	BZX84A47	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=46.5...47.5 В; I_L(V_R=32.9 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<170 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y82	BZX84A51	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=50.5...51.5 В; I_L(V_R=35.7 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<180 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y83	BZX84A56	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=55.4...56.6 В; I_L(V_R=39.2 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<200 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y84	BZX84A62	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=61.4...62.6 В; I_L(V_R=43.4 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<215 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y85	BZX84A68	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=67.3...68.7 В; I_L(V_R=47.6 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<240 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y86	BZX84A75	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2 мА)=74.3...75.7 В; I_L(V_R=52.5 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<255 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y8p	BZX84C22	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.8...23.3 В; I_L(V_R=15.4 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y8t	BZX84C22	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=20.8...23.3 В; I_L(V_R=15.4 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y9	BZX84C24	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.8...25.6 В; I_L(V_R=16.8 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<70 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y9	BZX84C24	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.8...25.6 В; I_L(V_R=16.8 В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<70 Ом; I_{ZM}<10 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y9	BZX84C24	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.8...25.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<70 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y9	BZX84C24LT1	MOT	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.8...25.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<70 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y9p	BZX84C24	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.8...25.6 В; I_L(V_R=16.8 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Y9t	BZX84C24	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=22.8...25.6 В; I_L(V_R=16.8 В)<50 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=250 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
YA	RN2101	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YA	RN2101F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YA	RN2101FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	TESM	B•E•C
YA	RN2301	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YA	RN2401	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YA-	2SC4784	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=20 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=50...250; f_T>7 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
YA-	2SC5049	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=20 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...250; f_T>7 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
YA-	2SC5543	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=20 мА; P_D=80 мВт; h_{21}=85...170; f_T>5.5 ГГц	SC81,MFPAK	C•B•E
YB	RN2102	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YB	RN2102F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YB	RN2102FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	TESM	B•E•C
YB	RN2302	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YB	RN2402	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YBs	BSS84	INF	pMOS	V_{DS}=50 В; I_D=130 мА; P_D=360 мВт; g_F=50 мСм; $R_{DS(on)}$=10 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
YC	RN2103	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YC	RN2103F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YC	RN2103FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	TESM	B•E•C
YC	RN2303	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=22 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
YC	RN2403	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=22/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YD	RN2104	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YD	RN2104F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YD	RN2104FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	TESM	B•E•C
YD	RN2304	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YD	RN2404	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YE	RN2105	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YE	RN2105F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YE	RN2105FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	TESM	B•E•C
YE	RN2305	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=2.2 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YE	RN2405	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=2.2/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YF	RN2106	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YF	RN2106F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YF	RN2106FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	TESM	B•E•C
YF	RN2306	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YF	RN2406	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YH	RN2107	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YH	RN2107F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YH	RN2107FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	TESM	B•E•C
YH	RN2307	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YH	RN2407	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YH-	2SC4899	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=20 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=50...250; f_T>6 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
YI	RN2108	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YI	RN2108F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YI	RN2108FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	TESM	B•E•C
YI	RN2308	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=22 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YI	RN2408	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=22/47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YJ	RN2109	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YJ	RN2109F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YJ	RN2109FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	TESM	B•E•C
YJ	RN2309	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47 кОм/22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YJ	RN2409	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47/22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YK	RN2110	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YK	RN2110F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YK	RN2110FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=4.7 кОм	TESM	B•E•C
YK	RN2310	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YK	RN2410	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=20 МГц; R_1=4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YK-	2SC4901	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...250; f_T>6 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
YL-	2SC4902	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...250; f_T>4 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
YL-	2SC4903	REN	npn	V_{CB0}=20 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...250; f_T>4 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
YM	RN2111	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1=10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YM	RN2111F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=10 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YM	RN2111FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=10 кОм	TESM	B•E•C
YM	RN2311	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1=10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YM	RN2411	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1=10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YN	RN2112	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1=22 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YN	RN2112F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=22 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YN	RN2112FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=22 кОм	TESM	B•E•C
YN	RN2312	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1=22 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YN	RN2412	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1=22 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YP	2SD1484KP	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
YP	2SD1949P	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=82...180; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C



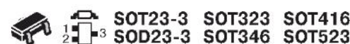


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
YP	RN2113	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1=47 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YP	RN2113F	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
YP	RN2113FT	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1=47 кОм	TESM	B•E•C
YP	RN2313	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1=47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YP	RN2413	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1=47 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YQ	2SD1484KQ	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
YQ	2SD1949Q	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
YQ	RN2114	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=1 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YQ	RN2314	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=1 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YQ	RN2414	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YR	2SD1484KR	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>250 МГц	SOT346,SC59	B•E•C
YR	2SD1949R	ROHM	npn	V_{CB0}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>250 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
YR	MSD601R	MOT	npn	V_{CB0}=25 В	SOT346,SC59	B•E•C
YS	MSD601S	MOT	npn	V_{CB0}=25 В	SOT346,SC59	B•E•C
YS	RN2115	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=2.2 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YS	RN2315	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=2.2 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YS	RN2415	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=2.2/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YT	RN2116	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YT	RN2316	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YT	RN2416	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=4.7/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YU	RN2117	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10 кОм/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YU	RN2317	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10 кОм/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YU	RN2417	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YV-	2SC4964	REN	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=100...600	SOT23,SOD23	B•E•C
YV-	2SC4965	REN	npn	V_{CB0}=12 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=100...600	SOT323,SC70	B•E•C
YW	RN2118	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
YW	RN2318	TOSH	Dpnp	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
YW	RN2418	TOSH	Dpnp	V_{CE0}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=47/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
YY1	CMPZDA11V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=10.4...11.6 В; $I_L(V_R$=8.0 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<20 Ом; I_{ZM}=15 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YY2	CMPZDA12V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=11.4...12.7 В; $I_L(V_R$=8.0 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<25 Ом; I_{ZM}=13 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YY3	CMPZDA13V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=12.4...14.1 В; $I_L(V_R$=8.0 В)<0.1 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=12 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YY4	CMPZDA15V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=13.8...15.6 В; $I_L(V_R$=10.5 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=11 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YY5	CMPZDA16V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=15.3...17.1 В; $I_L(V_R$=11.2 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=10 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YY6	CMPZDA18V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=16.8...19.1 В; $I_L(V_R$=12.6 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<45 Ом; I_{ZM}=9.2 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YY7	CMPZDA20V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=18.8...21.2 В; $I_L(V_R$=14.0 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=8.3 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YY8	CMPZDA22V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=20.8...23.3 В; $I_L(V_R$=15.4 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=7.6 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YY9	CMPZDA24V	CSI	dz×2	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=22.8...25.6 В; $I_L(V_R$=16.8 В)<0.05 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0 мА)<70 Ом; I_{ZM}=7.0 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
YZ-	2SC5050	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=50...250; f_T>8 ГГц	SOT23,SOD23	B•E•C
YZ-	2SC5051	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=100 мВт; h_{21}=50...250; f_T>8 ГГц	SOT323,SC70	B•E•C
YZ-	2SC5544	REN	npn	V_{CB0}=15 В; I_C=50 мА; P_D=80 мВт; h_{21}=85...170; f_T>3 ГГц	SC81,MFPAK	C•B•E
Z0	SST310	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=24...60 мА; g_F=10 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
Z1	BZX84C4V7	ALLEG	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.4...5.0 В; $I_L(V_R$=2.0 В)<3.0 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z1	BZX84C4V7	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.4...5.0 В; $I_L(V_R$=2.0 В)<3.0 мкА; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<80 Ом; I_{ZM}<53 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z1	BZX84C4V7	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5 мА)=4.4...5.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Z1	BZX84C4V7LT1	MOT	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.4...5.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<80 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z1	RN2357	TOSH	Dpnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_1/R_2=10 кОм/47 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
Z1	SSTJ211	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>7 мА; g_F>6 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
Z11	BZX84C2V4	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.2...2.6 В; I_L(V_R=1.0 В)<50 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z11	BZX84C2V4LT1	MOT	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.2...2.6 В; I_L(V_R=1.0 В)<50 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z12	BZX84C2V7	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.5...2.9 В; I_L(V_R=1.0 В)<20 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z12	BZX84C2V7	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.51...2.89 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z13	BZX84C3V0	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.8...3.2 В; I_L(V_R=1.0 В)<10 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<95 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z13	BZX84C3V0	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.8...3.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z13	BZX84-C3V0LT1	MOT	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=2.8...3.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z14	BZX84C3V3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=3.1...3.5 В; I_L(V_R=1.0 В)<5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<95 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z14	BZX84C3V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.1...3.5 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z15	BZX84C3V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=3.4...3.8 В; I_L(V_R=1.0 В)<5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z15	BZX84C3V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.4...3.8 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<95 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z16	BZX84C3V9	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=3.7...4.1 В; I_L(V_R=1.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z16	BZX84C3V9	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.7...4.1 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z17	BZX84C4V3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=4.0...4.6 В; I_L(V_R=1.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z17	BZX84C4V3	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.0...4.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<90 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z1A	BC846A	ZETEX	npn	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z1E	BC847A	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=110...220; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z1L	BC848C	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z1p	BZX84C4V7	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=4.4...5.0 В; I_L(V_R=2.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z1t	BZX84C4V7	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=4.4...5.0 В; I_L(V_R=2.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z2	BZX84C5V1	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.8...5.4 В; I_L(V_R=2.0 В)<2.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<60 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z2	BZX84C5V1	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.8...5.4 В; I_L(V_R=2.0 В)<2.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<60 Ом; I_{ZM}<49 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z2	BZX84C5V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.8...5.4 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<60 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z2	SSTJ212	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}>15 мА; g_F>7 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
Z21	DTC113ZE	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
Z21	DTC113ZKA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
Z21	DTC113ZUA	ROHM	Dnpn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}>33; f_T>250 МГц; R_1/R_2=1/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
Z2G	BC850C	ZETEX	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z2p	BZX84C5V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=4.8...5.4 В; I_L(V_R=2.0 В)<2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<60 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z2t	BZX84C5V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=4.8...5.4 В; I_L(V_R=2.0 В)<2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<60 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z2U	FMMTA63	ZETEX	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=10000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z2V	FMMTA64	ZETEX	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=20000; f_T>125 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z3	BZX84C5V6	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.2...6.0 В; I_L(V_R=2.0 В)<1.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z3	BZX84C5V6	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.2...6.0 В; I_L(V_R=2.0 В)<1.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом; I_{ZM}<45 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z3	BZX84C5V6	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.2...6.0 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z3B	BC856B	ZETEX	pnp	V_{CBO}=80 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z3E	BC857A	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T>150 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z3p	BZX84C5V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=5.2...6.0 В; I_L(V_R=2.0 В)<1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Z3t	BZX84C5V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=5.2...6.0 В; I_L(V_R=2.0 В)<1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z4	BZX84C6V2	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.8...6.6 В; I_L(V_R=4.0 В)<3.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z4	BZX84C6V2	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.8...6.6 В; I_L(V_R=4.0 В)<3.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом; I_{ZM}<40 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z4	BZX84C6V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.8...6.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z4A	BC859A	ZETEX	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z4C	BC859C	ZETEX	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z4E	BC860A	ZETEX	pnp	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
Z4p	BZX84C6V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=5.8...6.6 В; I_L(V_R=4.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<10 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z4t	BZX84C6V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5.0 мА)=5.8...6.6 В; I_L(V_R=4.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<10 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z5	BZX84C6V8	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.4...7.2 В; I_L(V_R=4.0 В)<2.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z5	BZX84C6V8	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.4...7.2 В; I_L(V_R=4.0 В)<2.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом; I_{ZM}<37 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z5	BZX84C6V8	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.4...7.2 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z50	BZX84B2V4	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.4...2.5 В; I_L(V_R=1.0 В)<50 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z51	BZX84B2V7	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.68...2.75 В; I_L(V_R=1.0 В)<20 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<100 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z52	BZX84B3V0	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=2.94...3.06 В; I_L(V_R=1.0 В)<10 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<95 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z53	BZX84B3V3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.23...3.37 В; I_L(V_R=1.0 В)<5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<95 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z54	BZX84B3V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.53...3.67 В; I_L(V_R=1.0 В)<5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z55	BZX84B3V9	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=3.82...3.98 В; I_L(V_R=1.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z56	BZX84B4V3	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.21...4.39 В; I_L(V_R=1.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z57	BZX84B4V7	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.61...4.79 В; I_L(V_R=2.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z58	BZX84B5V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.00...5.20 В; I_L(V_R=2.0 В)<2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<60 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z59	BZX84B5V6	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.49...5.71 В; I_L(V_R=2.0 В)<1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z5p	BZX84C6V8	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.4...7.2 В; I_L(V_R=4.0 В)<2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z5t	BZX84C6V8	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.4...7.2 В; I_L(V_R=4.0 В)<2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z6	BZX84C7V5	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.0...7.9 В; I_L(V_R=5.0 В)<1.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z6	BZX84C7V5	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.0...7.9 В; I_L(V_R=5.0 В)<1.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом; I_{ZM}<33 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z6	BZX84C7V5	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.0...7.9 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z60	BZX84B6V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.08...6.32 В; I_L(V_R=4.0 В)<3 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<10 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z61	BZX84B6V8	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.66...6.94 В; I_L(V_R=4.0 В)<2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z62	BZX84B7V5	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.35...7.65 В; I_L(V_R=5.0 В)<1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z63	BZX84B8V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.04...8.36 В; I_L(V_R=5.0 В)<700 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z64	BZX84B9V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.92...9.28 В; I_L(V_R=6.0 В)<500 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z65	BZX84B10	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.8...10.2; I_L(V_R=7.0 В)<200 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<20 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Z66	BZX84B11	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=10.8...11.2В; I_L(V_R=8.0В)<100нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<20 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z67	BZX84B12	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=11.8...12.2В; I_L(V_R=8.0В)<100нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<25 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z68	BZX84B13	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=12.7...13.3В; I_L(V_R=8.0В)<100нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z69	BZX84B15	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=14.7...15.3В; I_L(V_R=10.5В)<0.05 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z6p	BZX84C7V5	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=7.0...7.9В; I_L(V_R=5.0В)<1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z6t	BZX84C7V5	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=7.0...7.9В; I_L(V_R=5.0В)<1 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z7	BZX84C8V2	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=7.7...8.7В; I_L(V_R=5.0В)<0.7 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z7	BZX84C8V2	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=7.7...8.9В; I_L(V_R=5.0В)<0.7 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5мА)<15 Ом; I_{ZM}<30 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z7	BZX84C8V2	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=7.7...8.9В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z70	BZX84B16	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=15.7...16.3В; I_L(V_R=11.2В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<40 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z71	BZX84B18	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=17.6...18.4В; I_L(V_R=12.6В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<45 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z72	BZX84B20	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=19.6...20.4В; I_L(V_R=14.0В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z73	BZX84B22	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=21.6...22.4В; I_L(V_R=15.4В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<55 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z74	BZX84B24	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=23.5...24.5В; I_L(V_R=16.8В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<30 Ом; I_{ZM}=250мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z75	BZX84B27	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=26.5...27.5В; I_L(V_R=18.9В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z76	BZX84B30	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=29.4...30.6В; I_L(V_R=21.0В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z77	BZX84B33	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=32.3...33.7В; I_L(V_R=23.1В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<80 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z78	BZX84B36	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=35.3...36.7В; I_L(V_R=25.2В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<90 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z79	BZX84B39	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=38.2...39.8В; I_L(V_R=27.3В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0 мА)<75 Ом; I_{ZM}=250мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z7p	BZX84C8V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=7.7...8.7В; I_L(V_R=5.0В)<700нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z7t	BZX84C8V2	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=7.7...8.7В; I_L(V_R=5.0В)<700нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z8	BZX84C9V1	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=8.5...9.6В; I_L(V_R=6.0В)<0.5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z8	BZX84C9V1	CSI	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=8.5...9.6В; I_L(V_R=6.0В)<0.5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5мА)<15 Ом; I_{ZM}<27 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z8	BZX84C9V1	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5мА)=8.5...9.6В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5мА)<15 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z8	SST308	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=12...60мА; g_F=8мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
Z80	BZX84B43	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=42.1...43.9В; I_L(V_R=30.1В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2мА)<150 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z81	BZX84B47	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=46.1...47.9В; I_L(V_R=32.9В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2мА)<170 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z82	BZX84B51	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=50.0...52.0В; I_L(V_R=35.7В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2мА)<180 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z83	BZX84B56	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=54.9...57.1В; I_L(V_R=39.2В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2мА)<200 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z84	BZX84B62	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=60.8...63.2В; I_L(V_R=43.4В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2мА)<215 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z85	BZX84B68	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=66.6...69.4В; I_L(V_R=47.6В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2мА)<240 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z86	BZX84B75	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=2мА)=73.5...76.5В; I_L(V_R=52.5В)<50нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=2мА)<255 Ом; I_{ZM}=200мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Z8p	BZX84C9V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.5...9.6 В; I_L(V_R=6.0 В)<500 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z8t	BZX84C9V1	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.5...9.6 В; I_L(V_R=6.0 В)<500 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z9	BZX84C10	ALLEG	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6 В; I_L(V_R=7.0 В)<0.2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z9	BZX84C10	VISH	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6 В; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z9	SST309	SIL	nFET	V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=12...30 мА; g_F=10 мСм	SOT23,SOD23	D•S•G
Z9p	BZX84C10	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6; I_L(V_R=7.0 В)<200 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<20 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z9t	BZX84C10	PHIL	dz	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6; I_L(V_R=7.0 В)<200 нА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0 мА)<20 Ом; I_{ZM}=200 мА	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ZA6	FMMD2838	ZETEX	fid×2	V_R<75 В; I_F<100 мА; V_F(I_F=50 мА)<1.0 В; I_R<0.1 мкА; C_D<4.0 пФ; t_{RR}<6 нс	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
ZB	FMMT4123	ZETEX	npn	V_{CBO}=40 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...150; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZC	FMMT4124	ZETEX	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=120...360; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZC	KST4124	SAMS	npn	V_{CBO}=30 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=120...360; f_T>300 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZCA	KN3904S	KEC	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт	SOT23,SOD23	B•E•C
ZD	FMMT4125	ZETEX	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=50...150; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZD	KST4125	SAMS	pnp	V_{CBO}=30 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт; h_{21}=50...150; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZE	FMMT4126	ZETEX	pnp	V_{CBO}=25 В; I_C=200 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>60; f_T>250 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZFD	BCV26	ZETEX	dpnp	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>100; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZFE	BCV46	ZETEX	dpnp	V_{CBO}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>400; f_T>200 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZFF	BCV27	ZETEX	dnpn	V_{CBO}=40 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>100; f_T>170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZFG	BCV47	ZETEX	dnpn	V_{CBO}=80 В; I_C=500 мА; P_D=330 мВт; h_{21}>400; f_T>170 МГц	SOT23,SOD23	B•E•C
ZK-	2SJ451	REN	pMOS	V_{DS}=20 В; I_D=200 мА; P_D=150 мВт; $R_{DS(on)}$<9 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
ZM-	2SJ452	REN	pMOS	V_{DS}=50 В; I_D=200 мА; P_D=150 мВт; $R_{DS(on)}$<12 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
ZQ	2PC4081Q	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=120...270; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ZR	2PC4081R	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=180...390; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ZR	MSD1819ART1	MOT	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=210...340	SOT323,SC70	B•E•C
ZRA	KN3903S	KEC	npn	V_{CBO}=60 В; I_C=200 мА; P_D=350 мВт	SOT23,SOD23	B•E•C
ZS	2PC4081S	PHIL	npn	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=270...560; f_T>100 МГц	SOT323,SC70	B•E•C
ZS-	2SC5702	REN	npn	V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=80 мВт; h_{21}=80...160; f_T>6.5 ГГц	SC81,MFPAK	B•E•C
ZS1	ZHCS1000	ZETEX	shd	V_R<40 В; I_F<1 А; V_F(I_F=1 А)<0.425 В; I_R<100 мкА; C_D<25 пФ; t_{RR}<12 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ZS5	ZHCS500	ZETEX	shd	V_R<40 В; I_F<0.5 А; V_F(I_F=0.5 А)<0.55 В; I_R<40 мкА; C_D<20 пФ; t_{RR}<10 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ZS7	ZHCS750	ZETEX	shd	V_R<40 В; I_F<0.75 А; V_F(I_F=0.75 А)<0.49 В; I_R<0.1 мкА; C_D<25 пФ; t_{RR}<12 нс	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ZU-	2SJ486	REN	pMOS	V_{DS}=30 В; I_D=300 мА; P_D=150 мВт; $R_{DS(on)}$<1.2 Ом	SOT23,SOD23	G•S•D
ZZ1	CMPZDA4V7	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.4...5.0 В; I_L(V_R=2.0 В)<3.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<80 Ом; I_{ZM}=38 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ2	CMPZDA5V1	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=4.8...5.4 В; I_L(V_R=2.0 В)<2.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<60 Ом; I_{ZM}=35 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ3	CMPZDA5V6	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.2...6.0 В; I_L(V_R=2.0 В)<1.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<40 Ом; I_{ZM}=32 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ4	CMPZDA6V2	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=5.8...6.6 В; I_L(V_R=4.0 В)<3.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<10 Ом; I_{ZM}=28 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ5	CMPZDA6V8	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=6.4...7.2 В; I_L(V_R=4.0 В)<2.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом; I_{ZM}=25 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ6	CMPZDA7V5	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.0...7.9 В; I_L(V_R=5.0 В)<1.0 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом; I_{ZM}=23 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ7	CMPZDA8V2	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=7.7...8.7 В; I_L(V_R=5.0 В)<0.7 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом; I_{ZM}=21 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ8	CMPZDA9V1	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=8.5...9.6 В; I_L(V_R=6.0 В)<0.5 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<15 Ом; I_{ZM}=18 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ9	CMPZDA10V	CSI	dz×2	V_Z(I_{ZT}=5 мА)=9.4...10.6 В; I_L(V_R=7.0 В)<0.2 мкА; Z_{ZT}(I_{ZT}=5 мА)<20 Ом; I_{ZM}=16 мА	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
	2SA1666	REN	pnp	V_{CEO}=15 В; I_C=200 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=20...200; f_T=100 МГц	SOT346,SC59	B•E•C

SOT89/223, TO252/263…

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
21	Gali-21	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…8 ГГц; GAIN = 14 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
33	Gali-33	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…4 ГГц; GAIN = 19 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
51	Gali-51	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…4 ГГц; GAIN = 18 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
52	Gali-52	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…2 ГГц; GAIN = 23 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
55	Gali-55	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…4 ГГц; GAIN = 21 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
651	PZT651	ON	npn	V_{CBO} = 80 В; I_C = 2 А; P_D = 0.8 Вт; h_{21} > 40; f_T > 75 МГц	SOT-223, TO-261AA	B • C • E • C
720	BF720	STM	npn	V_{CB} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 50; f_T = 60 МГц	SOT-223, TO-261AA	B • C • E • C
721	BF721	STM	pnp	V_{CB} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 50; f_T = 60 МГц	SOT-223, TO-261AA	B • C • E • C
—	BCX68	SIEM	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85…375; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
—	BCX69	SIEM	pnp	V_{CBO} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85…375; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
01	Gali-1	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…8 ГГц; GAIN = 12 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
02	Gali-2	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…8 ГГц; GAIN = 16 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
03	Gali-3	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…3 ГГц; GAIN = 22 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
04	Gali-4	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…4 ГГц; GAIN = 17.5 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
05	Gali-4	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…4 ГГц; GAIN = 18 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
06	Gali-6	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0…4 ГГц; GAIN = 11 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
0C	MC78LC30HT1	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5…12 В; V_{OUT} = 3.0 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT-89, SC-62	GND • VIN • VOUT • VIN
0D	MC78LC40HT1	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5…12 В; V_{OUT} = 4.0 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT-89, SC-62	GND • VIN • VOUT • VIN
0E	MC78LC50HT1	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5…12 В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT-89, SC-62	GND • VIN • VOUT • VIN
10Y	BZV49C10	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 9.4…10.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 20 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
1117	LT1117CST	LT	reg	LDO; V_{IN} < 15 В; V_{REF} = 1.25 В; I_{OUT} = 800 мА	SOT-223, TO-261AA	ADJ/GND • OUT • IN • OUT
11172	LT1117CST-2.85	LT	reg	LDO; V_{IN} < 15 В; V_{OUT} = 2.85 В; I_{OUT} = 800 мА	SOT-223, TO-261AA	ADJ/GND • OUT • IN • OUT
11173	LT1117CST-3.3	LT	reg	LDO; V_{IN} < 15 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 800 мА	SOT-223, TO-261AA	ADJ/GND • OUT • IN • OUT


SOT89
SC62

SOT223
TO261A

TO252
DPAK

TO263
D2PAK

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
11175	LT1117CST-5	LT	reg	LDO; V_{IN} < 15 В; V_{OUT} = 5В; I_{OUT} = 800 мА	SOT-223, TO-261AA	ADJ/GND • OUT • IN • OUT
111825	LT1118CST-2.5	LT	reg	LDO; V_{IN} < 15 В; V_{OUT} = 2.5В; I_{OUT} = 800 мА	SOT-223, TO-261AA	OUT • GND • IN • GND
111828	LT1118CST-2.85	LT	reg	LDO; V_{IN} < 15 В; V_{OUT} = 2.85В; I_{OUT} = 800 мА	SOT-223, TO-261AA	OUT • GND • IN • GND
11185	LT1118CST-5	LT	reg	LDO; V_{IN} < 15 В; V_{OUT} = 5В; I_{OUT} = 800 мА	SOT-223, TO-261AA	OUT • GND • IN • GND
11Y	BZV49C11	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 20 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
12Y	BZV49C12	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 11.4...12.7 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 25 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
13Y	BZV49C13	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 12.4...14.1 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 30 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
15Y	BZV49C15	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 13.8...15.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 30 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
16Y	BZV49C16	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 15.3...17.1 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 40 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
18Y	BZV49C18	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 16.8...19.1 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 45 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
1A	SXT3904	SIEM	npn	V_{CB0} = 40В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 300 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1D	SXTA42	SIEM	npn	V_{CB0} = 300В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1E	SXTA43	SIEM	npn	V_{CB0} = 200В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1XP	2SB1599P	PAN	pnp	V_{CB0} = 50В; I_C = 3 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 50...100; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1XQ	2SB1599Q	PAN	pnp	V_{CB0} = 50В; I_C = 3 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 80...160; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1XR	2SB1599R	PAN	pnp	V_{CB0} = 50В; I_C = 3 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...220; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1YQ	2SD2457Q	PAN	npn	V_{CB0} = 50В; I_C = 1.5 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 80...160; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1YR	2SD2457R	PAN	npn	V_{CB0} = 50В; I_C = 1.5 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 120...220; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1ZQ	2SA1890Q	PAN	pnp	V_{CB0} = 80В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 120...240; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1ZR	2SA1890R	PAN	pnp	V_{CB0} = 80В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 170...340; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
20Y	BZV49C20	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 18.8...21.2 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 55 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
22Y	BZV49C22	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 20.8...23.3 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 55 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
24Y	BZV49C24	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 22.8...25.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 70 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
27Y	BZV49C27	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 25.1...28.9 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 80 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
2A	SXT3906	SIEM	pnp	V_{CB0} = 40В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2AR	2SC5026R	PAN	npn	V_{CB0} = 80В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 120...240; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2AS	2SC5026S	PAN	npn	V_{CB0} = 80В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 170...340; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2D	SXTA92	SIEM	pnp	V_{CB0} = 300В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 25; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2E	SXTA93	SIEM	pnp	V_{CB0} = 200В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 25; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2ER	2SD2459R	PAN	npn	V_{CB0} = 150В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 120...240; f_T = 90 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2ES	2SD2459S	PAN	npn	V_{CB0} = 150В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 170...340; f_T = 90 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2F	2SB1612	PAN	pnp	V_{CB0} = 10В; I_C = 2 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 200...800; f_T = 60 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2F	SXT2907A	SIEM	pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2I	2SD2474	PAN	npn	V_{CB0} = 10В; I_C = 2 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 200...800; f_T = 180 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2P	SXT2222A	SIEM	npn	V_{CB0} = 75В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 300 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2Y4	BZV49C2V4	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 2.2...2.6В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 100 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
2Y7	BZV49C2V7	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 2.5...2.9В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 100 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
30Y	BZV49C30	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 28.0...32.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 80 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K


TO263
D2PAK


TO252
DPAK


SOT223
TO261A


SOT89
SC62

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
33Y	BZV49C33	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 31.0...35.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 80$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
36Y	BZV49C36	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 34.0...38.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 90$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
37518	MC33375ST-1.8	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...13$ В; $V_{OUT} = 1.8$ В; $I_{OUT} = 300$ мА	SOT-223, TO-261AA	IN • ON/OFF • OUT • GND
37525	MC33375ST-2.5	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...13$ В; $V_{OUT} = 2.5$ В; $I_{OUT} = 300$ мА	SOT-223, TO-261AA	IN • ON/OFF • OUT • GND
37530	MC33375ST-3.0	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...13$ В; $V_{OUT} = 3.0$ В; $I_{OUT} = 300$ мА	SOT-223, TO-261AA	IN • ON/OFF • OUT • GND
37533	MC33375ST-3.3	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...13$ В; $V_{OUT} = 3.3$ В; $I_{OUT} = 300$ мА	SOT-223, TO-261AA	IN • ON/OFF • OUT • GND
37550	MC33375ST-5.0	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...13$ В; $V_{OUT} = 5.0$ В; $I_{OUT} = 300$ мА	SOT-223, TO-261AA	IN • ON/OFF • OUT • GND
39Y	BZV49C39	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 37.0...41.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 130$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
3C	MC78LC33HT1	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12$ В; $V_{OUT} = 3.3$ В; $I_{OUT} = 50$ мА	SOT-89, SC-62	GND • VIN • VOUT • VIN
3Y0	BZV49C3V0	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0$ мА$) = 2.8...3.2$В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА$) < 95$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
3Y3	BZV49C3V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0$ мА$) = 3.1...3.5$В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА$) < 95$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
3Y6	BZV49C3V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0$ мА$) = 3.4...3.8$В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА$) < 90$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
3Y9	BZV49C3V9	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0$ мА$) = 3.7...4.1$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА$) < 90$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
43Y	BZV49C43	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 40.0...46.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 150$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
47Y	BZV49C47	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 44.0...50.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 170$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
4F	Gali-4F	MC	amp	InGaP; $f_{BD} = 0...4$ ГГц; GAIN = 15 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
4Y3	BZV49C4V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0$ мА$) = 4.0...4.6$В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА$) < 90$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
4Y7	BZV49C4V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0$ мА$) = 4.4...5.0$В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА$) < 80$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
51Y	BZV49C51	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 48.0...54.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 180$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
56Y	BZV49C56	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 52.0...60.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 200$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
5F	Gali-5F	MC	amp	InGaP; $f_{BD} = 0...4$ ГГц; GAIN = 20 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
5Y1	BZV49C5V1	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0$ мА$) = 4.8...5.4$В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА$) < 60$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
5Y6	BZV49C5V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0$ мА$) = 5.2...6.0$В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА$) < 40$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
62Y	BZV49C62	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 58.0...66.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 215$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
68Y	BZV49C68	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT} = 2.0$ мА$) = 64.0...72.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 2.0$ мА$) < 240$ Ом; $I_{ZM} = 250$ мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
6A	KIA7019AF	KEC	vd	$V_{RG} = 1.9$ В; VCC (max) = 15В; $P_D = 500$ мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6B	KIA7021AF	KEC	vd	$V_{RG} = 2.1$ В; VCC (max) = 15В; $P_D = 500$ мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND

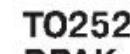

SOT89 SC62

SOT223 TO261A

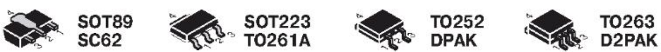

TO252 DPAK

TO263 D2PAK

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
6C	KIA7023AF	KEC	vd	V_{RG} = 2.3 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6D	KIA7025AF	KEC	vd	V_{RG} = 2.5 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6E	KIA7027AF	KEC	vd	V_{RG} = 2.7 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6F	Gali-6F	MC	amp	InGaP; f_{BD} = 0...4 ГГц; GAIN = 12 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
6F	KIA7029AF	KEC	vd	V_{RG} = 2.9 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6G	KIA7031AF	KEC	vd	V_{RG} = 3.1 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6H	KIA7032AF	KEC	vd	V_{RG} = 3.2 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6J	KIA7033AF	KEC	vd	V_{RG} = 3.3 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6K	KIA7034AF	KEC	vd	V_{RG} = 3.4 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6L	KIA7035AF	KEC	vd	V_{RG} = 3.5 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6M	KIA7036AF	KEC	vd	V_{RG} = 3.6 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6N	KIA7039AF	KEC	vd	V_{RG} = 3.9 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6P	KIA7042AF	KEC	vd	V_{RG} = 4.2 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6R	KIA7045AF	KEC	vd	V_{RG} = 4.5 В; VCC (max) = 15 В; P_D = 500 мВт	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6Y2	BZV49C6V2	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 5.8...6.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 10 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
6Y8	BZV49C6V8	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 6.4...7.2 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 15 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
75Y	BZV49C75	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 70.0...79.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 255 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
7Y5	BZV49C7V5	PHIL	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 7.0...7.9 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 15 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
8A	NJM78L02A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...30 В; V_{OUT} = 2.6 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8B	NJM78L03A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...30 В; V_{OUT} = 3.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8C	NJM78L05A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...30 В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8E	NJM78L06A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...30 В; V_{OUT} = 6.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8F	NJM78L07A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...30 В; V_{OUT} = 7.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8G	NJM78L08A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...30 В; V_{OUT} = 8.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8H	NJM78L09A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...30 В; V_{OUT} = 9.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8J	NJM78L10A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...35 В; V_{OUT} = 10.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8K	NJM78L12A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...35 В; V_{OUT} = 12.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8L	NJM78L15A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...35 В; V_{OUT} = 15.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8M	NJM78L18A	NJR	reg	V_{IN} = 2.5...40 В; V_{OUT} = 18.0 В; I_{OUT} = 100 мА	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND

TO263 D2PAK   TO252 DPAK  SOT223 TO261A  SOT89 SC62 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
8N	NJM78L20A	NJR	reg	V_{IN}=2.5...40В; V_{OUT}=20.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	OUT•GND• IN•GND
8P	NJM78L24A	NJR	reg	V_{IN}=2.5...40В; V_{OUT}=24.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	OUT•GND• IN•GND
8Y2	BZV49C8V2	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5.0мА)=7.7...8.7В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<15Ом; I_{ZM}=250мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
8Z	NJM78L62A	NJR	reg	V_{IN}=2.5...30В; V_{OUT}=6.2В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	OUT•GND• IN•GND
9B	NJM79L03UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-30В; V_{OUT}=-3.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9C	NJM79L05UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-30В; V_{OUT}=-5.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9E	NJM79L06UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-30В; V_{OUT}=-5.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9G	NJM79L08UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-30В; V_{OUT}=-8.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9H	NJM79L09UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-30В; V_{OUT}=-8.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9K	NJM79L12UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-35В; V_{OUT}=-12.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9L	NJM79L15UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-35В; V_{OUT}=-15.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9M	NJM79L18UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-40В; V_{OUT}=-18.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9P	NJM79L24UA	NJR	reg	V_{IN}=-2.5...-40В; V_{OUT}=-24.0В; I_{OUT}=100мА	SOT-89, SC-62	GND•IN• OUT•IN
9Y1	BZV49C9V1	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}$=5.0мА)=8.5...9.6В; $Z_{ZT}(I_{ZT}$=5.0мА)<15Ом; I_{ZM}=250мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
A27	PXTA27	PHIL	npn	V_{CBO}=60В; I_C=500мА; P_D=1Вт; h_{21}>100; f_T>125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AA	BCX51	PHIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=40...250; f_T=50МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AA	BCX51	SIEM	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=40...250; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AB	BCX516	PHIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=40...100; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AC	2SA1690	ROHM	pnp	V_{CBO}=400В; I_C=100мА; P_D=2Вт; h_{21}=56...270	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AC	BCX51-10	PHIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=63...160; f_T=50МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AC	BCX51-10	SIEM	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=63...160; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AD	BCX5116	PHIL	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=100...250; f_T=50МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AD	BCX5116	SIEM	pnp	V_{CBO}=45В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=100...250; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AE	BCX52	PHIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=40...250; f_T=50МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AE	BCX52	SIEM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=40...250; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AEP	2SB1424	ROHM	pnp	V_{CBO}=20В; I_C=3А; P_D=500мВт; h_{21}=82...180; f_T>240МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AEQ	2SB1424	ROHM	pnp	V_{CBO}=20В; I_C=3А; P_D=500мВт; h_{21}=120...270; f_T>240МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AER	2SB1424	ROHM	pnp	V_{CBO}=20В; I_C=3А; P_D=500мВт; h_{21}=180...390; f_T>240МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AF	2SA1575	SANYO	pnp	V_{CBO}=200В; I_C=100мА; P_D=500мВт; h_{21}=40...320; fT=400МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AF	BCX5206	PHIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=1А; h_{21}=40...100; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AF	BCX526	SIEM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=40...100; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AG	BCX5210	PHIL	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=63...160; f_T=50МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AG	BCX5210	SIEM	pnp	V_{CBO}=60В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=63...160; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AGP	2SA1797	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=2А; P_D=500мВт; h_{21}=82...180; f_T>200МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AGQ	2SA1797	ROHM	pnp	V_{CBO}=50В; I_C=2А; P_D=500мВт; h_{21}=120...270; f_T>200МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AH	BCP53	ON	pnp	V_{CEO}=80В; I_C=1.5А; P_D=1.5Вт; h_{21}=40...250; f_T=50МГц	SOT-223, TO-261AA	E•C•B•C
AH	BCX53	PHIL	pnp	V_{CBO}=100В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=40...250; f_T=50МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AH	BCX53	SIEM	pnp	V_{CBO}=80В; I_C=1А; P_D=1Вт; h_{21}=40...250; f_T=125МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AH-10	BCP53-10	ON	pnp	V_{CEO}=80В; I_C=1.5А; P_D=1.5Вт; h_{21}=63...160; f_T=50МГц	SOT-223, TO-261AA	E•C•B•C
AH-16	BCP53-16	ON	pnp	V_{CEO}=80В; I_C=1.5А; P_D=1.5Вт; h_{21}=100...250; f_T=50МГц	SOT-223, TO-261AA	E•C•B•C

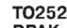


SOT89 SC62


SOT223 TO261A

TO252 DPAK
TO263 D2PAK

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
AHN	2SA1759	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AHP	2SA1759	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AHQ	2SA1759	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AHQ	2SD2098	ROHM	npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AHR	2SD2098	ROHM	npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AHS	2SD2098	ROHM	npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AJ	BCX536	PHIL	pnp	V_{CBO} = 100 В; I_C = 1 А; h_{21} = 40...100; f_T = 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AJ	BCX536	SIEM	pnp	V_{CBO} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...100; f_T = 125 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AJN	2SA1812	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AJP	2SA1812	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AJQ	2SA1812	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AK	BCX5310	PHIL	pnp	V_{CBO} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AK	BCX5310	SIEM	pnp	V_{CBO} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 125 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AL	BCX5316	PHIL	pnp	V_{CBO} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AL	BCX5316	SIEM	pnp	V_{CBO} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 125 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ALP	2SA1900	ROHM	pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ALQ	2SA1900	ROHM	pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ALR	2SA1900	ROHM	pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AM	BCX5216	PHIL	pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AM	BCX5216	SIEM	pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 125 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AQ	2SB766Q	PAN	pnp	V_{CBO} = 30 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...170; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AR	2SB766R	PAN	pnp	V_{CBO} = 30 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 120...240; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AR	2SC3338	REN	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 400 мВт; P_G = 8.3 дБ; f_T > 3.5 ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AR1	BSR40	PHIL	npn	V_{CBO} = 70 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...120; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AR2	BSR41	PHIL	npn	V_{CBO} = 70 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 100	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AR3	BSR42	PHIL	npn	V_{CBO} = 90 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...120; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AR4	BSR43	PHIL	npn	V_{CBO} = 90 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS	2SB766S	PAN	pnp	V_{CBO} = 30 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 170...340; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS1	BST50	PHIL	dpnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS1	BST50	MOT	dpnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS1	BST50	ZETEX	dpnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS2	BST51	PHIL	dpnp	V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS2	BST51	MOT	dpnp	V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS2	BST51	ZETEX	dpnp	V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS3	BSP52	ON	dnpn	V_{CBO} = 90 В; I_C = 800 мА; P_D = 800 мВт; h_{21} > 2000	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
AS3	BST52	PHIL	dpnp	V_{CBO} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS3	BST52	MOT	dpnp	V_{CBO} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AS3	BST52	ZETEX	dpnp	V_{CBO} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AT	2SD1470	REN	dnpn	V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 2000...100000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AT1	BST39	PHIL	npn	V_{CBO} = 400 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AT1	BST39	ZETEX	npn	V_{CBO} = 400 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AT2	BST40	PHIL	npn	V_{CBO} = 300 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
AT2	BST40	ZETEX	npn	V_{CBO} = 300 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ATN	2SA1812	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ATP	2SA1812	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ATQ	2SA1812	ROHM	pnp	V_{CBO} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 12 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BA	2SD1367A	REN	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BA	BCX54	PHIL	npn	V_{CBO} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BA	BCX54	SIEM	npn	V_{CBO} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BAP	2SB1132	ROHM	pnp	V_{CBO} = 40 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C


TO263
D2PAK

TO252
DPAK

SOT223
TO261A

SOT89
SC62


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
BAQ	2SB1132	ROHM	pnp	V_{CB0} = 40 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BAR	2SB1132	ROHM	pnp	V_{CB0} = 40 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BB	2SD1367B	REN	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BB	BCX546	PHIL	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...100; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BB	BCX546	SIEM	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...100; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BC	2SD1367C	REN	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 250...500; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BC	BCX5410	PHIL	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BC	BCX5410	SIEM	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BCP	2SB1188	ROHM	pnp	V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BCQ	2SB1188	ROHM	pnp	V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BCR	2SB1188	ROHM	pnp	V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BD	BCX5416	PHIL	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BD	BCX5416	SIEM	npn	V_{CB0} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BDP	2SB1189	ROHM	pnp	V_{CB0} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BDQ	2SB1189	ROHM	pnp	V_{CB0} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BDR	2SB1189	ROHM	pnp	V_{CB0} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BE	BCX55	PHIL	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BE	BCX55	SIEM	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BE_	2SB1260	ROHM	pnp	V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 2 Вт; h_{21} = 82...390; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BF	BCX5506	SIEM	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...100; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BF	BCX556	PHIL	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...100; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BFP	2SB1308	ROHM	pnp	V_{CB0} = 30 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BFQ	2SB1308	ROHM	pnp	V_{CB0} = 30 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BFR	2SB1308	ROHM	pnp	V_{CB0} = 30 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BG	BCX5510	PHIL	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BG	BCX5510	SIEM	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BGR	2SB1124R	SANYO	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BGS	2SB1124S	SANYO	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 140...280; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BGT	2SB1124T	SANYO	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 200...400; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BGU	2SB1124U	SANYO	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 280...560; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BH	2SB1001BH	REN	pnp	V_{CB0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; fT = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BH	2SB1125	SANYO	dpnp	V_{CB0} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 5000; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BH	BCP56	ON	npn	V_{CE0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 130 МГц	SOT-223, TO-261AA	E•C•B•C
BH	BCX56	PHIL	npn	V_{CB0} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BH	BCX56	SIEM	npn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BH-10	BCP56-10	ON	npn	V_{CE0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 130 МГц	SOT-223, TO-261AA	E•C•B•C
BH-16	BCP56-16	ON	npn	V_{CE0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 130 МГц	SOT-223, TO-261AA	E•C•B•C
BHP	2SB1386	ROHM	pnp	V_{CB0} = 30 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BHQ	2SB1386	ROHM	pnp	V_{CB0} = 30 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BHR	2SB1386	ROHM	pnp	V_{CB0} = 30 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BI	2SB1126	SANYO	dpnp	V_{CB0} = 80 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 4000; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BJ	2SB1001BJ	REN	pnp	V_{CB0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BJ	BCX5606	SIEM	npn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...100; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BJ	BCX566	PHIL	npn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...100; f_T = 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BJE	2SB1427	ROHM	pnp	V_{CB0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 390...820; f_T > 90 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BJS	2SB1427	ROHM	pnp	V_{CB0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 90 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BJU	2SB1427	ROHM	pnp	V_{CB0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 560...1200; f_T > 90 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BK	BCX5610	PHIL	npn	V_{CB0} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BK	BCX5610	SIEM	npn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
BL	BCX5616	PHIL	npn	V_{CB0} = 100В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BL	BCX5616	SIEM	npn	V_{CB0} = 80В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BLP	2SB1561	ROHM	pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BLQ	2SB1561	ROHM	pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BM	BCX5516	PHIL	npn	V_{CB0} = 60В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 130 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BM	BCX5516	SIEM	npn	V_{CB0} = 60В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BO	2SA1200	TOSH	pnp	V_{CE0} = 150 В; I_C = 50 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 70...140; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BO	KTA1660	KEC	pnp	V_{CB0} = 150В; I_C = 50 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BQ	2SB766AQ	PAN	pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...170; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BR	2SB766AR	PAN	pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 120...240; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BR1	BSR30	PHIL	pnp	V_{CB0} = 70В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...120; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BR2	BSR31	PHIL	pnp	V_{CB0} = 70В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BR3	BSR32	PHIL	pnp	V_{CB0} = 90В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...120; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BR4	BSR33	PHIL	pnp	V_{CB0} = 90В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS	2SB766AS	PAN	pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 170...340; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS1	BST60	PHIL	dpnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS1	BST60	MOT	dpnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS1	BST60	ZETEX	dpnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS2	BST61	PHIL	dpnp	V_{CB0} = 80В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS2	BST61	MOT	dpnp	V_{CB0} = 80В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS2	BST61	ZETEX	dpnp	V_{CB0} = 80В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS3	BSP62	ON	dpnp	V_{CB0} = 90В; I_C = 1 A; P_D = 1.25 Вт; h_{21} > 2000; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS3	BST62	PHIL	dpnp	V_{CB0} = 90В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS3	BST62	MOT	dpnp	V_{CB0} = 90В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BS3	BST62	ZETEX	dpnp	V_{CB0} = 90В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BT	2SB1048	REN	dpnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 2000...100000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BT1	BST15	PHIL	pnp	V_{CB0} = 200В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 30...150; f_T > 15 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BT2	BSP16	ON	pnp	V_{CB0} = 350В; I_C = 200 мА; P_D = 1.28 Вт; h_{21} > 30; f_T > 15 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
BT2	BST16	PHIL	pnp	V_{CB0} = 350В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 30...120; f_T > 15 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BY	2SA1200	TOSH	pnp	V_{CE0} = 150 В; I_C = 50 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...240; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BY	KTA1660	KEC	pnp	V_{CB0} = 150В; I_C = 50 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...240; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
BYR210	PBYR2100CT	PHIL	shd x2	V_R < 100 В; V_F (I_F = 1 A) < 0.69 В; C_T < 100 пФ	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR215	PBYR2150CT	PHIL	shd x2	V_R < 150 В; V_F (I_F = 1 A) < 0.69 В; C_T < 100 пФ	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR220	PBYR220CT	PHIL	shd x2	V_R < 20 В; V_F (I_F = 2 A) < 0.51 В; C_T = 160 пФ	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR225	PBYR225CT	PHIL	shd x2	V_R < 25 В; V_F (I_F = 2 A) < 0.51 В; C_T = 160 пФ	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR240	PBYR240CT	PHIL	shd x2	V_R < 40 В; V_F (I_F = 2 A) < 0.7 В; C_T = 60 пФ	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR245	PBYR245CT	PHIL	shd x2	V_R < 45 В; V_F (I_F = 2 A) < 0.7 В; C_T = 60 пФ	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR28	PBYR280CT	PHIL	shd x2	V_R < 80 В; V_F (I_F = 1 A) < 0.69 В; C_T < 100 пФ	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR29	PBYR290CT	PHIL	shd x2	V_R < 90 В; V_F (I_F = 1 A) < 0.69 В; C_T < 100 пФ	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
CA	BCP68	MOT	npn	V_{CE0} = 20В; I_C = 1 A; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 85...375; f_T = 60 МГц	SOT-223, TO-261AA	E•C•B•C
CAC	BC868	PHIL	npn	V_{CB0} = 25В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...375; f_T > 40 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CB	2SD1368	REN	npn	V_{CB0} = 100В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CB	BCX6810	SIEM	npn	V_{CB0} = 20В; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...160; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C

TO263 D2PAK  **TO252 DPAK**  **SOT223 TO261A**  **SOT89 SC62** 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
CBC	BC86810	PHIL	npn	V_{CBO} = 25 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...500; f_T > 40 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CBN	2SC4132	ROHM	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CBP	2SC4132	ROHM	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CBQ	2SC4132	ROHM	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CBR	2SC4132	ROHM	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CC	2SD1368	REN	npn	V_{CBO} = 100 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 250...500; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CC	BCX6816	SIEM	npn	V_{CBO} = 20 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CCC	BC86816	PHIL	npn	V_{CBO} = 25 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T > 40 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CD	BCX6825	SIEM	npn	V_{CBO} = 20 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...375; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CDC	BC86825	PHIL	npn	V_{CBO} = 25 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} > 160; f_T > 40 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CE	BCP69	MOT	pnp	V_{CEO} = 20 B; I_C = 1 A; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 85...375; f_T = 60 МГц	SOT-223, TO-261AA	E•C•B•C
CEC	BC869	PHIL	pnp	V_{CBO} = 25 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...375; f_T > 40 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CEN	2SC4505	ROHM	npn	V_{CBO} = 400 B; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 20 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CEP	2SC4505	ROHM	npn	V_{CBO} = 400 B; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 20 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CEQ	2SC4505	ROHM	npn	V_{CBO} = 400 B; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 20 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CF	BCX6910	SIEM	pnp	V_{CBO} = 20 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...160; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CFC	BC86910	PHIL	pnp	V_{CBO} = 25 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} > 160; f_T > 40 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CFQ	2SD2150	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 3 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 290 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CFR	2SD2150	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 3 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 290 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CFS	2SD2150	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 3 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 290 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CG	BCX6916	SIEM	pnp	V_{CBO} = 20 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CGC	BC86916	PHIL	pnp	V_{CBO} = 25 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T > 40 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CGP	2SC5053	ROHM	npn	V_{CBO} = 60 B; I_C = 1 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CGQ	2SC5053	ROHM	npn	V_{CBO} = 60 B; I_C = 1 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CGR	2SC5053	ROHM	npn	V_{CBO} = 60 B; I_C = 1 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CH	2SB1002CH	REN	pnp	V_{CBO} = 70 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; fT = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CH	BCX6925	SIEM	pnp	V_{CBO} = 20 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...375; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CHC	BC86925	PHIL	pnp	V_{CBO} = 25 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160; f_T > 40 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CI	2SC4080	SANYO	npn	V_{CBO} = 200 B; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 40...320; f_T = 400 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CJ	2SB1002CJ	REN	pnp	V_{CBO} = 70 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; fT = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CR	2SC4422	REN	npn	V_{CBO} = 15 B; I_C = 50 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} = 50250; f_T > 4.5 ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
CT	2SD1472	REN	dnpn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 1.5 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 2000...30000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DA	2SD1418	REN	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DA	BF622	PHIL	npn	V_{CBO} = 250 B; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DA	BF622	SIEM	npn	V_{CBO} = 250 B; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DAP	2SD1664	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 1 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DAQ	2SD1664	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 1 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DAR	2SD1664	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 1 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DB	2SD1418	REN	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DB	BF623	PHIL	pnp	V_{CBO} = 250 B; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DB	BF623	SIEM	pnp	V_{CBO} = 250 B; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DBP	2SD1766	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DBQ	2SD1766	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DBR	2SD1766	ROHM	npn	V_{CBO} = 40 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DC	2SD1418	REN	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 1 A; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DC	BF620	PHIL	npn	V_{CBO} = 300 B; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DC	BF720T1	ON	npn	V_{CB} = 300 B; I_C = 100 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 50; f_T = 60 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
DC	BFN20	SIEM	npn	V_{CBO} = 300 B; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DCP	2SD1767	ROHM	npn	V_{CBO} = 80 B; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C




SOT89 SC62



SOT223 TO261A



TO252 DPAK



TO263 D2PAK

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
DCQ	2SD1767	ROHM	npn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DCR	2SD1767	ROHM	npn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DD	2SD1419	REN	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DD	BFN16	SIEM	npn	V_{CB0} = 250 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DDP	2SD1766	ROHM	npn	V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DDQ	2SD1766	ROHM	npn	V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DDR	2SD1766	ROHM	npn	V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DE	2SD1419	REN	npn	V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DE	2SD1834	ROHM	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 2000	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DE	BFN18	SIEM	npn	V_{CB0} = 300 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 30; f_T > 70 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DF	2SD1898	ROHM	npn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 2 Вт; h_{21} = 82...390; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DF	BF621	PHIL	pnp	V_{CB0} = 300 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DF	BF721T1	ON	pnp	V_{CB} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 50; f_T = 60 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
DF	BFN21	SIEM	pnp	V_{CB0} = 300 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DG	BFN17	SIEM	pnp	V_{CB0} = 250 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DGQ	2SD1963	ROHM	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DGR	2SD1624R	SANYO	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DGR	2SD1963	ROHM	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DGS	2SD1624S	SANYO	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 140...280; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DGS	2SD1963	ROHM	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DGT	2SD1624T	SANYO	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 200...400; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DGU	2SD1624U	SANYO	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 280...560; f_T = 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DH	2SB1025DH	REN	pnp	V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DH	2SD1625	SANYO	dnpn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 5000; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DH	BFN19	SIEM	pnp	V_{CB0} = 300 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 30; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DI	2SD1626	SANYO	dnpn	V_{CB0} = 80 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 4000; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DJ	2SB1025DJ	REN	pnp	V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DJQ	2SD2098	ROHM	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DJR	2SD2098	ROHM	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DJS	2SD2098	ROHM	npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DK	2SB1025DK	REN	pnp	V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DKP	2SC4672	ROHM	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 210 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DKQ	2SC4672	ROHM	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 210 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DL	2SB1026DL	REN	pnp	V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DLN	2SD2167	ROHM	npn	V_{CB0} = 31 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DLP	2SD2167	ROHM	npn	V_{CB0} = 31 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DLQ	2SD2167	ROHM	npn	V_{CB0} = 31 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DM	2SB1026DM	REN	pnp	V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DM	2SD2170	ROHM	npn	V_{CB0} = 90 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1000...10000; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DNE	2SD2153	ROHM	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 390...820; f_T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DNU	2SD2153	ROHM	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 560...1200; f_T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DNV	2SD2153	ROHM	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 820...1800; f_T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DNW	2SD2153	ROHM	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1200...2700; f_T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DO	2SA1201	TOSH	pnp	V_{CE0} = 120 В; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 70...140; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DP	2SD2195	ROHM	npn	V_{CB0} = 100 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1000...10000; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DQN	2SD2211	ROHM	npn	V_{CB0} = 160 В; I_C = 1500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DQP	2SD2211	ROHM	npn	V_{CB0} = 160 В; I_C = 1500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DQQ	2SD2211	ROHM	npn	V_{CB0} = 160 В; I_C = 1500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C

TO263 D2PAK  **TO252 DPAK**  **SOT223 TO261A**  **SOT89 SC62** 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
DR	2SC4643	REN	npn	$V_{CB0}=15$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=400$ мВт; $h_{21}=40250$; $f_T>5.5$ ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DR	2SD2212	ROHM	npn	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=2$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}=1000...10000$; $f_T>80$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DTP	2SD2391	ROHM	npn	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=2$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}=82...180$; $f_T>210$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DTQ	2SD2391	ROHM	npn	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=2$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}=120...270$; $f_T>210$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
DY	2SA1201	TOSH	pnp	$V_{CE0}=120$ В; $I_C=800$ мА; $P_D=500$ мВт; $h_{21}>120...240$; $f_T=120$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
E01	DTDG14EP	ROHM	Dnpn+dz	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=1$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}>300$; $f_T>80$ МГц; $R_2=10$ кОм	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
E01	DTDG14GP	ROHM	Dnpn+dz	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=1$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}>300$; $f_T>80$ МГц; $R_2=10$ кОм	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
E02	DTDG23YP	ROHM	Dnpn+dz	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=1$ А; $P_D=1.5$ Вт; $h_{21}>300$; $f_T=80$ МГц; 2.2 к/10 к	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ED	2SD1421	REN	npn	$V_{CB0}=180$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=1$ Вт; $h_{21}=60...120$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ED	BCV28	INF	dpnp	$V_{CB0}=40$ В; $I_C=500$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}>100$; $f_T=200$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
EE	2SD1421	REN	npn	$V_{CB0}=180$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=1$ Вт; $h_{21}=100...200$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
EE	BCV48	INF	dpnp	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=500$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}>400$; $f_T=200$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
EF	BCV29	INF	dnpn	$V_{CB0}=40$ В; $I_C=500$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}>100$; $f_T=150$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
EG	BCV49	INF	dnpn	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=500$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}>400$; $f_T=150$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
EL	2SB1028EL	REN	pnp	$V_{CB0}=180$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=1$ Вт; $h_{21}=60...120$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
EM	2SB1028EM	REN	pnp	$V_{CB0}=180$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=1$ Вт; $h_{21}=100...200$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
ER	2SC4807	REN	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=200$ мА; $P_D=800$ мВт; $h_{21}=50...250$; $f_T>3$ ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FA	BFQ17	PHIL	npn	$V_{CB0}=40$ В; $I_C=300$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}=85$; $f_T=1.5$ ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FB	BFQ19	PHIL	npn	$V_{CB0}=15$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}>25$; $f_T=5.5$ ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FC	BFQ64	SIEM	npn	$I_C=200$ мА; $P_D=1$ Вт; h21 > 25; $f_T>3$ ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FD	BFQ17P	SIEM	npn	$V_{CB0}=40$ В; $I_C=300$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}=85$; $f_T=1.5$ ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FEs	BFQ19P	SIEM	npn	$V_{CB0}=15$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}>25$; $f_T=5.5$ ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FF	BFQ18A	PHIL	npn	$V_{CB0}=25$ В; $I_C=150$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}>25$; $f_T=4$ ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FGs	BFQ19S	SIEM	npn	$V_{CB0}=20$ В; $I_C=75$ мА; $P_D=1$ Вт; $h_{21}=40...220$; $f_T=5500$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FO	2SA1202	TOSH	pnp	$V_{CE0}=80$ В; $I_C=400$ мА; $P_D=500$ мВт; $h_{21}>70...140$; $f_T=120$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
FY	2SA1202	TOSH	pnp	$V_{CE0}=80$ В; $I_C=400$ мА; $P_D=500$ мВт; $h_{21}>120...240$; $f_T=120$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
GA	BAW78A	SIEM	di	$V_R<50$ В; $I_F<1$ А; $V_F(I_F=1$ А$)<1.6$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<1000$ нс	SOT-89, SC-62	A•K•n. c.•K
GB	BAW78B	SIEM	di	$V_R<100$ В; $I_F<1$ А; $V_F(I_F=1$ А$)<1.6$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<1000$ нс	SOT-89, SC-62	A•K•n. c.•K
GC	BAW78C	SIEM	di	$V_R<200$ В; $I_F<1$ А; $V_F(I_F=1$ А$)<1.6$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<1000$ нс	SOT-89, SC-62	A•K•n. c.•K
GD	BAW78D	SIEM	di	$V_R<400$ В; $I_F<1$ А; $V_F(I_F=1$ А$)<1.6$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<1000$ нс	SOT-89, SC-62	A•K•n. c.•K
GE	BAW79A	SIEM	di x2	$V_R<50$ В; $I_F<1$ А; $V_F(I_F=1$ А$)<1.6$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<1000$ нс	SOT-89, SC-62	A1•K1, K2•A2•K1, K2
GF	BAW79B	SIEM	di x2	$V_R<100$ В; $I_F<1$ А; $V_F(I_F=1$ А$)<1.6$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<1000$ нс	SOT-89, SC-62	A1•K1, K2•A2•K1, K2
GG	BAW79C	SIEM	di x2	$V_R<200$ В; $I_F<1$ А; $V_F(I_F=1$ А$)<1.6$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<1000$ нс	SOT-89, SC-62	A1•K1, K2•A2•K1, K2
GH	BAW79D	SIEM	di x2	$V_R<400$ В; $I_F<1$ А; $V_F(I_F=1$ А$)<1.6$ В; $I_R<1.0$ мкА; $C_D<10$ пФ; $t_{RR}<1000$ нс	SOT-89, SC-62	A1•K1, K2•A2•K1, K2
GO	KTC4375	KEC	npn	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}=100...200$; $f_T>120$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
GY	KTC4375	KEC	npn	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}=160...320$; $f_T>120$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
HO	2SA1203	TOSH	pnp	$V_{CE0}=30$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}=100...200$; $f_T=200$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
HO	KTA1663	KEC	pnp	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}=100...200$; $f_T>120$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
HY	2SA1203	TOSH	pnp	$V_{CE0}=30$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}>160...320$; $f_T=$ы120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
HY	KTA1663	KEC	pnp	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=1.5$ А; $P_D=500$ мВт; $h_{21}=160...320$; $f_T>120$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C


SOT89 SC62


SOT223 TO261A

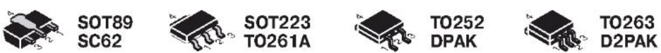

TO252 DPAK


TO263 D2PAK

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
JO	2SA1384	TOSH	npn	V_{CE0} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 50...150; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
JR	2SA1384	TOSH	npn	V_{CE0} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 30...90; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
JR	2SC5631	REN	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 80 мА; P_D = 800 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 8 ГГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
JX	2SK3391	REN	nMOS	V_{DS} = 17 В; I_D = 300 мА; P_D = 5 Вт	SOT-89, SC-62	G•S•D•S
K0	BST86	PHIL	nMOS	V_{DS} = 180 В; I_D = 300 мА; P_D = 1 Вт; $R_{DS(on)}$ = 7 Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
KA	2SC4409	TOSH	npn	V_{CE0} = 80 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
KA	BSS87	SIEM	nMOS	V_{DS} = 240 В; I_D = 290 мА; P_D = 1 Вт; g_F = 50мс; R_{DS} = 10 Ом	SOT-89, SC-62	G•D•S•D
KB	2SC4539	TOSH	npn	V_{CE0} = 30 В; I_C = 1.2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...400; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
KB	BSS192	INF	pMOS	V_{DS} = 240 В; I_D = 150 мА; P_D = 1 Вт; g_F = 120 мСм; R_{DS} = 3.5 Ом	SOT-89, SC-62	G•D•S•D
KC	2SC4540	TOSH	npn	V_{CE0} = 50 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...400; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
KD	2SC4541	TOSH	npn	V_{CE0} = 50 В; I_C = 3 А; P_D = 1500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
KM	BST80	PHIL	nMOS	V_{DS} = 80 В; I_D = 500 мА; P_D = 1 Вт; $R_{DS(on)}$ = 3 Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
KM	BST80	ZETEX	nMOS	V_{DS} = 80 В; I_D = 500 мА; P_D = 1 Вт; $R_{DS(on)}$ = 3 Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
KN	BST84	PHIL	nMOS	V_{DS} = 200 В; I_D = 250 мА; P_D = 1 Вт; $R_{DS(on)}$ = 6 Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
LA	2SC1681	TOSH	pnp	V_{CE0} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
LA	KTD1003	KEC	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1.0 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 800...1600; f_T > 250 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
LB	2SC1734	TOSH	pnp	V_{CE0} = 40 В; I_C = 1.2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
LB	KTD1003	KEC	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1.0 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1200...2400; f_T > 250 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
LC	2SC1735	TOSH	pnp	V_{CE0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
LC	KTD1003	KEC	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 1.0 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 2000...3200; f_T > 250 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
LD	2SC1736	TOSH	pnp	V_{CE0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
LM	BST120	PHIL	pMOS	V_{DS} = 60 В; I_D = 300 мА; P_D = 1 Вт; g_F = 200 мСм; $R_{DS(on)}$ = 4.5 Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
LN	BST122	PHIL	pMOS	V_{DS} = 60 В; I_D = 250 мА; P_D = 1 Вт; g_F = 125 мСм; $R_{DS(on)}$ = 7.5 Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
LYD	2SC4003D	SANYO	npn	V_{CB0} = 400 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 70 МГц	TO-252, DPAK	B•C•E•C
LYE	2SC4003E	SANYO	npn	V_{CB0} = 400 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 70 МГц	TO-252, DPAK	B•C•E•C
N01	DTDM12ZP	ROHM	Dnpn+ dz	V_{CB0} = 30 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 68; f_T > 80 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p1A	PXT3904	PHIL	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 300 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p1B	PXT2222	PHIL	npn	V_{CB0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p1D	PXTA42	PHIL	npn	V_{CB0} = 300 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
P1D	PZTA42	MOT	npn	V_{CB0} = 300 В; I_C = 500 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 25; f_T > 50 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
p1E	PXTA43	PHIL	npn	V_{CB0} = 200 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
P1F	PZT2222A	ON	npn	V_{CB0} = 75 В; I_C = 600 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 50...300; f_T > 300 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
p1M	PXTA13	PHIL	dnpn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 625 мВт; h_{21} > 5000; f_T > 125 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p1N	PXTA14	PHIL	dnpn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 300 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 20000; f_T > 125 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
P1N	PZTA14	MOT	dnpn	V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 10000; f_T > 125 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
p1P	PXT2222A	PHIL	npn	V_{CB0} = 75 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 300 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p2A	PXT3906	PHIL	pnp	V_{CB0} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p2B	PXT2907	PHIL	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p2D	PXTA92	PHIL	pnp	V_{CB0} = 300 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
P2D	PZTA92	MOT	pnp	V_{CB0} = 300 В; I_C = 500 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 25; f_T > 50 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
p2E	PXTA93	PHIL	pnp	V_{CB0} = 200 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p2F	PXT2907A	PHIL	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
P2F	PZT2907A	ON	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
p2T	PXT4403	PHIL	pnp	V_{CB0} = 40 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
p2V	PXTA64	PHIL	pnp	V_{CB0} = 30 В; I_C = 300 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 10000; f_T > 125 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
P2V	PZTA64	MOT	dpnp	V_{CB0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 10000; f_T > 125 МГц	SOT-223, TO-261AA	B•C•E•C
p2X	PXT4401	PHIL	npn	V_{CB0} = 40 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
PO	KTC4376	KEC	npn	V_{CB0} = 35 В; I_C = 0.8 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
PY	KTC4376	KEC	npn	V_{CB0} = 35 В; I_C = 0.8 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 160...320; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C

TO263 D2PAK  **TO252 DPAK**  **SOT223 TO261A**  **SOT89 SC62** 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
R111718	REG1117A-1.8	TI	reg	LDO; I_{OUT} = 1 A; V_{OUT} = 1.8 B	SOT-223, TO-261AA	GND • VOUT • VIN • VOUT
R111725	REG1117A-2.5	TI	reg	LDO; I_{OUT} = 1 A; V_{OUT} = 2.5 B	SOT-223, TO-261AA	GND • VOUT • VIN • VOUT
RCs	BFQ193	SIEM	npn	V_{CBO} = 20 B; I_C = 80 мА; P_D = 600 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 7500 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RE	2SC3357E	NEC	npn	V_{CBO} = 20 B; I_C = 100 мА; P_D = 1.2 Вт; h_{21} = 125...250; f_T = 6.5 ГГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
REG1117FA	REG1117FA	TI	reg	LDO; I_{OUT} = 1 A; V_{REF} = 1.25 B	TO-263, D2PAK	ADJ • VOUT • VIN • VOUT
REG1117FA1.8	REG1117FA-1.8	TI	reg	LDO; I_{OUT} = 1 A; V_{OUT} = 1.8 B	TO-263, D2PAK	GND • VOUT • VIN • VOUT
REG1117FA2.5	REG1117FA-2.5	TI	reg	LDO; I_{OUT} = 1 A; V_{OUT} = 2.5 B	TO-263, D2PAK	GND • VOUT • VIN • VOUT
REG1117FA5.0	REG1117FA-5	TI	reg	LDO; I_{OUT} = 1 A; V_{OUT} = 5 B	TO-263, D2PAK	GND • VOUT • VIN • VOUT
RF	2SC3357F	NEC	npn	V_{CBO} = 20 B; I_C = 100 мА; P_D = 1.2 Вт; h_{21} = 80...160; f_T = 6.5 ГГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RH	2SC3357H	NEC	npn	V_{CBO} = 20 B; I_C = 100 мА; P_D = 1.2 Вт; h_{21} = 50...100; f_T = 6.5 ГГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RO	2SA1204	TOSH	pnp	V_{CEO} = 35 B; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 100...200; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RO	KTA1664	KEC	pnp	V_{CBO} = 35 B; I_C = 0.8 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RY	2SA1204	TOSH	pnp	V_{CEO} = 35 B; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 160...320; f_T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RY	KTA1664	KEC	pnp	V_{CBO} = 35 B; I_C = 0.8 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 160...320; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SA	2SC2982	TOSH	npn	V_{CEO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 140...240; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SB	2SC2982	TOSH	npn	V_{CEO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 200...330; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SC	2SC2982	TOSH	npn	V_{CEO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 300...450; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SCO	KSC2881	SAMS	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SCY	KSC2881	SAMS	npn	V_{CBO} = 120 B; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...240; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SD	2SC2982	TOSH	npn	V_{CEO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 420...600; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SDO	KSA1201	SAMS	pnp	V_{CBO} = 120 B; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SDO	KSA1203	SAMS	pnp	V_{CBO} = 30 B; I_C = 1.5 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SDY	KSA1201	SAMS	pnp	V_{CBO} = 120 B; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...240; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SDY	KSA1203	SAMS	pnp	V_{CBO} = 30 B; I_C = 1.5 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 160...320; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SE	NE46234	NEC	npn	СВЧ; NF = 2.3 дБ; h_{21} = 125...250	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SE	NE462M02	NEC	npn	СВЧ; h_{21} = 125...250	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SF	NE46234	NEC	npn	СВЧ; NF = 2.3 дБ; h_{21} = 80...160	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SF	NE462M02	NEC	npn	СВЧ; h_{21} = 80...160	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SH	NE46234	NEC	npn	СВЧ; NF = 2.3 дБ; h_{21} = 50...100	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SH	NE462M02	NEC	npn	СВЧ; h_{21} = 50...100	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SHO	KSC2883	SAMS	npn	V_{CBO} = 30 B; I_C = 1500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SHY	KSC2883	SAMS	npn	V_{CBO} = 30 B; I_C = 1500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 160...320; f_T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SLG	KSB798	SAMS	pnp	V_{CBO} = 30 B; I_C = 1 A; P_D = 2 Вт; h_{21} = 200...400; f_T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SLO	KSB798	SAMS	pnp	V_{CBO} = 30 B; I_C = 1 A; P_D = 2 Вт; h_{21} = 90...180; f_T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SLY	KSB798	SAMS	pnp	V_{CBO} = 30 B; I_C = 1 A; P_D = 2 Вт; h_{21} = 135...270; f_T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SSA	KSC2982	SAMS	npn	V_{CBO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 140...240; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SSB	KSC2982	SAMS	npn	V_{CBO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 200...330; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SSC	KSC2982	SAMS	npn	V_{CBO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 300...450; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SSD	KSC2982	SAMS	npn	V_{CBO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 420...600; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SYR	KSD1621	SAMS	npn	V_{CBO} = 30 B; I_C = 2 A; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C

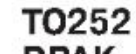


SOT89 SC62

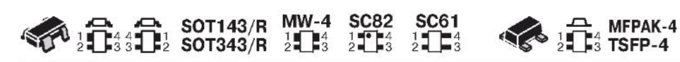

SOT223 TO261A
TO252 DPAK

TO263 D2PAK

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
SYS	KSD1621	SAMS	npn	V_{CB0} = 30В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 140...280; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
SYT	KSD1621	SAMS	npn	V_{CB0} = 30В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 200...400; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
SYU	KSD1621	SAMS	npn	V_{CB0} = 30В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 280...560; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
SZR	KSB1121	SAMS	pnp	V_{CB0} = 30В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
SZS	KSB1121	SAMS	pnp	V_{CB0} = 30В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 140...280; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
SZT	KSB1121	SAMS	pnp	V_{CB0} = 30В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 200...400; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
SZU	KSB1121	SAMS	pnp	V_{CB0} = 30В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 280...560; f_T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
T09A	MC33464N-09AT1	ON	mrc	V_{TR} = 0.9 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T09C	MC33464N-09CT1	ON	mrc	V_{TR} = 0.9 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T20A	MC33464N-20AT1	ON	mrc	V_{TR} = 2.0 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T20C	MC33464N-20CT1	ON	mrc	V_{TR} = 2.0 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T27A	MC33464N-27AT1	ON	mrc	V_{TR} = 2.7 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T27C	MC33464N-27CT1	ON	mrc	V_{TR} = 2.7 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T30A	MC33464N-30AT1	ON	mrc	V_{TR} = 3.0 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T30C	MC33464N-30CT1	ON	mrc	V_{TR} = 3.0 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T43C	MC33464N-43CT1	ON	mrc	V_{TR} = 4.3 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T45A	MC33464N-45AT1	ON	mrc	V_{TR} = 4.5 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
T45C	MC33464N-45CT1	ON	mrc	V_{TR} = 4.5 В; V_{IN} = 0.7...10 В	SOT-89, SC-62	RESET•IN•GND•IN
TA	2SA1314	TOSH	pnp	V_{CE0} = 20В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 140...280; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
TB	2SA1314	TOSH	pnp	V_{CE0} = 20В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 200...400; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
TC	2SA1314	TOSH	pnp	V_{CE0} = 20В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 300...600; f_T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
VD	1SV268	SANYO	pin	V_R > 50 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1 В; I_R < 0.5 мкА	SOT-89, SC-62	A•K•n. c.•K
VO	2SC3803	TOSH	npn	V_{CE0} = 45В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 70...140; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
VR	2SC3803R	TOSH	npn	V_{CE0} = 45В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40...80; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
VY	2SC3803Y	TOSH	npn	V_{CE0} = 45В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 140...280; f_T > 100 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
VY	2SC3803Y	TOSH	npn	V_{CE0} = 45В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 140...280; f_T > 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
W8	BZV49C3V9	ZETEX	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 90 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
W9	BZV49C4V3	ZETEX	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 4.0...4.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 90 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
WO	2SA1483O	TOSH	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 70...140; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
WR	2SA1483R	TOSH	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 40...80; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
WY	2SA1483Y	TOSH	pnp	V_{CB0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...240; f_T = 200 МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
WY	2SJ484	REN	pMOS	V_{DS} = 30 В; I_D = 2А; P_D = 1 Вт; $R_{DS(on)}$ < 0.23 Ом	SOT-89, SC-62	G•D•S•D
X2	BZV49C30	ZETEX	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 28.0...32.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 80 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
X5	BZV49C39	ZETEX	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 37.0...41.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 130 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
X6	BZV49C43	ZETEX	dz	V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 40.0...46.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 150 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
XC	RN5003	TOSH	Dnpn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; f_T = 120 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
Y1	BZV49C11	ZETEX	dz	V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 20 Ом; I_{ZM} = 250 мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K

TO263 D2PAK   **TO252 DPAK**  **SOT223 TO261A**  **SOT89 SC62** 

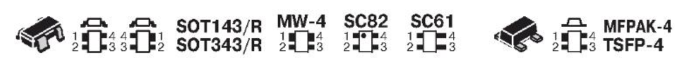
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
Y4	BZV49C15	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=13.8...15.6$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<30$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Y5	BZV49C16	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=15.3...17.1$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<40$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Y8	BZV49C22	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=20.8...23.3$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<55$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Y9	BZV49C24	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=22.8...25.6$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<70$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
YA	RN6001	TOSH	Dnpn	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=2$ А; $P_D=500$ мВт; $f_T=120$ МГц; $R_1=2$ кОм	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YB	2SK680A	NEC	nMOS	$V_{DS}=30$ В; $I_D=1$ А; $P_D=2$ Вт; $R_{DS(on)}<1$ Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
YB	RN6002	TOSH	Dnpn	$V_{CB0}=30$ В; $I_C=2$ А; $P_D=500$ мВт; $f_T=120$ МГц; $R_1=5.6$ кОм	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YK	2SB1115K	NEC	pnp	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=1$ А; $P_D=2$ Вт; $h_{21}=300...600$; $f_T>80$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YL	2SB1115L	NEC	pnp	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=1$ А; $P_D=2$ Вт; $h_{21}=200...400$; $f_T>80$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YM	2SB1115M	NEC	pnp	$V_{CB0}=60$ В; $I_C=1$ А; $P_D=2$ Вт; $h_{21}=135...270$; $f_T>80$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YP	2SB1115AP	NEC	pnp	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=1$ А; $P_D=2$ Вт; $h_{21}=200...400$; $f_T>80$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YQ	2SB1115AQ	NEC	pnp	$V_{CB0}=80$ В; $I_C=1$ А; $P_D=2$ Вт; $h_{21}=135...270$; $f_T>80$ МГц	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
Z1	BZV49C10	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=9.4...10.6$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<20$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z1	BZV49C4V7	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=4.4...5.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<80$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z2	BZV49C5V1	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=4.8...5.4$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<60$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z3	2SK1078	TOSH	nMOS	$V_{DS}=60$ В; $I_D=800$ мА; $P_D=500$ мВт; $R_{DS(on)}<1.1$ Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
Z3	BZV49C5V6	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=5.2...6.0$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<40$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z4	2SK1079	TOSH	nMOS	$V_{DS}=100$ В; $I_D=600$ мА; $P_D=500$ мВт; $R_{DS(on)}<1.8$ Ом	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
Z4	BZV49C6V2	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=5.8...6.6$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<10$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z5	2SK1717	TOSH	nMOS	$V_{DS}=60$ В; $I_D=2$ А; $P_D=500$ мВт; $R_{DS(on)}<0.53$ Ом	SOT-89, SC-62	G•D•S•D
Z5	BZV49C6V8	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=6.4...7.2$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<15$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z6	2SJ238	TOSH	pMOS	$V_{DS}=60$ В; $I_D=1$ А; $P_D=500$ мВт; $R_{DS(on)}=1.4$ Ом	SOT-89, SC-62	G•D•S•D
Z6	BZV49C7V5	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=7.0...7.9$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<15$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z7	BZV49C8V2	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=7.7...8.7$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<15$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z8	BZV49C9V1	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=8.5...9.6$ В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0$ мА$)<15$ Ом; $I_{ZM}=250$ мА	SOT-89, SC-62	A•K•A•K



SOT143/343...

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
18	BFP181T	TELEF	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 20 мА; P_D = 160 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 8 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
67	BFP67	TELEF	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 65...150; f_T = 7.5 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
77	MA4CS101E	M/A	shd x2	V_R = 70 В; I_F < 15 мА; $V_F(I_F = 15 мА)$ < 1 В; C_D < 2 пФ	SOT143, TO253	K2•K1•A1•A2
87	MA4CS102E	M/A	shd x2	V_R = 8 В; I_F < 30 мА; $V_F(I_F = 10 мА)$ < 500 мВ; C_D < 1 пФ	SOT143, TO253	K2•K1•A1•A2
822	S822T	VISH	npn	V_{CB0} = 12 В; I_C = 8 мА; P_D = 30 мВт; h_{21} = 40...150; f_T = 5.2 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
01	MRF9011LT1	MOT	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 30...200; f_T = 3800 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
02	MRF5711LT1	MOT	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 80 мА; P_D = 580 мВт; h_{21} = 50...300; f_T = 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
04	MRF4427	MOT	npn	V_{CB0} = 40 В; I_C = 400 мА; P_D = 220 мВт; h_{21} = 10...200; f_T = 1600 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
04	MRF5211LT1	MOT	pnp	V_{CB0} = 20 В; I_C = 70 мА; P_D = 333 мВт; h_{21} = 25...125; f_T = 4200 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
05	MRF9331LT1	MOT	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 2 мА; P_D = 50 мВт; h_{21} = 30...200; f_T = 5000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
05F	TSDF1205R	TELEF	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 12 мА; P_D = 40 мВт; h_{21} = 50...250; f_T = 12 ГГц	SOT143R	C•E•B•E
11	MRF9511ALT1	MOT	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 322 мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
17	BAS125-07	SIEM	shd x2	V_R < 25 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F = 35 мА)$ < 0.9 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 1.1 пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
17s	BAS125-07	INF	shd x2	V_R < 25 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F = 35 мА)$ < 0.9 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 1.1 пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
17s	BAS125-07W	INF	shd x2	V_R < 25 В; I_F < 100 мА; $V_F(I_F = 35 мА)$ < 0.9 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 1.1 пФ	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
18	MRF9331LT1	MOT	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 2 мА; P_D = 50 мВт; h_{21} = 30...200; f_T = 3500 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
18	MRF9411BLT1	MOT	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
18	MRF9411BLT3	MOT	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
1Jp	BCV61A	PHIL	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1Jp	BCV61A	PHIL	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1JS	BCV61A	INF	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1Js	BCV61A	INF	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 110...220; f_T = 250 МГц	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
1Kp	BCV61B	PHIL	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 200...450; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1Ks	BCV61B	INF	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 200...450; f_T = 250 МГц	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
1Lp	BCV61C	PHIL	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1Ls	BCV61C	INF	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 420...800; f_T = 250 МГц	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
1Mp	BCV61	PHIL	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...800; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
20	MRF5811LT1	MOT	npn	V_{CB0} = 36 В; I_C = 200 мА; P_D = 710 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 5 ГГц	SOT143, TO253	C•E•E•B

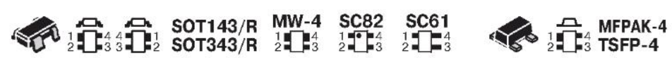
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
20F	TSDF1220R	TELEF	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 40 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 12 ГГц	SOT143R	C•E•B•E
28	BFP280T	TELEF	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 10 мА; P_D = 80 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 7 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
305	AT30511	HP	npn	V_{CB0} = 11 В; I_C = 8 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 70...300; f_T = 10 ГГц	SOT143, TO253	B•E•C•E
310	AT31011	HP	npn	V_{CB0} = 11 В; I_C = 16 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 70...300; f_T = 10 ГГц	SOT143, TO253	B•E•C•E
320	AT32011	HP	npn	V_{CB0} = 11 В; I_C = 32 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 70...300; f_T = 10 ГГц	SOT143, TO253	B•E•C•E
3Jp	BCV62A	PHIL	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 125...250; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
3Js	BCV62A	INF	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 125...220; f_T = 250 МГц	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
3Kp	BCV62B	PHIL	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 220...475; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
3Ks	BCV62B	INF	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 220...475; f_T = 250 МГц	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
3Lp	BCV62C	PHIL	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
3Ls	BCV62C	INF	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 420...800; f_T = c250 МГц	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
3Mp	BCV62	PHIL	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...800; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
3Ms	BCV62	INF	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...800; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
3RP	3SK184P	PAN	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 50 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 8.5...17 мА	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
3RQ	3SK184Q	PAN	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 50 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 15...21 мА	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
3RR	3SK184R	PAN	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 50 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 19...30 мА	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
3RS	3SK184S	PAN	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 50 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 25...35 мА	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
414	AT41411	HP	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 225 мВт; h_{21} = 30...270; f_T = 7000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
47s	BAS4007	SIEM	shd x2	V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_F (I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 5.0 пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
47s	BAS40-07	INF	shd x2	V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_F (I_F = 40 мА) < 1 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
47s	BAS40-07W	INF	shd x2	V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_F (I_F = 40 мА) < 1 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
57	BAT1707	SIEM	shd x2	V_R < 4 В; I_F < 130 мА; V_F (I_F = 10 мА) < 0.6 В; I_R < 0.25 мкА; C_D < 0.75 пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
57s	BAT17-07	INF	shd x2	V_R < 4 В; I_F < 130 мА; V_F (I_F = 10 мА) < 0.6 В; I_R < 0.25 мкА; C_D < 1 пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
60	BAR60	SIEM	pin x3	V_R < 100 В; I_F < 140 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.25 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 0.2 пФ	SOT143, TO253	K1, K2, A3•K3•A1•A2
61	BAR61	SIEM	pin x3	V_R < 100 В; I_F < 140 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.25 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 0.2 пФ	SOT143, TO253	K2, K3•A1•K1, A2•A3
62	BAT62	SIEM	shd x2	V_R < 40 В; I_F < 20 мА; V_F (I_F = 2 мА) < 1 В; I_R < 10 мкА; C_D < 0.6 пФ	SOT143, TO253	A1•K2•A2•K1
62s	BAT62	INF	shd x2	V_R < 40 В; I_F < 20 мА; V_F (I_F = 2 мА) < 1 В; I_R < 10 мкА; C_D < 0.6 пФ	SOT143, TO253	A1•K2•A2•K1
62s	BAT62-07W	INF	shd x2	V_R < 40 В; I_F < 20 мА; V_F (I_F = 2 мА) < 1 В; I_R < 10 мкА; C_D < 0.6 пФ	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
63	BAT63	SIEM	shd x2	V_R < 3 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 1 мА) < 0.3 В; I_R < 0.01 мкА; C_D < 0.85 пФ	SOT143, TO253	A1•K2•A2•K1
67R	BFP67R	TELEF	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 65...150; f_T = 7.5 ГГц	SOT143R	C•E•B•E





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
67s	BAT64-07	INF	shd x2	V_R<40В; I_F<250мА; V_F(I_F=100мА)<0.75В; I_R<2.0мкА; C_D<6пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
67s	BAT64-07W	INF	shd x2	V_R<40В; I_F<250мА; V_F(I_F=100мА)<0.75В; I_R<2мкА; C_D<6пФ	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
77p	BAS7007	PHIL	shd x2	V_R<70В; I_F<70мА; V_F(I_F=1мА)<410мВ; C_D<2пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
77s	BAS7007	SIEM	shd x2	V_R<70В; I_F<70мА; V_F(I_F=15мА)<1.0В; I_R<0.1мкА; C_D<2.0пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
77s	BAS70-07	INF	shd x2	V_R<70В; I_F<70мА; V_F(I_F=15мА)<1.0В; I_R<0.1мкА; C_D<2.0пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
77s	BAS70-07W	INF	shd x2	V_R<70В; I_F<70мА; V_F(I_F=15мА)<1.0В; I_R<0.1мкА; C_D<2.0пФ	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
82P	BFP182T	TELEF	npn	V_{CBO}=15В; I_C=35мА; P_D=200мВт; h_{21}=50...150; f_T=7.5ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
8372	MRF8372	MOT	npn	V_{CBO}=36В; I_C=200мА; P_D=1880мВт; h_{21}=30...200	SOT143, TO253	C•E•B•E
83P	BFP183T	TELEF	npn	V_{CBO}=15В; I_C=65мА; P_D=200мВт; h_{21}=50...150; f_T=8ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
87s	BAT68-07	INF	shd x2	V_R<8В; I_F<130мА; V_F(I_F=10мА)<0.5В; I_R<0.1мкА; C_D<1.0пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
87s	BAT68-07W	INF	shd x2	V_R<8В; I_F<130мА; V_F(I_F=10мА)<0.5В; I_R<0.1мкА; C_D<1.0пФ	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
8ALx	STM811L	STM	mrc	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8AMx	STM811M	STM	mrc	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8ANx	STM811T	STM	mrc	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8APx	STM811S	STM	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8AQx	STM811R	STM	mrc	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8ARx	STM812L	STM	mrc	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8ASx	STM812M	STM	mrc	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8ATx	STM812T	STM	mrc	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8AUx	STM812S	STM	mrc	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8AVx	STM812R	STM	mrc	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<15мкА	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
92V	BFP92A	TELEF	npn	V_{CBO}=20В; I_C=30мА; P_D=200мВт; h_{21}=50...150; f_T=6ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
97p	BCV65	PHIL	pnp(1)+npn(2)	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=75...800	SOT143, TO253	C2•B1, B2•C1•E1, E2
98p	BCV65B	PHIL	pnp(1)+npn(2)	V_{CBO}=30В; I_C=100мА; P_D=250мВт; h_{21}=200...475	SOT143, TO253	C2•B1, B2•C1•E1, E2
A	MRF947T3	MOT	npn	V_{CBO}=20В; I_C=50мА; P_D=188мВт; h_{21}>50; f_T=8000МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
A03	VAM-3	MC	amp	V_{CC}=4.7В; I_{CC}=35мА; f_P=0...2ГГц; GAIN=9.5дБ	SOT143, TO253	VCC, RF-OUT•GND•RF-IN•GND
A06	VAM-6	MC	amp	V_{CC}=3.3В; I_{CC}=16мА; f_P=0...2ГГц; GAIN=10дБ	SOT143, TO253	VCC, RF-OUT•GND•RF-IN•GND
A07	VAM-7	MC	amp	V_{CC}=3.8В; I_{CC}=22мА; f_P=0...2ГГц; GAIN=9.8дБ	SOT143, TO253	VCC, RF-OUT•GND•RF-IN•GND
A1	1SS272	TOSH	di x2	V_R>80В; I_F<300мА; V_F(I_F=100мА)<1.2В; I_R<0.5мкА; tRR<4нс	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
A1	1SS382	TOSH	di x2	V_R<80В; I_F<300мА; V_F(I_F=100мА)<1.2В; I_R<0.5мкА; tRR<4нс	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1
A2	CFY30	SIEM	nFET	GaAs; V_{DS}=5В; I_D=80мА; P_D=250мВт; I_{DSS}=15...60мА; g_F=30мСм	SOT143, TO253	S•D•S•G
A3	1SS306	TOSH	di x2	V_R<200В; I_F<300мА; V_F(I_F=100мА)<1.2В; t_{RR}<60нс	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
A4	1SS319	TOSH	di x2	V_R<40В; I_F<300мА; V_F(I_F=100мА)<0.6В; I_R(V_R=40В)<5мкА	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
A4	1SS383	TOSH	shd x2	V_R<40В; V_F(I_F=100мА)<0.6В; I_R(V_R=40В)<5мкА; C_T<25пФ	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1
A5	1SS384	TOSH	shd x2	V_R<15В; V_F(I_F=100мА)<0.5В; I_R(V_R=10В)<20мкА; C_T<40пФ	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1

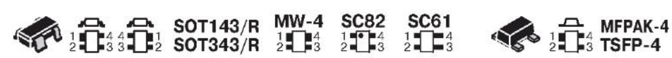
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
A5	1SS391	TOSH	shd x2	V_R < 10 В; V_F (I_F = 100 мА) < 0.5 В; I_R (V_R = 10 В) < 20 мкА; C_T < 20 пФ	SC61, MPAK-4	K1 • K2 • A2 • A1
A5	HSMS2805	HP	shd x2	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ; R_D = 35 Ом	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
A51	BRY62	PHIL	pnp/npn	V_{CB0} = 70 В; I_C = 175 мА; P_D = 250 мВт; h_{21NPN} > 50; h_{21PNP} > 3	SOT143, TO253	AG • A • C • CG
A6	1SS399	TOSH	di x2	V_R < 400 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.3 В; I_R < 1.0 мкА	SC61, MPAK-4	K1 • K2 • A2 • A1
A61	BAS28	CSI	fid x2	I_F < 250 мА; V_{BR} > 75 В; V_F (I_F = 10 мА) < 0.855 В; I_R < 1000 нА; t_{RR} < 6.0 нс; C_D < 2.0 пФ	SOT143, TO253	A1 • A2 • K2 • K1
A7	1SS402	TOSH	shd x2	V_R > 20 В; V_F (I_F = 50 мА) < 0.55 В; I_R (V_R = 20 В) < 0.5 мкА; C_T < 5 пФ	SC82, USQ	A1 • A2 • K2 • K1
A7	HSMS2807	HP	shd x4	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ; R_D = 35 Ом	SOT143, TO253	K1, A4 • K4, A3 • K3, A2 • K2, A1
A8	HSMS2808	HP	shd x4	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ; R_D = 35 Ом	SOT143, TO253	K1, K4 • A4, K3 • A3, A2 • K2, A1
AAB	MAX6711LXS	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAC	MAX6711MXS	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAD	MAX6711TXS	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAE	MAX6711SXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAF	MAX6711RXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAG	MAX6711ZXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAH	MAX6712LXS	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAI	MAX6712MXS	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAJ	MAX6712TXS	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAK	MAX6712SXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAL	MAX6712RXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAM	MAX6712ZXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAN	MAX6713LXS	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAO	MAX6713MXS	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAP	MAX6713TXS	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAQ	MAX6713SXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAR	MAX6713RXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAS	MAX6713ZXS	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAT	MAX6384XS16D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.58 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAU	MAX6385XS26D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAV	MAX6386XS17D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.67 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
AAW	MAX6387XS31D3	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • RES IN • VCC
AAX	MAX6388XS29D1	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • RES IN • VCC
AAY	MAX6389XS22D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.2 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • RES IN • VCC
AAZ	MAX6390XS26D4	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
ABA	MAX6384XS46D2	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT343, SC82A	GND • RES • MR • VCC
ACs	BFP620F	SIEM	npn	V_{CB0} = 7.5 В; I_C = 80 мА; P_D = 185 мВт; h_{21} = 110...270; f_T = 65 ГГц	TSFP-4	B • E • C • E
AE	1SS383T1G	ON	shd x2	V_R < 40 В; V_F (I_F = 100 мА) < 0.6 В; I_R (V_R = 40 В) < 5 мкА; C_T < 25 пФ	SC82, USQ	A1 • A2 • K2 • K1
ALs	BFP405	SIEM	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 12 мА; P_D = 55 мВт; h_{21} = 50...150; f_T > 20 ГГц	SOT343, SC82A	B • E • C • E
AMs	BFP420	SIEM	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 160 мВт; h_{21} = 50...150; f_T > 20 ГГц	SOT343, SC82A	B • E • C • E
ANs	BFP450	SIEM	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 10 мА; P_D = 450 мВт; h_{21} = 50...150; f_T > 15 ГГц	SOT343, SC82A	B • E • C • E





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
APs	BFP520	INF	npn	V_{CB0} = 10 В; I_C = 40 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 70…200; f_T = 45 ГГц	SOT343, SC82A	B • E • C • E
ATs	BFP540	SIEM	npn	V_{CB0} = 14 В; I_C = 80 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 50…200; f_T = 30 ГГц	SOT343, SC82A	B • E • C • E
B08	SST6908	SIL	nFET	V_{DS} = 30 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} > 2 мА; g_F = 3 мСм	SOT143, TO253	G • PRDI • S • D
B09	SST6909	SIL	nFET	V_{DS} = 30 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} > 10 мА; g_F > 0.4 мСм	SOT143, TO253	G • PRDI • S • D
B10	SST6910	SIL	nFET	V_{DS} = 30 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} > 10 мА; g_F > 1.2 мСм	SOT143, TO253	G • PRDI • S • D
B5	HSMS2815	HP	shd x2	V_{BR} > 20 В; V_F(I_F = 35 мА) < 1.0 В; I_R(V_R = 15 В) < 200 нА; C_T < 1.2 пФ; R_D = 15 Ом	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
B7	HSMS2817	HP	shd x4	V_{BR} > 20 В; V_F(I_F = 35 мА) < 1.0 В; I_R(V_R = 15 В) < 200 нА; C_D < 1.2 пФ; R_D = 15 Ом	SOT143, TO253	K1, A4 • K4, A3 • K3, A2 • K2, A1
B8	HSMS2818	HP	shd x4	V_{BR} > 20 В; V_F(I_F = 35 мА) < 1.0 В; I_R(V_R = 15 В) < 200 нА; C_D < 1.2 пФ; R_D = 15 Ом	SOT143, TO253	K1, K4 • A4, K3 • A3, A2 • K2, A1
BB	1SV237	TOSH	pin x2	V_R > 50 В; I_F < 50 мА; V_F(I_F = 50 мА) = 0.95 В; I_R < 0.1 мкА	SC61, MPAK-4	K1 • K2 • A2 • A1
BB	1SV312	TOSH	pin x2	V_R > 50 В; I_F < 50 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1 В; I_R < 0.1 мкА	SC82, USQ	A1 • A2 • K2 • K1
BBs	BAR81	INF	di	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; I_R < 0.02 мкА; C_D < 0.6 пФ	SOT143, TO253	K • A • K • A
BBs	BAR81W	INF	di	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1 В; I_R < 0.02 мкА; C_D < 0.6 пФ	SOT343, SC82A	K • A • K • A
BLs	BGA310	INF	amp	I_{CC} = 60 мА; G_{MA} = 9 дБ (f_T = 1 ГГц)	SOT143, TO253	OUT/BIAS • GND • IN • GND
BLs	BGA420	SIEM	amp	I_{CC} = 15 мА; G_{MA} = 13 дБ (f_T = 1.8 ГГц)	SOT343, SC82A	IN • GND • OUT • VD
BMs	BGA312	INF	amp	I_{CC} = 60 мА; G_{MA} = 11 дБ (f_T = 1 ГГц)	SOT143, TO253	OUT/BIAS • GND • IN • GND
BMs	BGA427	INF	amp	V_{CC} = 2…5 В; I_{CC} = 25 мА; G_{MA} = 18.5 дБ (f_T = 1.8 ГГц)	SOT343, SC82A	IN • GND • VD • OUT
BNs	BGA318	INF	amp	I_{CC} = 60 мА; G_{MA} = 16 дБ (f_T = 1 ГГц)	SOT143, TO253	OUT/BIAS • GND • IN • GND
BNs	BGA612	INF	amp	V_{CC} = 2.4…3 В; I_{CC} = 80 мА; G_{MA} = 17 дБ (f_T = 1 ГГц)	SOT343, SC82A	IN • GND • OUT • GND
BOs	BGA614	INF	amp	V_{CC} = 2.4…3 В; I_{CC} = 80 мА; G_{MA} = 17 дБ (f_T = 1 ГГц)	SOT343, SC82A	IN • GND • OUT • GND
BPs	BGA616	INF	amp	V_{CC} = 4.5…6 В; I_{CC} = 80 мА; G_{MA} = 17 дБ (f_T = 1 ГГц)	SOT343, SC82A	IN • GND • OUT • GND
BRs	BGA622	INF	amp	V_{CC} = 2.4…3 В; f_{BD} = 0.5…6 ГГц)	SOT343, SC82A	IN • GND • OUT • VCC
C5	HSMS2825	HP	shd x2	V_{BR} > 15 В; V_F(I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R(V_R = 1 В) < 100 нА; C_D < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
C7	HSMS2827	HP	shd x4	V_{BR} > 15 В; V_F(I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R(V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT143, TO253	K1, A4 • K4, A3 • K3, A2 • K2, A1
C8	HSMS2828	HP	shd x4	V_{BR} > 15 В; V_F(I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R(V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT143, TO253	K1, K4 • A4, K3 • A3, A2 • K2, A1
C9	HSMS2829	HP	shd x4	V_{BR} > 15 В; V_F(I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R(V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT143, TO253	K1, A2 • A3, K4 • A4, K2 • K3, A1
C95	BCV64	PHIL	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110…800; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, C2 • C1 • E1, E2 • B2
C96	BCV64B	PHIL	pnp x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 220…475; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, C2 • C1 • E1, E2 • B2
D1	SST211	TEMIC	nFET	V_{DS} = 30 В; P_D = 300 мВт; I_{DSS} = 4…20 мА; $R_{DS(on)}$ < 50 Ом	SOT143, TO253	SUBSTR • S • D • G
D3	SST213	TEMIC	nFET	V_{DS} = 10 В; P_D = 300 мВт; I_{DSS} = 4…20 мА; $R_{DS(on)}$ < 50 Ом	SOT143, TO253	SUBSTR • S • D • G
D5	SST215	TEMIC	nFET	V_{DS} = 20 В; P_D = 300 мВт; I_{DSS} = 4…20 мА; $R_{DS(on)}$ < 50 Ом	SOT143, TO253	SUBSTR • S • D • G
D89	BAT74	STM	shd x2	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 1 мА) < 320 мВ; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
D95	BCV63	PHIL	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110…800; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, C2 • C1 • E1, E2 • B2
D96	BCV63B	PHIL	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 200…450; f_T > 100 МГц	SOT143, TO253	B1, C2 • C1 • E1, E2 • B2
DF_	MAX2611EUS	MAX	amp	V_{CC} = 5 В; f_P = 0…1100 МГц; I_{CC} < 40 мА	SOT143, TO253	OUT • GND • IN • GND
DG_	MAX2630EUS	MAX	amp	V_{CC} = 2.7…5.5 В; f_P < 900 МГц; I_{CC} = 6.6 мА	SOT143, TO253	OUT • GND • IN • VCC
DHAA	MAX2650EUS	MAX	amp	V_{CC} = 4.5…5.5 В; f_P < 900 МГц; I_{CC} < 22 мА	SOT143, TO253	OUT • GND • IN • VCC

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
DI	2SC3867	REN	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 20...200; f_T > 1400 МГц	SOT343, SC82A	B • E • C • п. с.
EC	2SC2732	REN	npn	V_{CBO} = 30 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 30; f_T > 700 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
EI	3SK182	REN	nMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 50 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 10 дБ; NF < 6.0 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
F05	TSDF1205	TELEF	npn	V_{CBO} = 9 В; I_C = 12 мА; P_D = 40 мВт; h_{21} = 50...250; f_T = 12 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
F20	TSDF1220	TELEF	npn	V_{CBO} = 9 В; I_C = 40 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 12 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
FAs	BFP81	SIEM	npn	V_{CBO} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 280 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 5800 МГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
FB	BFP17	INF	npn	V_{CBO} = 12 В; I_C = 50 мА; P_D = 280 мВт	SOT143, TO253	E • C • E • B
FC	BFP29	SIEM	npn	V_{CBO} = 15 В; I_C = 30 мА; P_D = 280 мВт	SOT143, TO253	E • C • E • B
FEs	BFP93A	SIEM	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 6000 МГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
FI	3SK186	REN	nMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 16 дБ; NF < 4.5 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
G2	CGY50	SIEM	amp	GaAs; V_{CC} = 2.7...6 В; f_{BD} = 0.1...3 ГГц	SOT143, TO253	GND/S • OUT/D • GND/S • IN/G
G5	HSMP3895	HP	pin x2	I_F < 1 А; P_D < 250 мВт; V_{BR} > 100 В; R_S < 2.5 Ом; CT < 0.30 пФ	SOT143, TO253	A1 • A2 • K2 • K1
GC	2SC2734	REN	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 20...200; f_T > 1.4 ГГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
GIA	2SC3957A	REN	dnpn	V_{CBO} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 2000...100000	SOT143, TO253	C • п. с. • B • E
GIB	2SC3957B	REN	dnpn	V_{CBO} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 5000...100000	SOT143, TO253	C • п. с. • B • E
HC	2SC2733	REN	npn	V_{CBO} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 60; f_T > 600 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
HG	CFY77-08	SIEM	nFET	AlGaAs/InGaAs HEMT; V_{DS} = 3.5 В; I_D = 60 мА; P_D = 180 мВт; NF = 0.8 дБ	MW-4	S • D • S • G
HH	CFY77-10	SIEM	nFET	AlGaAs/InGaAs HEMT; V_{DS} = 3.5 В; I_D = 60 мА; P_D = 180 мВт; NF = 1 дБ	MW-4	S • D • S • G
HHs	BBY51-07	INF	var x2	V_R < 7 В; I_F < 20 мА; I_R < 0.01 мкА; C_{1B} = 4.8...6.0 пФ; C_{2B}/C4V = 1.55...2.15	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
HI	3SK188	REN	nMOS	V_{DS} = 22 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 18 дБ; NF < 3.2 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
ID	2SC3127	REN	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; P_G = 10.5 дБ; f_T > 3500 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
IJ	2SC3374	REN	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 20...200; f_T > 400 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
IL	2SC3493	REN	npn	V_{CBO} = 15 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 30...200; f_T > 700 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
IP	2SC3793	REN	npn	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 1400 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
IS	2SC3513	REN	npn	V_{CBO} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...250; f_T > 4500 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
IT	3SK162	REN	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 18 дБ; NF < 3.0 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
IV	2SK668	REN	nFET	GaAs; V_{DS} = 6.0 В; I_D = 100 мА; P_{CH} = 150 мВт; P_G = 10 дБ; NF = 2.5 дБ	SOT343, SC82A	G • S • D • G
IV	3SK136	REN	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 17 дБ; NF < 3.3 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
IW	3SK137	REN	dnMOS	V_{DS} = 15 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 10 дБ; NF < 5.0 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
IW	3SK137V	REN	dnMOS	V_{DS} = 15 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 20 дБ; NF < 3.0 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
IX	3SK138	REN	dnMOS	V_{DS} = 15 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 10 дБ; NF < 5.0 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1



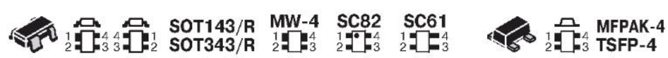


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
IY	3SK194	REN	nMOS	V_{DS} = 15 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 27 дБ; NF < 2.5 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
IZ	3SK154	REN	dnMOS	V_{DS} = 15 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 22 дБ; NF < 3.0 дБ	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
JC	2SC2735	REN	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 40; f_T > 600 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • п. с.
JKs	BF1009	INF	dnMOS	V_{DS} = 12В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 24 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
JLs	BF1009S	INF	dnMOS	V_{DS} = 12В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 30 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
JLs	BF1009SR	INF	dnMOS	V_{DS} = 12В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 30 мСм	SOT143R	D • S • G1 • G2
JPs	BAW101	SIEM	di x2	V_R < 300 В; I_F < 250 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.3 В; I_R < 0.15 мкА; C_D < 6.0 пФ; t_{RR} < 1000 нс	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
JSs	BAW100	SIEM	di x2	V_R < 75В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 1.0 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT143, TO253	A1 • A2 • K2 • K1
JTp	BAS28	PHIL	fd x2	V_R < 75В; I_F < 215 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1.0В; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
JTs	BAS28	INF	di x2	V_R < 75В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
JTs	BAS28W	INF	di x2	V_R < 75В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT343, SC82A	K1 • K2 • A2 • A1
JXAA	MAX6160EUS	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; I_{CC} < 130 мкА; V_{OUT} = 1.23...12.4 В	SOT143, TO253	GND • ADJ • IN • OUT
KAAP	MAX6335US16D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAQ	MAX6335US18D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.8В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAR	MAX6335US22D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.2В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAS	MAX6336US16D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAT	MAX6336US18D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.8В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAU	MAX6336US20D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.0В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAV	MAX6336US22D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.2В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAW	MAX6336US23D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.3В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAX	MAX6337US16D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAY	MAX6337US18D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.8В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KAAZ	MAX6337US22D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.2В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KABA	MAX6816EUS	MAX	swd	V_{CC} = 2.7...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT143, TO253	GND • IN • OUT • VCC
KABP	MAX6335US20D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.0В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KABQ	MAX6335US23D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.3В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KABR	MAX6337US20D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.0В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KABS	MAX6337US23D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.3В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KABT	MAX6806US46	MAX	vd	V_{TR} = 4.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 80 мкА	SOT143, TO253	RES • MR • VCC • GND
KABU	MAX6806US26	MAX	vd	V_{TR} = 2.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 80 мкА	SOT143, TO253	RES • MR • VCC • GND
KABV	MAX6806US23	MAX	vd	V_{TR} = 2.3В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 80 мкА	SOT143, TO253	RES • MR • VCC • GND
KABW	MAX6807US46	MAX	vd	V_{TR} = 4.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 80 мкА	SOT143, TO253	RES • MR • VCC • GND
KABX	MAX6807US26	MAX	vd	V_{TR} = 2.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 80 мкА	SOT143, TO253	RES • MR • VCC • GND
KABY	MAX6808US46	MAX	vd	V_{TR} = 4.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 80 мкА	SOT143, TO253	RES • MR • VCC • GND
KABZ	MAX6808US26	MAX	vd	V_{TR} = 2.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 80 мкА	SOT143, TO253	RES • MR • VCC • GND
KACA	MAX6336US25D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACB	MAX6337US17D3	MAX	mrc	V_{TR} = 1.7В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACC	MAX6808US32	MAX	vd	V_{TR} = 3.2В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 80 мкА	SOT143, TO253	RES • MR • VCC • GND
KACE	MAX6337US16D2	MAX	mrc	V_{TR} = 1.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACF	MAX6336US24D1	MAX	mrc	V_{TR} = 2.4В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 7 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACH	MAX6803US26D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACI	MAX6803US29D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACJ	MAX6803US31D3	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACK	MAX6803US44D3	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACL	MAX6803US46D3	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACN	MAX6804US26D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC

MFPAK-4 TSFP-4 **SC61** **SC82** **MW-4** **SOT143R SOT343R**

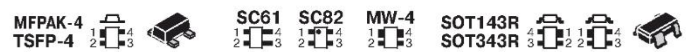



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
KACO	MAX6804US29D2	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACP	MAX6804US29D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACQ	MAX6804US31D3	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACR	MAX6804US44D3	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACS	MAX6804US46D3	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACT	MAX6805US26D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACU	MAX6805US29D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACV	MAX6805US31D3	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACW	MAX6805US44D3	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACX	MAX6805US46D3	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 12 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
L30	BAV23	PHIL	d x2	V_R < 200 В; I_F < 225 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 1.0 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
L41	BAT74	PHIL	shd x2	V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 1 мА) < 320 мВ; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
L51	BAS56	PHIL	fd x2	V_R < 60 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 200 мА) < 1.0 В; C_D < 2.5 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
L51	BAS56	CNTRL	fd x2	V_R < 60 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 200 мА) < 1.0 В; C_D < 2.5 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
L51	BAS56	CSI	fid x2	V_{BR} > 60 В; I_F < 200 мА; V_F(I_F = 10 мА) < 0.75 В; I_R < 100 нА; t_{RR} < 6.0 нс; C_D < 2.5 пФ	SOT143, TO253	A1 • A2 • K2 • K1
M	BAR6507	SIEM	pin x2	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 50 мА) < 1.0 В; C_D < 0.9 пФ	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
M01	BF901	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_{DS} = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 28 мс	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M02	BF901R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_{DS} = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 28 мс	SOT143R	S • D • G2 • G1
M04	BF904	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 7 В; I_{DS} = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 25 мс	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M06	BF904R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 7 В; I_{DS} = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 25 мс	SOT143R	S • D • G2 • G1
M26	BF908	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_{DS} = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 43 мс	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M27	BF908R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_{DS} = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 43 мс	SOT143R	S • D • G2 • G1
M28	BF909	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 7 В; I_{DS} = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 43 мс	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M29	BF909R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 7 В; I_{DS} = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 43 мс	SOT143R	S • D • G2 • G1
M31	BSD20	PHIL	nMOS	V_{DS} = 10 В	SOT343, SC82A	G • S • D
M32	BSD22	PHIL	nMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 50 мА; P_D = 230 мВт	SOT143, TO253	SUB • S • D • G
M52	BF992R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 25 мСм	SOT143R	S • D • G2 • G1
M56	BF1100	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 14В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 28 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M57	BF1100R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 14В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 28 мСм	SOT143R	S • D • G2 • G1
M74	BSS83	PHIL	nMOS	V_{DS} = 10 В; I_D = 50 мА; P_D = 230 мВт; $R_{DS(on)}$ < 45 Ом	SOT143, TO253	SUB • S • D • G
M87	BF990A	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 2 дБ; g_F > 18 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M90	BF990	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 2 дБ; g_F > 18 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M91	BF991	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 20 мА; P_D = 200 мВт; NF = 2 дБ; g_F > 14 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M92	BF992	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 25 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M94	BF994	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; I_{DS} = 4...18 мА; g_F > 15 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M96	BF996	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.8 дБ; I_{DSS} = 2...20 мА; g_F > 15 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MAp	BF989	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_{DS} = 20 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 12 мс	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MB	BF995	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.1 дБ; I_{DSS} = 4...20 мА; g_F > 12 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MB	BF995	TELEF	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; I_{DS} = 4...18 мА; g_F > 12 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MB	BF998WR	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 24мСм	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
MB3	ADM811-3TART	AD	mrc	V_{TR} = 3.08 В; t_{RES} = 300...700 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC



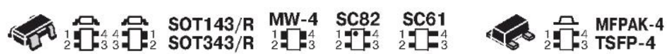


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
MBB	ADM811RART	AD	mrc	V_{TR} = 2.63 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MBE	ADM811SART	AD	mrc	V_{TR} = 2.93 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MBG	ADM811TART	AD	mrc	V_{TR} = 3.08 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MBT	ADM811MART	AD	mrc	V_{TR} = 4.38 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MBV	ADM811LART	AD	mrc	V_{TR} = 4.63 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MBZ	ADM811ZART	AD	mrc	V_{TR} = 2.32 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MC	BF904WR	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 7 В; I_{DS} = 30 мА; P_D = 280 мВт; g_F = 25 мс	SOT343R	S • D • G2 • G1
MCB	ADM812RART	AD	mrc	V_{TR} = 2.63 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MCE	ADM812SART	AD	mrc	V_{TR} = 2.93 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MCG	ADM812TART	AD	mrc	V_{TR} = 3.08 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MCT	ADM812MART	AD	mrc	V_{TR} = 4.38 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MCV	ADM812LART	AD	mrc	V_{TR} = 4.63 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MCZ	ADM812ZART	AD	mrc	V_{TR} = 2.32 В; t_{RES} = 140...560 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES/RES • MR • VCC
MD	BF908WR	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_{DS} = 40 мА; P_D = 300 мВт; g_F = 43 мс	SOT343R	S • D • G2 • G1
MDB	ADM6315-26D1ART	AD	mrc	V_{TR} = 2.63 В; t_{RES} = 1 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MDC	ADM6315-29D1ART	AD	mrc	V_{TR} = 2.93 В; t_{RES} = 1 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MDG	ADM6315-31D1ART	AD	mrc	V_{TR} = 3.08 В; t_{RES} = 1 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MDT	ADM6315-44D1ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.39 В; t_{RES} = 1 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MDU	ADM6315-45D1ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.5 В; t_{RES} = 1 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MDV	ADM6315-46D1ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.63 В; t_{RES} = 1 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MEB	ADM6315-26D2ART	AD	mrc	V_{TR} = 2.63 В; t_{RES} = 20 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MEC	ADM6315-29D2ART	AD	mrc	V_{TR} = 2.93 В; t_{RES} = 20 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MEG	ADM6315-31D2ART	AD	mrc	V_{TR} = 3.08 В; t_{RES} = 20 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MET	ADM6315-44D2ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.39 В; t_{RES} = 20 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MEU	ADM6315-45D2ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.5 В; t_{RES} = 20 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MEV	ADM6315-46D2ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.63 В; t_{RES} = 20 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MF	BF1100WR	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 14 В; I_D = 30 мА; P_D = 280 мВт; g_F = 28 мСм	SOT343R	S • D • G2 • G1
MFB	ADM6315-26D3ART	AD	mrc	V_{TR} = 2.63 В; t_{RES} = 140 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MFC	ADM6315-29D3ART	AD	mrc	V_{TR} = 2.93 В; t_{RES} = 140 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MFG	ADM6315-31D3ART	AD	mrc	V_{TR} = 3.08 В; t_{RES} = 140 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MFT	ADM6315-44D3ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.39 В; t_{RES} = 140 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MFU	ADM6315-45D3ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.5 В; t_{RES} = 140 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MFV	ADM6315-46D3ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.63 В; t_{RES} = 140 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MG	BF994S	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1 дБ; I_{DSS} = 2...20 мА; g_F > 15 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MG	BF994S	TELEF	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; I_{DS} = 4...18 мА; g_F > 15 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MGB	ADM6315-26D4ART	AD	mrc	V_{TR} = 2.63 В; t_{RES} = 1120 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MGC	ADM6315-29D4ART	AD	mrc	V_{TR} = 2.93 В; t_{RES} = 1120 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MGG	ADM6315-31D4ART	AD	mrc	V_{TR} = 3.08 В; t_{RES} = 1120 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MGp	BF994S	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; I_{DS} = 4...18 мА; g_F > 15 мСм	SOT143, TO253	S • D • G1 • G2
MGT	ADM6315-44D4ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.39 В; t_{RES} = 1120 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MGU	ADM6315-45D4ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.5 В; t_{RES} = 1120 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC



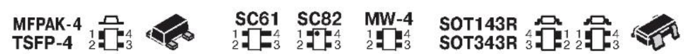


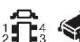
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
MGV	ADM6315-46D4ART	AD	mrc	V_{TR} = 4.63 В; t_{RES} = 1120 мс; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 15 мкА	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
MH	BF996S	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.8 дБ; I_{DSS} = 2...20 мА; g_F > 15 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MH	BF996S	TELEF	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; I_{DS} = 4...20 мА; g_F > 15 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MH	BF996S	VIS	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.8 дБ; g_F > 18 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MHp	BF996S	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.8 дБ; g_F > 18 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MI	2SC4126	REN	npn	V_{CBO} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...250; f_T > 4500 МГц	SOT343, SC82A	C • E • B • E
MK	BF997	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.0 дБ; I_{DSS} = 2...20 мА; g_F > 15мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MO	BF998	VIS	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; I_{DS} = 4...18 мА; g_F > 21мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MOp	BF998	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 24мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MOp	BF998R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 24мСм	SOT143R	S • D • G2 • G1
MOR	BF998R	VIS	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; I_{DS} = 4...18 мА; g_F > 21мСм	SOT143R	S • D • G2 • G1
MOs	BF998	INF	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.0 дБ; I_{DSS} = 2...20 мА; g_F = 24 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MR	BF998W	INF	dnMOS	V_{DS} = 12В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.0 дБ; I_{DSS} = 2...18 мА; g_F = 24 мСм	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
MRs	BF998R	INF	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.0 дБ; I_{DSS} = 2...20 мА; g_F = 24 мСм	SOT143R	S • D • G2 • G1
Ms	BAR65-07	INF	pin x2	V_R < 30 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.0 В; C_D < 0.9 пФ	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
MS	CF739	SIEM	nFET	GaAs; V_{DS} = 10 В; I_D = 80 мА; P_D = 240 мВт; I_{DSS} = 6...60 мА; g_F = 25 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MX	CF750	SIEM	nFET	GaAs; V_{DS} = 8В; I_D = 80 мА; P_D = 300 мВт; I_{DSS} = 50 мА; g_F = 25 мСм	SOT143, TO253	GND • D • G • S
MYs	BF1012	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 16В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.4 дБ; g_F = 26 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MYs	BF1012W	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 16В; I_D = 40 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.4 дБ; g_F = 26мСм	SOT343, SC82A	D • S • G1 • G2
MZs	BF1005	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 8В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.4 дБ; g_F = 24 мСм	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
N20	DA227	ROHM	di x2	V_R < 80 В; I_F < 300 мА; P_D < 200 мВт; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; t_{RR} < 4 нс	SOT343, SC82A	K1 • A1 • A2 • K2
N3	BFG520W	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 70 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 60; f_T = 9 ГГц	SOT343, SC82A	C • B • E • E
N33	BFG505	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 18 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 60; f_T = 9 ГГц	SOT143, TO253	C • B • E • E
N36	BFG520	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 70 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 60; f_T = 9 ГГц	SOT143, TO253	C • B • E • E
N37	BFG540	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 120 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 100; f_T = 9ГГц	SOT143, TO253	C • B • E • E
N38	BFG590	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 200 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 50; f_T = 5 ГГц	SOT143, TO253	C • B • E • E
N39	BFG505X	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 18 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 60; f_T = 9 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
N4	BFG520W/X	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 70 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 60; f_T = 9 ГГц	SOT343, SC82A	C • E • B • E
N42	BFG520/X	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 70 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 60; f_T = 9 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
N43	BFG540/X	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 120 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 100; f_T = 9ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
N44	BFG590X	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 200 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 50; f_T = 5 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
N48	BFG520/XR	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 70 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 60; f_T = 9 ГГц	SOT143R	C • E • B • E
N49	BFG540/XR	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 120 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 100; f_T = 9ГГц	SOT143R	C • E • B • E
N70	BFG10	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 250 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 25; f_T > 1.8 ГГц	SOT143, TO253	C • B • E • E
N71	BFG10/X	PHIL	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 250 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 25; f_T > 1.8 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E



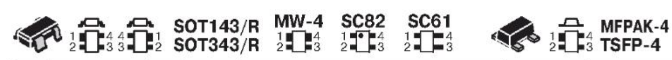


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
N72	BFG11	PHIL	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 500 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 25; f_T > 1.8 ГГц	SOT143, TO253	C•B•E•E
N73	BFG11/X	PHIL	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 500 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} > 25; f_T > 1.8 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
NA	BF1105WR	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 7 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 31 мСм	SOT343R	S•D•G2•G1
NA	CFY35-20	SIEM	nFET	GaAs; V_{DS} = 5В; I_D = 60 мА; P_D = 180 мВт; NF = 2.0 дБ	MW-4	S•D•S•G
NAp	BF1105R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 7 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 31 мСм	SOT143R	S•D•G2•G1
NB	BF1109WR	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 11 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 30 мСм	SOT343R	S•D•G2•G1
NB	CFY35-23	SIEM	nFET	GaAs; V_{DS} = 5В; I_D = 60 мА; P_D = 180 мВт; NF = 2.3 дБ	MW-4	S•D•S•G
NBp	BF1109R	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 11 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 30 мСм	SOT143R	S•D•G2•G1
NEp	BF1105	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 7 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 31 мСм	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
NFp	BF1109	PHIL	dnMOS	V_{DS} = 11 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; g_F = 30 мСм	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
NI	3SK191	REN	nFET	GaAs; V_{DS} = 12.0В; I_D = 80 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 12 дБ; NF < 3.0 дБ	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
NYs	BF1012S	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 16В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.4 дБ; g_F = 26 мСм	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
NZs	BF1005S	SIEM	dnMOS	V_{DS} = 8В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; NF = 1.6 дБ; g_F = 24 мСм	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
P5	HSMS2855	HP	shd x2	V_F (I_F = 1 мА) < 0.25 В; C_T = 0.3 пФ	SOT143, TO253	A1•A2•K2•K1
PAs	BFP136W	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 150 мА; P_D = 1000 мВт; h_{21} = 80...250; f_T > 5900 МГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
PTs	BAR6407	SIEM	pin x2	V_R < 200В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1.1 В; C_D < 0.35 пФ;	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
PTs	BAR64-07	INF	pin x2	V_R < 150В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1.1 В; C_D < 0.35 пФ	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
QI	2SC4196	REN	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...180; f_T > 1800 МГц	SOT343, SC82A	E•B•C•п. с.
QV	1SV298	SANYO	pin x3	V_R > 50В; I_F < 50 мА; V_F (I_F = 50 мА) = 0.92...0.97 В; I_R < 0.1 мкА	SOT143, TO253	K1, K2•A3•A2, K3•A1
R26	2SC4093Q	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 50...100; f_T = 7 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R26	2SC5011Q	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...100; f_T = 6.5 ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R27	2SC4093R	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 80...160; f_T = 7 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R27	2SC5011R	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 80...160; f_T = 6.5 ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R28	2SC4093S	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 125...250; f_T = 7 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R28	2SC5011S	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 125...250; f_T = 6.5 ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R2s	BFP620	SIEM	npn	V_{CB0} = 7.5 В; I_C = 80 мА; P_D = 185 мВт; h_{21} = 110...270; f_T = 65 ГГц	SOT343, SC82A	B•E•C•E
R36	2SC4094Q	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 50...100; f_T = 9 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R36	2SC5012Q	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...100; f_T = 9 ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R37	2SC4094R	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 80...160; f_T = 9 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R37	2SC5012R	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 80...160; f_T = 9 ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R38	2SC4094S	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 125...250; f_T = 9 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R38	2SC5012S	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 125...250; f_T = 9 ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R4	2SC4092	NEC	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 70 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 40...120; f_T = 6 ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E






Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
R46	2SC4095Q	NEC	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 35мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 50...100; f_T = 10ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R46	2SC5013Q	NEC	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 35мА; P_D = 150мВт; h_{21} = 50...100; f_T = 10ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R47	2SC4095R	NEC	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 35мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 80...160; f_T = 10ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R47	2SC5013R	NEC	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 35мА; P_D = 150мВт; h_{21} = 80...160; f_T = 10ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R48	2SC4095S	NEC	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 35мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 125...250; f_T = 10ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R48	2SC5013S	NEC	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 35мА; P_D = 150мВт; h_{21} = 125...250; f_T = 10ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R4s	BFP640	SIEM	npn	V_{CBO} = 13В; I_C = 50мА; P_D = 185мВт; h_{21} = 110...270; f_T = 40ГГц	SOT343, SC82A	B•E•C•E
R5	2SC4092	NEC	npn	V_{CBO} = 25В; I_C = 70мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 6ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R5	HSMS-8205	HP	shd x2	V_{BR} > 4В; V_F (I_F = 1мА) < 0.35В; C_D < 0.26пФ; R_D = 14Ом	SOT143, TO253	A1•A2•K2•K1
R54	2SC5454	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 50мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 14.5ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R54	2SC5750	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 50мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 15ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
R54	2SC5751	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 50мА; P_D = 205мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 15ГГц	MFPAK-4	E•C•E•B
R54	NE67718	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 50мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 15ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
R54	NE67739	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 50мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 14.5ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R54	NE677M04	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 50мА; P_D = 205мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 15ГГц	MFPAK-4	E•C•E•B
R55	2SC5455	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R55	2SC5752	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
R55	2SC5753	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 100мА; P_D = 205мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12ГГц	MFPAK-4	E•C•E•B
R55	NE67818	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
R55	NE67839	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R55	NE678M04	NEC	npn	V_{CBO} = 9В; I_C = 100мА; P_D = 205мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12ГГц	MFPAK-4	E•C•E•B
R5s	BFP650	SIEM	npn	V_{CBO} = 13В; I_C = 150мА; P_D = 500мВт; h_{21} = 110...270; f_T = 37ГГц	SOT343, SC82A	B•E•C•E
R66	2SC4091Q	NEC	npn	V_{CBO} = 15В; I_C = 5мА; P_D = 50мВт; h_{21} = 50...100; f_T > 4ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R67	2SC4091R	NEC	npn	V_{CBO} = 15В; I_C = 5мА; P_D = 50мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 4ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R68	2SC4091S	NEC	npn	V_{CBO} = 15В; I_C = 5мА; P_D = 50мВт; h_{21} = 125...250; f_T > 4ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
R7	HSMS-8207	HP	shd x4	V_{BR} > 4В; V_F (I_F = 1мА) < 0.35В; C_D < 0.26пФ; R_D = 14Ом	SOT143, TO253	A1, K4•A2, K1•A3, K2•A4, K3
R8	BFG93A	PHIL	npn	V_{CBO} = 15В; I_C = 35мА; P_D = 300мВт; h_{21} > 40; f_T > 4.5ГГц	SOT143, TO253	C•B•E•E
R9	HSMS-8209	HP	shd x4	V_{BR} > 4В; V_F (I_F = 1мА) < 0.35В; C_D < 0.26пФ; R_D = 14Ом	SOT143, TO253	A1, K4•A2, K3•A3, K1•A4, K2
RAs	BF772	SIEM	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 80мА; P_D = 580мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RCs	BFP193	SIEM	npn	V_{CBO} = 20В; I_C = 80мА; P_D = 580мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E

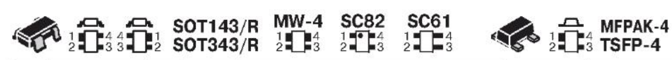




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
RCs	BFP193W	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 80 мА; P_D = 580 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
RDs	BFP180	SIEM	npn	V_{CB0} = 10 В; I_C = 4 мА; P_D = 30 мВт; h_{21} = 30...200; f_T = 6200 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RDs	BFP180W	SIEM	npn	V_{CB0} = 10 В; I_C = 4 мА; P_D = 30 мВт; h_{21} = 30...200; f_T > 6200 МГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
REs	BFP280	SIEM	npn	V_{CB0} = 10 В; I_C = 10 мА; P_D = 80 мВт; h_{21} = 30...200; f_T > 7000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
REs	BFP280W	SIEM	npn	V_{CB0} = 10 В; I_C = 10 мА; P_D = 80 мВт; h_{21} = 30...200; f_T > 7000 МГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
RFs	BFP181	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 20 мА; P_D = 175 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RFs	BFP181R	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 20 мА; P_D = 175 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RFs	BFP181W	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 20 мА; P_D = 175 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
RGs	BFP182	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RGs	BFP182R	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RGs	BFP182W	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 8300 МГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
RHs	BFP183	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 450 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RHs	BFP183R	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 8000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RHs	BFP183W	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 450 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
RKs	BFP194	SIEM	pnp	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 700 мВт; h_{21} = 20...150; f_T = 5000 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RIs	BFP196	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 700 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 7500 МГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
RIs	BFP196W	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 700 мВт; h_{21} = 50...200; f_T > 7200 МГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
S4	BBY62	PHIL	var x2	V_R < 30 В; I_F < 20 мА; C_{1B} = 16.5 пФ; C_{28B} = 1.6...2 пФ; C_{1B}/C_{28B} = 8.3	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
S5	BAT15099	SIEM	shd x2	V_R < 4 В; I_F < 110 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.32 В; C_D < 0.35 пФ	SOT143, TO253	K1•A2•K2•A1
S5s	BAT15-099	INF	shd x2	V_R < 4 В; I_F < 110 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.41 В; C_D < 0.35 пФ	SOT143, TO253	K1•A2•K2•A1
S6	BAT15099R	SIEM	shd x4	V_R < 4 В; I_F < 110 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.32 В; C_D < 0.38 пФ	SOT143, TO253	K1, A4•A3, K2•K4, A2•A1, K3
S6s	BAT15-099R	INF	shd x4	V_R < 4 В; I_F < 110 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.41 В; C_D < 0.35 пФ	SOT143, TO253	K1, A4•A3, K2•K4, A2•A1, K3
S7	BAT114-099	SIEM	shd x2	V_R < 4 В; I_F < 90 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.8 В; I_R = 5 мкА; C_D < 0.5 пФ	SOT143, TO253	K1•A2•K2•A1
S8	BAT14099R	SIEM	shd x4	V_R < 4 В; I_F < 90 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.48 В; C_D < 0.38 пФ	SOT143, TO253	K1, A4•A3, K2•K4, A2•A1, K3
S8s	BAT14-099R	INF	shd x4	V_R < 4 В; I_F < 90 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.48 В; C_D < 0.38 пФ	SOT143, TO253	A1, K4•A3, K2•K1, A2•K3, A4
S9	BAT14099	SIEM	shd x2	V_R < 4 В; I_F < 90 мА; $V_F(I_F$ = 10 мА) < 0.55 В; C_D < 0.35 пФ	SOT143, TO253	K1•A2•K2•A1
SN	BAT63099R	SIEM	shd x4	I_F < 50 мА; $V_F(I_F$ = 1 мА) < 0.3 В; C_D < 1.1 пФ	SOT143, TO253	A3, K1•A4, K2•K3, A2•A1, C4
T5	HSMS2865	HP	shd x2	V_{BR} > 5 В; $V_F(I_F$ = 30 мА) < 0.6 В; C_D < 0.30 пФ; R_D = 10 Ом	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
T78	2SC5507	NEC	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 12 мА; P_D = 39 мВт; h_{21} = 50...100; f_T > 20 ГГц	MFPAK-4	E•C•E•B
T79	2SC5508	NEC	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 115 мВт; h_{21} = 50...100; f_T > 20 ГГц	MFPAK-4	E•C•E•B

MFPAK-4 TSFP-4 SC61 SC82 MW-4 SOT143R SOT343R

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
T8	1SV306	TOSH	var x2	V_R > 15 В; I_R(V_R = 15 В) < 0.003 мкА; $C_{2В}$ = 14...16 пФ; $C_{10В}$ = 5.5...6.5 пФ	SC82, USQ	A1 • A2 • K2 • K1
T82	2SC4956	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 10 мА; P_D = 60 мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12 ГГц	SC61, MPAK-4	C • E • B • E
T82	2SC5014	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 10 мА; P_D = 60 мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12 ГГц	SOT343, SC82A	E • C • E • B
T83	2SC4957	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 180 мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12 ГГц	SC61, MPAK-4	C • E • B • E
T83	2SC5015	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12 ГГц	SOT343, SC82A	E • C • E • B
T84	2SC5178	NEC	npn	V_{CB0} = 5 В; I_C = 10 мА; P_D = 30 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 10.5 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
T84	2SC5180	NEC	npn	V_{CB0} = 5 В; I_C = 10 мА; P_D = 30 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 10 ГГц	SOT343, SC82A	E • C • E • B
T86	2SC5183	NEC	npn	V_{CB0} = 5 В; I_C = 30 мА; P_D = 90 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 9.5 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
T88	2SC5192	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 4 ГГц	SOT143, TO253	C • E • B • E
T89	2SC5288	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 150 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 60	SOT143, TO253	C • E • B • E
T90	2SC5289	NEC	npn	V_{CB0} = 9 В; I_C = 300 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 60	SOT143, TO253	C • E • B • E
TC	2SC2736	REN	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 30...200; f_T > 1400 МГц	SOT343, SC82A	E • B • C • n. c.
TI	2SC4197	REN	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...180; f_T > 3 ГГц	SOT343, SC82A	E • B • C • n. c.
TV	JDV4P08U	TOSH	var x2	V_R < 10 В; I_R < 0.003 мкА; $C_{1В}$ = 17.3...19.3 пФ; $C_{4В}$ = 5.3...6.6	SOT343, SC82A	A1 • A2 • K2 • K1
U1A	3SK230UAA	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 16 мСм; I_{DSS} = 0.01...3 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U1B	3SK230UAB	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 16 мСм; I_{DSS} = 0.01...3 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U1C	3SK231C	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; I_{DSS} = 0.01...10 мА	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
U1D	3SK231D	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; I_{DSS} = 0.01...10 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U1E	3SK252UAE	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 14 мСм; I_{DSS} = 0.1...5 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U1E	3SK254U1E	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 130 мВт; g_F > 14 мСм; I_{DSS} = 0.1...0.5 мА	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
U1G	3SK253UAG	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 14 мСм; I_{DSS} = 0.5...7 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U1G	3SK255U1G	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 130 мВт; g_F > 14 мСм; I_{DSS} = 0.1...7 мА	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
U1s	BGX50A	INF	di x4	V_R < 50 В; I_F < 140 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.3 В; I_R < 0.2 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 6 нс	SOT143, TO253	K1, K2 • K4, A1 • A4, A3 • A2, K3
U55	3SK134UEE	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 25 мСм; I_{DSS} = 0.4...5 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U55	3SK245	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 130 мВт; I_{DSS} = 0.4...8 мА	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
U56	3SK134UEF	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 25 мСм; I_{DSS} = 3...8 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U56	3SK245	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 130 мВт; I_{DSS} = 0.4...8 мА	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
U65	3SK135ALS	NEC	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 14 мСм; I_{DSS} = 0.01...2 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U66	3SK135AKS	NEC	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 14 мСм; I_{DSS} = 1...6 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U7	3SK320	TOSH	dnMESFET	V_{DS} = 6 В; I_D = 18 мА; P_D = 100 мВт; g_F = 22 мСм	SC82, USQ	G1 • G2 • D • S
U71	3SK177U71	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 5...15 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1
U71	3SK299	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 120 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 5...15 мА	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
U72	3SK177U72	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 10...25 мА	SC61, MPAK-4	S • D • G2 • G1

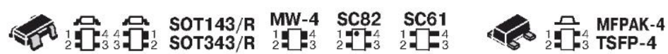




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
U72	3SK299	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 120 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 10...25 мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U72	NE25118	NEC	nMESFET	GaAs; V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 120 мВт; g_F = 25 мСм	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U73	3SK177U73	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 20...35 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U73	3SK299	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 120 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 20...35 мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U73	NE25118	NEC	nMESFET	GaAs; V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 120 мВт; g_F = 25 мСм	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U74	3SK177U74	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 30...40 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U74	3SK299	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 120 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 30...40 мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U74	NE25118	NEC	nMESFET	GaAs; V_{DS} = 13 В; I_D = 40 мА; P_D = 120 мВт; g_F = 25 мСм	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U76	3SK206	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 10 В; I_D = 80 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 25 мСм; I_{DSS} = 10...25 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U77	3SK206	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 10 В; I_D = 80 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 25 мСм; I_{DSS} = 20...35 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U78	3SK206	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 10 В; I_D = 80 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 25 мСм; I_{DSS} = 30...50 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U79	3SK206	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 10 В; I_D = 80 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 25 мСм; I_{DSS} = 45...80 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U87	3SK176AUHG	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 22 мСм; I_{DSS} = 1...6 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U88	3SK176AUHH	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 22 мСм; I_{DSS} = 4...10 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U90	3SK223UIO	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 15 мСм; I_{DSS} = 0.01...3 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U90	3SK243	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; I_{DSS} = 0.01...8 мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U91	3SK223UIA	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 15 мСм; I_{DSS} = 1...8 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U91	3SK243	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; I_{DSS} = 0.01...8 мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U94	3SK224UID	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 0.5...7 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U94	3SK244D	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 130 мВт; I_{DSS} = 0.5...15 мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U95	3SK224UIE	NEC	dnMOS	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 18 мСм; I_{DSS} = 5...15 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U95	3SK244E	NEC	dnMESFET	V_{DS} = 18 В; I_D = 25 мА; P_D = 130 мВт; I_{DSS} = 0.5...15 мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
UF	3SK293	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 12.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F > 22 мСм; I_{DSS} < 0.1 мА	SC82, USQ	D•S•G1•G2
UHGR	3SK260GR	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 13.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F = 27 мСм; I_{DSS} = 6...14 мА	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UHY	3SK260Y	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 13.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F = 27 мСм; I_{DSS} = 3...7 мА	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UI	3SK259	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 13.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F = 21 мСм; I_{DSS} < 2 мА	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UK	3SK294	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 12.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F > 19.5 мСм; I_{DSS} < 0.1 мА	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UN	3SK274	TOSH	dnMESFET	V_{GS} = 9 В; I_D = 20 мА; P_D = 100 мВт; I_{DSS} = 0.4...8 мА; g_F = 19 мСм	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UO	3SK249	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 12.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F > 17 мСм; I_{DSS} = 0.01...3 мА	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UR	3SK256	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 13.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F = 21.5 мСм; I_{DSS} < 0.1 мА	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UT	3SK257	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 13.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F = 21 мСм	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UU	3SK258	TOSH	dnMOS	V_{DS} = 13.5 В; I_D = 30 мА; P_D = 100 мВт; g_F = 13 мСм; I_{DSS} < 0.1 мА	SC82, USQ	G1•G2•D•S
V11	3SK131	NEC	dnMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 25 мА; P_D = 200 мВт; g_F > 22 мСм; I_{DSS} = 7...13 мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1

MFPAK-4 TSFP-4 SC61 SC82 MW-4 SOT143R SOT343R

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
V11	3SK242	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 130$ мВт; $I_{DSS} = 7...25$ мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V12	3SK131	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 200$ мВт; $g_F > 22$ мСм; $I_{DSS} = 11...19$ мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
V12	3SK242	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 130$ мВт; $I_{DSS} = 7...25$ мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V12	BFG67/X	PHIL	npn	$V_{CB0} = 10$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 8$ ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
V13	3SK131	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 200$ мВт; $g_F > 22$ мСм; $I_{DSS} = 17...25$ мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
V13	3SK242	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 130$ мВт; $I_{DSS} = 7...25$ мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V13	BFG197/X	PHIL	npn	$V_{CB0} = 20$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} > 40$; $f_T = 7.5$ ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
V15	BFG93A/X	PHIL	npn	$V_{CB0} = 15$ В; $I_C = 35$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} > 40$; $f_T > 4.5$ ГГц	SOT143, TO253	C•E•B•E
V21	3SK222VBA	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 18$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 200$ мВт; $g_F > 15$ мСм; $I_{DSS} = 0.01...3$ мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
V21	3SK246	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 130$ мВт; $I_{DSS} = 0.01...8$ мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V22	3SK222VBB	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 18$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 200$ мВт; $g_F > 15$ мСм; $I_{DSS} = 1...8$ мА	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
V22	3SK246	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 25$ мА; $P_D = 130$ мВт; $I_{DSS} = 0.01...8$ мА	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V26	BFG67/XR	PHIL	npn	$V_{CB0} = 10$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 8$ ГГц	SOT143R	C•E•B•E
V3	BFG67	VIS	npn	$V_{CB0} = 10$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 8$ ГГц	SOT143, TO253	C•B•E•E
V3	BFG67	PHIL	npn	$V_{CB0} = 10$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 8$ ГГц	SOT143, TO253	C•B•E•E
V35	BFG197A/XR	PHIL	npn	$V_{CB0} = 20$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} > 40$; $f_T = 7.5$ ГГц	SOT143R	C•E•B•E
V5	BFG197	PHIL	npn	$V_{CB0} = 20$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} > 40$; $f_T = 7.5$ ГГц	SOT143, TO253	C•B•E•E
VH-	2SC5624	REN	npn	$V_{CB0} = 10$ В; $I_C = 35$ мА; $P_D = 100$ мВт; $h_{21} = 80...160$; $f_T > 25$ ГГц	SOT343, SC82A	B•E•C•E
VI	2SC4229	REN	npn	$V_{CB0} = 30$ В; $I_C = 20$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 50...180$; $f_T > 700$ МГц	SOT343, SC82A	E•B•C•n. c.
W0F	TSDF1205RW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 9$ В; $I_C = 12$ мА; $P_D = 40$ мВт; $h_{21} = 50...250$; $f_T = 12$ ГГц	SOT343R	C•E•B•E
W18	BFP181TW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 15$ В; $I_C = 20$ мА; $P_D = 160$ мВт; $h_{21} = 50...150$; $f_T = 8$ ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W22	S822TW	VISH	npn	$V_{CB0} = 12$ В; $I_C = 8$ мА; $P_D = 30$ мВт; $h_{21} = 40...150$; $f_T = 5.2$ ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
W28	BFP280TW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 15$ В; $I_C = 10$ мА; $P_D = 80$ мВт; $h_{21} = 50...150$; $f_T = 7$ ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W2F	TSDF1220RW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 9$ В; $I_C = 40$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 50...150$; $f_T = 12$ ГГц	SOT343R	C•E•B•E
W4s	BCR400R	INF	abc	$V_{CC} < 18$ В; $I_{SMIN} = 0.1$ мА	SOT143, TO253	GND•CONTR•VS•REXT
W4s	BCR400W	INF	abc	$V_{CC} < 18$ В; $I_{SMIN} = 0.1$ мА	SOT343, SC82A	GND•CONTR•VS•REXT
W67	BFP67W	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 65...150$; $f_T = 7.5$ ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W82	BFP182TW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 15$ В; $I_C = 35$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 50...150$; $f_T = 7.5$ ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W83	BFP183TW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 15$ В; $I_C = 65$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 50...150$; $f_T = 8$ ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W92	BFP92AW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20$ В; $I_C = 30$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 50...150$; $f_T = 6$ ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
WF0	TSDF1205W	TELEF	npn	$V_{CB0} = 9$ В; $I_C = 12$ мА; $P_D = 40$ мВт; $h_{21} = 50...250$; $f_T = 12$ ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
WF2	TSDF1220W	TELEF	npn	$V_{CB0} = 9$ В; $I_C = 40$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 50...150$; $f_T = 12$ ГГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
WFE	BFP93A	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 50...200$; $f_T = 6$ ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
WH-	2SC5623	REN	npn	$V_{CB0} = 10$ В; $I_C = 12$ мА; $P_D = 50$ мВт; $h_{21} = 60...140$; $f_T > 23$ ГГц	SOT343, SC82A	B•E•C•E



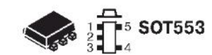


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
WI	3SK197	REN	nMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G = 24.6 дБ; NF = 5.5 дБ	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
WJ-	2SC5894	REN	npn	V_{CB0} = 12 В; I_C = 12 мА; P_D = 50 мВт; h_{21} = 70...150; f_T > 16 ГГц	SOT343, SC82A	B•E•C•E
WMO	BF998RW	VIS	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 30 мА; P_D = 200 мВт; I_{DS} = 4...18 мА; g_F > 21 мСм	SOT343R	S•D•G2•G1
WSE	BFP280TRW	TELEF	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 10 мА; P_D = 80 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 7 ГГц	SOT343R	C•E•B•E
WSF	BFP181TRW	TELEF	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 20 мА; P_D = 160 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 8 ГГц	SOT343R	C•E•B•E
WSF	S822TRW	VISH	npn	V_{CB0} = 12 В; I_C = 8 мА; P_D = 30 мВт; h_{21} = 40...150; f_T = 5.2 ГГц	SOT343R	E•C•E•B
WSG	BFP182TRW	TELEF	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 7.5 ГГц	SOT343R	C•E•B•E
WSH	BFP183TRW	TELEF	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 65 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 8 ГГц	SOT343R	C•E•B•E
XB	2SC4416	REN	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...180; f_T > 3000 МГц	SOT343, SC82A	B•E•C•п. с.
XC	2SC4415	REN	npn	V_{CB0} = 30 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...180; f_T > 700 МГц	SOT343, SC82A	C•B•E•B
XE	2SK1092	REN	nFET	GaAs; V_{DS} = 4 В; I_D = 150 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 8 дБ; NF < 3.5 дБ	SOT343, SC82A	S•D•п. с.•G
XI	3SK196	REN	nMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 35 мА; P_D = 150 мВт; P_G = 32 дБ; NF = 1.0 дБ	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
XM	2SC4591	REN	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 40...250; f_T > 6500 МГц	SOT343, SC82A	E•B•C•п. с.
XN	2SC4592	REN	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 40...250; f_T > 7000 МГц	SOT343, SC82A	C•E•B•E
XR	3SK228	REN	nFET	GaAs; V_{DS} = 12.0 В; I_D = 50 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 17 дБ; NF < 2.0 дБ	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
XS	3SK229	REN	nFET	GaAs; V_{DS} = 12.0 В; I_D = 50 мА; P_D = 150 мВт; P_G > 17 дБ; NF < 2.0 дБ	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
XV	2SC4680	REN	npn	V_{CB0} = 12 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100;	SOT343, SC82A	E•B•C•п. с.
XV-	3SK309	REN	dnMESFET	V_{DS} = 6 В; I_D = 18 мА; P_D = 100 мВт; g_F > 30 мСм	SOT343, SC82A	S•G1•G2•D
YB-	3SK318	REN	dnMOS	V_{DS} = 6 В; I_D = 20 мА; P_D = 100 мВт; g_F > 18 мСм	SOT343, SC82A	S•G1•G2•D
YB-	3SK319	REN	dnMOS	V_{DS} = 6 В; I_D = 20 мА; P_D = 100 мВт; g_F > 18 мСм	SC61, MPAK-4	S•G1•G2•D
YJ-	2SC4900	REN	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...250; f_T > 6 ГГц	SC61, MPAK-4	C•E•B•E
ZD-	2SC5080	REN	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...160; f_T > 10.5 ГГц	SC61, MPAK-4	E•C•E•B
ZD-	2SC5081	REN	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 50...160; f_T > 10.5 ГГц	SOT343, SC82A	E•C•E•B
ZP-	3SK297	REN	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 25 мА; P_D = 150 мВт; g_F > 16 мСм; I_{DSS} = 0.5...10 мА	SC61, MPAK-4	S•G1•G2•D
ZP-	3SK298	REN	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 25 мА; P_D = 150 мВт; g_F > 16 мСм; I_{DSS} = 0.5...10 мА	SOT343, SC82A	S•G1•G2•D
ZQ-	3SK295	REN	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 25 мА; P_D = 150 мВт; g_F > 16 мСм; I_{DSS} = 0.5...10 мА	SC61, MPAK-4	S•G1•G2•D
ZQ-	3SK296	REN	dnMOS	V_{DS} = 12 В; I_D = 25 мА; P_D = 150 мВт; g_F > 16 мСм; I_{DSS} = 0.5...10 мА	SOT343, SC82A	S•G1•G2•D
ZR-	3SK300	REN	dnMOS	V_{DS} = 14 В; I_D = 25 мА; P_D = 150 мВт; g_F > 20 мСм	SC61, MPAK-4	S•G1•G2•D
ZR-	3SK317	REN	dnMOS	V_{DS} = 14 В; I_D = 25 мА; P_D = 100 мВт; g_F > 20 мСм	SOT343, SC82A	S•G1•G2•D
ZS-	2SC5545	REN	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 10 ГГц	SC61, MPAK-4	B•C•E•C

SOT23-5, SOT353/553…

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
#CGA	AD7415ARTZ	AD	dts	10-разр.; SMBus/I²C; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-5	AS • GND • VDD • SDA • SCL
#CGB	AD7415ARTZ	AD	dts	10-разр.; SMBus/I²C; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-5	AS • GND • VDD • SDA • SCL
0J	MC33464N-20CTR	ON	mrc	V_{TR}=2.0B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
0K	MC33464N-30CTR	ON	mrc	V_{TR}=3.0B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
0R	MC33464N-20ATR	ON	mrc	V_{TR}=2.0B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
0S	MC33464N-30ATR	ON	mrc	V_{TR}=3.0B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
1R	MC33464N-21ATR	ON	mrc	V_{TR}=2.1B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
21	RN47A1	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0}=50B; I_C=100мА; P_D=200мВт; f_T=250МГц; R_1=4.7кОм	SOT353, SC88A	E1 • B1 • E2 • C2 • C1, B2
22	RN47A2	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0}=50B; I_C=100мА; P_D=200мВт; f_T=250МГц; R_1=22кОм	SOT353, SC88A	E1 • B1 • E2 • C2 • C1, B2
23	RN47A3	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0}=50B; I_C=100мА; P_D=200мВт; f_T=250МГц; R_1=10кОм	SOT353, SC88A	E1 • B1 • E2 • C2 • C1, B2
24	RN47A4	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0}=50B; I_C=100мА; P_D=200мВт; Q1: R_1/R_2=47кОм/47кОм; Q2: R_1/R_2=10кОм/47кОм	SOT353, SC88A	E1 • B1 • E2 • C2 • C1, B2
25	RN47A5	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0}=50B; I_C=100мА; P_D=200мВт; Q1: R_1/R_2=47кОм/47кОм; Q2: R_1/R_2=4.7кОм/10кОм	SOT353, SC88A	E1 • B1 • E2 • C2 • C1, B2
44A	RN1544A	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0}=50B; I_C=300мА; P_D=300мВт; h_{21}=200...700; f_T=30МГц; R_1=2.2кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
44B	RN1544B	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0}=50B; I_C=300мА; P_D=300мВт; h_{21}=350...1200; f_T=30МГц; R_1=2.2кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
5L	MC33464N-45CTR	ON	mrc	V_{TR}=4.5B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
5T	MC33464N-45ATR	ON	mrc	V_{TR}=4.5B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
7J	MC33464N-27CTR	ON	mrc	V_{TR}=2.7B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
7R	MC33464N-27ATR	ON	mrc	V_{TR}=2.7B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
7Z25	NC7SZ125M5X	FAIR	3-stbuff	V_{CC}=1.65...5.5 В; I_{OUT}=±24мА	SOT23-5	OE • A • GND • Y • VCC
8T	MC33464N-48ATR	ON	mrc	V_{TR}=4.8B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
9F	MC33464N-09CTR	ON	mrc	V_{TR}=0.9B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
9N	MC33464N-09ATR	ON	mrc	V_{TR}=0.9B; V_{IN}=0.7...10B	SOT23-5	RES • IN • GND • n. c. • n. c.
A03	OPA703NA	TI	OA	R-R; V_{DD}=4...12/±2...±6B; f_{BD}=1МГц; I_S=300мкА; V_{OSI}<±0.75мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A04	OPA704NA	TI	OA	R-R; V_{DD}=4...12/±2...±6B; f_{BD}=3МГц; I_S=300мкА; V_{OSI}<±0.75мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A05	OPA705NA	TI	OA	R-R; V_{DD}=4...12/±2...±6B; f_{BD}=1МГц; I_S=250мкА; V_{OSI}<±5мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A0N	AD8565AKSZ	AD	OA	f_{BD}=5МГц; P_D=12мВт; V_{DD}=4.5...16В	SOT353, SC88A	OUT • V+ • +IN • –IN • V–
A0P	AD8531ARTZ	AD	OA	f_{BD}=3МГц; P_D=6мВт; V_{DD}=2.7...6В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
A0Q	AD8531AKSZ	AD	OA	f_{BD}=3МГц; P_D=6мВт; V_{DD}=2.7...6В	SOT353, SC88A	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
A1	1SS308	TOSH	di x4	V_R<80В; I_F<300мА; $V_F(I_F$=100мА)<1.2В; I_R<0.5мкА; tRR<4нс	SOT23-5	K1 • A • K2 • K3 • K4
A1	FMA1A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; 22кОм/22кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A1	UMA1N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 22кОм/22кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A10	FMA10A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; R2/R1=10	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A10	FMA9A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; 10кОм/10кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1





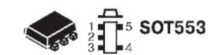
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
A10	UMA10N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; R2/R1 = 10	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A10	UMA9N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 10 кОм/10 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A11	EMA11	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 4.7 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A11	FMA11A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 56; 4.7 кОм/47 кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A11	UMA11N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 4.7 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A2	1SS309	TOSH	di x4	V_R < 80 В; I_F < 300 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; I_R < 0.5 мкА; tRR < 4 нс	SOT23-5	A1 • K • A2 • A3 • A4
A2	EMA2	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A2	FMA2A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A2	UMA2N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A2G	OP179GRT	AD	OA	R-R; V_{DD} = 5...12 В; f_{BD} = 5 МГц; I_S = 3.5 мА; V_{OSI} < ±5 мВ	SOT23-5	OUT • V+ • +IN • –IN • V–
A3	EMA3	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R_1 4.7 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A3	FMA3A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R_1 4.7 кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A3	UMA3N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R_1 4.7 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A36	OPA336NA	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.3...5.5 В; I_S = 42 мкА; V_{OSI} < ±125 мкВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A38	OPA338N	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 12.5 МГц; I_S = 2 мА; V_{OSI} < ±3.5 мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A3A	AD8519ART	AD	OA	f_{BD} = 8 МГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 2.7...12 В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
A3B	AD8519AKS	AD	OA	f_{BD} = 8 МГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 2.7...12 В	SOT353, SC88A	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
A4	EMA4	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R_1 10 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A4	FMA4A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R_1 10 кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A4	UMA4N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R_1 10 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A40	OPA340NA	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 5.5 МГц; I_S = 1.1 мА; V_{OSI} < ±0.5 мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A41	OPA364I	TI	OA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5 В; f_{BD} = 7 МГц; I_S = 1.4 мА; V_{OSI} < 0.9 мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A44	OPA244NA	TI	OA	V_{DD} = 2.2...36/±1.1...±18 В; I_S = 70 мкА; V_{OSI} < ±2 мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A47	OPA347NA	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.3...5.5 В; f_{BD} = 350 кГц; I_S = 43 мкА; V_{OSI} < 7 мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A48	OPA348AI	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.1...5.5 В; f_{BD} = 1 МГц; I_S = 75 мкА; V_{OSI} < 6 мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
A4A	AD8541ART	AD	OA	f_{BD} = 1 МГц; P_D = 0.3 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
A4B	AD8541AKS	AD	OA	f_{BD} = 1 МГц; P_D = 0.3 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT353, SC88A	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
A5	EMA5	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 21	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A5	FMA5A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 21	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A5	UMA5N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 21	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A6	FMA6A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R_1 47 кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1



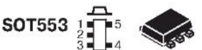
SOT353 SOT23-5
SC88A TSOT23-5

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
A6	UMA6N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R_1 47 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A6A	AD8614ART	AD	OA	f_{BD} = 5.5 МГц; P_D = 20 мВт; V_{DD} = 5...18 В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN • –IN • V+
A7	EMA7	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 2.1	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A7	FMA7A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 2.1	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A7	UMA7N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 2.1	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A7A	AD8531ART	AD	OA	f_{BD} = 3 МГц; P_D = 6 мВт; V_{DD} = 2.7...6 В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
A7B	AD8531AKS	AD	OA	f_{BD} = 3 МГц; P_D = 6 мВт; V_{DD} = 2.7...6 В	SOT353, SC88A	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
A8	EMA8	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 4.7	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
A8	FMA8A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 4.7	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
A8	UMA8N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 4.7	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
AAA	AD8601ART	AD	OA	f_{BD} = 8 МГц; P_D = 6 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN A • –IN • V+
AAA	MAX4450EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 4.5...11/±2.25...±5.5 В; f_{BD} = 210 МГц; V_{OSI} < 26 мВ	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
AAAA	MAX4501UK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 350 Ом; V_{DD} = 2...12 В	SOT23-5	COM • NO • GND • IN • V+
AAAB	MAX4502UK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 350 Ом; V_{DD} = 2...12 В	SOT23-5	COM • NC • GND • IN • V+
AAAG	MAX4516CUK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 25 Ом; V_{DD} = ±1...±6 В	SOT23-5	COM • NO • V- • IN • V+
AAAH	MAX4517CUK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 25 Ом; V_{DD} = ±1...±6 В	SOT23-5	COM • NC • V- • IN • V+
AAB	MAX4490AXK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5/±1.35...±2.75 В; f_{BD} = 10 МГц; V_{OSI} < 16 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
AABK	MAX2631EUK	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P < 900 МГц; I_{CC} = 6.6 мА	SOT23-5	SHDN • GND • OUT • VCC • IN
AABL	MAX2632EUK	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P < 900 МГц; I_{CC} = 6.6 мА	SOT23-5	BIAS • GND • OUT • VCC • IN
AABZ	MAX4200EUK	MAX	buf	V_{DD} = ±5 В; f_{BD} = 780 МГц; Gain = 0.96; V_{OSI} < 15 мВ	SOT23-5	n. c. • VEE • IN • VCC • OUT
AAC	MAX9075EXK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±8 мВ; V_{CC} = 2.1...5.5 В; I_{CC} < 6.6 мкА	SOT353, SC88A	OUT • GND • IN+ • IN- • VCC
AAD	AD8601DRT	AD	OA	f_{BD} = 8 МГц; P_D = 6 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN A • –IN • V+
AAD	MAX4291EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5/±0.9...±2.75 В; f_{BD} = 500 кГц; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VEE • IN- • OUT • VCC
AAE	MAX4501EXK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 350 Ом; V_{DD} = 2...12 В	SOT353, SC88A	COM • NO • GND • IN • V+
AAF	MAX4502EXK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 350 Ом; V_{DD} = 2...12 В	SOT353, SC88A	COM • NC • GND • IN • V+
AAFx	SA56606-20	PHIL	mrc	V_{TR} = 2.0 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x = коддаты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AAG	MAX4400AXK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 800 кГц; V_{OSI} < 5.5 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
AAGx	SA56606-27	PHIL	mrc	V_{TR} = 2.7 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x = коддаты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AAH	MAX4594EXK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 12 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5 В	SOT353, SC88A	COM • NO • GND • IN • V+
AAHx	SA56606-28	PHIL	mrc	V_{TR} = 2.8 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x = коддаты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AAI	MAX4595EXK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 12 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5 В	SOT353, SC88A	COM • NC • GND • IN • V+
AAJ	MAX4596EXK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 12 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5 В	SOT353, SC88A	IN • COM • GND • NO • V+
AAJx	SA56606-29	PHIL	mrc	V_{TR} = 2.9 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x = коддаты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AAK	MAX4597EXK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 12 Ом; V_{DD} = 2.0...5.5 В	SOT353, SC88A	IN • COM • GND • NC • V+
AAKx	SA56606-30	PHIL	mrc	V_{TR} = 3.0 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x — коддаты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AALx	SA56606-31	PHIL	mrc	V_{TR} = 3.1 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x — коддаты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.



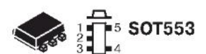


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
AAMx	SA56606-42	PHIL	mrc	V_{TR} = 4.2 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x — код даты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AANx	SA56606-43	PHIL	mrc	V_{TR} = 4.3 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x — код даты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AAPx	SA56606-44	PHIL	mrc	V_{TR} = 4.4 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x — код даты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AARx	SA56606-45	PHIL	mrc	V_{TR} = 4.5 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x — код даты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AASx	SA56606-46	PHIL	mrc	V_{TR} = 4.6 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x — код даты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AATx	SA56606-47	PHIL	mrc	V_{TR} = 4.7 В; V_{DD} = 1...12 В; I_{OUT} < 50 мА; x — код даты	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
ABAA	MAX4201EUK	MAX	buf	V_{DD} = ±5 В; f_{BD} = 780 МГц; Gain = 0.5; R_T = 50 Ом; V_{OSI} < 15 мВ	SOT23-5	n. c. • VEE • IN • VCC • OUT
ABAB	MAX4202EUK	MAX	buf	V_{DD} = ±5 В; f_{BD} = 780 МГц; Gain = 0.5; R_T = 75 Ом; V_{OSI} < 15 мВ	SOT23-5	n. c. • VEE • IN • VCC • OUT
ABAF	MAX4212EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 3.3...10/±1.65...±5 В; f_{BD} = 300 МГц; V_{OSI} < 12 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABAH	MAX4214EUK	MAX	buf	R-R; V_{DD} = 3.15...11/±1.575...±5.5 В; f_{BD} = 230 МГц; Gain = 2; V_{OSI} < 15 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABAJ	MAX4330EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.3...6.5/±1.15...±3.25 В; f_{BD} = 3 МГц; V_{OSI} < 1.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABAK	MAX6305UK00D1	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABAL	MAX6305UK00D2	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABAM	MAX6305UK00D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABBB	MAX6306UK47D2	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABBG	MAX6306UK46D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABBO	MAX6306UK44D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDO	MAX6306UK31D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDP	MAX6306UK31D4	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDQ	MAX6306UK30D1	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDS	MAX6306UK30D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDW	MAX6306UK29D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABEA	MAX6306UK28D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABEK	MAX6306UK25D1	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABEM	MAX6306UK25D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABFG	MAX6307UK46D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABFJ	MAX6307UK45D2	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABFO	MAX6307UK44D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABG	MAX9031AXK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±5 мВ; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{DD} < 55 мкА	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ABGY	MAX6307UK35D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABH	MAX4412EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 500 МГц; V_{OSI} < 9 мВ	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABI	MAX4452EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.25 В; f_{BD} = 200 МГц; V_{OSI} < 12 мВ	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABIO	MAX6308UK00D1	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABIQ	MAX6308UK00D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC



SOT353 SC88A SOT23-5 TSOT23-5

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ABJ	MAX4352EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.7...5.25 В; f_{BD}=80 МГц; V_{OSI}< 12 мВ	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABJK	MAX6309UK46D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABJL	MAX6309UK46D4	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABJS	MAX6309UK44D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABK	MAX985EXK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}< ±7 мВ; V_{CC}=2.5...5.5 В; I_{CC}< 24 мкА	SOT353, SC88A	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ABKA	MAX6309UK42D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABL	MAX986EXK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}< ±7 мВ; V_{CC}=2.5...5.5 В; I_{CC}< 24 мкА	SOT353, SC88A	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ABLM	MAX6309UK32D1	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABLS	MAX6309UK31D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABM	MAX987EXK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}< ±7 мВ; V_{CC}=2.5...5.5 В; I_{CC}< 96 мкА	SOT353, SC88A	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ABMA	MAX6309UK29D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABN	MAX988EXK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}< ±7 мВ; V_{CC}=2.5...5.5 В; I_{CC}< 96 мкА	SOT353, SC88A	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ABNK	MAX6310UK46D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABO	MAX6605MXK	MAX	ats	T_{AMB}=-55...125°C; V_{CC}=2.7...5.5 В; I_{CC}< 10 мА	SOT353, SC88A	VCC • A • OUT • B • GND
ABOH	MAX6310UK40D2	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABP	MAX9021AXK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}< ±8 мВ; V_{DD}=2.5...5.5 В; I_{DD}< 5 мкА	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ABQ	MAX4484AXK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.7...5.5 В; f_{BD}=7 МГц; V_{OSI}< 9 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ABQU	MAX6311UK00D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABR	MAX4493AXK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=±2.25...±5.5 В; f_{BD}=5 МГц; V_{OSI}< 10 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VEE • IN- • OUT • VCC
ABRO	MAX6312UK46D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABRP	MAX6312UK46D4	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABRW	MAX6312UK44D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABS	MAX4470EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=1.8...5.5 В; f_{BD}=9 кГц; I_{CC}< 1.2 мкА; V_{OSI}< 7 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ABSA	MAX6312UK43D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABT	MAX4464EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=1.8...5.5 В; f_{BD}=40 кГц; I_{CC}< 1.2 мкА; V_{OSI}< 7 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ABU	MAX4480AXK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; I_{CC}< 100 мкА; V_{OSI}< 5.5 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ABUE	MAX6312UK29D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABV	MAX3370EXK	MAX	levtrans	RS-232; V_{CC}=2.5...5.5 В; f_{DR}=2 Мбит/с; I_{CC}< 100 мкА	SOT353, SC88A	VL • GND • I/O VL • I/O VCC • VCC
ABVO	MAX6313UK46D3	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}< 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABW	MAX9117EXK	MAX	cmp+vref	V_{OSI}< 10 мВ; V_{CC}=1.8...5.5 В; V_{REF}=1.252 В; I_{CC}< 1.6 мкА	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ABX	MAX9118EXK	MAX	cmp+vref	V_{OSI}< 10 мВ; V_{CC}=1.8...5.5 В; V_{REF}=1.252 В; I_{CC}< 1.6 мкА	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ABY	MAX9119EXK	MAX	cmp	V_{OSI}< 10 мВ; V_{CC}=1.8...5.5 В; I_{CC}< 0.8 мкА	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABYW	MAX477EUK	MAX	OA	V_{DD}=±15 В; f_{BD}=300 МГц; V_{OSI}< 5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABYX	MAX4178EUK	MAX	buf	V_{DD}=±5 В; f_{BD}=330 МГц; V_{OSI}< ±3 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN • GND • VCC
ABYY	MAX4278EUK	MAX	buf	V_{DD}=±5 В; f_{BD}=310 МГц; V_{OSI}< 3 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN • GND • VCC
ABYZ	MAX985EUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}< ±7 мВ; V_{CC}=2.5...5.5 В; I_{CC}< 24 мкА	SOT23-5	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE

SOT23-5 SOT353 TSOT23-5 SC88A **SOT553**

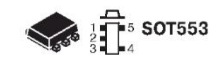
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ABZ	MAX9120EXK	MAX	cmp	V_{OSI} < 10 мВ; V_{CC} = 1.8...5.5 В; I_{CC} < 0.8 мкА	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABZA	MAX986EUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 24 мкА	SOT23-5	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ABZB	MAX987EUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 96 мкА	SOT23-5	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ABZC	MAX988EUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 96 мкА	SOT23-5	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ABZD	MAX1615EUK	MAX	reg	V_{IN} = 4...28 В V_{OUT} = 3.3/5 В; I_{OUT} = 30 мА	SOT23-5	IN • GND • OUT • 5/3 (FB) • SHDN
ABZE	MAX1616EUK	MAX	reg	V_{IN} = 4...28 В V_{OUT} = 1.24...28 В; I_{OUT} = 30 мА	SOT23-5	IN • GND • OUT • 5/3 (FB) • SHDN
ABZF	MAX6501UKP035	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +35 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ABZG	MAX6502UKP035	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +35 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ABZH	MAX8873TUK	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 3.15 В; I_{OUT} = 120 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • SET • OUT
ABZI	MAX8873SUK	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 2.88 В; I_{OUT} = 120 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • SET • OUT
ABZJ	MAX8874TUK	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 3.15 В; I_{OUT} = 120 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • SET • OUT
ABZK	MAX8874SUK	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 2.88 В; I_{OUT} = 120 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • SET • OUT
ABZL	MAX8873RUK	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 2.8 В; I_{OUT} = 120 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • SET • OUT
ABZM	MAX8874RUK	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 2.8 В; I_{OUT} = 120 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • SET • OUT
ABZP	MAX4012EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 3.3...10/±1.65...±5 В; f_{BD} = 200 МГц; V_{OSI} < 20 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABZQ	MAX4014EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 3.15...11/±1.575...±5.5 В; f_{BD} = 200 МГц; V_{OSI} < 20 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABZR	MAX6501UKP045	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +45 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ABZS	MAX6501UKP065	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +65 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ABZT	MAX6501UKP095	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +95 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ABZU	MAX6502UKP045	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +45 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ABZV	MAX6502UKP065	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +65 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ABZW	MAX6502UKP095	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +95 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ABZX	MAX6503UKP005	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +5 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ABZY	MAX6504UKP005	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +5 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACA	MAX5460EXK	MAX	Dpot	32 позиции; 100 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT353, SC88A	VDD • GND • U/D • CS • H
ACAB	MAX999EUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±4.5 мВ; V_{CC} = 2.7...5.5 В; I_{CC} < 5 мА	SOT23-5	Q • GND • IN+ • IN- • VCC
ACAG	MAX6501UKP115	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +115 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACAM	MAX6503UKP015	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = +15 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACAN	MAX6503UKN005	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = -5 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACAP	MAX6503UKN025	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = -25 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACAQ	MAX6503UKN035	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = -35 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACAT	MAX6504UKN005	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = -5 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACAV	MAX6504UKN025	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = -25 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACAW	MAX6504UKN035	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = -35 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACAX	MAX6504UKN045	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5В; T_{TH} = -45 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACAY	MAX8867UK25	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACAZ	MAX8867UK28	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 2.8 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACB	MAX5463EXK	MAX	Dpot	32 позиции; 50 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT353, SC88A	VDD • GND • U/D • CS • H
ACBA	MAX8867UK29	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 2.84 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBB	MAX8867UK30	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5В; V_{OUT} = 3.0 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP



SOT353 SOT23-5
SC88A TSOT23-5

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ACBC	MAX8867UK32	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 3.15 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBD	MAX8867UK33	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBE	MAX8867UK50	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBF	MAX8868UK25	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBG	MAX8868UK28	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 2.8 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBH	MAX8868UK29	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 2.84 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBI	MAX8868UK30	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 3.0 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBJ	MAX8868UK32	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 3.15 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBK	MAX8868UK33	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACBL	MAX8868UK50	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACC	MAX9140EXK	MAX	cmp	V_{OSI} < 4.5 мВ; V_{CC} = 2.7...5.5 В; I_{CC} < 300 мкА	SOT353, SC88A	OUT • GND • IN+ • IN- • VCC
ACCO	MAX4104EUK	MAX	OA	V_{DD} = ±3.5...±5.5 В; f_{BD} = 625 МГц; V_{OSI} < 8 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACCP	MAX4105EUK	MAX	OA	V_{DD} = ±3.5...±5.5 В; f_{BD} = 410 МГц; V_{OSI} < 8 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACCQ	MAX4304EUK	MAX	OA	V_{DD} = ±3.5...±5.5 В; f_{BD} = 730 МГц; V_{OSI} < 8 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACCR	MAX4305EUK	MAX	OA	V_{DD} = ±3.5...±5.5 В; f_{BD} = 340 МГц; V_{OSI} < 8 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACCS	MAX4240EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5/±0.9...±2.75 В; I_{CC} < 18 мкА; V_{OSI} < 1.4 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACCZ	MAX8867UK36	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 3.6 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACDA	MAX8868UK36	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 3.6 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ACDD	MAX6316LUK46C	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ACDE	MAX6316LUK29C	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ACDF	MAX6316MUK46C	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ACDG	MAX6316MUK29C	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ACDH	MAX6318LHUK46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ACDI	MAX6318LHUK29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ACDJ	MAX6318MHUK46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ACDK	MAX6319LHUK46C	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ACDL	MAX6319LHUK29C	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ACDM	MAX6319MHUK46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ACDN	MAX6320PUK46C	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ACDO	MAX6320PUK29C	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ACDP	MAX6501UKP085	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5 В; T_{TH} = +85 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACDQ	MAX6317HUK46C	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ACDR	MAX4281EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 1; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACDS	MAX4174ABUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 1.25; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACDT	MAX4174ACUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 1.5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACDU	MAX4174ADUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 32.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACDV	MAX4174AEUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2.25; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACDW	MAX4174AFUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2.5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACDX	MAX4174AGUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 3; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACDY	MAX4174AHUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 3.5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACDZ	MAX4174AJUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 4; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEA	MAX4174AKUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC





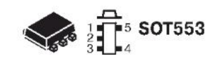
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ACEB	MAX4174ALUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 6; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEC	MAX4174AMUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 7; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACED	MAX4174ANUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 9; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEE	MAX4174AOUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 10; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEF	MAX4174BAUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 11; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEG	MAX4174BBUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 13.5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEH	MAX4174BCUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 16; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEI	MAX4174BDUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 21; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEJ	MAX4174BEUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 25; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEK	MAX4174BFUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 26; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEL	MAX4174BGUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 31; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEM	MAX4174BHUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 41; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEN	MAX4174BJUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 50; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEO	MAX4174BKUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 51; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEP	MAX4174BLUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 61; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEQ	MAX4174BMUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 80; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACER	MAX4174BNUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 100; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACES	MAX4174CAUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 101; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACET	MAX4175ABUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 1.25; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEU	MAX4175ACUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 1.5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEV	MAX4175ADUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 32.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEW	MAX4175AEUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2.25; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEX	MAX4175AFUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2.5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEY	MAX4175AGUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 3; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACEZ	MAX4175AHUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 3.5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACF	MAX4350EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = ±4.5...±5.5 В; f_{BD} = 210 МГц; V_{OSI} < 26 мВ	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFA	MAX4175AJUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 4; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFB	MAX4175AKUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 5; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFC	MAX4175ALUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 6; I_S < 530 мкА; V_{OSI} < 2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ACFD	MAX4175AMUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=7; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFE	MAX4175ANUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=9; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFF	MAX4175AOUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=10; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFG	MAX4175BAUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=11; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFH	MAX4175BBUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=13.5; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFI	MAX4175BCUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=16; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFJ	MAX4175BDUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=21; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFK	MAX4175BEUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=25; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFL	MAX4175BFUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=26; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFM	MAX4175BGUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=31; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFN	MAX4175BHUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=41; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFO	MAX4175BJUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=50; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFP	MAX4175BKUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=51; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFQ	MAX4175BLUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=61; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFR	MAX4175BMUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=80; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFS	MAX4175BNUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=100; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFT	MAX4175CAUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5 В; Gain=101; I_S<530 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACFU	MAX6501UKP105	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=+105 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACFV	MAX6501UKP075	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=+75 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACFW	MAX6501UKP055	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=+55 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACFX	MAX6503UKN015	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=-15 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACFY	MAX6502UKP115	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=+115 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACFZ	MAX6502UKP105	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=+105 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACG	MAX4465EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.4...5.5 В; f_{BD}=200 кГц; I_{CC}<60 мкА; V_{OSI}<5 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • GND • IN- • OUT • VCC
ACGA	MAX6502UKP085	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=+85 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACGB	MAX6502UKP075	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=+75 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACGC	MAX6502UKP055	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=+55 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ACGD	MAX6504UKN015	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=-15 °С; I_{CC}<85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ACGE	MAX4322EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.4...6.5/±1.2...±3.25 В; f_{BD}=5 МГц; V_{OSI}<3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACGF	MAX4040EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.4...5.5/±1.2...±2.75 В; I_S<20 мкА; V_{OSI}<2.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ACGJ	MAX6317HUK29C	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ACGK	MAX6321HPUK29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ACGL	MAX6321HPUK46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ACGM	MAX6322HPUK29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ACGN	MAX6322HPUK46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ACGY	MAX987EUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 96 мкА	SOT23-5	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ACH	MAX4466EXK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.4...5.5 В; f_{BD} = 200 кГц; I_{CC} < 60 мкА; V_{OSI} < 5 мВ	SOT353, SC88A	IN+ • GND • IN- • OUT • VCC
ACHF	MAX8867UK27	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5 В; V_{OUT} = 2.7 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADA	AD8517ART	AD	OA	f_{BD} = 7 МГц; P_D = 6 мВт; V_{DD} = 1.8...6 В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
ADIP	MAX6319LHUK49	MAX	mrc	V_{TR} = 4.9 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ADIQ	MAX917EUK	MAX	cmp+vref	V_{OSI} < 10 мВ; V_{CC} = 1.8...5.5 В; V_{REF} = 1.245 В; I_{CC} < 1.6 мкА	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ADIR	MAX918EUK	MAX	cmp+vref	V_{OSI} < 10 мВ; V_{CC} = 1.8...5.5 В; V_{REF} = 1.245 В; I_{CC} < 1.6 мкА	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ADIS	MAX919EUK	MAX	cmp	V_{OSI} < 10 мВ; V_{CC} = 1.8...5.5 В; I_{CC} < 0.8 мкА	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADIT	MAX920EUK	MAX	cmp	V_{OSI} < 10 мВ; V_{CC} = 1.8...5.5 В; I_{CC} < 0.8 мкА	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADIU	MAX4372TEUK	MAX	CSA	V_{DD} = 2.7...28 В; Gain = 20; I_{CC} < 1.9 мА	SOT23-5	GND • OUT • VCC • RS+ • RS-
ADIV	MAX4372FEUK	MAX	CSA	V_{DD} = 2.7...28 В; Gain = 50; I_{CC} < 1.9 мА	SOT23-5	GND • OUT • VCC • RS+ • RS-
ADIW	MAX4372HEUK	MAX	CSA	V_{DD} = 2.7...28 В; Gain = 100; I_{CC} < 1.9 мА	SOT23-5	GND • OUT • VCC • RS+ • RS-
ADIX	MAX1749EUK	MAX	vibdrv	V_{IN} = 2.5 ...6.5 В; V_{OUT} = 1.25/1.25...6.5 В В; I_{OUT} < 120 мА	SOT23-5	ON • GND • IN • OUT • SET
ADIZ	MAX6503UKN045	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7 ...5.5 В; T_{TH} = -45 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ADJA	MAX4076EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 1; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJB	MAX4074ABUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 1.25; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJC	MAX4074ACUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 1.5; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJD	MAX4074ADUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJE	MAX4074AEUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2.25; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJF	MAX4074AFUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 2.5; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJG	MAX4074AGUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 3; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJH	MAX4074AHUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 3.5; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJI	MAX4074AJUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 4; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJJ	MAX4074AKUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 5; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJK	MAX4074ALUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 6; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJL	MAX4074AMUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 7; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJM	MAX4074ANUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 9; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJN	MAX4074AOUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 10; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJO	MAX4074BAUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 11; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJP	MAX4074BBUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 13.5; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJQ	MAX4074BCUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 16; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJR	MAX4074BDUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 21; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJS	MAX4074BEUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 25; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC



SOT553 1 2 3 / 5 4

SOT353 SC88A SOT23-5 TSOT23-5 1 2 3 / 5 4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADJT	MAX4074BFUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 26; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJU	MAX4074BGUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 31; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJV	MAX4074BHUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 41; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJW	MAX4074BJUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 50; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJX	MAX4074BKUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 51; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJY	MAX4074BLUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 61; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADJZ	MAX4074BMUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 80; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADKA	MAX4074BNUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 100; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADKB	MAX4074CAUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; Gain = 101; I_S < 55 мкА; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ADKC	MAX6318LHUK49	MAX	mrc	V_{TR} = 4.9 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADKD	MAX8867UK40	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 4.0 В; I_{OUT} = 150 мА	SOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADKE	MAX6504UKP015	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5 В; T_{TH} = +15 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TUNDER
ADKF	MAX3180EUK	MAX	rec	RS-232; V_{CC} = 3...5.5 В; f_{DR} = 1.5 Мбит/с; I_{CC} < 5 мкА	SOT23-5	EN • GND • ROUT • RIN • VCC
ADKG	MAX3181EUK	MAX	rec	RS-232; V_{CC} = 3...5.5 В; f_{DR} = 1.5 Мбит/с; I_{CC} < 5 мкА	SOT23-5	INVALID • GND • ROUT • RIN • VCC
ADKH	MAX3182EUK	MAX	rec	RS-232; V_{CC} = 3...5.5 В; f_{DR} = 1.5 Мбит/с; I_{CC} < 5 мкА	SOT23-5	EN • GND • ROUT • RIN • VCC
ADKI	MAX3183EUK	MAX	rec	RS-232; V_{CC} = 3...5.5 В; f_{DR} = 1.5 Мбит/с; I_{CC} < 5 мкА	SOT23-5	INVALID • GND • ROUT • RIN • VCC
ADKJ	MAX6352LSUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADKK	MAX6352SYUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADKL	MAX6353LSUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADKM	MAX6353SYUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADKN	MAX6354LSUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADKO	MAX6354SYUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADKP	MAX4450EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 4.5...11/±2.25...±5.5 В; f_{BD} = 210 МГц; V_{OSI} < 26 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADKQ	MAX4490AUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5/±1.35...±2.75 В; f_{BD} = 10 МГц; V_{OSI} < 16 мВ	SOT23-5	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ADKR	MAX6316LUK46B	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADKS	MAX6306UK47D3	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5...5 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 16 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ADKT	MAX1734EUK33	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.7...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 250 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • OUT (FB) • LX
ADKU	MAX1734EUK30	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.7...5.5 В; V_{OUT} = 3 В; I_{OUT} = 250 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • OUT (FB) • LX
ADKV	MAX1734EUK25	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.7...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 250 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • OUT (FB) • LX
ADKW	MAX1734EUK18	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.7...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} = 250 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • OUT (FB) • LX
ADKX	MAX1734EUK15	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.7...5.5 В; V_{OUT} = 1.5 В; I_{OUT} = 250 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • OUT (FB) • LX
ADKY	MAX1733EUK	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.7...5.5 В; V_{OUT} = 1.25...2 В; I_{OUT} = 250 мА	SOT23-5	IN • GND • SHDN • OUT (FB) • LX
ADLM	MAX6318LHUK26C	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADLO	MAX6318LHUK44C	MAX	mrc	V_{TR} = 4.39 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADLP	MAX6319LHUK26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADLQ	MAX6319LHUK29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<20мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ADLR	MAX6319LHUK31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<20мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ADLS	MAX6319LHUK44	MAX	mrc	V_{TR}=4.39 В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<20мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ADLT	MAX6316LUK26C	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<20мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ADLU	MAX6316LUK31C	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<20мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ADLV	MAX6309UK27D1	MAX	mrc	V_{TR}=2.5...5В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<16мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•RST IN•VCC
ADLX	MAX9075EUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}<±8мВ; V_{CC}=2.1...5.5В; I_{CC}<6.6мкА	SOT23-5	OUT•GND•IN+•IN-•VCC
ADMA	MAX4430EUK	MAX	OA	V_{DD}=±5В; f_{BD}=180МГц; V_{OSI}<5мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ADMB	MAX4431EUK	MAX	OA	V_{DD}=±5В; f_{BD}=215МГц; V_{OSI}<5мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ADMI	MAX6316LUK26D	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1...5.5В; I_{CC}<20мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ADMJ	MAX4626EUK	MAX	asw	SPST; R_{ON}<12 Ом; V_{DD}=1.8...5.5В	SOT23-5	COM•NO•GND•IN•V+
ADMK	MAX4627EUK	MAX	asw	SPST; R_{ON}<12 Ом; V_{DD}=1.8...5.5В	SOT23-5	COM•NC•GND•IN•V+
ADML	MAX4291EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD}=1.8...5.5/±0.9...±2.75В; f_{BD}=500кГц; V_{OSI}<2.5мВ	SOT23-5	IN+•VEE•IN-•OUT•VCC
ADM M	MAX5360LEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x60; V_{DD}=2.7...3.6В; V_{REF}=2В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMN	MAX5380LEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x60; V_{DD}=2.7...3.6В; V_{REF}=2В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMO	MAX5360PEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x66; V_{DD}=2.7...3.6В; V_{REF}=2В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMP	MAX5380PEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x66; V_{DD}=2.7...3.6В; V_{REF}=2В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMQ	MAX5361PEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x66; V_{DD}=4.5...5.5В; V_{REF}=4В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMR	MAX5381PEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x66; V_{DD}=4.5...5.5В; V_{REF}=4В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMS	MAX5362PEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x66; V_{DD}=2.7...5.5В; V_{REF}=0.9xV_{DD}	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMT	MAX5382PEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x66; V_{DD}=2.7...5.5В; V_{REF}=0.9xV_{DD}	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMU	MAX5361LEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x60; V_{DD}=4.5...5.5В; V_{REF}=4В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMV	MAX5381LEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x60; V_{DD}=4.5...5.5В; V_{REF}=4В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADM W	MAX5362LEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x60; V_{DD}=2.7...5.5В; V_{REF}=0.9xV_{DD}	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMX	MAX5382LEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x60; V_{DD}=2.7...5.5В; V_{REF}=0.9xV_{DD}	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMY	MAX5360MEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x62; V_{DD}=2.7...3.6В; V_{REF}=2В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADMZ	MAX5380MEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x62; V_{DD}=2.7...3.6В; V_{REF}=2В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNA	MAX5361MEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x62; V_{DD}=4.5...5.5В; V_{REF}=4В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNB	MAX5381MEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x62; V_{DD}=4.5...5.5В; V_{REF}=4В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNC	MAX5362MEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x62; V_{DD}=2.7...5.5В; V_{REF}=0.9xV_{DD}	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADND	MAX5382MEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x62; V_{DD}=2.7...5.5В; V_{REF}=0.9xV_{DD}	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNE	MAX5360NEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x64; V_{DD}=2.7...3.6В; V_{REF}=2В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNF	MAX5380NEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x64; V_{DD}=2.7...3.6В; V_{REF}=2В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNG	MAX5361NEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x64; V_{DD}=4.5...5.5В; V_{REF}=4В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNH	MAX5381NEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x64; V_{DD}=4.5...5.5В; V_{REF}=4В	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADNI	MAX5362NEUK	MAX	DAC	6-разр.; I^2C; адрес: 0x64; V_{DD}=2.7...5.5 В; V_{REF} = 0.9 x V_{DD}	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNJ	MAX5382NEUK	MAX	DAC	8-разр.; I^2C; адрес: 0x64; V_{DD}=2.7...5.5 В; V_{REF} = 0.9 x V_{DD}	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNP	MAX4400AUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 800 кГц; V_{OSI} < 5.5 мВ	SOT23-5	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ADNR	MAX6316LUK44C	MAX	mrc	V_{TR} = 4.39 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADNS	MAX6318LHUK26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADNT	MAX6509CAUK	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5 В; T_{TH} = -40...+125 °C; I_{CC} < 165 мкА	SOT23-5	SET • GND • OUT • HYST • VCC
ADNU	MAX6509HAUK	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5 В; T_{TH} = -40...+125 °C; I_{CC} < 165 мкА	SOT23-5	SET • GND • OUT • HYST • VCC
ADNV	MAX9040AEUK	MAX	cmp+vref	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; V_{REF} = 2.048 В; I_{CC} < 72 мкА	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ADNW	MAX9050AEUK	MAX	cmp+vref	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.7...5.5 В; V_{REF} = 2.500 В; I_{CC} < 72 мкА	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ADNX	MAX9040BEUK	MAX	cmp+vref	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; V_{REF} = 2.048 В; I_{CC} < 72 мкА	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ADNY	MAX9050BEUK	MAX	cmp+vref	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.7...5.5 В; V_{REF} = 2.500 В; I_{CC} < 72 мкА	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ADOA	MAX4321EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.4...6.5/±1.2...±3.25 В; f_{BD} = 5 МГц; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VCC • IN+ • IN- • VEE
ADOB	MAX4645EUK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 3 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-5	COM • NO • GND • IN • V+
ADOC	MAX4646EUK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 3 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-5	COM • NC • GND • IN • V+
ADOD	MAX6320PUK26C	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADOE	MAX4568EUK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 75 Ом; V_{DD} = 1.8...12 В	SOT23-5	COM • NO • GND • IN • V+
ADOF	MAX4569EUK	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 75 Ом; V_{DD} = 1.8...12 В	SOT23-5	COM • NC • GND • IN • V+
ADOG	MAX4376TAUK	MAX	CSA	V_{DD} = 3...28 В; Gain = 20; I_{CC} < 2.2 мА	SOT23-5	OUT • GND • VCC • RS+ • RS-
ADOH	MAX4376FAUK	MAX	CSA	V_{DD} = 3...28 В; Gain = 50; I_{CC} < 2.2 мА	SOT23-5	OUT • GND • VCC • RS+ • RS-
ADOI	MAX4376HAUK	MAX	CSA	V_{DD} = 3...28 В; Gain = 100; I_{CC} < 2.2 мА	SOT23-5	OUT • GND • VCC • RS+ • RS-
ADOJ	MAX9031AUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±5 мВ; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{DD} < 55 мкА	SOT23-5	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ADOK	MAX6316LUK46C	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADOL	MAX4412EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 500 МГц; V_{OSI} < 9 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADOM	MAX6319MHUK29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ADOP	MAX6319MHUK46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ADOR	MAX9100EUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±20 мВ; V_{CC} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT23-5	OUT • GND • IN+ • IN- • VCC
ADOS	MAX9101EUK	MAX	cmp	V_{OSI} < ±20 мВ; V_{CC} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT23-5	OUT • GND • IN+ • IN- • VCC
ADOT	MAX4434EUK	MAX	OA	V_{DD} = ±5 В; f_{BD} = 150 МГц; Gain = 1; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADOU	MAX4435EUK	MAX	OA	V_{DD} = ±5 В; f_{BD} = 150 МГц; Gain = 5; V_{OSI} < 3.5 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADOV	MAX4452EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.25 В; f_{BD} = 200 МГц; V_{OSI} < 12 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADOW	MAX4352EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.25 В; f_{BD} = 80 МГц; V_{OSI} < 12 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADOX	MAX1735EUK25	MAX	reg	LDO; V_{IN} = -2.5...-6.5 В; V_{OUT} = -2.5/-1.25...-5.5 В; I_{OUT} = 200 мА	SOT23-5	GND • IN • SHDN • SET • OUT
ADOY	MAX1735EUK30	MAX	reg	LDO; V_{IN} = -2.5...-6.5 В; V_{OUT} = -3.0/-1.25...-5.5 В; I_{OUT} = 200 мА	SOT23-5	GND • IN • SHDN • SET • OUT
ADOZ	MAX1735EUK50	MAX	reg	LDO; V_{IN} = -2.5...-6.5 В; V_{OUT} = -5.0/-1.25...-5.5 В; I_{OUT} = 200 мА	SOT23-5	GND • IN • SHDN • SET • OUT
ADPC	MAX6321HPUK25	MAX	mrc	V_{TR} = 2.463 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADPD	MAX9021AUK	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±8 мВ; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{DD} < 5 мкА	SOT23-5	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ADPE	MAX4484AUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 7 МГц; V_{OSI} < 9 мВ	SOT23-5	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ADPF	MAX6317HUK46B	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADPG	MAX4493AUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = ±2.25...±5.5 В; f_{BD} = 5 МГц; V_{OSI} < 10 мВ	SOT23-5	IN+ • VEE • IN- • OUT • VCC
ADPH	MAX4470EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5 В; f_{BD} = 9 кГц; I_{CC} < 1.2 мкА; V_{OSI} < 7 мВ	SOT23-5	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ADPI	MAX4464EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5 В; f_{BD} = 40 кГц; I_{CC} < 1.2 мкА; V_{OSI} < 7 мВ	SOT23-5	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ADPJ	MAX4480AUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 100 мкА; V_{OSI} < 5.5 мВ	SOT23-5	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD





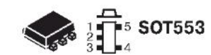
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADPP	MAX6823VUK	MAX	mrc+wdt	V_{TR} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADPQ	MAX6821LUK	MAX	mrc+wdt	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADPR	MAX6822WUK	MAX	mrc+wdt	V_{TR} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADPS	MAX6824ZUK	MAX	mrc+wdt	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADPT	MAX6825TUK	MAX	mrc+wdt	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ADPU	MAX6352TWUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 3.08 В; V_{TR2} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADPV	MAX6353SVUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADPW	MAX6354UWUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.78 В; V_{TR2} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQF	MAX1722EZK	MAX	dcdc	V_{IN} = 0.8...5.5 В; V_{OUT} = 2...5.5 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQG	MAX1723EZK	MAX	dcdc	V_{IN} = 0.8...5.5 В; V_{OUT} = 2...5.5 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQH	MAX1724EZK27	MAX	dcdc	V_{IN} = 0.8...5.5 В; V_{OUT} = 2.7 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQI	MAX1724EZK30	MAX	dcdc	V_{IN} = 0.8...5.5 В; V_{OUT} = 3 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQJ	MAX1724EZK33	MAX	dcdc	V_{IN} = 0.8...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQJ	MAX6354LTUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQK	MAX1724EZK50	MAX	dcdc	V_{IN} = 0.8...5.5 В; V_{OUT} = 5 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQK	MAX6501UKP125	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7 ...5.5В; T_{TH} = +125 °С; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
ADQL	MAX6821ZUK	MAX	mrc+wdt	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADQM	MAX6825YUK	MAX	mrc+wdt	V_{TR} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADQM	MAX8867ZK25	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQO	MAX8867ZK28	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 2.8 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQP	MAX8867ZK29	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 2.84 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQP	MAX9140EUK	MAX	cmp	V_{OSI} < 4.5 мВ; V_{CC} = 2.7...5.5В; I_{CC} < 300 мкА	SOT23-5	OUT • GND • IN+ • IN- • VCC
ADQQ	MAX5466EUK	MAX	Dpot	32 позиции; 10 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-5	VDD • GND • U/D • CS • H
ADQQ	MAX8867ZK30	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 3.0В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQR	MAX8867ZK32	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 3.15 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQS	MAX8867ZK33	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQT	MAX8867ZK36	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 3.6 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQV	MAX8867ZK50	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQW	MAX6352SVUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQW	MAX8868ZK25	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQX	MAX6353RVUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.63 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQX	MAX8868ZK28	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 2.8 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQY	MAX6354SWUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQY	MAX8868ZK29	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 2.84 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQZ	MAX6354RVUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.63 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQZ	MAX8868ZK30	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 3.0В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRA	MAX4350EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = ±4.5...±5.5 В; f_{BD} = 210 МГц; V_{OSI} < 26 мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADRA	MAX8868ZK32	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 3.15 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRB	MAX6316MUK46A	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADRB	MAX8868ZK33	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRC	MAX6353UVUK	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.78 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADRC	MAX8868ZK36	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...6.5В; V_{OUT} = 3.6 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRD	MAX4465EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.4...5.5 В; f_{BD} = 200 кГц; I_{CC} < 60 мкА; V_{OSI} < 5 мВ	SOT23-5	IN+ • GND • IN- • OUT • VDD

SOT553 

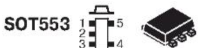
SOT353 SOT23-5
SC88A TSOT23-5

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADRD	MAX8868ZK50	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...6.5 В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 150 мА	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRE	MAX4466EUK	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.4...5.5 В; f_{BD} = 200 кГц; I_{CC} < 60 мкА; V_{OSI} < 5 мВ	SOT23-5	IN+ • GND • IN- • OUT • VCC
ADUD	MAX6502UKP125	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.7...5.5 В; T_{TH} = +125 °C; I_{CC} < 85 мкА	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOVER
AEA	AD8631ART	AD	OA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 3 мВт; V_{DD} = 1.8...6В	SOT23-5	OUT A • V– • +IN A • –IN A • V+
ALW	TPS62208DBV	TI	dcdc	V_{IN} = 2.5...6.0 В; V_{OUT} = 1.875 В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW
AOH	AD8515AKSZ	AD	OA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 3 мВт; V_{DD} = 1.8...5В	SOT353, SC88A	OUT • V– • +IN • –IN • V+
AOH	AD8515ARTZ	AD	OA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 3 мВт; V_{DD} = 1.8...5В	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
AQ	AN1433SSM	PAN	reg	V_{IN} = 1.25...14 В; I_{CAT} < 20 мА; V_{OUT} = 1.25...15 В	SOT553, EMT5	VCC • ANODE • CATHODE • n. c. • REF
ASA	AD8565AKS	AD	OA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 4.5...16 В	SOT353, SC88A	OUT • V+ • +IN • –IN • V–
B3A	AD8605ART	AD	OA	f_{BD} = 10 МГц; P_D = 7 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5В	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
B3A#	AD8605ARTZ	AD	OA	f_{BD} = 10 МГц; P_D = 7 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5В	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
B43	OPA343NA	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 5.5 МГц; I_S = 1.4 мА; V_{OSI} < ±8 мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
B9A	AD8627AKS	AD	OA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 25 мВт; V_{DD} = 5...26/±2.5...±13 В	SOT353, SC88A	OUT A • V– • +IN • –IN • V+
BA	AN80L18RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 2.8 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 1.8 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BB	AN80L19RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 2.9 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 1.9 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BC	AN80L20RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 3.0 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 2.0 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BD	AN80L21RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 3.1 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 2.1 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BDA	AD8515AKS	AD	OA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 3 мВт; V_{DD} = 1.8...5В	SOT353, SC88A	OUT • V– • +IN • –IN • V+
BDA	AD8515ART	AD	OA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 3 мВт; V_{DD} = 1.8...5В	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
BE	AN80L22RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 3.2 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 2.2 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BF	AN80L28RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 3.8 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 2.8 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BG	AN80L29RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 3.9 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 2.9 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BH	AN80L30RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 4.0 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 3.0 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BJ	AN80L31RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 4.1 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 3.1 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BK	AN80L32RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 4.2 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 3.2 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BL	AN80L33RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 4.3 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 3.3 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BM	AN80L34RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 4.4 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 3.4 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BN	AN80L35RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 4.5 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 3.5 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BP	AN80L36RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 4.6 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 3.6 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BQ	AN80L48RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 5.8 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 4.8 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BR	AN80L49RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 5.9 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 4.9 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BS	AN80L50RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 6.0 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 5.0 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BT	AN80L51RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 6.1 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 5.1 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BU	AN80L52RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 6.2 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 5.2 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
BW	AN80L25RMS	PAN	reg	LDO; V_{IN} = 3.5 В; I_{OUT} = 150 мА; V_{OUT} = 2.5 В	SOT23-5	CONT • GND • n. c. • OUT • IN
C1	FMC1A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 56	SOT23-5	C1 • C2 • E2, B2 • B1 • E1
C1	UMC1N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56	SOT353, SC88A	E1 • B1 • E2, B2 • C2 • C1
C12	LMV331M5	NS	cmp	V_{OSI} < 7мВ; V_{DD} = 2.7...5 В; I_{CC} < 100 мкА	SOT23-5	+IN • V– • –IN • OUT • V+
C13	LMV331M7	NS	cmp	V_{OSI} < 7мВ; V_{DD} = 2.7...5 В; I_{CC} < 100 мкА	SOT353, SC88A	+IN • V– • –IN • OUT • V+
C2	EMC2	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT553, EMT5	E1 • B1 • E2, B2 • C2 • C1
C2	FMC2A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT23-5	C1 • C2 • E2, B2 • B1 • E1
C2	UMC2N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT353, SC88A	E1 • B1 • E2, B2 • C2 • C1





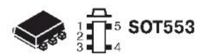
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
C3	FMC3A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; 10кОм/10кОм	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C3	UMC3N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 10кОм/10кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C4	FMC4A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; 47кОм/47кОм; 47кОм/10кОм	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C4	UMC4N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 47кОм/47кОм; 47кОм/10кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C5	FMC5A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; 47кОм/47кОм; 4.7кОм/10кОм	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C5	UMC5N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 47кОм/47кОм; 4.7кОм/10кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C6	FMC6A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; 100кОм/100кОм	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C6	UMC6N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 100кОм/100кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C7	FMC7A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=300мВт; h_{21}>56	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C7	UMC7N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
CGA	AD7415ART	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5В	SOT23-5	AS•GND•VDD•SDA•SCL
CGB	AD7415ART	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5В	SOT23-5	AS•GND•VDD•SDA•SCL
D43	OPA743NA	TI	OA	R-R; V_{DD}=3.5...12/±1.75...±6В; f_{BD}=7МГц; I_S=1.7мА; V_{OSI}<±7мВ	SOT23-5	OUT•V–•+IN•–IN•V+
D53	OPA353NA	TI	OA	R-R; V_{DD}=2.7...5.5В; f_{BD}=44МГц; I_S=9мА; V_{OSI}<±10мВ	SOT23-5	OUT•V–•+IN•–IN•V+
DNC	ADP3309ART-2.7	AD	reg	LDO; V_{IN}=2.8...12В; I_{OUT}=100мА; V_{OUT}=2.7В	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c.•OUT
DPC	ADP3309ART-3	AD	reg	LDO; V_{IN}=2.8...12В; I_{OUT}=100мА; V_{OUT}=3В	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c.•OUT
DRC	ADP3309ART-3.3	AD	reg	LDO; V_{IN}=2.8...12В; I_{OUT}=100мА; V_{OUT}=3.3В	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c.•OUT
DTC	ADP3309ART-3.6	AD	reg	LDO; V_{IN}=2.8...12В; I_{OUT}=100мА; V_{OUT}=3.6В	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c.•OUT
DVC	ADP3309ART-2.85	AD	reg	LDO; V_{IN}=2.8...12В; I_{OUT}=100мА; V_{OUT}=2.85В	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c.•OUT
DWC	ADP3309ART-2.9	AD	reg	LDO; V_{IN}=2.8...12В; I_{OUT}=100мА; V_{OUT}=2.9В	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c.•OUT
E37	OPA137NA	TI	OA	V_{DD}=4.5...36/±2.25...±18В; I_S=320мкА; V_{OSI}<±7мВ	SOT23-5	OUT•V–•+IN•–IN•V+
EV	1SV241	SANYO	pin x2	V_R>50В; I_F<50мА; $V_F(I_F=50мА)$=0.95В; I_R<0.1мкА	SOT23-5	A1•n. c.•A2•K2•K1
G1	EMG1	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 22кОм/22кОм	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G1	FMG1A	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; 22кОм/22кОм	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G1	UMG1N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 22кОм/22кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G10	UMG10N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>33; R2/R1=10	SOT353, SC88A	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G11	EMG11	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; R2/R1=21	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G11	FMG11A	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; R2/R1=21	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G11	UMG11N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; R2/R1=21	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G2	FMG2A	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=300мВт; h_{21}>56; 47кОм/47кОм	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G2	UMG2N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100 мА; P_D=150мВт; h_{21}>56; 47кОм/47кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G3	IMG3A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21}>100; R1 4.7кОм	SOT23-5	B2•B1•C2•E1,E1•C1
G37	OPA337NA	TI	OA	R-R; V_{DD}=2.5...5.5В; f_{BD}=3МГц; I_S=1.2мА; V_{OSI}<±3.5мВ	SOT23-5	OUT•V–•+IN•–IN•V+



SOT353 SC88A SOT23-5 TSOT23-5 1 2 3 5 4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
G4	EMG4	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; R1 10кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G4	FMG4A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21} > 100; R1 10кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
G4	UMG4N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; R1 10кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G5	EMG5	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; 10кОм/47кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G5	FMG5A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21} > 100; 10кОм/47кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
G5	UMG5N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; 10кОм/47кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G5	UMG5N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 4.7	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G6	EMG6	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; R1 47кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G6	FMG6A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21} > 100; R1 47кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
G6	UMG6N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; R1 47кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G6	UMG6N	ROHM	Dnpn x2	V_{CB}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; R_1 =47кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G7	FMG7A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21} > 100	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
G7	UMG7N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G7	UMG7N	ROHM	Dnpn x2	V_{CB}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; R_1 = 10кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1 • E2 • C2 • C1, B2
G8	EMG8	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; 4.7кОм/47кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G8	FMG8A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=300мВт; h_{21} > 100; 4.7кОм/47кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
G8	UMG8N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; 4.7кОм/47кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G8	UMG8N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 80; R2/R1 = 10	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G9	EMG9	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 56; 10кОм/10кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
G9	FMG9A	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=300мВт; h_{21} > 56; 10кОм/10кОм	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
G9	UMG9N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC}=50В; I_{OUT}=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 56; 10кОм/10кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
H0A	AD8031ART	AD	OA	f_{BD}=80МГц; P_D=16мВт; V_{DD}=2.7...12В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
H0D	AD8061ARTZ	AD	OA	f_{BD}=320МГц; P_D=75мВт; V_{DD}=2.7...8В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
H1A	AD8005AR	AD	OA	f_{BD}=270МГц; P_D=4мВт; V_{DD}=±3...±6В	SOT23-5	OUT • –VS • +IN • –IN • +VS
H2A	AD8051ART	AD	OA	f_{BD}=110МГц; P_D=60мВт; V_{DD}=3...12В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
H3A	AD8055ART	AD	OA	f_{BD}=300МГц; P_D=40мВт; V_{DD}=±4...±6В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
H3B	AD8033AKS	AD	OA	f_{BD}=80МГц; P_D=65мВт; V_{DD}=5...24В	SOT353, SC88A	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
H4	EMH4	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50В; I_C=100мА; P_D=150мВт; h_{21} > 100; R1 10кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
H7A	AD8057ART	AD	OA	f_{BD}=325МГц; P_D=70мВт; V_{DD}=3...12В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
HAA	AD8014ART	AD	OA	f_{BD}=480МГц; P_D=8мВт; V_{DD}=±2.25...±6В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
HEA	AD8001ART	AD	OA	f_{BD}<880МГц; P_D=50мВт; V_{DD}=±3...±6В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
HGA	AD8061ART	AD	OA	f_{BD}=320МГц; P_D=75мВт; V_{DD}=2.7...8В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
HRA	AD8065ART	AD	OA	f_{BD}=145МГц; P_D=150мВт; V_{DD}=5...24В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
HRA#	AD8065ARTZ	AD	OA	f_{BD}=145МГц; P_D=150мВт; V_{DD}=5...24В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
HTA	AD8007AKS	AD	OA	f_{BD}=650МГц; P_D=120мВт; V_{DD}=5...12В	SOT353, SC88A	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS



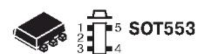


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
HUA	AD8038AKS	AD	OA	f_{BD} = 350 МГц; P_D = 18 мВт; V_{DD} = 3...12 В	SOT353, SC88A	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
HVA	AD8091ART	AD	OA	f_{BD} = 110 МГц; P_D = 60 мВт; V_{DD} = 3...12 В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
HVA#	AD8091ARTZ	AD	OA	f_{BD} = 110 МГц; P_D = 60 мВт; V_{DD} = 3...12 В	SOT23-5	VOUT • –VS • +IN • –IN • +VS
J36	OPA336NJ	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.3...5.5 В; I_S = 42 мкА; V_{OSI} < ±125 мкВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
K1	UM5K1N	ROHM	nMOS x2	V_{DS} = 30 В; I_D = 100 мА; P_D = 150 мВт; $R_{DS(on)}$ < 13 Ом	SOT353, SC88A	G1 • S1, S2 • G2 • D2 • D1
L1	UML1N	ROHM	pnp+di	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; h_{21} > 120; V_R = 80 В; I_F = 100 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.2 В	SOT353, SC88A	A • E • B • C • K
L2	UML2N	ROHM	npn+di	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; h_{21} > 120; V_R = 80 В; I_F = 100 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.2 В	SOT353, SC88A	A • E • B • C • K
LA	MC74LCX1G14	ON	Schminv	V_{CC} = 2.0...3.6 В; I_{OUT} = 24 мА	SOT23-5	n. c. • INA • GND • OUT Y • VCC
LAG	MC78LC15NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 1.5 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAH	MC78LC18NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAI	MC78LC25NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAJ	MC78LC27NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 2.7 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAK	MC78LC28NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 2.8 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAL	MC78LC30NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 3.0 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAM	MC78LC33NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAN	MC78LC50NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LDE	ADP3309ART-2.5	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.8...12 В; I_{OUT} = 100 мА; V_{OUT} = 2.5 В	SOT23-5	IN • GND • SD • ERR/n. c. • OUT
LEC	MC78LC40NTR	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...12 В; V_{OUT} = 4.0 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LV	1SV265	SANYO	pin x2	V_R > 50 В; I_F < 50 мА; $V_F(I_F$ = 50 мА) = 0.91 В; I_R < 0.1 мкА	SOT23-5	A1 • n. c. • A2 • K2 • K1
OAQI	OPA842IDBV	TI	OA	V_{DD} = ±5...±6 В; f_{BD} = 200 МГц; I_S = 22.5 мА; V_{OSI} < ±1.5 мВ	SOT23-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
PAPI	TPS3823-25DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.25 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PAQI	TPS3823-30DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PARI	TPS3823-33DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PASI	TPS3823-50DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 4.55 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PATI	TPS3824-25DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.25 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VDD
PAUI	TPS3824-30DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VDD
PAVI	TPS3824-33DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VDD
PAWI	TPS3824-50DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 4.55 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VDD
PCPI	TPS77001DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 1.2...5.5 В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCQI	TPS77012DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 1.2В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCQI	TPS77018DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 1.8В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCRI	TPS77015DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 1.5В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCTI	TPS77025DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 2.5В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCUI	TPS77027DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 2.7В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCVI	TPS77028DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 2.8В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCWI	TPS77030DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 3.0В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCXI	TPS77033DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 3.3В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCYI	TPS77050DBV	TI	reg	LDO; V_{IN} = 2.7...10.0 В; V_{OUT} = 5.0В; I_{OUT} = 50 мА	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PDDI	TPS3820-50DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 4.55 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PDEI	TPS3820-33DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PDFI	TPS3825-50DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 4.55 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VDD
PDGI	TPS3825-33DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VDD
PDHI	TPS3828-50DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 4.55 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PDII	TPS3828-33DBV	TI	mrc+wdt	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.1...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PHKI	TPS62200DBV	TI	dcdc	V_{IN} = 2.5...6.0 В; V_{OUT} = 0.7...V_{IN} В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW
PHLI	TPS62201DBV	TI	dcdc	V_{IN} = 2.5...6.0 В; V_{OUT} = 1.5 В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW






Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
PHMI	TPS62202DBV	TI	dcdc	V_{IN} = 2.5...6.0 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW
PHNI	TPS62203DBV	TI	dcdc	V_{IN} = 2.5...6.0 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW
PHSI	TPS62204DBV	TI	dcdc	V_{IN} = 2.5...6.0 В; V_{OUT} = 1.6 В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW
PHTI	TPS62205DBV	TI	dcdc	V_{IN} = 2.5...6.0 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW
PJGI	TPS62207DBV	TI	dcdc	V_{IN} = 2.5...6.0 В; V_{OUT} = 1.2 В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW
Q2	FMQ2	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 40 В; I_C = 30 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120; 100 кОм/100 кОм/200 Ом	SOT23-5	E2 • B2, E2 • C1 • B1 • C2
R02A	LM4130AIM5-2.0	NS	vref	V_{OUT} = 2.0 В; ACC = 0.05 %; 10 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R02B	LM4130BIM5-2.0	NS	vref	V_{OUT} = 2.0 В; ACC = 0.2 %; 10 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R02C	LM4130CIM5-2.0	NS	vref	V_{OUT} = 2.0 В; ACC = 0.1 %; 20 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R02D	LM4130DIM5-2.0	NS	vref	V_{OUT} = 2.0 В; ACC = 0.4 %; 20 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R02E	LM4130EIM5-2.0	NS	vref	V_{OUT} = 2.0 В; ACC = 0.5 %; 30 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R03A	LM4130AIM5-2.5	NS	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC = 0.05 %; 10 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R03B	LM4130BIM5-2.5	NS	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC = 0.2 %; 10 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R03C	LM4130CIM5-2.5	NS	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC = 0.1 %; 20 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R03D	LM4130DIM5-2.5	NS	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC = 0.4 %; 20 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R03E	LM4130EIM5-2.5	NS	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC = 0.5 %; 30 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R04A	LM4130AIM5-4.1	NS	vref	V_{OUT} = 4.1 В; ACC = 0.05 %; 10 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R04B	LM4130BIM5-4.1	NS	vref	V_{OUT} = 4.1 В; ACC = 0.2 %; 10 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R04C	LM4130CIM5-4.1	NS	vref	V_{OUT} = 4.1 В; ACC = 0.1 %; 20 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R04D	LM4130DIM5-4.1	NS	vref	V_{OUT} = 4.1 В; ACC = 0.4 %; 20 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R04E	LM4130EIM5-4.1	NS	vref	V_{OUT} = 4.1 В; ACC = 0.5 %; 30 ppm/°C	SOT23-5	n. c. • GND • n. c. • VIN • VREF
R0A	ADR318ARJ	AD	vref	V_{IN} = 2.4...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 1.8 В	SOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • –VOUTF • GND
R0A	ADR390AUJZ	AD	vref	V_{IN} = 2.5...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 2.048 В	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R0B	ADR390BUJZ	AD	vref	V_{IN} = 2.5...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 2.048 В	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R1A	ADR391AUJZ	AD	vref	V_{IN} = 2.5...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 2.5 В	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R1B	ADR391BUJZ	AD	vref	V_{IN} = 2.5...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 2.5 В	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R1E	ADR01AKSZ	AD	vref	V_{IN} = 12...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 10 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1E	ADR01AUJZ	AD	vref	V_{IN} = 12...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 10 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1F	ADR01BKSZ	AD	vref	V_{IN} = 12...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 10 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1F	ADR01BUJZ	AD	vref	V_{IN} = 12...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 10 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1G	ADR02AKSZ	AD	vref	V_{IN} = 7...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 5 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1G	ADR02AUJZ	AD	vref	V_{IN} = 7...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 5 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1H	ADR02BKSZ	AD	vref	V_{IN} = 7...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 5 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1H	ADR02BUJZ	AD	vref	V_{IN} = 7...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 5 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1J	ADR03AKSZ	AD	vref	V_{IN} = 4.5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.5 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1J	ADR03AUJZ	AD	vref	V_{IN} = 4.5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.5 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1K	ADR03BKSZ	AD	vref	V_{IN} = 4.5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.5 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1K	ADR03BUJZ	AD	vref	V_{IN} = 4.5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.5 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1L	ADR06AKSZ	AD	vref	V_{IN} = 5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 3 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1L	ADR06AUJZ	AD	vref	V_{IN} = 5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 3 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1M	ADR06BKSZ	AD	vref	V_{IN} = 5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 3 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM

SOT23-5 SOT353
TSOT23-5 SC88A
SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
R1M	ADR06BUJZ	AD	vref	V_{IN} = 5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 3 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R8A	ADR01AKS	AD	vref	V_{IN} = 12...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 10 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R8A	ADR01AUJ	AD	vref	V_{IN} = 12...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 10 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R8B	ADR01BKS	AD	vref	V_{IN} = 12...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 10 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R8B	ADR01BUJ	AD	vref	V_{IN} = 12...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 10 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R9A	ADR02AKS	AD	vref	V_{IN} = 7...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 5 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R9A	ADR02AUJ	AD	vref	V_{IN} = 7...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 5 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R9B	ADR02BKS	AD	vref	V_{IN} = 7...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 5 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R9B	ADR02BUJ	AD	vref	V_{IN} = 7...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 5 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
RCA	ADR392AUJZ	AD	vref	V_{IN} = 2.5...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 4.096 В	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
RCB	ADR392BUJZ	AD	vref	V_{IN} = 2.5...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 4.096 В	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
RDA	ADR395AUJZ	AD	vref	V_{IN} = 2.5...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 5 В	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
RDB	ADR395BUJZ	AD	vref	V_{IN} = 2.5...15 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 5 В	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
RFA	ADR03AKS	AD	vref	V_{IN} = 4.5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.5 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
RFA	ADR03AUJ	AD	vref	V_{IN} = 4.5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.5 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
RFB	ADR03BKS	AD	vref	V_{IN} = 4.5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.5 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
RFB	ADR03BUJ	AD	vref	V_{IN} = 4.5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.5 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
RWA	ADR06AKS	AD	vref	V_{IN} = 5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 3 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
RWA	ADR06AUJ	AD	vref	V_{IN} = 5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 3 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
RWB	ADR06BKS	AD	vref	V_{IN} = 5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 3 В	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
RWB	ADR06BUJ	AD	vref	V_{IN} = 5...40 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 3 В	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
S00	ADG741BKSZ5	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT353, SC88A	D • S • GND • IN • VDD
S01	ADG742BKSZ5	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT353, SC88A	D • S • GND • IN • VDD
S1	EMS1	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 120	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
S1	FMS1A	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
S1	UMS1N	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
S2	FMS2A	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-5	C1 • C2 • E2 • B1, B2 • E1
S2	UMS2N	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT353, SC88A	E1 • B1, B2 • E2 • C2 • C1
S3	FMS3	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-5	C2 • E1, E2 • C1 • B1 • B2
S3B	ADG701BRJ	AD	asw	SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-5	D • S • GND • IN • VDD
S4	FMS4	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
S47	OPA347SA	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.3...5.5 В; f_{BD} = 350 кГц; I_S = 43 мкА; V_{OSI} < 7 мВ	SOT353, SC88A	+IN • V– • –IN • OUT • V+
S48	OPA348AI	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.1...5.5 В; f_{BD} = 1 МГц; I_S = 75 мкА; V_{OSI} < 6 мВ	SOT353, SC88A	+IN • V– • –IN • OUT • V+
S4B	ADG702BRJ	AD	asw	SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-5	D • S • GND • IN • VDD
T2B	LM20BIM7	NS	ats	T_{AMB} = -55...130 °C; V_{CC} = 2.4...5.5 В; I_{OUT} < 10 мА	SOT353, SC88A	n. c. • GND • Vo • GND • V+
T2C	LM20CIM7	NS	ats	T_{AMB} = -55...130 °C; V_{CC} = 2.4...5.5 В; I_{OUT} < 10 мА	SOT353, SC88A	n. c. • GND • Vo • GND • V+





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
T5G	TMP35GRT	AD	ats	T_{AMB}=10...125°C; V_{CC}=2.7...5.5 В; $I_{OUT} < 50$ мкА; ACC=±3°C	SOT23-5	VOUT • +VS • n. c. • SHDN • GND
T6G	TMP36GRT	AD	ats	T_{AMB}=-40...125°C; V_{CC}=2.7...5.5 В; $I_{OUT} < 50$ мкА; ACC=±3°C	SOT23-5	VOUT • +VS • n. c. • SHDN • GND
T7G	TMP37GRT	AD	ats	T_{AMB}=5...100°C; V_{CC}=2.7...5.5 В; $I_{OUT} < 50$ мкА; ACC=±3°C	SOT23-5	VOUT • +VS • n. c. • SHDN • GND
V0	MC74VHC1G01DF	ON	2-NAND	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.7 нс	SOT353, SC88A	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
V0	MC74VHC1G01DT	ON	2-NAND	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.7 нс	SOT23-5	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
V3	MC74VHC1G02DF	ON	2-NOR	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.0 нс	SOT353, SC88A	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VA	MC74VHC1G14	ON	Schminv	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=4.5 нс	SOT23-5	n. c. • INA • GND • OUT Y • VCC
VAZI	TLV2631IDBV	TI	OA	R-R; V_{DD}=2.7...5.5 В; f_{BD}=9 МГц; $V_{OSI} < 4.5$ мВ	SOT23-5	OUT • GND • IN+ • IN • VDD
VC	MC74VHC1GT14DF	ON	Schminv	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=4.5 нс	SOT353, SC88A	n. c. • INA • GND • OUT Y • VCC
VC	MC74VHC1GT14DT	ON	Schminv	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=4.5 нс	SOT23-5	n. c. • INA • GND • OUT Y • VCC
VD	MC74VHC1G132DF	ON	SchmNAND	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.6 нс	SOT353, SC88A	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VD	MC74VHC1G132DT	ON	SchmNAND	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.6 нс	SOT23-5	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VT	MC74VHC1GT08DF	ON	2-AND	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT353, SC88A	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VT	MC74VHC1GT08DT	ON	2-AND	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT23-5	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VU	MC74VHC1GT132DF	MOT	SchmNAND	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=3.6 нс	SOT353, SC88A	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VU	MC74VHC1GT132DT	MOT	SchmNAND	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=3.6 нс	SOT23-5	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VX	MC74VHC1G09DF	ON	2-AND	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=4.3 нс	SOT353, SC88A	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VZ	MC74VHC1G135DF	ON	SchmNAND	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=4.9 нс	SOT353, SC88A	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
VZ	MC74VHC1G135DT	ON	SchmNAND	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=4.9 нс	SOT23-5	INB • INA • GND • OUT Y • VCC
W0	MC74VHC1G125DF	ON	3-stbuff	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT353, SC88A	OE • INA • GND • OUT Y • VCC
W0	MC74VHC1G125DT	ON	3-stbuff	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT23-5	OE • INA • GND • OUT Y • VCC
W1	FMW1	ROHM	npn x2	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=300 мВт; $h_{21} > 120$	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
W1	MC74VHC1GT125DF	ON	3-stbuff	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT353, SC88A	OE • INA • GND • OUT Y • VCC
W1	MC74VHC1GT125DT	ON	3-stbuff	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT23-5	OE • INA • GND • OUT Y • VCC
W1	UMW1N	ROHM	npn x2	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D (com.)=300 мВт; h_{21}=180...560	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
W11	UMW11N	ROHM	npn x2	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D (com.)=300 мВт; h_{21}=27...270; $f_T > 1500$ МГц	SOT353, SC88A	E1 • B1, B2 • E2 • C2 • C1
W12	UMW12N	ROHM	npn x2	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D (com.)=300 мВт; $h_{21} > 120$	SOT353, SC88A	E1, C2 • C1 • B1 • B2 • E2
W13	UMW13N	ROHM	npn x2	V_{CB0}=30 В; I_C=50 мА; P_D (com.)=300 мВт; h_{21}=27...270; $f_T > 2000$ МГц	SOT353, SC88A	E1 • B1, B2 • E2 • C2 • C1
W2	FMW2	ROHM	npn x2	V_{CB0}=60 В; I_C=150 мА; P_D=300 мВт; $h_{21} > 120$	SOT23-5	C1 • C2 • E2 • B1, B2 • E1
W2	MC74VHC1G126DF	ON	3-stbuff	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT353, SC88A	OE • INA • GND • OUT Y • VCC
W2	MC74VHC1G126DT	ON	3-stbuff	V_{CC}=2.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT23-5	OE • INA • GND • OUT Y • VCC
W2	UMW2N	ROHM	npn x2	V_{CB0}=50 В; I_C=100 мА; P_D (com.)=300 мВт; $h_{21} > 120$	SOT353, SC88A	E1 • B1, B2 • E2 • C2 • C1
W3	FMW3	ROHM	npn x2	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; $h_{21} > 180$	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
W3	MC74VHC1GT126DF	ON	3-stbuff	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT353, SC88A	OE • INA • GND • OUT Y • VCC
W3	MC74VHC1GT126DT	ON	3-stbuff	V_{CC}=3.0...5.5 В; t_{PD}=3.5 нс	SOT23-5	OE • INA • GND • OUT Y • VCC
W4	FMW4	ROHM	npn x2	V_{CB0}=120 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; $h_{21} > 180$	SOT23-5	C1 • C2 • E2 • B1, B2 • E1





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
W5	UMW5N	ROHM	npn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D(com.)=300 мВт; h_{21}>250	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
W6	FMW6	ROHM	npn x2	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>27	SOT23-5	C2, E1•C1•B1•B2•E2
W6	UMW6N	ROHM	npn x2	V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D(com.)=300 мВт; h_{21}=27...270; f_T>1500 МГц	SOT353, SC88A	E2•B2•B1•C1•E1, C2
W7	FMW7	ROHM	npn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>27	SOT23-5	C1, E2•C2•B2•B1•E1
W7	UMW7N	ROHM	npn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D(com.)=300 мВт; h_{21}=27...270; f_T>3200 МГц	SOT353, SC88A	E2•B2•B1•C1•E1, C2
W8	UMW8N	ROHM	npn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D(com.)=300 мВт; h_{21}=27...270; f_T>3200 МГц	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
W9	UMW9T	ROHM	npn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D(com.)=300 мВт; h_{21}=27...270; f_T>3200 МГц	SOT353, SC88A	E1•B1, B2•E2•C2•C1
XA	RN1501	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XA	RN1701	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XA	RN1701JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XB	RN1502	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10 кОм/10 кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XB	RN1702	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10 кОм/10 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XB	RN1702JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10 кОм/10 кОм	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XC	RN1503	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22 кОм/22 кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XC	RN1703	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22 кОм/22 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XC	RN1703JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22 кОм/22 кОм	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XD	RN1504	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47 кОм/47 кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XD	RN1704	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XD	RN1704JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=47 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XE	RN1505	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=2.2 кОм/47 кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XE	RN1705	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=2.2 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XE	RN1705JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=2.2 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XF	RN1506	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/47 кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XF	RN1706	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XF	RN1706JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=4.7 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XH	RN1507	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10 кОм/47 кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XH	RN1707	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XH	RN1707JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=10 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XI	RN1508	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22 кОм/47 кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XI	RN1708	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_1/R_2=22 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
XI	RN1708JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 100мВт; f_T = 250МГц; R_1/R_2 = 22кОм/47кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XJ	RN1509	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 300мВт; f_T = 250МГц; R_1/R_2 = 47кОм/22кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XJ	RN1709	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; f_T = 250МГц; R_1/R_2 = 47кОм/22кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XJ	RN1709JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 100мВт; f_T = 250МГц; R_1/R_2 = 47кОм/22кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XK	RN1510	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 300мВт; f_T = 250МГц; R_1 = 4.7кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XK	RN1710	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; f_T = 250МГц; R_1 = 4.7кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XK	RN1710JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 100мВт; f_T = 250МГц; R_1 = 4.7кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XM	RN1511	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 300мВт; f_T = 250МГц; R_1 = 10кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XM	RN1711	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; f_T = 250МГц; R_1 = 10кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
XM	RN1711JE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 100мВт; f_T = 250МГц; R_1 = 10кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
Y1	EMY1	ROHM	npn+pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 150мА; P_D = 300мВт; $h_{21} > 120$	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
Y1	FMY1A	ROHM	npn+pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 150мА; P_D = 300мВт; $h_{21} > 120$	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1
Y1	UMY1N	ROHM	pnp(1)+npn (2)	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D (com.) = 300мВт; $h_{21} > 120$; $f_T > 180$МГц	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
Y3	FMY3A	ROHM	npn+pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 150мА; P_D = 300мВт; $h_{21} > 120$	SOT23-5	C1 • C2 • E2 • B2, E1 • B1
Y3	UMY3N	ROHM	pnp(1)+npn (2)	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D (com.) = 300мВт; h_{21} = 120...560; $f_T > 180$МГц	SOT353, SC88A	B1 • E1, B2 • E2 • C2 • C1
Y4	FMY4A	ROHM	npn+pnp	V_{CB0} = 60В; I_C = 150мА; P_D = 300мВт; $h_{21} > 120$	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • B1, E2 • E1
Y4	UMY4N	ROHM	pnp(1)+npn (2)	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D (com.) = 300мВт; h_{21} = 120...560; $f_T > 180$МГц	SOT353, SC88A	E1 • B1, E2 • B2 • C2 • C1
Y5	FMY5	ROHM	npn+pnp	V_{CB0} = 120В; I_C = 50мА; P_D = 300мВт; $h_{21} > 120$	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B2
Y6	FMY6	ROHM	npn+pnp	V_{CB0} = 40В; I_C = 500мА; P_D = 300мВт; $h_{21} > 120$	SOT23-5	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B2
YA	RN2501	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 300мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 4.7кОм/4.7кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YA	RN2701	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 4.7кОм/4.7кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YA	RN2701JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 100мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 4.7кОм/4.7кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YB	RN2502	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 300мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 10кОм/10кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YB	RN2702	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 10кОм/10кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YB	RN2702JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 100мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 10кОм/10кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YC	RN2503	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 300мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 22кОм/22кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YC	RN2703	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 22кОм/22кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YC	RN2703JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 100мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 22кОм/22кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YD	RN2504	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 300мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 47кОм/47кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YD	RN2704	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 200мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 47кОм/47кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YD	RN2704JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 100мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 47кОм/47кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YE	RN2505	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50В; I_C = 100мА; P_D = 300мВт; f_T = 200МГц; R_1/R_2 = 2.2кОм/47кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
YE	RN2705	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YE	RN2705JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YF	RN2506	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YF	RN2706	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YF	RN2706JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YH	RN2507	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YH	RN2707	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YH	RN2707JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YI	RN2508	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YI	RN2708	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YI	RN2708JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YJ	RN2509	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YJ	RN2709	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YJ	RN2709JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YK	RN2510	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YK	RN2710	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YK	RN2710JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YM	RN2511	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT23-5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YM	RN2711	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT353, SC88A	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
YM	RN2711JE	TOSH	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT553, EMT5	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1
Z25	NC7SZ125P5X	FAIR	3-stbuff	V_{CC} = 1.65...5.5 В; I_{OUT} = ± 24 мА	SOT353, SC88A	OE • A • GND • Y • VCC

SOT23-6, SOT363/563…

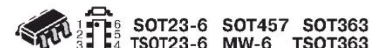
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
11	MUN5311DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 35; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
12	MUN5312DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
13	MUN5313DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
14	MUN5314DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
15	MUN5315DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 160; R_1 10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
16	MUN5316DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 160; R_1 4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
30	MUN5330DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 3; 1 кОм/1 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
31	MUN5331DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
32	MUN5332DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
33	MUN5333DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
34	MUN5334DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 22 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
35	MUN5335DW1	ON	Dnpn/pnp	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
#CHA	AD7414ARTZ	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
0A	NSBA114EDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 35; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0A	MUN5111DW1	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 35; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0B	NSBA124EDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0B	MUN5112DW1	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0C	NSBA144EDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0C	MUN5113DW1	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0D	NSBA114YDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0D	MUN5114DW1	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0E	NSBA114TDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 160; R_1 10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0E	MUN5115DW1	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 160; R_1 10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0F	NSBA143TDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 160; R_1 4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0F	MUN5116DW1	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 160; R_1 4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0G	MUN5130DW1	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 3; 1 кОм/1 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0G	NSBA113EDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 3; 1 кОм/1 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
0H	NSBA123EDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0H	MUN5131DW1	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0J	NSBA143EDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0J	MUN5132DW1	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0K	NSBA143ZDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0K	MUN5133DW1	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0L	NSBA124XDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 22 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0L	MUN5134DW1	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 22 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0M	NSBA123JDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0M	MUN5135DW1	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0N	MUN5136DW1	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 100 кОм/100 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0N	NSBA115EDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 100 кОм/100 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0P	MUN5137DW1	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0P	NSBA144WDXV6	ON	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
100	NMT2222	NS	npn	V_{CBO} = 75 В; I_C = 1 А; h_{21} > 35; f_T > 300 МГц	SOT23-6	B1•E2•B2•C2•E1•C1
1000	ZXTS1000E6	ZETEX	pnp+ shd	V_{CEO} = 12 В; I_C = 1.25 А; V_R = 40 В; I_F = 0.5 А	SOT23-6	C•E•K•A•n. c.•B1
11	NSBC114EPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 35; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
11	RN46A1	TOSH	Dpnp/npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; Q1: R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм; Q2: R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
12	NSBC124EPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
13	NSBC144EPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
14	NSBC114YPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
15	NSBC114TPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 160; R_1 10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
15	RN49A1	TOSH	Dpnp/npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; Q1: R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм; Q2: R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
16	MT6L61AFS	TOSH	npn x2	V_{CEO} = 5 В; I_C = 25/40 мА; P_D = 50 мВт; f_T > 7 ГГц	fS6	B2•E2•B1•C1•E1•C2
16	NSBC143TPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 160; R_1 4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
17	MT6L62AFS	TOSH	npn x2	V_{CEO} = 5 В; I_C = 25/40 мА; P_D = 50 мВт; f_T > 10 ГГц	fS6	B2•E2•B1•C1•E1•C2
17B	RN4962FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
1Bs	BC817UPN	INF	npn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 160...400; f_T = 170 МГц	SOT457, SC74	E1•B1•C2•E2•B2•C1
1Cs	BC847S	INF	npn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...630; f_T = 250 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
1Ds	BC846U	INF	npn x2	V_{CBO} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 200...450; f_T = 250 МГц	SOT457, SC74	E1•B1•C2•E2•B2•C1

fS6 SON-6 SOT563  **SOT363 SOT457 SOT23-6** 

M16 USM-6 SOT666 **TSOT363 MW-6 TSOT23-6**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
1Os	BC846PN	INF	pnp/npn	V_{CBO} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 200...450; f_T > 100 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
1Ps	BC847PN	INF	pnp/npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...630; f_T = 250 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
24R	µPA810T	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 3 ГГц	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
25R	µPA810T	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 110...240; f_T > 3 ГГц	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
28	RN49A2	TOSH	Dpnp/npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; Q1: R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм; Q2: R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
2N02	ZXM62N02E6	ZETEX	nMOS	V_{DS} = 20 В; I_D = 2.6 А; P_D = 330 мВт; $R_{DS(on)}$ < 0.125 Ом	SOT23-6	D•D•G•S•D•D
30	NSBC113EPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 3; 1 кОм/1 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
31	NSBC123EPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
32	NSBC143EPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
33	NSBC143ZPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
34	NSBC124XPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 22 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
34R	µPA812TFB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 70...150; f_T > 4.5 ГГц	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
35	NSBC123JPDXV6	ON	Dnpn/pnp	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
35R	µPA812TGB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 110...240; f_T > 4.5 ГГц	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
3Cs	BC857S	INF	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 125...630; f_T = 250 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
3F	µPA873TC	NEC	npn x2	V_{CBO} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 100...145; f_T > 3 ГГц	USM-6	C1•E1•C2•E2•B2•B1
3Ft	BC857BS	PHIL	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 220...475; f_T > 150 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
3G	MGSF3454X	ON	nMOS	I_D = 1.75 А	SOT457, SC74	D•D•G•S•D•D
44R	µPA811TFB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 5.5 ГГц	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
4591	ZXTD4591E6	ZETEX	npn/pnp	V_{CBO} = 80 В; I_C = 1 А; h_{21} > 20; P_D = 1.1 Вт	SOT23-6	C1•B1•C2•E2•B2•E1
45R	µPA811TGB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 125...250; f_T > 5.5 ГГц	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
46	MBT3946DW1	ON	pnp/npn	V_{CBO} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 30; f_T > 250 МГц	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
4B	µPA891TC	NEC	npn x2	V_{CBO} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 100...160; f_T > 3.5 ГГц	USM-6	C1•E1•C2•B2•E2•B1
4C	µPA892TC	NEC	npn x2	V_{CBO} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 210 мВт; h_{21} = 50...100; f_T > 18 ГГц	USM-6	C1•E1•C2•B2•E2•B1
5Ft	BC856S	PHIL	pnp x2	V_{CBO} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 110; f_T > 100 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
62s	BAT62-08S	INF	shd x3	V_R < 40 В; I_F < 20 мА; V_F (I_F = 2 мА) < 1 В; I_R < 10 мкА; C_D < 0.6 пФ	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
69s	BAT62-09S	INF	shd x2	V_R < 40 В; I_F < 20 мА; V_F (I_F = 2 мА) < 1 В; I_R < 10 мкА; C_D < 0.6 пФ	SOT363, SC88	A1•n.c.•A2•K2•n.c.•K1
6A	RN4981	TOSH	Dpnp/npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6A	RN4981FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1

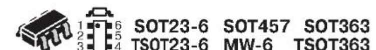




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
6B	RN4982	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6B	RN4982FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6C	RN4983	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6C	RN4983FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6D	RN4984	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6D	RN4984FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6E	RN4985	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6E	RN4985FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6F	RN4986	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6F	RN4986FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6H	RN4987	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6H	RN4987FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6I	RN4988	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6I	RN4988FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6J	RN4989	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6J	RN4989FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6K	RN4990	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6K	RN4990FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6M	RN4991	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
6M	RN4991FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
70	µPA801TCFB	NEC	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 3 ГГц	USM-6	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
71	µPA801TCGB	NEC	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 125...250; f_T > 3 ГГц	USM-6	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
72	µPA804TCFB	NEC	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 3 ГГц	USM-6	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
73	µPA804TCGB	NEC	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 3 ГГц	USM-6	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
73T	µPA813TFB	NEC	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 160 мВт; h_{21} = 60...120; f_T = 5.5 ГГц	SOT363, SC88	C1 • B2 • C2 • E2 • E1 • B1
74s	BAS70-04S	INF	shd x4	V_R < 70 В; I_F < 70 мА; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 2.0 пФ	SOT363, SC88	A1 • K2 • A3, K4 • A4 • K3 • K1, A2
74T	µPA813TGB	NEC	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 160 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 5.5 ГГц	SOT363, SC88	C1 • B2 • C2 • E2 • E1 • B1
75	µPA810TC	NEC	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 3 ГГц	USM-6	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
7A	MUN5211DW1	ON	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 35; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E2 • B2 • C1 • E1 • B1 • C2



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
7A	NSBC114EDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 35; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7B	MUN5212DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7B	NSBC124EDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7C	MUN5213DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7C	NSBC144EDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7D	MUN5214DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7D	NSBC114YDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7E	MUN5215DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 160; R_1 10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7E	NSBC114TDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 160; R_1 10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7F	MUN5216DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 160; R_1 4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7F	NSBC143TDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 160; R_1 4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7G	MUN5230DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 3; 1 кОм/1 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7G	NSBC113EDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 3; 1 кОм/1 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7H	MUN5231DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7H	NSBC123EDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 8; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7J	MUN5232DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7J	NSBC143EDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 15; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7K	MUN5233DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7K	NSBC143ZDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 4.7 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7L	MUN5234DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 22 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7L	NSBC124XDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 22 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7M	MUN5235DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7M	NSBC123JDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7N	MUN5236DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 100 кОм/100 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7N	NSBC115EDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 100 кОм/100 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7P	MUN5237DW1	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7P	NSBC144WDXV6	ON	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 357 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
83s	BAT68-08S	INF	shd x3	V_R < 8 В; I_F < 130 мА; V_F (I_F = 10 мА) < 0.5 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 1.0 пФ	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
87	µPA814TC	NEC	npn x2	V_{CBO} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 4 ГГц	USM-6	C1•B2•C2•E2•E1•B1




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
88T	μPA814T	NEC	npn x2	V_{CBO} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 80...160; f_T > 4 ГГц	SOT363, SC88	C1 • B2 • C2 • E2 • E1 • B1
89s	BAT68-09S	INF	shd x2	V_R < 8 В; I_F < 130 мА; V_F (I_F = 10 мА) < 0.5 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 1.0 пФ	SOT363, SC88	A1 • n. c. • A2 • K2 • n. c. • K1
A1s	BAW56S	INF	di x4	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT363, SC88	K1 • K2 • A3, A4 • K4 • K3 • A2, A1
A1s	BAW56U	INF	di x4	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT457, SC74	K1 • K2 • A3, A4 • K4 • K3 • A2, A1
A1t	BAW56S	PHIL	di x2	V_R < 85 В; I_F < 250 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1 В; I_R < 1 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT363, SC88	K1 • K2 • A3, A4 • K4 • K3 • A2, A1
A2	MBT3906DW1	ON	pnp x2	V_{CBO} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 30; f_T > 250 МГц	SOT363, SC88	E2 • B2 • C1 • E1 • B1 • C2
A40	OPA363I	TI	OA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5 В; f_{BD} = 7 МГц; I_S = 1.4 мА; V_{OSI} < 0.9 мВ	SOT23-6	OUT • V– • +IN • –IN • ENBL • V+
A4s	BAV70S	INF	di x4	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1 В; I_R (V_R = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT363, SC88	A1 • A2 • K3, K4 • A4 • A3 • K1, K2
A4s	BAV70U	INF	di x4	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 1 В; I_R (V_R = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT457, SC74	A1 • A2 • K3, K4 • A4 • A3 • K1, K2
A5	HN2D02FU	TOSH	di x3	V_R < 80 В; I_F < 80 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1.2 В; C_D < 4 пФ	SOT363, SC88	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
A6	HN2S01F	TOSH	shd x3	V_R < 10 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 0.5 В; C_D < 40 пФ	SOT23-6	K1 • K2 • K3 • A3 • A2 • A1
A6	HN2S01FU	TOSH	shd x3	V_R < 10 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 0.5 В; C_D < 40 пФ	SOT363, SC88	K1 • K2 • K3 • A3 • A2 • A1
A6s	BAS16S	INF	di x 3	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 50 мкА	SOT363, SC88	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
A6s	BAS16U	INF	di x 3	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 50 мкА	SOT457, SC74	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
A7s	BAV99S	INF	di x4	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT363, SC88	A1 • K2 • A3, K4 • A4 • K3 • A2, K1
A7s	BAV99U	INF	di x4	V_R < 80 В; I_F < 200 мА; V_F (I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 4 нс	SOT457, SC74	A1 • K2 • A3, K4 • A4 • K3 • A2, K1
A8	HN2S03FU	TOSH	shd x3	V_R < 20 В; I_F < 50 мА; V_F (I_F = 50 мА) < 0.55 В; C_D = 3.9 пФ	SOT363, SC88	K1 • K2 • K3 • A3 • A2 • A1
A9	HN2S02FU	TOSH	shd x3	V_R < 40 В; I_F < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 0.6 В; C_D = 18 пФ	SOT363, SC88	K1 • K2 • K3 • A3 • A2 • A1
A9A	AD8591ART	AD	OA	f_{BD} = 2.2 МГц; P_D = 7 мВт; V_{DD} = 2.5...6 В	SOT23-6	OUT A • V– • +IN A • –IN A • SD • V+
AAA	MAX9010EXT	MAX	cmp	V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 4.5...5.5 В; I_{CC} < 2.1 мА	SOT363, SC88	OUT • GND • IN+ • IN- • VCC • VCC
AAAA	MAX2633EUT	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P < 900 МГц; I_{CC} = 6.6 мА	SOT23-6	SHDN • GND • OUT • VCC • BIAS • IN
AAAA	MAX5161LEZT	MAX	Dpot	32 позиции; 50 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	L • H • GND • U/D • INC • VDD
AAAB	MAX4180EUT	MAX	OA	V_{DD} = +5/±2.25...±5.5 В; f_{BD} = 270 МГц; V_{OSI} < ±7 мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • SHDN • VCC
AAAB	MAX5161MEZT	MAX	Dpot	32 позиции; 100 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	L • H • GND • U/D • INC • VDD
AAAC	MAX4181EUT	MAX	OA	V_{DD} = +5/±2.25...±5.5 В; f_{BD} = 270 МГц; V_{OSI} < ±7 мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • SHDN • VCC
AAAC	MAX5161NEZT	MAX	Dpot	32 позиции; 200 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	L • H • GND • U/D • INC • VDD
AAAD	MAX4223EUT	MAX	OA	V_{DD} = ±2.85...±5.5 В; f_{BD} = 1 ГГц; V_{OSI} < 7 мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • SHDN • VCC
AAAE	MAX4224EUT	MAX	OA	V_{DD} = ±2.85...±5.5 В; f_{BD} = 1 ГГц; V_{OSI} < 7 мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • SHDN • VCC
AAAF	MAX2660EUT	MAX	upmixer	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...2500 МГц; I_{CC} = 4.8 мА	SOT23-6	LO • GND • IFIN • RFOUT • VCC • SHDN
AAAG	MAX2661EUT	MAX	upmixer	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...2500 МГц; I_{CC} = 8.3 мА	SOT23-6	LO • GND • IFIN • RFOUT • VCC • SHDN
AAAH	MAX2662EUT	MAX	upmixer	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...2500 МГц	SOT23-6	LOIN • GND • IFIN • RFOUT • VCC • SHDN



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAAI	MAX5383EZT	MAX	DAC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...3.6 В; V_{REF} = 2 В	TSOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AAAJ	MAX2671EUT	MAX	upmixer	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...2500 МГц; I_{CC} = 11.8 мА	SOT23-6	LO • GND • IFIN • RFOUT • VCC • SHDN
AAAJ	MAX5385EZT	MAX	DAC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В; V_{REF} = 0.9 x V_{DD}	TSOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AAAL	MAX2663EUT	MAX	upmixer	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...2500 МГц; I_{CC} = 3.0 мА	SOT23-6	LO • GND • IFIN • RFOUT • VCC • SHDN
AAAM	MAX4544EUT	MAX	asw	SPDT; R_{ON} < 75 Ом; V_{DD} = 2.7...12 В	SOT23-6	IN • V+ • GND • NC • COM • NO
AAAO	MAX998EUT	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±3 мВ; V_{CC} = 2.7...5.5 В; I_{CC} < 650 мкА	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN- • SHDN • VCC
AAAQ	MAX4529UT	MAX	asw	двунапр. РЧ/видео; R_{ON} < 100 Ом; V_{DD} = 2.7...12/±2.7...±6 В	SOT23-6	NC • V+ • V- • IN • GND • COM
AAAR	MAX2680EUT	MAX	dnmixer	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...2500 МГц; I_{CC} < 21.8 мА	SOT23-6	LO • GND • RFIN • IFOUT • VCC • SHDN
AAAS	MAX2681EUT	MAX	dnmixer	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...2500 МГц; I_{CC} < 21.8 мА	SOT23-6	LO • GND • RFIN • IFOUT • VCC • SHDN
AAAT	MAX2682EUT	MAX	dnmixer	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...2500 МГц; I_{CC} < 21.8 мА	SOT23-6	LO • GND • RFIN • IFOUT • VCC • SHDN
AAAU	MAX6817EUT	MAX	swd x2	V_{CC} = 2.7...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-6	IN1 • GND • IN2 • OUT2 • VCC • OUT1
AAAV	MAX2640EUT	MAX	amp	SiGe; V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 400...1500 МГц; I_{CC} = 3.5 мА	SOT23-6	RFIN • GND • GND • RFOUT • GND • VCC
AAAW	MAX2641EUT	MAX	amp	SiGe; V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 1400...2500 МГц; I_{CC} = 3.5 мА	SOT23-6	RFIN • GND • GND • RFOUT • GND • VCC
AAAX	MAX2470EUT	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 10...200/10...500 МГц; I_{CC} < 7.4 мА	SOT23-6	OUT • GND • OUT • HI/LO (IN) • IN • VCC
AAAY	MAX2471EUT	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 10...500 МГц; I_{CC} < 7.4 мА	SOT23-6	OUT • GND • OUT • HI/LO (IN) • IN • VCC
AAAZ	MAX2472EUT	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 500...2500 МГц; I_{CC} < 8 мА	SOT23-6	OUT1 • GND • OUT2 • IN • GND • VCC
AAB	MAX4401AXT	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 800 кГц; V_{OSI} < 5.5 мВ	SOT363, SC88	IN+ • VSS • IN- • OUT • SHDN • VDD
AABA	MAX2473EUT	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 500...2500 МГц; I_{CC} = 2.7 мА	SOT23-6	OUT • GND • BIAS • IN • GND • VCC
AABB	MAX2605EUT	MAX	VCO	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 45...70 МГц; I_{CC} = 1.9 мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT- • VCC • OUT+
AABC	MAX2606EUT	MAX	VCO	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 70...150 МГц; I_{CC} = 2.1 мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT- • VCC • OUT+
AABD	MAX2607EUT	MAX	VCO	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 150...300 МГц; I_{CC} = 2.1 мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT- • VCC • OUT+
AABE	MAX2608EUT	MAX	VCO	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 300...500 МГц; I_{CC} = 2.7 мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT- • VCC • OUT+
AABF	MAX2609EUT	MAX	VCO	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 500...650 МГц; I_{CC} = 3.6 мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT- • VCC • OUT+
AABG	MAX6575LZUT	MAX	dts	T_{AMB} = -40...125 °C; V_{CC} = 2.7...5.5 В; I_{CC} < 400 мА	SOT23-6	VDD • GND • n. c. • TS0 • TS1 • I/O
AABH	MAX6575HZUT	MAX	dts	T_{AMB} = -40...125 °C; V_{CC} = 2.7...5.5 В; I_{CC} < 400 мА	SOT23-6	VDD • GND • n. c. • TS0 • TS1 • I/O
AABI	MAX6576ZUT	MAX	dts	T_{AMB} = -40...125 °C; V_{CC} = 2.7...5.5 В; I_{CC} < 400 мА	SOT23-6	VDD • GND • n. c. • TS0 • TS1 • OUT
AABJ	MAX6577ZUT	MAX	dts	T_{AMB} = -40...125 °C; V_{CC} = 2.7...5.5 В; I_{CC} < 400 мА	SOT23-6	VDD • GND • n. c. • TS0 • TS1 • OUT
AABN	MAX4173TEUT	MAX	CSA	V_{DD} = 3...28 В; f_{BD} = 1.7 МГц; Gain = 20; I_{CC} < 1 мА	SOT23-6	GND • GND • VCC • RS+ • RS- • OUT
AABO	MAX4173FEUT	MAX	CSA	V_{DD} = 3...28 В; f_{BD} = 1.7 МГц; Gain = 50; I_{CC} < 1 мА	SOT23-6	GND • GND • VCC • RS+ • RS- • OUT
AABP	MAX4173HEUT	MAX	CSA	V_{DD} = 3...28 В; f_{BD} = 1.7 МГц; Gain = 100; I_{CC} < 1 мА	SOT23-6	GND • GND • VCC • RS+ • RS- • OUT
AABQ	MAX4285EUT	MAX	buf	V_{DD} = +2.85...+6.5/±1.425...±3.25 В; f_{BD} = 250 МГц; V_{OSI} < ±12 мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • DISABLE • VCC
AABR	MAX4286EUT	MAX	buf	V_{DD} = +2.85...+6.5/±1.425...±3.25 В; f_{BD} = 150 МГц; V_{OSI} < ±12 мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • DISABLE • VCC
AABV	MAX1697REUT	MAX	vcpcon	V_{IN} = 1.25...5.5 В; f_P = 12 кГц; I_{OUT} = 60 мА	SOT23-6	OUT • IN • C1- • GND • SHDN • C1+
AABW	MAX1697SEUT	MAX	vcpcon	V_{IN} = 1.25...5.5 В; f_P = 35 кГц; I_{OUT} = 60 мА	SOT23-6	OUT • IN • C1- • GND • SHDN • C1+





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AABX	MAX1697TEUT	MAX	vcpcon	V_{IN} = 1.25...5.5 В; f_P = 125 кГц; I_{OUT} = 60 мА	SOT23-6	OUT • IN • C1- • GND • SHDN • C1+
AABY	MAX1697UEUT	MAX	vcpcon	V_{IN} = 1.25...5.5 В; f_P = 250 кГц; I_{OUT} = 60 мА	SOT23-6	OUT • IN • C1- • GND • SHDN • C1+
AABZ	MAX4510EUT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 225 Ом; V_{DD} = 9...36/±4.5...±20 В	SOT23-6	V+ • V- • IN • GND • COM • NC
AAC	MAX2642EXT	MAX	amp	SiGe; V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 800...1000 МГц; I_{CC} < 7.5 мА	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AACB	MAX6351LSUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST1 • GND • MR • VCC2 • RST2 • VCC1
AACC	MAX6351SYUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST1 • GND • MR • VCC2 • RST2 • VCC1
AACD	MAX6355LSUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACE	MAX6355SYUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACF	MAX6356LSUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACG	MAX6356SYUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACH	MAX6357LSUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACI	MAX6357SYUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACJ	MAX6358LSUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACK	MAX6358SYUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACL	MAX6359LSUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACM	MAX6359SYUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACN	MAX6360LSUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.63 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACO	MAX6360SYUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACP	MAX6342LUT	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACQ	MAX6342MUT	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACR	MAX6342TUT	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACS	MAX6342SUT	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACT	MAX6342RUT	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACU	MAX6342ZUT	MAX	mrc	V_{TR} = 2.33 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACV	MAX6343LUT	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACW	MAX6343MUT	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACX	MAX6343TUT	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACY	MAX6343SUT	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACZ	MAX6343RUT	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AAD	MAX2643EXT	MAX	amp	SiGe; V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 800...1000 МГц; I_{CC} < 7.5 мА	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AADA	MAX6343ZUT	MAX	mrc	V_{TR} = 2.33 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADD	MAX9011EUT	MAX	cmp	V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 4.5...5.5 В; I_{CC} < 2.1 мА	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN- • LE • VCC
AADE	MAX5363EUT	MAX	DAC	6-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...3.6 В; V_{REF} = 2 В	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADF	MAX5383EUT	MAX	DAC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...3.6 В; V_{REF} = 2 В	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADG	MAX5364EUT	MAX	DAC	6-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 4.5...5.5 В; V_{REF} = 4 В	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADH	MAX5384EUT	MAX	DAC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 4.5...5.5 В; V_{REF} = 4 В	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AADI	MAX5365EUT	MAX	DAC	6-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В; V_{REF}=0.9 x V_{DD}	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADJ	MAX5384EZT	MAX	DAC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=4.5...5.5 В; V_{REF}=4 В	TSOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADJ	MAX5385EUT	MAX	DAC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В; V_{REF}=0.9 x V_{DD}	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADK	MAX4520EUT	MAX	asw	SPST; R_{ON}<225 Ом; V_{DD}=9...36/±4.5...±20 В	SOT23-6	V+ • V- • IN • GND • COM • NO
AADN	MAX4628EUT	MAX	asw	SPST; R_{ON}<12 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	SOT23-6	COM • NO • GND • IN • IN • V+
AADQ	MAX6344LUT	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADR	MAX6344MUT	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADS	MAX6344TUT	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADT	MAX6344SUT	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADU	MAX6344RUT	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADV	MAX6344ZUT	MAX	mrc	V_{TR}=2.33 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADW	MAX6345LUT	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADX	MAX6345MUT	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADY	MAX6345TUT	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADZ	MAX6345SUT	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AAEA	MAX6345RUT	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AAEB	MAX6345ZUT	MAX	mrc	V_{TR}=2.33 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<60 мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AAEC	MAX4323EUT	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.4...6.5/±1.2...±3.25 В; f_{BD}=5 МГц; V_{OSI}<3.5 мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • SHDN • VCC
AAED	MAX6361LUT46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEE	MAX6361LUT44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEF	MAX6361LUT31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEG	MAX6361LUT29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEH	MAX6361LUT26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEI	MAX6361LUT23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEJ	MAX6361PUT46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEK	MAX6361PUT44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEL	MAX6361PUT31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEM	MAX6361PUT29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEN	MAX6361PUT26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEO	MAX6361PUT23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEP	MAX6361HUT46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEQ	MAX6361HUT44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAER	MAX6361HUT31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAES	MAX6361HUT29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAET	MAX6361HUT26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEU	MAX6361HUT23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEV	MAX6362LUT46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAEW	MAX6362LUT44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAEX	MAX6362LUT31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAEY	MAX6362LUT29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAEZ	MAX6362LUT26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAF	MAX4599EXT	MAX	asw	SPDT; R_{ON}<65 Ом; V_{DD}=2.0...5.5 В	SOT363, SC88	IN • V+ • GND • NC • COM • NO

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAFA	MAX6362LUT23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFB	MAX6362PUT46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFC	MAX6362PUT44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFD	MAX6362PUT31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFE	MAX6362PUT29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFF	MAX6362PUT26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFG	MAX6362PUT23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.25 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFH	MAX6362HUT46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFI	MAX6362HUT44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFJ	MAX6362HUT31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFK	MAX6362HUT29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFL	MAX6362HUT26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFM	MAX6362HUT23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFN	MAX6363LUT46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFO	MAX6363LUT44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFP	MAX6363LUT31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFQ	MAX6363LUT29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFR	MAX6363LUT26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFS	MAX6363LUT23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFT	MAX6363PUT46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFU	MAX6363PUT44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFV	MAX6363PUT31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFW	MAX6363PUT29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFX	MAX6363PUT26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFY	MAX6363PUT23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	$\overline{RES}$ • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFZ	MAX6363HUT46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAG	MAX2644EXT	MAX	amp	SiGe; V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 2400...2500 МГц; I_{CC} < 11 мА	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AAGA	MAX6363HUT44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAGB	MAX6363HUT31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAGC	MAX6363HUT29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAGD	MAX6363HUT26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAGE	MAX6363HUT23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAGF	MAX6364LUT46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGG	MAX6364LUT44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGH	MAX6364LUT31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGI	MAX6364LUT29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGJ	MAX6364LUT26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGK	MAX6364LUT23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGL	MAX6364PUT46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGM	MAX6364PUT44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGN	MAX6364PUT31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGO	MAX6364PUT29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGP	MAX6364PUT26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGQ	MAX6364PUT23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGR	MAX6364HUT46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGS	MAX6364HUT44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGT	MAX6364HUT31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGU	MAX6364HUT29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGV	MAX6364HUT26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAGW	MAX6364HUT23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RES • GND • RES IN • VCC • OUT • BATT
AAH	MAX9030AXT	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}<±5 мВ; V_{DD}=2.5...5.5 В; I_{DD}<55 мкА	SOT363, SC88	IN+ • VSS • IN- • OUT • SHDN • VDD
AAHA	MAX6510CAUT	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=-40...+125 °С; I_{CC}<165 мкА	SOT23-6	SET • GND • OUT, OUT • HYST • OUTSET • VCC
AAHB	MAX6510HAUT	MAX	tempsw	V_{CC}=2.7...5.5 В; T_{TH}=-40...+125 °С; I_{CC}<165 мкА	SOT23-6	SET • GND • OUT, OUT • HYST • OUTSET • VCC
AAHC	MAX4599EUT	MAX	asw	SPDT; R_{ON}<65 Ом; V_{DD}=2.0...5.5 В	SOT23-6	IN • V+ • GND • NC • COM • NO
AAHF	MAX9041AEUT	MAX	cmp + vref	R-R; V_{OSI}<±7 мВ; V_{CC}=2.5...5.5 В; V_{REF}=2.048 В; I_{CC}<72 мкА	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • REF • VCC
AAHG	MAX9051AEUT	MAX	cmp + vref	R-R; V_{OSI}<±7 мВ; V_{CC}=2.7...5.5 В; V_{REF}=2.500 В; I_{CC}<72 мкА	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • REF • VCC
AAHH	MAX9041BEUT	MAX	cmp + vref	R-R; V_{OSI}<±7 мВ; V_{CC}=2.5...5.5 В; V_{REF}=2.048 В; I_{CC}<72 мкА	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • REF • VCC
AAHI	MAX9051BEUT	MAX	cmp + vref	R-R; V_{OSI}<±7 мВ; V_{CC}=2.7...5.5 В; V_{REF}=2.500 В; I_{CC}<72 мкА	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • REF • VCC





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAHJ	MAX3188EUT	MAX	trnsmit	RS-232; V_{CC} = ±4.5...±6 В; f_{DR} = 256 Кбит/с; I_{CC} < 170 мкА	SOT23-6	SHDN • GND • TIN • TOUT • VEE • VCC
AAHK	MAX3189EUT	MAX	trnsmit	RS-232; V_{CC} = ±4.5...±6 В; f_{DR} = 1 Мбит/с; I_{CC} < 170 мкА	SOT23-6	SHDN • GND • TIN • TOUT • VEE • VCC
AAHL	MAX4645EUT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 3 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	COM • NO • GND • IN • n. c. • V+
AAHM	MAX4646EUT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 3 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	COM • NC • GND • IN • n. c. • V+
AAHO	MAX1736EUT42	MAX	chg	1 x Li+; V_{IN} = 4.7 ...22 В; V_{OUT} = 4.2 В; I_{CH} < 0.75 мА	SOT23-6	IN • GATE • GND • EN • CT • BATT
AAHP	MAX1605EUT	MAX	vcon	V_{IN} = 2.4...5.5 В; V_{OUT} = 0.8...30 В; I_{CC} < 35 мкА	SOT23-6	SHDN • VCC • GND • LX • LIM • FB
AAHQ	MAX4644EUT	MAX	asw	SPDT; R_{ON} < 4.75 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	IN • V+ • GND • NC • COM • NO
AAHR	MAX8880EUT	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...12 В; V_{OUT} = 1.25...5 В; I_{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHS	MAX8881EUT18	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...12 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHT	MAX8881EUT25	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...12 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHU	MAX8881EUT33	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...12 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHV	MAX8881EUT50	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5 ...12 В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHY	MAX6625PMUT	MAX	dts	9-разр.; T_{AMB} = -55...125 °C; I^2C; V_{DD}=3...5.5 В	SOT23-6	SDA • GND • SCL • OT • ADD • VS
AAHZ	MAX6625RMUT	MAX	dts	9-разр.; T_{AMB} = -55...125 °C; I^2C; V_{DD}=3...5.5 В	SOT23-6	SDA • GND • SCL • OT • ADD • VS
AAI	MAX2654EXT	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 1575 МГц; I_{CC} < 9.2 мА	SOT363, SC88	GND • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AAIA	MAX3190EUT	MAX	trnsmit	RS-232; V_{CC} = ±7.5...±12 В; f_{DR} = 460 Кбит/с; I_{CC} < 250 мкА	SOT23-6	SHDN • GND • TIN • TOUT • VEE • VCC
AAIE	MAX4561EUT	MAX	asw	SPDT; R_{ON} < 75 Ом; V_{DD} = 1.8...12 В	SOT23-6	IN • V+ • GND • NC • COM • NO
AAIJ	MAX9030AUT	MAX	cmp	R-R; V_{OSI} < ±5 мВ; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{DD} < 55 мкА	SOT23-6	IN+ • VSS • IN- • OUT • SHDN • VDD
AAIK	MAX6329SHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIL	MAX6329SLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIM	MAX6329SPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIN	MAX6329THUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIO	MAX6329TLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIP	MAX6329TPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIQ	MAX6329VHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIR	MAX6329VLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIS	MAX6329VPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIT	MAX6329WHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIU	MAX6329WLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIV	MAX6329WPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIW	MAX6329YHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIX	MAX6329YLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIY	MAX6329YPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAIZ	MAX6329ZHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAJ	MAX2655EXT	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 1575 МГц; I_{CC} < 9.2 мА	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AAJA	MAX6329ZLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJB	MAX6329ZPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJC	MAX6349SHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJD	MAX6349SLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJE	MAX6349SPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJF	MAX6349THUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJG	MAX6349TLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJH	MAX6349TPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJI	MAX6349VHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJJ	MAX6349VLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJK	MAX6349VPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAJL	MAX6349WHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJM	MAX6349WLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJN	MAX6349WPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJO	MAX6349YHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJP	MAX6349YLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJQ	MAX6349YPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJR	MAX6349ZHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJS	MAX6349ZLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJT	MAX6349ZPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • $\overline{RES}$ • SET • OUT
AAJU	MAX6339AUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = 2.5 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAJV	MAX6339BUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = 2.5 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAJW	MAX6339CUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = 1.8 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAJX	MAX6339DUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = 1.8 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAJY	MAX6339EUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3 В; V_{IN3} = 2.5 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAJZ	MAX6339FUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3 В; V_{IN3} = 2.5 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAK	MAX2656EXT	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 1960 МГц; I_{CC} < 9.2 мА	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AAKA	MAX6339GUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3 В; V_{IN3} = 1.8 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKB	MAX6339HUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3 В; V_{IN3} = 1.8 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKC	MAX6339IUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = 2.5 В; V_{IN4} = 1.8 В; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKD	MAX6339JUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = 2.5 В; V_{IN4} = 1.8 В; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKE	MAX6339KUT	MAX	mrc	V_{IN1} = рег.; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = 2.5 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKF	MAX6339LUT	MAX	mrc	V_{IN1} = рег.; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = 2.5 В; V_{IN4} = рег.; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKG	MAX6339MUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3 В; V_{IN3} = рег.; V_{IN4} = -5 В; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKH	MAX6339NUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3 В; V_{IN3} = рег.; V_{IN4} = -5 В; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKI	MAX6339OUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = рег.; V_{IN4} = -5 В; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKJ	MAX6339PUT	MAX	mrc	V_{IN1} = 5 В; V_{IN2} = 3.3 В; V_{IN3} = рег.; V_{IN4} = -5 В; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 115 мкА	SOT23-6	IN1 • IN2 • IN3 • IN4 • GND • $\overline{RES}$
AAKK	MAX6505UTN035	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -35 °C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKL	MAX6505UTN030	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -30 °C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKM	MAX6505UTN025	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -25 °C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKN	MAX6505UTN020	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -20 °C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKO	MAX6505UTN015	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -15 °C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKP	MAX6505UTN010	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -10 °C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKQ	MAX6505UTN005	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -5 °C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM

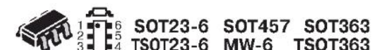




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAKR	MAX6505UTP000	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=0°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKS	MAX6505UTP005	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+5°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKT	MAX6505UTP010	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+10°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKU	MAX6505UTP015	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+15°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKV	MAX6505UTP020	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+20°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKW	MAX6505UTP025	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+25°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKX	MAX6505UTP030	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+30°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKY	MAX6505UTP035	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+35°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAKZ	MAX6505UTP040	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+40°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAL	MAX1852EXT	MAX	vcpcon	V_{IN}=2.5...5.5В; f_P=50кГц; I_{OUT}=30мА	SOT363, SC88	OUT • GND • SHDN • IN • C1- • C1+
AALA	MAX6505UTP045	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+45°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALB	MAX6505UTP050	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+50°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALC	MAX6505UTP055	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+55°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALD	MAX6505UTP060	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+60°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALE	MAX6505UTP065	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+65°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALF	MAX6505UTP070	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+70°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALG	MAX6505UTP075	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+75°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALH	MAX6505UTP080	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+80°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALI	MAX6505UTP085	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+85°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALJ	MAX6505UTP090	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+90°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALK	MAX6505UTP095	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+95°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALL	MAX6505UTP100	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+100°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALM	MAX6505UTP105	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+105°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALN	MAX6505UTP110	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+110°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALO	MAX6505UTP115	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+115°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALP	MAX6505UTP120	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+120°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALQ	MAX6505UTP125	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=+125°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALR	MAX6506UTN035	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=-35°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALS	MAX6506UTN030	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5...5.5В; T_{TH}=-30°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM



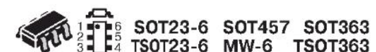
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AALT	MAX6506UTN025	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -25°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALU	MAX6506UTN020	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -20°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALV	MAX6506UTN015	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -15°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALW	MAX6506UTN010	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -10°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALX	MAX6506UTN005	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = -5°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALY	MAX6506UTP000	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = 0°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AALZ	MAX6506UTP005	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +5°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAM	MAX1853EXT	MAX	vcpcon	V_{IN} = 2.5...5.5 В; f_P = 200 кГц; I_{OUT} = 30 мА	SOT363, SC88	OUT • GND • SHDN • IN • C1- • C1+
AAMA	MAX6506UTP010	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +10°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMB	MAX6506UTP015	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +15°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMC	MAX6506UTP020	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +20°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMD	MAX6506UTP025	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +25°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAME	MAX6506UTP030	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +30°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMF	MAX6506UTP035	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +35°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMG	MAX6506UTP040	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +40°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMH	MAX6506UTP045	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +45°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMI	MAX6506UTP050	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +50°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMJ	MAX6506UTP055	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +55°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMK	MAX6506UTP060	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +60°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAML	MAX6506UTP065	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +65°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMM	MAX6506UTP070	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +70°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMN	MAX6506UTP075	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +75°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMO	MAX6506UTP080	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +80°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMP	MAX6506UTP085	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +85°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMQ	MAX6506UTP090	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +90°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMR	MAX6506UTP095	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +95°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMS	MAX6506UTP100	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +100°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMT	MAX6506UTP105	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +105°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM
AAMU	MAX6506UTP110	MAX	tempsw	V_{CC} = 2.5 ...5.5 В; T_{TH} = +110°C; I_{CC} < 80 мкА	SOT23-6	WARN • GND • S1 • VCC • S0 • ALARM

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAMV	MAX6506UTP115	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5…5.5В; T_{TH}=+115°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMW	MAX6506UTP120	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5…5.5В; T_{TH}=+120°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMX	MAX6506UTP125	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5…5.5В; T_{TH}=+125°C; I_{CC}<80мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMY	MAX6507UT8255	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5…5.5В; T_{THL}=-80°C; T_{THU}=+85°C; I_{CC}<60мкА	SOT23-6	OK•GND•S0•VCC•n.c.•OVER
AAMZ	MAX6507UT0A32	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5…5.5В; T_{THL}=+10°C; T_{THU}=+50°C; I_{CC}<60мкА	SOT23-6	OK•GND•S0•VCC•n.c.•OVER
AAN	MAX4481AXT	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.5…5.5В; I_{CC}<100мкА; V_{OSI}<5.5мВ	SOT363, SC88	IN+•VSS•IN-•OUT•SHDN•VDD
AANA	MAX6508UT8255	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5…5.5В; T_{THL}=-80°C; T_{THU}=+85°C; I_{CC}<60мкА	SOT23-6	OK•GND•S0•VCC•n.c.•OVER
AANB	MAX6508UT0A32	MAX	tempsw	V_{CC}=2.5…5.5В; T_{THL}=+10°C; T_{THU}=+50°C; I_{CC}<60мкА	SOT23-6	OK•GND•S0•VCC•n.c.•OVER
AANC	MAX1736EUT41	MAX	chg	1xLi+; V_{IN}=4.7…22В; V_{OUT}=4.1В; I_{CH}<0.75мА	SOT23-6	IN•GATE•GND•EN•CT•BATT
AAND	MAX4675EUT	MAX	asw	SPST; R_{ON}<4Ом; V_{DD}=2.7…5.5/±2.7…±5.5В	SOT23-6	V+•COM•V-•GND•NO•IN
AANE	MAX4676EUT	MAX	asw	SPST; R_{ON}<4Ом; V_{DD}=2.7…5.5/±2.7…±5.5В	SOT23-6	V+•COM•V-•GND•NC•IN
AANF	MAX1818EUT25	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5…5.5В; V_{OUT}=2.5/1.25…5В; I_{OUT}=500мА	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANG	MAX1818EUT33	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5…5.5В; V_{OUT}=3.3/1.25…5В; I_{OUT}=500мА	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANH	MAX1818EUT50	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5…5.5В; V_{OUT}=5.0/1.25…5В; I_{OUT}=500мА	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANI	MAX6351LRUT	MAX	mrc	V_{TR1}=4.63В; V_{TR2}=2.63В; V_{DD}=1.2…5.5В; I_{CC}<50мкА	SOT23-6	RST1•GND•MR•VCC2•RST2•VCC1
AANL	MAX1755BAUT	MAX	ltcmp	SMBus; V_{CC}=2.375…5.5В; T_{THAC}=±3°C; I_{CC}<200мкА	SOT23-6	ADD•SMBDATA•SMBCLK•OVERT•VCC•GND
AANM	MAX1755AAUT	MAX	ltcmp	SMBus; V_{CC}=2.375…5.5В; T_{THAC}=±3°C; I_{CC}<200мкА	SOT23-6	ADD•SMBDATA•SMBCLK•OVERT•VCC•GND
AANN	MAX1756BAUT	MAX	ltcmp	SMBus; V_{CC}=2.375…5.5В; T_{THAC}=±3°C; I_{CC}<200мкА	SOT23-6	ADD•SMBDATA•SMBCLK•ALERT•VCC•GND
AANO	MAX1756AAUT	MAX	ltcmp	SMBus; V_{CC}=2.375…5.5В; T_{THAC}=±3°C; I_{CC}<200мкА	SOT23-6	ADD•SMBDATA•SMBCLK•ALERT•VCC•GND
AANP	MAX6626PMUT	MAX	dts	12-разр.; T_{AMB}=-55…125°C; I²C; V_{DD}=3…5.5В	SOT23-6	SDA•GND•SCL•OT•ADD•VS
AANQ	MAX6626RMUT	MAX	dts	12-разр.; T_{AMB}=-55…125°C; I²C; V_{DD}=3…5.5В	SOT23-6	SDA•GND•SCL•OT•ADD•VS
AANT	MAX6355MRUT	MAX	mrc	V_{TR1}=4.38В; V_{TR2}=2.63В; V_{DD}=1.2…5.5В; I_{CC}<50мкА	SOT23-6	RST•GND•MR•VCC2•RSTIN•VCC1
AANU	MAX1818EUT18	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5…5.5В; V_{OUT}=1.8/1.25…5В; I_{OUT}=500мА	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANV	MAX1818EUT20	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5…5.5В; V_{OUT}=2.0/1.25…5В; I_{OUT}=500мА	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANW	MAX1836EUT50	MAX	vcon	V_{IN}=4.5…24В; V_{OUT}=5В; I_{OUT}<125мА	SOT23-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AANX	MAX1837EUT50	MAX	vcon	V_{IN}=4.5…24В; V_{OUT}=5В; I_{OUT}<250мА	SOT23-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AANY	MAX1836EUT33	MAX	vcon	V_{IN}=4.5…24В; V_{OUT}=3.3В; I_{OUT}<125мА	SOT23-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AANZ	MAX1837EUT33	MAX	vcon	V_{IN}=4.5…24В; V_{OUT}=3.3В; I_{OUT}<250мА	SOT23-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AAO	MAX3371EXT	MAX	levtrans	RS-232; V_{CC}=2.5…5.5В; f_{DR}=2Мбит/с; I_{CC}<100мкА	SOT363, SC88	VL•GND•I/O VL•I/O VCC•SHDN•VCC
AAOA	MAX6511UT045	MAX	tempsw	V_{CC}=3.0…5.5В; T_{TH}=+45°C; I_{CC}<600мкА	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOB	MAX6511UT055	MAX	tempsw	V_{CC}=3.0…5.5В; T_{TH}=+55°C; I_{CC}<600мкА	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOC	MAX6511UT065	MAX	tempsw	V_{CC}=3.0…5.5В; T_{TH}=+65°C; I_{CC}<600мкА	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOD	MAX6511UT075	MAX	tempsw	V_{CC}=3.0…5.5В; T_{TH}=+75°C; I_{CC}<600мкА	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP



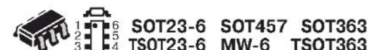
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAOE	MAX6511UT085	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +85 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOF	MAX6511UT095	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +95 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOG	MAX6511UT105	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +105 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOH	MAX6511UT115	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +115 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOI	MAX6511UT125	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +125 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOJ	MAX6512UT045	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +45 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOK	MAX6512UT055	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +55 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOL	MAX6512UT065	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +65 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOM	MAX6512UT075	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +75 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAON	MAX6512UT085	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +85 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOO	MAX6512UT095	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +95 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOP	MAX6512UT105	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +105 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOQ	MAX6512UT115	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +115 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOR	MAX6512UT125	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +125 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAOS	MAX4481AUT	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 100 мкА; V_{OSI} < 5.5 мВ	SOT23-6	IN+ • VSS • IN- • OUT • SHDN • VDD
AAOT	MAX1832EUT	MAX	vcon	V_{IN} = 1.5...5.5 В; V_{OUT} = 2...5.5 В; I_{OUT} < 150 мА	SOT23-6	SHDN • BATT • GND • LX • OUT • FB
AAOU	MAX1833EUT	MAX	vcon	V_{IN} = 1.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} < 150 мА	SOT23-6	SHDN • BATT • GND • LX • OUT • RST
AAOV	MAX1834EUT	MAX	vcon	V_{IN} = 1.5...5.5 В; V_{OUT} = 2...5.5 В; I_{OUT} < 150 мА	SOT23-6	SHDN • BATT • GND • LX • OUT • FB
AAOW	MAX1835EUT	MAX	vcon	V_{IN} = 1.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} < 150 мА	SOT23-6	SHDN • BATT • GND • LX • OUT • RST
AAOX	MAX1522EUT	MAX	bcontr	V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА; T_{AMB} = -40...85 °C	SOT23-6	GND • FB • SET • SHDN • EXT • VCC
AAOY	MAX1523EUT	MAX	bcontr	V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА; T_{AMB} = -40...85 °C	SOT23-6	GND • FB • SET • SHDN • EXT • VCC
AAOZ	MAX1524EUT	MAX	bcontr	V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА; T_{AMB} = -40...85 °C	SOT23-6	GND • FB • SET • SHDN • EXT • VCC
AAP	MAX5461EXT	MAX	Dpot	32 позиции; 100 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT363, SC88	VDD • GND • U/D • CS • L • H
AAPD	MAX6513UT045	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +45 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPE	MAX6513UT055	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +55 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPF	MAX6513UT065	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +65 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPG	MAX6513UT075	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +75 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPH	MAX6513UT085	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +85 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPI	MAX6513UT095	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +95 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPJ	MAX6513UT105	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +105 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPK	MAX6513UT115	MAX	tempsw	V_{CC} = 3.0 ...5.5 В; T_{TH} = +115 °C; I_{CC} < 600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAPL	MAX6513UT125	MAX	tempsw	V_{CC}=3.0...5.5 В; T_{TH}=+125°C; I_{CC}<600 мкА	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPM	MAX6629MUT	MAX	dts	12-разр.+знак; T_{AMB}=-55...125°C; SPI; V_{DD}=3...5.5В; I_{CC}=200 мкА	SOT23-6	п. с. • GND • VCC • SCK • CS • SO
AAPN	MAX6630MUT	MAX	dts	12-разр.+знак; T_{AMB}=-55...125°C; SPI; V_{DD}=3...5.5В; I_{CC}=200 мкА	SOT23-6	GND • п. с. • VCC • SCK • CS • SO
AAPO	MAX6631MUT	MAX	dts	12-разр.+знак; T_{AMB}=-55...125°C; SPI; V_{DD}=3...5.5В; I_{CC}=30 мкА	SOT23-6	п. с. • GND • VCC • SCK • CS • SO
AAPP	MAX6632MUT	MAX	dts	12-разр.+знак; T_{AMB}=-55...125°C; SPI; V_{DD}=3...5.5В; I_{CC}=30 мкА	SOT23-6	GND • п. с. • VCC • SCK • CS • SO
AAPQ	MAX6826SUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAPR	MAX6827RUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAPS	MAX6828YUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.19 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAPT	MAX6829SVUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR1}=2.93 В; V_{TR2}=1.575 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AAPU	MAX6830ZGUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR1}=2.32 В; V_{TR2}=1.11 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AAPV	MAX6831VDUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR1}=1.58 В; V_{TR2}=0.788 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AAQ	MAX5462EXT	MAX	Dpot	32 позиции; 100 кОм; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT363, SC88	VDD • GND • U/D • CS • W • H
AAQA	MAX6351UVUT	MAX	mrc	V_{TR1}=2.78 В; V_{TR2}=1.58 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RST1 • GND • MR • VCC2 • RST2 • VCC1
AAQB	MAX6358RWUT	MAX	mrc	V_{TR1}=2.63 В; V_{TR2}=1.67 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AAQC	MAX6359TWUT	MAX	mrc	V_{TR1}=2.93 В; V_{TR2}=2.19 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AAQD	MAX6360RVUT	MAX	mrc	V_{TR1}=2.63 В; V_{TR2}=1.58 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AAQE	MAX6355TVUT	MAX	mrc	V_{TR1}=3.08 В; V_{TR2}=1.58 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AAQF	MAX6356SWUT	MAX	mrc	V_{TR1}=2.93 В; V_{TR2}=1.67 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AAQG	MAX6357UVUT	MAX	mrc	V_{TR1}=2.78 В; V_{TR2}=1.58 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AAQH	MAX6355TYUT	MAX	mrc	V_{TR1}=3.08 В; V_{TR2}=2.19 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AAQJ	MAX5900AAEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=200 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQK	MAX5900ABEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=300 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQL	MAX5900ACEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=400 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQM	MAX5900LAEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=200 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQN	MAX5900LBEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=300 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQO	MAX5900LCEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=400 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQP	MAX5901AAEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=200 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQQ	MAX5901ABEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=300 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQR	MAX5901ACEUT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9 В; I_{CC}<1.3 мА; V_{CB}=400 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAQS	MAX5901LAEUT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9 В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 200 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • $\overline{GATE}$ • GND • PGOOD • ON/$\overline{OFF}$
AAQT	MAX5901LBEUT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9 В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 300 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/$\overline{OFF}$
AAQU	MAX5901LCEUT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9 В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 400 мВ	SOT23-6	VEE • DRAIN • $\overline{GATE}$ • GND • PGOOD • ON/$\overline{OFF}$
AAQV	MAX5900NNEUT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9 В; I_{CC} < 1.3 мА	SOT23-6	VEE • DRAIN • $\overline{GATE}$ • GND • PGOOD • ON/$\overline{OFF}$
AAQW	MAX5901NNEUT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9 В; I_{CC} < 1.3 мА	SOT23-6	VEE • DRAIN • $\overline{GATE}$ • GND • PGOOD • ON/$\overline{OFF}$
AAQX	MAX6826TUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAQY	MAX6827LUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAQZ	MAX6829SHUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 1.313 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AAR	MAX5464EXT	MAX	Dpot	32 позиции; 50 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT363, SC88	VDD • GND • U/D • CS • L • H
AARA	MAX6830YGUT	MAX	mrc + wdt	V_{TR1} = 2.19 В; V_{TR2} = 1.11 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 30 мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AARB	MAX6323CUT46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 57 мкА	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDPO • RES
AARC	MAX6324HUT31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.00 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 57 мкА	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDPO • RES
AARD	MAX6323FUT23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.25 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 57 мкА	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDPO • RES
AARE	MAX6324AUT46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 57 мкА	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDPO • RES
AARF	MAX6819UT	MAX	vseq	V_{TR} = 0.62 В; V_{CC} = 0.9...5.5 В; I_{CC} < 120 мкА	SOT23-6	VCC1 • GND • SETV • EN • GATE • VCC2
AARG	MAX6820UT	MAX	vseq	V_{TR} = 0.62 В; V_{CC} = 0.9...5.5 В; I_{CC} < 120 мкА	SOT23-6	VCC1 • GND • SETV • SETD • GATE • VCC2
AARH	MAX5467EUT	MAX	Dpot	32 позиции; 10 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VDD • GND • U/D • CS • L • H
AARI	MAX5468EUT	MAX	Dpot	32 позиции; 10 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VDD • GND • U/D • CS • W • H
AARJ	MAX6323AUT29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 57 мкА	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDPO • RES
AARK	MAX6351RVUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.63 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST1 • GND • MR • VCC2 • RST2 • VCC1
AARL	MAX6356RWUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.63 В; V_{TR2} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AARM	MAX6357UWUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.78 В; V_{TR2} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AARN	MAX6358TWUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARO	MAX6358SVUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARP	MAX6359RVUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.63 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARQ	MAX6360SWUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.93 В; V_{TR2} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARR	MAX6355RWUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.63 В; V_{TR2} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AARS	MAX6356UVUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.78 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AART	MAX6359UVUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 2.78 В; V_{TR2} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARU	MAX9109EUT	MAX	cmp	V_{DSI} < 4 мВ; V_{CC} = 4.5...5.5 В; I_{CC} < 0.7 мА	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN- • LE • VCC
AARV	MAX4647EUT	MAX	asw	SPST; R_{DN} < 30 Ом; V_{DD} = 9...36/±4.5...±20 В	SOT23-6	NC • V- • IN • GND • V+ • COM




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AARW	MAX4648EUT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 30 Ом; V_{DD} = 9...36/±4.5...±20 В	SOT23-6	NO • V- • IN • GND • V+ • COM
AARX	MAX4289EUT	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 1.0...5.5 В; I_{CC} < 40 мкА; V_{OSI} < 6 мВ	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN- • n. c. • VCC
AAS	MAX5465EXT	MAX	Dpot	32 позиции; 50 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT363, SC88	VDD • GND • U/D • CS • W • H
AASA	MAX5902AAEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 300 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASB	MAX5902ABEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 400 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASC	MAX5902ACEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 500 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASD	MAX5902LAEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 300 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASE	MAX5902LBEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 400 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASF	MAX5902LCEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 500 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASG	MAX5903AAEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 300 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASH	MAX5903ABEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 400 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASI	MAX5903ACEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 500 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASJ	MAX5903LAEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 300 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASK	MAX5903LBEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 400 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASL	MAX5903LCEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 500 мВ	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASM	MAX5902NNEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASN	MAX5903NNEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72 В; I_{CC} < 2 мА	SOT23-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AASO	MAX1818EUT15	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.5/1.25...5 В; I_{OUT} = 500 мА	SOT23-6	IN • POK • SHDN • GND • SET • OUT
AASP	MAX6355MSUT	MAX	mrc	V_{TR1} = 4.38 В; V_{TR2} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AASQ	MAX5021EUT	MAX	PWM	V_{IN} = 11...28 В; DT < 50%; I_{CC} < 2.43 мкА	SOT23-6	CS • GND • NDRV • VCC • VIN • OPTO
AASR	MAX5022EUT	MAX	PWM	V_{IN} = 11...28 В; DT < 70%; I_{CC} < 2.43 мкА	SOT23-6	CS • GND • NDRV • VCC • VIN • OPTO
AAT	MAX1474AXT	MAX	flecap	C = 6.4...13.3 пФ; цифровой интерфейс; V_{DD} = 4.5...5.5 В	SOT363, SC88	CP • VDD • EN • DAT • VSS • CM
AAU	MAX9109EXT	MAX	cmp	V_{OSI} < 4 мВ; V_{CC} = 4.5...5.5 В; I_{CC} < 0.7 мА	SOT363, SC88	OUT • GND • IN+ • IN- • LE • VCC
AAV	MAX4380EXT	MAX	OA	R-R; V_{DD} = 4.5...11/±2.25...±5.5 В; f_{BD} = 210 МГц; V_{OSI} < 20 мВ	SOT363, SC88	OUT • VEE • IN+ • IN- • DISABLE • VCC
AAXH	MAX6033CAUT25	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.1 %; V_{OUT} = 2.500 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
AAXI	MAX6033CAUT30	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.1 %; V_{OUT} = 3.000 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
AAXJ	MAX6033CAUT41	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.1 %; V_{OUT} = 4.096 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
AAXK	MAX6033CAUT50	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.1 %; V_{OUT} = 5.000 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
AAXL	MAX6033BAUT25	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.2 %; V_{OUT} = 2.500 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
AAXM	MAX6033BAUT30	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.2 %; V_{OUT} = 3.000 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
AAXN	MAX6033BAUT41	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.2 %; V_{OUT} = 4.096 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
AAXO	MAX6033BAUT50	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.2 %; V_{OUT} = 5.000 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
ABDF	MAX6033AAUT25	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.04 %; V_{OUT} = 2.500 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
ABDG	MAX6033AAUT30	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.04 %; V_{OUT} = 3.000 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
ABDH	MAX6033AAUT41	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.04 %; V_{OUT} = 4.096 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
ABDI	MAX6033AAUT50	MAX	vref	V_{IN} = 2.7...12.6 В; AC < ±0.04 %; V_{OUT} = 5.000 В	SOT23-6	i. c. • GND • i. c. • IN • OUTF • OUTS
ABEC	MAX5048AAUT	MAX	drv	КМОП-вход; V_{CC} = 4...12.6 В; I_{OUT} < 7.6/1.3 А	SOT23-6	V+ • P_OUT • N_OUT • GND • IN- • IN+
ABED	MAX5048BAUT	MAX	drv	ТТЛ-вход; V_{CC} = 4...12.6 В; I_{OUT} < 7.6/1.3 А	SOT23-6	V+ • P_OUT • N_OUT • GND • IN- • IN+
ABQS	MAX3190EEUT	MAX	trnsmit	RS-232; V_{CC} = ±7.5...±12 В; f_{DR} = 460 Кбит/с; I_{CC} < 250 мкА	SOT23-6	SHDN • GND • TIN • TOUT • VEE • VCC
AD0	ADS1100A0IDBV	TI	ADC	16-разр.; I²C; адрес 1001000; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN–
AD1	ADS1100A1IDBV	TI	ADC	16-разр.; I²C; адрес 1001001; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN–
AD2	ADS1100A2IDBV	TI	ADC	16-разр.; I²C; адрес 1001010; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN–
AD3	ADS1100A3IDBV	TI	ADC	16-разр.; I²C; адрес 1001011; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN–
AD4	ADS1100A4IDBV	TI	ADC	16-разр.; I²C; адрес 1001100; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN–
AD5	ADS1100A5IDBV	TI	ADC	16-разр.; I²C; адрес 1001101; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN–
AD6	ADS1100A6IDBV	TI	ADC	16-разр.; I²C; адрес 1001110; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN–
AD7	ADS1100A7IDBV	TI	ADC	16-разр.; I²C; адрес 1001111; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN–
AK	HSMS280K	HP	shd x2	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT363, SC88	A1 • n. c. • A2 • K2 • n. c. • K1
AL	HSMS280L	HP	shd x3	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT363, SC88	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
AM	HSMS280M	HP	shd x4	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT363, SC88	A1 • K1, K2, K3, K4 • A2 • A3 • K1, K2, K3, K4 • A4
AN	HSMS280N	HP	shd x4	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT363, SC88	K1 • A1, A2, A3, A4 • K2 • K3 • A1, A2, A3, A4 • K4
AP	HSMS280P	HP	shd x4	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT363, SC88	A1 • K1, A2 • K2 • K3 • K4,A3 • A4
B1	IMB1A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B1	UMB1N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B10	EMB10	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B10	IMB10A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B10	UMB10N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B11	EMB11	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B11	IMB11A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B11	UMB11N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B16	IMB16	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 30; R2/R1 = 2.1	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B17	IMB17A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 33; R2/R1 = 10	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
B2	EMB2	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B2	IMB2A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1

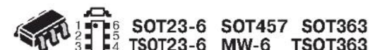




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
B2	UMB2N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B3	EMB3	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 4.7 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B3	IMB3A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; R_1 4.7 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B3	UMB3N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B4	EMB4	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 10 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B4	IMB4A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; R_1 10 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B4	UMB4N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B5	IMB5A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 56; R2/R1 = 1	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • C1
B5	UMB5N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; R2/R1 = 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
B6	EMB6	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 1	SOT563, EMT6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
B6	IMB6A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 1	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
B6	UMB6N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 1	SOT363, SC88	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
B7	IMB7A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 4.7 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
B8	IMB8A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 10 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
B8	UMB8N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 10 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
B9	EMB9	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B9	IMB9A	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B9	UMB9N	ROHM	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
BAC	ADP3820ART-4.1	AD	chg	Li-Ion; V_{IN} = 4.5...15 В; V_{OUT} = 4.1 В	SOT23-6	SD • GND • VOUT • GATE • VIN • IS
BBC	ADP3820ART-4.2	AD	chg	Li-Ion; V_{IN} = 4.5...15 В; V_{OUT} = 4.2 В	SOT23-6	SD • GND • VOUT • GATE • VIN • IS
BK	HSMS281K	HP	shd x2	V_{BR} > 20 В; V_F(I_F = 35 мА) < 1.0 В; I_R(V_R = 15 В) < 200 нА; C_D < 1.2 пФ	SOT363, SC88	A1 • n. c. • A2 • K2 • n. c. • K1
BL	HSMS281L	HP	shd x3	V_{BR} > 20 В; V_F(I_F = 35 мА) < 1.0 В; I_R(V_R = 15 В) < 200 нА; C_D < 1.2 пФ	SOT363, SC88	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
BL	MBD54DW	ON	shd x2	V_R < 30 В; V_F(I_F = 10 мА) < 0.4 В; C_D < 10 пФ	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
C06	DDX123JK	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 2.2 к/47 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C06	DDX123JU	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 2.2 к/47 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C07	DDX143TK	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 4.7 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C07	DDX143TU	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 4.7 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C12	DDX114TK	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 10 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C12	DDX114TU	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 10 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C13	DDX114EK	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/10 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C13	DDX114EU	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/10 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C14	DDX114YK	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/47 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
C14	DDX114YU	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10к/47к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C17	DDX124EK	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 22к/22к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C17	DDX124EU	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 22к/22к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C20	DDX144EK	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 47к/47к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C20	DDX144EU	DIODS	Dnpn/pnp	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 47к/47к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
C2T	AD7466BRTZ	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
C410	ZXSC410	ZETEX	vcon	V_{CC} = 1.65...8.0В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-6	VCC • GND • STDN • SENSE • VFB • DRIVE
C420	ZXSC420	ZETEX	vcon	V_{CC} = 1.65...8.0В; I_{OUT} = 300 мА	SOT23-6	VCC • GND • EOR • SENSE • VFB • DRIVE
C55	OPA355NA	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 200 МГц; I_S = 14 мА; V_{DSI} < ±15 мВ	SOT23-6	OUT • V– • +IN • –IN • ENBL • V+
CAA	AD7814ART	AD	dts	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5В	SOT23-6	GND • DIN • VDD • SCLK • CS • DOUT
CEW	AD7476AYKS	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CEY	AD7476ABKS	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CEZ	AD7476AAKS	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CFZ	AD7477AAKS	AD	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CHA	AD7414ART	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5В	SOT23-6	AS • GND • VDD • SCL • ALERT • SDA
CHB	AD7414ART	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5В	SOT23-6	AS • GND • VDD • SCL • ALERT • SDA
CHC	AD7414ART	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5В	SOT23-6	AS • GND • VDD • SCL • ALERT • SDA
CHD	AD7414ART	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5В	SOT23-6	AS • GND • VDD • SCL • ALERT • SDA
CJZ	AD7478AAKS	AD	ADC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CK	HSMS282K	HP	shd x2	V_{BR} > 15 В; V_F(I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R(V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT363, SC88	A1 • n. c. • A2 • K2 • n. c. • K1
CL	HSMS282L	HP	shd x3	V_{BR} > 15 В; V_F(I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R(V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT363, SC88	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
CLB	AD7466BRT	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CMB	AD7467BRT	AD	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CMU	AD7467BRTZ	AD	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CNA	AD7466ART	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CNB	AD7468BRT	AD	ADC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6 В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CNU	AD7468BRTZ	AD	ADC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6 В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
cP	µPA873TD	NEC	npn x2	V_{CB0} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 100...145; f_T > 3 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
cP	µPA873TS	NEC	npn x2	V_{CB0} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 100...145; f_T > 3 ГГц	SOT666	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
CP	HSMS282P	HP	shd x4	V_{BR} > 15 В; V_F(I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R(V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT363, SC88	A1 • K1, A2 • K2 • K3 • K4, A3 • A4




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
CQA	AD7680ARJ	AD	ADC	16-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CQB	AD7680BRJ	AD	ADC	16-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CUA	AD7920AKS	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CUB	AD7920BKS	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CVA	AD7910AKS	AD	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
D1	IMD1A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; R_1 22 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D10	IMD10A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT1} = 500 мА; I_{OUT2} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; 10 кОм/100 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D12	UMD12N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D14	IMD14	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 82; R2/R1 = 45.5	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D16	IMD16A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 82; 2.2 кОм/2.2 кОм; R_1 100 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D2	EMD2	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D2	IMD2A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D2	UMD2N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 500 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D2B	AD5300BRT	AD	DAC	8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VOUT • GND • VDD • DIN • SCLK • SYNC
D3	EMD3	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D3	IMD3A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D3	UMD3N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D3B	AD5310BRT	AD	DAC	10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VOUT • GND • VDD • DIN • SCLK • SYNC
D4B	AD5320BRT	AD	DAC	12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VOUT • GND • VDD • DIN • SCLK • SYNC
D6	EMD6	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 4.7 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D6	IMD6A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; R_1 4.7 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D6	UMD6N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R_1 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D619	ZXTD09N50DE6	ZETEX	npn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 1 А; P_D = 900 мВт; h_{21} > 20; f_T = 215 МГц	SOT23-6	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
D8	IMD8A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; R_1 47 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D8B	AD5301BRT	AD	DAC	8-разр.; I^2C; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	GND • SDA • SCL • VOUT • A0 • VDD
D9	EMD9	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D9	IMD9A	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D9	UMD9N	ROHM	Dpnp/npn	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D9B	AD5311BRT	AD	DAC	10-разр.; I^2C; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	GND • SDA • SCL • VOUT • A0 • VDD
D9N	AD5320BRTZ	AD	DAC	12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VOUT • GND • VDD • DIN • SCLK • SYNC

fS6 SON-6 SOT563 **SOT363 SOT457 SOT23-6**
M16 USM-6 SOT666 **TSOT363 MW-6 TSOT23-6** 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
DAB	AD5321BRT	AD	DAC	12-разр.; I²C; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-6	GND•SDA•SCL•VOUT•A0•VDD
F2	RN1903FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=22 кОм/22 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
F3	RN1904FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=47 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
F4	RN1905FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=2.2 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
F5	RN1906FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=4.7 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
F6	RN1907FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=10 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
F7	RN1908FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=22 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
F8	RN1909FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=47 кОм/22 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
F9	RN1910FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1=4.7 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
FF	RN1911FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1=10 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
FF	RN2971FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1=10 кОм	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
GAAI	REG71050DDC	TI	scvcon	V_{IN}=1.8...5.5 В; I_{OUT}>30 мА; V_{OUT}=5.0 В	TSOT23-6	VOUT•GND•ENBL•CPUMP•VIN•CPUMP+
H0	RN2901FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=4.7 кОм/4.7 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H0E	AD8063ARTZ	AD	OA	f_{BD}=320 МГц; P_D=75 мВт; V_{DD}=2.7...8 В	SOT23-6	VOUT•–VS•+IN•–IN•DIS•+VS
H1	EMH1	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H1	IMH1A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>56; 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	C1•B1•B2•C2•E2•E1
H1	RN2902FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=10 кОм/10 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H1	UMH1N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>56; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H10	EMH10	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H10	IMH10A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1•B2•E2•C2•B1•E1
H10	UMH10N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H11	EMH11	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H11	IMH11A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT23-6	C1•B1•B2•C2•E2•E1
H11	UMH11N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>30; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H14	IMH14A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>100; R1 47 кОм	SOT23-6	C1•B1•B2•C2•E2•E1
H14	UMH14N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>100; R1 47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
H14	UMH14N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>100; R_1=47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
H15	IMH15A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>100; R1 47 кОм	SOT23-6	C1•B2•E2•C2•B1•E1
H2	EMH2	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=150 мВт; h_{21}>68; 47 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H2	IMH2A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO}=50 В; I_C=30 мА; P_D=300 мВт; h_{21}>68; 47 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1•B1•B2•C2•E2•E1
H2	RN2903FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=50 мВт; R_1/R_2=22 кОм/22 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
H2	UMH2N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	C1 • B1 • B2 • C2 • E2 • E1
H3	EMH3	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R1 4.7 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H3	IMH3A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; R1 4.7 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • B2 • C2 • E2 • E1
H3	RN2904FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H3	UMH3N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R1 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H4	IMH4A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; R1 10 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
H4	RN2905FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H4	UMH4N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R1 10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H5	IMH5A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
H5	MBD770DW	ON	shd x2	V_R < 70 В; V_F (I_F = 10 мА) < 1 В; C_D < 1 пФ	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
H5	RN2906FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H5	UMH5N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
H6	IMH6A	ROHM	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 1	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
H6	RN2907FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H6	UMH6N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 30 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; R2/R1 = 1	SOT363, SC88	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
H6B	AD8029AKS	AD	OA	f_{BD} = 120 МГц; P_D = 18 мВт; V_{DD} = 2.7...12 В	SOT363, SC88	VOUT • –VS • +IN • –IN • DIS • +VS
H7	RN2908FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H8	IMH8A	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100; R1 10 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • B2 • E2 • E1
H8	RN2909FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H8	UMH8N	ROHM	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100; R1 10 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
H9	EMH9	ROHM	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H9	IMH9A	ROHM	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 68; 10 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • E2 • C2 • B1 • E1
H9	RN2910FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1 = 4.7 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H9	UMH9N	ROHM	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_{OUT} = 70 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 68; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
HF	RN2911FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1 = 10 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
HH	HSMS282M	HP	shd x4	V_{BR} > 15 В; V_F (I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R (V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT363, SC88	A1 • K1, K2, K3, K4 • A2 • A3 • K1, K2, K3, K4 • A4
HHA	AD8063ART	AD	OA	f_{BD} = 320 МГц; P_D = 75 мВт; V_{DD} = 2.7...8 В	SOT23-6	VOUT • –VS • +IN • –IN • DIS • +VS
J0	RN1961FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
J1	RN1962FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
J2	RN1963FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
J3	RN1964FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
J3A	AD8361ART	AD	PD	f_{BD} < 2.5 ГГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	VRMS • COMM • FLTR • PWDN • RFIN • VPOS
J4	RN1965FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
J5	RN1966FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
J6	RN1967FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
J7	RN1968FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
J8	RN1969FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
J9	RN1901FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
J9	RN1970FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1 = 4.7 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
JF	RN1902FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
JF	RN1971FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1 = 10 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
JH	RN1972FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1 = 22 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
JJ	RN1973FS	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1 = 47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
JSs	BAS21U	INF	di x 3	V_R < 200 В; I_F < 250 мА; $V_F(I_F$ = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА	SOT457, SC74	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
K0	RN2961FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K1	RN2962FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K1	UM6K1N	ROHM	nMOS x2	V_{DS} = 30 В; I_D = 100 мА; P_D = 150 мВт; $R_{DS(on)}$ < 13 Ом	SOT363, SC88	S1 • G1 • D2 • S2 • G2 • D1
K2	RN2963FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K3	RN2964FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K4	RN2965FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K5	RN2966FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K6	RN2967FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K7	NCP802SAN5T1	ON	batprot	V_{CC} = 1.5...5 В; V_{TROU} = 4.275 В	SON-6	DO • Vcell • GND • DS • CO • P
K7	RN2968FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K7P	BC847PN	DIODS	pnp/npn	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 200...475; f_T > 100 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
K8	RN2969FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
K9	RN2970FS	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 50 мВт; R_1 = 4.7 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
KC1	MMBZ5221BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 2.28...2.52 В; I_R < 100 мкА	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
KC3	MMBZ5223BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 2.57...2.84 В; I_R < 75 мкА	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
KC5	MMBZ5225BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 2.85...3.15 В; I_R < 50 мкА	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
KD	NCP802SAN6T1	ON	batprot	V_{CC} = 1.5...5 В; V_{TROU} = 4.28 В	SON-6	DO • Vcell • GND • DS • CO • P
KE1	MMBZ5231BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}$ = 20 мА) = 4.85...5.36 В; I_R < 5 мкА	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
KE2	MMBZ5232BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=5.32...5.88$ В; $I_R<5$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KE3	MMBZ5233BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=5.70...6.30$ В; $I_R<5$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KE4	MMBZ5234BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=5.89...6.51$ В; $I_R<5$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KE5	MMBZ5235BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=6.46...7.14$ В; $I_R<3$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KF1	MMBZ5236BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=7.13...7.88$ В; $I_R<3$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KF2	MMBZ5237BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=7.79...8.61$ В; $I_R<3$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KF3	MMBZ5238BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=8.27...9.14$ В; $I_R<3$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KF4	MMBZ5239BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=8.65...9.56$ В; $I_R<3$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KF5	MMBZ5240BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=9.5...10.5$ В; $I_R<3$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KG1	MMBZ5226BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=3.14...3.47$ В; $I_R<25$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KG2	MMBZ5227BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=3.42...3.78$ В; $I_R<15$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KG3	MMBZ5228BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=3.71...4.10$ В; $I_R<10$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KG4	MMBZ5229BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=4.09...4.52$ В; $I_R<5$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KG5	MMBZ5230BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=4.47...4.94$ В; $I_R<5$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
kH	µPA891TD	NEC	npn x2	$V_{CBO}=9$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=230$ мВт; $h_{21}=100...160$; $f_T>3.5$ ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
KH1	MMBZ5241BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=10.45...11.55$ В; $I_R<2$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KH2	MMBZ5242BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20$ мА$)=11.4...12.6$ В; $I_R<1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KH3	MMBZ5243BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=9.5$ мА$)=12.35...13.65$ В; $I_R<0.5$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KH5	MMBZ5245BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=8.5$ мА$)=14.25...15.75$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KJ1	MMBZ5246BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=7.8$ мА$)=15.2...16.8$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KJ3	MMBZ5248BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=7.0$ мА$)=17.1...18.9$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KJ5	MMBZ5250BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=6.2$ мА$)=19.0...21.0$ В; $I_R<01$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KK1	MMBZ5251BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=5.6$ мА$)=20.9...23.1$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KK2	MMBZ5252BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=5.2$ мА$)=22.8...25.2$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KK4	MMBZ5254BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=5.0$ мА$)=25.65...28.35$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KK5	MMBZ5255BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=4.5$ мА$)=26.6...29.4$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
kL	µPA828TD	NEC	npn x2	$V_{CBO}=5$ В; $I_C=30$ мА; $P_D=180$ мВт; $h_{21}=70...140$; $f_T>7$ ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
KM1	MMBZ5256BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=4.2$ мА$)=28.5...31.5$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1
KM2	MMBZ5257BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=3.8$ мА$)=31.35...34.65$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • п. с. • K2 • A2 • п. с. • K1

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
KM3	MMBZ5258BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=3.4$ мА$)=34.2...37.8$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
KM4	MMBZ5259BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=3.2$ мА$)=37.05...41.0$ В; $I_R<0.1$ мкА	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
kN	μPA892TD	NEC	npn x2	$V_{CBO}=15$ В; $I_C=35$ мА; $P_D=210$ мВт; $h_{21}=50...100$; $f_T>18$ ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
KN	NCP802SAN1T1	ON	batprot	$V_{CC}=1.5...5$ В; $V_{TROU}=4.35$ В	SON-6	DO • Vcell • GND • DS • CO • P
KN	NCP802SN1T1	ON	batprot	$V_{CC}=1.5...5$ В; $V_{TROU}=4.35$ В	SOT23-6	DO • P • CO • DS • Vcell • GND
kP	μPA895TD	NEC	npn x2	$V_{CBO}=9$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=210$ мВт; $h_{21}=100...145$; $f_T>3$ ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
kP	μPA895TS	NEC	npn x2	$V_{CBO}=9$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=210$ мВт; $h_{21}=100...145$; $f_T>3$ ГГц	SOT666	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
L1B	ADP3330ART-2.5	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12$ В; $I_{OUT}=200$ мА; $V_{OUT}=2.5$ В	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L2B	ADP3330ART-2.75	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12$ В; $I_{OUT}=200$ мА; $V_{OUT}=2.75$ В	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L3B	ADP3330ART-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12$ В; $I_{OUT}=200$ мА; $V_{OUT}=2.85$ В	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L4B	ADP3330ART-3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12$ В; $I_{OUT}=200$ мА; $V_{OUT}=3$ В	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L5B	ADP3330ART-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12$ В; $I_{OUT}=200$ мА; $V_{OUT}=3.3$ В	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L6B	ADP3330ART-3.6	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12$ В; $I_{OUT}=200$ мА; $V_{OUT}=3.6$ В	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L8B	ADP3330ART-5	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12$ В; $I_{OUT}=200$ мА; $V_{OUT}=5$ В	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L9B	ADP3331ART	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.6...12$ В; $I_{OUT}=200$ мА; $V_{OUT}=1.5...11.75$ В	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • FB • SD
LAB	ADP3300ART-2.7	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=50$ мА; $V_{OUT}=2.7$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LBB	ADP3300ART-3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=50$ мА; $V_{OUT}=3$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LCB	ADP3300ART-3.2	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=50$ мА; $V_{OUT}=3.2$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LDB	ADP3300ART-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=50$ мА; $V_{OUT}=3.3$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LEB	ADP3300ART-5	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=50$ мА; $V_{OUT}=5$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LFB	ADP3300ART-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=50$ мА; $V_{OUT}=2.85$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LTC	ADP3307ART-2.7	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=100$ мА; $V_{OUT}=2.7$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LUC	ADP3307ART-3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=100$ мА; $V_{OUT}=3$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LVC	ADP3307ART-3.2	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=100$ мА; $V_{OUT}=3.2$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LWC	ADP3307ART-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=100$ мА; $V_{OUT}=3.3$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LXC	ADP3307ART-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12$ В; $I_{OUT}=100$ мА; $V_{OUT}=2.85$ В	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
M4	MBD110DW	ON	shd x2	$V_R<7$ В; $V_F(I_F=10$ мА$)<0.6$ В; $C_D<1$ пФ	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
MA	MBT3904DW1	ON	npn x2	$V_{CBO}=60$ В; $I_C=200$ мА; $P_D=150$ мВт; $h_{21}>30$; $f_T>300$ МГц	SOT363, SC88	E2 • B2 • C1 • E1 • B1 • C2
MCs	BFS17S	SIEM	npn x2	$V_{CBO}=25$ В; $I_C=50$ мА; $P_D=280$ мВт; $h_{21}=20...150$; $f_T>2500$ МГц	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
MJ	MBT3904DW2	ON	npn x2	$V_{CBO}=60$ В; $I_C=200$ мА; $P_D=150$ мВт; $h_{21}>30$; $f_T>300$ МГц	SOT363, SC88	B2 • B1 • C1 • E1 • E2 • C2
MM0	ADM8828ART	AD	dcdc	$V_{IN}=1.5...5.5$ В; $I_{OUT}>25$ мА; $V_{OUT}=-1.5...-5.5$ В; $I_{CC}<1$ мА	SOT23-6	OUT • IN • CAP– • GND • SHDN • CAP+
MN0	ADM8829ART	AD	dcdc	$V_{IN}=1.5...5.5$ В; $I_{OUT}>25$ мА; $V_{OUT}=-1.5...-5.5$ В; $I_{CC}<1$ мА	SOT23-6	OUT • IN • CAP– • GND • n. c. • CAP+
N06	DDC123JK	DIODS	Dnpn x2	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; 2.2к/47к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N06	DDC123JU	DIODS	Dnpn x2	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; 2.2к/47к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N07	DDC143TK	DIODS	Dnpn x2	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; R_1 4.7к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N07	DDC143TU	DIODS	Dnpn x2	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; R_1 4.7к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N12	DDC114TK	DIODS	Dnpn x2	$V_{CC}=50$ В; $I_C=100$ мА; R_1 10к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
N12	DDC114TU	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 10 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N13	DDC114EK	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/10 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N13	DDC114EU	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/10 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N14	DDC114YK	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/47 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N14	DDC114YU	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/47 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N17	DDC124EK	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 22 к/22 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N17	DDC124EU	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 22 к/22 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N20	DDC144EK	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 47 к/47 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N20	DDC144EU	DIODS	Dnpn x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 47 к/47 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
NN	HSMS282N	HP	shd x4	V_{BR} > 15 В; V_F (I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R (V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT363, SC88	K1 • A1, A2, A3, A4 • K2 • K3 • A1, A2, A3, A4 • K4
nQ	µPA841TD	NEC	npn x2	V_{CBO} = 9 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 210 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3.5 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
O	HSMS280R	HP	shd x4	V_{BR} > 70 В; V_F (I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_R (V_R = 50 В) < 200 нА; C_D < 2.0 пФ	SOT363, SC88	K1 • A1, K2 • A2 • K3 • A3, K4 • A4
OO	HSMS282R	HP	shd x4	V_{BR} > 15 В; V_F (I_F = 30 мА) < 0.7 В; I_R (V_R = 1 В) < 100 нА; C_T < 1.0 пФ; R_D = 12 Ом	SOT363, SC88	K1 • A1, K2 • A2 • K3 • A3, K4 • A4
P06	DDA123JK	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 2.2 к/47 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P06	DDA123JU	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 2.2 к/47 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P07	DDA143TK	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 4.7 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P07	DDA143TU	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 4.7 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P12	DDA114TK	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 10 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P12	DDA114TU	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; R_1 10 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P13	DDA114EK	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/10 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P13	DDA114EU	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/10 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P14	DDA114YK	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/47 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P14	DDA114YU	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 10 к/47 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P17	DDC124EK	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 22 к/22 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P17	DDC124EU	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 22 к/22 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P20	DDA144EK	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 47 к/47 к	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
P20	DDA144EU	DIODS	Dpnp x2	V_{CC} = 50 В; I_C = 100 мА; 47 к/47 к	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
PGs	BGA428	INF	amp	V_{CC} = 2.4...3 В; I_{CC} = 8.2 мА; G_{MA} = 20 дБ (f_T = 1 ГГц)	SOT363, SC88	VD • GND • OUT • GS • GND • IN
PL	HSMS285L	HP	shd x3	V_F (I_F = 1 мА) < 0.25 В; C_T = 0.3 пФ	SOT363, SC88	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
PP	HSMS285P	HP	shd x4	V_F (I_F = 1 мА) < 0.25 В; C_T = 0.3 пФ	SOT363, SC88	A1 • K1, A2 • K2 • K3 • K4, A3 • A4
R10B	REG710NA-5	TI	scvcon	V_{IN} = 1.8...5.5 В; I_{OUT} > 30 мА; V_{OUT} = 5.0 В	SOT23-6	VOUT • GND • Enable • CPUMP • VIN • CPUMP+
R10C	REG710NA-3.3	TI	scvcon	V_{IN} = 1.8...5.5 В; I_{OUT} > 30 мА; V_{OUT} = 3.3 В	SOT23-6	VOUT • GND • Enable • CPUMP • VIN • CPUMP+
R10D	REG710NA-3	TI	scvcon	V_{IN} = 1.8...5.5 В; I_{OUT} > 30 мА; V_{OUT} = 3.0 В	SOT23-6	VOUT • GND • Enable • CPUMP • VIN • CPUMP+
R10F	REG710NA-2.7	TI	scvcon	V_{IN} = 1.8...5.5 В; I_{OUT} > 30 мА; V_{OUT} = 2.7 В	SOT23-6	VOUT • GND • Enable • CPUMP • VIN • CPUMP+



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
R10G	REG710NA-2.5	TI	scvcon	V_{IN} = 1.8...5.5 В; I_{OUT} > 30 мА; V_{OUT} = 2.5 В	SOT23-6	VOUT • GND • Enable • CPUMP • VIN • CPUMP+
R10H	REG71055DDC	TI	scvcon	V_{IN} = 1.8...5.5 В; I_{OUT} > 30 мА; V_{OUT} = 5.5 В	TSOT23-6	VOUT • GND • Enable • CPUMP • VIN • CPUMP+
R24	µPA801TFB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 3 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
R25	µPA801TGB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 230 мВт; h_{21} = 125...250; f_T > 3 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
R34	µPA802TFB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 70...150; f_T > 4.5 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
R35	µPA802TGB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 110...240; f_T > 4.5 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
R84	µPA827TF	NEC	npn x2	V_{CBO} = 5 В; I_C = 10 мА; P_D = 60 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 8.5 ГГц	TSOT363	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
R86	µPA828TF	NEC	npn x2	V_{CBO} = 5 В; I_C = 30 мА; P_D = 180 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 7 ГГц	TSOT363	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
REs	BFS480	SIEM	npn x2	V_{CBO} = 10 В; IC = 10 мА; P_D = 80 мВт; h_{21} = 30...200; f_T = 7500 МГц	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
RFs	BFS481	SIEM	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
RGs	BFS482	SIEM	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
RHs	BFS483	SIEM	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 450 мВт; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
RL	µPA800T	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 80...200; f_T > 5.5 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
RL	µPA800TF	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 80...200; f_T > 5.5 ГГц	TSOT363	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
S00	ADG741BKSZ	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT363, SC88	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
S01	ADG742BKSZ	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT363, SC88	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
S0M	ADG779BKSZ	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 6 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT363, SC88	IN • VDD • GND • S1 • D • S2
S18	ADG602BRTZ	AD	asw	SPST; R_{ON} < 5.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	SOT23-6	VDD • S • VSS • GND • D • IN
s1A	SMBT3904S	SIEM	npn x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 300 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
s1A	SMBT3904U	SIEM	npn x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 300 МГц	SOT457, SC74	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
S1B	ADG465BRT	AD	prot	V_{PROT} < ±40 В; V_{DD} = ±15 В	SOT23-6	VD1 • n. c. • VSS • VS1 • n. c. • VDD
s2A	SMBT3906S	SIEM	pnp x2	V_{CBO} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
s2A	SMBT3906U	SIEM	pnp x2	V_{CBO} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц	SOT457, SC74	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
S3B	ADG701BRT	AD	asw	SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
s3P	SMBT3904PN	SIEM	npn/pnp	V_{CBO} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
S4B	ADG702BRT	AD	asw	SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
S5B	ADG719BRT	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 7 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	IN • VDD • GND • S1 • D • S2
SDA	ADG751ART	AD	asw	SPST; R_{ON} < 40 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	S • VDD • n. c. • IN • GND • D
SDB	ADG751BRT	AD	asw	SPST; R_{ON} < 40 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	S • VDD • n. c. • IN • GND • D
SEB	ADG752BRT	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 20 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	D • VDD • S1 • IN • GND • S2
SFB	ADG741BKS	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT363, SC88	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
SGB	ADG742BKS	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT363, SC88	D • S • GND • IN • n. c. • VDD





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
SHB	ADG749BKS	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 7 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT363, SC88	IN • VDD • GND • S1 • D • S2
SKB	ADG779BKS	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 6 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT363, SC88	IN • VDD • GND • S1 • D • S2
SLB	ADG801BRT	AD	asw	SPST; R_{ON} < 0.4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
SMB	ADG802BRT	AD	asw	SPST; R_{ON} < 0.4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
SNB	ADG819BRT	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	IN • VDD • GND • S1 • D • S2
SPB	ADG820BRT	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	IN • VDD • GND • S1 • D • S2
STB	ADG601BRT	AD	asw	SPST; R_{ON} < 5.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	SOT23-6	VDD • S • VSS • GND • D • IN
STB#	ADG601BRTZ	AD	asw	SPST; R_{ON} < 5.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	SOT23-6	VDD • S • VSS • GND • D • IN
SUB	ADG602BRT	AD	asw	SPST; R_{ON} < 5.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	SOT23-6	VDD • S • VSS • GND • D • IN
T1	EMT1	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 120	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
T1	IMT1A	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1 • B1 • E2 • C2 • B1 • E1
T1	UMT1N	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
T17	IMT17	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
T1H	ADT7301ARTZ	AD	dts	13-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.25 В	SOT23-6	GND • DIN • VDD • SCLK • CS • DOUT
T2	EMT2	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100	SOT563, EMT6	E2 • E1 • B1 • C1 • B2 • C2
T2	IMT2A	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100	SOT23-6	C2 • B2 • C1 • B1 • E1 • E2
T2	UMT2N	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
T3	EMT3	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100	SOT563, EMT6	E2 • B2 • B1 • C1 • E1 • C2
T3	IMT3A	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 100	SOT457, SC74	C2 • E1 • C1 • B1 • B2 • E2
T3	UMT3N	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT363, SC88	E1 • B1 • B2 • C2 • E2 • C1
T4	IMT4	ROHM	pnp x2	V_{CBO} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 180	SOT23-6	C1 • E2 • C2 • B2 • B1 • E1
T4	MBD330DW	ON	shd x2	V_R < 30 В; V_F(I_F = 10 мА) < 0.6 В; C_D < 1 пФ	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
T76	μPA804TFB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 3 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
T77	μPA804TGB	NEC	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 3 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
T83	μPA806T	NEC	npn x2	V_{CBO} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 12 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
T84	μPA807T	NEC	npn x2	V_{CBO} = 5 В; I_C = 10 мА; P_D = 60 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 8.5 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
T86	μPA808T	NEC	npn x2	V_{CBO} = 5 В; I_C = 30 мА; P_D = 180 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 7 ГГц	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
TCA	ADT7301ART	AD	dts	13-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.25 В	SOT23-6	GND • DIN • VDD • SCLK • CS • DOUT
TK	HSMS286K	HP	shd x2	V_F(I_F = 1 мА) < 0.35 В; C_T < 0.30 пФ	SOT363, SC88	A1 • n. c. • A2 • K2 • n. c. • K1
TL	HSMS286L	HP	shd x3	V_F(I_F = 1 мА) < 0.35 В; C_T < 0.30 пФ	SOT363, SC88	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
TOH	AD7414ARTZ	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-6	AS • GND • VDD • SCL • ALERT • SDA
TOJ	AD7414ARTZ	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-6	AS • GND • VDD • SCL • ALERT • SDA
TOK	AD7414ARTZ	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-6	AS • GND • VDD • SCL • ALERT • SDA
TP	HSMS286P	HP	shd x4	V_F(I_F = 1 мА) < 0.35 В; C_T < 0.30 пФ	SOT363, SC88	A1 • K1, A2 • K2 • K3 • K4, A3 • A4



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
TR	HSMS286R	HP	shd x4	$V_F(I_F = 1$ мА$) < 0.35$ В; $C_T < 0.30$ пФ	SOT363, SC88	K1 • A1, K2 • A2 • K3 • A3, K4 • A4
VA	RN4601	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 4.7$ кОм/4.7 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VA	RN4901	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 4.7$ кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VA	RN4901FE	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 100$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 4.7$ кОм/4.7 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VAYI	TLV2630IDBV	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В; $f_{BD} = 9$ МГц; $V_{OSI} < 4.5$ мВ	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN • SHDN • VDD
VB	RN4602	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 10$ кОм/10 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VB	RN4902	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 10$ кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VB	RN4902FE	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 100$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 10$ кОм/10 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VC	RN4603	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 22$ кОм/22 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VC	RN4903	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 22$ кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VC	RN4903FE	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 100$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 22$ кОм/22 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VD	RN4604	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 47$ кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VD	RN4904	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 47$ кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VD	RN4904FE	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 100$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 47$ кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VE	RN4605	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 2.2$ кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VE	RN4905	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 2.2$ кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VE	RN4905FE	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 100$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 2.2$ кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VF	RN4606	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 4.7$ кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VF	RN4906	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 4.7$ кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VF	RN4906FE	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 100$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 4.7$ кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
vH	μPA851TD	NEC	npn x2	$V_{CB01} = 5$ В; $V_{CB02} = 15$ В; $I_{C1} = 30$ мА; $I_{C2} = 100$ мА; $P_D = 210$ мВт; $f_{T1} > 10$ ГГц; $f_{T2} > 4.5$ ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
VH	RN4607	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 10$ кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VH	RN4907	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 10$ кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VH	RN4907FE	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 100$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 10$ кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VI	RN4608	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 22$ кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VI	RN4908	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 22$ кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VI	RN4908FE	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 100$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 22$ кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VJ	RN4609	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 47$ кОм/22 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VJ	RN4909	TOSH	Dpnp/npn	$V_{CB0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $f_T = 200$ МГц; $R_1/R_2 = 47$ кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1



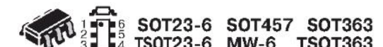


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
VJ	RN4909FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VK	RN4610	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VK	RN4910	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VK	RN4910FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
vL	µPA854TD	NEC	npn x2	V_{CB01} = 9 В; V_{CB02} = 15 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 210 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
VM	RN4611	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VM	RN4911	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VM	RN4911FE	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
vN	µPA855TD	NEC	npn x2	V_{CB01} = 5 В; V_{CB02} = 15 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 210 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
VN	RN4612	TOSH	Dpnp/npn	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 22 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
vT	µPA859TD	NEC	npn x2	V_{CB01} = 5 В; V_{CB02} = 9 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 210 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 4 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
vV	µPA860TD	NEC	npn x2	V_{CB01} = 9 В; V_{CB02} = 9 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 35 мА; P_D = 210 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 17 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
vX	µPA861TD	NEC	npn x2	V_{CB01} = 5 В; V_{CB02} = 9 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 35 мА; P_D = 195 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 17 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
vY	µPA862TD	NEC	npn x2	V_{CB01} = 9 В; V_{CB02} = 9 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 210 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
vY	µPA862TS	NEC	npn x2	V_{CB01} = 9 В; V_{CB02} = 9 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 130 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3 ГГц	SOT666	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
W10	FMW10	ROHM	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 27	SOT23-6	C1 • C2 • B2 • E1, E2 • B1 • n. c.
W10	UMW10N	ROHM	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} = 27...270; f_T > 1500 МГц	SOT363, SC88	B1 • E1, E2 • B2 • C2 • C1 • n. c.
W1s	BCR10PN	INF	Dpnp(2) +npn(1)	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; f_T = 130 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
W5	SEMB10	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 70 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T = 100 МГц	SOT666	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2
W8	FMW8	ROHM	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 27	SOT457, SC74	C1 • n. c. • C2 • B2 • E1, E2 • B1
WC	SEMH11	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 30; f_T = 130 МГц	SOT666	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2
WCs	BCR133S	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 30; f_T = 130 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
WCs	BCR133U	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 30; f_T = 130 МГц	SOT457, SC74	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2
WD	SEMH1	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 50; f_T > 130 МГц	SOT666	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2
WDs	BCR141S	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 130 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2
WDs	BCR141U	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 50; f_T > 130 МГц	SOT457, SC74	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2
WE	SEMH2	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 70 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 100 МГц	SOT666	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2
WEs	BCR148S	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 70 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 100 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2
WEs	BCR148U	INF	Dpnp x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 70 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 100 МГц	SOT457, SC74	E1 • B1 • C1 • E2 • B2 • C2





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
WFs	BCR08PN	INF	Dpnp(2) +npn(1)	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T = 170 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WH	SEMH10	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 170 МГц	SOT666	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WHs	BCR108S	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 170 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WJ	SEMH9	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 150 МГц	SOT666	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WJs	BCR135S	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 150 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WKs	BCR119S	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 120...630; f_T > 150 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WMs	BCR183S	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30;	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WMs	BCR183U	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30;	SOT457, SC74	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WNs	BCR185S	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 200 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WNs	BCR185U	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 200 МГц	SOT457, SC74	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WOs	BCR191S	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 200 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WPs	BCR192U	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 200 МГц	SOT457, SC74	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WPs	BCR22PN	INF	Dpnp(2) +npn(1)	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 50; f_T = 130 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WRs	BCR198S	INF	D2 pnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 70 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 190 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WSs	BCR169S	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 120...630; f_T > 150 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WTs	BCR48PN	INF	Dpnp(1) +npn(2)	V_{CBO} = 50 В; ICNPN = 70 мА; ICPNP = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 100 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WU	MRF2947AT1	MOT	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 188 мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 9 ГГц	SOT363, SC88	B1•E2•C2•B2•E1•C1
WVs	BCR129S	INF	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 120...630; f_T > 150 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WVs	BCR35PN	INF	Dpnp(1) +npn(2)	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; f_T > 150 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
X1	EMX1	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 120	SOT563, EMT6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
X1	IMX1	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1•B2•E2•C2•B1•E1
X1	UMX1N	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
X11	UMX11N	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 25 В; I_C = 20 мА; h_{21} = 39...180; f_T > 700 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•B2•C2•E2•C1
X17	IMX17	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1•B2•E2•C2•B1•E1
X2	IMX2	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1•B1•C2•B2•E2•E1
X2	UMX2N	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
X3	IMX3	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1•E2•C2•B2•B1•E1
X3	UMX3N	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT363, SC88	E1•B1•B2•C2•E2•C1
X4	EMX4	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 27	SOT563, EMT6	E1•B1•B2•C2•E2•C1
X4	IMX4	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 27	SOT23-6	C1•E2•C2•B2•B1•E1
X4	UMX4N	ROHM	npn x2	V_{CBO} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} = 56...180; f_T > 1500 МГц	SOT363, SC88	E1•B1•B2•C2•E2•C1



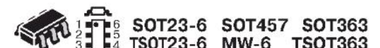


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
X5	IMX5	ROHM	npn x2	V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 27	SOT23-6	C1 • E2 • C2 • B2 • B1 • E1
X5	UMX5N	ROHM	npn x2	V_{CB0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} = 56...180; f_T > 1500 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • B2 • C2 • E2 • C1
X6	UMX6N	ROHM	npn x2	V_{CB0} = 40 В; I_C = 50 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} > 56; f_T > 300 МГц	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
X8	IMX8	ROHM	npn x2	V_{CB0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 180	SOT23-6	C1 • E2 • C2 • B2 • B1 • E1
X9	IMX9	ROHM	npn x2	V_{CB0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 560	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
XA	RN1601	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XA	RN1901	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XA	RN1901FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XB	RN1602	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XB	RN1902	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XB	RN1902FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
xC	μPA863TD	NEC	npn x2	V_{CB01} = 5 В; V_{CB02} = 9В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 130 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3 ГГц	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
xC	μPA863TS	NEC	npn x2	V_{CB01} = 5 В; V_{CB02} = 9В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 130 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3 ГГц	SOT666	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
XC	RN1603	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XC	RN1903	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XC	RN1903FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XD	RN1604	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XD	RN1904	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XD	RN1904FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XE	RN1605	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XE	RN1905	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XE	RN1905FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XF	RN1606	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XF	RN1906	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XF	RN1906FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XH	RN1607	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XH	RN1907	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XH	RN1907FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XI	RN1608	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
XI	RN1908	TOSH	Dnpn x2	V_{CB0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
XI	RN1908FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XJ	RN1609	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XJ	RN1909	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XJ	RN1909FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XK	RN1610	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XK	RN1910	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XK	RN1910FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XM	RN1611	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XM	RN1911	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XM	RN1911FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XR	MRF2947RAT1	MOT	npn x2	V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 188 мВт; h_{21} = 75...150; f_T = 9 ГГц	SOT363, SC88	B1•E1•C2•B2•E2•C1
XXA	RN1961	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXA	RN1961FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXB	RN1962	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXB	RN1962FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXC	RN1963	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXC	RN1963FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXD	RN1964	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXD	RN1964FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXE	RN1965	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXE	RN1965FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXF	RN1966	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXF	RN1966FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXH	RN1967	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXH	RN1967FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXI	RN1968	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXI	RN1968FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXJ	RN1969	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXJ	RN1969FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
XXK	RN1970	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
XXK	RN1970FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT666	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
XXM	RN1971	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
XXM	RN1971FE	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT666	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
XXP	RN1973	TOSH	Dnpn x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; R_1 = 47 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
Y0s	CGY121B	SIEM	amp	GaAs; V_{CC} = 2.7...6 В; f_{BD} = 0.8...2.5 ГГц	MW-6	V2/RF-OUT • RF-GND • VD1 • RF-IN • RF-GND • VCONTR
Y2	CLY2	SIEM	nFET	GaAs; V_{DS} = 9 В; I_D = 600 мА; P_D = 900 мВт; I_{DSS} = 650 мА	MW-6	G • S • D • D • S • G
Y5s	CGY59	SIEM	amp	GaAs; f_{BD} = 0.9/1.8 ГГц	SOT363, SC88	DC-GND • RF-GND • IN • OUT • RF-GND • VD
Y6s	CGY62	SIEM	amp	GaAs; V_{CC} = 2.7...5 В; f_{BD} = 0.2...2.5 ГГц	MW-6	OUT • GND • INTERS • IN • GND • GND
Y7	CGY60	SIEM	amp	GaAs; f_{BD} = 1.8 ГГц	MW-6	DC-GND • RF-GND • IN • OUT • RF-GND • VD
Y8	CGY120	SIEM	amp	GaAs; V_{CC} = 2.7...6 В; f_{BD} = 0.8...2.5 ГГц	MW-6	IN • GND • VCONTR • OUT • GND • VD1
Y9s	CGY121A	SIEM	amp	GaAs; V_{CC} = 2.7...6 В; f_{BD} = 0.8...2.5 ГГц	MW-6	V2/RF-OUT • RF-GND • VD1 • RF-IN • RF-GND • VCONTR
YA	RN2601	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YA	RN2901	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YA	RN2901FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YB	RN2602	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YB	RN2902	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YB	RN2902FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YC	RN2603	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YC	RN2903	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YC	RN2903FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YD	RN2604	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YD	RN2904	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YD	RN2904FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YE	RN2605	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YE	RN2905	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YE	RN2905FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YF	RN2606	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YF	RN2906	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
YF	RN2906FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YH	RN2607	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YH	RN2907	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YH	RN2907FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YI	RN2608	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YI	RN2908	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YI	RN2908FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YJ	RN2609	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YJ	RN2909	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YJ	RN2909FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YK	RN2610	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YK	RN2910	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YK	RN2910FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YM	RN2611	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YM	RN2911	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YM	RN2911FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YYA	RN2961	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYA	RN2961FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYB	RN2962	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYB	RN2962FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYC	RN2963	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYC	RN2963FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYD	RN2964	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYD	RN2964FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYE	RN2965	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYE	RN2965FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYF	RN2966	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYF	RN2966FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYH	RN2967	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1



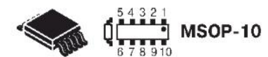

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
YYH	RN2967FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYI	RN2968	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYI	RN2968FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм	SOT666	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYJ	RN2969	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYJ	RN2969FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/22 кОм	SOT666	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYK	RN2970	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYK	RN2970FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм	SOT666	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYM	RN2971	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYM	RN2971FE	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_1 = 10 кОм	SOT666	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
YYS	RN2975	TOSH	Dpnp x2	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
Z1	EMZ1	ROHM	npn/pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 120	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
Z1	IMZ1A	ROHM	npn/pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
Z1	UMZ1N	ROHM	pnp(2)+npn (1)	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} = 120...560; f_T > 400 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
Z2	EMZ2	ROHM	npn/pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 120	SOT563, EMT6	E1 • B1 • B2 • C2 • E2 • C1
Z2	IMZ2A	ROHM	npn/pnp	V_{CBO} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1 • E2 • C2 • B2 • B1 • E1
Z2	UMZ2N	ROHM	pnp(1)+npn (2)	V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D(com.) = 300 мВт; h_{21} = 120...560; f_T > 180 МГц	SOT363, SC88	E1 • B1 • B2 • C2 • E2 • C1
Z4	IMZ4	ROHM	npn/pnp	V_{CBO} = 40 В; I_C = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 120	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
ZS20	ZHCS2000	ZETEX	shd	V_R < 40 В; I_F < 2 А; V_F(I_F = 3 А) < 0.615 В; I_R < 300 мкА; C_D = 50 пФ	SOT23-6	K • K • A • A • K • K



MSOP/SOP-8/10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
#DBB	AD5304BRMZ	AD	DAC	4x8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#DCA	AD5314ARMZ	AD	DAC	4x10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#DCB	AD5314BRMZ	AD	DAC	4x10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#DDB	AD5324BRMZ	AD	DAC	4x12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#HCA	AD8062ARMZ	AD	dOA	f_{BD} = 320 МГц; P_D = 75 мВт; V_{DD} = 2.7...8 В	MSOP-8	VOUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • VOUT2 • +VS
0412	LT1004CS8-1.2	LT	vref	V_{OUT} = 1.2 В; ACC = ±4 мВ	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • n.c. • VOUT • n.c. • VOUT
0412I	LT1004IS8-1.2	LT	vref	V_{OUT} = 1.2 В; ACC = ±4 мВ	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • n.c. • VOUT • n.c. • VOUT
0425	LT1004CS8-2.5	LT	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC = ±20 мВ	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • n.c. • VOUT • n.c. • VOUT
0425I	LT1004IS8-2.5	LT	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC = ±20 мВ	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • n.c. • VOUT • n.c. • VOUT
1001	LT1001CS8	LT	OA	V_{OSI} < 60 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; P_D < 80 мВт	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • VOSTRIM
1006	LT1006S8	LT	OA	V_{OSI} < 50 мкВ; V_{DD} > 2.7 В; P_D < 80 мВт	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • VOSTRIM • OUT • V+ • ISY SET
1007	LT1007CS8	LT	OA	V_{OSI} < 60 мкВ; V_{DD} > 2.7 В; P_D < 160 мВт	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • VOSTRIM
1007I	LT1007IS8	LT	OA	V_{OSI} < 60 мкВ; V_{DD} > 2.7 В; P_D < 160 мВт	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • VOSTRIM
1008	LT1008S8	LT	OA	V_{OSI} < 180 мкВ; V_{DD} > 2.7 В	SOP-8	COMP1 • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • COMP2
1009	LT1009S8	LT	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC < 0.2%; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • (–) • ADJ • (+) • n.c. • (+)
1009I	LT1009IS8	LT	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC < 0.2%; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • (–) • ADJ • (+) • n.c. • (+)
1011	LT1011CS8	LT	cmp	V_{OSI} < 0.5 мВ; V_{DD} = ± 15 В; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	GND • INPUT • INPUT • V– • BAL • BAL/STR • OUTPUT • V+
1011AI	LT1011AIS8	LT	cmp	V_{OSI} < 0.5 мВ; V_{DD} = ± 15 В; T_{AMB} = -55...125 °C	SOP-8	GND • INPUT • INPUT • V– • BAL • BAL/STR • OUTPUT • V+
1011I	LT1011IS8	LT	cmp	V_{OSI} < 0.5 мВ; V_{DD} = ± 15 В; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	GND • INPUT • INPUT • V– • BAL • BAL/STR • OUTPUT • V+
1012	LT1012S8	LT	OA	V_{OSI} < 25 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 600 мкА; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • OVER COMP • OUT • V+ • VOSTRIM
1012A	LT1012ACS8	LT	OA	V_{OSI} < 25 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 600 мкА; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • OVER COMP • OUT • V+ • VOSTRIM
1012AI	LT1012AIS8	LT	OA	V_{OSI} < 25 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 600 мкА; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • OVER COMP • OUT • V+ • VOSTRIM
1012I	LT1012IS8	LT	OA	V_{OSI} < 25 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 600 мкА; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • OVER COMP • OUT • V+ • VOSTRIM
1013	LT1013DS8	LT	dOA	V_{OSI} < 150 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 550 мкА; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	+INA • V– • +INB • –INB • OUTB • V+ • OUTA • –INA
1013I	LT1013IS8	LT	dOA	V_{OSI} < 150 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 550 мкА; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	+INA • V– • +INB • –INB • OUTB • V+ • OUTA • –INA
1016	LT1016CS8	LT	cmp	V_{OSI} < 0.5 мВ; V_{DD} = 5/±5 В; t_{PD} = 10 нс; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	V+ • +IN • –IN • V– • LAT ENBL • GND • Q OUT • Q OUT
1016I	LT1016IS8	LT	cmp	V_{OSI} < 0.5 мВ; V_{DD} = 5/±5 В; t_{PD} = 10 нс; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	V+ • +IN • –IN • V– • LAT ENBL • GND • Q OUT • Q OUT
1017	LT1017CS8	LT	cmp x2	V_{OSI} < 1 мВ; V_{DD} = 1.1...40 В; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	+IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+ • OUT A • –IN A

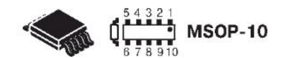




Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
1017I	LT1017IS8	LT	cmp x2	V_{OSI} < 1 мВ; V_{DD} = 1.1...40В; T_{AMB} = -40...85°C	SOP-8	+IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+ • OUT A • –IN A
1018	LT1018CS8	LT	cmp x2	V_{OSI} < 1 мВ; V_{DD} = 1.1...40В; T_{AMB} = 0...70°C	SOP-8	+IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+ • OUT A • –IN A
1026	LT1026CS8	LT	vcon	V_{OUT} = ± 18 В; I_{OUT} > 10 мА; T_{AMB} = 0...70°C	SOP-8	C1– • C2+ • C2– • –VOUT • GND • VIN • C1+ • +VOUT
1026I	LT1026IS8	LT	vcon	V_{OUT} = ± 18 В; I_{OUT} > 10 мА; T_{AMB} = -40...85°C	SOP-8	C1– • C2+ • C2– • –VOUT • GND • VIN • C1+ • +VOUT
1027C5	LT1027CCS8-5	LT	vref	V_{OUT} = 5 В; T_{AMB} = 0...70°C; T_{CVOUT} < 3 ppm/°C	SOP-8	NR • GND • VTRIM • VOUT • n.c. • n.c. • n.c. • VIN
1027D5	LT1027DCS8-5	LT	vref	V_{OUT} = 5 В; T_{AMB} = 0...70°C; T_{CVOUT} < 5 ppm/°C	SOP-8	NR • GND • VTRIM • VOUT • n.c. • n.c. • n.c. • VIN
1027E5	LT1027ECS8-5	LT	vref	V_{OUT} = 5 В; T_{AMB} = 0...70°C; T_{CVOUT} < 7.5ppm/°C	SOP-8	NR • GND • VTRIM • VOUT • n.c. • n.c. • n.c. • VIN
1028	LT1028CS8	LT	OA	V_{OSI} < 40 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 10.5 мА; T_{AMB} = -40...85°C	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • OVER COMP • OUT • V+ • VOSTRIM
1034I12	LT1034IS8-1.2	LT	vref x2	V_{OUT1} = 1.2 В; V_{OUT2} = 7 В; T_{AMB} = -40...85°C	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • 7V • 2.5V • n.c. • 2.5V
1037	LT1037CS8	LT	OA	V_{OSI} < 60 мкВ; V_{DD} > 2.7 В; P_D < 160 мВт	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • VOS TRIM
1054	LT1054CS8	LT	vcon + reg	V_{CC} = 3.5...15 В; I_{OUT} = 100 мА; T_{AMB} = 0...100°C	SOP-8	FB/SHDN • CAP+ • GND • CAP– • VOUT • VREF • OSC • V+
1054A	LT1054ACS8	LT	vcon + reg	V_{CC} = 3.5...15 В; I_{OUT} = 100 мА; T_{AMB} = 0...100°C	SOP-8	FB/SHDN • CAP+ • GND • CAP– • VOUT • VREF • OSC • V+
1054I	LT1054IS8	LT	vcon + reg	V_{CC} = 3.5...15 В; I_{OUT} = 100 мА; T_{AMB} = -40...100°C	SOP-8	FB/SHDN • CAP+ • GND • CAP– • VOUT • VREF • OSC • V+
1054L	LT1054LCS8	LT	vcon + reg	V_{CC} = 3.5...7 В; I_{OUT} = 100 мА; T_{AMB} = 0...100°C	SOP-8	FB/SHDN • CAP+ • GND • CAP– • VOUT • VREF • OSC • V+
1055	LT1055S8	LT	OA	V_{OSI} < 150 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 7 мА; T_{AMB} = 0...70°C	SOP-8	BAL • –IN • +IN • V – • BAL • OUT • V+ • n.c.
1056	LT1056S8	LT	OA	V_{OSI} < 150 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 7 мА; T_{AMB} = 0...70°C	SOP-8	BAL • –IN • +IN • V – • BAL • OUT • V+ • n.c.
1057	LT1057S8	LT	dOA	V_{OSI} < 450 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 2.8 мА; T_{AMB} = 0...70°C	SOP-8	+IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+ • OUT A • –IN A
1057I	LT1057IS8	LT	dOA	V_{OSI} < 450 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 2.8 мА; T_{AMB} = -40...85°C	SOP-8	+IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+ • OUT A • –IN A
1072	LT1072CS8	LT	reg	V_{IN} = 3...60В; f_{SW} = 40 кГц	SOP-8	GND • VC • FB • n.c. • VIN • E1 • VSW • E2
1073	LT1073CS8	LT	dcdc	V_{IN} = 1...30В; I_S < 130 мкА	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
107312	LT1073CS8-12	LT	dcdc	V_{IN} = 1...30В; V_{OUT} = 12 В; I_S < 130 мкА	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
10735	LT1073CS8-5	LT	dcdc	V_{IN} = 1...30В; V_{OUT} = 5 В; I_S < 130 мкА	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
1077	LT1077S8	LT	OA	V_{OSI} < 40 мкВ; V_{DD} = 5В; I_D < 68 мкА; T_{AMB} = 0...70°C	SOP-8	VOS TRIM • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • VOS TRIM
1077I	LT1077IS8	LT	OA	V_{OSI} < 40 мкВ; V_{DD} = 5В; I_D < 68 мкА; T_{AMB} = -40...85°C	SOP-8	VOS TRIM • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • VOS TRIM
1078	LT1078S8	LT	dOA	V_{OSI} < 70 мкВ; V_{DD} = 5В; I_D < 68 мкА; T_{AMB} = 0...70°C	SOP-8	+IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+ • OUT A • –IN A
1078I	LT1078IS8	LT	dOA	V_{OSI} < 70 мкВ; V_{DD} = 5В; I_D < 68 мкА; T_{AMB} = -40...85°C	SOP-8	+IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+ • OUT A • –IN A
10905	LT1109CS8-5	LT	dcdc	V_{IN} = 3...20В; V_{OUT} = 5 В; I_S < 320 мкА; T_{AMB} = 0...70°C°C	SOP-8	VIN • n.c. • SW • GND • n.c. • n.c. • SHUTDOWN • SENSE
10912	LT1109CS8-12	LT	dcdc	V_{IN} = 3...20В; V_{OUT} = 12 В; I_S < 320 мкА; T_{AMB} = 0...70°C°C	SOP-8	VIN • n.c. • SW • GND • n.c. • n.c. • SHUTDOWN • SENSE
1097	LT1097S8	LT	OA	V_{OSI} < 50 мкВ; V_{DD} = ± 15 В; I_D < 0.7 мА; T_{AMB} =-40...85°C	SOP-8	VOS TRIM • –IN • +IN • V– • OVER COMP • OUT • V+ • VOS TRIM
11012	LT1110CS8-12	LT	dcdc	V_{IN} = 1...30В; V_{OUT} = 12 В; T_{AMB} = 0...70°C°C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
1107	LT1107CS8	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; I_S<450 мкА; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • AO • SET • FB/SENSE
110712	LT1107CS8-12	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; V_{OUT}=12 В; I_S<450 мкА; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • AO • SET • FB/SENSE
11075	LT1107CS8-5	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; V_{OUT}=5 В; I_S<450 мкА; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • AO • SET • FB/SENSE
1107I	LT1107IS8	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; I_S<450 мкА; T_{AMB}=-40...85 °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • AO • SET • FB/SENSE
1108	LT1108CS8	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; I_S<110 мкА; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
11081	LT1108CS8-12	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; V_{OUT}=12 В; I_S<110 мкА; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
11085	LT1108CS8-5	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; V_{OUT}=5 В; I_S<110 мкА; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
1109	LT1109CS8	LT	dcdc	V_{IN}=3...20 В; I_S<320 мкА; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	VIN • n.c. • SW • GND • n.c. • n.c. • SHUTDOWN • SENSE
1109A	LT1109ACS8	LT	dcdc	V_{IN}=3...20 В; I_S<320 мкА; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	VIN • n.c. • SW • GND • n.c. • n.c. • SHUTDOWN • SENSE
1109A1	LT1109ACS8-12	LT	dcdc	V_{IN}=3...20 В; V_{OUT}=12 В; I_S<320 мкА; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	VIN • n.c. • SW • GND • n.c. • n.c. • SHUTDOWN • SENSE
1109A5	LT1109ACS8-5	LT	dcdc	V_{IN}=3...20 В; V_{OUT}=5 В; I_S<320 мкА; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	VIN • n.c. • SW • GND • n.c. • n.c. • SHUTDOWN • SENSE
1110	LT1110CS8	LT	dcdc	V_{IN}=1...30 В; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
11105	LT1110CS8-5	LT	dcdc	V_{IN}=1...30 В; V_{OUT}=5 В; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
1111	LT1111CS8	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
11111	LT1111CS8-12	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; V_{OUT}=12 В; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
11115	LT1111CS8-5	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; V_{OUT}=5 В; T_{AMB}=0...70 °C °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
1111I	LT1111IS8	LT	dcdc	V_{IN}=2...30 В; T_{AMB}=-40...85 °C	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
1112	LT1112S8	LT	dOA	V_{OSI}<60 мкВ; V_{DD}=± 15 В; I_D<400 мкА; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
1112I	LT1112IS8	LT	dOA	V_{OSI}<60 мкВ; V_{DD}=± 15 В; I_D<400 мкА; T_{AMB}=-40...85 °C	SOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
1113	LT1113CS8	LT	dOA	JFET; V_{OSI}<1.5 мВ; V_{DD}=± 15 В; I_D<6.5 мА; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
1116	LT1116CS8	LT	cmp	V_{OSI}<3.5 мВ; V_{DD}=5/±5 В; t_{PD}=12 нс; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	V+ • +IN • –IN • V– • LAT ENBL • GND • Q OUT • Q OUT
1118	LT1118CS8	LT	reg	LDO; V_{IN}<15 В; I_{OUT}=800 мА	SOP-8	GND • n.c. • EN • FB • IN • OUT • IN • GND
111825	LT1118CS8-2.5	LT	reg	LDO; V_{IN}<15 В; V_{OUT}=2.5 В; I_{OUT}=800 мА	SOP-8	IN • OUT • GND • IN • n.c. • GND • GND • EN
111828	LT1118CS8-2.85	LT	reg	LDO; V_{IN}<15 В; V_{OUT}=2.85 В; I_{OUT}=800 мА	SOP-8	IN • OUT • GND • IN • n.c. • GND • GND • EN
11185	LT1118CS8-5	LT	reg	LDO; V_{IN}<15 В; V_{OUT}=5 В; I_{OUT}=800 мА	SOP-8	IN • OUT • GND • IN • n.c. • GND • GND • EN
1128	LT1128CS8	LT	OA	V_{OSI}<40 мкВ; V_{DD}=± 15 В; I_D<10.5 мА; T_{AMB}=-40...85 °C	SOP-8	VOSTRIM • –IN • +IN • V– • OVER COMP • OUT • V+ • VOSTRIM
1905	LT1019CS8-5	LT	vref	V_{OUT}=5 В; ACC<0.2%; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
1910	LT1019CS8-10	LT	vref	V_{OUT}=10 В; ACC<0.2%; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
1925	LT1019CS8-2.5	LT	vref	V_{OUT}=2.5 В; ACC<0.2%; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
1945	LT1019CS8-4.5	LT	vref	V_{OUT}=4.5 В; ACC<0.2%; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19A05	LT1019ACS8-5	LT	vref	V_{OUT}=5 В; ACC<0.05%; T_{AMB}=0...70 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
19A25	LT1019ACS8-2.5	LT	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC < 0.05 %; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19AI05	LT1019AIS8-5	LT	vref	V_{OUT} = 5 В; ACC < 0.05 %; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19AI25	LT1019AIS8-2.5	LT	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC < 0.05 %; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19I05	LT1019IS8-5	LT	vref	V_{OUT} = 5 В; ACC < 0.2 %; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19I25	LT1019IS8-2.5	LT	vref	V_{OUT} = 2.5 В; ACC < 0.2 %; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
2105	LT1021DCS8-5	LT	vref	V_{OUT} = 5 В; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	i.c. • VIN • i.c. • GND • TRIM • VOUT • i.c. • i.c.
2107	LT1021DCS8-7	LT	vref	V_{OUT} = 7 В; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	i.c. • VIN • i.c. • GND • TRIM • VOUT • i.c. • i.c.
2110	LT1021DCS8-10	LT	vref	V_{OUT} = 10 В; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	i.c. • VIN • i.c. • GND • TRIM • VOUT • i.c. • i.c.
3401	LT1034CS8-1.2	LT	vref x2	V_{OUT1} = 1.2 В; V_{OUT2} = 7 В; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • 7V • 2.5V • n.c. • 2.5V
3402	LT1034CS8-2.5	LT	vref x2	V_{OUT1} = 2.5 В; V_{OUT2} = 7 В; T_{AMB} = 0...70 °C	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • 7V • 2.5V • n.c. • 2.5V
34I02	LT1034IS8-2.5	LT	vref x2	V_{OUT1} = 2.5 В; V_{OUT2} = 7 В; T_{AMB} = -40...85 °C	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • 7V • 2.5V • n.c. • 2.5V
37518	MC33375D-1.8	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...13 В; V_{OUT} = 1.8 В; I_{OUT} = 300 мА	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
37525	MC33375D-2.5	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...13 В; V_{OUT} = 2.5 В; I_{OUT} = 300 мА	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
37530	MC33375D-3.0	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...13 В; V_{OUT} = 3.0 В; I_{OUT} = 300 мА	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
37533	MC33375D-3.3	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...13 В; V_{OUT} = 3.3 В; I_{OUT} = 300 мА	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
37550	MC33375D-5.0	ON	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...13 В; V_{OUT} = 5.0 В; I_{OUT} = 300 мА	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
5812	MRF5812	MOT	npn	V_{CBO} = 30 В; I_C = 200 мА; P_D = 1670 мВт; h_{21} = 30...200; f_T = 5.5 ГГц	SOP-8	E • C • C • E • E • B • B • E
5943	MRF5943	MOT	npn	V_{CBO} = 40 В; I_C = 400 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 25...200; f_T = 1.3 ГГц	SOP-8	E • C • C • E • E • B • B • E
A0R	AD8532ARMZ	AD	dOA	f_{BD} = 3 МГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 2.7...6 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
A1A	OP777ARM	AD	OA	V_{DD} = 2.7...30/±1.35...±15 В; I_S = 320 мкА; V_{OSI} < 200 мкВ	MSOP-8	n.c. • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • n.c.
A34	OPA234EA	TI	OA	V_{DD} = 2.7...36/±1.35...±18 В; I_S = 300 мкА; V_{OSI} < ±350 мкВ	MSOP-8	OFF TRIM • –IN • +IN • V– • OFF TRIM • OUT • V+ • n.c.
A4	NLAS323US	ON	asw	2 x SPST; R_{ON} < 55 Ом; V_{DD} = 2.7...6.0 В	US-8	NO1 • COM1 • IN2 • GND • NO2 • COM2 • IN1 • VCC
A40A	OPA2340EA	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 5.5 МГц; I_S = 1.1 мА; V_{OSI} < ±0.5 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
A44	OPA2244EA	TI	dOA	V_{DD} = 2.2...36/±1.1...±18 В; I_S = 70 мкА; V_{OSI} < ±2 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
A5A	AD8529ARU	AD	dOA	f_{BD} = 8 МГц; P_D = 24 мВт; V_{DD} = 2.7...12 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
A7	OPA2337EA	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 3 МГц; I_S = 2 мА; V_{OSI} < ±3.5 мВ	SOT23-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
A8	OPA2338EA	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 12.5 МГц; I_S = 2 мА; V_{OSI} < ±3.5 мВ	SOT23-8	OUT A • –IN A • +IN A • V • +IN B • –IN B • OUT B • V+
AAAA	MAX1792EUA18	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8/1.25...5 В; I_{OUT} = 500 мА	MSOP-8	IN • IN • RST • SHDN • GND • SET • OUT • OUT
AAAA	MAX4451EKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 4.5...11/±2.25...±5.5 В; f_{BD} = 210 МГц; V_{OSI} < 26 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC

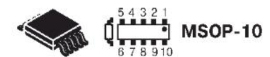
MSOP-10 5 4 3 2 1 / 6 7 8 9 10

US-8 **SOT23-8** **TSOT23-8** **MSOP-8** **SOP-8** 4 3 2 1 / 5 6 7 8

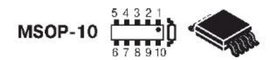


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAAB	MAX1792EUA25	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5...5.5 В; V_{OUT}=2.5/1.25...5 В; I_{OUT}=500 мА	MSOP-8	IN • IN • RST • SHDN • GND • SET • OUT • OUT
AAAB	MAX4453EZA	MAX	dOA	R-R; V_{DD}=2.7...5.25 В; f_{BD}=200 МГц; V_{DSI} < 12 мВ	TSOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAAC	MAX1792EUA33	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5...5.5 В; V_{OUT}=3.3/1.25...5 В; I_{OUT}=500 мА	MSOP-8	IN • IN • RST • SHDN • GND • SET • OUT • OUT
AAAC	MAX5222EKA	MAX	DAC	2 x 8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-8	CS • GND • VDD • SCLK • OUTA • OUTB • REF • DIN
AAAD	MAX1792EUA50	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5...5.5 В; V_{OUT}=5.0/1.25...5 В; I_{OUT}=500 мА	MSOP-8	IN • IN • RST • SHDN • GND • SET • OUT • OUT
AAAD	MAX9077EKA	MAX	cmp x2	R-R; V_{OSI} < ±8 мВ; V_{CC}=2.1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА	SOT23-8	OUTA • GND • INA- • INA+ • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAAE	MAX1792EUA15	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5...5.5 В; V_{OUT}=1.5/1.25...5 В; I_{OUT}=500 мА	MSOP-8	IN • IN • RST • SHDN • GND • SET • OUT • OUT
AAAE	MAX4541EKA	MAX	asw	2 x SPST; R_{ON} < 75 Ом; V_{DD}=2.7...12 В	SOT23-8	NO1 • V+ • IN2 • COM2 • NO2 • GND • IN1 • COM1
AAAF	MAX1792EUA20	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5...5.5 В; V_{OUT}=2.0/1.25...5 В; I_{OUT}=500 мА	MSOP-8	IN • IN • RST • SHDN • GND • SET • OUT • OUT
AAAF	MAX4542EKA	MAX	asw	2 x SPST; R_{ON} < 75 Ом; V_{DD}=2.7...12 В	SOT23-8	NC1 • V+ • IN2 • COM2 • NC2 • GND • IN1 • COM1
AAAG	MAX4543EKA	MAX	asw	2 x SPST; R_{ON} < 75 Ом; V_{DD}=2.7...12 В	SOT23-8	NO1 • V+ • IN2 • COM2 • NC2 • GND • IN1 • COM1
AAAH	MAX6365LKA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAI	MAX6365LKA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAJ	MAX6365LKA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAK	MAX6365LKA29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAL	MAX6365LKA26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAM	MAX6365LKA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAN	MAX6365PKA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAO	MAX6365PKA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAP	MAX6365PKA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAQ	MAX6365PKA29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAR	MAX6365PKA26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAS	MAX6365PKA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAT	MAX6365HKA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAU	MAX6365HKA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAV	MAX6365HKA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAW	MAX6365HKA29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAX	MAX6365HKA26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AAAY	MAX6365HKA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • MR • VCC • OUT • BATT • CE OUT





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAAZ	MAX6366LKA46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABA	MAX6366LKA44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABB	MAX6366LKA31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABC	MAX6366LKA29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABD	MAX6366LKA26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABE	MAX6366LKA23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABF	MAX6366PKA46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABG	MAX6366PKA44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABH	MAX6366PKA31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABI	MAX6366PKA29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABJ	MAX6366PKA26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABK	MAX6366PKA23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABL	MAX6366HKA46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABM	MAX6366HKA44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABN	MAX6366HKA31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABO	MAX6366HKA29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABP	MAX6366HKA26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABQ	MAX6366HKA23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • WDI • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABR	MAX6367LKA46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABS	MAX6367LKA44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABT	MAX6367LKA31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABU	MAX6367LKA29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABV	MAX6367LKA26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABW	MAX6367LKA23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABX	MAX6367PKA46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABY	MAX6367PKA44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AABZ	MAX6367PKA31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACA	MAX6367PKA29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACB	MAX6367PKA26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 50мкА	SOT23-8	$\overline{\text{RESET}}$ • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT



US-8 SOT23-8 TSOT23-8 MSOP-8 SOP-8



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AACC	MAX6367PKA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACD	MAX6367HKA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACE	MAX6367HKA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACF	MAX6367HKA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACG	MAX6367HKA29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACH	MAX6367HKA26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACI	MAX6367HKA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACJ	MAX6368LKA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACK	MAX6368LKA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACL	MAX6368LKA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACM	MAX6368LKA29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACN	MAX6368LKA26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACO	MAX6368LKA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACP	MAX6368PKA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACQ	MAX6368PKA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACR	MAX6368PKA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACS	MAX6368PKA29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACT	MAX6368PKA26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACU	MAX6368PKA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACV	MAX6368HKA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACW	MAX6368HKA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACX	MAX6368HKA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACY	MAX6368HKA29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACZ	MAX6368HKA26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AADA	MAX6368HKA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<50 мкА	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AADB	MAX4491AKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD}=2.7...5.5/±1.35...±2.75 В; f_{BD}=10 МГц; V_{OSI}<16 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AADC	MAX6369KA	MAX	wdt	t_{STUP}=0.001...60 с; V_{DD}=2.5...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADD	MAX6370KA	MAX	wdt	t_{STUP}=0.001...60 с; V_{DD}=2.5...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADE	MAX6371KA	MAX	wdt	t_{STUP}=60 с; V_{DD}=2.5...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC



MSOP-8 SOT23-8 US-8
SOP-8 TSOT23-8



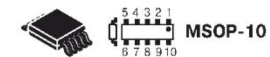
MSOP-10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AADF	MAX6372KA	MAX	wdt	t_{STUP} = 60 с; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADG	MAX6373KA	MAX	wdt	t_{STUP} = 0.0002...60 с; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADH	MAX6374KA	MAX	wdt	t_{STUP} = 0.0002...60 с; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADI	MAX4402AKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 800 кГц; V_{OSI} < 5.5 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AADK	MAX3314KA	MAX	trans	RS-232; V_{CC} = ±4.75...±5.25 В; f_{DR} = 460 Кбит/с; I_{CC} < 100 мкА	SOT23-8	VCC • SHDN • ROUT • TIN • TOUT • RIN • V- • GND
AADL	MAX3314EKA	MAX	trans	RS-232; V_{CC} = ±4.75...±5.25 В; f_{DR} = 460 Кбит/с; I_{CC} < 100 мкА	SOT23-8	VCC • SHDN • ROUT • TIN • TOUT • RIN • V- • GND
AADM	MAX1801EKA	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.7...5.5 В; V_{REF} = 1.25 В; I_{CC} < 300 мкА	SOT23-8	OSC • GND • REF • DCON • COMP • FB • IN • DL
AADN	MAX9110EKA	MAX	LVDS drv	V_{OD} = 350 мВ; V_{CC} = 3...3.6 В; I_{CC} < 8 мА	SOT23-8	DIN • GND • n.c. • VCC • n.c. • n.c. • DO+ • DO-
AADO	MAX9112EKA	MAX	LVDS drv x2	V_{OD} = 350 мВ; V_{CC} = 3...3.6 В; I_{CC} < 13 мА	SOT23-8	DIN1 • GND • DIN2 • VCC • DO2- • DO2+ • DO1+ • DO1-
AADR	MAX4413EKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 500 МГц; V_{OSI} < 9 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AADS	MAX4453EKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.25 В; f_{BD} = 200 МГц; V_{OSI} < 12 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AADT	MAX4353EKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.25 В; f_{BD} = 80 МГц; V_{OSI} < 12 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AADU	MAX1115EKA	MAX	ADC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...3.6 В	SOT23-8	VDD • CH0 • i.c. • GND • i.c. • CONVST • DOUT • SCLK
AADV	MAX1116EKA	MAX	ADC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 4.5...5.5 В	SOT23-8	VDD • CH0 • i.c. • GND • i.c. • CONVST • DOUT • SCLK
AADW	MAX1117EKA	MAX	ADC	2x8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...3.6 В	SOT23-8	VDD • CH0 • CH1 • GND • (REF) i.c. • CNVST • DOUT • SCLK
AADX	MAX1118EKA	MAX	ADC	2x8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-8	VDD • CH0 • CH1 • GND • (REF) i.c. • CNVST • DOUT • SCLK
AADY	MAX1119EKA	MAX	ADC	2x8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 4.5...5.5 В	SOT23-8	VDD • CH0 • CH1 • GND • (REF) i.c. • CNVST • DOUT • SCLK
AADZ	MAX989EKA	MAX	cmp x2	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 48 мкА	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAEA	MAX990EKA	MAX	cmp x2	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 48 мкА	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAEB	MAX991EKA	MAX	cmp x2	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 190 мкА	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAEC	MAX992EKA	MAX	cmp x2	R-R; V_{OSI} < ±7 мВ; V_{CC} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 190 мкА	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAED	MAX9113EKA	MAX	LVDS drv x2	V_{OH} > 2.7 В; V_{OL} < 0.4 В; V_{CC} = 3...3.6 В; I_{CC} < 11 мА	SOT23-8	VCC • GND • OUT1 • OUT2 • IN2- • IN2+ • IN1+ • IN1-
AAEE	MAX9111EKA	MAX	LVDS drv	V_{OH} > 2.7 В; V_{OL} < 0.4 В; V_{CC} = 3...3.6 В; I_{CC} < 6 мА	SOT23-8	VCC • GND • OUT • n.c. • n.c. • n.c. • IN+ • IN1-
AAEF	MAX9032AKA	MAX	cmp x2	R-R; V_{OSI} < ±5 мВ; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{DD} < 110 мкА	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AAEG	MAX9022AKA	MAX	cmp x2	R-R; V_{OSI} < ±8 мВ; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{DD} < 10 мкА	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AAEI	MAX4564EKA	MAX	asw	SPDT; R_{ON} < 100 Ом; V_{DD} = 1.8...12/±1.8...±6 В	SOT23-8	NC • V+ • IN • NO • GND • V- • EN • COM
AAEJ	MAX4482AKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; I_{CC} < 100 мкА; V_{OSI} < 5.5 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AAEK	MAX4471EKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5 В; f_{BD} = 9 кГц; I_{CC} < 1.2 мкА; V_{OSI} < 7 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAEL	MAX4474EKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5 В; f_{BD} = 40 кГц; I_{CC} < 1.2 мкА; V_{OSI} < 7 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VCC



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAEM	MAX4494AKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD}=±2.25...±5.5 В; f_{BD}=5 МГц; V_{OSI} < 10 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AAEN	MAX5400EKA	MAX	Dpot	256 позиций; 50 кОм; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-8	L • GND • CS • DIN • SCLK • VDD • W • H
AAEO	MAX5401EKA	MAX	Dpot	256 позиций; 100 кОм; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-8	L • GND • CS • DIN • SCLK • VDD • W • H
AAEP	MAX4486AKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD}=2.7...5.5 В; f_{BD}=7 МГц; V_{OSI} < 9 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AAEQ	MAX6627MKA	MAX	dts	12-разр.+знак; T_{AMB}=-55...125°C; SPI; V_{DD}=3...5.5 В; I_{CC}=30 мкА	SOT23-8	GND • DXN • DXP • VCC • SCK • CS • SO • n.c.
AAER	MAX6628MKA	MAX	dts	12-разр.+знак; T_{AMB}=-55...125°C; SPI; V_{DD}=3...5.5 В; I_{CC}=200 мкА	SOT23-8	GND • DXN • DXP • VCC • SCK • CS • SO • n.c.
AAES	MAX5223EKA	MAX	DAC	2x8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-8	CS • GND • VDD • SCLK • OUTA • OUTB • REF • DIN
AAEU	MAX9203EKA	MAX	cmp	V_{OSI} < 7.5 мВ; V_{CC}=4.75...10.5 В; V_{DD}=4.75...5.25 В	SOT23-8	VDD • OUT • GND • LATCH • VEE • IN- • IN+ • VCC
AAEV	MAX1087EKA	MAX	ADC	2x10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...3.6 В	SOT23-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAEW	MAX1287EKA	MAX	ADC	2x12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...3.6 В	SOT23-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAEX	MAX1089EKA	MAX	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...3.6 В	SOT23-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAEY	MAX1289EKA	MAX	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...3.6 В	SOT23-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAEZ	MAX1086EKA	MAX	ADC	2x10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=4.5...5.5 В	SOT23-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAFA	MAX1286EKA	MAX	ADC	2x12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=4.5...5.5 В	SOT23-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAFB	MAX1088EKA	MAX	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=4.5...5.5 В	SOT23-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAFC	MAX1288EKA	MAX	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=4.5...5.5 В	SOT23-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAFD	MAX9141EKA	MAX	cmp	V_{OSI} < 4.5 мВ; V_{CC}=2.7...5.5 В; I_{CC} < 300 мкА	SOT23-8	VCC • IN+ • IN- • GND • LE • SHDN • OUT • n.c.
AAFE	MAX9142EKA	MAX	cmp x2	V_{OSI} < 4.5 мВ; V_{CC}=2.7...5.5 В; I_{CC} < 300 мкА	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • GND • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAFF	MAX6705LKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • $\overline{RESET}$ • WDO
AAFG	MAX6705MKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • $\overline{RESET}$ • WDO
AAFH	MAX6705RKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • $\overline{RESET}$ • WDO
AAFI	MAX6705SKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • $\overline{RESET}$ • WDO
AAFJ	MAX6705TKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • $\overline{RESET}$ • WDO
AAFK	MAX6705YKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.19 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • $\overline{RESET}$ • WDO
AAFL	MAX6705ZKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • $\overline{RESET}$ • WDO
AAFM	MAX6706LKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • RESET • WDO
AAFN	MAX6706MKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • RESET • WDO
AAFO	MAX6706RKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • RESET • WDO
AAFP	MAX6706SKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • RESET • WDO
AAFQ	MAX6706TKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	$\overline{MR}$ • VCC • GND • PFI • $\overline{PFO}$ • WDI • RESET • WDO





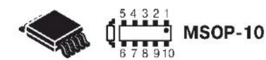
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAFR	MAX6706YKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.19В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFS	MAX6706ZKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFU	MAX6707MKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFV	MAX6707RKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFW	MAX6707SKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFX	MAX6707TKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFY	MAX6707YKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.19В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFZ	MAX6707ZKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAGA	MAX6708LKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • n.c. • RESET • RESET
AAGB	MAX6708MKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • n.c. • RESET • RESET
AAGC	MAX6708RKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • n.c. • RESET • RESET
AAGD	MAX6708SKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • n.c. • RESET • RESET
AAGE	MAX6708TKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • n.c. • RESET • RESET
AAGF	MAX6708YKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.19В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • n.c. • RESET • RESET
AAGG	MAX6708ZKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • n.c. • RESET • RESET
AAGH	MAX6701LKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGI	MAX6701MKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGJ	MAX6701RKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGK	MAX6701SKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGL	MAX6701TKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGM	MAX6701YKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.19В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGN	MAX6701ZKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGO	MAX6702LKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGP	MAX6702MKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGQ	MAX6702RKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGR	MAX6702SKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGS	MAX6702TKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGT	MAX6702YKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.19В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGU	MAX6702ZKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO

MSOP-10 **US-8** **SOT23-8** **TSOT23-8** **MSOP-8** **SOP-8**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAGV	MAX6703LKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGW	MAX6703MKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGX	MAX6703RKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGY	MAX6703SKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGZ	MAX6703TKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAHA	MAX6703YKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.19 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAHB	MAX6703ZKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAHC	MAX6704LKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHD	MAX6704MKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHE	MAX6704RKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHF	MAX6704SKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHG	MAX6704TKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHG	MAX9052AEUA	MAX	cmp x2 + vref	R-R; V_{OSI}<±7 мВ; V_{CC}=2.7...5.5 В; V_{REF}=2.500 В; I_{CC}<72 мкА	MSOP-8	OUTA • REF • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAHH	MAX6704YKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.19 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHI	MAX6704ZKA	MAX	mrc + wdt	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<20 мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHI	MAX9052BEUA	MAX	cmp x2 + vref	R-R; V_{OSI}<±7 мВ; V_{CC}=2.7...5.5 В; V_{REF}=2.500 В; I_{CC}<72 мкА	MSOP-8	OUTA • REF • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAHJ	MAX6391KA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHK	MAX6391KA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHL	MAX6391KA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHM	MAX6391KA29	MAX	mrc	V_{TR}=2.93 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHN	MAX6391KA26	MAX	mrc	V_{TR}=2.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHO	MAX6391KA23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHP	MAX6391KA22	MAX	mrc	V_{TR}=2.19 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHQ	MAX6391KA17	MAX	mrc	V_{TR}=1.67 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHR	MAX6391KA16	MAX	mrc	V_{TR}=1.58 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHS	MAX6392KA46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHT	MAX6392KA44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHU	MAX6392KA31	MAX	mrc	V_{TR}=3.08 В; V_{DD}=1.2...5.5 В; I_{CC}<25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR



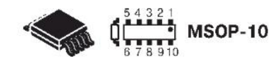


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAHV	MAX6392KA29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHW	MAX6392KA26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHX	MAX6392KA23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHY	MAX6392KA22	MAX	mrc	V_{TR} = 2.19 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHZ	MAX6392KA17	MAX	mrc	V_{TR} = 1.67 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAIA	MAX6392KA16	MAX	mrc	V_{TR} = 1.58 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 25 мкА	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAIB	MAX9107EKA	MAX	cmp x2	V_{OSI} < 4 мВ; V_{CC} = 4.5...5.5 В; I_{CC} < 1.4 мА	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • GND • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAIC	MAX4351EKA	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = ±4.5...±5.5 В; f_{BD} = 210 МГц; V_{OSI} < 26 мВ	SOT23-8	OUTA • INA- • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAID	MAX5407EKA	MAX	Dpot	32 позиции; логарифм.; 20 кОм; V_{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-8	H • GND • W • L • U/D • CS • VDD • ZCEN
AAIE	MAX4649EKA	MAX	asw	SPDT; R_{ON} < 60 Ом; V_{DD} = 9...36/±4.5...±20 В	SOT23-8	COM • NC • GND • V+ • n.c. • IN • V- • NO
ABA	AD8602ARM	AD	dOA	f_{BD} = 8 МГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
ABD	AD8602DRM	AD	dOA	f_{BD} = 8 МГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
AFA	AD8527ARM	AD	dOA	f_{BD} = 7 МГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 1.8...6 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
AGA	AD8632ARM	AD	dOA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 6 мВт; V_{DD} = 1.8...6 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
AHA	AD8551ARM	AD	OA	f_{BD} = 1.5 МГц; P_D = 5 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	n.c. • –IN A • +IN A • V– • n.c. • OUT A • V+ • n.c.
AJA	AD8571ARM	AD	OA	f_{BD} = 1.5 МГц; P_D = 5 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	n.c. • –IN A • +IN A • V– • n.c. • OUT A • V+ • n.c.
AK	SSM2250RM	AD	amp	V_{CC} = 2.7...6 В; I_{CC} = 6.4 мА; P_{OUT} = 1.5 Вт (моно)/0.25 Вт (стерео); f_{BD} = 4 МГц	MSOP-10	L IN • SHTDN • SE/BTL • GND • R IN • R OUT • BPS • BTL+ • VDD • L OUT/BTL–
AK#	SSM2250RMZ	AD	amp	V_{CC} = 2.7...6 В; I_{CC} = 6.4 мА; P_{OUT} = 1.5 Вт (моно)/0.25 Вт (стерео); f_{BD} = 4 МГц	MSOP-10	L IN • SHTDN • SE/BTL • GND • R IN • R OUT • BPS • BTL+ • VDD • L OUT/BTL–
AKG	TLV2632IDGK	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 9 МГц; V_{OSI} < 4.5 мВ	MSOP-8	OUT1 • IN1 • IN1+ • GND • IN2+ • IN2 • OUT2 • VDD
AKK	TLV2633IDGS	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 9 МГц; V_{OSI} < 4.5 мВ	MSOP-10	OUT1 • IN1 • IN1+ • GND • SHDN1 • SHDN2 • IN2+ • IN2 • OUT2 • VDD
AND	OP162DRM	AD	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...12 В; f_{BD} = 15 МГц; I_S = 850 мкА; V_{OSI} < 325 мкВ	MSOP-8	NULL • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • NULL
AOB	THS4130CDGN	TI	DA	V_{DD} = 5...30/2.5...±15 В; f_{BD} = 150 МГц; V_{OSI} < 3 мВ	MSOPPowerPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
AOC	THS4130IDGN	TI	DA	V_{DD} = 5...30/2.5...±15 В; f_{BD} = 150 МГц; V_{OSI} < 3 мВ	MSOPPowerPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
AOD	THS4131CDGN	TI	DA	V_{DD} = 5...30/2.5...±15 В; f_{BD} = 150 МГц; V_{OSI} < 3 мВ	MSOPPowerPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
AOE	THS4131IDGN	TI	DA	V_{DD} = 5...30/2.5...±15 В; f_{BD} = 150 МГц; V_{OSI} < 3 мВ	MSOPPowerPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
AOF	THS4140CDGN	TI	DA	V_{DD} = 5...30/2.5...±15 В; f_{BD} = 160 МГц; V_{OSI} < 8.5 мВ	MSOPPowerPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
AOG	THS4140IDGN	TI	DA	V_{DD} = 5...30/2.5...±15 В; f_{BD} = 160 МГц; V_{OSI} < 8.5 мВ	MSOPPowerPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
AOI	THS4141CDGN	TI	DA	V_{DD} = 5...30/2.5...±15 В; f_{BD} = 160 МГц; V_{OSI} < 8.5 мВ	MSOPPowerPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
AOJ	OP162DRMZ	AD	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...12 В; f_{BD} = 15 МГц; I_S = 850 мкА; V_{OSI} < 325 мкВ	MSOP-8	NULL • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • NULL

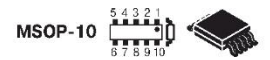
MSOP-10 5 4 3 2 1 / 6 7 8 9 10 **US-8** **SOT23-8** **TSOT23-8** **MSOP-8** **SOP-8** 4 3 2 1 / 5 6 7 8 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AOK	THS4141IDGN	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=160 МГц; V_{OSI} < 8.5 мВ	MSOPPowerPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
AQA	AD8592ARM	AD	dOA	f_{BD}=2.2 МГц; P_D=14 мВт; V_{DD}=2.5...6 В	MSOP-10	OUT A • –IN A • +IN A • V– • SDA • SDB • +IN B • –IN B • OUT B • V+
ARA	AD8532ARM	AD	dOA	f_{BD}=3 МГц; P_D=12 мВт; V_{DD}=2.7...6 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
ASO	THS4130IDGK	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=150 МГц; V_{OSI} < 3 мВ	MSOP-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
ASP	THS4131IDGK	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=150 МГц; V_{OSI} < 3 мВ	MSOP-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
ASQ	THS4140IDGK	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=160 МГц; V_{OSI} < 8.5 мВ	MSOP-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
ASR	THS4141IDGK	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=160 МГц; V_{OSI} < 8.5 мВ	MSOP-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
ATA	AD8566ARM	AD	dOA	f_{BD}=5 МГц; P_D=24 мВт; V_{DD}=4.5...16 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
ATA#	AD8566ARMZ	AD	dOA	f_{BD}=5 МГц; P_D=24 мВт; V_{DD}=4.5...16 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
ATP	THS4130CDGK	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=150 МГц; V_{OSI} < 3 мВ	MSOP-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
ATQ	THS4131CDGK	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=150 МГц; V_{OSI} < 3 мВ	MSOP-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
ATR	THS4140CDGK	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=160 МГц; V_{OSI} < 8.5 мВ	MSOP-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
ATS	THS4141CDGK	TI	DA	V_{DD}=5...30/2.5...±15 В; f_{BD}=160 МГц; V_{OSI} < 8.5 мВ	MSOP-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
AVA	AD8542ARM	AD	dOA	f_{BD}=1 МГц; P_D=0.6 мВт; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
AZA	OP1177ARM	AD	OA	V_{DD}=±2.5...±15 В; I_S=600 мкА; V_{OSI} < 60 мкВ	MSOP-8	n.c. • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • n.c.
B03	OPA2703EA	TI	dOA	R-R; V_{DD}=4...12/±2...±6 В; f_{BD}=1 МГц; I_S=300 мкА; V_{OSI} < ±0.75 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B04	OPA2704EA	TI	dOA	R-R; V_{DD}=4...12/±2...±6 В; f_{BD}=3 МГц; I_S=300 мкА; V_{OSI} < ±0.75 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B05	OPA2705EA	TI	dOA	R-R; V_{DD}=4...12/±2...±6 В; f_{BD}=1 МГц; I_S=250 мкА; V_{OSI} < ±5 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B0A	AD8610ARM	AD	OA	f_{BD}=25 МГц; P_D=40 мВт; V_{DD}=±5...±13 В	MSOP-8	NULL • –IN • +IN • V– • NULL • OUT • V+ • n.c.
B10	AD5220BRM-10	AD	Dpot	128 позиций; 10 кОм	MSOP-8	CLK • U/D • A1 • GND • W1 • B1 • CS • VDD
B100	AD5220BRM-100	AD	Dpot	128 позиций; 100 кОм	MSOP-8	CLK • U/D • A1 • GND • W1 • B1 • CS • VDD
B26	INA326	BB/TI	IA	R-R; V_{OSI}=100 мкВ; V_{DD}=2.7...5 В	MSOP-8	R1 • VIN • VIN+ • V • R2 • VO • V+ • R1
B27	INA327	BB/TI	IA	R-R; V_{OSI}=100 мкВ; V_{DD}=2.7...5 В; блокировка	MSOP-10	R1 • VIN • VIN+ • V • V+ • ENBL • R2 • VO • V+ • R1
B2A	OP2177ARM	AD	dOA	V_{DD}=±2.5...±15 В; I_S=1.2 мА; V_{OSI} < 60 мкВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B36	OPA2336EA	TI	dOA	R-R; V_{DD}=2.3...5.5 В; I_S=85 мкА; V_{OSI} < ±125 мкВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B47	OPA2347EA	TI	dOA	R-R; V_{DD}=2.3...5.5 В; f_{BD}=350 кГц; I_S=80 мкА; V_{OSI} < 7 мВ	SOT23-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B48	OPA2348AI	TI	dOA	R-R; V_{DD}=2.1...5.5 В; f_{BD}=1 МГц; I_S=150 мкА; V_{OSI} < 6 мВ	SOT23-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B4A	AD822ARM	AD	dOA	f_{UG}=1.8 МГц; P_D=50 мВт; V_{DD}=3...36/±1.5...±18 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • V– • +IN2 • –IN2 • OUT2 • V+
B50	AD5220BRM-50	AD	Dpot	128 позиций; 50 кОм	MSOP-8	CLK • U/D • A1 • GND • W1 • B1 • CS • VDD
B6A	AD8606ARM	AD	dOA	f_{BD}=10 МГц; P_D=14 мВт; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B6A#	AD8606ARMZ	AD	dOA	f_{BD}=10 МГц; P_D=14 мВт; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
B7A	AD8510ARM	AD	OA	f_{BD}=8 МГц; P_D=70 мВт; V_{DD}=±5...±15 В	MSOP-8	n.c. • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • n.c.





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
B8A	AD8512ARM	AD	dOA	f_{BD} = 8 МГц; P_D = 70 мВт; V_{DD} = ±5...±15 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
BHK	OPA2363AI	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5 В; f_{BD} = 7 МГц; I_S = 1.4 мА; V_{OSI} < 0.9 мВ	MSOP-10	OUT A • –IN A • +IN A • V– • ENBL A • ENBL B • +IN B • –IN B • OUT B • V+
BHL	OPA2364AI	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5 В; f_{BD} = 7 МГц; I_S = 1.4 мА; V_{OSI} < 0.9 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
BJA	AD8626ARM	AD	dOA	f_{BD} = 5 МГц; P_D = 50 мВт; V_{DD} = 5...26/±2.5...±13 В	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
C1Y	AD7810YRM	AD	ADC	10-разр.; послед. интерфейс; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	CONVST • VIN+ • VIN– • GND • VREF • DOUT • SCLK • VDD
C2T	AD7466BRMZ	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
C2Y	AD7823YRM	AD	ADC	8-разр.; I^2C; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	CONVST • VIN+ • VIN– • GND • VREF • DOUT • SCLK • VDD
C3A	AD7818ARM	AD	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	CONVST • OTI • GND • VIN • VDD • DIN/OUT • SCLK • RD/WR
C3B	AD7495ARMZ	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.25 В	MSOP-8	REF OUT • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
C3C	AD7475BRMZ	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.25 В	MSOP-8	REF IN • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
C43	OPA2343EA	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 5.5 МГц; I_S = 2.7 мА; V_{OSI} < ±8 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
C4A	AD7816ARM	AD	dts	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	CONVST • OTI • GND • REFIN • VDD • DIN/OUT • SCLK • RD/WR
C50	OPA350EA	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 38 МГц; I_S = 8.5 мА; V_{OSI} < ±1 мВ	MSOP-8	n.c. • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • n.c.
C5A	AD7887ARM	AD	ADC	2x12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.25 В	MSOP-8	CS • VDD • GND • AIN1/VREF • AIN0 • DIN • DOUT • SCLK
C6A	AD7416ARM	AD	dts	10-разр.; I^2C; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	SDA • SCL • OTI • GND • A2 • A1 • A0 • VDD
C7A	AD7418ARM	AD	ADC	10-разр.; I^2C; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	SDA • SCL • OTI • GND • AIN • REFIN • VDD • CONVST
C9A	AD7475ARM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.25 В	MSOP-8	REF IN • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
C9B	AD7475BRM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.25 В	MSOP-8	REF IN • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
CAA	AD7814ARM	AD	dts	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	n.c. • DOUT • CS • SCLK • VDD • DIN • GND • n.c.
CCA	AD7495ARM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.25 В	MSOP-8	REF OUT • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
CCB	AD7495BRM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.25 В	MSOP-8	REF OUT • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
CEW	AD7476AYRM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CEY	AD7476ABRM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CFZ	AD7477AARM	AD	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CHA	AD7414ARM	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	n.c. • SDA • ALERT • SCL • VDD • GND • AS • NC
CHB	AD7414ARM	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	n.c. • SDA • ALERT • SCL • VDD • GND • AS • NC
CJZ	AD7478AARM	AD	ADC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 2.35...5.25 В	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CKA	AD7314ARM	AD	dts	10-разр.; SPI; V_{DD} = 2.65...5.5 В	MSOP-8	n.c. • CE • SCLK • GND • SDO • SDI • ID • VDD
CLB	AD7466BRM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
CMB	AD7467BRM	AD	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD} = 1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD

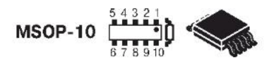
MSOP-10  **US-8 SOT23-8 TSOT23-8 MSOP-8 SOP-8** 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
CNA	AD7466ARM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
CNB	AD7468BRM	AD	ADC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
CNU	AD7468BRMZ	AD	ADC	8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
CPA	AD7450ARM	AD	ADC	12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-8	VREF • VIN+ • VIN– • GND • CS • SDATA • SCLK • VDD
CPB	AD7450BRM	AD	ADC	12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-8	VREF • VIN+ • VIN– • GND • CS • SDATA • SCLK • VDD
CQA	AD7680ARM	AD	ADC	16-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-8	VDD • GND • GND • VIN • SCLK • n.c. • SDATA • CS
CQB	AD7680BRM	AD	ADC	16-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-8	VDD • GND • GND • VIN • SCLK • n.c. • SDATA • CS
CUB	AD7920BRM	AD	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.35...5.25 В	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CVA	AD7910ARM	AD	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.35...5.25 В	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
D13E	DAC7513E	TI	DAC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • VREF • VFB • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
D13N	DAC7513N	TI	DAC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В	SOT23-8	VOUT • VFB • VREF • VDD • GND • DIN • SCLK • SYNC
D1B	AD7303BRM	AD	DAC	2x8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	VOUTA • VDD • GND • REF • SCLK • DIN • SYNC • VOUTB
D1P	AD5425YRM	AD	DAC	8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • LDAC • VDD • VREF • RFB
D1Q	AD5426YRM	AD	DAC	8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D1R	AD5432YRM	AD	DAC	10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D1S	AD5443YRM	AD	DAC	12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D22	OPA2822E	TI	dOA	V_{DD}=5...12 В; f_{BD}=100 МГц; I_S=10.4 мА; V_{OSI} < ±1.6 мВ	SOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
D2B	AD5300BRM	AD	DAC	8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • n.c. • n.c. • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
D3B	AD5310BRM	AD	DAC	10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • n.c. • n.c. • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
D4B	AD5320BRM	AD	DAC	12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • n.c. • n.c. • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
D50	OPA2350EA	TI	dOA	R-R; V_{DD}=2.7...5.5 В; f_{BD}=38 МГц; I_S=8.5 мА; V_{OSI} < ±1 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
D55	OPA2355DGSA	TI	dOA	R-R; V_{DD}=2.7...5.5 В; f_{BD}=200 МГц; I_S=14 мА; V_{OSI} < ±15 мВ	MSOP-10	OUT A • –IN A • +IN A • V– • ENBL A • ENBL B • +IN B • –IN B • OUT B • V+
D5A	AD5302ARM	AD	DAC	2x8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D5B	AD5302BRM	AD	DAC	2x8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6A	AD5312ARM	AD	DAC	2x10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6B	AD5312BRM	AD	DAC	2x10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6C	AD5322BRMZ	AD	DAC	2x12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6T	AD5322ARMZ	AD	DAC	2x12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6U	AD5443YRMZ	AD	DAC	12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB





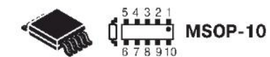
Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
D6V	AD5432YRMZ	AD	DAC	10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D6W	AD5426YRMZ	AD	DAC	8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D7A	AD5322ARM	AD	DAC	2x 12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D7B	AD5322BRM	AD	DAC	2x 12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D8B	AD5301BRM	AD	DAC	8-разр.; I²C; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • A0 • A1 • VOUT • PD • SCL • SDA • GND
D8V	AD5302ARMZ	AD	DAC	2x 8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D8W	AD5302BRMZ	AD	DAC	2x 8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D8X	AD5312ARMZ	AD	DAC	2x 10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D8Y	AD5312BRMZ	AD	DAC	2x 10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D9B	AD5311BRM	AD	DAC	10-разр.; I²C; V_{DD} = 2.7...5.5В	MSOP-8	VDD • A0 • A1 • VOUT • PD • SCL • SDA • GND
D9N	AD5320BRMZ	AD	DAC	12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • n.c. • n.c. • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
DAB	AD5321BRM	AD	DAC	12-разр.; I²C; V_{DD} = 2.7...5.5В	MSOP-8	VDD • A0 • A1 • VOUT • PD • SCL • SDA • GND
DBA	AD5304ARM	AD	DAC	4x 8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DBB	AD5304BRM	AD	DAC	4x 8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DCA	AD5314ARM	AD	DAC	4x 10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DCB	AD5314BRM	AD	DAC	4x 10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DDA	AD5324ARM	AD	DAC	4x 12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DDB	AD5324BRM	AD	DAC	4x 12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DEA	AD5305ARM	AD	DAC	4x 8-разр.; I²C; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DEB	AD5305BRM	AD	DAC	4x 8-разр.; I²C; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DFA	AD5315ARM	AD	DAC	4x 10-разр.; I²C; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DFB	AD5315BRM	AD	DAC	4x 10-разр.; I²C; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DGA	AD5325ARM	AD	DAC	4x 12-разр.; I²C; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DGB	AD5325BRM	AD	DAC	4x 12-разр.; I²C; V_{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DJB	AD9833BRM	AD	gen	f_{OUT} < 12.5 МГц; P_D = 30 мВт; V_{DD} = 2.3...5.5 В	MSOP-10	COMP • VDD • CAP/2.5V • DGND • MCLK • SDATA • SCLK • FSYNC • AGND • VOUT
DLA	AD5200BRM-10	AD	Dpot	256 позиций; 10 кОм; SPI	MSOP-10	B • VSS • GND • CS • SDI • CLK • SHDN • VDD • W • A
DLB	AD5200BRM-50	AD	Dpot	256 позиций; 50 кОм; SPI	MSOP-10	B • VSS • GND • CS • SDI • CLK • SHDN • VDD • W • A
DMA	AD5201BRM-10	AD	Dpot	33 позиции; 10 кОм; SPI	MSOP-10	B • VSS • GND • CS • SDI • CLK • SHDN • VDD • W • A
DMB	AD5201BRM-50	AD	Dpot	33 позиции; 50 кОм; SPI	MSOP-10	B • VSS • GND • CS • SDI • CLK • SHDN • VDD • W • A

MSOP-10 

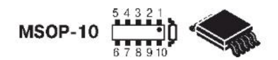
US-8 **SOT23-8 TSOT23-8** **MSOP-8 SOP-8** 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
DSB	AD5399RM	AD	DAC	2 x 12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD} = 4.5...5.5 В	MSOP-10	CLK • SDI • DGND • VOUTB • VOUTA • VBZ • AGND • VDD • VTP • CS
DUC	AD5553CRM	AD	DAC	14-разр.; SPI; V_{DD} = 4.5...5.5 В	MSOP-8	CLK • SDI • RFB • VREF • IOUT • GND • VDD • CS
DXB	AD5543BRM	AD	DAC	16-разр.; SPI; V_{DD} = 4.5...5.5 В	MSOP-8	CLK • SDI • RFB • VREF • IOUT • GND • VDD • CS
DYA	AD5273BRJ1	AD	Dpot	64 позиции; 1 кОм; OTP; I^2C	SOT23-8	W • VDD • GND • SCL • SDA • AD0 • B • A
DYB	AD5273BRJ10	AD	Dpot	64 позиции; 10 кОм; OTP; I^2C	SOT23-8	W • VDD • GND • SCL • SDA • AD0 • B • A
DYC	AD5273BRJ50	AD	Dpot	64 позиции; 50 кОм; OTP; I^2C	SOT23-8	W • VDD • GND • SCL • SDA • AD0 • B • A
DYD	AD5273BRJ100	AD	Dpot	64 позиции; 100 кОм; OTP; I^2C	SOT23-8	W • VDD • GND • SCL • SDA • AD0 • B • A
E37	OPA2137EA	TI	dOA	V_{DD} = 4.5...36/±2.25...±18 В; I_S = 600 мкА; V_{OSI} < ±7 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
E43	OPA2743EA	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 3.5...12/±1.75...±6 В; f_{BD} = 7 МГц; I_S = 1.7 мА; V_{OSI} < ±7 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
E53	OPA2353EA	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 2.7...5.5 В; f_{BD} = 44 МГц; I_S = 9 мА; V_{OSI} < ±10 мВ	MSOP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
G1A	AD8611ARM	AD	cmp	f_{IN} = 100 МГц; P_D = 14 мВт; V_{DD} = 3...5 В	MSOP-8	V+ • +IN • –IN • V– • LATCH • GND • OUT • OUT
G37	OPA337EA	TI	OA	R-R; V_{DD} = 2.5...5.5 В; f_{BD} = 3 МГц; I_S = 1.2 мА; V_{OSI} < ±3.5 мВ	MSOP-8	n.c. • –IN • +IN • V– • n.c. • OUT • V+ • n.c.
H1B	AD8066ARM	AD	dOA	f_{BD} = 145 МГц; P_D = 150 мВт; V_{DD} = 5...24 В	MSOP-8	VOUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • VOUT2 • +VS
H2B	AD8008ARM	AD	dOA	f_{BD} = 650 МГц; P_D = 120 мВт; V_{DD} = 5...12 В	MSOP-8	VOUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • VOUT2 • +VS
H4A	AD8052ARM	AD	dOA	f_{BD} = 110 МГц; P_D = 60 мВт; V_{DD} = 3...12В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
H5A	AD8056ARM	AD	dOA	f_{BD} = 300 МГц; P_D = 40 мВт; V_{DD} = ±4...±6 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
H5B	AD8028ARM	AD	dOA	f_{BD} = 185 МГц; P_D = 100 мВт; V_{DD} = 2.7...12В	MSOP-10	VOUTA • –IN A • –IN A • –VS • DIS/SEL A • DIS/SEL B • +IN B • –IN B • VOUTB • +VS
H5B#	AD8028ARMZ	AD	dOA	f_{BD} = 185 МГц; P_D = 100 мВт; V_{DD} = 2.7...12В	MSOP-10	VOUTA • –IN A • –IN A • –VS • DIS/SEL A • DIS/SEL B • +IN B • –IN B • VOUTB • +VS
H6A	AD8012ARM	AD	dOA	f_{BD} = 350 МГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = ±1.5...±6 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
H7B	AD8030ARJ	AD	dOA	f_{BD} = 120 МГц; P_D = 18 мВт; V_{DD} = 2.7...12В	SOT23-8	VOUT 1 • –IN 1 • +IN 1 • –VS • +IN 2 • -IN 2 • +VOUT 2 • +VS
H7C	AD8066ARMZ	AD	dOA	f_{BD} = 145 МГц; P_D = 150 мВт; V_{DD} = 5...24 В	MSOP-8	VOUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • VOUT2 • +VS
H8A	AD8058ARM	AD	dOA	f_{BD} = 325 МГц; P_D = 70 мВт; V_{DD} = 3...12В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
H9A	AD8032ARM	AD	dOA	f_{BD} = 80 МГц; P_D = 16 мВт; V_{DD} = 2.7...12 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
HCA	AD8062ARM	AD	dOA	f_{BD} = 320 МГц; P_D = 75 мВт; V_{DD} = 2.7...8 В	MSOP-8	VOUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • VOUT2 • +VS
HDA	AD8022ARM	AD	dOA	f_{BD} = 130 МГц; P_D = 55 мВт; V_{DD} = ±4.5...±13 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
HDB	AD8022ARMZ	AD	dOA	f_{BD} = 130 МГц; P_D = 55 мВт; V_{DD} = ±4.5...±13 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
HFA	AD8002ARM	AD	dOA	f_{BD} = 600 МГц; P_D = 55 мВт; V_{DD} = ±3...±6 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
HKJ	AD8009ARM	AD	OA	f_{BD} = 1 ГГц; P_D = 100 мВт; V_{DD} = ±4...±6 В	SOT23-8	n.c. • –IN • +IN • –VS • n.c. • OUT • +VS • n.c.
HLA	AD8072JR	AD	dOA	f_{BD} = 100 МГц; P_D = 30 мВт; V_{DD} = ±2.5...±6 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT2 • +VS
HMA	AD8132ARM	AD	OA	f_{BD} = 350 МГц, P_D = 70 мВт, V_{DD} = ±1.35...±5.5 В	MSOP-8	–IN • VOCM • V+ • +OUT • –OUT • V– • n.c. • +IN
HMA#	AD8132ARMZ	AD	OA	f_{BD} = 350 МГц; P_D = 70 мВт; V_{DD} = ±1.35...±5.5 В	MSOP-8	–IN • VOCM • V+ • +OUT • –OUT • V– • n.c. • +IN





Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
HNA	AD8021ARM	AD	OA	f_{BD} = 490 МГц; P_D = 100 мВт; V_{DD} = ±2.25...±12 В	MSOP-8	LOG REF • –IN • +IN • –VS • CCOMP • VOUT • +VS • DIS
HNA	AD8021ARMZ	AD	OA	f_{BD} = 490 МГц; P_D = 100 мВт; V_{DD} = ±2.25...±12 В	MSOP-8	LOG REF • –IN • +IN • –VS • CCOMP • VOUT • +VS • DIS
HWA	AD8092ARM	AD	dOA	f_{BD} = 110 МГц; P_D = 60 мВт; V_{DD} = 3...12 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT • +VS
HWA#	AD8092ARMZ	AD	dOA	f_{BD} = 110 МГц; P_D = 60 мВт; V_{DD} = 3...12 В	MSOP-8	OUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • OUT • +VS
HYA	AD8039ART	AD	dOA	f_{BD} = 350 МГц; P_D = 18 мВт; V_{DD} = 3...12 В	SOT23-8	VOUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • VOUT2 • +VS
HZA	AD8034ART	AD	dOA	f_{BD} = 80 МГц; P_D = 65 мВт; V_{DD} = 5...24 В	SOT23-8	VOUT1 • –IN1 • +IN1 • –VS • +IN2 • –IN2 • VOUT2 • +VS
J0A	AD623ARM	AD	IA	V_{DD} = 3...12 В; Gain = 1...1000; V_{OSI} < 500 мкВ	MSOP-8	–RG • –IN • +IN • –VS • REF • OUTPUT • +VS • +RG
J1A	AD8313ARM	AD	LA	f_{BD} = 0.1...2.5 ГГц; DD = 70 дБ; P_D = 60 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VPOS • INHI • INLO • VPOS • PWDN • COMM • VSET • VOUT
J2N	AD8350ARM15	AD	DA	f_{BD} = 1.1 ГГц; Gain = 15 дБ; P_D = 330 мВт; V_{DD} = 4...11 В	MSOP-8	IN+ • ENBL • VCC • OUT+ • OUT– • GND • GND • IN–
J2P	AD8350ARM20	AD	DA	f_{BD} = 1.1 ГГц; Gain = 20 дБ; P_D = 330 мВт; V_{DD} = 4...11 В	MSOP-8	IN+ • ENBL • VCC • OUT+ • OUT– • GND • GND • IN–
J3A	AD8361ARM	AD	PD	f_{BD} < 2.5 ГГц; P_D = 12 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VPOS • IREF • RFIN • PWDN • COMM • FLTR • VRMS • SREF
J5A	AD8314ARM	AD	LA	f_{BD} = 0.1...2.7 ГГц; P_D = 30 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	RFIN • ENBL • VSET • FLTR • COMM • V UP • V DN • VPOS
J6A	AD8310ARM	AD	LA	f_{BD} < 440 МГц; DD = 95 дБ; P_D = 50 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	INLO • COMM • OFLT • VOUT • VPOS • BFIN • ENBL • INHI
J7A	AD8315ARM	AD	LA	f_{BD} = 0.1...2.5 ГГц; P_D = 60 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	RFIN • ENBL • VSET • FLTR • COMM • n.c. • VAPC • VPOS
J8A	AD8316ARM	AD	LA	f_{BD} = 0.1...2.5 ГГц; P_D = 60 мВт; V_{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-10	RFIN • ENBL • VSET • FLTR • BSEL • FLT2 • OUT2 • COMM • OUT1 • VPOS
L0C	ADR420ARMZ	AD	vref	XFET®; V_{IN} = 4...18 В; I_{OUT} = 10 мА; V_{OUT} = 2.048 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
L7	NLAS324US	ON	asw	2 x SPST; R_{ON} < 55 Ом; V_{DD} = 2.7...6.0 В	US-8	NC1 • COM1 • IN2 • GND • NC2 • COM2 • IN1 • VCC
L7	NLAS325US	ON	asw	2 x SPST; R_{ON} < 105 Ом; V_{DD} = 2.7...6.0 В	US-8	NO1 • COM1 • IN2 • GND • NC2 • COM2 • IN1 • VCC
LFA	ADP3335ARM-1.8	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 500 мА; V_{OUT} = 1.8 В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LFC	ADP3335ARM-2.5	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 500 мА; V_{OUT} = 2.5 В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LFD	ADP3335ARM-2.85	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 500 мА; V_{OUT} = 2.85 В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LFE	ADP3335ARM-3.3	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 500 мА; V_{OUT} = 3.3 В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LFF	ADP3335ARM-5	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 500 мА; V_{OUT} = 5 В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LHA	ADP3336ARM	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 500 мА; V_{OUT} = 1.5...10 В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • FB • SD • IN • IN
LKA	ADP3333ARM-1.5	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 300 мА; V_{OUT} = 1.5 В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKB	ADP3333ARM-1.8	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 300 мА; V_{OUT} = 1.8 В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKC	ADP3333ARM-2.5	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 300 мА; V_{OUT} = 2.5 В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKD	ADP3333ARM-2.77	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 300 мА; V_{OUT} = 2.77 В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKE	ADP3333ARM-3	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 300 мА; V_{OUT} = 3 В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKF	ADP3333ARM-3.15	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 300 мА; V_{OUT} = 3.15 В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKG	ADP3333ARM-3.3	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12 В; I_{OUT} = 300 мА; V_{OUT} = 3.3 В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.

MSOP-10 

US-8 SOT23-8 TSOT23-8 MSOP-8 SOP-8 

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
LKH	ADP3333ARM-5	AD	reg	LDO; V_{IN}=2.6...12 В; I_{OUT}=300 мА; V_{OUT}=5 В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LTQZ	LT1009CMS8	LT	vref	V_{OUT}=2.5 В; ACC < 0.2%; T_{AMB}=0...70 °C	MSOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • (–) • ADJ • (+) • n.c. • (+)
M01	ADM101EARM	AD	trans	RS-232; 460 кбит/с; V_{DD}=4.5...5.5 В	MSOP-10	GND • C1– • V– • TIN • ROUT • RIN • TOUT • SD • C1+ • VCC
M2B	ADM1232ARM	AD	mrc	V_{TR}=4.62 В (5%)/4.37 В (10%); V_{DD}=4.5...5.5 В; I_{CC} < 0.5 мА	MSOP-8	PB RES • TD • TOL • GND • RES • RES • STR • VCC
P0A	ADP3088ARM	AD	reg	V_{IN}=2.5...11 В; I_{OUT}=750 мА; f_{OSC}=1 МГц; V_{OUT}=1.25...10.5 В	MSOP-8	IN • IN • GND • COMP • FB • GND • DRV • SW
P1E	ADP3415LRM	AD	drv	R_{OUT} < 3 Ом; V_{CC}=5 В; I_{CC} < 2 мА	MSOP-10	IN • SD • DRVLSD • DLY • VCC • DRVL • GND • SW • DRVH • BST
R06	ADR421ARMZ	AD	vref	XFET®; V_{IN}=4.5...18 В; I_{OUT}=10 мА; V_{OUT}=2.5 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
R0U	ADR423ARMZ	AD	vref	XFET®; V_{IN}=5...18 В; I_{OUT}=10 мА; V_{OUT}=3 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
R0V	ADR425ARMZ	AD	vref	XFET®; V_{IN}=7...18 В; I_{OUT}=10 мА; V_{OUT}=5 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
R4A	ADR420ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=4...18 В; I_{OUT}=10 мА; V_{OUT}=2.048 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
R5A	ADR421ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=4.5...18 В; I_{OUT}=10 мА; V_{OUT}=2.5 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
R6A	ADR423ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=5...18 В; I_{OUT}=10 мА; V_{OUT}=3 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
R7A	ADR425ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=7...18 В; I_{OUT}=10 мА; V_{OUT}=5 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
RHA	ADR430ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=4.1...18 В; I_{OUT}=+30/–20 мА; V_{OUT}=2.048 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
RJA	ADR431ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=4.5...18 В; I_{OUT}=+30/–20 мА; V_{OUT}=2.5 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
RKA	ADR433ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=5...18 В; I_{OUT}=+30/–20 мА; V_{OUT}=3 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
RLA	ADR434ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=6.1...18 В; I_{OUT}=+30/–20 мА; V_{OUT}=4.096 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
RMA	ADR435ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=7...18 В; I_{OUT}=+30/–20 мА; V_{OUT}=5 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
RNA	ADR439ARM	AD	vref	XFET®; V_{IN}=6.5...18 В; I_{OUT}=+30/–20 мА; V_{OUT}=4.5 В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
S18	ADG602BRMZ	AD	asw	SPST; R_{ON} < 5.5 Ом; V_{DD}=2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • VSS • IN • GND • S
S1B	ADG465BRM	AD	prot	V_{PROT} < ±40 В; V_{DD}=±15 В	MSOP-8	n.c. • VDD • VS1 • n.c. • n.c. • VSS • VD1 • n.c.
S1G	ADG601BRMZ	AD	asw	SPST; R_{ON} < 5.5 Ом; V_{DD}=2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • VSS • IN • GND • S
S21	ADG620BRMZ	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 8.5 Ом; V_{DD}=2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
S21	ADG620BRTZ	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 8.5 Ом; V_{DD}=2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	SOT23-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
S29B	LM3485MM	NS	SPM	V_{IN}=4.5...35 В; V_{OUT}=1.242...V_{IN} В	MSOP-8	ISENSE • GND • n.c. • FB • ADJ • PWR GND • PGATE • VIN
S3B	ADG701BRM	AD	asw	SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • n.c. • IN • GND • S
S4B	ADG702BRM	AD	asw	SPST; R_{ON} < 4 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • n.c. • IN • GND • S
S5B	ADG719BRM	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 7 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • n.c. • S2
S6B	ADG721BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 5 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
S7B	ADG722BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 5 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
S8B	ADG723BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 5 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
S9B	ADG704BRM	AD	amux	4 канала; R_{ON} < 4.5 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	MSOP-10	A0 • S1 • GND • S3 • EN • VDD • S4 • D • S2 • A1
SAB	ADG736BRM	AD	asw	2 x SPDT; R_{ON} < 4.5 Ом; V_{DD}=1.8...5.5 В	MSOP-10	IN1 • S1A • GND • S2A • IN2 • D2 • S2B • VDD • S1B • D1



MSOP-8 SOT23-8 US-8
SOP-8 TSOT23-8



MSOP-10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
SBB	ADG419BRM	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 70 Ом; V_{DD} = ±15 В; V_L = 5 В	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • VL • IN • VSS • S2
SCC	ADG619BRMZ	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 8.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SCC	ADG619BRTZ	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 8.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	SOT23-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SDA	ADG751ARM	AD	asw	SPST; R_{ON} < 40 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	n.c. • S • GND • IN • n.c. • n.c. • D • VDD
SDB	ADG751BRM	AD	asw	SPST; R_{ON} < 40 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	n.c. • S • GND • IN • n.c. • n.c. • D • VDD
SEB	ADG752BRM	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 20 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	n.c. • S2 • GND • IN • n.c. • S1 • VDD • D
SLB	ADG801BRM	AD	asw	SPST; R_{ON} < 0.4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • n.c. • IN • GND • S
SMB	ADG802BRM	AD	asw	SPST; R_{ON} < 0.4 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • n.c. • IN • GND • S
SNB	ADG819BRM	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • n.c. • S2
SPB	ADG820BRM	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • n.c. • S2
SQB	ADG821BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
SRB	ADG822BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
SSB	ADG823BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
STB	ADG601BRM	AD	asw	SPST; R_{ON} < 5.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • VSS • IN • GND • S
SUB	ADG602BRM	AD	asw	SPST; R_{ON} < 5.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • VSS • IN • GND • S
SVB	ADG619BRM	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 8.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SVB	ADG619BRT	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 8.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	SOT23-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SWB	ADG620BRM	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 8.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SWB	ADG620BRT	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 8.5 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	SOT23-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SXB	ADG621BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 7 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-10	S1 • D1 • IN2 • GND • VSS • n.c. • S2 • D2 • IN1 • VDD
SYB	ADG622BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 7 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-10	S1 • D1 • IN2 • GND • VSS • n.c. • S2 • D2 • IN1 • VDD
SZB	ADG623BRM	AD	asw	2 x SPST; R_{ON} < 7 Ом; V_{DD} = 2.7...5.5/±2.7...±5.5 В	MSOP-10	S1 • D1 • IN2 • GND • VSS • n.c. • S2 • D2 • IN1 • VDD
T13	ADM1032ARMZ-1	AD	dts	2 канала; 108 °C; SMBus; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-8	VDD • D+ • D– • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T1A	ADM1032ARM-1	AD	dts	2 канала; 108 °C; SMBus; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-8	VDD • D+ • D– • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T1C	ADM1032ARMZ-2	AD	dts	2 канала; 85 °C; SMBus; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-8	VDD • D+ • D– • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T1H	ADT7301ARMZ	AD	dts	13-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...5.25 В	MSOP-8	n.c. • DOUT • CS • SCLK • VDD • DIN • GND • n.c.
T1J	ADM1032ARMZ	AD	dts	2 канала; 85 °C; SMBus; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-8	VDD • D+ • D– • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T2A	ADM1032ARM	AD	dts	2 канала; 85 °C; SMBus; V_{DD}=3...5.5 В	MSOP-8	VDD • D+ • D– • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T0H	AD7414ARMZ	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	n.c. • SDA • ALERT • SCL • VDD • GND • AS • NC
T0L	AD7414ARMZ	AD	dts	10-разр.; SMBus/I^2C; V_{DD}=2.7...5.5 В	MSOP-8	n.c. • SDA • ALERT • SCL • VDD • GND • AS • NC
V0K	AD7740KRM	AD	VFC	V_{DD} = 3...3.6 В/4.75...5.25 В; синхронный	MSOP-8	CLKOUT • CLKIN • GND • REFIN/OUT • VIN • VDD • FOUT • BUF
V0Y	AD7740YRM	AD	VFC	V_{DD} = 3...3.6 В/4.75...5.25 В; синхронный	MSOP-8	CLKOUT • CLKIN • GND • REFIN/OUT • VIN • VDD • FOUT • BUF
V0Y	AD7740YRT	AD	VFC	V_{DD} = 3...3.6 В/4.75...5.25 В; синхронный	SOT23-8	BUF • FOUT • VDD • VIN • REFIN/OUT • GND • CLKIN • CLKOUT
W1B	ADG3233BRJ	AD	dsw	t_{PD} < 10.5 нс; V_{DD} = 1.65...3.6 В	SOT23-8	VCC1 • A1 • A2 • EN • GND • Y2 • Y1 • VCC2
W1B	ADG3233BRM	AD	dsw	t_{PD} < 10.5 нс; V_{DD} = 1.65...3.6 В	MSOP-8	VCC2 • Y1 • Y2 • GND • EN • A2 • A1 • VCC1

LFCSP-16

9 10 11 12
8 13
7 14
6 15
5 16
4 3 2 1

TQFN-12

7 8 9
6 10
5 11
4 12
3 2 1

LFCSP-10
TDFN-10
TQFN-10

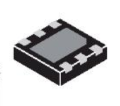
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1

LFCSP-8
TDFN-8

5 6 7 8
4 3 2 1

TDFN-6

6 7 8
3 2 1



LFCSP, TDFN, TQFN

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•...•16
#DBA	AD5304ACPZ	AD	DAC	4x8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5В	LFCSP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#DBB	AD5304BCPZ	AD	DAC	4x8-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5В	LFCSP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#DCA	AD5314ACPZ	AD	DAC	4x10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5В	LFCSP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#DCB	AD5314BCPZ	AD	DAC	4x10-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5В	LFCSP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#DDA	AD5324ACPZ	AD	DAC	4x12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5В	LFCSP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
#DDB	AD5324BCPZ	AD	DAC	4x12-разр.; SPI/Microwire; V_{DD}=2.5...5.5В	LFCSP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
+AFN	MAX1287ETA	MAX	ADC	2x12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...3.6В	TDFN-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
+AFP	MAX1289ETA	MAX	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=2.7...3.6В	TDFN-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
+AFR	MAX1286ETA	MAX	ADC	2x12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=4.5...5.5В	TDFN-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
+AFT	MAX1288ETA	MAX	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; V_{DD}=4.5...5.5В	TDFN-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
1S1	ZX3CD1S1M832	ZETEX	pnp + shd	V_{CEO}=12В; I_C=4А; V_R=40В; I_F=1.85А	MLP-832	B • E • n. c. • A • F2 • K • K • C • C • F1
2S1	ZX3CD2S1M832	ZETEX	pnp + shd	V_{CEO}=20В; I_C=3.5А; V_R=40В; I_F=1.85А	MLP-832	B • E • n. c. • A • F2 • K • K • C • C • F1
3S1	ZX3CD3S1M832	ZETEX	pnp + shd	V_{CEO}=40В; I_C=3А; V_R=40В; I_F=1.85А	MLP-832	B • E • n. c. • A • F2 • K • K • C • C • F1
91A	ZXTD4591AM832	ZETEX	npn/pnp	V_{CBO}=40В; I_{CN}=2А; I_{CP}=1.5А; P_D=1.5Вт	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
AAAM	MAX1595ETC50	MAX	cpreg	V_{IN}=1.8...5.5В; V_{OUT}=5В; I_{OUT}=125мА	TQFN-12	SHDN • IN • IN • GND • PGND • PGND • CXN • CXN • CXP • OUT • OUT • AOUT
AAAP	MAX1595ETC33	MAX	cpreg	V_{IN}=1.8...5.5В; V_{OUT}=3.3В; I_{OUT}=125мА	TQFN-12	SHDN • IN • IN • GND • PGND • PGND • CXN • CXN • CXP • OUT • OUT • AOUT
AAG	MAX4684ETB	MAX	asw	2xSPDT; R_{ON}<0.5Ом; V_{DD}=1.8...5.5В	TQFN-10	V+ • NO1 • COM1 • IN1 • NC1 • GND • NC2 • IN2 • COM2 • NO2
AAH	MAX4685ETB	MAX	asw	2xSPDT; R_{ON}<0.8Ом; V_{DD}=1.8...5.5В	TQFN-10	V+ • NO1 • COM1 • IN1 • NC1 • GND • NC2 • IN2 • COM2 • NO2
ABW	MAX1605ETT	MAX	vcon	V_{IN}=2.4...5.5В; V_{OUT}=0.8...30В; I_{CC}<35мкА	TDFN-6	SHDN • VCC • GND • LX • LIM • FB
ABX	MAX1833ETT30	MAX	vcon	V_{IN}=1.5...5.5В; V_{OUT}=3.3В; I_{OUT}<150мА	TDFN-6	SHDN • BATT • GND • LX • OUT • RST
AGS	MAX8880ETT	MAX	reg	LDO; V_{IN}=2.5...12В; V_{OUT}=1.25...5В; I_{OUT}=200мА	TDFN-6	FB • GND • OUT • IN • SHDN • POK
AJE	MAX1836ETT50	MAX	vcon	V_{IN}=4.5...24В; V_{OUT}=5В; I_{OUT}<125мА	TDFN-6	FB • GND • IN • LX • SHDN • OUT
AJF	MAX1837ETT50	MAX	vcon	V_{IN}=4.5...24В; V_{OUT}=5В; I_{OUT}<250мА	TDFN-6	FB • GND • IN • LX • SHDN • OUT
AJG	MAX1836ETT33	MAX	vcon	V_{IN}=4.5...24В; V_{OUT}=3.3В; I_{OUT}<125мА	TDFN-6	FB • GND • IN • LX • SHDN • OUT
AJH	MAX1837ETT33	MAX	vcon	V_{IN}=4.5...24В; V_{OUT}=3.3В; I_{OUT}<250мА	TDFN-6	FB • GND • IN • LX • SHDN • OUT
AJT	MAX5900NNETT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9В; I_{CC}<1.3мА	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJU	MAX5900AAETT	MAX	hscontr	V_{EE}=-100...-9В; I_{CC}<1.3мА; V_{CB}=200мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF



TDFN-6

LFCSP-8 TDFN-8

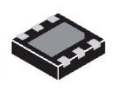
LFCSP-10 TDFN-10 TQFN-10

TQFN-12

LFCSP-16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•...•16
AJV	MAX5900ABETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 300 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJW	MAX5900ACETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 400 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJX	MAX5900LAETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 200 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJY	MAX5900LBETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 300 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJZ	MAX5900LCETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 400 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKA	MAX5901NNETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKB	MAX5901AAETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 200 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKC	MAX5901ABETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 300 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKD	MAX5901ACETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 400 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKE	MAX5901LAETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 200 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKF	MAX5901LBETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 300 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKG	MAX5901LCETT	MAX	hscontr	V_{EE} = -100...-9В; I_{CC} < 1.3 мА; V_{CB} = 400 мВ	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKH	MAX5902NNETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKI	MAX5902AAEUT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 300 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKJ	MAX5902ABETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 400 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKK	MAX5902ACETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 500 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKL	MAX5902LAETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 300 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKM	MAX5902LBETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 400 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKN	MAX5902LCETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 500 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKO	MAX5903NNETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKP	MAX5903AAETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 300 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKQ	MAX5903ABETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 400 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKR	MAX5903ACETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 500 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKS	MAX5903LAETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 300 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKT	MAX5903LBETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 400 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKU	MAX5903LCETT	MAX	hscontr	V_S = +9...+72В; I_{CC} < 2 мА; V_{CB} = 500 мВ	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKV	MAX5048AATT	MAX	drv	КМОП-вход; V_{CC} = 4...12.6 В; I_{OUT} < 7.6/1.3 А	TDFN-6	V+ • P_OUT • N_OUT • GND • IN- • IN+
AKW	MAX5048BATT	MAX	drv	ТТЛ-вход; V_{CC} = 4...12.6 В; I_{OUT} < 7.6/1.3 А	TDFN-6	V+ • P_OUT • N_OUT • GND • IN- • IN+
BS1	ZX3CDBS1M832	ZETEX	npn + shd	V_{CEO} = 20 В; I_C = 4.5 А; V_R = 40 В; I_F = 1.85 А	MLP-832	B • E • п. с. • A • F2 • K • K • C • C • F1
C01	ZXMC3AM832	ZETEX	nMOS/pMOS	V_{DS} = 30 В; I_{DN} = 2.9 А; I_{DP} = 2.1 А; $R_{DS(on)N}$ < 0.18 Ом; $R_{DS(on)P}$ < 0.33 Ом	MLP-832	S1 • G1 • S2 • G2 • F2 • D2 • D2 • D1 • D1 • F1
D11	ZXTD1M832	ZETEX	pnp x2	V_{CE0} = 12 В; I_C = 4А; P_D = 1.5 Вт	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
D22	ZXTD2M832	ZETEX	pnp x2	V_{CE0} = 20 В; I_C = 3.5А; P_D = 1.5 Вт	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
D33	ZXTD3M832	ZETEX	pnp x2	V_{CE0} = 40 В; I_C = 3А; P_D = 1.5 Вт	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
DA1	ZXTDA1M832	ZETEX	npn/pnp	V_{CE0N} = 15 В; V_{CE0P} = 12 В; I_{CN} = 4.5 А; I_{CP} = 4 А; P_D = 1.5 Вт	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
DAA	ZXTDAM832	ZETEX	npn x2	V_{CE0} = 15 В; I_C = 4.5А; P_D = 1.5 Вт	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1

LFCSP-16 TQFN-12 LFCSP-10 TDFN-10 TQFN-10 LFCSP-8 TDFN-8 TDFN-6



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•...•16
DB2	ZXTDB2M832	ZETEX	npn/pnp	V_{CE0N} = 20В; V_{CE0P} = 20В; I_{CN} = 4.5А; I_{CP} = 3.5А; P_D = 1.5Вт	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DBB	ZXTDBM832	ZETEX	npn x2	V_{CE0} = 20В; I_C = 4.5А; P_D = 1.5Вт	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DC3	ZXTDC3M832	ZETEX	npn/pnp	V_{CE0N} = 50В; V_{CE0P} = 40В; I_{CN} = 4А; I_{CP} = 3А; P_D = 1.5Вт	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DCC	ZXTDCM832	ZETEX	npn x2	V_{CE0} = 50В; I_C = 4А; P_D = 1.5Вт	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DE4	ZXTDE4M832	ZETEX	npn/pnp	V_{CE0N} = 80В; V_{CE0P} = 70В; I_{CN} = 3.5А; I_{CP} = 2.5А; P_D = 1.5Вт	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DNA	ZXMN2AM832	ZETEX	nMOS x2	V_{DS} = 20В; I_D = 13А; P_D = 1.5Вт; $R_{DS(on)}$ < 0.3 Ом	MLP-832	S1•G1•S2•G2•F2•D2•D2•D1•D1•F1
DNB	ZXMN3AM832	ZETEX	nMOS x2	V_{DS} = 30В; I_D = 13А; P_D = 1.5Вт; $R_{DS(on)}$ < 0.18 Ом	MLP-832	S1•G1•S2•G2•F2•D2•D2•D1•D1•F1
DPA	ZXMP62M832	ZETEX	pMOS x2	V_{DS} = 20В; I_D = 1.3А; P_D = 1.5Вт; $R_{DS(on)}$ < 0.9 Ом	MLP-832	S1•G1•S2•G2•F2•D2•D2•D1•D1•F1
J5A	AD8314ACP	AD	LA	f_{BD} = 0.1...2.7ГГц; P_D = 30мВт; V_{DD} = 2.7...5.5В	LFCSP-8	RFIN•ENBL•VSET•FLTR•COMM•V UP•V DN•VPOS
J7A	AD8315ACP	AD	LA	f_{BD} = 0.1...2.5ГГц; P_D = 60мВт; V_{DD} = 2.7...5.5В	LFCSP-8	RFIN•ENBL•VSET•FLTR•COMM•n. c.•VAPC•VPOS
J8A	AD8316ACP	AD	LA	f_{BD} = 0.1...2.5ГГц; P_D = 60мВт; V_{DD} = 2.7...5.5В	LFCSP-16	RFIN•ENBL•VSET•FLTR•n. c.•BSEL•FLT2•n. c.•OUT2•COMM•OUT1•VPOS•n. c.•COMM•n. c.•n. c.
LFA	ADP3335ACP-1.8	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12В; I_{OUT} = 500мА; V_{OUT} = 1.8В	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
LFC	ADP3335ACP-2.5	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12В; I_{OUT} = 500мА; V_{OUT} = 2.5В	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
LFD	ADP3335ACP-2.85	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12В; I_{OUT} = 500мА; V_{OUT} = 2.85В	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
LFE	ADP3335ACP-3.3	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12В; I_{OUT} = 500мА; V_{OUT} = 3.3В	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
LFF	ADP3335ACP-5	AD	reg	LDO; V_{IN} = 2.6...12В; I_{OUT} = 500мА; V_{OUT} = 5В	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
MSA	ZXMNS3BM832	ZETEX	nMOS + shd	V_{DS} = 30В; I_D = 2А; V_R = 40В; I_F = 1.85А	MLP-832	S•G•n. c.•A•F2•K•K•D•D•F1
MSB	ZXMPS62M832	ZETEX	pMOS + shd	V_{DS} = 20В; I_D = 1.3А; V_R = 40В; I_F = 1.85А	MLP-832	S•G•n. c.•A•F2•K•K•D•D•F1

UCSP-4 UCSP-5 UCSP-6 WLCSP-5 WLCSP-6 WCSP-8





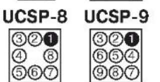






UCSP-8 UCSP-9 UCSP-10 UCSP-12



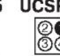


UCSP, WCSP...

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•...•12
AAA	MAX2240EBL	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...5 В; f_P = 2.4...2.5 ГГц; I_{CC} < 155 мА	UCSP-9	D0 • D1 • BIAS • RFOUT • SHDN • GND1 • GND2 • VCC • RFIN
AAA	MAX6400BS22	MAX	mrc	V_{TR} = 2.2 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAB	MAX1820ZEBC	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.6...5.5 В; V_{OUT} = 0.4...3.4 В; I_{OUT} = 600 мА	UCSP-10	SKIP • COMP • OUT • REF • GND • PGND • LX • BATT • SHDN • SYNC
AAB	MAX2374EBT	MAX	amp	SiGe; V_{CC} = 2.7...5.5 В; f_P = 750...1000 МГц; I_{CC} < 10.5 мА	UCSP-6	GAIN • LNAIN • GND • BIAS • LNAOUT • VCC
AAB	MAX6400BS23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAC	MAX1819EBL20	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.0/1.25...5 В; I_{OUT} = 500 мА	UCSP-6	IN • POK • SHDN • GND • SET • OUT
AAC	MAX1821EBC	MAX	dcdc	V_{IN} = 2.6...5.5 В; V_{OUT} = 1.25...5.5 В; I_{OUT} = 600 мА	UCSP-10	SKIP • COMP • FB • REF • GND • PGND • LX • BATT • SHDN • SYNC
AAC	MAX6400BS24	MAX	mrc	V_{TR} = 2.4 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAD	MAX1819EBL25	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 2.5/1.25...5 В; I_{OUT} = 500 мА	UCSP-6	IN • POK • SHDN • GND • SET • OUT
AAD	MAX6400BS25	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAE	MAX1819EBL33	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 3.3/1.25...5 В; I_{OUT} = 500 мА	UCSP-6	IN • POK • SHDN • GND • SET • OUT
AAE	MAX2242EBC	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...3.6 В; f_P = 2.4...2.5 ГГц; I_{CC} < 335 мА	UCSP-12	GND • VCC2 • GND • VCC1 • RF_OUT • PD_OUT • n. c. • GND • BIAS • SHDN • VCCB • RF_IN
AAE	MAX2648EBT	MAX	amp	SiGe; V_{CC} = 2.7...3.6 В; f_P = 5000+R[1841]C...6000 МГц; I_{CC} < 18 мА	UCSP-6	RFIN • GND • GND • VCC • GND • RFOUT
AAE	MAX6400BS26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAF	MAX1819EBL50	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 5.0/1.25...5 В; I_{OUT} = 500 мА	UCSP-6	IN • POK • SHDN • GND • SET • OUT
AAF	MAX4684EBC	MAX	asw	2 x SPDT; R_{ON} < 0.5 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	UCSP-10	NC2 • IN2 • COM2 • NO2 • GND • V+ • NC1 • IN1 • COM1 • NO1
AAF	MAX6400BS27	MAX	mrc	V_{TR} = 2.7 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAG	MAX1819EBL18	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.8/1.25...5 В; I_{OUT} = 500 мА	UCSP-6	IN • POK • SHDN • GND • SET • OUT
AAG	MAX4685EBC	MAX	asw	2 x SPDT; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	UCSP-10	NC2 • IN2 • COM2 • NO2 • GND • V+ • NC1 • IN1 • COM1 • NO1
AAG	MAX6400BS28	MAX	mrc	V_{TR} = 2.8 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAH	MAX1819EBL15	MAX	reg	LDO; V_{IN} = 2.5...5.5 В; V_{OUT} = 1.5/1.25...5 В; I_{OUT} = 500 мА	UCSP-6	IN • POK • SHDN • GND • SET • OUT
AAH	MAX2307EBC	MAX	amp	V_{CC} = 2.8...4.2 В; f_P = 887...925 МГц; I_{CC} < 38 мА	UCSP-12	VCC • VCC MIXP • VCC MIXM • GND • LOIN/SHDN • n. c. • GC • RF_OUT • GND • IFINP • IFINM • SHDN
AAH	MAX6400BS29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAI	MAX4686EBT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 3.5 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	UCSP-6	NO • I.C. • COM • GND • IN • V+
AAI	MAX6400BS30	MAX	mrc	V_{TR} = 3.0 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAJ	MAX2383BC	MAX	amp	V_{CC} = 2.7...3 В; f_P = 1920...1980 МГц; I_{CC} < 44 мА	UCSP-12	LO+/LO_EN • VCC • DROUT • GND • LO-/SHDN • n. c. • GC • DRIN • IFIN- • IFIN+ • RF_OUT • GND
AAJ	MAX4292EBL	MAX	dOA	R-R; V_{DD} = 1.8...5.5/±0.9...±2.75 В; f_{BD} = 500 кГц; V_{OSI} < 2.5 мВ	UCSP-8	OUTA • VCC • OUTB • INB- • INB+ • VEE • INA+ • INA-
AAJ	MAX4687EBT	MAX	asw	SPST; R_{ON} < 3.5 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	UCSP-6	NC • I.C. • COM • GND • IN • V+
AAJ	MAX6400BS31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
AAK	MAX4688EBT	MAX	asw	SPDT; R_{ON} < 3.5 Ом; V_{DD} = 1.8...5.5 В	UCSP-6	NO • COM • NC • GND • IN • V+










Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•...•12
AAK	MAX6410BS33	MAX	vd	V_{TR}=3.30В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAL	MAX1820YEBC	MAX	dcdc	V_{IN}=2.6...5.5В; V_{OUT}=0.4...3.4В; f_{CLK}=19.8МГц; I_{OUT}=600мА	UCSP-10	SKIP•COMP•OUT•REF•GND•PGND•LX•BATT•SHDN•SYNC
AAL	MAX4696EBT	MAX	asw	SPST; R_{ON}<40Ом; V_{DD}=2.0...5.5В	UCSP-6	NO•COM•COM•GND•IN•V+
AAL	MAX6410BS34	MAX	vd	V_{TR}=3.40В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAM	MAX1820XEBC	MAX	dcdc	V_{IN}=2.6...5.5В; V_{OUT}=0.4...3.4В; f_{CLK}=13МГц; I_{OUT}=600мА	UCSP-10	SKIP•COMP•OUT•REF•GND•PGND•LX•BATT•SHDN•SYNC
AAM	MAX4697EBT	MAX	asw	SPST; R_{ON}<40Ом; V_{DD}=2.0...5.5В	UCSP-6	NC•COM•COM•GND•IN•V+
AAM	MAX6410BS35	MAX	vd	V_{TR}=3.50В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAN	MAX4698EBT	MAX	asw	SPDT; R_{ON}<40Ом; V_{DD}=2.0...5.5В	UCSP-6	NO•COM•NC•GND•IN•V+
AAN	MAX6410BS36	MAX	vd	V_{TR}=3.60В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAO	MAX6410BS37	MAX	vd	V_{TR}=3.70В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAP	MAX6410BS38	MAX	vd	V_{TR}=3.80В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAQ	MAX6410BS39	MAX	vd	V_{TR}=3.90В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAR	MAX6410BS40	MAX	vd	V_{TR}=4.00В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAS	MAX6410BS41	MAX	vd	V_{TR}=4.10В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAT	MAX6410BS42	MAX	vd	V_{TR}=4.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAU	MAX6410BS43	MAX	vd	V_{TR}=4.30В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAV	MAX1821XEBC	MAX	dcdc	V_{IN}=2.6...5.5В; V_{OUT}=1.25...5.5В; f_{CLK}=13МГц; I_{OUT}=600мА	UCSP-10	SKIP•COMP•FB•REF•GND•PGND•LX•BATT•SHDN•SYNC
AAV	MAX6410BS44	MAX	vd	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAW	MAX4323EBT	MAX	OA	R-R; V_{DD}=2.4...6.5/±1.2...±3.25В; f_{BD}=5МГц; V_{OSI}<3.5мВ	UCSP-6	VEE•OUT•VCC•SHDN•IN-•IN+
AAW	MAX6410BS45	MAX	vd	V_{TR}=4.50В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAX	MAX6410BS46	MAX	vd	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAY	MAX6411BS33	MAX	vd	V_{TR}=3.30В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAY	MAX985EBT	MAX	cmp	R-R; V_{OSI}<±7мВ; V_{CC}=2.5...5.5В; I_{CC}<24мкА	UCSP-6	VEE•OUT•VCC•n.c.•IN-•IN+
AAZ	MAX6411BS34	MAX	vd	V_{TR}=3.40В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAZ	MAX9039BEBT	MAX	cmp +vref	R-R; V_{OSI}<±7мВ; V_{CC}=2.5...5.5В; V_{REF}=1.230В; I_{CC}<72мкА	UCSP-6	VEE•OUT•VCC•REF•IN-•IN+
ABA	MAX6411BS35	MAX	vd	V_{TR}=3.50В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABB	MAX6411BS36	MAX	vd	V_{TR}=3.60В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABC	MAX6411BS37	MAX	vd	V_{TR}=3.70В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABD	MAX6411BS38	MAX	vd	V_{TR}=3.80В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABE	MAX6411BS39	MAX	vd	V_{TR}=3.90В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABF	MAX6411BS40	MAX	vd	V_{TR}=4.00В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABG	MAX6411BS41	MAX	vd	V_{TR}=4.10В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABH	MAX6411BS42	MAX	vd	V_{TR}=4.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABI	MAX6411BS43	MAX	vd	V_{TR}=4.30В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABJ	MAX6411BS44	MAX	vd	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABK	MAX6411BS45	MAX	vd	V_{TR}=4.50В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABL	MAX6411BS46	MAX	vd	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABM	MAX6401BS22	MAX	mrc	V_{TR}=2.2В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABN	MAX6401BS23	MAX	mrc	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABO	MAX6401BS24	MAX	mrc	V_{TR}=2.4В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABP	MAX6401BS25	MAX	mrc	V_{TR}=2.5В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET



UCSP-4 UCSP-5 UCSP-6 WLCSP-5 WLCSP-6 WCSP-8






UCSP-8 UCSP-9 UCSP-10 UCSP-12

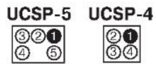
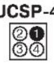


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•...•12
ABQ	MAX6401BS26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABR	MAX6401BS27	MAX	mrc	V_{TR} = 2.7В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABS	MAX6401BS28	MAX	mrc	V_{TR} = 2.8В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABT	MAX6401BS29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABU	MAX6401BS30	MAX	mrc	V_{TR} = 3.0В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABV	MAX6401BS31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABW	MAX6402BS22	MAX	mrc	V_{TR} = 2.2В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABX	MAX6402BS23	MAX	mrc	V_{TR} = 2.32В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABY	MAX6402BS24	MAX	mrc	V_{TR} = 2.4В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABZ	MAX6402BS25	MAX	mrc	V_{TR} = 2.5В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACA	MAX6402BS26	MAX	mrc	V_{TR} = 2.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACB	MAX6402BS27	MAX	mrc	V_{TR} = 2.7В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACC	MAX6402BS28	MAX	mrc	V_{TR} = 2.8В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACD	MAX6402BS29	MAX	mrc	V_{TR} = 2.93В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACE	MAX6402BS30	MAX	mrc	V_{TR} = 3.0В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACF	MAX6402BS31	MAX	mrc	V_{TR} = 3.08В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACG	MAX6403BS33	MAX	mrc	V_{TR} = 3.3В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACH	MAX6403BS34	MAX	mrc	V_{TR} = 3.4В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACI	MAX6403BS35	MAX	mrc	V_{TR} = 3.5В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACJ	MAX6403BS36	MAX	mrc	V_{TR} = 3.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACK	MAX6403BS37	MAX	mrc	V_{TR} = 3.7В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACL	MAX6403BS38	MAX	mrc	V_{TR} = 3.8В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACM	MAX6403BS39	MAX	mrc	V_{TR} = 3.9В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACN	MAX6403BS40	MAX	mrc	V_{TR} = 4.0В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACO	MAX6403BS41	MAX	mrc	V_{TR} = 4.1В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACP	MAX6403BS42	MAX	mrc	V_{TR} = 4.2В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACQ	MAX6403BS43	MAX	mrc	V_{TR} = 4.3В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACR	MAX6403BS44	MAX	mrc	V_{TR} = 4.38В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACS	MAX6403BS45	MAX	mrc	V_{TR} = 4.5В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACT	MAX6403BS46	MAX	mrc	V_{TR} = 4.63В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACU	MAX6404BS33	MAX	mrc	V_{TR} = 3.3В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACV	MAX6404BS34	MAX	mrc	V_{TR} = 3.4В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACW	MAX6404BS35	MAX	mrc	V_{TR} = 3.5В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACX	MAX4372TEBT	MAX	CSA	V_{DD} = 2.7...28В; Gain = 20; I_{CC} < 1.9мА	UCSP-5	VCC•GND•OUT•RS-•RS+
ACX	MAX6404BS36	MAX	mrc	V_{TR} = 3.6В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACY	MAX4372FEBT	MAX	CSA	V_{DD} = 2.7...28В; Gain = 50; I_{CC} < 1.9мА	UCSP-5	VCC•GND•OUT•RS-•RS+
ACY	MAX6404BS37	MAX	mrc	V_{TR} = 3.7В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ACZ	MAX4372HEBT	MAX	CSA	V_{DD} = 2.7...28В; Gain = 100; I_{CC} < 1.9мА	UCSP-5	VCC•GND•OUT•RS-•RS+
ACZ	MAX6404BS38	MAX	mrc	V_{TR} = 3.8В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ADA	MAX6404BS39	MAX	mrc	V_{TR} = 3.9В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ADB	MAX6404BS40	MAX	mrc	V_{TR} = 4.0В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ADC	MAX6404BS41	MAX	mrc	V_{TR} = 4.1В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ADD	MAX6404BS42	MAX	mrc	V_{TR} = 4.2В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ADE	MAX6404BS43	MAX	mrc	V_{TR} = 4.3В; V_{DD} = 1.2...5.5В; I_{CC} < 1мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET

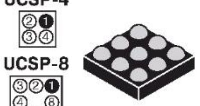
WCSP-8 WLCSP-6 WLCSP-5 UCSP-6 UCSP-5 UCSP-4





UCSP-12 UCSP-10 UCSP-9 UCSP-8



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•...•12
ADF	MAX6404BS44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADG	MAX6404BS45	MAX	mrc	V_{TR}=4.5В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADH	MAX6404BS46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADI	MAX6405BS33	MAX	mrc	V_{TR}=3.3В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADJ	MAX6405BS34	MAX	mrc	V_{TR}=3.4В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADK	MAX6405BS35	MAX	mrc	V_{TR}=3.5В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADL	MAX6405BS36	MAX	mrc	V_{TR}=3.6В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADM	MAX6405BS37	MAX	mrc	V_{TR}=3.7В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADN	MAX6405BS38	MAX	mrc	V_{TR}=3.8В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADO	MAX6405BS39	MAX	mrc	V_{TR}=3.9В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADP	MAX6405BS40	MAX	mrc	V_{TR}=4.0В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADQ	MAX6405BS41	MAX	mrc	V_{TR}=4.1В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADR	MAX6405BS42	MAX	mrc	V_{TR}=4.2В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADS	MAX6405BS43	MAX	mrc	V_{TR}=4.3В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADT	MAX6405BS44	MAX	mrc	V_{TR}=4.38В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADU	MAX6405BS45	MAX	mrc	V_{TR}=4.5В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADV	MAX6405BS46	MAX	mrc	V_{TR}=4.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • RESET
ADW	MAX6406BS22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
ADX	MAX6406BS23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
ADY	MAX6406BS24	MAX	vd	V_{TR}=2.40В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
ADZ	MAX6406BS25	MAX	vd	V_{TR}=2.50В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEA	MAX6406BS26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEB	MAX6406BS27	MAX	vd	V_{TR}=2.70В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEC	MAX6406BS28	MAX	vd	V_{TR}=2.80В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AED	MAX6406BS29	MAX	vd	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEE	MAX6406BS30	MAX	vd	V_{TR}=3.00В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEF	MAX6406BS31	MAX	vd	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEG	MAX6407BS22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEH	MAX6407BS23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEI	MAX6407BS24	MAX	vd	V_{TR}=2.40В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEJ	MAX6407BS25	MAX	vd	V_{TR}=2.50В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEK	MAX6407BS26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEL	MAX6407BS27	MAX	vd	V_{TR}=2.70В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEM	MAX6407BS28	MAX	vd	V_{TR}=2.80В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEN	MAX6407BS29	MAX	vd	V_{TR}=2.93В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEO	MAX6407BS30	MAX	vd	V_{TR}=3.00В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEP	MAX6407BS31	MAX	vd	V_{TR}=3.08В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEQ	MAX6408BS22	MAX	vd	V_{TR}=2.20В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AER	MAX6408BS23	MAX	vd	V_{TR}=2.32В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AES	MAX6408BS24	MAX	vd	V_{TR}=2.40В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AET	MAX6408BS25	MAX	vd	V_{TR}=2.50В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEU	MAX6408BS26	MAX	vd	V_{TR}=2.63В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEV	MAX6408BS27	MAX	vd	V_{TR}=2.70В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEW	MAX6408BS28	MAX	vd	V_{TR}=2.80В; V_{DD}=1.2...5.5В; I_{CC}<1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT



UCSP-4 UCSP-5 UCSP-6 WLCSP-5 WLCSP-6 WCSP-8



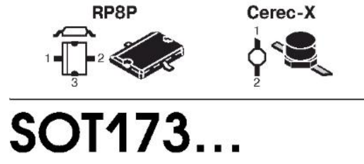




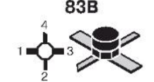

UCSP-8 UCSP-9 UCSP-10 UCSP-12



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•…•12
AEX	MAX6408BS29	MAX	vd	V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEY	MAX6408BS30	MAX	vd	V_{TR} = 3.00 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEZ	MAX6408BS31	MAX	vd	V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFA	MAX6409BS33	MAX	vd	V_{TR} = 3.30 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFB	MAX6409BS34	MAX	vd	V_{TR} = 3.40 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFC	MAX6409BS35	MAX	vd	V_{TR} = 3.50 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFD	MAX6409BS36	MAX	vd	V_{TR} = 3.60 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFE	MAX6409BS37	MAX	vd	V_{TR} = 3.70 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFF	MAX6409BS38	MAX	vd	V_{TR} = 3.80 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFG	MAX6409BS39	MAX	vd	V_{TR} = 3.90 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFH	MAX6409BS40	MAX	vd	V_{TR} = 4.00 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFI	MAX6409BS41	MAX	vd	V_{TR} = 4.10 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFJ	MAX6409BS42	MAX	vd	V_{TR} = 4.20 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFK	MAX6409BS43	MAX	vd	V_{TR} = 4.30 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFL	MAX6409BS44	MAX	vd	V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFM	MAX6409BS45	MAX	vd	V_{TR} = 4.50 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFN	MAX6409BS46	MAX	vd	V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2…5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
B3A	AD8605ACB	AD	OA	f_{BD} = 10 МГц; P_D = 7 мВт; V_{DD} = 2.7…5.5 В	WLCSP-5	OUT • V– • +IN • –IN • V+
CCS	OPA2347YED	TI	dOA	R-R; V_{DD} = 2.3…5.5 В; f_{BD} = 350 кГц; I_S = 80 мкА; V_{OSI} < 7 мВ	WCSP-8	OUT A • –IN A • +IN A • V– • +IN B • –IN B • OUT B • V+
SNB	ADG819BCB	AD	asw	SPDT; R_{ON} < 0.8 Ом; V_{DD} = 1.8…5.5 В	WLCSP-6	S2 • D • S1 • GND • VDD • IN









SOT173...

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
57	BFQ57	SIEM	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 35 мА; P_D = 450 мВт	SOT-173	B•E•C•E
58	BFQ58	SIEM	npn	V_{CB0} = 16 В; I_C = 30 мА; P_D = 450 мВт	SOT-173	B•E•C•E
70	BFQ70	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 50; f_T = 5 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
71	BFQ71	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 40; f_T = 5.2 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
72	BFQ72	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 40; f_T = 5.1 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
74	BFQ74	SIEM	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 35 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 50; f_T = 6 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
75	BFQ75	SIEM	pnp	V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 20; f_T = 5 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
76	BFQ76	SIEM	pnp	V_{CB0} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 20; f_T = 5 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
77	BFQ77	SIEM	npn	V_{CB0} = 25 В; I_C = 20 мА; P_D = 250 мВт; f_T = 2 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
0	2SC3603	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 580 мВт; h_{21} = 50...300; f_T = 7 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
1	2SC3587	NEC	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 580 мВт; h_{21} = 50...250; f_T = 10 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
32	BAT32	INF	shd	V_R < 6.5 В; I_F < 50 мА; V_F (I_F = 10 мА) < 0.6 В; C_D = 0.24 пФ	Cerec-X	A•K
674	NE67483B	NEC	nMESFET	GaAs; V_{DS} = 5 В; I_D = 120 мА; P_D = 270 мВт; g_F < 100 мСм	83B	S•D•S•G
73S	BFQ73S	SIEM	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 30; f_T = 5.3 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
C1	BFQ51C	PHIL	pnp	V_{CB0} = 15 В; I_C = 30 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 20; f_T > 5 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
C2	BFQ32C	PHIL	pnp	V_{CB0} = 15 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 20; f_T > 4.5 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
C3	BFQ23C	PHIL	pnp	V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 20; f_T > 5 ГГц	SOT-173	B•E•C•E
IX	2SK3390	REN	nMOS	V_{DS} = 17 В; I_D = 1 А; P_D = 20 Вт	RP8P	G•S•D
P0	BFP90A	PHIL	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 80 мА; P_D = 350 мВт	SOT-173	B•E•C•E
P1	BFP91A	PHIL	npn	V_{CB0} = 15 В; I_C = 80 мА; P_D = 350 мВт	SOT-173	B•E•C•E
P6	BFP96	PHIL	npn	V_{CB0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 25; f_T > 5 ГГц	SOT-173	B•E•C•E

РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

BL, BW, BH, PL	1:1		BL	BW	BH	PL
Резисторы *стр. 16* Кондесаторы *стр. 17* Индуктивности Термисторы Варисторы		**0402** (1005)	1	0.5	0.35...0.55	0.2
		0603 (1608)	1.6	0.8	0.45...0.95	0.3
		0805 (2012)	2	1.2	0.4...1.6	0.5
		1206 (3216)	3.2	1.6	0.4...1.75	0.5
		1210 (3225)	3.2	2.5	0.55...1.9	0.5
		1218 (3245)	3.2	4.5	0.55...1.9	0.5
		1806 (4516)	4.5	1.6	1.6	0.5
		1808 (4520)	4.5	2	2	0.5
		1812 (4532)	4.5	3.2	0.6...2.3	0.5
		2010 (5025)	5	2.5	0.55	0.5
		2220 (5750)	5.7	5	1.7	0.5
		2225 (5763)	5.7	6.3	2	0.5
		2512 (6432)	6.4	3.2	2	0.5
		2824 (7161)	7.1	6.1	3.9	0.5
		3225 (8063)	8	6.3	3.2	0.5
		4030	10.2	7.6	3.9	0.5
		4032	10.2	8	3.2	0.5
		5040	12.7	10.2	4.8	0.5
		6054	15.2	13.7	4.8	0.5

1:1	Тип	BL	BW	BH	PB	PW	PH	SB	SL	SW
	SOD623	1.0	0.6	0.52	1.4	0.2	0.12			
	SOD723	1.0	0.6	0.52	1.4	0.29	0.1			
	SOD523, SC79	1.2	0.8	0.6	1.6	0.3	0.14			
	SCD80	1.3	0.8	0.7	1.7	0.3	0.13	1.8	0.35	0.35
	DO219AB	2.8	1.8	1.0	3.7	1.0	0.16	4.2	1.3	1.4

1:1	Тип	BL	BW	BH	PB	PW	PH	SB	SL	SW
	ESC	1.2	0.8	0.6	1.6	0.3				
	SSC	1.3	0.8	0.8	2.1	0.3				
	SOD323, SC76	1.7	1.25	0.9	2.5	0.3	0.15	3.3	0.8	0.6
	SOD123	2.7	1.55	1.35	3.2	0.6	0.15	4.19	0.91	1.22
	DO215AC	4.3	2.6	2.4	6.1	1.4				
	DO215AA	4.3	3.6	2.3	6.2	2.0	0.25			
	DO215BA	4.45	2.6	2.95	6.2	1.3				
	DO215AB	6.85	5.9	2.3	9.9	3				

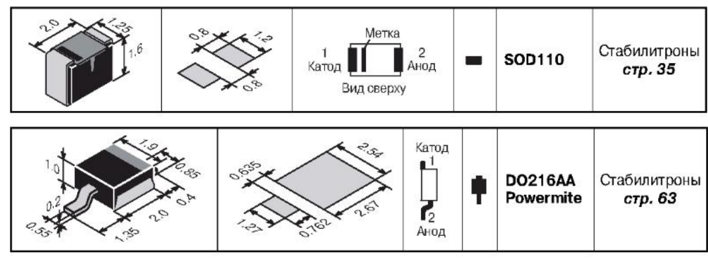
1:1	Тип	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SB	SL	SW
	2012 (0805)		1.2	1.2	1.1		2			
	3216L **3216** (1206)		1.6	1.2 1.6	1.2		3.2			
	3528L **3528**		2.8	1.2 1.9	2.2		3.5			
	DO214AC SMA	4.4	2.6	2.15	1.5	0.15	5.2	5.5	1.7	2
	DO214BA		2.6	2.95	1.3		5.25			
	DO214AA SMB	4.4	3.6	2.2	2	0.2	5.4	6.1	2	2.5
	SOD6		3.8	2.5	2.2		5.5			
	5832		3.2	1.5	2.2		5.8			
	5845		4.5	3.1	2.2		5.8			
	6032		3.2	2.5	2.2		6			
	7343 **7343H**		4.3	2.8 4.3	2.4		7.3			
	SOD15		5	2.8	3		7.8			
	DO214AB, SMC	6.8	5.8	2.3	3	0.2	7.9	8.5	2.2	3.5

Кондесаторы
стр. 17

Индуктивности
стр. 18

Термисторы
Варисторы

Диоды
Стабилитроны
стр. 35 *(DO214)*
стр. 63 *(DO215)*
стр. 82 *(DO219)*



	1:1	Тип корпуса	BL	BD	PL	PH	Источник
Резисторы *стр. 8* Кондесаторы Диоды Стабилитроны	■	**ERD03LL**	1.6	1	0.2	0.05	PANASONIC
	■	**ERO21L**	2	1.25	0.3	0.07	PANASONIC
	■	**DO213AC**	3.45	1.4	0.42	-	JEDEC
	■	**SOD80, miniMELF**	3.5	1.6	0.3	0.075	PHILIPS
	■	**DO213AA, SOD80**	3.5	1.65	0.48	0.03	JEDEC
	■	**SOD80C**	3.6	1.52	0.3	0.075	PHILIPS
	■	**SOD87**	3.5	2.05	0.3	0.075	PHILIPS
	■	**MELF**	5	2.5	0.5	0.1	CENTS
	■	**DO213AB, MELF**	5	2.52	0.48	0.03	JEDEC
	■	**ERSM**	5.9	2.2	0.6	0.15	PANASONIC

0.25, 0.5, 0.4, 0.6, 0.65, 1.0	0.35, 0.6, 1.0	2 1	■	**TSLP-2**	Диоды Варикапы Транзисторы *стр. 88*
0.25, 0.5, 0.4, 0.15, 0.6, 0.65, 1.0	0.35, 0.6, 0.225, 1.0	3 1 2	■	**TSLP-3**	
0.35, 0.25, 0.4, 0.45, 0.8, 0.75, 1.2	0.4, 0.3, 0.8, 1.2	3 4 2 1	■	**TSLP-4**	
0.2, 0.3, 0.72, 0.6, 0.5, 1.0, 1.5	0.5, 0.6, 0.42, 0.32	4 5 6 3 2 1	■	**µDFN-6**	

1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
	SOT523	1	1.6	0.8	0.75	0.22	0.12	1.6			
	SOT416, SC75A	1	1.6	0.8	0.75	0.2	0.15	1.6	0.4	0.65	1.15
	SOT323, SC70	1.3	2	1.25	0.9	0.32	0.13	2.1	0.45	0.9	1.5
	SOT346, SC59	1.9	2.9	1.5	1	0.4	0.18	2.8			
	SOT23, SOD23	1.9	2.9	1.5	1.1	0.42	0.13	2.8	0.55	1.05	1.95

1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
	TSFP-3, VESM	0.8	1.2	0.8	0.53	0.2	0.15	1.2			
	VMT3, VMD3	0.8	1.2	0.8	0.5	0.22*	0.13	1.2			
	SC81, MFPAK	0.9	1.4	0.8	0.57	0.22	0.13	1.2	0.35	0.5	0.75
	TESM	0.9	1.4	0.8	0.59	0.22	0.14	1.2			
	SOT490, SC89	1	1.6	0.85	0.7	0.28	0.15	1.6			

* Для вывода 3: PW = 0.32

Диоды, Стабилитроны
Транзисторы, Датчики
Стабилизаторы
Схемы сброса
стр. 90

SOT89, SC62

Вид сверху

SOT223, TO261AA

TO252, DPAK

TO263, D2PAK

Диоды
Стабилитроны
Транзисторы
Стабилизаторы
Мониторы
Схемы сброса
АЦП
стр. 229

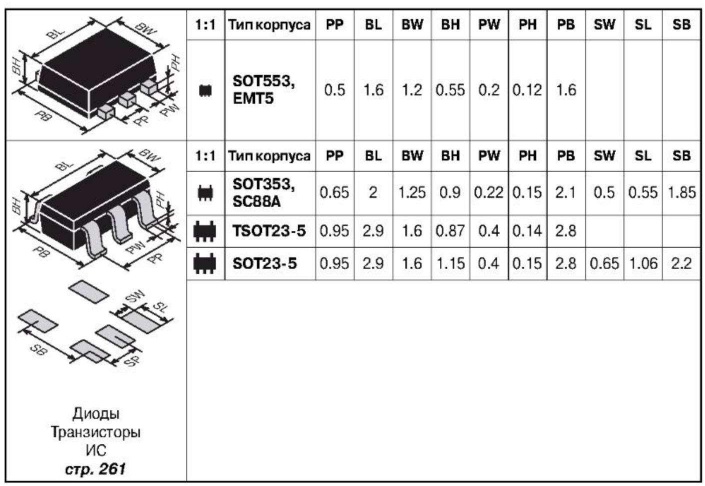
1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
	TSFP-4	1	1.4	0.8	0.55	0.2	0.15	1.2			
	MFPAK-4	1.3*	2	1.25	0.59	0.3*	0.11	2.05			

* Для вывода 2: PW = 0.4, PP = 1.25

1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
	SC82, USQ	1.3	2	1.25	0.95	0.2	0.15	2.1			
	SOT343, SC82A	1.3[1]	2	1.25	1	0.3[1]	0.12	2	0.5[1]	0.55	1.85
	SOT343R	1.3[1]	2	1.25	1	0.3[1]	0.12	2	0.5[1]	0.55	1.85
	MW-4	1.3[2]	2.9	1.3	1	0.4[2]	0.12	2.6			
	SOT143, TO253	1.9	2.9	1.3	1	0.4[3]	0.1	2.5	0.5[3]	0.6	1.9
	SOT143R	1.9	2.9	1.3	1	0.4[3]	0.1	2.5	0.5[3]	0.6	1.9
	SC61, MPAK-4	1.9	2.9	1.5	1.1	0.4[4]	0.16	2.9[5]			

Диоды
Варикапы
Транзисторы
ИС
стр. 244

[1] Для вывода 1: PW = 0.6, SW = 0.7, PP = 1.15
[2] Для выводов 1 и 4: PW = 0.7, PP = 1.15
[3] Для вывода 1: PW = 0.8, SW = 0.9
[4] Для вывода 4: PW = 0.6
[5] Выводы имеют разную длину: 0.55 для выводов 1, 2 и 0.85 для выводов 3, 4



1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
	SOT553, EMT5	0.5	1.6	1.2	0.55	0.2	0.12	1.6			

1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
	SOT353, SC88A	0.65	2	1.25	0.9	0.22	0.15	2.1	0.5	0.55	1.85
	TSOT23-5	0.95	2.9	1.6	0.87	0.4	0.14	2.8			
	SOT23-5	0.95	2.9	1.6	1.15	0.4	0.15	2.8	0.65	1.06	2.2

Диоды
Транзисторы
ИС
стр. 261

1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
	fS6	0.35	1	0.8	0.48	0.15	0.1	1			
	M16, 1208	0.4	1.2	0.8	0.5	0.15	0.125	1			
	USM-6	0.48	1.5	1.1	0.55	0.2	0.11	1.5			
	SOT666	0.5	1.6	1.2	0.55	0.2	0.12	1.6	0.4	0.5	1.7
	SOT563, EMT6	0.5	1.6	1.2	0.55	0.22	0.12	1.6			
	SON-6	0.5	1.6	2.6	0.8	0.2	0.13	3			

1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
	TSOT363	0.65	2	1.25	0.6	0.22	0.13	2.1			
	SOT363, SC88	0.65	2	1.25	0.9	0.22	0.15	2.1	0.3	0.7	1.6
	MW-6	0.95	2.9	1.3	1	0.3*	0.12	2.6			
	SOT457, SC74	0.95	2.9	1.6	1	0.35	0.15	2.5	0.5	0.5	2.4
	TSOT23-6	0.95	2.9	1.6	0.88	0.4	0.18	2.75			
	SOT23-6	0.95	2.9	1.6	1.15	0.4	0.15	2.8	0.65	1.06	2.2

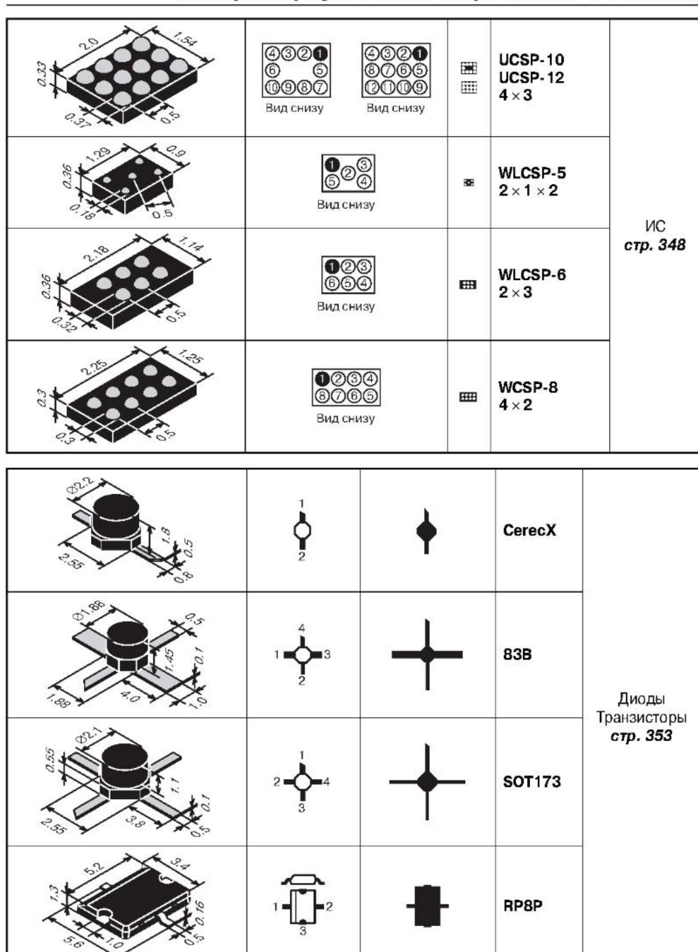
* Для вывода 5: PW = 0.6

Диоды,
Транзисторы, ИС
стр. 285

Тип корпуса	
US-8 **VSSOP-8** **SOT765**	Транзисторы ИС *стр. 325*
SOT23-8	
MSOP-8	
MSOP-10	
SOP-8	

3.0; 2.0; 0.9; 0.4; 0.3; 0.65	5 6 7 8 / 4 3 2 1 Вид снизу		MLP832-8	Транзисторы ИС *стр. 345*
3.0; 2.0; 0.9; 0.4; 0.2; 0.5	5 6 7 8 / 4 3 2 1 Вид снизу		LFCSP-8	
3.0; 3.0; 0.8; 0.4; 0.23; 0.5	6 7 8 9 10 / 5 4 3 2 1 Вид снизу		LFCSP-10	
3.0; 3.0; 0.8; 0.4; 0.4; 0.95	6 7 8 / 3 2 1 Вид снизу		TDFN-6	
3.0; 3.0; 0.8; 0.4; 0.3; 0.65	5 6 7 8 / 4 3 2 1 Вид снизу		TDFN-8	
3.0; 3.0; 0.8; 0.4; 0.25; 0.5	6 7 8 9 10 / 5 4 3 2 1 Вид снизу		TDFN-10, TQFN-10	
4.0; 4.0; 0.8; 0.55; 0.3; 0.8	7 8 9 / 6 10 / 5 11 / 4 12 / 3 2 1 Вид снизу		TQFN-12	

1.0; 1.0; 0.33; 0.3; 0.5	② ❶ / ③ ④ Вид снизу		UCSP-4 2 × 2	ИС *стр. 348*
1.52; 1.0; 0.33; 0.37; 0.5	③ ② ❶ / ④ ⑤ Вид снизу; ③ ② ❶ / ④ ⑤ ⑥ Вид снизу		UCSP-5 UCSP-6 3 × 2	
1.52; 1.52; 0.33; 0.37; 0.5	③ ② ❶ / ④ ⑧ / ⑤ ⑥ ⑦ Вид снизу; ③ ② ❶ / ⑥ ⑤ ④ / ⑨ ⑧ ⑦ Вид снизу		UCSP-8 UCSP-9 3 × 3	


2.0
1.54
0.33
0.37
0.5
Вид снизу
Вид снизу
UCSP-10
UCSP-12
4 × 3
1.29
0.9
0.36
0.18
0.5
Вид снизу
WLCSP-5
2 × 1 × 2
ИС
стр. 348
2.18
1.14
0.36
0.32
0.5
Вид снизу
WLCSP-6
2 × 3
2.25
1.25
0.3
0.3
0.5
Вид снизу
WCSP-8
4 × 2
Ø2.2
1.8
0.5
2.55
0.8
CerecX
Ø1.88
0.5
1.45
0.1
1.88
4.0
1.0
83B
Диоды
Транзисторы
стр. 353
Ø2.1
0.55
1.1
0.1
2.55
3.8
0.5
SOT173
5.2
3.4
1.3
0.16
5.6
1.0
0.5
RP8P

СПИСОК ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сокра-щение	Полное название фирмы
8X8	8x8, Inc.
ACAP	Acapella, Ltd.
ACC	ACC Microelectronics Corp.
ACCUL	Acculin, Inc.
ACTEL	Actel Corporation
AD	Analog Devices
ADAP	Adaptec
AEROF	Aeroflex Circuit Technology
AGI	Agilent
AHA	Advanced Hardware Architectures, Inc.
AIT	AITech International
AKM	AKM Semiconductor, Inc.
ALD	Advanced Linear Devices
ALLEG	Allegro Micro Systems, Inc.
ALLIA	Alliance Semiconductor
ALPHA	Alpha Semiconductor
ALT	AverLogic Technologies, Inc.
ALTER	Altera Corporation
AMC	Accutek Microcircuit Corporation
AMCC	AMCC (Applied Micro Circuits Corp)
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.
AMI	American Microsystems, Inc.
AMS	Applied Microsystems Corporation
AMSI	Austria Mikro Systeme International, Inc.
ANAD	Anadigics, Inc.
ANALO	Analogic Corporation
APEX	Apex Microtechnology Corporation
APTEK	Aptek Williams, Inc.
APTOS	Aptos Semiconductor Corporation
ARRAY	Array Microsystems
AS	Analog Systems
ASHL	Ashling Microsystems Ltd
ASPEC	Aspec Technology, Inc.
ASTEC	Astec Semiconductor
ATMEL	ATMEL Corporation
AUK	AUK Semiconductor
AUST	Austin Semiconductor, Inc.
AVG	AVG Semiconductors
AVX	AVX KYOCERA
BB	BurrBrown Corporation
BEL	Bel Fuse Incorporated
BENCH	Benchmarq Microelectronics
BOUR	BOURNS
BROOK	Brooktree Corporation
BUTT	ButterflyDSP,Inc.
C&T	Chips and Technologies, Incorporated
CALOG	Calogic Corporation
CATAL	Catalyst Semiconductor

Сокра-щение	Полное название фирмы
CCD	Cologne Chip Designs
CDIL	CDIL
CEC	Chip Express Corporation
CENTO	Centon Electronics, Inc.
CENTU	Century Microelectronics, Inc.
CERM	Cermetek Microelectronics, Inc.
CHERR	Cherry Semiconductor Corporation
CHRON	Chrontel
CL	Cirrus Logic, Inc.
CMDC	California Micro Devices Corporation
CML	Consumer Microcircuits Limited
CNTRL	Central Semiconductor
COLOR	Colorado Microcircuits
COMC	Comcore Semiconductor
COML	Comlinear Corporation
CONV	Conversion Devices, Inc.
CPC	CP Clare Corporation
CPS	Crosspoint Solutions, Inc.
CROSS	Crosslink Semiconductor, Inc.
CRYST	Crystal
CSC	Central Semiconductor Corp
CSI	Central Semiconductor, Inc.
CTC	CTC
CYBER	Cybernetic Micro Systems
CYPR	Cypress Semiconductor Corp.
CYRIX	Cyrix Corporation
CYS	CYStech Electronic Corporation
DALL	Dallas Semiconductor
DALSA	Dalsa Incorporated
DATEL	Datel, Inc.
DDD	Data Delay Devices, Inc.
DENSE	DensePac Microsystems, Inc.
DIGIT	Digital Semiconductor
DIODS	Diodes Incorporeted
DION	Dionics Inc.
DIOT	Diotec Semiconductor
DSPG	DSP Group, Inc.
EDGE	Edge Technology, Inc.
EDI	Electronic Designs Inc.
EG&GI	EG&G IC Sensors
EG&GR	EG&G Reticon Corporation
ELANT	Elantec, Inc.
ELET	Eletech Electronics
ELMOS	Elmos Elektronik in MOSTechnologie GmbH
ELNA	ELNA
EMBED	Embedded Support Tools Corp.
EMM	EM Microelectronics
EMS	Enhanced Memory Systems, Inc.

Сокра-щение	Полное название фирмы
EMUL	Emulation Technology, Inc.
ENABL	Enable Semiconductor, Inc.
EPSON	Epson America Inc.
ERIC	Ericsson Components
ESC	ESC Electronics Corporation
ESS	ESS Technology, Inc.
ETC	Electronic Technology Corporation
EUROM	Eurom Ltd.
EXAR	Exar Corporation
EXEL	EXEL Microelectronics, Inc.
EXPO	Exponential Technology, Inc.
FAIR	Fairchild Semiconductor
FUJIT	Fujitsu Microelectronics, Inc.
GALIL	Galileo Technology
GENES	Genesis Microchip Inc.
GENN	Gennum Corporation
GETE	GET Engineering Corp.
GLINK	GLink Technology Corporation
GOAL	Goal Electronics Inc.
GREEN	Greenwich Instruments USA
GS	General Semiconductor
GSI	GSI Technology
HARR	Harris Corporation
HIFN	Hifn
HIT	Hitachi Semiconductor (America), Inc.
HOLT	Holt Integrated Circuits, Inc.
HOLTE	Holtek Microelectronics Inc.
HONEY	Honeywell Solid State Electronics Ctr.
HP	HewlettPackard Logic Systems Division
HUAL	Hualon Microelectronics Corp
HUGH	Hughes Aircraft Co.
HUNT	Huntsville Microsystems, Inc.
HYU	Hyundai Electronics America
IBM	IBM Corporation
ICH	IC Haus
ICS	Integrated Circuit Systems, Inc.
ICT	ICT Inc
ICW	IC Works, Inc.
IDC	IDC Semiconductors
IDEAL	Ideal Semiconductor
IDT	Integrated Device Technology, Inc.
ILC	ILC Data Device Corp.
ILS	Integrated Logic Systems Inc.
IMI	International Microcircuits, Inc.
IMP	IMP, Inc.
IMPAL	Impala Linear Corporation
INF	Infineon
INTEL	Intel Corporation

Сокра-щение	Полное название фирмы
INTRO	Intronics, Inc.
IO	IOtech, Inc.
IPC	Interpoint Corporation
IR	International Rectifier Corp.
ISD	Information Storage Devices, Inc
ISOC	Isocom Incorporated
ISS	Integrated Silicon Solution Inc.
IST	International Semiconductor Technologies
ITI	Interface Technology, Inc.
ITT	ITT Semiconductor
ITTI	Integrated Telecom Technology, Inc.
IXYS	IXYS Corporation
JGD	Japan Gude Electronic Devices
KAWAS	Kawasaki LSI, USA
KEC	Korean Electr. Corp.
KEMET	KEMET
KRUE	Krueger Company
LAMBD	Lambda Advanced Analog
LANSD	Lansdale Semiconductor, Inc.
LATT	Lattice Semiconductor Corp.
LD	Logic Devices Inc.
LECRO	LeCroy Corporation
LEVEL	Level One
LG	LG Semicon Company, Ltd.
LINF	Linfinity Microelectronics
LINT	Lintel Security S.A.
LIS	Linear Integrated Systems
LM	Lockheed Martin
LRC	Leshan Radio Company, Ltd.
LSIC	LSI Computer Systems, Inc.
LSIL	LSI Logic Corporation
LT	Linear Technology Corporation
LUC	Lucent Technologies Inc.
M/A	M/A-COM, Inc.
MALL	Mallory
MARV	Marvell Semiconductor, Inc.
MATRA	Matra MHS, Inc.
MATS	Matsuo
MAX	Maxim Integrated Products
MC	Mini-Circuits
MCC	Micro Commercial Components
MCHIP	Microchip Technology, Inc.
MCS	Microsemi
MICR	Micrel
MICRO	Microtek International, Inc.
MII	Micropac Industries, Inc.
MISI	Micronix Integrated Systems, Inc.
MITEL	Mitel Semiconductor

Сокращение	Полное название фирмы
MITS	Mitsubishi Electronics America, Inc.
ML	Micro Linear
MLINK	MetaLink Corporation
MNC	Micro Networks Company
MOSAI	Mosaic Semiconductor, Inc.
MOSEL	MoselVitelic
MOSYS	MOSYS
MOT	Motorola Semiconductor Products
MPSC	MagePOWER Semiconductor Corporation
MR	MicroRel
MSIC	Mixed Signal Integration Corporation
MSIS	MSIS Semiconductor, Incorporated
MTI	Micron Technology, Inc.
MUR	Murata
MUSIC	Music Semiconductors, Inc.
MXC	MXCOM, Inc.
NACC	NACC
NANO	Nanoteq (Pty) Ltd
Nat	National Semiconductor
NCM	NCM Corporation
NEC	NEC Electronics Inc.
NEWP	Newport Components Limited
NEXC	Nexcom Technology, Inc.
NI	National Instruments
NJR	NJR Corporation
NOHAU	Nohau Corporation
NOVER	Nover
NPC	Nippon Precision Circuits Ltd.
NPNX	NPNX Corporation
NS	National Semiconductor Corporation
NTE	NTE Electronics, Inc.
OAK	Oak Technology, Inc.
OEI	Optical Electronics Inc.
OKI	OKI Semiconductor, Inc.
ON	ON Semiconductors
ONCH	OnChip Systems, Inc.
OPTEK	Optek Technology, Inc.
OPTI	OPTi Inc.
OPTO	Optotek Limited
ORBIT	Orbit Semiconductor Inc.
ORION	Orion Instruments, Inc.
OXFOR	Oxford Micro Device, Inc.
PAN	Panasonic Industrial Company/Electronic Comp.
PANJIT	Panjit Semiconductor
PARAD	Paradigm Technology, Inc.
PCA	PCA Electronics Inc.
PCC	Power Convertibles Corporation
PECG	Philips ECG

Сокращение	Полное название фирмы
PEPS	Performance Electronic Packaging Services
PERIC	Pericom Semiconductor Corporation
PHIL	Philips Semiconductors
PHYLO	Phylon Inc.
PI	Power Integrations, Inc.
PLESS	GEC Plessey Semiconductors
PLX	PLX Technology, Inc.
PMCS	PMCSierra
PMD	Performance Motion Devices, Inc.
PSC	Performance Semiconductor Corp.
PT	Power Trends
QLC	QuickLogic Corp
QLOG	QLogic Corporation
QS	Quality Semiconductor
QUALC	Qualcomm Incorporated
R&E	R&E International, Inc
RAMTR	Ramtron Corporation
RAYTH	Raytheon Company
REALT	Realtek Semiconductor Corporation
REN	Renesas
RFM	RF Micro Devices
RICOH	Ricoh Corporation
RMV	RMV Electronics Inc.
ROCH	Rochester Electronics Incorporated
ROCK	Rockwell Semiconductor Systems
ROHM	ROHM Corporation
S+M	Siemens Matsushita Components.
SAMS	Samsung Semiconductor, Inc.
SANYO	Sanyo Semiconductor Corporation
SCI	Silicon Composers, Inc.
SEEQ	SEEQ Technology, Incorporated
SEI	Space Electronics Incorporated
SEIKO	Seiko Instruments USA, Inc.
SEMT	Semtech Corporation
SENS	Sensory, Inc.
SEPON	Seponix Corporation
SGS	SGS-Thompson
SHARP	Sharp Electronics Corporation
SIEM	Siemens Microelectronics Inc.
SIGN	Signum Systems
SIL	Vishay Siliconix
SILIC	Silicom Inc.
SIMT	Simtek Corporation
SINC	Sincera
SIPEX	Sipex Corporation
SIS	SIS Microelectronics, Inc.
SMC	Standard Microsystems Corporation
SMOS	SMOS Systems, Inc.

Сокра-щение	Полное название фирмы
SMS	Samsung Microwave Semiconductor, Inc.
SOFT	Soft Device
SOLIT	Solitron Devices, Inc.
SONY	Sony Semiconductor Company of America
SOUTH	South African MicroElectronic Systems (Pty) Ltd
SPACE	Space Research Technology, Inc.
SPT	Signal Processing Technologies
SS	Silicon Systems Inc.
SST	Silicon Storage Technology, Inc.
STANF	Stanford Telecommunications Inc.
STM	ST Microelectronics, Inc.
SUMIT	Sumitomo Metal Industries, Ltd.
SUN	Sun Microsystems, Inc.
SUPER	Supertex, Inc.
SYFER	Syfer
SYMB	Symbios Logic
SYNER	Synergy Semiconductor Corporation
SYNT	Syntaq Technology Inc.
SYSTR	Systronix. Inc.
TDK	TDK Semiconductor Corp.
TECH	Technitrol Pulse Components Div.
TELC	TelCom Semiconductor
TELEF	Vishay Telefunken
TELT	Teltone Corporation
TEMIC	Temic Semiconductors
Tfk	Telefunken (Vishay-Telefunken)
THAL	Thaler Corp
THAT	THAT Corporation
THES	Thesys Gesellschaft fur Mikroelektronik mbH
THIRD	Third Domain, Inc.
THOMS	Thomson Components and Tubes Corporation
TI	Texas Instruments, Inc.
TLSI	TLSI Incorporated
Tok	Toko Inc.
TOKO	Toko America Incorporated
TOSH	Toshiba America Electronic Components, Inc.
TRANS	TranSwitch Corporation
TRID	Trident Microsystems Incorporated
TRIQ	TriQuint Semiconductor
TRITE	TriTech Microelectronics

Сокра-щение	Полное название фирмы
TSC	Taiwan Semiconductor
TSENG	Tseng Labs, Inc.
TSQW	Tsqware, Inc.
TUNDR	Tundra Semiconductor Corporation
TURBO	Turbo IC, Inc.
UMC	United Microelectronics Corporation
UNITR	Unitrode Integrated Circuits Corp.
UNIV	Universal Semiconductor Inc.
US M	US MikroChips,Inc.
USAR	USAR Systems, Inc.
UTM	United Technologies Microelectronics Center
V3	V3 Semiconductor
VADEM	Vadem
VANT	Vantis Corporation
VETRA	Vetra Systems Corporation
VIA	VIA Technologies, Inc
VIS	Vishay Semiconductors (Gen Semi, Tfk, Sil etc)
VISH	Lite On (Vishay Lite On)
VITES	Vitesse Semiconductor Corp.
VITR	Vitramon
VLSI	VLSI Technology Inc.
VORT	Vortex Incorporated
VTC	VTC Inc.
WAFER	Waferscale Integration Inc.
WD	Western Digital Corporation
WDC	The Western Design Center, Inc.
WEIT	Weitron
WELTR	Weltrend
WHITE	White Microelectronics
WINB	Winbond Electronics Corp
WOLF	Wolfson Microelectronics
WTE	WTE Power Semiconductors
XECOM	Xecom, Inc.
XICOR	Xicor, Inc.
XILIN	Xilinx Corp.
YAGEO	Yageo
YAMA	Yamaha Corp of America
ZAXT	Zaxtek, Inc.
ZETEX	Zetex
ZOWIE	Zowie Technology Corporation

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

—	— вывод отсутствует
A	— анод
a	— соединено с анодом
ACC	— погрешность
B	— база
C	— коллектор
$C_{10\,В}$	— емкость при напряжении на варикапе 10 В
$C_{25\,В}$	— емкость при напряжении на варикапе 25 В
$C_{2\,В}$	— емкость при напряжении на варикапе 2 В
$C_{2\,В}/C_{30\,В}$	— отношение емкостей для различных напряжений
ca	— с общим анодом
cc	— с общим катодом
C_D	— емкость диода
C_{ISS}	— входная емкость полевого транзистора
Com	— общий
comp	— комплиментарный
C_T	— суммарная емкость
D	— сток
DD	— динамический диапазон
DT	— рабочий цикл
E	— эмиттер
f_{BD}	— ширина полосы пропускания
f_{CLK}	— тактовая частота
f_{DR}	— скорость передачи данных
f_{IN}	— входная частота
f_{OSC}	— частота генератора
f_P	— рабочая частота
f_T	— граничная частота
f_{UG}	— частота единичного усиления
G	— затвор/управляющий электрод
Gain	— коэффициент усиления
g_F	— прямая проводимость полевого транзистора
G_{MA}	— коэффициент усиления мощности
gnd	— земля
h_{21}	— статический коэффициент передачи тока
i.c.	— вывод внутренне подключен (не подсоединять к внешней точке)
IC	— ток коллектора
I_{CAT}	— ток катода
I_{CB0}	— обратный ток перехода коллектор — база
I_{CH}	— ток заряда батареи
I_D	— ток стока
I_{DSS}	— ток стока при нулевом потенциале на затворе
I_F	— прямой ток
I_G	— ток затвора
I_{leak}	— ток утечки
in	— вход
I_{PP}	— пиковый импульсный ток разряда
I_R	— обратный ток
I_T	— средний ток в состоянии включения
I_Z	— ток стабилизации
I_{ZM}	— максимальный ток стабилизации
I_{ZT}	— ток стабилизации в контрольной точке
K	— катод
k	— соединено с катодом
LT	— суммарная индуктивность
max	— максимальное значение
min	— минимальное значение
n.c.	— вывод не подключен
out	— выход
pd	— несимметричный динистор для защиты оборудования связи
P_D	— рассеиваемая мощность
R_{25}	— сопротивление температурного датчика
$R_{DS(on)}$	— сопротивление канала в открытом состоянии
R_{ON}	— сопротивление ключа в открытом состоянии
R-R	— вход/выход полного размаха (rail-to-rail)
R_Z	— динамическое сопротивление
S	— исток
Si	— кремний
substr	— подложка
T_{AMB}	— температура окружающей среды
TC_{VOUT}	— температурный коэффициент выходного напряжения
TC_{VZ}	— температурный коэффициент напряжения стабилизации
t_{OFF}	— время выключения
t_{PD}	— задержка переключения
t_{RES}	— длительность сброса
t_{RR}	— время обратного восстановления
t_{STUP}	— задержка включения
T_{TH}	— температурный порог срабатывания
T_{THAC}	— точность температурного порога срабатывания
T_{THL}	— нижний температурный порог срабатывания
T_{THU}	— верхний температурный порог срабатывания
V_{BR}	— напряжение пробоя
V_{BRDSS}	— напряжение пробоя сток-исток
V_C	— напряжение фиксации (коллектора)
V_{CB}	— пороговое напряжение circuit-breaker thresholds
V_{CB0}	— постоянное напряжение коллектор — база
V_{CC}	— положительное напряжение питания
$V_{CE(sat)}$	— напряжение насыщения коллектор — эмиттер
V_{CE0}	— постоянное напряжение коллектор эмиттер
V_{DS}	— напряжение сток — исток
V_F	— прямое напряжение
V_{GS}	— напряжение затвор — исток
V_{GSS}	— напряжение пробоя затвор исток
V_{GSTH}	— пороговое напряжение на затворе
V_{OD}	— дифференциальное выходное напряжение
V_{OH}	— выходное напряжение высокого уровня
V_{OL}	— выходное напряжение низкого уровня
V_{OSI}	— напряжение смещения
V_{OUT}	— выходное напряжение
V_R	— обратное напряжение
V_{REF}	— опорное напряжение
V_{TR}	— пороговое напряжение срабатывания
V_{TROV}	— порог превышения допустимого напряжения
V_{WM}	— напряжение выключения
V_Z	— напряжение стабилизации
x	— безразличное состояние
Z_Z	— дифференциальное сопротивление
Z_{ZT}	— дифференциальное сопротивление в контрольной точке

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ ПРИБОРА

2-AND — 2-входовый вентиль И
2-NAND — 2-входовый вентиль И-НЕ
2-NOR — 2-входовый вентиль ИЛИ-НЕ
3-stbuff — неинвертирующий буфер с тремя состониями
abc — контроллер тока смещения
ADC — аналого-цифровой преобразователь
amp — усилитель
amux — аналоговый мультиплексор
asw — аналоговый ключ
ats — аналоговый температурный датчик
atten — аттенюатор
batprot — схема защиты литиевых аккумуляторов
bcontr — контроллер для повышающих dc-dc-преобразователей
btd — динистор
buf — буфер
byd — быстрый выпрямительный диод с «мягким» восстановлением
byg — быстрый высоковольный выпрямительный диод с «мягким» восстановлением
byh — выпрямительный диод общего применения
byv — высоковольтный выпрямительный диод
cld — стабилизатор тока
chg — контроллер зарядного устройства для аккумуляторов
cmp — компаратор
cpin — переключательный pin-диод
cpreg — стабилизатор напряжения с накачкой заряда
CSA — токовый усилитель
d — диод (сборка)
DA — дифференциальный усилитель
DAC — цифро-аналоговый преобразователь
dcdc — DC/DC-преобразователь
di — импульсный диод
dih — импульсный диод с большим рабочим током
dl — диод общего применения с малым током утечки
dnMESFET — *n*-канальный полевой транзистор с барьером Шоттки на основе GaAs с двумя затворами
dnmixer — преобразователь-смеситель с понижением частоты сигнала
DnMOS — "цифровой" n-канальный МОП-транзистор
dnMOS — *n*-канальный МОП-транзистор с двумя затворами
Dnpn — «цифровой» *n-p-n*-транзистор
dnpn — составной *n-p-n*-транзистор
dOA — двухканальный операционный усилитель
DpMOS — "цифровой" p-канальный МОП-транзистор
Dpnp — «цифровой» pnp-транзистор
dpnp — составной pnp-транзистор
Dpot — цифровой потенциометр
dr — выпрямительный диод
drv — драйвер МОП-транзистора
dsw — цифровой ключ
dts — цифровой температурный датчик
dtv — диод для переключения диапазонов телевизионного приемника
dz — стабилитрон
fd — быстродействующий диод
fid — быстродействующий импульсный диод
flecap — программируемый конденсатор
frd — быстровосстанавливающийся выпрямительный диод
gen — программируемый генератор сигналов
hscontr — контроллер "горячей замены"
IA — инструментальный усилитель
JFETOA — операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе
LA — логарифмический усилитель
levtrans — преобразователь уровней логических сигналов
ltcmp — компаратор локальной температуры
LVDSdrv — LVDS-драйвер линии
mmic — СВЧ-микросхема
mrc — схема сброса для микропроцессора
nFET — n-канальный полевой транзистор с управляющим *p-n*-переходом
nMESFET — *n*-канальный полевой транзистор с барьером Шоттки на основе GaAs
nMOS — *n*-канальный МОП-транзистор
npn — *n-p-n*-транзистор
O — однопереходный транзистор
OA — операционный усилитель
PD — детектор ВЧ-сигнала
pd — несимметричный динистор для защиты оборудования связи
pFET — *p*-канальный полевой транзистор с управляющим *p-n*-переходом
pin — *p-i-n*-диод
pMOS — *p*-канальный МОП-транзистор
pnp — *p-n-p*-транзистор
pnpn — программируемый однопереходной транзистор
prot — микросхема защиты аналоговых входов
PWM — ШИМ-контроллер для изолированных источников питания
pz — защитный стабилитрон
rec — приемник
reg+mrc — стабилизатор напряжения со схемой сброса для микропроцессора
reg — стабилизатор напряжения
reg– — стабилизатор отрицательного напряжения
reg+ — стабилизатор положительного напряжения
rts — резистивный температурный датчик
Schminv — инвертор с триггером Шмитта на входе
SchmNAND — 2-входовый вентиль И-НЕ с триггером Шмитта на входе
scvcon — преобразователь напряжения на переключающих конденсаторах
sd — импульсный переключающий диод
shd — диод Шоттки
shy — выпрямительный диод Шоттки
spd — симметричный динистор для защиты оборудования связи
SPM — ШИМ-контроллер для понижающих dc-dc-преобразователей
spz — симметричный защитный стабилитрон
sw — переключатель (ключ)
swd — подавитель дребезга контактов
tempsw — пороговый датчик температуры
trans — приемопередатчик
trnsmit — передатчик
TSPD — тиристрный прибор защиты
upmixer — преобразователь-смеситель с повышением частоты сигнала
var — варикап
VCO — генератор управляемый напряжением
vcon — преобразователь напряжения
vcpcon — инвертирующий преобразователь напряжения с накачкой заряда
vd — монитор напряжения (детектор напряжения)
VFC — преобразователь напряжение-частота
vibdrv — драйвер виброзвонка
vref — источник опорного напряжения
vs — подавитель выбросов напряжения (супрессор)
vseq — монитор напряжения для приборов с двумя напряжениями питания
wdt — сторожевой таймер

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ КОРПУСОВ

JEDEC	EIAJ	PHILIPS SIEMENS CENTS MAXIM	ROHM	SANYO	HITACHI	MOTOROLA	TOSHIBA KEC
TO-236	SC-59	SOT-346	SMD/T3		MPAK2	SC-59	S-MINI
TO-236AB	SC-59A	SOT/SOD-23	SSD/T3	CP	MPAK	SOT-23	
TO-243AA	SC-62	SOT-89A	MPT3	PCP	UPAK		PW-MINI
TO-243AB		SOT-89B					
TO-252-3	SC-63		CPT3				
TO-253		SOT-143	SMD/T4			SOT-143	
TO-253		SOT-143R					
		SOD-123				SOD-123	
	SC-76	SOD-323	UMD2				USE
	SC-82A	SOT-343					
		SOT-343R			CMPAK-4		
		SOT-87					
	SC-70	SOT-323	UMD/T3	MCP	CMPAK	SOT-323	USM
	SC-74	SOT457	SMD/T6				SM6
	SC-74A	SOT23-5	SMD/T5				SMV
	SC-75A, SC90	SOT-416	EMD/T3	SMCP	SMPAK		SSM
	SC-79	SOD-523	EMD2				ESC
	SC-82		UMD/T4				USQ
	SC-88	SOT-363	UMD/T6				US6
	SC-88A	SOT-353	UMD/T5				USV
	SC61				MPAK-4		SMQ
	SC89	SOT490					ESM
			VMT3				USQ


RadioHata.RU
Портал радиолюбителя
Радиотехнические журналы
Журнал Радио
Программы для радиолюбителя
Начинающему радиолюбителю
Телевидение и Радио
Источники питания
Для дома и быта
Прием-передача
Полезное видео
Автолюбителю
Аудиотехника
Arduino / Rasberry
Разное